«РЕМОНТ» № 90

А.В. Нефедов
А.И. Аксенов



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

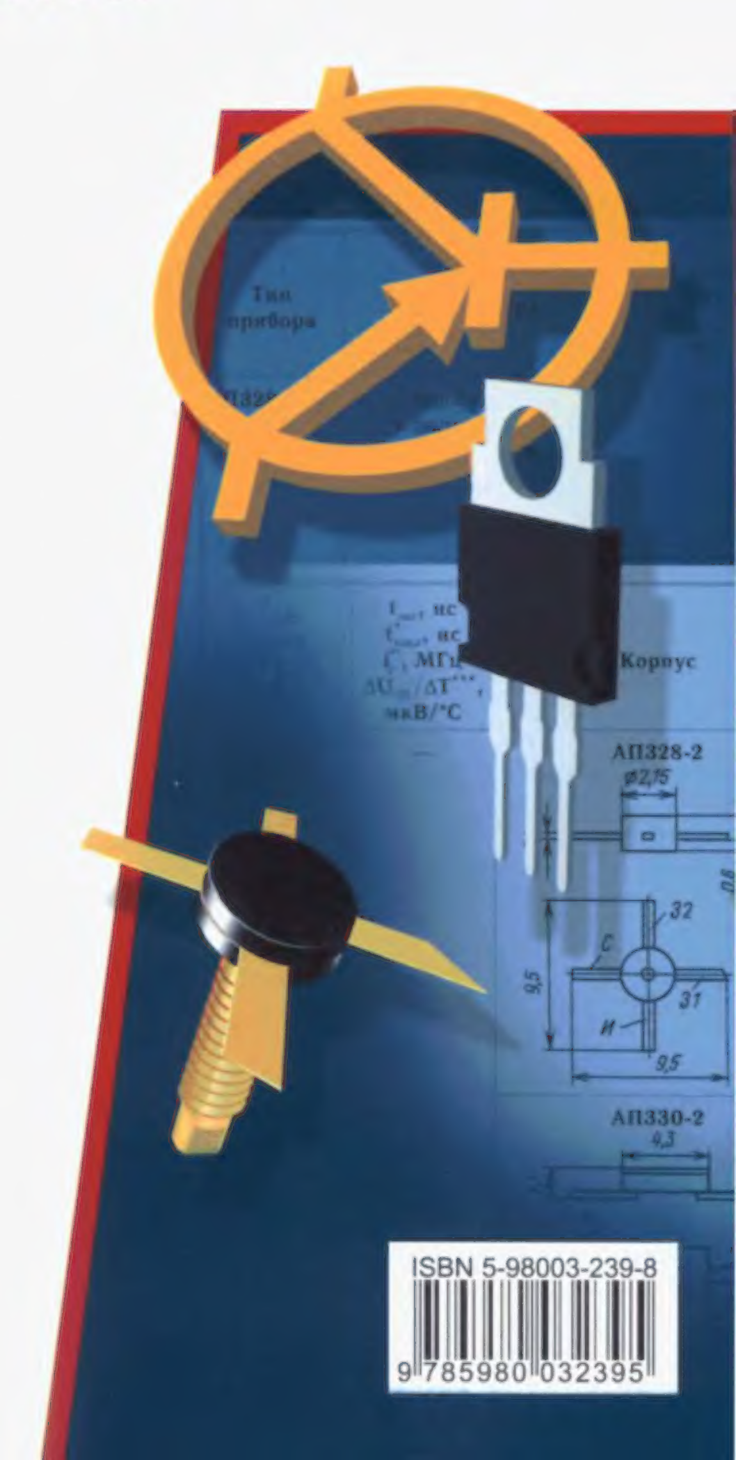
ДЛЯ БЫТОВОЙ, ПРОМЫШЛЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ

Справочное пособие

Полная информация о приборах

Номенклатура
Изготовители
Параметры
Корпуса
Аналоги

Представлено до 5000 наименований!



ISBN 5-98003-239-8
9 785980 032395

УДК 621.397
ББК 32.94-5
Н58

Серия «Ремонт», выпуск 90

Нефедов А. В., Аксенов А. И.

Н58 Транзисторы для бытовой, промышленной и специальной аппаратуры. Справочное пособие. — М.: СОЛОН-Пресс, 2006. — 600 с. — (Серия «Ремонт»)

ISBN 5-98003-239-8

Рассмотрены свойства и особенности биполярных и полевых транзисторов (с p-n-переходом, МОП, биполярных транзисторов со статической индукцией и с изолированным затвором), предназначенных для применения в бытовой, промышленной и специальной аппаратуре, приведены их электрические параметры, области применения, стандартизованные корпуса и зарубежные аналоги, а также указаны предприятия-изготовители.

Справочное пособие рассчитано на широкий круг читателей, специалистов, студентов и радиолюбителей, занимающихся конструированием и ремонтом радиоэлектронной аппаратуры.

УДК 621.397
ББК 32.94-5

ISBN 5-98003-239-8

Содержание

Предисловие

В справочном пособии представлена информация об особенностях применения, параметрах и характеристиках биполярных и полевых транзисторов, изготовленных в странах СНГ и Балтии.

Справочное пособие состоит из пяти разделов. В первом разделе даны классификация и условные обозначения полупроводниковых приборов. Приведены условные графические обозначения биполярных и полевых транзисторов, указатель транзисторов и их изготовители.

Во втором разделе описаны свойства, специфические особенности, основные электрические параметры, области применения, буквенные обозначения параметров, а также электрические параметры биполярных транзисторов широкого применения и специального назначения.

В третьем разделе рассмотрены основные свойства и особенности полевых транзисторов (с p-n переходом, МОП-транзисторов), а также транзисторов со статической индукцией, биполярных транзисторов с изолированным затвором, относящихся к классу полевых транзисторов, области применения, буквенные обозначения параметров, электрические параметры кремниевых полевых и арсенидгаллиевых транзисторов, в том числе со структурой HEMT (High Electron-mobility Transistor) GaAlAs/GaAs, широкого применения и специального назначения.

В четвертом разделе даны корпуса транзисторов.

В пятом разделе рассматривается взаимозаменяемость отечественных и зарубежных транзисторов, буквенные обозначения зарубежных транзисторов и их изготовителей. Кроме того, приведены таблицы отечественных транзисторов и их зарубежных аналогов и зарубежных транзисторов и их отечественных аналогов.

В справочное пособие включены как современные типы транзисторов, так и снятые по разным причинам с производства, и используемые для применения в бытовой, промышленной и специальной радиоэлектронной аппаратуре.

Указатель транзисторов и предприятий-изготовителей

Германиевые транзисторы

Кремниевые транзисторы

Тип прибора	Изготовитель (см. стр. 31)	Стр.
КТ104А	ЗАО «Кремний»	82
КТ104Б	ЗАО «Кремний»	82
КТ104В	ЗАО «Кремний»	82
КТ104Г	ЗАО «Кремний»	82
КТ117А	27. 30	82
КТ117Б	27. 30	82
КТ117В	27. 30	82
КТ117Г	27. 30	82
КТ118А	3-д «Пульсар»	82
КТ118Б	3-д «Пульсар»	82
КТ118В	3-д «Пульсар»	82
КТ119А	3-д «Пульсар»	82
КТ119Б	3-д «Пульсар»	82
КТ120А	23, 13	82
КТ120Б	23, 13	82
КТ120В	23, 13	82
КТ120А-1	23, 13	82
КТ120В-1	23, 13	82
КТ120А-5	23, 13	82
КТ120В-5	23, 13	82
КТ127А-1	3-д «Старт»	82
КТ127Б-1	3-д «Старт»	82
КТ127В-1	3-д «Старт»	82
КТ127Г-1	3-д «Старт»	82
КТ132А	3-д «Транзистор»	84
КТ132Б	3-д «Транзистор»	84
КТ133А	3-д «Транзистор»	84
КТ133Б	3-д «Транзистор»	84
КТ201А	26, 33	84
КТ201Б	26, 33	84
КТ201В	26, 33	84
КТ201Г	26, 33	84
КТ201Д	26, 33	84
КТ201АМ	4, 26, 33	84
КТ201БМ	4, 26, 33	84
КТ201ВМ	4, 26, 33	84
КТ201ГМ	4, 26, 33	84
КТ201ДМ	4, 26, 33	84
КТ202А-1	ЗАО «Кремний»	84
КТ202Б-1	ЗАО «Кремний»	84
КТ202В-1	ЗАО «Кремний»	84
КТ202Г-1	ЗАО «Кремний»	84
КТ202Д-1	ЗАО «Кремний»	84
КТ203А	АО «Элекс»	84
КТ203Б	АО «Элекс»	84
КТ203В	АО «Элекс»	84
КТ203АМ	4, 33	84
КТ203БМ	4, 33	84
КТ203ВМ	4, 33	84
КТ206А	33, 26	86
КТ206Б	АО «Светлана»	86
КТ207А	АО «Светлана»	86
КТ207Б	АО «Элекс»	86
КТ207В	АО «Элекс»	86
КТ208А	4, 12, 33	86

Тип прибора	Изготовитель (см. стр. 31)	Стр.
КТ208Б	4, 12, 33	86
КТ208В	4, 12, 33	86
КТ208Г	4, 12, 33	86
КТ208Д	4, 12, 33	86
КТ208Е	4, 12, 33	86
КТ208Ж	4, 12, 33	86
КТ208И	4, 12, 33	86
КТ208К	4, 12, 33	86
КТ208Л	4, 12, 33	86
КТ208М	4, 12, 33	86
КТ209А	4, 12, 28, 33	86
КТ209Б	4, 12, 28, 33	86
КТ209В	4, 12, 28, 33	86
КТ209В2	4, 12, 28, 33	86
КТ209Г	4, 12, 28, 33	86
КТ209Д	4, 12, 28, 33	86
КТ209Е	3-д «Арсенал»	86
КТ209Ж	3-д «Арсенал»	86
КТ209И	3-д «Арсенал»	86
КТ209К	НПО «Планета»	86
КТ209Л	3-д «Арсенал»	86
КТ209М	3-д «Арсенал»	86
КТ209К9	НПО «Планета»	86
КТ210А	ЗАО «Кремний»	86
КТ210Б	ЗАО «Кремний»	86
КТ210В	ЗАО «Кремний»	86
КТ211А-1	ЗАО «Кремний»	86
КТ211Б-1	ЗАО «Кремний»	86
КТ211В-1	ЗАО «Кремний»	86
КТ214А-1	33, 13	88
КТ214Б-1	33, 13	88
КТ214В-1	33, 13	88
КТ214Г-1	33, 13	88
КТ214Д-1	33, 13	88
КТ214Е-1	33, 13	88
КТ215А-1	33, 13	88
КТ215Б-1	33, 13	88
КТ215В-1	33, 13	88
КТ215Г-1	33, 13	88
КТ215Д-1	33, 13	88
КТ215Е-1	33, 13	88
КТ216А	АО «Элекс»	88
КТ216Б	АО «Элекс»	88
КТ216В	АО «Элекс»	88
КТ218А-9	АО «Элекс»	88
КТ218Б-9	АО «Элекс»	88
КТ218В-9	АО «Элекс»	88
КТ218Г-9	АО «Элекс»	88
КТ218Д-9	АО «Элекс»	88
КТ218Е-9	АО «Элекс»	88
КТ220А9	3-д «Транзистор»	88
КТ220Б9	3-д «Транзистор»	88
КТ220В9	3-д «Транзистор»	88
КТ220Г9	3-д «Транзистор»	88
КТ301	7, 36	88

Тип прибора	Изготовитель (см. стр. 31)	Стр.
КТ301А	7, 36	88
КТ301Б	7, 36	88
КТ301В	7, 36	88
КТ301Г	33, 36	88
КТ301Д	ПО «НИИЭТ»	88
КТ301Е	ПО «НИИЭТ»	88
КТ301Ж	ПО «НИИЭТ»	88
КТ302А	ПО «НИИЭТ»	88
КТ302Б	ПО «НИИЭТ»	88
КТ302В	ПО «НИИЭТ»	88
КТ302Г	ПО «НИИЭТ»	88
КТ306А	ПО «НИИЭТ»	88
КТ306Б	ПО «НИИЭТ»	88
КТ306В	ПО «НИИЭТ»	88
КТ306Г	ПО «НИИЭТ»	88
КТ306Д	ПО «НИИЭТ»	88
КТ306АМ	26, 36	90
КТ306БМ	26, 36	90
КТ306ВМ	26, 36	90
КТ306ГМ	26, 36	90
КТ306ДМ	26, 36	90
КТ307А-1	АО «Светлана»	90
КТ307Б-1	АО «Светлана»	90
КТ307В-1	АО «Светлана»	90
КТ307Г-1	АО «Светлана»	90
КТ3101А-2	АО «Светлана»	90
КТ3101АМ	АО «Светлана»	90
КТ3102А	4, 7, 12, 13, 26, 28, 33	90
КТ3102Б	4, 7, 12, 13, 26, 28, 33	90
КТ3102В	4, 7, 12, 13, 26, 28, 33	90
КТ3102Г	4, 7, 12, 13, 26, 28, 33	90
КТ3102Д	4, 7, 12, 13, 26, 28, 33	90
КТ3102Е	4, 7, 12, 13, 26, 28, 33	90
КТ3102Ж	4, 7, 12, 13, 26, 28, 33	90
КТ3102И	4, 7, 12, 13, 26, 28, 33	90
КТ3102К	4, 7, 12, 13, 26, 28, 33	90
КТ3102АМ	4, 12, 28, 33	90
КТ3102БМ	4, 12, 28, 33	90
КТ3102ВМ	4, 12, 28, 33	90
КТ3102ГМ	4, 12, 28, 33	90
КТ3102ДМ	4, 12, 28, 33	90
КТ3102ЕМ	4, 12, 28, 33	90
КТ3102ЖМ	4, 12, 28, 33	90
КТ3102ИМ	4, 12, 28, 33	90
КТ3102КМ	4, 12, 28, 33	90
КТ3102А2	ЗАО «Кремний»	90
КТ3102Б2	ЗАО «Кремний»	90
КТ3102В2	ЗАО «Кремний»	90
КТ3102Г2	ЗАО «Кремний»	90
КТ3102Д2	ЗАО «Кремний»	90
КТ3102Е2	ЗАО «Кремний»	90
КТ3102Ж2	ЗАО «Кремний»	90
КТ3102И2	ЗАО «Кремний»	90
КТ3102К2	ЗАО «Кремний»	90
КТ3104А	АО «Восход»	92

Тип прибора	Изготовитель (см. стр. 31)	Стр.
КТ361Г-2	12, 28, 33	118
КТ361Г-3	12, 28, 33	118
КТ361Д-2	12, 28, 33	118
КТ361Д-3	12, 28, 33	118
КТ361Е-2	12, 28, 33	118
КТ361Ж-2	12, 28, 33	118
КТ361И-2	12, 28, 33	118
КТ361К-2	12, 28, 33	118
КТ361Л-2	12, 28, 33	118
КТ361М-2	12, 28, 33	118
КТ361Н-2	12, 28, 33	118
КТ361П-2	12, 28, 33	118
КТ363А	2, 33	118
КТ363Б	2, 33	118
КТ363АМ	2, 33	118
КТ363БМ	2, 33	118
КТ364А-2	3-д ПО «Альфа»	120
КТ364Б-2	3-д ПО «Альфа»	120
КТ364В-2	3-д ПО «Альфа»	120
КТ366А	НИИМП	120
КТ366Б	НИИМП	120
КТ366В	НИИМП	120
КТ368А	2, 4, 33	120
КТ368Б	2, 4, 33	120
КТ368А-5	4, 28, 33	120
КТ368А-9	4, 28, 33	120
КТ368Б-9	4, 28, 33	120
КТ368АМ	4, 28, 33	120
КТ368БМ	4, 28, 33	120
КТ368ВМ	4, 28, 33	120
КТ369А	3-д «Транзистор»	120
КТ369Б	3-д «Транзистор»	120
КТ369В	3-д «Транзистор»	120
КТ369Г	3-д «Транзистор»	120
КТ369А-1	3-д «Транзистор»	120
КТ369Б-1	3-д «Транзистор»	120
КТ369В-1	3-д «Транзистор»	120
КТ369Г-1	3-д «Транзистор»	120
КТ370А-1	3-д ПО «Альфа»	122
КТ370Б-1	3-д ПО «Альфа»	122
КТ370А-9	3-д ПО «Альфа»	122
КТ370Б-9	3-д ПО «Альфа»	122
КТ371А	АО «Светлана»	122
КТ371АМ	АО «Светлана»	122
КТ372А	3-д «Пульсар»	122
КТ372Б	3-д «Пульсар»	122
КТ372В	3-д «Пульсар»	122
КТ373А	АО «Элекс»	122
КТ373Б	АО «Элекс»	122
КТ373В	АО «Элекс»	122
КТ373Г	АО «Элекс»	122
КТ375А	ВЗПП	122
КТ375Б	ВЗПП	122
КТ379А	АО «Элекс»	122
КТ379Б	АО «Элекс»	122
КТ379В	АО «Элекс»	122
КТ379Г	АО «Элекс»	122
КТ380А	АО «Элекс»	124
КТ380Б	АО «Элекс»	124
КТ380В	АО «Элекс»	124
КТ381Б	СКБ «Элькор»	124
КТ381В	СКБ «Элькор»	124
КТ381Г	СКБ «Элькор»	124
КТ381Д	СКБ «Элькор»	124
КТ381Е	СКБ «Элькор»	124
КТ382А	АО «Светлана»	124
КТ382Б	АО «Светлана»	124
КТ382АМ	АО «Светлана»	124
КТ382БМ	АО «Светлана»	124
КТ384А-2	3-д «Транзистор»	124
КТ384АМ-2	3-д «Транзистор»	124
КТ385А-2	3-д «Транзистор»	124
КТ385АМ-2	3-д «Транзистор»	124
КТ385БМ-2	3-д «Транзистор»	124
КТ388Б-2	АО «Элекс»	126
КТ388БМ-2	АО «Элекс»	126
КТ389Б-2	АО «Элекс»	126
КТ391А-2	3-д «Пульсар»	126
КТ391Б-2	3-д «Пульсар»	126
КТ391В-2	3-д «Пульсар»	126
КТ392А-2	3-д ПО «Альфа»	126
КТ396А-2	АО «Светлана»	126
КТ396А-9	АО «Светлана»	126
КТ397А-2	АО «Светлана»	126
КТ399А	АО «Светлана»	128
КТ399АМ	АО «Светлана»	128
КТ501А	ЗАО «Кремний»	128
КТ501Б	ЗАО «Кремний»	128
КТ501В	ЗАО «Кремний»	128
КТ501Г	ЗАО «Кремний»	128
КТ501Д	ЗАО «Кремний»	128
КТ501Е	ЗАО «Кремний»	128
КТ501Ж	ЗАО «Кремний»	128
КТ501И	ЗАО «Кремний»	128
КТ501К	ЗАО «Кремний»	128
КТ501Л	ЗАО «Кремний»	128
КТ501М	ЗАО «Кремний»	128
КТ502А	4, 12, 28, 33	128
КТ502Б	4, 12, 28, 33	128
КТ502В	4, 12, 28, 33	128
КТ502Г	4, 12, 28, 33	128
КТ502Д	4, 12, 28, 33	128
КТ502Е	4, 12, 28, 33	128
КТ503А	4, 12, 28, 33	128
КТ503Б	4, 12, 28, 33	128
КТ503В	4, 12, 28, 33	128
КТ503Г	4, 12, 28, 33	128
КТ503Д	4, 12, 28, 33	128
КТ503Е	4, 12, 28, 33	128
КТ504А	12, 33	128
КТ504Б	12, 33	128
КТ504В	12, 33	128
КТ505А	ЗАО «Кремний»	128
КТ505Б	ЗАО «Кремний»	128
КТ506А	ЗАО «Кремний»	128
КТ506Б	ЗАО «Кремний»	128
КТ509А	ЗАО «Кремний»	130
КТ511А9	АО «Элекс»	130
КТ511Б9	АО «Элекс»	130
КТ511В9	АО «Элекс»	130
КТ511Г9	АО «Элекс»	130
КТ511Д9	АО «Элекс»	130
КТ511Е9	АО «Элекс»	130
КТ511Ж9	АО «Элекс»	130
КТ511И9	АО «Элекс»	130
КТ511К9	АО «Элекс»	130
КТ512А9	АО «Элекс»	130
КТ512Б9	АО «Элекс»	130
КТ512В9	АО «Элекс»	130
КТ512Г9	АО «Элекс»	130
КТ512Д9	АО «Элекс»	130
КТ512Е9	АО «Элекс»	130
КТ512Ж9	АО «Элекс»	130
КТ512И9	АО «Элекс»	130
КТ512К9	АО «Элекс»	130
КТ513А9	АО «Элекс»	130
КТ513Б9	АО «Элекс»	130
КТ513В9	АО «Элекс»	130
КТ513Г9	АО «Элекс»	130
КТ513Д9	АО «Элекс»	130
КТ514А9	АО «Элекс»	130
КТ514Б9	АО «Элекс»	130
КТ514В9	АО «Элекс»	130
КТ514Г9	АО «Элекс»	130
КТ514Д9	АО «Элекс»	130
КТ515А9	АО «Элекс»	130
КТ515Б9	АО «Элекс»	130
КТ515В9	АО «Элекс»	130
КТ516А9	АО «Элекс»	130
КТ516Б9	АО «Элекс»	130
КТ516В9	АО «Элекс»	130
КТ517А	АО «Элекс»	130
КТ517Б	АО «Элекс»	130
КТ517В	АО «Элекс»	130
КТ517Г	АО «Элекс»	130
КТ517Д	АО «Элекс»	130
КТ517Е	АО «Элекс»	130
КТ517А-1	АО «Элекс»	132
КТ517Б-1	АО «Элекс»	132
КТ517В-1	АО «Элекс»	132
КТ517Г-1	АО «Элекс»	132
КТ517Д-1	АО «Элекс»	132
КТ517Е-1	АО «Элекс»	132
КТ517А-9	АО «Элекс»	132
КТ517Б-9	АО «Элекс»	132
КТ517В-9	АО «Элекс»	132
КТ517Г-9	АО «Элекс»	132
КТ517Д-9	АО «Элекс»	132
КТ517Е-9	АО «Элекс»	132
КТ519А	3-д «Микрон»	132
КТ519Б	3-д «Микрон»	132

Тип прибора	Изготовитель (см. стр. 31)	Стр.
КТ624АМ-2	3-д «Транзистор»	146
КТ625А	3-д «Транзистор»	148
КТ625АМ	3-д «Транзистор»	148
КТ625АМ-2	3-д «Транзистор»	148
КТ626А	ЗАО «Кремний»	148
КТ626Б	ЗАО «Кремний»	148
КТ626В	ЗАО «Кремний»	148
КТ626Г	ЗАО «Кремний»	148
КТ626Д	ЗАО «Кремний»	148
КТ629А-2	АО «Элекс»	148
КТ629Б-2	АО «Элекс»	148
КТ629БМ-2	АО «Элекс»	148
КТ630А	12, 33	148
КТ630Б	12, 33	148
КТ630В	12, 33	148
КТ630Г	12, 33	148
КТ630Д	12, 33	148
КТ630Е	12, 33	148
КТ630А-5	12, 33	148
КТ630Б-5	12, 33	148
КТ630В-5	12, 33	148
КТ630Г-5	12, 33	148
КТ632Б	АО «Элекс»	148
КТ632Б-1	АО «Элекс»	150
КТ632В-1	АО «Элекс»	150
КТ633А	3-д «Транзистор»	150
КТ633Б	3-д «Транзистор»	150
КТ634А-2	3-д «Транзистор»	150
КТ634Б-2	3-д «Транзистор»	150
КТ635А	28, 33	150
КТ635Б	28, 33	150
КТ637А-2	3-д «Транзистор»	150
КТ637Б-2	3-д «Транзистор»	150
КТ638А	АО «Элекс»	150
КТ638А1	АО «Элекс»	150
КТ639А	2, 12, 15	152
КТ639Б	2, 12, 15	152
КТ639В	2, 12, 15	152
КТ639Г	2, 12, 15	152
КТ639Д	2, 12, 15	152
КТ639Е	2, 12, 15	152
КТ639Ж	2, 12, 15	152
КТ639И	2, 12, 15	152
КТ639А-1	2, 12, 15	152
КТ639Б-1	2, 12, 15	152
КТ639В-1	2, 12, 15	152
КТ639Г-1	2, 12, 15	152
КТ639Д-1	2, 12, 15	152
КТ639Е-1	2, 12, 15	152
КТ639Ж-1	2, 12, 15	152
КТ639И-1	2, 12, 15	152
КТ640А-2	3-д «Пульсар»	152
КТ640Б-2	3-д «Пульсар»	152
КТ640В-2	3-д «Пульсар»	152
КТ642А-2	3-д «Пульсар»	152
КТ642А-5	3-д «Пульсар»	152
КТ643А-2	3-д «Пульсар»	152
КТ644А	2, 12	152
КТ644Б	2, 12	152
КТ644В	2, 12	152
КТ644Г	2, 12	152
КТ645А	12, 28, 33	154
КТ645Б	12, 28, 33	154
КТ646А	12, 28, 33	154
КТ646Б	12, 28, 33	154
КТ646В	12, 28, 33	154
КТ647А-2	3-д «Пульсар»	154
КТ647А-5	3-д «Пульсар»	154
КТ648А-2	3-д «Пульсар»	154
КТ648А-5	3-д «Пульсар»	154
КТ653А	ЗАО «Кремний»	154
КТ653Б	ЗАО «Кремний»	154
КТ657А-2	3-д «Пульсар»	154
КТ657Б-2	3-д «Пульсар»	154
КТ657В-2	3-д «Пульсар»	154
КТ657А-5	3-д «Пульсар»	156
КТ657Б-5	3-д «Пульсар»	156
КТ657В-5	3-д «Пульсар»	156
КТ659А	ПО «НИИЭТ»	156
КТ660А	28, 33	156
КТ660Б	28, 33	156
КТ661А	4, 33	156
КТ662А	АО «Элекс»	156
КТ664А-9	12, 28, 33	156
КТ664Б-9	12, 28, 33	156
КТ665А-9	12, 33	156
КТ665Б-9	12, 33	156
КТ666А-9	ЗАО «Кремний»	156
КТ667А-9	ЗАО «Кремний»	156
КТ668А	3-д ПО «Альфа»	158
КТ668Б	3-д ПО «Альфа»	158
КТ668В	3-д ПО «Альфа»	158
КТ680А	АО «Элекс»	158
КТ681А	АО «Элекс»	158
КТ682А-2	3-д «Пульсар»	158
КТ682Б-2	3-д «Пульсар»	158
КТ682А-5	3-д «Пульсар»	158
КТ682Б-5	3-д «Пульсар»	158
КТ683А	ЗАО «Кремний»	158
КТ683Б	ЗАО «Кремний»	158
КТ683В	ЗАО «Кремний»	158
КТ683Г	ЗАО «Кремний»	158
КТ683Д	ЗАО «Кремний»	158
КТ683Е	ЗАО «Кремний»	158
КТ684А	3-д ПО «Альфа»	158
КТ684Б	3-д ПО «Альфа»	158
КТ684В	3-д ПО «Альфа»	158
КТ684Г	3-д ПО «Альфа»	158
КТ685А	3-д ПО «Альфа»	158
КТ685Б	3-д ПО «Альфа»	158
КТ685В	3-д ПО «Альфа»	158
КТ685Г	3-д ПО «Альфа»	158
КТ685Д	3-д ПО «Альфа»	158
КТ685Е	3-д ПО «Альфа»	158
КТ685Ж	3-д ПО «Альфа»	158
КТ686А	3-д ПО «Альфа»	158
КТ686Б	3-д ПО «Альфа»	158
КТ686В	3-д ПО «Альфа»	158
КТ686Г	3-д ПО «Альфа»	158
КТ686Д	3-д ПО «Альфа»	158
КТ686Е	3-д ПО «Альфа»	158
КТ686Ж	3-д ПО «Альфа»	158
КТ692А	АО «Элекс»	160
КТ695А	АО «Элекс»	160
КТ698А	АО «Элекс»	160
КТ698Б	АО «Элекс»	160
КТ698В	АО «Элекс»	160
КТ698Г	АО «Элекс»	160
КТ698Д	АО «Элекс»	160
КТ698Е	АО «Элекс»	160
КТ698Ж	АО «Элекс»	160
КТ698И	АО «Элекс»	160
КТ698К	АО «Элекс»	160
КТ704А	АО «Электронприбор»	160
КТ704Б	АО «Электронприбор»	160
КТ704В	АО «Электронприбор»	160
КТ708А	ЗАО «Кремний»	160
КТ708Б	ЗАО «Кремний»	160
КТ708В	ЗАО «Кремний»	160
КТ709А	ЗАО «Кремний»	160
КТ709Б	ЗАО «Кремний»	160
КТ709В	ЗАО «Кремний»	160
КТ710А	АО «Элиз»	160
КТ712А	ЗАО «Кремний»	162
КТ712Б	ЗАО «Кремний»	162
КТ715А	1, 34	162
КТ716А	ЗАО «Кремний»	162
КТ716Б	ЗАО «Кремний»	162
КТ716В	ЗАО «Кремний»	162
КТ716Г	ЗАО «Кремний»	162
КТ719А	ЗАО «Кремний»	162
КТ720А	ЗАО «Кремний»	162
КТ721А	ЗАО «Кремний»	162
КТ722А	ЗАО «Кремний»	162
КТ723А	ЗАО «Кремний»	162
КТ724А	ЗАО «Кремний»	162
КТ728А	3-д «Искра»	162
КТ729А	ЗАО «Кремний»	162
КТ729Б	ЗАО «Кремний»	162
КТ730А	ЗАО «Кремний»	164
КТ731А	3-д ПО «Фотон»	164
КТ731Б	3-д ПО «Фотон»	164
КТ731В	3-д ПО «Фотон»	164
КТ731Г	3-д ПО «Фотон»	164
КТ732А	3-д «Транзистор»	164
КТ733А	3-д «Транзистор»	164
КТ734А	3-д «Микрон»	164
КТ734Б	3-д «Микрон»	164
КТ734В	3-д «Микрон»	164
КТ734Г	3-д «Микрон»	164
КТ735А	3-д «Микрон»	164

Тип прибора	Изготовитель (см. стр. 31)	Стр.
КТ853В	ЗАО «Кремний»	210
КТ853Г	ЗАО «Кремний»	210
КТ854А	10, 12	210
КТ854Б	10, 12	210
КТ855А	ЗАО «Кремний»	210
КТ855Б	ЗАО «Кремний»	210
КТ855В	ЗАО «Кремний»	210
КТ856А	З-д «Искра»	210
КТ856Б	З-д «Искра»	210
КТ856А-1	З-д «Искра»	212
КТ856Б-1	З-д «Искра»	212
КТ857А	10, 12	212
КТ858А	10, 12, 34	212
КТ859А	10, 12, 34	212
КТ862Б	З-д «Пульсар»	212
КТ862В	З-д «Пульсар»	212
КТ862Г	З-д «Пульсар»	212
КТ863А	ЗАО «Кремний»	212
КТ863Б	ЗАО «Кремний»	212
КТ863В	ЗАО «Кремний»	212
КТ864А	ЗАО «Кремний»	212
КТ865А	ЗАО «Кремний»	212
КТ866А	З-д «Пульсар»	212
КТ866Б	З-д «Пульсар»	212
КТ867А	10, 12	212
КТ868А	З-д «Искра»	214
КТ868Б	З-д «Искра»	214
КТ872А	28, 34	214
КТ872Б	З-д «Транзистор»	214
КТ872В	З-д «Транзистор»	214
КТ874А	З-д «Пульсар»	214
КТ874Б	З-д «Пульсар»	214
КТ878А	З-д «Искра»	214
КТ878Б	З-д «Искра»	214
КТ878В	З-д «Искра»	214
КТ879А	З-д «Искра»	214
КТ879Б	З-д «Искра»	214
КТ885А	З-д «Пульсар»	214
КТ885Б	З-д «Пульсар»	214
КТ886А-1	АО «Электронприбор»	214
КТ886Б-1	АО «Электронприбор»	214
КТ887А	ЗАО «Кремний»	214
КТ887Б	ЗАО «Кремний»	214
КТ888А	ЗАО «Кремний»	216
КТ888Б	ЗАО «Кремний»	216
КТ890А	АО «Элиз»	216
КТ890Б	АО «Элиз»	216
КТ890В	АО «Элиз»	216
КТ892А	З-д «Искра»	216
КТ892Б	З-д «Искра»	216
КТ892В	З-д «Искра»	216
КТ893А	АО «Элиз»	216
КТ896А	ЗАО «Кремний»	216
КТ896Б	ЗАО «Кремний»	216
КТ897А	ЗАО «Кремний»	216
КТ897Б	ЗАО «Кремний»	216
КТ898А	ЗАО «Кремний»	216
КТ898Б	ЗАО «Кремний»	216
КТ898А-1	ЗАО «Кремний»	218
КТ898Б-1	ЗАО «Кремний»	218
КТ899А	З-д «Искра»	218
КТ902А	ВЗПП	218
КТ902АМ	ВЗПП	218
КТ903А	ВЗПП	218
КТ903Б	ВЗПП	218
КТ904А	ВЗПП	218
КТ904Б	ВЗПП	218
КТ907А	ПО «НИИЭТ»	218
КТ907Б	ПО «НИИЭТ»	218
КТ908А	АО «Элиз»	218
КТ908Б	АО «Элиз»	218
КТ909А	7, 36	220
КТ909Б	7, 36	220
КТ909В	7, 36	220
КТ909Г	7, 36	220
КТ9101АС	7, 36	220
КТ9104А	7, 36	220
КТ9104Б	7, 36	220
КТ9105АС	7, 36	220
КТ9106АС-2	НПП «Пульсар»	220
КТ9106БС-2	НПП «Пульсар»	220
КТ9109А	7, 36	220
КТ9111А	З-д «Пульсар»	220
КТ9115А	ЗАО «Кремний»	222
КТ9115Б	ЗАО «Кремний»	222
КТ9116А	ПО «НИИЭТ»	222
КТ9116Б	ПО «НИИЭТ»	222
КТ911А	7, 36	222
КТ911Б	7, 36	222
КТ911В	7, 36	222
КТ911Г	7, 36	222
КТ912А	З-д «Пульсар»	222
КТ912Б	З-д «Пульсар»	222
КТ9131А	З-д «Пульсар»	222
КТ9132АС	ПО «НИИЭТ»	222
КТ913А	З-д «Транзистор»	222
КТ913Б	З-д «Транзистор»	222
КТ913В	З-д «Транзистор»	222
КТ9120А	ЗАО «Кремний»	222
КТ9121А	З-д «Пульсар»	224
КТ9121Б	З-д «Пульсар»	224
КТ9121В	З-д «Пульсар»	224
КТ9121Г	З-д «Пульсар»	224
КТ9125АС	ПО «НИИЭТ»	224
КТ9126А	З-д «Пульсар»	224
КТ9127А	З-д «Пульсар»	224
КТ9127Б	З-д «Пульсар»	224
КТ9128АС	ПО «НИИЭТ»	224
КТ9130А	ЗАО «Кремний»	224
КТ9133А	7, 36	224
КТ9134А	З-д «Пульсар»	226
КТ9134Б	З-д «Пульсар»	226
КТ9136АС	ПО «НИИЭТ»	226
КТ914А	АО «Элекс»	226
КТ9141А	З-д «Пульсар»	226
КТ9141А-1	З-д «Пульсар»	226
КТ9142А	ПО «НИИЭТ»	226
КТ9143А	НПО «Планета»	226
КТ9143Б	НПО «Планета»	226
КТ9143В	НПО «Планета»	226
КТ9144А-5	ЗАО «Кремний»	228
КТ9145А-5	ЗАО «Кремний»	228
КТ9144А-9	ЗАО «Кремний»	228
КТ9145А-9	ЗАО «Кремний»	228
КТ9146А	З-д «Пульсар»	228
КТ9146Б	З-д «Пульсар»	228
КТ9146В	З-д «Пульсар»	228
КТ9147АС	ПО «НИИЭТ»	228
КТ9150А	ПО «НИИЭТ»	228
КТ9151А	ПО «НИИЭТ»	228
КТ9152А	ПО «НИИЭТ»	228
КТ9153АС	ПО «НИИЭТ»	230
КТ9153БС	ПО «НИИЭТ»	230
КТ9155А	ПО «НИИЭТ»	230
КТ9155Б	ПО «НИИЭТ»	230
КТ9155В	ПО «НИИЭТ»	230
КТ9156АС	ПО «НИИЭТ»	230
КТ9156БС	ПО «НИИЭТ»	230
КТ9157А	ЗАО «Кремний»	230
КТ9160А	З-д «Пульсар»	230
КТ9160Б	З-д «Пульсар»	230
КТ9160В	З-д «Пульсар»	230
КТ9161АС	ПО «НИИЭТ»	232
КТ9164А	З-д «Пульсар»	232
КТ9166А	ЗАО «Кремний»	232
КТ916А	З-д «Транзистор»	232
КТ916Б	З-д «Транзистор»	232
КТ9173А	ПО «НИИЭТ»	232
КТ9174А	ПО «НИИЭТ»	232
КТ9176А	З-д «Искра»	232
КТ9177А	З-д «Искра»	232
КТ9180А	ЗАО «Кремний»	234
КТ9180Б	ЗАО «Кремний»	234
КТ9180В	ЗАО «Кремний»	234
КТ9180Г	ЗАО «Кремний»	234
КТ9181А	ЗАО «Кремний»	234
КТ9181Б	ЗАО «Кремний»	234
КТ9181В	ЗАО «Кремний»	234
КТ9181Г	ЗАО «Кремний»	234
КТ918А-2	З-д «Транзистор»	234
КТ918Б-2	З-д «Транзистор»	234
КТ9182А	ПО «НИИЭТ»	234
КТ9186А	ЗАО «Кремний»	234
КТ9186Б	ЗАО «Кремний»	234
КТ9186В	ЗАО «Кремний»	234

2 зак 9

Кремниевые сборки

Тип прибора	Изготовитель (см. стр. 31)	Стр.
КТС303А-2	3-д ПО«Альфа»	256
КТС3103А	3-д ПО«Альфа»	256
КТС3103Б	3-д ПО«Альфа»	256
КТС3103А1	3-д ПО«Альфа»	256
КТС3103Б1	3-д ПО«Альфа»	256
КТС3161АС	АО «Элекс»	256
КТС3174АС-2	АО «Элекс»	256
КТС381Б	—	256
КТС381В	—	256
КТС381Г	—	256
КТС381Д	—	256
КТС381Е	—	256
КТС393А	3-д ПО«Альфа»	258
КТС393Б	3-д ПО«Альфа»	258
КТС393А-1	3-д ПО«Альфа»	258
КТС393Б-1	3-д ПО«Альфа»	258
КТС393А-9	3-д ПО«Альфа»	258
КТС393Б-9	3-д ПО«Альфа»	258
КТС394А-2	АО «Элекс»	258
КТС394Б-2	АО «Элекс»	258
КТС395А-1	АО «Элекс»	258
КТС395Б-1	АО «Элекс»	258
КТС395А-2	АО «Элекс»	258
КТС395Б-2	АО «Элекс»	258
КТС395В-2	АО «Элекс»	258
КТС398А-1	АО «Светлана»	258
КТС398Б-1	АО «Светлана»	258
КТС398А9	АО «Светлана»	260
КТС398Б9	АО «Светлана»	260
КТС613А	3-д «Транзистор»	260
КТС613Б	3-д «Транзистор»	260
КТС613В	3-д «Транзистор»	260
КТС613Г	3-д «Транзистор»	260
КТС622А	ВЗПП	260
КТС622Б	ВЗПП	260
КТС631А	3-д «Транзистор»	260
КТС631Б	3-д «Транзистор»	260
КТС631В	3-д «Транзистор»	260
КТС631Г	3-д «Транзистор»	260
КТ674АС	АО «Элекс»	260
КТ677АС	АО «Элекс»	260
КТ678АС	АО «Элекс»	262
КТ693АС	ЗАО «Кремний»	262
К1НТ251	7, 36	262
К1НТ661А	АО «Элекс»	262
К129НТ1А-1	—	262
К129НТ1Б-1	—	262
К129НТ1В-1	—	262
К129НТ1Г-1	—	262
К129НТ1Д-1	—	262
К129НТ1Е-1	—	262
К129НТ1Ж-1	—	262
К129НТ1И-1	—	262

Германиевые транзисторы специального назначения

Тип прибора	Изготовитель (см. стр. 31)	Стр.
1Т101	АО «Светлана»	264
1Т101А	АО «Светлана»	264
1Т101Б	АО «Светлана»	264
1Т102	АО «Светлана»	264
1Т102А	АО «Светлана»	264
1Т115А	ЗАО «Кремний»	264
1Т115Б	ЗАО «Кремний»	264
1Т115В	ЗАО «Кремний»	264
1Т115Г	ЗАО «Кремний»	264
1Т116А	ЗАО «Кремний»	264
1Т116Б	ЗАО «Кремний»	264
1Т116В	ЗАО «Кремний»	264
1Т116Г	ЗАО «Кремний»	264
1Т303	—	264
1Т303А	—	264
1Т303Б	—	264
1Т303В	—	264
1Т303Г	—	264
1Т303Д	—	264
1Т305А	НПО «Планета»	264
1Т305Б	НПО «Планета»	264
1Т305В	НПО «Планета»	264
1Т308А	СКБ «Элькор»	264
1Т308Б	СКБ «Элькор»	264
1Т308В	СКБ «Элькор»	264
1Т308Г	СКБ «Элькор»	264
1Т311А	3-д «Квазар»	264
1Т311Б	3-д «Квазар»	264
1Т311Г	3-д «Квазар»	264
1Т311Д	3-д «Квазар»	264
1Т311К	3-д «Квазар»	264
1Т311Л	3-д «Квазар»	264
1Т3110А-2	СКБ «Элькор»	266
1Т313А	3-д «Квазар»	266
1Т313Б	3-д «Квазар»	266
1Т313В	3-д «Квазар»	266
1Т320А	«Тонди электроника»	266
1Т320Б	«Тонди электроника»	266
1Т320В	«Тонди электроника»	266
1Т321А	СКБ «Элькор»	266
1Т321Б	СКБ «Элькор»	266
1Т321В	СКБ «Элькор»	266
1Т321Г	СКБ «Элькор»	266
1Т321Д	СКБ «Элькор»	266
1Т321Е	СКБ «Элькор»	266
1Т329А	3-д ПО«Альфа»	266
1Т329Б	3-д ПО«Альфа»	266
1Т329В	3-д ПО«Альфа»	266
1Т330А	3-д «Пульсар»	266
1Т330Б	3-д «Пульсар»	266
1Т330В	3-д «Пульсар»	266
1Т330Г	3-д «Пульсар»	266
1Т335А	«Тонди электроника»	266
1Т335Б	«Тонди электроника»	266
1Т335В	«Тонди электроника»	266
1Т335Г	«Тонди электроника»	266
1Т335Д	«Тонди электроника»	266
1Т341А	3-д ПО«Альфа»	266
1Т341Б	3-д ПО«Альфа»	266
1Т341В	3-д ПО«Альфа»	266
1Т362А	3-д «Квазар»	268
1Т374А-6	3-д «Квазар»	268
1Т376А	НПО «Планета»	268
1Т383А-2	—	268
1Т383Б-2	—	268
1Т383В-2	—	268
1Т386А	3-д «Транзистор»	268
1Т387А-2	СКБ «Элькор»	268
1Т387Б-2	СКБ «Элькор»	268
1Т403А	—	268
1Т403Б	—	268
1Т403В	—	268
1Т403Г	—	268
1Т403Д	—	268
1Т403Е	—	268
1Т403Ж	—	268
1Т403И	—	268
1Т612А-4	СКБ «Элькор»	270
1Т614А	СКБ «Элькор»	270
1Т615	—	270
1Т702А	3-д ПО «Фотон»	270
1Т702Б	3-д ПО «Фотон»	270
1Т702В	3-д ПО «Фотон»	270
1Т806А	ЗАО «Кремний»	270
1Т806Б	ЗАО «Кремний»	270
1Т806В	ЗАО «Кремний»	270
1Т813А	ЗАО «Кремний»	270
1Т813Б	ЗАО «Кремний»	270
1Т813В	ЗАО «Кремний»	270
1Т901А	3-д ПО «Фотон»	270
1Т901Б	3-д ПО «Фотон»	270
1Т905А	3-д ПО «Фотон»	270
1Т906А	3-д ПО «Фотон»	270
1Т910АД	3-д ПО «Фотон»	270

Кремниевые транзисторы специального назначения

Тип прибора	Изготовитель (см. стр. 31)	Стр.
2Т876Г	ЗАО «Кремний»	328
2Т877А	ЗАО «Кремний»	328
2Т877Б	ЗАО «Кремний»	328
2Т877В	ЗАО «Кремний»	328
2Т878А	3-д «Искра»	328
2Т878Б	3-д «Искра»	328
2Т878В	3-д «Искра»	328
2Т879А	3-д «Искра»	328
2Т879Б	3-д «Искра»	328
2Т880А	ЗАО «Кремний»	328
2Т880Б	ЗАО «Кремний»	328
2Т880В	ЗАО «Кремний»	328
2Т880Г	ЗАО «Кремний»	328
2Т880А-5	ЗАО «Кремний»	328
2Т880Б-5	ЗАО «Кремний»	328
2Т881А	ЗАО «Кремний»	328
2Т881Б	ЗАО «Кремний»	328
2Т881В	ЗАО «Кремний»	328
2Т881Г	ЗАО «Кремний»	328
2Т881А-5	ЗАО «Кремний»	328
2Т881Б-5	ЗАО «Кремний»	328
2Т882А	ЗАО «Кремний»	328
2Т882Б	ЗАО «Кремний»	328
2Т882В	ЗАО «Кремний»	328
2Т883А	ЗАО «Кремний»	330
2Т883Б	ЗАО «Кремний»	330
2Т884А	ЗАО «Кремний»	330
2Т884Б	ЗАО «Кремний»	330
2Т885А	3-д «Пульсар»	330
2Т885Б	3-д «Пульсар»	330
2Т886А	ЗАО «Кремний»	330
2Т886Б	ЗАО «Кремний»	330
2Т887А	ЗАО «Кремний»	330
2Т887Б	ЗАО «Кремний»	330
2Т888А	ЗАО «Кремний»	330
2Т888Б	ЗАО «Кремний»	330
2Т891А	3-д «Пульсар»	330
2Т903А	ВЗПП	330
2Т903Б	ВЗПП	330
2Т904А	ПО «Знамя»	330
2Т907А	ВЗПП	332
2Т908А	3-д «Искра»	332
2Т909А	ВЗПП	332
2Т909Б	ВЗПП	332
2Т9101АС	ВЗПП	332
2Т9102А-2	3-д «Пульсар»	332
2Т9102Б-2	3-д «Пульсар»	332
2Т9103А-2	3-д «Пульсар»	332
2Т9103Б-2	3-д «Пульсар»	332
2Т9104А	ВЗПП	332
2Т9104Б	ВЗПП	332
2Т9105АС	ВЗПП	332
2Т9107А-2	3-д «Пульсар»	334
2Т9108А-2	3-д «Пульсар»	334
2Т9109А	ВЗПП	334
2Т9110А-2	3-д «Пульсар»	334
2Т9110Б-2	3-д «Пульсар»	334
2Т9111А	3-д «Пульсар»	334
2Т9112А	АО «Элиз»	334
2Т9113А	АО «Элиз»	334
2Т9114А	3-д «Пульсар»	336
2Т9114Б	3-д «Пульсар»	336
2Т911А	ВЗПП	336
2Т911Б	ВЗПП	336
2Т912А	3-д «Пульсар»	336
2Т912Б	3-д «Пульсар»	336
2Т912А-5	3-д «Пульсар»	336
2Т912Б-5	3-д «Пульсар»	336
2Т913А	3-д «Транзистор»	336
2Т913Б	3-д «Транзистор»	336
2Т913В	3-д «Транзистор»	336
2Т9117А	ЗАО «Кремний»	336
2Т9117Б	ЗАО «Кремний»	336
2Т9117В	ЗАО «Кремний»	336
2Т9117Г	ЗАО «Кремний»	336
2Т9118А	3-д «Пульсар»	336
2Т9118Б	3-д «Пульсар»	336
2Т9118В	3-д «Пульсар»	336
2Т9119А-2		338
2Т9121А	3-д «Пульсар»	338
2Т9121Б	3-д «Пульсар»	338
2Т9121В	3-д «Пульсар»	338
2Т9121Г	3-д «Пульсар»	338
2Т9122А	3-д «Пульсар»	338
2Т9122Б	3-д «Пульсар»	338
2Т9123А	АО «Элиз»	338
2Т9123Б	АО «Элиз»	338
2Т9124А	3-д «Пульсар»	338
2Т9124Б	3-д «Пульсар»	338
2Т9125АС	ВЗПП	338
2Т9126А	3-д «Пульсар»	340
2Т9127А	3-д «Пульсар»	340
2Т9127Б	3-д «Пульсар»	340
2Т9127В	3-д «Пульсар»	340
2Т9127Г	3-д «Пульсар»	340
2Т9127Д	3-д «Пульсар»	340
2Т9127Е	3-д «Пульсар»	340
2Т9127Ж	3-д «Пульсар»	340
2Т9127И	3-д «Пульсар»	340
2Т9127К	3-д «Пульсар»	340
2Т9128АС	ПО «НИИЭТ»	340
2Т9129А	3-д «Пульсар»	340
2Т9130А	ЗАО «Кремний»	340
2Т9131А	3-д «Пульсар»	340
2Т9132АС	ПО «НИИЭТ»	340
2Т9133А	3-д «Пульсар»	342
2Т9134А	3-д «Пульсар»	342
2Т9134Б	3-д «Пульсар»	342
2Т9135А-2	3-д «Пульсар»	342
2Т9137А	3-д «Пульсар»	342
2Т9137Б	3-д «Пульсар»	342
2Т9138А	АО «Элиз»	342
2Т9139А	3-д «Пульсар»	344
2Т9139Б	3-д «Пульсар»	344
2Т9139В	3-д «Пульсар»	344
2Т9139Г	3-д «Пульсар»	344
2Т9140А	3-д «Пульсар»	344
2Т914А	АО «Элекс»	344
2Т9143А	НПО «Планета»	344
2Т9146А	3-д «Пульсар»	344
2Т9146Б	3-д «Пульсар»	344
2Т9146В	3-д «Пульсар»	344
2Т9146Г	3-д «Пульсар»	344
2Т9146Д	3-д «Пульсар»	344
2Т9146Е	3-д «Пульсар»	344
2Т9146Ж	3-д «Пульсар»	344
2Т9146И	3-д «Пульсар»	344
2Т9146К	3-д «Пульсар»	344
2Т9147АС	ПО «НИИЭТ»	344
2Т9149А	3-д «Пульсар»	346
2Т9149Б	3-д «Пульсар»	346
2Т9153АС	ПО «НИИЭТ»	346
2Т9153БС	ПО «НИИЭТ»	346
2Т9155А	ПО «НИИЭТ»	346
2Т9155Б	ПО «НИИЭТ»	346
2Т9155В	ПО «НИИЭТ»	346
2Т9156АС	ПО «НИИЭТ»	346
2Т9156БС	ПО «НИИЭТ»	346
2Т9158А	НПП «Пульсар»	346
2Т9158Б	НПП «Пульсар»	346
2Т9159А	3-д «Пульсар»	346
2Т9159А5	3-д «Пульсар»	346
2Т916А	3-д «Транзистор»	348
2Т9161АС	ПО «НИИЭТ»	348
2Т9162А	3-д «Пульсар»	348
2Т9162Б	3-д «Пульсар»	348
2Т9162В	3-д «Пульсар»	348
2Т9162Г	3-д «Пульсар»	348
2Т9164А	3-д «Пульсар»	348
2Т9175А	ПО «НИИЭТ»	348
2Т9175Б	ПО «НИИЭТ»	348
2Т9175В	ПО «НИИЭТ»	348
2Т9175А-4	ПО «НИИЭТ»	350
2Т9175Б-4	ПО «НИИЭТ»	350
2Т9175В-4	ПО «НИИЭТ»	350
2Т9183А-5	АО «Элекс»	350
2Т9184А	3-д «Искра»	350
2Т9188А	ПО «НИИЭТ»	350
2Т9188А-4		350
2Т919А	3-д «Пульсар»	352
2Т919Б	3-д «Пульсар»	352
2Т919В	3-д «Пульсар»	352
2Т919А-2	3-д «Пульсар»	352
2Т919Б-2	3-д «Пульсар»	352
2Т919В-2	3-д «Пульсар»	352

Тип прибора	Изготовитель (см. стр. 31)	Стр.
2Т920А	ВЗПП	352
2Т920Б	ВЗПП	352
2Т920В	ВЗПП	352
2Т921А	3-д «Пульсар»	352
2Т921А-4	3-д «Пульсар»	352
2Т922А	ВЗПП	352
2Т922Б	ВЗПП	352
2Т922В	ВЗПП	352
2Т925А	ВЗПП	352
2Т925Б	ВЗПП	352
2Т925В	ВЗПП	352
2Т926А	АО «Элиз»	352
2Т928А	3-д «Транзистор»	354
2Т928Б	3-д «Транзистор»	354
2Т929А	ВЗПП	354
2Т930А	ВЗПП	354
2Т930Б	ВЗПП	354
2Т931А	ВЗПП	354
2Т932А	3-д НИИПП	354
2Т932Б	3-д НИИПП	354
2Т933А	3-д НИИПП	354
2Т933Б	3-д НИИПП	354
2Т934А	ВЗПП	354
2Т934Б	ВЗПП	354
2Т934В	ВЗПП	354
2Т935А	АО «Элиз»	354
2Т935А-5	АО «Элиз»	356
2Т937А-2	3-д «Пульсар»	356
2Т937Б-2	3-д «Пульсар»	356
2Т937А-5	3-д «Пульсар»	356
2Т938А-2	3-д «Транзистор»	356
2Т939А	3-д «Транзистор»	356
2Т939Б	3-д «Транзистор»	356
2Т939А1	3-д «Транзистор»	356
2Т941А	АО «Элекс»	356
2Т942А	3-д «Пульсар»	356
2Т942Б	3-д «Пульсар»	356
2Т942А-5	3-д «Пульсар»	356
2Т942Б-5	3-д «Пульсар»	356
2Т944А	3-д «Искра»	358
2Т945А	АО «Элиз»	358
2Т945Б	АО «Элиз»	358
2Т945В	АО «Элиз»	358
2Т945А-5	АО «Элиз»	358
2Т946А	22, 35	358
2Т947А	3-д «Искра»	358
2Т948А	3-д «Пульсар»	358
2Т948Б	3-д «Пульсар»	358
2Т949А	—	358
2Т950А	3-д «Пульсар»	358
2Т950Б	3-д «Пульсар»	358
2Т951А	3-д «Пульсар»	360
2Т951Б	3-д «Пульсар»	360
2Т951В	3-д «Пульсар»	360
2Т955А	АО «Элиз»	360
2Т956А	АО «Элиз»	360
2Т957А	АО «Элиз»	360
2Т958А	ВЗПП	360
2Т960А	ВЗПП	360
2Т962А	ВЗПП	360
2Т962Б	ВЗПП	360
2Т962В	ВЗПП	360
2Т963А-2	3-д «Пульсар»	360
2Т963Б-2	3-д «Пульсар»	360
2Т963А-5	3-д «Пульсар»	362
2Т964А	3-д «Пульсар»	362
2Т965А	ВЗПП	362
2Т966А	ВЗПП	362
2Т967А	АО «Элиз»	362
2Т968А	3-д «Искра»	362
2Т968А-5	3-д «Искра»	362
2Т970А	ВЗПП	362
2Т971А	ВЗПП	364
2Т974А	3-д «Пульсар»	364
2Т974Б	3-д «Пульсар»	364
2Т974В	3-д «Пульсар»	364
2Т974Г	3-д «Пульсар»	364
2Т975А	3-д «Пульсар»	364
2Т975Б	3-д «Пульсар»	364
2Т976А	ВЗПП	364
2Т977А	3-д «Пульсар»	364
2Т978А	3-д «Искра»	364
2Т978Б	3-д «Искра»	364
2Т979А	3-д «Пульсар»	364
2Т980А	3-д «Пульсар»	364
2Т980Б	3-д «Пульсар»	364
2Т981А	АО «Элиз»	366
2Т982А-2	3-д «Пульсар»	366
2Т982А-5	3-д «Пульсар»	366
2Т983А	ВЗПП	366
2Т983Б	ВЗПП	366
2Т983В	ВЗПП	366
2Т984А	ВЗПП	366
2Т984Б	ВЗПП	366
2Т985АС	ВЗПП	366
2Т986А	3-д «Пульсар»	366
2Т986Б	3-д «Пульсар»	366
2Т986В	3-д «Пульсар»	366
2Т986Г	3-д «Пульсар»	366
2Т987А	3-д «Пульсар»	366
2Т988А	3-д «Пульсар»	368
2Т988Б	3-д «Пульсар»	368
2Т989А	3-д «Пульсар»	368
2Т989Б	3-д «Пульсар»	368
2Т989В	3-д «Пульсар»	368
2Т989Г	3-д «Пульсар»	368
2Т990А-2	3-д «Пульсар»	368
2Т991АС	ВЗПП	368
2Т993А	АО «Элиз»	368
2Т994А-2	3-д «Пульсар»	368
2Т994Б-2	3-д «Пульсар»	368
2Т994В-2	3-д «Пульсар»	368
2Т995А-2	3-д «Пульсар»	370
2Т996А-5	3-д «Пульсар»	370
2Т996Б-5	3-д «Пульсар»	370
2Т998А		370

Кремниевые сборки специального назначения

Тип прибора	Изготовитель (см. стр. 31)	Стр.
2ТС303А-2	3-д ПО «Альфа»	372
2ТС3103А	3-д ПО «Альфа»	372
2ТС3103Б	3-д ПО «Альфа»	372
2ТС3111А-1	НИИМП	372
2ТС3111Б-1	НИИМП	372
2ТС3111В-1	НИИМП	372
2ТС3111Г-1	НИИМП	372
2ТС3111Д-1	НИИМП	372
2ТС3136А-1	3-д ПО «Альфа»	372
2Т3155АС-1	АО «Светлана»	372
2Т3155БС-1	АО «Светлана»	372
2ТС393А-1	3-д ПО «Альфа»	372
2ТС393Б-1	3-д ПО «Альфа»	372
2ТС393А-9	3-д ПО «Альфа»	372
2ТС393Б-9	3-д ПО «Альфа»	372
2ТС398А-1	АО «Светлана»	372
2ТС398Б-1	АО «Светлана»	372
2ТС398А-94	АО «Светлана»	374
2ТС398Б-94	АО «Светлана»	374
2ТС613А	3-д «Транзистор»	374
2ТС613Б	3-д «Транзистор»	374
2ТС622А	ВЗПП	374
2ТС622Б	ВЗПП	374
2ТС622Б-1	ВЗПП	374
2Т670АС	3-д «Транзистор»	374
2ТС687АС-2	3-д «Пульсар»	376
2ТС687БС-2	3-д «Пульсар»	376
2Т689АС	ВЗПП	376
2ТС843А	АО «Плутон»	376
2ТС941А-2	АО «Элекс»	376

Полевые транзисторы

Тип прибора	Изготовитель (см. стр. 31)	Стр.
АП320А-2	НПП «Пульсар»	392
АП320Б-2	НПП «Пульсар»	392
АП324А-2	НПП «Пульсар»	392
АП324Б-2	НПП «Пульсар»	392
АП324В-2	НПП «Пульсар»	392
АП324Б-5	НПП «Пульсар»	392
АП325А-2	НПО «Планета»	392
АП326А-2	НПО «Планета»	392
АП326Б-2	НПО «Планета»	392
АП328А-2	НПО «Планета»	394
АП330А-2	НПО «Планета»	394
АП330Б-2	НПО «Планета»	394
АП330В-2	НПО «Планета»	394
АП330В1-2	НПО «Планета»	394
АП330В2-2	НПО «Планета»	394
АП330В3-2	НПО «Планета»	394
АП331А-2	НПО «Планета»	394
АП331А-5	НПО «Планета»	394
АП339А-2	НПО «Планета»	394
АП343А-2	НПО «Планета»	394
АП343А1-2	НПО «Планета»	394
АП343А2-2	НПО «Планета»	394
АП343А3-2	НПО «Планета»	394
АП344А-2	НПО «Планета»	396
АП344А1-2	НПО «Планета»	396
АП344А2-2	НПО «Планета»	396
АП344А3-2	НПО «Планета»	396
АП344А4-2	НПО «Планета»	396
АП354А-5	НПО «Сатурн»	396
АП354Б-5	НПО «Сатурн»	396
АП354В-5	НПО «Сатурн»	396
АП355А-5	НПО «Сатурн»	396
АП355Б-5	НПО «Сатурн»	396
АП355В-5	НПО «Сатурн»	396
АП356А-5	НПО «Сатурн»	396
АП356Б-5	НПО «Сатурн»	396
АП356В-5	НПО «Сатурн»	396
АП357А-5	НПО «Сатурн»	396
АП357Б-5	НПО «Сатурн»	396
АП357В-5	НПО «Сатурн»	396
АП358А-5	НПО «Сатурн»	396
АП358Б-5	НПО «Сатурн»	396
АП358В-5	НПО «Сатурн»	396
АП362А-9	НПО «Планета»	396
АП362Б-9	НПО «Планета»	396
АП379А-9	НПО «Планета»	398
АП379Б-9	НПО «Планета»	398
АП381А-5	НПП «Пульсар»	398
АП602А-2	НПП «Пульсар»	398
АП602Б-2	НПП «Пульсар»	398
АП602В-2	НПП «Пульсар»	398
АП602Г-2	НПП «Пульсар»	398
АП602Д-2	НПП «Пульсар»	398
АП603А-2	З-д «Пульсар»	398
АП603Б-2	З-д «Пульсар»	398
АП603А-1-2	З-д «Пульсар»	398
АП603Б-1-2	З-д «Пульсар»	398
АП603А-5	З-д «Пульсар»	398
АП603Б-5	З-д «Пульсар»	398
АП604А-2	З-д «Пульсар»	398
АП604Б-2	З-д «Пульсар»	398
АП604В-2	З-д «Пульсар»	398
АП604Г-2	З-д «Пульсар»	398
АП604А1-2	НПО «Планета»	400
АП604Б1-2	З-д «Пульсар»	400
АП604В1-2	З-д «Пульсар»	400
АП604Г1-2	З-д «Пульсар»	400
АП605А-2	З-д «Пульсар»	400
АП605А1-2	НПО «Планета»	400
АП605А2-2	НПО «Планета»	400
АП606А-2	З-д «Пульсар»	400
АП606Б-2	З-д «Пульсар»	400
АП606В-2	З-д «Пульсар»	400
АП606А-5	З-д «Пульсар»	400
АП606Б-5	З-д «Пульсар»	400
АП606В-5	З-д «Пульсар»	400
АП607А-2	З-д «Пульсар»	400
АП608А-2	З-д «Пульсар»	402
АП608Б-2	З-д «Пульсар»	402
АП608В-2	З-д «Пульсар»	402
АП608А-5	З-д «Пульсар»	402
АП608Д-5	З-д «Пульсар»	402
АП608Е-5	З-д «Пульсар»	402
АП915А-2	З-д «Пульсар»	402
АП915Б-2	З-д «Пульсар»	402
АП925А-2	З-д «Пульсар»	402
АП925Б-2	З-д «Пульсар»	402
АП925В-2	З-д «Пульсар»	402
АП930А-2	З-д «Пульсар»	402
АП930Б-2	З-д «Пульсар»	402
АП930В-2	З-д «Пульсар»	402
АП967А-2	З-д «Пульсар»	402
АП967Б-2	З-д «Пульсар»	402
АП967В-2	З-д «Пульсар»	402
АП967Г-2	З-д «Пульсар»	402
АП967Д-2	З-д «Пульсар»	402
АП967Е-2	З-д «Пульсар»	402
АП967Ж-2	З-д «Пульсар»	402
КЕ702А	НПП «Пульсар»	404
КЕ702Б	НПП «Пульсар»	404
КЕ702В	НПП «Пульсар»	404
КЕ707А	ОАО «Ангстрем»	404
КЕ707Б	ОАО «Ангстрем»	404
КЕ707А2	ОАО «Ангстрем»	404
КЕ707Б2	ОАО «Ангстрем»	404
КП101Г	Тонди электроника	404
КП101Д	Тонди электроника	404
КП101Е	Тонди электроника	404
КП103Е	18, 33	404
КП103Ж	18, 33	404
КП103И	18, 33	404
КП103К	18, 33	404
КП103Л	18, 33	404
КП103М	18, 33	404
КП103ЕР1	ППО «Октябрь»	404
КП103ЖР1	ППО «Октябрь»	404
КП103ИР1	ППО «Октябрь»	404
КП103КР1	ППО «Октябрь»	404
КП103ЛР1	ППО «Октябрь»	404
КП103МР1	ППО «Октябрь»	404
КП103Е9	18, 33	404
КП103Ж9	18, 33	404
КП103И9	18, 33	404
КП103К9	18, 33	404
КП103Л9	18, 33	404
КП103М9	18, 33	404
КП150	7, 36	406
КП201Е-1	АО «Восход»	406
КП201Ж-1	АО «Восход»	406
КП201И-1	АО «Восход»	406
КП201К-1	АО «Восход»	406
КП201Л-1	АО «Восход»	406
КП202Д-1	АО «Восход»	406
КП202Е-1	АО «Восход»	406
КП214А-9	З-д «Транзистор»	406
КП240	7, 36	406
КП250	7, 36	406
КП301Б	ППО «Октябрь»	406
КП301В	ППО «Октябрь»	406
КП301Г	ППО «Октябрь»	406
КП302А	ППО «Октябрь»	406
КП302Б	ППО «Октябрь»	406
КП302В	ППО «Октябрь»	406
КП302Г	ППО «Октябрь»	406
КП302АМ	ППО «Октябрь»	408
КП302БМ	ППО «Октябрь»	408
КП302ВМ	ППО «Октябрь»	408
КП302ГМ	ППО «Октябрь»	408
КП303А	31, 33	408
КП303Б	31, 33	408
КП303В	31, 33	408
КП303Г	31, 33	408
КП303Д	31, 33	408
КП303Е	31, 33	408
КП303Ж	31, 33	408
КП303И	31, 33	408
КП303А9	31, 33	408
КП303Б9	31, 33	408
КП303В9	31, 33	408
КП303Г9	31, 33	408
КП303Д9	31, 33	408
КП303Е9	31, 33	408
КП303Ж9	31, 33	408
КП303И9	31, 33	408
КП304А	АО «Светлана»	408
КП305Д	24, 25	408
КП305Е	24, 25	408
КП305Ж	24, 25	408
КП305И	24, 25	408
КП306А	5, 18	408
КП306Б	5, 18	408

Полевые транзисторы специального назначения

Тип прибора	Изготовитель (см. стр. 31)	Стр.
3П320А-2	3-д «Пульсар»	472
3П320Б-2	3-д «Пульсар»	472
3П321А-2	3-д «Пульсар»	472
3П324А-2	3-д «Пульсар»	472
3П324Б-2	3-д «Пульсар»	472
3П324В-2	3-д «Пульсар»	472
3П325А-2	НПО «Планета»	472
3П325А-5	НПО «Планета»	474
3П326А-2	НПО «Планета»	474
3П326Б-2	НПО «Планета»	474
3П326А-5	НПО «Планета»	474
3П328А-2	НПО «Планета»	474
3П328А-5	НПО «Планета»	474
3П330А-5	НПО «Планета»	474
3П330А-2	НПО «Планета»	474
3П330Б-2	НПО «Планета»	474
3П330В-2	НПО «Планета»	474
3П330В1-2	НПО «Планета»	476
3П330В2-2	НПО «Планета»	476
3П330В3-2	НПО «Планета»	476
3П331А-2	НПО «Планета»	476
3П331А-5	НПО «Планета»	476
3П339А-2	НПО «Планета»	476
3П343А-2	НПО «Планета»	476
3П343А1-2	НПО «Планета»	476
3П343А2-2	НПО «Планета»	476
3П343А3-2	НПО «Планета»	476
3П344А-2	НПО «Планета»	476
3П344А1-2	НПО «Планета»	476
3П344А2-2	НПО «Планета»	476
3П344А3-2	НПО «Планета»	476
3П344А4-2	НПО «Планета»	476
3П345А-2	НПП «Пульсар»	478
3П345Б-2	НПП «Пульсар»	478
3П345А-5	НПП «Пульсар»	478
3П348А-2	НПО «Планета»	478
3П351А-2	НПО «Планета»	478
3П351А-5	НПО «Планета»	478
3П351А1-2	НПО «Планета»	478
3П353А-5	НПО «Планета»	480
3П372А-2	НПП «Пульсар»	480
3П373А-2	НПО «Планета»	480
3П373Б-2	НПО «Планета»	480
3П373В-2	НПО «Планета»	480
3П376А-5	НПО «Салют»	480
3П384А-5	НПП «Пульсар»	480
3П385А-2	НПО «Планета»	480
3П385Б-2	НПО «Планета»	480

Тип прибора	Изготовитель (см. стр. 31)	Стр.
3П385В-2	НПО «Планета»	480
3П385А-5	НПО «Планета»	480
3П385Б-5	НПО «Планета»	480
3П385В-5	НПО «Планета»	480
3П602А-2	3-д «Пульсар»	480
3П602Б-2	3-д «Пульсар»	480
3П602В-2	3-д «Пульсар»	480
3П602Г-2	3-д «Пульсар»	480
3П602Д-2	3-д «Пульсар»	480
3П602Б-5	3-д «Пульсар»	482
3П602Д-5	3-д «Пульсар»	482
3П603А-2	3-д «Пульсар»	482
3П603Б-2	3-д «Пульсар»	482
3П603А1-2	3-д «Пульсар»	482
3П603Б1-2	3-д «Пульсар»	482
3П603Б-5	3-д «Пульсар»	482
3П604А-2	3-д «Пульсар»	482
3П604Б-2	3-д «Пульсар»	482
3П604В-2	3-д «Пульсар»	482
3П604Г-2	3-д «Пульсар»	482
3П604А1-2	3-д «Пульсар»	482
3П604Б1-2	3-д «Пульсар»	482
3П604В1-2	3-д «Пульсар»	482
3П604Г1-2	3-д «Пульсар»	482
3П604А-5	3-д «Пульсар»	482
3П604Б-5	3-д «Пульсар»	482
3П604В-5	3-д «Пульсар»	482
3П604Г-5	3-д «Пульсар»	482
3П605А-2	НПО «Планета»	484
3П605А-5	НПО «Планета»	484
3П606А-2	3-д «Пульсар»	484
3П606Б-2	3-д «Пульсар»	484
3П606В-2	3-д «Пульсар»	484
3П606Б-5	3-д «Пульсар»	484
3П606В-5	3-д «Пульсар»	484
3П607А-2	3-д «Пульсар»	484
3П608А-2	3-д «Пульсар»	484
3П608Б-2	3-д «Пульсар»	484
3П608В-2	3-д «Пульсар»	484
3П608Г-2	3-д «Пульсар»	484
3П608А-5	3-д «Пульсар»	484
3П608Д-5	3-д «Пульсар»	484
3П608Е-5	3-д «Пульсар»	484
3П910А-2	3-д «Пульсар»	486
3П910Б-2	3-д «Пульсар»	486
3П910А-5	3-д «Пульсар»	486
3П910Б-5	3-д «Пульсар»	486
3П915А-2	3-д «Пульсар»	486

Тип прибора	Изготовитель (см. стр. 31)	Стр.
3П915Б-2	3-д «Пульсар»	486
3П925А-2	НПП «Пульсар»	486
3П925Б-2	НПП «Пульсар»	486
3П925В-2	НПП «Пульсар»	486
3П925А-5	НПП «Пульсар»	486
3П927А-2	3-д «Пульсар»	486
3П927Б-2	3-д «Пульсар»	486
3П927В-2	3-д «Пульсар»	486
3П927Г-2	3-д «Пульсар»	486
3П927Д-2	3-д «Пульсар»	486
3П929А-2	3-д «Пульсар»	486
3П930А-2	3-д «Пульсар»	488
3П930Б-2	3-д «Пульсар»	488
3П930В-2	3-д «Пульсар»	488
2Е701А	НПП «Пульсар»	488
2Е701Б	НПП «Пульсар»	488
2Е701В	НПП «Пульсар»	488
2Е701Г	НПП «Пульсар»	488
2П101А	Тонди электроника	488
2П101Б	Тонди электроника	488
2П101В	Тонди электроника	488
2П103А	18, 33	488
2П103Б	18, 33	488
2П103В	18, 33	488
2П103Г	18, 33	488
2П103Д	18, 33	488
2П103АР	18, 33	488
2П103БР	18, 33	488
2П103ВР	18, 33	488
2П103ГР	18, 33	488
2П103ДР	18, 33	488
2П201А-1	АО «Восход»	488
2П201Б-1	АО «Восход»	488
2П201В-1	АО «Восход»	488
2П201Г-1	АО «Восход»	488
2П201Д-1	АО «Восход»	488
2П201Е-1	АО «Восход»	488
2П201Ж-1	АО «Восход»	488
2П202Д-1	АО «Восход»	490
2П202Е-1	АО «Восход»	490
2П301А	ППО «Октябрь»	490
2П301Б	ППО «Октябрь»	490
2П301В	ППО «Октябрь»	490
2П301А-1	ППО «Октябрь»	490
2П301Б-1	ППО «Октябрь»	490
2П301В-1	ППО «Октябрь»	490
2П301А-5	ППО «Октябрь»	490
2П302А	ППО «Октябрь»	490

Тип прибора	Изготовитель (см. стр. 31)	Стр.
2П302Б	ППО «Октябрь»	490
2П302В	ППО «Октябрь»	490
2П302А-1	ППО «Октябрь»	490
2П302Б-1	ППО «Октябрь»	490
2П302В-1	ППО «Октябрь»	490
2П303А	31, 33	490
2П303Б	31, 33	490
2П303В	31, 33	490
2П303Г	31, 33	490
2П303Д	31, 33	490
2П303Е	31, 33	490
2П303И	31, 33	490
2П304А	АО «Светлана»	492
2П305А	САРЗПУЛ	492
2П305Б	САРЗПУЛ	492
2П305В	САРЗПУЛ	492
2П305Г	САРЗПУЛ	492
2П305А-2	САРЗПУЛ	492
2П305Б-2	САРЗПУЛ	492
2П305В-2	САРЗПУЛ	492
2П305Г-2	САРЗПУЛ	492
2П306А	НПП «Восток»	492
2П306Б	НПП «Восток»	492
2П306В	НПП «Восток»	492
2П306Г	НПП «Восток»	492
2П306Д	НПП «Восток»	492
2П306Е	НПП «Восток»	492
2П307А	3-д ПО «Фотон»	492
2П307Б	3-д ПО «Фотон»	492
2П307В	3-д ПО «Фотон»	492
2П307Г	3-д ПО «Фотон»	492
2П307Д	3-д ПО «Фотон»	492
2П308А	31, 33	492
2П308Б	31, 33	492
2П308В	31, 33	492
2П308Г	31, 33	492
2П308Д	31, 33	492
2П308А-1	31, 33	492
2П308Б-1	31, 33	492
2П308В-1	31, 33	492
2П308Г-1	31, 33	492
2П308Д-1	31, 33	492
2П308А-9	31, 33	494
2П308Б-9	31, 33	494
2П308В-9	31, 33	494
2П308Г-9	31, 33	494
2П308Д-9	31, 33	494
2П308Е-9	31, 33	494
2П310А	НПП «Восток»	494
2П310Б	НПП «Восток»	494

Тип прибора	Изготовитель (см. стр. 31)	Стр.
2П312А	3-д «Пульсар»	494
2П312Б	3-д «Пульсар»	494
2П312А-5	3-д «Пульсар»	494
2П312Б-5	3-д «Пульсар»	494
2П313А	НПП «Восток»	494
2П313Б	НПП «Восток»	494
2П313В	НПП «Восток»	494
2П322А	3-д ПО «Фотон»	494
2П333А	3-д ПО «Фотон»	494
2П333Б	3-д ПО «Фотон»	494
2П333В	3-д ПО «Фотон»	494
2П333Г	3-д ПО «Фотон»	494
2П334А	3-д ПО «Фотон»	494
2П334Б	3-д ПО «Фотон»	494
2П335А-2	3-д ПО «Фотон»	496
2П335Б-2	3-д ПО «Фотон»	496
2П336А-1	3-д ПО «Фотон»	496
2П336Б-1	3-д ПО «Фотон»	496
2П337АР	3-д ПО «Фотон»	496
2П337БР	3-д ПО «Фотон»	496
2П338АР-1	3-д ПО «Фотон»	496
2П340А-1	ВЗПП	496
2П340Б-1	ВЗПП	496
2П341А	3-д «Пульсар»	496
2П341Б	3-д «Пульсар»	496
2П347А-2	3-д «Пульсар»	496
2П350А	ППО «Октябрь»	496
2П350Б	ППО «Октябрь»	496
2П601А	3-д ПО «Фотон»	498
2П601Б	3-д ПО «Фотон»	498
2П601А9	3-д ПО «Фотон»	498
2П609А	3-д ПО «Фотон»	498
2П609Б	3-д ПО «Фотон»	498
2П609А-5	3-д ПО «Фотон»	498
2П609Б-5	3-д ПО «Фотон»	498
2П701А	3-д «Пульсар»	498
2П701Б	3-д «Пульсар»	498
2П702А	3-д «Пульсар»	498
2П703А	НПП «Пульсар»	498
2П703Б	НПП «Пульсар»	498
2П706А	3-д «Пульсар»	500
2П706Б	3-д «Пульсар»	500
2П706В	3-д «Пульсар»	500
2П7102А	3-д «Транзистор»	500
2П7118А	3-д «Пульсар»	500
2П7118Б	3-д «Пульсар»	500
2П7118В	3-д «Пульсар»	500
2П7118Г	3-д «Пульсар»	500
2П7118Д	3-д «Пульсар»	500
2П7118Е	3-д «Пульсар»	500

Тип прибора	Изготовитель (см. стр. 31)	Стр.
2П7118Ж	3-д «Пульсар»	500
2П7118И	3-д «Пульсар»	500
2П7118К	3-д «Пульсар»	500
2П7118Л	3-д «Пульсар»	500
2П712А	НПП «Пульсар»	500
2П712Б	НПП «Пульсар»	500
2П712В	НПП «Пульсар»	500
2П712А-5	НПП «Пульсар»	500
2П712Б-5	НПП «Пульсар»	500
2П712В-5	НПП «Пульсар»	500
2П7140А	3-д «Транзистор»	502
2П7141А	3-д «Транзистор»	502
2П7142А	3-д «Транзистор»	502
2П7143А	3-д «Транзистор»	502
2П7144А	3-д «Транзистор»	502
2П7145А	—	502
2П762А	НПП «Пульсар»	502
2П762В	НПП «Пульсар»	502
2П762Д	НПП «Пульсар»	502
2П762Ж	НПП «Пульсар»	502
2П762К	НПП «Пульсар»	502
2П762Л	НПП «Пульсар»	502
2П762М	НПП «Пульсар»	502
2П762Н	НПП «Пульсар»	502
2П762И2	НПП «Пульсар»	504
2П762Б1	НПП «Пульсар»	504
2П762Г1	НПП «Пульсар»	504
2П762Е1	НПП «Пульсар»	504
2П762Г1-5	НПП «Пульсар»	504
2П762Е1-5	НПП «Пульсар»	504
2П762И2-5	НПП «Пульсар»	504
2П771А	3-д «Транзистор»	504
2П771А91	3-д «Транзистор»	504
2П797Г	3-д «Транзистор»	504
2П797Г91	3-д «Транзистор»	504
2П802А	НПП «Восток»	504
2П803А	3-д «Пульсар»	506
2П803Б	3-д «Пульсар»	506
2П815А	3-д «Пульсар»	506
2П815Б	3-д «Пульсар»	506
2П815В	3-д «Пульсар»	506
2П815Г	3-д «Пульсар»	506
2П816А	3-д «Пульсар»	506
2П816Б	3-д «Пульсар»	506
2П816В	3-д «Пульсар»	506
2П816Г	3-д «Пульсар»	506
2П901А	3-д «Пульсар»	506
2П901Б	3-д «Пульсар»	506
2П901А-5	3-д «Пульсар»	506
2П901Б-5	3-д «Пульсар»	506

Тип прибора	Изготовитель (см. стр. 31)	Стр.
2П902А	3-д «Пульсар»	506
2П902Б	3-д «Пульсар»	506
2П903А	3-д «Пульсар»	506
2П903Б	3-д «Пульсар»	506
2П903В	3-д «Пульсар»	506
2П903А-5	3-д «Пульсар»	508
2П903Б-5	3-д «Пульсар»	508
2П903В-5	3-д «Пульсар»	508
2П904А	3-д «Пульсар»	508
2П904Б	3-д «Пульсар»	508
2П905А	НПП «Пульсар»	508
2П905Б	НПП «Пульсар»	508
2П905А-5	НПП «Пульсар»	508
2П907А	НПП «Пульсар»	508
2П907Б	НПП «Пульсар»	508
2П908А	3-д «Пульсар»	508
2П908Б	3-д «Пульсар»	508
2П909А	3-д «Пульсар»	508
2П909Б	3-д «Пульсар»	508
2П909В	3-д «Пульсар»	508
2П909Г	3-д «Пульсар»	508
2П911А	3-д «Пульсар»	508
2П911Б	3-д «Пульсар»	508
2П912А	3-д «Гравитон»	508
2П912Б	3-д «Гравитон»	508
2П913А	3-д «Пульсар»	510
2П913Б	3-д «Пульсар»	510
2П914А	3-д ПО «Фотон»	510
2П917А	—	510
2П917Б	—	510
2П918А	НПП «Пульсар»	510
2П918Б	НПП «Пульсар»	510
2П920А	3-д «Пульсар»	510
2П920Б	3-д «Пульсар»	510
2П922А	3-д «Гравитон»	510
2П922Б	3-д «Гравитон»	510
2П922А-5	3-д «Гравитон»	510
2П922Б-5	3-д «Гравитон»	510
2П923А	3-д «Пульсар»	512
2П923Б	3-д «Пульсар»	512
2П923В	3-д «Пульсар»	512
2П923Г	3-д «Пульсар»	512
2П926А	НПП «Восток»	512
2П926Б	НПП «Восток»	512
2П928А	НПП «Пульсар»	512
2П928Б	НПП «Пульсар»	512
2П933А	НПП «Пульсар»	512
2П933Б	НПП «Пульсар»	512
2П934А	НПО «Октава»	512
2П934Б	НПО «Октава»	512
2П938А	НПП «Восток»	512
2П938Б	НПП «Восток»	512
2П938В	НПП «Восток»	512
2П938Г	НПП «Восток»	512
2П938Д	НПП «Восток»	512
2П941А	НПП «Пульсар»	514
2П941Б	НПП «Пульсар»	514
2П941В	НПП «Пульсар»	514
2П941Г	НПП «Пульсар»	514
2П941Д	НПП «Пульсар»	514
2П942А	—	514
2П942Б	—	514
2П942В	—	514
2П942А-5	—	514
2П942Б-5	—	514
2П942В-5	—	514
2ПС104А	АО «Восход»	514
2ПС104Б	АО «Восход»	514
2ПС104В	АО «Восход»	514
2ПС104Г	АО «Восход»	514
2ПС104Д	АО «Восход»	514
2ПС104Е	АО «Восход»	514
2ПС202А-2	АО «Восход»	516
2ПС202Б-2	АО «Восход»	516
2ПС202В-2	АО «Восход»	516
2ПС202Г-2	АО «Восход»	516
2ПС202Д-1	АО «Восход»	516
2ПС202Е-1	АО «Восход»	516
2ПС316А-1	3-д ПО «Фотон»	516
2ПС316Б-1	3-д ПО «Фотон»	516
2ПС316В-1	3-д ПО «Фотон»	516
2ПС316Г-1	3-д ПО «Фотон»	516

Адреса предприятий-изготовителей

№	Название предприятия	Почтовый адрес
1	З-д «Алиот»	396072, г. Нововоронеж, Воронежской обл., ул. Первомайская, д. 2
2	З-д ПО «Альфа»	LV1006, Рижск. з-д ППП АО «Альфа». г. Рига, ул. Ропажу, 140
3	ОАО «Ангстрем»	124460, г. Москва, Зеленоград
4	З-д «Арсенал»	143090, г. Краснознаменск, Московской обл., а/я 226
5	НПП «Восток»	630075, г. Новосибирск. ул. Дуси Ковальчук, д. 276
6	АО «Восход»	248014, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д 60-а
7	ВЗПП	394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 118-а
8	З-д «Гравитон»	274031, Украина, г. Черновцы, ул. Русская, д. 248
9	ПО «Знамя»	314002, Украина, г. Полтава, ул. Автобазовская, д. 2/9
10	З-д «Искра»	432030, г. Ульяновск, ул, Репина, д. 2
11	З-д «Квазар»	254136, Украина, г. Киев, ул. Северо-Сырецкая, д. 1
12	ЗАО «Кремний»	241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103
13	СКБ «Элькор»	360603, Республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик. Государственное СКБ «Элькор»
14	НРП «Октава»	630049, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 220
15	З-д НИИПП	634034, г. Томск, Красноармейская ул., д. 99-а
16	НИИМП	103460, г. Москва, г. Зеленоград
17	АО «Орбита»	430904, г. Саранск, п/о Ялга
18	ППО «Октябрь»	287100, Украина. г. Винница, ул. Ватутина, д. 18
19	НПО «Планета»	173004, г. Великий Новгород, Федоровский ручей, д. 2/13
20	АО «Плутон»	107120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1
21	НПП «Пульсар»	105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27
22	З-д «Пульсар»	105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27
23	ПРЗПП	361005, Республика Кабардино-Балкария, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 104
24	ПО «Рефлектор»	410033, г. Саратов, проспект 50-летия Октября, д. 101
25	САРЗПУЛ	410033, г. Саратов, проспект 50-летия Октября, д. 101
26	АО «Светлана»	194156, г. С-Петербург, проспект Энгельса, д. 27
27	З-д «Старт»	107066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7
28	З-д «Транзистор»	220108, Республика Беларусь. Минск, ул. Корженевского, 16
29	«Тонди электроника»	EE107, Эстония, г. Таллин, Пярнусское шоссе., д. 142
30	УлРЛЗД	432028, г. Ульяновск, Октябрьская, д. 28-а
31	З-д. ПО «Фотон»	700047, Узбекистан. г. Ташкент, ул. Пролетарская. д. 13
32	З-д «Экситон»	142500, г. Павловский Посад Московской области. ул. Интернациональная, д. 34-а
33	АО «Элекс»	601600, г. Александров. Владимирской обл. ул. Институтская, д. 3
34	АО «Электронприбор»	141120, г, Фрязино Московской обл, Заводской проезд, д. 2
35	АО «Элиз»	141120, г. Фрязино Московской обл, Заводской проезд, д. 2
36	ПО «НИИЭТ»	394042, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119-а
37	З-д «Юпитер»	396750, г. Богучар Воронежской обл., ул. Здоровья, д. 11
38	НПО «Сатурн»	Украина, 252680, г. Киев, ул. 50 лет Октября, 2-6
39	АО «Эльдаг»	367009, г. Махачкала, ул. Авиационная. 7
40	З-д «Микрон»	103460, г. Москва, Зеленоград 1, Западный проезд, 12

Перечень стандартизованных корпусов отечественного производства

Перечень корпусов зарубежных транзисторов

3 зак 9

Раздел 1
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1.1. Система условных обозначений

Система условных обозначений (маркировка) отечественных полупроводниковых приборов широкого и специального применения основывается на буквенно-цифровом коде.

Элементы буквенно-цифрового кода отражают следующую информацию: тип исходного материала, из которого изготовлен прибор, подкласс прибора, функциональное назначение и конструктивно-технологические особенности.

Первый элемент	Буква или цифра, обозначает исходный полупроводниковый материал, на основе которого изготовлен полупроводниковый прибор
Второй элемент	Буква, определяет подкласс полупроводникового прибора
Третий элемент	Цифра, определяет основные функциональные возможности (допустимое значение рассеиваемой мощности, граничную и максимальную рабочую частоту)
Четвертый, пятый и шестой элементы	Цифры и буквы, обозначают порядковый номер разработки технологического типа
Седьмой элемент	Буква, определяет классификацию приборов по параметрам

Первый элемент обозначения. Буква или цифра (для специального применения), обозначает исходный полупроводниковый материал, на основе которого изготовлен полупроводниковый прибор.

Условное обозначение	Исходный материал
Г или 1	Германий или его соединения
К или 2	Кремний или его соединения
А или 3	Соединения галлия (например, арсенид галлия)
И или 4	Соединения индия (например, фосфид индия)

Второй элемент обозначения. Буква, определяет подкласс полупроводникового прибора.

Условное обозначение	Подкласс (или группа) приборов
Т	Транзисторы (за исключением полевых)
П	Транзисторы полевые

Третий элемент обозначения.

Условное обозначение	Назначение прибора
	Транзисторы биполярные
	Транзисторы малой мощности (с мощностью рассеяния $P_К = 0{,}3$ Вт):
1	низкой частоты ($f_{гр} < 3$ МГц)
2	средней частоты ($f_{гр} = 3...30$ МГц)

Условное обозначение	Назначение прибора
3	высокой частоты ($f_{гр}$ > 30 МГц)
	Транзисторы средней мощности ($P_к$ = 0,3...1,5 Вт):
4	низкой частоты
5	средней частоты
6	высокой и сверхвысокой частот
	Транзисторы большой мошности ($P_к$ > 1,5 Вт):
7	низкой частоты
8	средней частоты
9	высокой и свервысокой частот
	Транзисторы полевые
	Транзисторы малой мощности ($P_с$ < 0,3 Вт):
1	низкой частоты
2	средней частоты
3	высокой и сверхвысокой частот
	Транзисторы средней мощности ($P_с$ = 0,3...1,5 Вт):
4	низкой частоты
5	средней частоты
6	высокой и сверхвысокой частот
	Транзисторы большой мощности ($P_с$ > 1,5 Вт):
7	низкой частоты
8	средней частоты
9	высокой и сверхвысокой частот

Четвертый, пятый и шестой элементы обозначения. Цифры и буквы, которые обозначают порядковый номер разработки технологического типа.

Условное обозначение	Назначение прибора
От 01 до 999	Определяет порядковый номер разработки технологического типа

Седьмой элемент обозначения. Буква, которая определяет классификацию приборов по параметрам.

Условное обозначение	Назначение прибора
От А до Я (кроме букв З, О, Ч)	Определяет классификацию (разбраковку) по параметрам приборов, изготовленных по единой технологии

1.2. Условные графические обозначения транзисторов

Ниже приводятся графические обозначения транзисторов.

Условное графическое обозначение	Наименование
	Транзистор типа p-n-p
	Транзистор типа n-p-n
	Лавинный транзистор типа n-p-n
	Однопереходной транзистор с n-базой
	Однопереходный транзистор с p-базой
Э Э К Б	Транзистор двухэмиттерный типа p-n-p
З И С	Полевой транзистор с каналом n-типа
З И С	Полевой транзистор с каналом p-типа
З И П С	Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного типа с n-каналом

Окончание графических обозначений транзисторов

	Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного типа с р-каналом
	Полевой транзистор с изолированным затвором обедненного типа с п-каналом
	Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного типа с п-каналом и с внутренним соединением подложки и истока
	Полевой транзистор с изолированным затвором обедненного типа с р-каналом
	Полевой транзистор с двумя изолированными затворами обедненного типа с п-каналом и с выводом от подложки
	Условные графические обозначения БТИЗ (IGBT-транзисторов)

Раздел 2
БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

2.1. Буквенные обозначения параметров биполярных транзисторов

Буквенное обозначение		Параметр
отечественное	международное	
$I_{КБО}$	I_{CBO}	Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера.
$I_{ЭБО}$	I_{EBO}	Обратный ток эмиттера — ток через эмиттерный переход при заданном обратном напряжении эмиттер-база и разомкнутом выводе коллектора.
$I_{КЭО}$	I_{CEO}	Обратный ток коллектор-эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор-эмиттер и разомкнутом выводе базы.
$I_{КЭR}$	I_{CER}	Обратный ток коллектор-эмиттер при заданных обратном напряжении коллектор-эмиттер и сопротивлении в цепи база-эмиттер.
$I_{КЭК}$	I_{CES}	Обратный ток коллектор-эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор-эмиттер и короткозамкнутых выводах базы и эмиттера.
$I_{КЭV}$	I_{CEV}	Обратный ток коллектор-эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор-эмиттер и запирающем напряжении (смещении) в цепи база-эмиттер.
$I_{КЭХ}$	I_{CEX}	Обратный ток коллектор-эмиттер при заданных обратном напряжении коллектор-эмиттер и обратном напряжении база-эмиттер.
$I_{К\ max}$	$I_{C\ max}$	Максимально допустимый постоянный ток коллектора.
$I_{Э\ max}$	$I_{E\ max}$	Максимально допустимый постоянный ток эмиттера.
$I_{Б\ max}$	$I_{B\ max}$	Максимально допустимый постоянный ток базы.
$I_{К,\ и\ max}$	$I_{CM\ max}$	Максимально допустимый импульсный ток коллектора.
$I_{Э,\ и\ max}$	$I_{EM\ max}$	Максимально допустимый импульсный ток эмиттера.
$I_{КР}$	—	Критический ток биполярного транзистора.
$U_{КБО\ проб}$	$U_{(BR)\ CBO}$	Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера.
$U_{ЭБО\ проб}$	$U_{(BR)\ EBO}$	Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора.
$U_{КЭО\ проб}$	$U_{(BR)\ CEO}$	Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и разомкнутой цепи базы.
$U_{КЭR\ проб}$	$U_{(BR)\ CER}$	Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и заданном (конечном) сопротивлении в цепи база-эмиттер.
$U_{КЭК\ проб}$	$U_{(BR)\ CES}$	Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и короткозамкнутых выводах базы и эмиттера.
$U_{КЭV\ проб}$	$U_{(BR)\ CEV}$	Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при запирающем напряжении в цепи база-эмиттер.

Продолжение буквенных обозначений

Буквенное обозначение: отечественное	Буквенное обозначение: международное	Параметр
$U_{КЭХ\ проб}$	$U_{(BR)\ CEX}$	Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при заданных обратном напряжении база-эмиттер и токе коллектор-эмиттер.
$U_{КЭО\ гр}$	$U_{(L)\ CEO}$	Граничное напряжение транзистора — напряжение между коллектором и эмиттером при разомкнутой цепи базы и заданном токе эмиттера.
$U_{смк}$	U_{pt}	Напряжение смыкания транзистора.
$U_{КЭ\ нас}$	$U_{CE\ sat}$	Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при заданных токах базы и коллектора.
$U_{БЭ\ нас}$	$U_{BE\ sat}$	Напряжение насыщения база-эмиттер при заданных токах базы и эмиттера.
$U_{ЭБ\ пл}$	U_{EBfl}	Плавающее напряжение эмиттер-база — напряжение между эмиттером и базой при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутой цепи эмиттера.
$U_{КБ\ max}$	$U_{CB\ max}$	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база.
$U_{КЭmax}$	$U_{CE\ max}$	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер.
$U_{ЭБ\ max}$	$U_{EB\ max}$	Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база.
$U_{КЭ,\ и\ max}$	$U_{CEM\ max}$	Максимальное допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер.
$U_{КБ,\ и\ max}$	$U_{CBM\ max}$	Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база.
$U_{ЭБ,\ и\ max}$	$U_{EBM\ max}$	Максимально допустимое импульсное напряжение эмиттер-база.
P	P_{tot}	Постоянная рассеиваемая мощность транзистора.
$P_{ср}$	P_{AV}	Средняя рассеиваемая мощность транзистора.
$P_{и}$	P_{M}	Импульсная рассеиваемая мощность транзистора.
$P_{К}$	P_{C}	Постоянная рассеиваемая мощность коллектора.
$P_{К,\ т\ max}$	—	Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом.
$P_{вых}$	P_{out}	Выходная мощность транзистора.
$P_{и\ max}$	$P_{M\ max}$	Максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность.
$P_{К\ max}$	$P_{C\ max}$	Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора.
$P_{К\ ср\ max}$	—	Максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность коллектора.
$r_{б}$	r_{bb}, r_{b}	Сопротивление базы.
$r_{КЭ\ нас}$	$r_{CE,\ sat}$	Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером.
$c_{11э}$, $c_{11б}$	c_{11e}, c_{11b}	Входная емкость транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
$c_{22э}$, $c_{22б}$	c_{22e}, c_{22b}	Выходная емкость транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
$c_{к}$	c_{c}	Емкость коллекторного перехода.
$c_{э}$	c_{e}	Емкость эмиттерного перехода.
$f_{гр}$	f_{T}	Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером.
f_{max}	f_{max}	Максимальная частота генерации.
$f_{h21э}$, $f_{h21б}$	f_{h21e}, f_{hfe}; f_{h21b}, f_{hfb}	Предельная частота коэффициента передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой.
$t_{вкл}$	t_{on}	Время включения.
$t_{выкл}$	t_{off}	Время выключения.
$t_{зд}$	t_{d}	Время задержки.
$t_{нр}$	t_{r}	Время нарастания.
$t_{рас}$	t_{s}	Время рассасывания.
$t_{сп}$	t_{f}	Время спада.

Окончание буквенных обозначений

Буквенное обозначение		Параметр
отечественное	международное	
$h_{11э}$, $h_{11б}$	h_{11e}, h_{11b}; h_{ie}, h_{ib}	Входное сопротивление в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
$h_{21э}$, $h_{21б}$	h_{21e}, h_{21b}; h_{fe}, h_{fb}	Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
$h_{21э}$, $h_{12б}$	h_{12e}, h_{12b}; h_{re}, h_{rb}	Коэффициент обратной связи по напряжению транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
$h_{22э}$, $h_{22б}$	h_{22e}, h_{22b}; h_{oe}, h_{ob}	Выходная полная проводимость транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
$\|h_{21э}\|$	$\|h_{21e}\|$	Модуль коэффициента передачи тока транзистора на высокой частоте.
$h_{11Э}$	h_{11E}, h_{IE}	Входное сопротивление транзистора в режиме большого сигнала для схемы с общим эмиттером.
$h_{21Э}$	H_{21E}, H_{FE}	Статический коэффициент передачи тока для схемы с общим эмиттером в режиме большого сигнала.
$Y_{21Э}$	Y_{21E}	Статическая крутизна прямой передачи в схеме с общим эмиттером.
$Y_{11э}$, $Y_{11б}$	Y_{11e}, Y_{11b}; Y_{ie}, Y_{ib}	Входная полная проводимость транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
$Y_{12э}$, $Y_{12б}$	Y_{12e}, Y_{12b}; Y_{re}, Y_{rb}	Полная проводимость обратной передачи транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
$Y_{21э}$, $Y_{21б}$	Y_{21e}, Y_{21b}; Y_{fe}, Y_{fb}	Полная проводимость прямой передачи транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
$Y_{22э}$, $Y_{22б}$	Y_{22e}, Y_{22b}; Y_{oe}, Y_{ob}	Выходная полная проводимость транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
$S_{11э}$, $S_{11б}$, $S_{11к}$	S_{11e}, S_{11b}, S_{11c} S_{ie}, S_{ib}, S_{ic}	Коэффициент отражения входной цепи транзистора для схем с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором соответственно.
$S_{12э}$, $S_{12б}$, $S_{12к}$	S_{12e}, S_{12b}, S_{12c}; S_{re}, S_{rb}, S_{rc}	Коэффициент обратной передачи напряжения для схемы с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором соответственно.
$S_{22э}$, $S_{22б}$, $S_{22к}$	S_{22e}, S_{22b}, S_{22c}; S_{oe}, S_{ob}, S_{oc}	Коэффициент отражения выходной цепи транзистора для схемы с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором соответственно.
$S_{21э}$, $S_{21б}$, $S_{21к}$	S_{21e}, S_{21b}, S_{21c}; S_{fc}, S_{fb}, S_{fc}	Коэффициент прямой передачи для схем с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором соответственно.
—	f_{se}, f_{sb}, f_{sc}	Частота, при которой коэффициент прямой передачи равен 1 (S_{21e}=1, S_{21b}=1, S_{21c}=1).
$K_{у,\ р}$	G_p	Коэффициент усиления мощности.
—	G_A, G_a	Номинальный коэффициент усиления по мощности.
$K_ш$	F	Коэффициент шума транзистора.
$\tau_к$ ($r'_б$ $C_к$)	τ_c (r'_{bb} C_c)	Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте.
$T_{окр}$	T_A, T_{amb}	Температура окружающей среды.
$T_к$	T_c, T_{case}	Температура корпуса.
$T_п$	T_j	Температура перехода.
$R_{т,\ п-с}$	R_{thja}	Тепловое сопротивление от перехода к окружающей среде.
$R_{т,\ п-к}$	R_{thjc}	Тепловое сопротивление от перехода к корпусу.
$R_{т,\ к-с}$	R_{thca}	Тепловое сопротивление от корпуса к окружающей среде.
$\tau_{т,\ п-к}$	τ_{thjc}	Тепловая постоянная времени переход-корпус.
$\tau_{т,\ п-с}$	τ_{thja}	Тепловая постоянная времени переход-окружающая среда.
$\tau_{т,\ к-с}$	τ_{thca}	Тепловая постоянная времени корпус-окружающая среда.

2.2. Параметры и характеристики биполярных транзисторов

Перечень параметров, включаемых в ТУ, характеризующих свойства полупроводниковых приборов, выбирается с учетом их физико-технологических особенностей и схемного назначения. В большинстве случаев необходимы сведения об их статических, динамических и предельных параметрах. Статические параметры характеризуют поведение приборов при постоянном токе, динамические — их частотно-временные свойства, предельные параметры определяют область устойчивой и надежной работы.

В справочники, стандарты или ТУ на полупроводниковые приборы включается необходимая для детального расчета схем информация о параметрах: нормы на значения параметров, режимы их измерений, максимальные и максимально допустимые значения параметров, вольт-амперные характеристики, зависимости параметров от режима и температуры, конструктивно-технологические особенности приборов, их основное назначение, специфические требования, методы измерения параметров, типовые схемы применения.

Постоянные (случайные) изменения технологических факторов оказывают существенное влияние на значения параметров изготавливаемых приборов. Поэтому значения параметров даже одного типа приборов являются случайными величинами, т. е. имеется отклонение от среднего (типового, номинального) уровня. Для некоторых параметров устанавливаются граничные (предельные) значения (нормы) и возможные отклонения (разброс). Нормы на разброс параметров устанавливаются на основе экспериментально-статистических данных при обеспечении надежной и устойчивой работы приборов в различных условиях и режимах применения, а также исходя из экономических соображений.

В зависимости от технологии и качества изготовления приборы имеют различные диапазоны разброса параметров. Для одних параметров ($I_{КБО}$, $C_к$, $r_б'C_к$, $U_{КЭ\ нас}$, $К_ш$) предусматривается одностороннее ограничение (по минимуму или максимуму), для других ($h_{21э}$, $h_{21Э}$,) — двустороннее.

Параметры транзисторов, определяемые геометрией конструкции (длиной, шириной, площадью или объемом отдельных областей): емкости переходов, распределенное сопротивление базы, частотные характеристики — подвержены меньшим изменениям, чем параметры, зависящие от состояния поверхности. Состояние поверхности определяет значения пробивных напряжений и стабильность обратных токов, коэффициент усиления.

Пробивные (максимальные) и максимально допустимые напряжения

Максимальное напряжение, которое может выдерживать диод или транзистор, ограничивается явлением пробоя. Пробой p-n-перехода выражается в резком увеличении обратного тока при достижении обратным напряжением определенного (критического) значения. Различают электрический и тепловой пробои. Механизм пробоя определяется физическими параметрами исходного материала, типом проводимости, мощностью прибора, конструктивно-технологическими факторами, внешними условиями и другими причинами.

Существуют два вида электрического пробоя: туннельный (зенеровский) и лавинный, связанные с увеличением напряженности электрического поля в p-n-переходе. Туннельный и лавинный пробои различаются знаками температурного коэффициента напряжения (ТКН) — отрицательным для туннельного (он уменьшается с ростом температуры) и положительным для лавинного (он увеличивается с ростом температуры). Электрический пробой определяется характеристиками p-n-перехода (шириной, объемными и поверхностными свойствами, удельным сопротивлением исходного материала). Оба вида электрического пробоя находят применение в стабилитронах: в области пробоя напряжение слабо зависит от тока, что и определяет стабилизацию напряжения.

Тепловой пробой возникает из-за потери устойчивости теплового режима работы и появления теплоэлектрической обратной связи. При плохих условиях теплопередачи от перехода происходит повышение его температуры (саморазогрев) и возможно разрушение прибора из-за перегрева (общего или локального). На вольт-амперной характеристике появляется участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением. Вероятность возникновения теплового пробоя существенно зависит от теплового сопротивления прибора, внешних условий, схемы включения, элементов входной цепи, рабочего тока и напряжения на приборе. Чем выше $T_{п\ max}$ и ниже обратные токи и тепловые сопротивления, тем более устойчивы к тепловому пробою приборы. Теплового пробоя можно избежать, обеспечив тепловую стабильность режима работы прибора, т. е. хороший теплообмен. Напряжения теплового пробоя значительно больше напряжений лавинного и туннельного пробоев для кремниевых приборов.

Транзисторы характеризуются максимальными (пробивными) напряжениями переходов ($U_{\text{КБО проб}}$, $U_{\text{ЭБО проб}}$, $U_{\text{обр}}$). Кроме того, максимальное напряжение коллектор-эмиттер зависит от схемы, в которой применяется транзистор, — от условий во входной цепи (между эмиттером и базой), т. е. от значений сопротивлений $R_{\text{бэ}}$ и $R_{\text{э}}$ и напряжения смещения. Значения напряжения коллектор-эмиттер для произвольной схемы ($U_{\text{КЭR проб}}$, $U_{\text{КЭК проб}}$, $U_{\text{КЭV проб}}$) находятся а интервале между значениями напряжений $U_{\text{КЭО проб}}$ и $U_{\text{КБО проб}}$. Пробивное напряжение $U_{\text{КЭО проб}}$ является наименьшим из всех возможных пробивных напряжений коллектор-эмиттер и соответствует наихудшим условиям на входе, когда цепь базы отключена ($R_{\text{бэ}} = \infty$), т. е. $U_{\text{КБО проб}} > U_{\text{КЭХ проб}} > U_{\text{КЭК проб}} > U_{\text{КЭR проб}} > U_{\text{КЭО проб}}$ (рис. 2.1). Схемы измерения пробивных напряжений и обратных токов приведены на рис. 2.2, *а—е*. Для обеспечения стабильной и надежной работы транзисторов рабочее напряжение коллектор-эмиттер выбирают меньше $U_{\text{КЭО проб}}$. Изменение напряжения коллектор-эмиттер от сопротивлений $R_{\text{бэ}}$ и $R_{\text{э}}$ характеризуется зависимостью $U_{\text{КЭRпроб}}$ от этих сопротивлений. При включении сопротивления $R_{\text{э}}$ входное сопротивление увеличивается, поэтому возможно увеличение $R_{\text{бэ}}$ (см. рис. 2.2, *д*). Имеется критическое сопротивление в цепи базы $R_{\text{бэ кр}}$, при котором начинается снижение допустимого рабочего напряжения (рис. 2.3). Чем больше $R_{\text{бэ}}$, тем сильнее зависимость $U_{\text{КЭR проб}}$ от температуры. Сопротивление $R_{\text{бэ}}$ существенно изменяет $U_{\text{КЭR проб}}$, если оно сравнимо или больше входного сопротивления транзистора.

Напряжение $U_{\text{КЭК проб}}$ используется для расчета схем с трансформатором или резонансным контуром на входе; напряжение $U_{\text{ЭБО проб}}$ — для расчета напряжения запирания переключающих или усилительных схем при работе с отсечкой коллекторного тока; напряжение $U_{\text{КБО проб}}$ — для расчета режимов работы запертого транзистора и схем с общей базой.

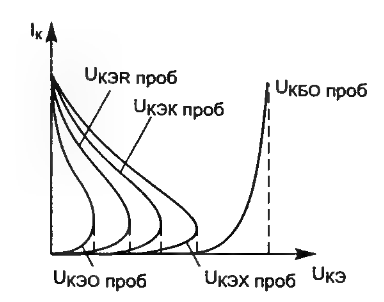


Рис. 2.1. Выходные вольт-амперные характеристики транзистора в области пробоя при различных условиях на входе

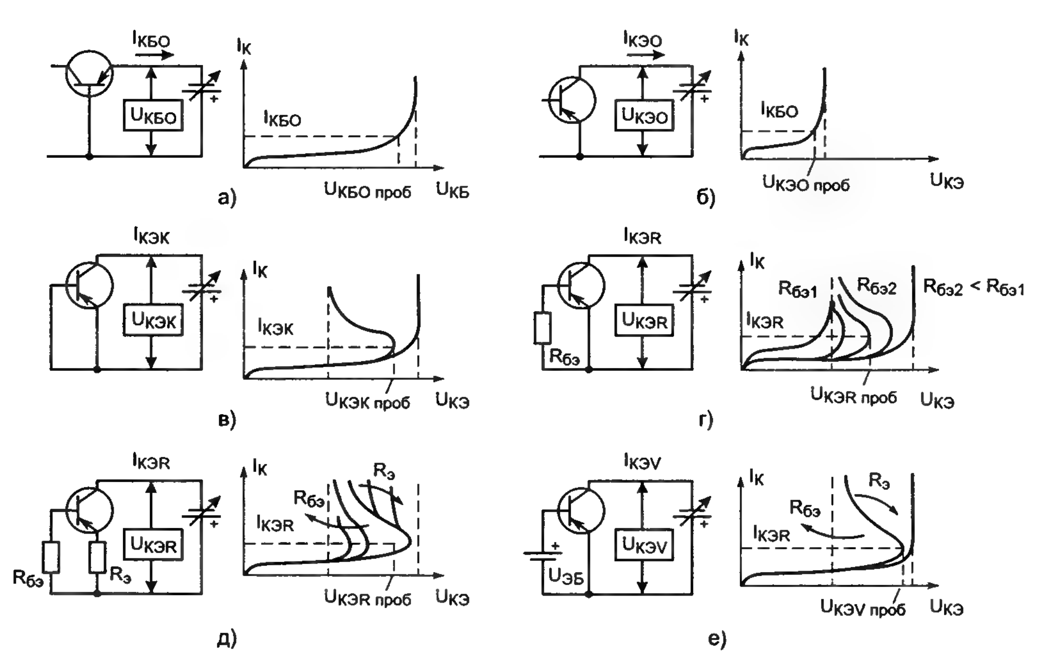


Рис. 2.2. Схемы измерения пробивных напряжений и обратных токов при различных условиях на входе

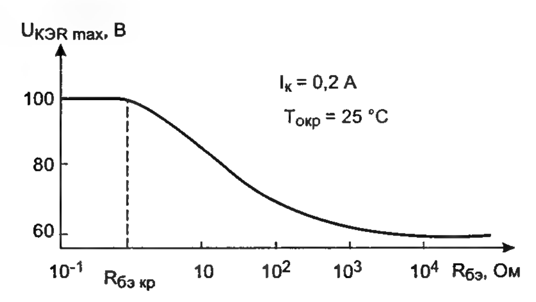


Рис. 2.3. Зависимость пробивного напряжения от сопротивления резистора в цепи базы

Пробивные напряжения переходов устанавливаются при определенном значении тока (например, для маломощных транзисторов напряжение $U_{КБО\ проб}$ фиксируется при токах от 1 до 200 мкА). Пробивные напряжения снижаются, если повышается температура, т. е. приборы могут выйти из строя при напряжениях, безопасных при нормальной температуре.

Максимально допустимые напряжения устанавливаются по наименьшим из измеренных значений пробивных напряжений с некоторым запасом для обеспечения надежной работы приборов. Максимальные и максимально допустимые напряжения определяют верхнюю допустимую границу рабочего диапазона обратных напряжений диодов и транзисторов.

При некотором сочетании параметров (при больших напряжениях и токах, даже не превышающих предельных значений) у любого транзистора в активном режиме при прямом или обратном (в режиме отсечки) смещении на переходе эмиттер-база может возникнуть второй пробой (рис. 2.4). Поэтому изготовители приборов определяют области их безопасной работы, исключающие этот вид пробоя, сходного с тепловым. Кроме того, созданы транзисторы с повышенной устойчивостью ко второму пробою (например, транзисторы с эпитаксиальной базой, с балластными стабилизирующими резисторами в цепях эмиттеров). Существуют также схемные решения, уменьшающие вероятность возникновения второго пробоя. В большей степени второму пробою подвержены транзисторы, работающие с индуктивной нагрузкой в ключевом режиме (при запирании). Вследствие второго пробоя значительно сужается область безопасной работы мощных высокочастотных транзисторов. Даже при наличии запасов по предельным параметрам они могут выйти из строя при средней мощности, меньшей предельно допустимой. Часто в ТУ для прямого смещения приводятся значения тока, при которых происходит второй пробой.

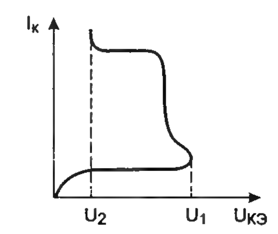


Рис. 2.4. Форма вольт-амперной характеристики в области второго пробоя (U_1 и U_2 — напряжения первого и второго пробоя)

Максимальные токи

Максимальный ток, протекающий через полупроводниковый прибор, определяется допустимой рассеиваемой мощностью, коэффициентом усиления, уменьшающимся при увеличении тока $I_К$ (например до значения $h_{21Э}$ < 10), критическим током, при котором происходит второй пробой, сопротивлением $r_{КЭ\ нас}$ транзистора. Поэтому для увеличения максимального тока стараются уменьшить $r_{КЭнас}$ и $U_{пр}$, увеличить рассеиваемую мощность (т. е. уменьшить тепловое сопротивление, увеличить допустимую температуру перехода), повысить устойчивость ко второму пробою, уменьшить снижение коэффициента усиления при увеличении тока $I_К$. Максимально допустимый ток устанавливается через максимальный с учетом коэффициента запаса.

Максимальный ток базы ограничивается сопротивлениями вывода и контактов базы. Ограничение максимального тока коллектора, как правило, наступает раньше, чем достигается максимальный ток базы.

Обратные токи

Обратные токи и их зависимости от приложенных напряжений и температуры учитываются при расчете режима работы транзисторов.

Значение обратного тока через переход зависит от свойства материала, технологии изготовления (геометрии перехода, состояния поверхности), мощности прибора и рабочей температуры. Полный обратный ток p-n-переходов $I_{обр}$ состоит из трех компонентов: теплового тока I_0, тока термогенерации $I_Т$ и тока утечки $I_У$.

Тепловой ток зависит от физических свойств материала и обычно характеризуется температурой удвоения (приращением температуры, вызывающим удвоение теплового тока). У кремниевых он значительно меньше, чем у германиевых p-n-переходов при одной и той же площади перехода. Ток I_0 экспоненциально зависит от температуры, причем у германиевых диодов он примерно удваивается при увеличении температуры на каждые 7...10 °С, у кремниевых — на каждые 8...12 °С.

Особенностью тока термогенерации является зависимость от напряжения (ширина перехода увеличивается с ростом напряжения, и ток $I_т$ возрастает). Он пропорционален $\sqrt{U_{обр}}$, но увеличивается с ростом температуры слабее, чем ток I_0. Ток I_0 начинает превышать $I_т$ при температуре 100 °С. При комнатной температуре для германиевых p-n-переходов $I_т$ обычно мал и меньше I_0, но для кремниевых, у которых $I_т$ является главным компонентом полного обратного тока, $I_т \gg I_0$ (на несколько порядков). Ток $I_т$ для германиевых приборов становится соизмеримым с током I_0 лишь при отрицательной температуре.

Ток утечки $I_у$ обусловлен проводимостью поверхности кристалла (характером ее обработки), связан с нарушением кристаллической решетки, наличием окисных пленок, шунтирующих переход, загрязнением поверхности и является основной причиной нестабильности $I_{обр}$ во времени. При повышении напряжения ток $I_у$ растет почти линейно и слабо зависит от температуры. Обычно у реальных кремниевых p-n-переходов $I_у > I_0 + I_т$.

Небольшой наклон вольт-амперных характеристик свидетельствует о том, что основная составляющая обратного тока — не зависящий от напряжения ток $I_б$. Если же характеристики имеют большой наклон, то основными составляющими являются токи $I_т$ и $I_у$. Большой ток $I_у$ нарушает указанный выше закон удвоения, т. е. увеличение $I_{обр}$ ослабляет его зависимость от температуры.

Транзисторы характеризуются обратными токами переходов эмиттер-база $I_{ЭБО}$ и коллектор-база $I_{КБО}$, а также обратным током между коллектором и эмиттером, значение которого, как и пробивное напряжение между коллектором и эмиттером, зависит от условий во входной цепи транзистора.

Обратный ток коллектора $I_{КБО}$ экспоненциально увеличивается с ростом температуры. Считается, что он изменяется приблизительно на 6...8% у германиевых приборов и на 8...10% у кремниевых при изменении температуры на 1 °С (рис. 2.5).

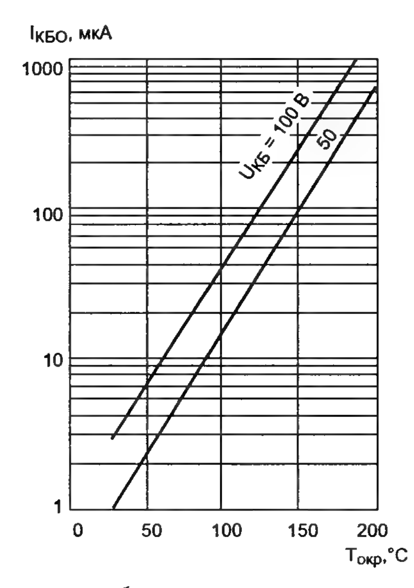


Рис. 2.5. Зависимость обратного тока коллектора от температуры

Обратные токи обычно определяются при максимальных обратных напряжениях. Большие обратные токи переходов свидетельствуют о недостаточно хорошем качестве приборов.

Тепловые параметры

К тепловым параметрам приборов относятся минимальная $T_{п\,min}$ и максимальная $T_{п\,max}$ температуры перехода, тепловые сопротивления $R_т$, тепловые постоянные времени $\tau_т$ и теплоемкости $C_т$. Они определяют стабильность работы полупроводниковых приборов при изменении температуры, ограничивают максимальные мощности, токи и напряжения, допустимые диапазоны температур окру-

жающей среды, при которых обеспечивается надежная работа. В частности, параметры $R_т$, $\tau_т$, $C_т$ позволяют определять нагрев транзистора или диода в рабочем режиме.

Как уже отмечалось, максимальная мощность полупроводниковых приборов в различных условиях эксплуатации ограничивается максимальной температурой перехода, при достижении которой либо резко ухудшаются их параметры, либо они выходят из строя из-за теплового пробоя переходов. При постоянных условиях окружающей среды $T_п$ является функцией электрической мощности $P = UI$, приложенной к прибору, и зависит от его структуры, теплофизических характеристик материалов (типа исходного материала, степени его легирования, состояния поверхности) и других технологических факторов. Кремниевые p-n-переходы сохраняют свои свойства до температуры 150...200 °С, германиевые — до 70...120 °С.

В процессе работы на p-n-переходах выделяется основная мощность и происходит повышение температуры. Так как p-n-переход нагревается до температуры, большей, чем температура корпуса и окружающей среды, то для полупроводниковых приборов устанавливается диапазон максимально допустимой окружающей температуры: для кремниевых приборов −60...+125 °С, для германиевых −60...+70 °С. Связь между $T_п$ и $T_{окр}$ описывается формулой $T_п - T_{окр} = R_т P$, где $R_т$ показывает возрастание температуры на единицу рассеиваемой мощности.

Приводимые в справочниках значения $T_{п\,max}$ определяются экспериментально или рассчитываются и имеют запас по сравнению со значением температуры, при которой наступает разрушение прибора.

Измерять $T_п$ прямыми методами сложно, поэтому используются косвенные методы, при которых она оценивается по значению какого-либо термочувствительного параметра. Термочувствительными параметрами диодов являются обратный ток $I_{обр}$ и прямое напряжение $U_{пр}$, а транзисторов — обратные токи $I_{КБО}$, $I_{ЭБО}$, напряжения $U_{ЭБ}$, $U_{КБ}$, коэффициент передачи тока $h_{21Э}$, входное сопротивление. Температуру рабочих областей полупроводниковых приборов измеряют и другими методами, например методом регистрации инфракрасного излучения, физическим (термопарой).

Теплообмен между переходом и окружающей средой принято характеризовать тепловым сопротивлением прибора — сопротивлением элементов конструкции распространению тепла от перехода к корпусу и теплоотводу, которое определяется конструкцией прибора, теплопроводностью ее элементов и системой охлаждения корпуса. Тепловое сопротивление переход—среда $R_{т,\,п\text{-}с}$ необходимо знать для расчета допустимой рассеиваемой мощности маломощных диодов и транзисторов, обычно работающих без теплоотвода, а тепловое сопротивление переход—корпус $R_{т,\,п\text{-}к}$ — для расчета режима работы мощных приборов при наличии внешнего радиатора (рис. 2.6). Обычно $R_{т,\,п\text{-}с} \gg R_{т,\,п\text{-}к}$ (сопротивление $R_{т,\,п\text{-}к}$ остается постоянным только в случае работы при малых плотностях тока). Тепло от кристалла с переходами к корпусу или радиатору отводится за счет теплопроводности, а от корпуса в окружающее пространство — конвекцией и излучением.

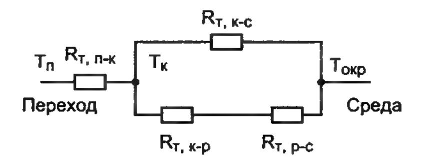


Рис. 2.6. Тепловая эквивалентная схема транзистора с теплоотводом ($R_{т,\,п\text{-}к}$, $R_{т,\,к\text{-}с}$, $R_{т,\,к\text{-}р}$, $R_{т,\,р\text{-}с}$ — тепловые сопротивления переход—корпус, корпус—среда, корпус—радиатор и радиатор—среда соответственно)

Для охлаждения корпуса мощного прибора вместо радиатора может использоваться поток жидкости или газа. При применении радиатора нагрев полупроводникового прибора зависит от качества теплового контакта корпуса с радиатором, т. е. сопротивление корпус—среда $R_{т,\,к\text{-}с}$ зависит от типа радиатора, метода крепления, чистоты сопрягающихся поверхностей, усилия, с которым прижимается прибор (контактного давления). Для уменьшения контактного сопротивления применяются специальные смазки (например, кремнийорганические) и пасты, заполняющие пустоты между контактирующими поверхностями, а также прокладки из мягких, легко деформируемых металлов: свинца, индия, меди, алюминия.

Тепловые постоянные времени переход—корпус $\tau_{т,\,п\text{-}к}$ и корпус—среда $\tau_{т,\,к\text{-}с}$ используются для расчета теплового режима приборов в динамическом режиме и характеризуют скорость нарастания температуры отдельных участков объема полупроводникового прибора, когда температура перехода значительно изменяется за период действия импульсной мощности. Постоянная времени $\tau_{т,\,п\text{-}к}$ опре-

деляется по переходным тепловым характеристикам нагревания или остывания приборов и зависит от типа материала и конструкции приборов; $\tau_{т,\,к\text{-}с}$ зависит от способа отвода тепла от прибора. Постоянная времени переход—среда $\tau_{т,\,п\text{-}с}$ характеризует время установления теплового режима диодов и транзисторов без теплоотвода.

Значения теплоемкостей переход—корпус $C_{т,\,п\text{-}к}$ и корпус—среда $C_{т,\,к\text{-}с}$ необходимы при определении тепловых режимов в случае работы приборов при малых длительностях импульсов. Они определяются экспериментально.

Для приборов средней и большой мощностей, используемых с радиатором, обычно оговаривается предельная температура корпуса прибора.

Для зарубежных приборов часто указывается максимальная температура хранения, которая является предельной температурой перехода данного прибора. При больших температурах даже в нерабочем состоянии могут происходить необратимые изменения свойств прибора. При высокой температуре активизируется действие примесей на поверхности кристалла, поэтому скорость деградации электрических параметров выше, чем при низких температурах.

Рассеиваемая мощность

Рассеиваемая мощность определяется физическими свойствами полупроводникового материала, геометрическими, конструктивно-технологическими и тепловыми характеристиками прибора. Мощность, рассеиваемая транзистором, состоит из мощностей, выделяемых на переходах коллектор—база и эмиттер—база: $P_{общ} = P_Э + P_К = I_Б U_{БЭ} + I_К U_{КЭ} \approx P_К$ (часто величиной $P_Э$ можно пренебречь, так как $P_Э \ll P_К$). Различают максимально допустимую рассеиваемую мощность в статическом и импульсном режимах. В последнем случае она зависит от формы, длительности, частоты и скважности импульсов. При тепловом равновесии рассеиваемая мощность расходуется на нагревание и влияет на температуру перехода при заданной температуре окружающей среды $T_{окр}$ или температуре корпуса $T_к$.

Максимальная мощность, рассеиваемая диодом или транзистором, ограничивается максимальной температурой перехода $T_п$, а также рядом специфических процессов, определяющих максимальные напряжения и токи. Зависимость между максимальной (максимально допустимой) мощностью рассеяния и максимальной температурой перехода для прибора без радиатора (теплоотвода) имеет вид $P_{К\,max} = (T_п - T_{окр})/R_{т,\,п\text{-}с}$, где $R_{т,\,п\text{-}с}$ — тепловое сопротивление переход—среда.

Для приборов, работающих с внешним теплоотводом, $P_{К,т\,max} = (T_п - T_к)/R_{т,\,п\text{-}к}$, где $R_{т,\,п\text{-}к}$ — тепловое сопротивление переход—корпус. Максимальная (максимально допустимая) мощность при увеличении $T_{окр}$ или $T_к$ линейно уменьшается. Она рассчитывается в соответствии с указанными формулами или находится из типовых зависимостей, которые приводятся для конкретных приборов (рис. 2.7). Для мощных транзисторов значения $P_{К,\,т\,max}$ приводятся в справочниках при условии идеального отвода тепла или для радиаторов различных размеров (рис. 2.8, 2.9). Максимально допустимая мощность, в отличие от максимальной, приводится с запасом, гарантирующим заданную надежность.

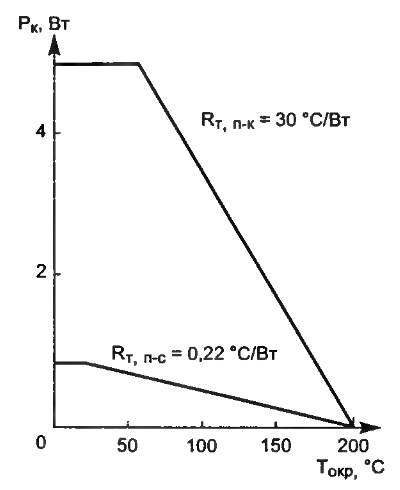


Рис. 2.7. Зависимость рассеиваемой мощности от температуры

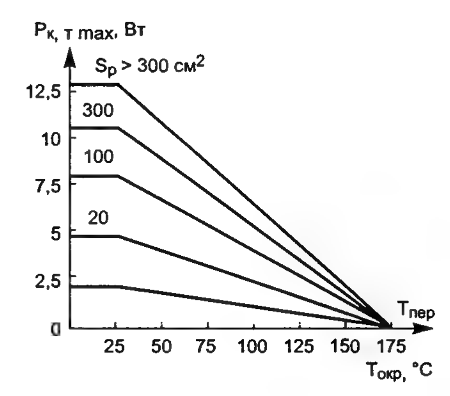


Рис. 2.8. Зависимость рассеиваемой мощности от температуры при различных значениях и площади радиатора $S_р$

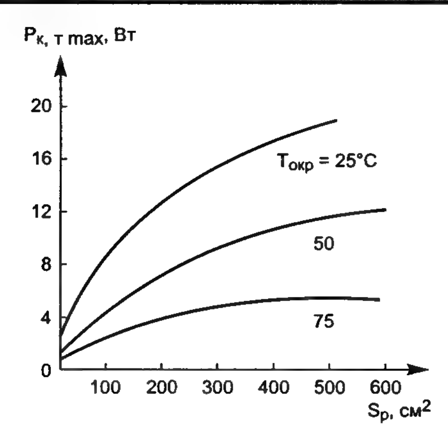


Рис. 2.9. Зависимость мощности рассеяния от площади радиатора при различных значениях температуры

Коэффициент передачи по току

Коэффициент передачи $h_{21Э}$ транзистора зависит от тока коллектора (эмиттера); с увеличением тока $I_К$ ($I_Э$) он сначала возрастает, достигает максимума, а затем уменьшается. В зависимости от технологии изготовления максимум кривой $h_{21Э} = \varphi(I_К)$ может быть резко выраженным или размытым (рис. 2.10). Например, максимум этой кривой у меза-транзисторов достигается при токах, на 1—2 порядка больших, чем у сплавных. После прохождения максимума $h_{21Э}$ уменьшается приблизительно обратно пропорционально $I_К$. Такая неравномерность усиления в диапазоне токов является источником нелинейных искажений. В мощных транзисторах спад коэффициента передачи происходит более резко, чем в маломощных. Особенно резкий спад происходит у сплавных кремниевых p-n-p транзисторов (из-за физико-технологических причин). Поэтому не удалось создать такие транзисторы на большие рабочие токи. Для повышения усиления используются составные транзисторы.

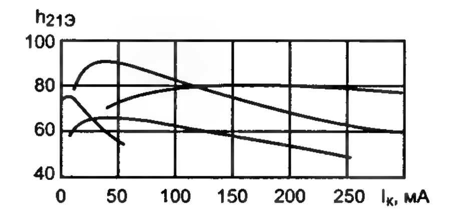


Рис. 2.10. Типовые зависимости коэффициента передачи от тока коллектора

У сплавных приборов $h_{21Э}$ растет с увеличением напряжения на коллекторе $U_К$, у диффузионных эта зависимость слабо выражена (она наблюдается лишь при малых напряжениях на коллекторе). С ростом температуры $h_{21Э}$ обычно увеличивается (рис. 2.11).

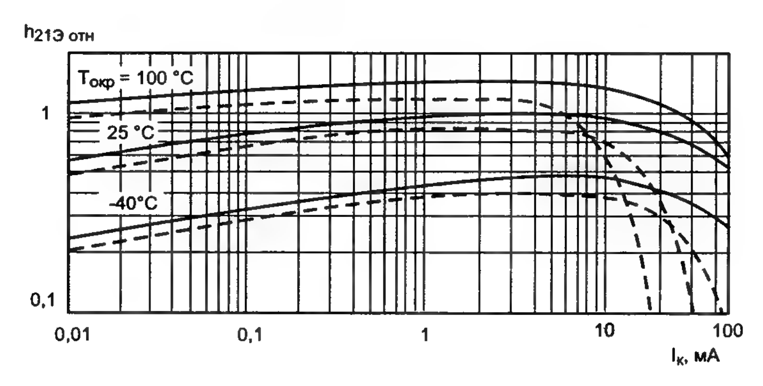


Рис. 2.11. Зависимость относительного коэффициента передачи от тока коллектора, при различных значениях температуры и напряжения (— — — $U_{КЭ}$ = 1 В, ——— $U_{КЭ}$ = 10 В)

Составные транзисторы

Составной транзистор фактически представляет собой соединение двух биполярных транзисторов по определенной схеме, имеющей три внешних вывода, Например, в составном транзисторе по схеме Дарлингтона (рис. 2.12, *а*, *б*) коллекторы соединены вместе, входом служит база транзистора VT1, а эмиттером — эмиттер транзистора VT2. Для обеспечения нормальных режимов работы управляющего VT1 и выходного VT2 транзисторов по постоянному току и напряжению транзистор VT2 делается более мощным. Такой составной транзистор функционально соответствует одному транзистору с высоким результирующим коэффициентом передачи тока, равным произведению коэффициентов передачи входящих в него одиночных транзисторов:

$$h_{21Э об} = h_{21Э1} + h_{21Э2} + h_{21Э1}h_{21Э2} \approx h_{21Э1}h_{21Э2}.$$

Недостатком составных транзисторов является повышенное напряжение насыщения $U_{КЭ\ нас} = U_{КЭ\ нас1} + U_{БЭ2}$, а также относительно большой обратный ток.

а) б)

Рис. 2.12. Составные p-n-p (а) и n-p-n (б) транзисторы

Для увеличения стабильности работы эмиттерные переходы транзисторов VT1 и VT2 могут шунтироваться резисторами $R_{бэ1}$ и $R_{бэ2}$ (например, $R_{бэ1}$ = 1...10 кОм, $R_{бэ2}$ = 25...300 Ом), предотвращающими возрастание токов утечки (особенно при высоких температурах), но и влияющими на общий коэффициент усиления (рис. 2.13, *а*, *б*):

$$h_{21Э об} = h_{21Э1}R_{бэ1}/(R_{бэ1} + r_{вх1}) + h_{21Э2}R_{бэ2}/(R_{бэ2} + r_{вх2}) +$$
$$+ h_{21Э1}h_{1Э2}R_{бэ1}R_{бэ2}/[(R_{бэ1} + r_{вх1})(R_{бэ2} + r_{вх2})],$$

где $r_{вх}$ — входное сопротивление транзистора. При этом

$$I_{КЭО\ об} = I_{КЭR1}(h_{21Э2}R_{бэ1})/(R_{бэ2} + r_{вх2}).$$

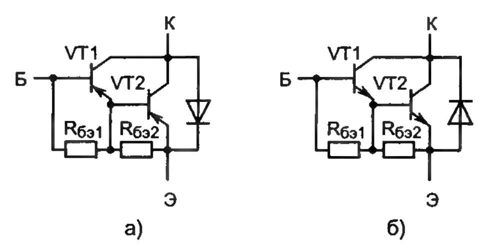


Рис. 2.13. Составные p-n-p (*а*) и n-p-n (*б*) транзисторы с резисторами $R_{бэ1}$ и $R_{бэ2}$

Внутренняя структура составных транзисторов варьируется в зависимости от области их применения. В ряде приборов могут отсутствовать резисторы $R_{бэ1}$ и $R_{бэ2}$ (например, у 2SB678, 2SB679, 2SB880, 2SD549, 2SD688, 2SD1190, 2SD1224), может быть только резистор $R_{бэ1}$ (например, у RCA9203, 2SD684, 2SD1088, 2SD1410, 2SD1861). Имеются приборы, в которых между коллектором и эмиттером выходного транзистора включается диод (например, у КТ825, 2N6050, 2N6285, TIP110), защищающий транзистор от инверсных (обратных) токов, возникающих в результате переходного процесса при работе на индуктивную нагрузку и при непредусмотренном изменении полярности напряжения питания (см. рис. 2.13). Но тогда они становятся не пригодными для использования в инверторных мостовых схемах. Для повышения стойкости ко второму пробою между коллектором и

базой или между коллектором и эмиттером включается стабилитрон (например, у 2SD706, 2SD708, 2SD1208, 2SD1294).

Составные транзисторы применяются в стабилизаторах напряжения непрерывного и импульсного действия, электронных системах зажигания автомобилей (например, КТ848А), схемах управления двигателей, в различных усилительных и переключательных схемах.

Необходимо отметить, что большое усиление могут иметь и одиночные мощные и маломощные транзисторы со сверхбольшим коэффициентом усиления (так называемые Ultra-Beta и Super-Beta), например 2N5961—2N5963, 2SC1888, 2SC1983, 2SC2198, 2SC2315—2SC2317, 2SC2491, 2SD920, 2SD931, 2SD982, 2SD1052, 2SD1090, 2SD1353.

Емкости переходов и постоянная времени коллектора

Емкости p-n-переходов влияют на частотные и импульсные характеристики полупроводниковых приборов. Обычный p-n-переход подобен конденсатору, емкость которого меняется при изменении приложенного напряжения. Эта емкость состоит из двух компонентов, проявляющихся при работе диода в прямом и обратном направлениях, — барьерной и диффузионной емкостей. Барьерная (зарядная) емкость $C_б$ не зависит от тока через переход и является функцией частоты и обратного приложенного напряжения. Диффузионная емкость $C_д$ пропорциональна прямому току (даже при небольших прямых токах $C_д > C_б$) и также зависит от частоты. Емкость p-n-перехода при прямом смещении диода равна сумме $C_д$ и $C_б$, при обратном — приблизительно емкости $C_б$, так как в этом случае емкость $C_д$ пренебрежимо мала.

Обычно в ТУ на прибор даются зависимости емкостей от напряжений, приложенных к переходам. На рис. 2.14 приведена зависимость $C_к(U_{КБ})$. С увеличением напряжения емкость нелинейно уменьшается. Емкость $C_к$ равна разности измерений выходной емкости $C_{22э}$ и паразитной емкости ножки корпуса.

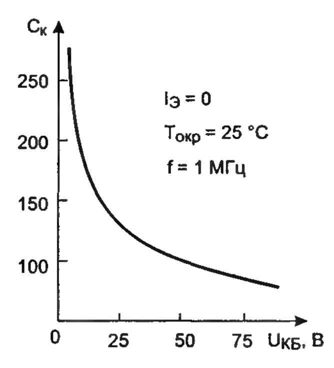


Рис. 2.14. Зависимость емкости коллектора от напряжения коллектор-база

Постоянная времени $\tau_к = r'_б C_к$, где $r'_б$ — сопротивление базы, характеризует внутреннюю обратную связь в транзисторе и определяет частотные и усилительные свойства, максимальную частоту генерации и коэффициент усиления по мощности на высокой частоте. Кроме того, чем меньше его значение, тем выше устойчивость к самовозбуждению транзистора в усилителе. Через параметры $\tau_к$ и $C_к$ можно определить сопротивление базы, необходимое для расчета схем.

Шумы транзисторов

Собственные шумы транзисторов ограничивают чувствительность усилителей. Их источниками являются шумы: тепловые, дробовые эмиттерного и коллекторного переходов, избыточные, а также случайного перераспределения тока эмиттера между коллектором и базой.

Тепловые шумы транзистора практически определяются омическим сопротивлением базовой области. Дробовые шумы обусловлены флуктуациями носителей заряда через прибор (возникают при прохождении тока через эмиттерный и коллекторный переходы).

Избыточные шумы (фликкер-шумы) — специфические шумы, возникающие вследствие изменения состояния поверхности кристалла полупроводника во времени. Они пропорциональны протекающему току и проявляются на низких частотах: в диапазоне звуковых и инфранизких частот. Значения избыточных шумов могут сильно колебаться даже для транзисторов одного типа, так как зависят от технологических факторов. Избыточные шумы больше у n-p-n транзисторов, чем у p-n-p. Транзисторы с большими или нестабильными токами $I_{КБО}$ имеют повышенные избыточные шумы.

4 зак 9

С ростом рабочей частоты доля избыточных шумов уменьшается и шумы транзисторов определяются в основном дробовыми и тепловыми составляющими.

Шумовые свойства транзистора обычно характеризуются коэффициентом шума, который определяется экспериментально или рассчитывается на основе анализа отдельных источников шума. Рассчитать точно коэффициент шума для области избыточных шумов невозможно, поэтому его определяют экспериментально.

Коэффициент шума — сложная функция многих переменных: полного сопротивления источника сигнала $R_г$, параметров режима, параметров транзисторов ($h_{21э}$, $I_{КБО}$, $C_э$, $f_{h21б}$, $r'_б$, $r_э$) и рабочей частоты $f_р$. Зависимость $К_ш$ от частоты имеет три характерных участка (рис. 2.15): низких частот ($К_ш$ уменьшается пропорционально $1/f$); средних частот ($К_ш$ не зависит от частоты) — область «белого» шума; высоких частот (при $f > f_{гр}$ усиление резко уменьшается и шумы возрастают, $К_ш$ зависит от $r'_б$ и отношения $(f_р/f_{h21б})^2$).

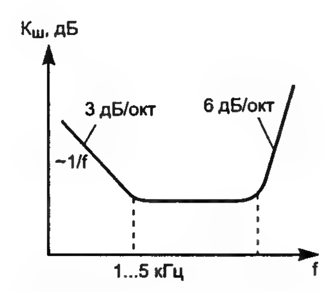


Рис. 2.15. Типовая зависимость коэффициента шума от частоты

Эти участки обусловлены тем, что на различных частотах шумы генерируются различными источниками шумов. В области низких частот (0,1...5 кГц) коэффициент шума уменьшается примерно на 3 дБ на октаву, в области высоких частот увеличивается на 6 дБ на октаву, в области средних частот он минимален.

Следует отметить, что имеется взаимосвязь низкочастотных шумов и отказов приборов. Уровень низкочастотных шумов, пропорциональных $1/f$, дает информацию о структурных изменениях приборов и используется для распознавания разных дефектов в транзисторах, в частности трещин и нарушений целостности кристалла, наличия загрязнений поверхности, которые могут привести к отказам приборов. Методы неразрушающего контроля качества приборов по их шумам используются в технологическом цикле производства. Кроме того, существуют методы прогнозирования основных параметров надежности приборов по их низкочастотным шумам.

Минимальное значение $К_ш$ достигается при определенных значениях сопротивления источника сигнала $R_г$ и тока $I_К$ (рис. 2.16, 2.17). Увеличение $К_ш$ при росте $I_К$ происходит медленно при малых токах. При больших токах $К_ш$ растет почти пропорционально $I_К$. С ростом $U_К$ (в пределах 1...10 В) $К_ш$ почти не меняется, пока избыточные шумы малы по сравнению с дробовыми и тепловыми. В дальнейшем из-за увеличения избыточных шумов $К_ш$ возрастает. Таким образом, для того чтобы свести шумы к минимуму, выбирают оптимальный режим работы транзистора.

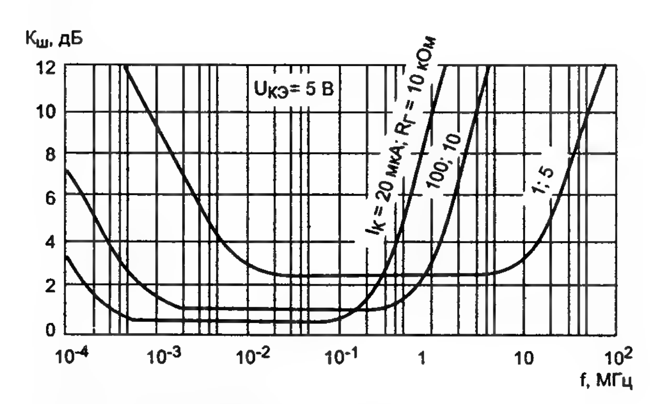


Рис. 2.16. Зависимость коэффициента шума от частоты при различных значениях тока коллектора и сопротивления источника сигнала

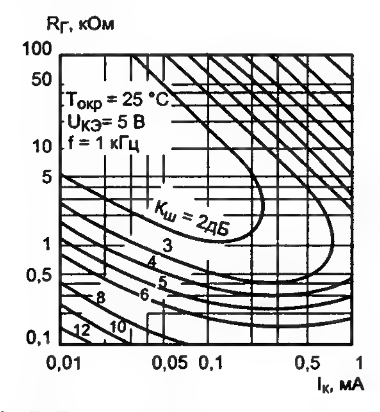


Рис. 2.17. Типовая зависимость коэффициента шума от сопротивления источника сигнала и тока коллектора

На средних и высоких частотах минимальный $К_ш$ будут иметь транзисторы с малыми $r'_б$ и $I_{КБО}$ и большими $h_{21э}$ и $h_{21б}$.

Измерения параметра $К_ш$ производятся обычно при стандартном сопротивлении $R_г$. Как правило, коэффициент шума увеличивается с ростом температуры.

2.3. Эквивалентные схемы и параметры четырехполюсника

Для анализа работы транзистора в усилительном или генераторном режимах используются метод эквивалентных схем и метод четырехполюсника.

При первом методе основные расчетные соотношения схемы усилителя выражаются через параметры, отражающие физические процессы в транзисторе (диффузию, модуляцию ширины запирающего слоя), зарядные емкости, последовательные сопротивления и др., с учетом особенностей конструкции, паразитных емкостей и индуктивностей выводов в рабочем интервале частот. Для различных областей применения и диапазонов рабочих частот эти схемы различны. В зависимости от расположения пассивных элементов получаются Т- и П-образные эквивалентные схемы.

Эквивалентная схема диода, включающая сопротивление p-n-перехода, емкости p-n-перехода ($С_б$ и $С_д$), емкость корпуса, индуктивности выводов, сопротивления базы и выводов, видоизменяется при обратном и прямом смещениях.

Метод четырехполюсника позволяет рассчитывать усилитель с помощью матриц без составления эквивалентной схемы транзистора. При этом параметры четырехполюсника (четыре комплексных параметра), характеризующие свойства транзистора, определяются экспериментально. В отличие от параметров эквивалентной схемы, они зависят от схемы включения. Существуют три системы параметров, однозначно определяющие свойства транзисторов: h-, Y- и S-параметры. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Выбор той или иной системы параметров определяется удобством анализа и расчета каждой конкретной схемы.

При расчете низкочастотных схем наибольшее распространение получили Z- и h-параметры, высокочастотных схем — Y-параметры.

Для устранения нестабильности работы транзисторов в усилительном режиме, связанной с внутренней обратной связью, используются схемные методы нейтрализации и демпфирования входных и выходных проводимостей. С помощью внешних схемных элементов стараются уменьшить коэффициенты, характеризующие обратную связь (h_{12}, Y_{12}). У ряда современных транзисторов влияние обратной связи снижается технологическим способом.

Измерение параметра $Y_{11б}$ позволяет оценить сопротивление базы, которое, в свою очередь, определяет усилительные и частотные свойства транзисторов, а также высокочастотные шумы токораспределения (у транзисторов с малым сопротивлением $r'_б$ уровень шумов также мал). Вообще сопротивление $r'_б$ зависит от конструкции и типа транзистора и лежит в диапазоне от нескольких единиц (у мощных приборов) до нескольких сотен Ом.

В качестве параметров, описывающих транзистор как четырехполюсник для СВЧ-диапазона, используются S-параметры: S_{11} и S_{12} — коэффициенты отражения соответственно от входа и выхода четырехполюсника при нагрузке на волновое сопротивление (входные и выходные сопротивления), S_{12} и S_{21} — коэффициенты обратной и прямой передач. Они применяются для расчета схем, работающих на частотах от 100 МГц до нескольких гигагерц (на этих частотах трудно осуществить условие короткого замыкания при измерении Y-параметров). Кроме того, S-параметры имеют ряд преимуществ с точки зрения обеспечения устойчивости в процессе измерения, но определяются только для конкретной рабочей точки и на фиксированной частоте.

Типовые (нормализованные) зависимости параметров четырехполюсника от режима и температуры иногда приводятся в справочниках или ТУ (технических условиях).

Частотные свойства транзисторов

Частотные свойства полупроводниковых приборов определяют области их применения.

Для эквивалентных схем и четырехполюсников существует ряд характеристических частот. Практическое значение имеют частоты, связанные с параметрами $h_{21б}$, $h_{21э}$ и $Y_{21Э}$, а также частота генерации f_{max}, определяющая область частот, в которой транзистор, в принципе, может применяться как генератор колебаний (на этой частоте коэффициент усиления по мощности $К_{уp} = 1$). Кроме того, f_{max} используется для оценки $К_{уp}$ на других частотах.

Модули коэффициентов передачи тока $h_{21б}$, $h_{21э}$ и крутизны $Y_{21Э}$ уменьшаются с ростом частоты, поэтому вводятся характеристические частоты, на которых эти параметры снижаются в $\sqrt{2}$ раз (до 0,707) относительно их значения на низкой частоте (соответствующие предельные частоты $f_{h21б}$, $f_{h21э}$, $f_{Y21э}$). Усиление транзистора на частотах, превышающих $f_{h21э}$ и $f_{h21б}$, падает со скоростью 6 дБ на октаву, т. е. при рабочей частоте, в 2 раза превышающей $f_{h21э}$ и $f_{h21б}$, коэффициент усиления уменьшается в 2 раза.

С ростом частоты входного сигнала коэффициент передачи плавно снижается и на некоторой частоте, называемой граничной ($f_{гр} = |h_{21э}|f_{изм}$, где $f_{изм}$ — частота измерения), модуль $h_{21э}$ достигает значения, равного единице, т. е. усиление по току отсутствует (рис. 2.18).

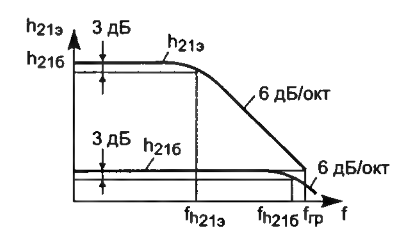


Рис. 2.18. Зависимости коэффициентов передачи тока от частоты

Частота f_{Y21} используется для расчета ограниченного ряда схем (генераторов и широкополосных усилителей) и связана с $f_{гр}$ формулой

$$f_{Y21Э} = f_{гр} r_э / r'_б.$$

Частота f_{max} также связана с $f_{гр}$:

$$f_{max} = \sqrt{f_{гр}/8\pi \cdot r'_б C_к}.$$

Для характеристики транзисторов частота $f_{h21б}$ обычно используется на частотах до 20 МГц, а $f_{гр}$ — свыше 20 МГц.

Имеются формулы, связывающие частоты $f_{h21б}$, $f_{h21э}$ и $f_{гр}$. В частности, $f_{гр} = kf_{h21б}$, где $k = 0{,}65...0{,}82$ для различных типов транзисторов или $f_{h21б} = (1{,}2...1{,}6)f_{гр}$. Для бездрейфовых (сплавных) транзисторов обычно $k = 0{,}82$, а предельная частота $f_{h21э} = (1 - h_{21б})f_{h21б}$. Значения $f_{гр}$ зависят от положения рабочей точки (рис. 2.19) и температуры. Максимум зависимости $f_{гр}$ от тока коллектора (эмиттера) обычно почти совпадает с максимумом зависимости параметра $h_{21э}$ от тока (рис. 2.20). При больших токах предельная частота падает, при малых токах частотные свойства транзисторов также ухудшаются.

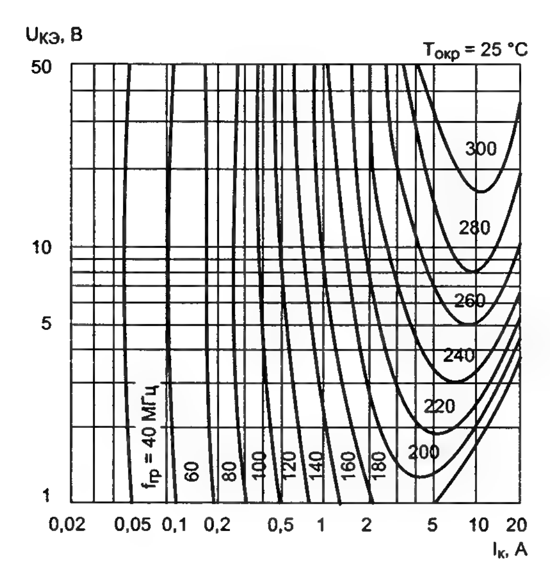


Рис. 2.19. Зависимость граничной частоты от тока коллектора

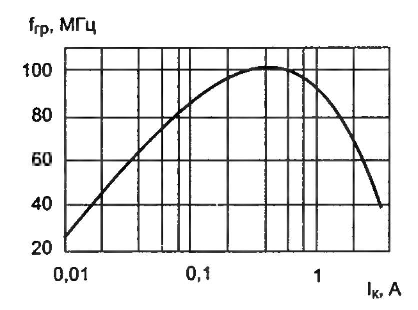


Рис. 2.20. Зависимость граничной частоты от режима работы (Tокр = 25 °C)

Высокочастотные транзисторы

Различие между низкочастотными и высокочастотными транзисторами заключается в размерах активных областей и в значениях параметров структуры и паразитных параметров корпуса — для высокочастотных приборов они должны быть значительно меньшими.

К транзисторам, предназначенным для работы на высоких и сверхвысоких частотах, предъявляется ряд дополнительных требований. Они должны иметь малые емкости между электродами, создающие паразитную обратную связь, и малую индуктивность общего вывода. Кроме того, для получения максимального $K_{уР}$ они должны иметь высокую частоту $f_{гр}$ и малые $\tau_К$, $C_К$ и $U_{КЭ\,нас}$. При создании высокочастотных приборов труднее получить высокую воспроизводимость и идентичность параметров у приборов одного технологического типа.

Высокочастотные транзисторы могут работать и как усилители, и как генераторы. Однако транзистор, оптимальный для усилителя мощности, не обязательно будет пригоден для генератора и, наоборот.

Высокочастотные мощные транзисторы характеризуются такими параметрам, как $P_{вых}$, $K_{уР}$, КПД, $I_{кр}$ (критический ток коллектора, при достижении которого происходит уменьшение $f_{гр}$ в $\sqrt{2}$ раз по отношению к максимальному значению, — определяет условную границу, при которой получают удовлетворительные частотные свойства транзистора). Факторы, определяющие усиление и ширину полосы транзисторных усилителей, могут быть найдены только в комбинации свойств транзистора и схемы, в которой он используется. Кроме того, параметр K_P зависит от условий определения входной и выходной мощностей, поэтому имеется несколько коэффициентов, характеризующих усиление транзистора. В качестве обобщенной характеристики усилительных свойств транзисторов используется U-функция (максимальный $K_{у,\,Р}$ при обратной связи, нейтрализованной внешней схемой). Помимо указанных параметров они должны иметь хорошую устойчивость к рассогласованию нагрузки.

Для получения высокого КПД рабочая точка транзисторов должна находиться вблизи области насыщения. Высокочастотное напряжение насыщения (оно больше статического) определяет также выходную мощность на высокой частоте. Следует отметить, что использовать транзисторы с большими пробивными напряжениями для низковольтных устройств нецелесообразно, так как они имеют большие напряжения насыщения и низкие КПД.

Надежная работа мощных приборов при больших $P_{вых}$ обеспечивается лишь при пониженных значениях параметров электрического и теплового режимов. Обычно $P_{вых}$ указывается в справочниках для уровня, соответствующего надежной работе, и не превышает в режиме непрерывных колебаний 50% $P_{К\,max}$. На высоких частотах выходная мощность изменяется пропорционально $1/f^2$. Она монотонно увеличивается до определенных значений с ростом входной мощности и напряжения источника питания $U_{ип}$.

Высокочастотные транзисторы, используемые в качестве усилителя мощности, должны иметь пробивное напряжение коллекторного перехода в 2...3 раза больше $U_{ип}$. В схемах генераторов при расстройке коллекторной цепи пиковое значение напряжения на коллекторе может достигать (3...4)$U_{ип}$ и более, особенно на нижнем участке рабочего диапазона частот.

Обычно высокочастотные мощные транзисторы работают ненадежно в режимах короткого замыкания и холостого хода и могут отказывать при рассогласовании нагрузки на выходе. Например, транзистор 2N5178 обеспечивает мощность около 50 Вт на частоте 500 МГц лишь в тщательно настраиваемом узкополосном усилителе, и даже при слабом нарушении согласования возможен отказ.

Имеются высокочастотные транзисторы, которые могут работать при всех условиях рассогласования нагрузочного полного сопротивления. Так, транзисторы 2N5764 и 2N5765 могут работать в условиях сильного рассогласования, в отличие от типов 2N4430 и 2N4431. Разработаны также приборы для специальных областей применения, в которых требуются различные значения рабочего напряжения (6; 12; 13,5; 24; 28 В и др.), с различными уровнями широкополосности, с высокой линейностью.

Для передачи информации с помощью кабелей (например, в кабельных телевизионных системах) разработаны специальные широкополосные линейные транзисторы, работающие в классе А или АВ, при котором обеспечивается малый уровень искажений, вызываемых перекрестной модуляцией. Они имеют слабую зависимость коэффициента усиления от тока, малую емкость $C_К$ и применяются на частотах много меньших, чем максимальная рабочая частота. Для стабилизации температурного режима в корпусе транзистора монтируют схему температурной стабилизации с диодом — датчиком температуры. Нелинейность таких транзисторов характеризуется коэффициентом нелинейных (ин-

термодуляционных) искажений. При сравнительной оценке линейности транзисторов могут использоваться зависимости $S_{21}(I_K)$ и $S_{21}(U_K)$.

Транзисторы для линейных широкополосных усилителей, работающих в режиме одной боковой полосы, характеризуются отдаваемой мощностью в пике огибающей (P_{PEP}).

Мощные высокочастотные транзисторы могут применяться в импульсном режиме, при этом выходная мощность может быть увеличена при повышении рабочих напряжений. Например, транзистор MSC1330 имеет в непрерывном режиме выходную мощность 30 Вт на частоте 1,3 ГГц при $U_{ип}$ = 28 В, а в импульсном ($t_и$ = 10 мкс) при $U_{ип}$ = 40 В на той же частоте уже 70 Вт.

Современные мощные высокочастотные транзисторы имеют сложные геометрические и технологические структуры (полосковые, гребенчатые, многоэмиттерные, сетчатые, многоэлементные). В этих структурах возможно развитие второго пробоя, который чаще всего проявляется при работе или испытаниях транзисторов в статическом режиме (на постоянном токе) или режиме класса А.

Среди возможных причин отказа высокочастотных и сверхвысокочастотных усилительных транзисторов можно назвать возникновение генерации за счет паразитных реактивностей схемы, перегрузку при переходных процессах и действие статического электричества.

2.4. Области работы и вольт-амперные характеристики транзисторов

Для транзисторов принято различать четыре области работы (рис. 2.21): отсечки, активную (усиления), насыщения и лавинного пробоя (умножения), а также три схемы включения: с общим эмиттером (ОЭ), общей базой (ОБ) и общим коллектором (ОК). Транзисторы работают в прямом и инверсном включениях.

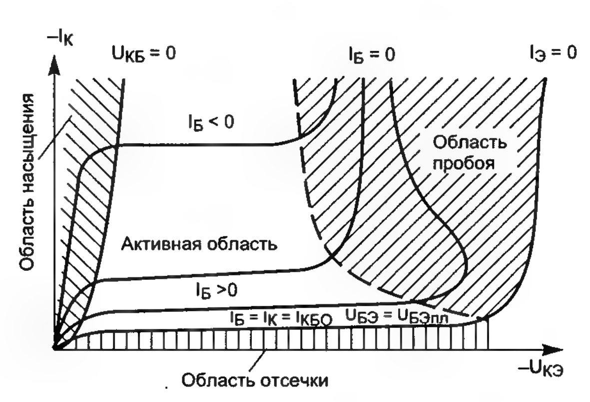


Рис. 2.21. Выходная вольт-амперная характеристика транзистора

При прямом включении в области отсечки оба перехода (эмиттерный и коллекторный) смещены в обратном направлении и через них протекают очень малые токи $I_{КБО}$ и $I_{ЭБО}$. В активной области транзистор работает как усилительный элемент (эмиттерный переход смещен в прямом направлении, а коллекторный — в обратном). В области насыщения оба перехода смещены в прямом направлении, через транзистор протекает большой ток, а остаточное напряжение насыщения коллектор-эмиттер $U_{кэ\,нас}$ характеризует его как переключатель в замкнутом состоянии. В области умножения коллекторный переход находится в состоянии лавинного (электрического) пробоя.

При инверсном включении, в отличие от прямого, эмиттер смещен в обратном направлении, а коллектор — в прямом. Транзистор работает в активной области, но его усилительные свойства хуже (например, $h_{21б\,inv}$ = 0,1...0,8). Дрейфовые (диффузионные) транзисторы редко используются в таком включении, так как из-за асимметрии конструкции (большого различия площадей эмиттера и коллектора) инверсное усиление мало. Инверсный режим может иметь место во время переходных процессов в импульсных схемах.

Вольт-амперные характеристики, приводимые в справочниках, дают информацию о работе транзисторов во всех областях и режимах работы на большом и малом сигналах при различных допустимых сочетаниях токов и напряжений. По ним можно определить ряд основных параметров транзистора, выбрать оптимальное положение рабочей точки, рассчитать нелинейные искажения,

цепи смещения и стабилизации режима. Для анализа режимов и расчета схем обычно широко используются два семейства статических характеристик: входных и выходных для схем с ОБ и ОЭ. При необходимости по ним можно построить переходные характеристики (прямые и обратные). По входным характеристикам определяются параметры $h_{11б}$ и $h_{11э}$, по выходным — $h_{22б}$, $Y_{22б}$, $h_{21э}$, $Y_{21э}$, $Y_{21б}$ (в зависимости от режима).

Наклон начального участка выходных характеристик определяет сопротивление $r_{КЭ\ нас}$. Кроме того, на выходных характеристиках обычно указывают область безопасной работы транзисторов.

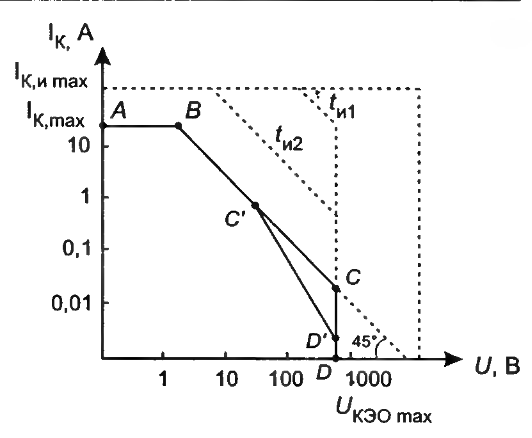


Рис. 2.22. Область безопасных режимов работы (пунктирными линиями — импульсный режим)

Типичная область безопасных режимов работы (ОБР) для статического режима эксплуатации приведена на рис. 2.22. Они ограничены отрезками АВ (определяет значение максимально допустимого тока прибора), CD (определяет значение максимально допустимого напряжения $U_{КЭО\ max}$), ВС (характеризует ограничение электрического режима по мощности, т. е. значение выделяющейся мощности не должно выходить за пределы ВС).

Для большинства транзисторов ОБР ограничивается отрезком C'D' и уменьшается, что связано с воздействием электротепловой нестабильности: выделяющаяся мощность и тепловое сопротивление увеличиваются с ростом температуры (растет нагрев транзистора), а теплоотвод ухудшается и растет температура перехода. Выход рабочей точки за пределы ОБР приводит обычно к необратимому ухудшению параметров транзистора.

Для обеспечения надежной работы режимы использования, особенно мощных транзисторов, должны не выходить за пределы области максимальных режимов.

При переходе от статического режима к импульсному и при уменьшении длительности рабочего импульса $t_и$ границы области ОБР перемещаются в сторону больших значений токов и напряжений. Чем меньше $t_и$ и больше скважность, тем будет больше импульсная мощность рассеяния, вызывающая разогрев p-n-перехода до предельно допустимой температуры.

Импульсный и ключевой режимы работы

Рабочие токи, напряжения или мощности при работе в импульсном и ключевом режимах могут значительно превышать номинальное значение, установленное для режима постоянного тока.

Транзисторные ключи работают в насыщенном (режим переключения) или ненасыщенном режиме (в импульсных усилителях). В первом случае рабочая точка на семействе выходных характеристик циклически перемещается из области отсечки в область насыщения через активную область и обратно. Во втором случае рабочая точка проходит только через две области — отсечки и активную.

В режиме переключения (рис. 2.23, *а*) транзистор как ключевой элемент меняет свое состояние от закрытого (высокое напряжение и малый ток) до открытого (низкое напряжение и большой ток). Насыщенные ключи имеют меньшую мощность рассеяния Pк во включенном состоянии и хорошую помехоустойчивость, но у них хуже быстродействие, так как переход из области насыщения происходит с задержкой, и больше мощность рассеяния на базе при больших степенях насыщения. Увеличение быстродействия транзисторов достигается уменьшением времени жизни неосновных носителей путем легирования активных и пассивных областей структуры атомами золота. Но для таких транзисторов велика вероятность возникновения лавинного пробоя. Поэтому для увеличения быстродействия часто параллельно переходу коллектор-база подключается диод Шотки, что предотвращает насыщение транзистора (отсутствуют режимы накопления и рассасывания зарядов). Такие транзисторы более устойчивы ко второму пробою в случае больших запирающих токов (например КТ635).

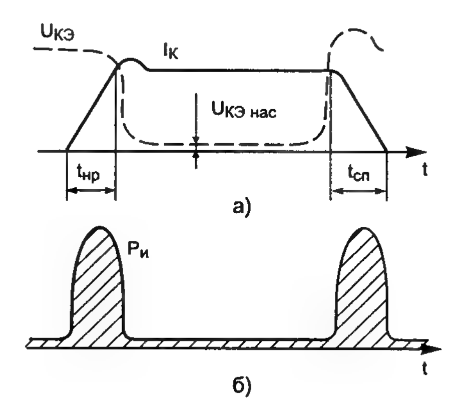


Рис. 2.23. Выходные напряжение и ток (*а*) и выходная мощность (*б*) импульсного транзистора

Для переключательных транзисторов в справочниках приводятся импульсные значения максимально допустимых параметров или графики, позволяющие определить импульсную рассеивае-

мую мощность $P_и$ в зависимости от соотношения длительности импульса $t_и$, скважности Q и частоты. Значения $P_и$ на фронте или срезе импульса могут превышать $P_{к\,max}$ (рис. 2.23, *б*). Ток $I_{К,\,и\,max}$ обычно определяется экспериментально для заданной длительности импульса и ограничивается $P_{к\,max}$. Формы входного и выходного импульсов тока представлены на рис. 2.24. Как видно, выходной импульс сдвинут относительно входного на $t_{зд}$, а фронт и срез имеют конечную длительность. Задержка фронта обусловлена зарядом входной емкости, равной сумме барьерных емкостей эмиттерного и коллекторного переходов.

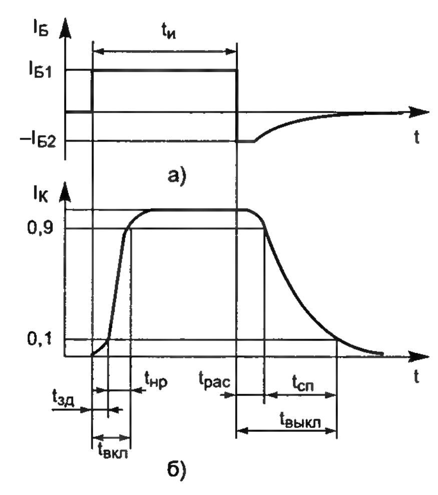


Рис. 2.24. Форма токов базы и коллектора импульсного транзистора

Время переключения транзистора, т. е. его быстродействие, состоит из времен включения $t_{вкл}$ и выключения $t_{выкл}$. В свою очередь, время включения состоит из времен задержки $t_{зд}$ и нарастания $t_{нр}$, а время выключения — из времен задержки выключения $t_{рас}$ (времени рассасывания) и спада $t_{сп}$. Время переключения определяется как свойствами самого транзистора, так и выбранной схемой включения транзистора и параметрами управляющего сигнала. Оно является функцией частоты $f_{гр}$ и эмиттерного и коллекторного токов. Получить высокое быстродействие при большом токе трудно.

Для высокочастотных транзисторов (с $f_{гр} > 100$ МГц) задержка включения определяется в основном емкостью $C_э$. Кремниевые транзисторы имеют большие значения $t_{зд}$, чем германиевые. Время задержки может быть уменьшено путем увеличения мощности включающего сигнала. Для времени нарастания влияние емкости $C_э$ незначительно, но играют роль $f_{гр}$ и входной ток. Как уже отмечалось, на длительности фронта и среза значительное влияние оказывает емкость $C_к$. Время $t_{сп}$ зависит от $I_К$ и от отношения $I_К/I_Б$.

Время рассасывания зависит от конкретной схемы включения и режима измерения. При больших степенях насыщения (или больших запирающих токах) и существенных отклонениях режима использования от указанного в справочнике время рассасывания может принимать значения, отличающиеся от номинального.

Параметры $t_{рас}$, $C_к$, $C_э$, $f_{гр}$, $h_{21Э}$ дают возможность сравнивать переключательные свойства транзисторов при одинаковых режимах измерения.

Параметры $t_{вкл}$ и $t_{выкл}$ приводятся лишь для некоторых типов транзисторов, используемых при предельном быстродействии. Эти времена определяются для конкретной (типовой) электрической схемы, зависят от элементов внешних цепей (сопротивления нагрузки, сопротивления входной цепи, реактивных сопротивлений) и используются как справочные или рекламные сведения.

Работа транзистора в режиме насыщения характеризуется также остаточным напряжением коллектор—эмиттер $U_{КЭ\,нас}$ или сопротивлением насыщения $r_{кэ\,нас}$. При сравнении транзисторов удобнее использовать параметр $r_{кэ\,нас}$, а не $U_{КЭ\,нас}$, так как он слабо зависит от тока. Напряжение $U_{КЭ\,нас}$ зависит от геометрических и физических параметров транзистора. Его уменьшают, выбирают определенную геометрию структуры, а также создавая конструкции с эпитаксиальными слоями. С увеличением степени насыщения (в 3...5 раз и выше) $U_{КЭ\,нас}$ почти не меняется. С ростом температуры оно несколько увеличивается (рис. 2.25). Большое сопротивление $r_{кэ\,нас}$ транзистора и диода увеличивает потери мощности в приборах и снижает КПД устройств, особенно при работе на больших токах.

Переключательные транзисторы (в отличие от усилительных) обычно имеют малые остаточные напряжения ($U_{КЭ\,нас}$, $U_{БЭ\,нас}$), времена переключения и большие пробивные напряжения $U_{КБО\,проб}$,

$U_{ЭБО\,проб}$. Для этих транзисторов нет необходимости иметь большие $h_{21э}$. В общем случае мощность, выделяемая транзистором в ключевом режиме, состоит из мощностей, выделяющихся на коллекторном переходе в режиме насыщения ($P_{вкл}$), в режиме отсечки ($P_{выкл}$), в процессе перехода транзистора из одного режима в другой ($P_{пер}$), и управляющей мощности в цепи базы ($P_{упр}$). При небольших рабочих частотах (менее 1 кГц) основной составляющей, определяющей тепловые потери в транзисторе, является $P_{вкл}$. Мощностью $P_{пер}$ ограничивается предельная частота работы транзистора. Следует отметить, что для надежного отпирания транзистора необходимо подавать напряжение, превышающее плавающее напряжение $U_{ЭБ\,пл}$ — напряжение между выводами базы и эмиттера, обусловленное параметрами $I_{КБО}$, $r'_б$ и сопротивлением утечки.

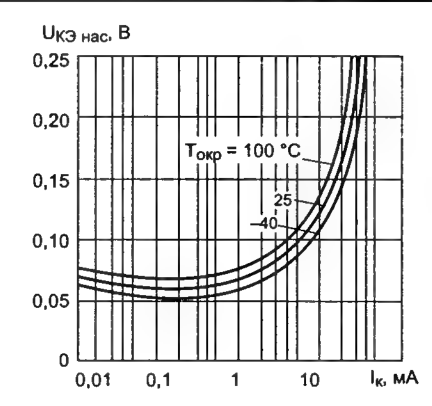


Рис. 2.25. Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора при различных значениях температуры

2.5. Надежность и применение биполярных транзисторов

Надежность полупроводниковых приборов существенно зависит от электрических и тепловых режимов работы, т. е. определяется реальными условиями их эксплуатации. Приборы работают надежно, если их рабочие токи, напряжения, мощности, температура перехода и температура окружающей среды не превышают максимально допустимых значений.

Надежность полупроводниковых приборов закладывается еще на этапе разработки и в дальнейшем обеспечивается на всех стадиях их изготовления. В производственных условиях надежность приборов зависит от конструкции, технологии изготовления (например, надежность планарных приборов выше надежности сплавных и сплавно-диффузионных) и методов контроля качества и надежности.

В ТУ на приборы определены условия, при которых гарантируется их надежная и устойчивая работа и предусмотрен комплекс мероприятий для обеспечения высокой надежности. При заводских испытаниях проводятся испытания приборов на безотказность и долговечность, позволяющие определить производственную надежность (для оговоренных в ТУ режимов, условий испытаний и критериев отказов), как правило, в условиях и режимах более тяжелых, чем условия эксплуатации, и с оценкой результатов испытаний по более жестким критериям. Количественные показатели надежности приборов в процессе работы в аппаратуре определяются эксплуатационной надежностью. Эксплуатационная надежность (в конкретных режимах, условиях и схемах применения) обычно выше производственной, т. е. интенсивность отказов приборов в аппаратуре меньше, чем при заводских испытаниях.

Разница между производственной и эксплуатационной надежностями более значительна, если приборы работают в облегченных электрических и эксплуатационных режимах по сравнению с максимально допустимыми (предусмотрены запасы по напряжению, току и мощности рассеяния) и если работа схемы (устройства) допускает большой диапазон изменения параметров используемых приборов. Для повышения надежности транзисторов при эксплуатации необходимо выбирать рабочие режимы с коэффициентом нагрузки по напряжению и мощности в диапазоне 0,7...0,8. Не рекомендуется применять транзисторы при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми обратными токами во всем диапазоне рабочих температур, а также в совмещенных предельных режимах.

Данные об эксплуатационной надежности накапливаются при эксплуатации аппаратуры и учитываются при ее доработке или усовершенствовании.

Применение биполярных транзисторов

Среди серийно выпускаемых транзисторов имеются приборы как общего назначения (малошумящие, переключательные и генераторные), так и специализированные, отличающиеся специфическим сочетанием параметров: для применения в схемах с автоматической регулировкой усиления, для работы в микроамперном диапазоне токов, двухэмиттерные, однопереходные, сдвоенные и счетверенные, с малой емкостью обратной связи, универсальные (по сочетанию параметров), комплементарные пары транзисторов, составные и лавинные транзисторы.

Общими для расчетов усилителей на транзисторах (постоянного тока, низкой частоты, промежуточной частоты, высокой частоты и др.) являются входное и выходное сопротивления каскада, соотношения, определяющие усиление, частотные свойства, режимы работы, температурная стабильность и прочие показатели.

В соответствии с назначением различают каскады предварительного усиления (напряжения, тока или мощности), предназначенные для получения максимального усиления (обычно по резисторной или трансформаторной схемам), и каскады усиления мощности, обеспечивающие на заданной нагрузке необходимую (выходную) мощность при минимальных искажениях и мощности потребления от источника питания. В многокаскадных усилителях с отрицательной обратной связью имеют место фазовые сдвиги между входными и выходными токами, поэтому для их устойчивой работы транзисторы выбирают исходя из условия $f_в \leq 0{,}3f_{h21э}$ ($f_в$ — верхняя рабочая частота усилителя); при малой обратной связи $f_в \leq f_{h21э}$. Возможны два варианта усилителя с мощным выходным каскадом: бестрансформаторный (с выходной мощностью не более 5...10 Вт) и трансформаторный (на десятки и сотни ватт). При выходной мощности 0,1...1 Вт каскады выполняются однотактными с режимом работы в классе А; при больших значениях мощности — двухтактными с режимом работы в классах А, АВ или В.

В схемах с дополнительной симметрией, т. е. с использованием транзисторов со структурами p-n-p и n-p-n, приборы должны иметь одинаковые параметры и характеристики. Требуется подбор пар последовательно включенных транзисторов по параметрам $h_{21э}$ и $f_{h21э}$ с разбросом не более 10...15%. Для этой цели разработаны специальные (комплементарные) пары транзисторов, например отечественные транзисторы со структурами n-p-n и p-n-p соответственно: КТ502 и КТ503; КТ814 и КТ815; КТ816 и КТ817; КТ818 и КТ819 и другие.

В каскадах предварительного усиления напряжение $U_{КЭ}$ в рабочей точке мало (несколько вольт). Оно выбирается из соображений получения малого напряжения шумов или неискаженной формы сигнала на выходе.

В усилителях, имеющих хорошую температурную и режимную стабилизацию, замена транзистора на однотипный с более высоким значением $h_{21э}$ обычно не приводит к значительному увеличению тока коллектора в рабочей точке.

В транзисторных генераторах наиболее предпочтительными являются режимы классов В и С (реже АВ). При расчете транзисторного генератора с внешним возбуждением по заданным выходной мощности и верхней рабочей частоте выбирают тип транзистора и проверяют его пригодность по параметрам $P_К$, $f_{гр}$ и предельно допустимым параметрам $U_{КБО\ max}$, $U_{ЭБО\ max}$, $I_{К\ max}$ для заданного угла отсечки коллекторного тока. Для расчета генераторов необходимо также знать $C_к$, $\tau_к$, f_{max}. Следует учитывать, что чем выше частота генерируемых колебаний, тем меньше коэффициент усиления по мощности $K_{ур}$. Для получения $K_{ур}$ = 5...7 дБ необходимо, чтобы частота $f_в$ была в 4...10 раз ниже $f_{h21б}$.

В каскадах усиления и генерации мощности $U_{КЭ}$ выбирается достаточно большим для получения максимального КПД и малых нелинейных искажений.

Транзисторы некоторых типов используются в специфических классах схем и характеризуются рядом особенностей режима и условий работы. Эти специализированные транзисторы образуют своеобразный класс приборов, например, транзисторы для схем с автоматической регулировкой усиления (АРУ), для усилителей промежуточной частоты, для работы в микроамперном диапазоне токов, для работы в ВЧ- и СВЧ-диапазонах, лавинные транзисторы, сдвоенные, составные, двухэмиттерные и т. п. Есть узлы, в которых требуются высоковольтные транзисторы. Кроме того, разработаны транзисторы универсального назначения. Оптимальное сочетание параметров и характеристик, удовлетворяющих различным требованиям, дает возможность использовать их в радиоэлектронной аппаратуре вместо некоторых усилительных и переключательных транзисторов (например, транзистор КТ630).

Для схем с АРУ разработаны специальные транзисторы (германиевые и кремниевые), обладающие регулируемым усилением при увеличении рабочего тока (прямая АРУ). Уменьшение усиления таких транзисторов на высокой частоте происходит вследствие снижения $f_{гр}$ при увеличении тока эмиттера и уменьшения напряжения на коллекторе, например, КТ3128, ГТ328, КТ3153, предназначенные для применения в радиоприемниках с АРУ и телевизорах (каскады ПТК и УПЧ), блоках УКВ приемников (за счет смещения их рабочей точки можно регулировать усиление в широком диапазоне). В связи с этим наблюдается сильная зависимость Кур от тока. Обычно транзисторы имеют меньшую зависимость коэффициента усиления от электрического режима. Для зарубежных транзисторов, предназначенных для АРУ, часто указывается глубина регулировки усиления (отношение максимального коэффициента усиления к минимальному).

Жесткие требования к экономичности радиоэлектронной аппаратуры в ряде специальных применений способствовали созданию кремниевых транзисторов, функционирующих при малых токах (единицы и десятки микроампер), поскольку германиевые транзисторы вследствие большого обратного тока коллектора для этой цели непригодны. Такие приборы (например, транзисторы КТ3102, КТ3107) имеют малые токи $I_{КБО}$ и большие коэффициенты усиления. Однако при работе в микрорежиме у них ухудшаются частотные свойства, но несколько улучшаются шумовые характеристики. Кроме того, при малых токах обычно увеличивается зависимость параметров от температуры, снижается крутизна и затрудняется стабилизация режима.

Реализация большого коэффициента усиления по мощности в высокочастотных усилителях связана с уменьшением паразитной обратной связи, обусловленной проходной проводимостью транзистора Y_{12}. Разработаны транзисторы (например, КТ339АМ), у которых для снижения емкости обратной связи в транзисторную структуру введен интегральный экран (электростатический экран Фарадея), представляющий собой сочетание диффузионного экрана и дополнительного экранирующего диода. Применение интегрального экрана позволяет снизить емкость между коллекторным и базовым выводами в 2,5...4 раза (емкость $C_{12э}$ снижается до значения не более 0,3 пФ) и обеспечить большой коэффициент усиления $K_{ур}$ без применения схем нейтрализации.

Лавинные транзисторы предназначены для работы в режиме электрического пробоя коллекторного перехода. В зависимости от схемы включения они могут иметь управляемые S-образные (со стороны коллектора или эмиттера) и N-образные (со стороны базы) вольт-амперные характеристики. Использование обычных транзисторов в этом режиме принципиально возможно и встречается на практике, но при этом не обеспечиваются необходимые быстродействие, амплитуда импульсов, стабильность и надежность. Например, одной из причин, снижающих эффективность применения обычных высокочастотных транзисторов в лавинном режиме, является значительное снижение частоты $f_{гр}$ при увеличении коллекторного тока.

Лавинные транзисторы имеют следующие основные параметры: напряжение лавинного пробоя коллекторного перехода $U_{КБО\,проб}$, напряжение пробоя при отключенной базе $U_{КЭО\,проб}$, напряжение $U'_{КЭО\,проб}$ в максимуме вольт-амперной характеристики, зависящее от сопротивления $R_{бэ}$ и управляющего тока, максимальный ток разряда и время нарастания лавинного импульса. Область лавинного пробоя лежит между напряжениями $U_{КБО\,проб}$ и $U_{КЭО\,проб}$. Лавинные транзисторы применяются в релаксационных генераторах в ждущем или автоколебательном режиме и позволяют получить необходимое быстродействие и амплитуду импульсов при более высоких надежности и стабильности, чем обычные транзисторы, используемые в режиме пробоя.

С помощью лавинных транзисторов можно формировать амплитуды импульсов 10...15 В и выше на низкоомной нагрузке (50...70 Ом) и при малом времени нарастания фронта (менее 1 нс).

Отечественной промышленностью выпускаются лавинные транзисторы типов ГТ338 и КТ3122, за рубежом — лавинные транзисторы типов ASZ23, ECL1239, NS1110—NS1116, PADT51, RT1110—RT1116, SYL3013, 2N3033—2N3035, 2N5236, 2N5271, 2SA252, 2SA411.

В связи с тем, что напряжения датчиков контролируемых параметров (например, термопары), изменяются от десятков микровольт до десятков милливольт, то транзисторные модуляторы, преобразующие эти малые напряжения постоянного тока в переменные для последующего усиления, должны иметь хорошие метрологические характеристики. При работе транзистора в качестве модулятора ключевым элементом служит промежуток коллектор-эмиттер, сопротивление которого изменяется в зависимости от полярности управляющего напряжения, приложенного к одному из p-n-переходов транзистора. Различают работу такого ключа в нормальном включении (управляющее напряжение $U_у$ приложено между базой и эмиттером) и инверсном включении $U_у$ приложено между базой и коллектором). Если $U_у$ приложено, например, в p-n-p транзисторе минусом к базе, то оба перехода транзистора будут смещены в прямом направлении (режим насыщения — ключ открыт). При изменении полярности $U_у$ оба перехода смещаются в обратном направлении (режим отсечки — ключ закрыт). В реальном режиме точки пересечения прямых режима насыщения и режима отсечки не совпадают с началом координат. Поэтому промежуток коллектор-эмиттер характеризуется остаточным сопротивлением $R_{ост}$ и напряжением $U_{ост}$ в открытом состоянии, а также сопротивлением $R_{закр}$ и остаточным током $I_{закр}$ в закрытом состоянии (у идеального ключа $R_{ост} = 0$, $U_{ост} = 0$, $R_{закр} = \infty$, $I_{закр} = 0$). Остаточные параметры ограничивают значение (уровень) полезной мощности в нагрузке. Следует отметить, что транзисторный ключ в инверсном включении имеет примерно на порядок меньшие значения $U_{ост}$ и $I_{закр}$, чем в прямом включении (особенно для сплавных транзисторов, у которых площадь коллектора много больше площади эмиттера).

Для некоторых транзисторов (например, КТ206, КТ209) нормируются остаточные параметры ($U_{ост} \leq 12$ мВ). Кроме того, разработаны двухэмиттерные транзисторы, которые имеют еще меньшие значения остаточных параметров (например, у КТ118 $U_{ост}$ менее 0,2 мВ, зарубежные 3N74, 3N111).

Следует также отметить транзисторы, предназначенные для использования в инверсном включении (например, зарубежные транзисторы 2N2432, 2N2944—2N2946, 2N4138), которые имеют малое остаточное напряжение (менее 1 мВ) и применяются в модуляторах для стабильных усилителей постоянного тока, построенных по схеме модуляции—демодуляции, в схемах управления реверсивными двигателями, в логических схемах, амплитудных детекторах и других схемах. В некоторых схемах, например автомобильного зажигания и строчной развертки телевизоров, при запирании транзистор может переходить в режим инверсного включения при работе на комплексную нагрузку.

Для работы в выходных каскадах усилителя низких частот радиовещательных приемников, высококачественных магнитофонов, радиол, телевизоров разработаны германиевые и кремниевые транзисторы разного типа проводимости (например ГТ401, ГТ402, ГТ701, ГТ703). Они характеризуются слабой зависимостью коэффициента усиления от тока, высокой частотой $f_{h21э}$, низким напряжением $U_{КЭ\ нас}$, что позволяет улучшить акустические показатели устройств в широком диапазоне звуковых частот. В свою очередь, это дает возможность упрощать схемы усилителей, уменьшать число применяемых транзисторов, повышать надежность и снижать себестоимость устройств. Зависимость коэффициента передачи $h_{h21э}$ от тока характеризуется коэффициентом линейности — отношением коэффициентов передачи при двух значениях тока эмиттера.

Составные транзисторы представляют собой соединение двух биполярных транзисторов по определенной схеме (например, в схеме Дарлингтона соединены коллекторы, входом служит база первого транзистора, а эмиттером — эмиттер второго, более мощного транзистора). Такие транзисторы функционально соответствуют одному транзистору с высоким коэффициентом передачи тока, примерно равным произведению коэффициентов передачи составляющих его одиночных транзисторов. Составные транзисторы (например, КТ712, КТ825, КТ827, КТ829, КТ834, КТ852, КТ853, КТ972, КТ973, КТ8131, КТ8141, КТ8143, КТ890, КТ894, КТ896, КТ897, КТ898, КТ899, КТ8115, КТ8116, КТ8158, КТ8159, КТ8214, КТ8215, КТ8225) применяются в стабилизаторах напряжения непрерывного и импульсного действия, бесконтактных электронных системах зажигания в двигателях внутреннего сгорания (например, КТ848), устройствах управления двигателями, в различных усилительных и переключательных устройствах.

Для экономичной радиоэлектронной аппаратуры созданы маломощные кремниевые транзисторы с различной структурой, которые могут нормально функционировать в микроамперном диапазоне токов (например, КТ3102, КТ3107, КТ3129, КТ3130).

Ряд транзисторов разработан для целевого применения:

- высоковольтные для оконечных каскадов строчной развертки черно-белых и цветных телевизоров (например, КТ872) и высоковольтных источников питания (КТ8126, КТ8224, КТ8228);
- импульсные для работы на индуктивную нагрузку (КТ997);
- для высококачественных усилителей низкой частоты (КТ9115), линейных высокочастотных каскадов класса А и широкополосных усилителей;
- для селекторов телевизоров, с повышенной устойчивостью к интермодуляционным искажениям (КТ3109);
- для сбалансированных фазоинверсных каскадов высококачественных УНЧ и видеоусилителей телевизоров (КТ940, КТ969, КТ9115, КТ828, КТ838, КТ846, КТ850, КТ872, КТ893; КТ895 и КТ8138Е, КТ8138И (с демпферным диодом), КТ999;
- для высокочастотных широкополосных усилителей с малой постоянной времени $\tau_к$ (КТ368);
- для строчной и кадровой разверток телевизоров (КТ805, КТ8107, КТ8118, КТ8129, КТ887, КТ888);
- для УНЧ и кадровой развертки телевизоров (КТ807);
- для линейных и импульсных устройств (КТ315 — первый отечественный прибор в пластмассовом корпусе); ·
- универсальные транзисторы для вычислительных устройств (КТ349, КТ350, КТ351, КТ352);
- для предварительных каскадов видеоусилителей телевизоров (КТ342);
- для применения в ключевых схемах, прерывателях, модуляторах и демодуляторах, во входных каскадах усилителей (КТ201 и КТ203);
- высоковольтные для строчной развертки телевизоров (КТ808) — при непосредственном включении отклоняющих катушек в цепь коллектора они выдерживают импульсы 800... 1000 В;
- для мощных модуляторов (КТ917 и КТ926).

Для линейных широкополосных усилителей предназначены транзисторы КТ610 ($U_п$ = 10 В), КТ912 и КТ921 ($U_п$ = 27 В), КТ927, КТ932, КТ936, КТ939 ($U_п$ = 28 В), КТ955, КТ956, КТ957, КТ965, КТ966, КТ967, КТ972, КТ980, КТ981 $U_п$ = 12,6 В), КТ9133, КТ9116 (в схемах с общим эмиттером, $U_п$ = 28 В).

Транзисторы КТ117, КТ119, КТ132, КТ133 являются однопереходными. Транзистор КТ120Б-1 имеет два вывода (используется в качестве диода). Транзисторные сборки, состоящие из двух транзисторов с согласующими LC-цепями (балансовые транзисторы), КТ985, КТ991, КТ9101, КТ9105 предназначены для построения двухтактных широкополосных усилителей мощности класса С в схеме с общей базой (ОБ).

Для построения схем генераторов, усилителей мощности с независимым возбуждением и умножителей используются транзисторы КТ606 ($U_п$ = 28 В), КТ607 ($U_п$ = 20 В), КТ640 и КТ643 (с ОБ, $U_п$ = 15 В), КТ642, КТ647 ($U_п$ = 15 В), КТ648 ($U_п$ = 10 В), КТ657 (с ОЭ, $U_п$ = 15 В), КТ682, КТ996 $U_п$ = 10 В), КТ902, КТ904, КТ907, КТ909, КТ911, КТ913, КТ914, КТ916, КТ922, КТ930, КТ931, КТ934, КТ944, КТ970, КТ971 $U_п$ = 28 В), КТ930 ($U_п$ = 30 В), КТ918, КТ938 ($U_п$ = 20 В), КТ919 (с ОБ, $U_п$ = 28 В), КТ920, КТ925, КТ960, КТ963 ($U_п$= 12,6 В), КТ929 ($U_п$ = 8 В), КТ937 (с ОБ, $U_п$ = 21 В), КТ942, КТ946, КТ948, КТ962, КТ976 (допускают работу на рассогласованную нагрузку), КТ9104 (с ОБ, $U_п$ = 28 В), КТ945, КТ947 ($U_п$ = 27 В), КТ977 (с ОК, $U_п$ = 40 В), КТ9142.

Транзистор КТ921В представляет собой высокотемпературный прибор (рабочий диапазон температур −60...+200 °С). Для видеоусилителей графических дисплеев используется транзистор КТ9141, а для схем фотовспышек — КТ863 и КТ9137, транзистор КТ3166 — для контроля температуры воздуха и элементов конструкции систем (у него соединены коллектор и база).

Комплементарные транзисторные пары КТ511 и КТ512, КТ513 и КТ514, КТ515 и КТ516, предназначены для применения в усилительных схемах с дополнительной симметрией. Эти транзисторы выпускаются в корпусе КТ-47 (зарубежный аналог Sot-89) для применения в схемах для поверхностного монтажа. Комплементарные транзисторы КТ520 и КТ521 выпускаются в корпусе КТ-26.

Транзисторы типов КТ517 и КТ523 представляют собой схемы Дарлингтона и выпускаются в различных корпусах (КТ-26, КТ-27 и КТ-46). Транзисторы типа КТ528 предназначены для применения в схемах с рабочими токами до 2 А и имеют корпус для поверхностного монтажа (КТ-47).

Транзисторы КТ519А, КТ6128 предназначены для малошумящих низкочастотных усилителей, а транзисторы КТ524 и КТ525 предназначены для двухтактных выходных усилителей, работающих в режиме класса «В» портативных радиоприемников. В малошумящем предварительном усилителе может использоваться транзистор КТ526А.

Транзисторы КТ732—КТ739, КТ6136 и КТ6137, КТ8212 и КТ8213, КТ8229 и КТ8230 предназначены для схем с дополнительной симметрией со структурами n-p-n и p-n-p в линейных переключательных и усилительных схемах.

Для схем усилителей промежуточной частоты АМ/ЧМ-приемников, гетеродинов ЧМ/УКВ-тюнеров предназначены транзисторы КТ6140, в схемах усилителей мощности, стабилизаторах и переключателях применяются транзисторы КТ8199. Для схем высоковольтных ключей, стабилизаторов с импульсным регулированием и систем управления электроприводом двигателей предназначены транзисторы КТ8201, КТ8203, КТ8205, КТ8207 и КТ8209. Конструктивно эти транзисторы могут изготавливаться как в корпусном, так и в бескорпусном исполнениях (в виде кристалла).

Необходимо также отметить комплементарные пары транзисторов Дарлингтона КТ8233 и КТ8234, КТ8240 и КТ8241, КТ8242 и КТ8243, КТ8244 и КТ8245, выпускаемых в бескорпусном исполнении, и мощные транзисторы КТ8246 и КТ8250 (на ток 15 А), КТ8171, КТ8232, КТ740, КТ8111 (на ток 20 А), мощные генераторные транзисторы КТ9131, КТ9132, КТ9147, КТ9153, КТ9156 для работы в ВЧ и СВЧ диапазонах.

Комплементарные транзисторы (со структурами p-n-p и n-p-n) КТ315 и КТ361, ГТ402 и ГТ403, ГТ703 и ГТ705, КТ502 и КТ503, КТ664 и КТ665, КТ666 и КТ667, КТ680 и КТ681, КТ719 и КТ720, КТ721 и КТ722, КТ723 и КТ724, КТ814 и КТ815, КТ816 и КТ817, КТ818 и КТ819, КТ8101 и КТ8102, КТ969 и КТ9115, КТ8130 и КТ8131, КТ9144 и КТ9145, КТ9180 и КТ9181 могут использоваться в паре в схемах с дополнительной симметрией.

Имеется также группа транзисторов в миниатюрном корпусе для поверхностного монтажа в составе гибридных микросхем (например, малошумящие КТ3129 и КТ3130, КТ682; переключательные КТ3145 и КТ3146; для работы в усилителях, в системах спутниковой связи, ключевых схемах, модуляторах, преобразователях, линейных стабилизаторах напряжения КТ216, КТ3170А9, КТ3173А9, КТ3179А9, КТ3180А9, КТ3186А9, КТ3187А9, КТ664 и КТ665; для СВЧ усилителей КТ3168, КТ3169).

2.6. Биполярные германиевые транзисторы

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
ГТ108А	p-n-p	75	0,5*	5	5	50	10 (5 В)
ГТ108Б	p-n-p	75	1*	5	5	50	10 (5 В)
ГТ108В	p-n-p	75	1*	5	5	50	10 (5 В)
ГТ108Г	p-n-p	75	1*	5	5	50	10 (5 В)
ГТ109А	p-n-p	30	≥1*	10 (18 имп.)	—	20	≤5 (5 В)
ГТ109Б	p-n-p	30	≥1*	10 (18 имп.)	—	20	≤5 (5 В)
ГТ109В	p-n-p	30	≥1*	10 (18 имп.)	—	20	≤5 (5 В)
ГТ109Г	p-n-p	30	≥1*	10 (18 имп.)	—	20	≤5 (5 В)
ГТ109Д	p-n-p	30	≥3*	10 (18 имп.)	—	20	≤2 (1,2 В)
ГТ109Е	p-n-p	30	≥5*	10 (18 имп.)	—	20	≤2 (1,2 В)
ГТ109Ж	p-n-p	30	—	10 (18 имп.)	—	20	≤1 (1,5 В)
ГТ109И	p-n-p	30	≥1*	10 (18 имп.)	—	20	≤5 (5 В)
ГТ115А	p-n-p	50	≥1*	20	20	30	≤40 (20 В)
ГТ115Б	p-n-p	50	≥1*	30	20	30	≤40 (30 В)
ГТ115В	p-n-p	50	≥1*	20	20	30	≤40 (20 В)
ГТ115Г	p-n-p	50	≥1*	30	20	30	≤40 (30 В)
ГТ115Д	p-n-p	50	≥1*	20	20	30	≤40 (20 В)
ГТ122А	n-p-n	150	≥1*	35	—	20 (150*)	≤20 (5 В)
ГТ122Б	n-p-n	150	≥1*	20	—	20 (150*)	≤20 (5 В)
ГТ122В	n-p-n	150	≥2*	20	—	20 (150*)	≤20 (5 В)
ГТ122Г	n-p-n	150	≥2*	20	—	20 (150*)	≤20 (5 В)
ГТ124А	p-n-p	75	≥1*	25	10	100*	≤15 (15 В)
ГТ124Б	p-n-p	75	≥1*	25	10	100*	≤15 (15 В)
ГТ124В	p-n-p	75	≥1*	25	10	100*	≤15 (15 В)
ГТ124Г	p-n-p	75	≥1*	25	10	100*	≤15 (15 В)
ГТ125А	p-n-p	150	≥1*	35	20	300*	≤15 (15 В)
ГТ125Б	p-n-p	150	≥1*	35	20	300*	≤15 (15 В)
ГТ125В	p-n-p	150	≥1*	35	20	300*	≤15 (15 В)
ГТ125Г	p-n-p	150	≥1*	35	20	300*	≤15 (15 В)
ГТ125Д	p-n-p	150	≥1*	35	20	300*	≤15 (15 В)
ГТ125Е	p-n-p	150	≥1*	35	20	300*	≤15 (15 В)
ГТ125Ж	p-n-p	150	≥1*	35	20	300*	≤15 (15 В)
ГТ125И	p-n-p	150	≥1*	70	20	300*	≤15 (15 В)
ГТ125К	p-n-p	150	≥1*	70	20	300*	≤15 (15 В)
ГТ125Л	p-n-p	150	≥1*	70	20	300*	≤15 (15 В)
ГТ305А	p-n-p	75	≥140	15	1,5	40 (100*)	—
ГТ305Б	p-n-p	75	≥160	15	1,5	40 (100*)	—
ГТ305В	p-n-p	75	≥160	15	0,5	40 (100*)	≤4 (15 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r^{*}_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
20...50 (5 В; 1 мА) 35...80 (5 В; 1 мА) 60...130 (5 В; 1 мА) 110...250 (5 В; 1 мА)	50 (50 В) 50 (50 В) 50 (50 В) 50 (50 В)	— — — —	— — — —	5000 5000 5000 5000	ГТ108
20...50 (5 В; 1 мА) 35...80 (5 В; 1 мА) 60...130 (5 В; 1 мА) 110...250 (5 В; 1 мА) 20...70 (5 В; 1 мА0 50...100 (5 В; 1 мА) ≥100* (1,5 В) 20...80 (5 В; 1 мА)	≤30 (5 В) ≤30 (5 В) ≤30 (5 В) ≤30 (5 В) ≤40 (1,2 В) ≤40 (1,2 В) — ≤30 (5 В)	— — — — — — — —	— — — — — — — ≤12 (1 кГц)	≤10000 ≤10000 ≤10000 ≤10000 ≤10000 ≤10000 ≤10000 ≤10000	ГТ109
20...80 (1 В; 25 мА) 20...80 (1 В; 25 мА) 60...150 (1 В; 25 мА) 60...150 (1 В; 25 мА) 125...250 (1 В; 25 мА)	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	ГТ115
15...45 (5 В; 1 мА) 15...45 (5 В; 1 мА) 30...60 (5 В; 1 мА) 30...60 (5 В; 1 мА)	— — — —	— — — —	200* 200* 200* 200*	— — — —	ГТ122
28...56 (0,5 В; 0,1 А) 45...90 (0,5 В; 0,1 А) 71...162 (0,5 В; 0,1 А) 120...200 (0,5 В; 0,1 А)	— — — —	≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5	— — — —	— — — —	ГТ124
28...56 (0,5 В; 25 мА) 45...90 (5 В; 25 мА) 71...140 (5 В; 25 мА) 120...200 (5 В; 25 мА) ≥28* (0,5 В; 100 мА) 45...90 (5 В; 25 мА) 71...140 (5 В; 25 мА) 25...56* (0,5 В; 100 мА) 45...90* (0,5 В; 100 мА) 71...140* (0,5 В; 100 мА)	— — — — — — — — — —	≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	ГТ125
25...80* (1 В; 10 мА) 60...180* (1 В; 10 мА) 40...120* (5 В; 5 мА)	≤7 (5 В) ≤7 (5 В) ≤5,5 (5 В)	≤50 ≤50 —	— — ≤6 (1,6 МГц)	≤300 ≤300 ≤300	ГТ305

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
ГТ308А	p-n-p	150 (360**)	≥90	20	3	50 (120*)	≤2 (5 В)
ГТ308Б	p-n-p	150 (360**)	≥120	20	3	50 (120*)	≤2 (5 В)
ГТ308В	p-n-p	150 (360**)	≥120	20	3	50 (120*)	≤2 (5 В)
ГТ308Г	p-n-p	150 (360**)	≥120	20*	3	50 (120*)	≤2 (5 В)
ГТ309А	p-n-p	75	≥120	10	1,5	10	≤5 (5 В)
ГТ309Б	p-n-p	75	≥120	10	1,5	10	≤5 (5 В)
ГТ309В	p-n-p	75	≥80	10	1,5	10	≤5 (5 В)
ГТ309Г	p-n-p	75	≥80	10	1,5	10	≤5 (5 В)
ГТ309Д	p-n-p	75	≥80	10	1,5	10	≤5 (5 В)
ГТ309Е	p-n-p	75	≥80	10	1,5	10	≤5 (5 В)
ГТ310А	p-n-p	20 (35°C)	≥160	12	—	10	≤5 (5 В)
ГТ310Б	p-n-p	20 (35°C)	≥160	12	—	10	≤5 (5 В)
ГТ310В	p-n-p	20 (35°C)	≥120	12	—	10	≤5 (5 В)
ГТ310Г	p-n-p	20 (35°C)	≥120	12	—	10	≤5 (5 В)
ГТ310Д	p-n-p	20 (35°C)	≥80	12	—	10	≤5 (5 В)
ГТ310Е	p-n-p	20 (35°C)	≥80	12	—	10	≤5 (5 В)
ГТ311А	n-p-n	150	≥300	12	2	50	≤5 (5 В)
ГТ311Б	n-p-n	150	≥300	12	2	50	≤5 (5 В)
ГТ311В	n-p-n	150	≥450	12	2	50	≤5 (5 В)
ГТ311Г	n-p-n	150	≥450	12	2	50	≤5 (5 В)
ГТ311Д	n-p-n	150	≥600	12	2	50	≤5 (5 В)
ГТ311Е	n-p-n	150	≥250	12 (20 имп.)	2	50	≤5 (12 В)
ГТ311Ж	n-p-n	150	≥300	12 (20 имп.)	2	50	≤5 (12 В)
ГТ311И	n-p-n	150	≥450	10	1,5	50	≤5 (10 В)
ГТ313А	p-n-p	100	≥300	15	0,7	30	≤5 (12 В)
ГТ313Б	p-n-p	100	≥450	15	0,7	30	≤5 (12 В)
ГТ313В	p-n-p	100	≥350	15	0,7	30	≤5 (12 В)
ГТ320А	p-n-p	200	≥80	20	3	150 (300*)	≤10 (20 В)
ГТ320Б	p-n-p	200	≥120	20	3	150 (300*)	≤10 (20 В)
ГТ320В	p-n-p	200	≥160	20	3	150 (300*)	≤10 (20 В)
ГТ321А	p-n-p	160 (20** Вт)	≥60	40**	4	200 (2* А)	≤500 (60 В)
ГТ321Б	p-n-p	160 (20** Вт)	≥60	40**	4	200 (2* А)	≤500 (60 В)
ГТ321В	p-n-p	160 (20** Вт)	≥60	40**	4	200 (2* А)	≤500 (60 В)
ГТ321Г	p-n-p	160 (20** Вт)	≥60	30**	2,5	200 (2* А)	≤500 (45 В)
ГТ321Д	p-n-p	160 (20** Вт)	≥60	30**	2,5	200 (2* А)	≤500 (45 В)
ГТ321Е	p-n-p	160 (20** Вт)	≥60	30**	2,5	200 (2* А)	≤500 (45 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^{*}_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
20...75* (1 В; 10 мА)	≤8 (5 В)	≤30	—	≤400	ГТ308
50...120* (1 В; 10 мА)	≤8 (5 В)	≤24	—	≤1000*	
80...200* (1 В; 10 мА)	≤8 (5 В)	≤24	≤8 (1,6 МГц)	≤400	
80...150 (1 В; 10 мА)	≤8 (5 В)	≤24	≤8 (1,6 МГц)	≤500	
				≤1000*	
20...70 (5 В; 1 мА)	≤7,5 (5 В)	—	—	≤500	ГТ309
60...180 (5 В; 1 мА)	≤7,5 (5 В)	—	≤6 (1,6 МГц)	≤500	
20...70 (5 В; 1 мА)	≤7,5 (5 В)	—	≤6 (1,6 МГц)	≤1000	
60...180 (5 В; 1 мА)	≤7,5 (5 В)	—	—	≤1000	
20...70 (5 В; 1 мА)	≤7,5 (5 В)	—	—	≤1000	
60...180 (5 В; 1 мА)	≤7,5 (5 В)	—	—	≤1000	
20...70 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≤3 (1,6 МГц)	≤300	ГТ310
60...180 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В)	—	≤3 (1,6 МГц)	≤300	
20...70 (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤300	
60...180 (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤300	
20...70 (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤500	
60...180 (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤500	
15...80* (3 В; 5 мА)	≤2,5 (5 В)	≤20	—	≤50*	ГТ311
30...180* (3 В; 5 мА)	≤2,5 (5 В)	≤20	—	≤50*	
15...50* (3 В; 5 мА)	≤2,5 (5 В)	≤20	—	≤50*	
30...80* (3 В; 5 мА)	≤2,5 (5 В)	≤20	—	≤50*	
60...180* (3 В; 5 мА)	≤2,5 (5 В)	≤20	—	≤50*	
20...80* (3 В; 5 мА)	≤2,5 (5 В)	≤20	—	≤75; ≤50*	
50...200* (3 В; 5 мА)	≤2,5 (5 В)	≤20	—	≤100; ≤50*	
100...300* (3 В; 5 мА)	≤2,5 (5 В)	≤20	—	≤100; ≤50*	
20...250 (5 В; 5 мА)	≤2,5 (5 В)	≤4,6	—	≤75	ГТ313
20...250 (5 В; 5 мА)	≤2,5 (5 В)	≤4,6	—	≤40	
30...170 (5 В; 5 мА)	≤2,5 (5 В)	≤4,6	—	≤75	
20...80* (1 В; 10 мА)	≤8 (5 В)	≤8,5	—	≤500	ГТ320
50...160* (1 В; 10 мА)	≤8 (5 В)	≤8,5	—	≤500	
80...250* (1 В; 10 мА)	≤8 (5 В)	≤8,5	—	≤600	
20...60* (3 В; 0,5 мА)	≤80 (10 В)	≤3,5	—	≤600	ГТ321
40...120* (3 В; 0,5 мА)	≤80 (10 В)	≤3,5	—	≤600	
80...200* (3 В; 0,5 мА)	≤80 (10 В)	≤3,5	—	≤600	
20...60* (3 В; 0,5 мА)	≤80 (10 В)	≤3,5	—	≤600	
40...120* (3 В; 0,5 мА)	≤80 (10 В)	≤3,5	—	≤600	
80...200* (3 В; 0,5 мА)	≤80 (10 В)	≤3,5	—	≤600	

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^*_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^*_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ проб}$, В	$I_{К\ max}$, $I^*_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
ГТ322А	p-n-p	50	≥80	25	0,25	10	≤4 (25 В)
ГТ322Б	p-n-p	50	≥80	25	0,25	10	≤4 (25 В)
ГТ322В	p-n-p	50	≥80	25	0,25	10	≤4 (25 В)
ГТ322Г	p-n-p	50	≥50	15	0,25	5	≤4 (15 В)
ГТ322Д	p-n-p	50	≥50	15	0,25	5	≤4 (15 В)
ГТ322Е	p-n-p	50	≥50	15	0,25	5	≤4 (15 В
ГТ323А	n-p-n	500	≥200	20	2	1000	≤30
ГТ323Б	n-p-n	500	≥200	20	2	1000	≤30
ГТ323В	n-p-n	500	≥300	20	2	1000	≤30
ГТ328А	p-n-p	50 (55°C)	≥400	15* (5к)	0,25	10	≤10 (15 В)
ГТ328Б	p-n-p	50 (55°C)	≥300	15* (5к)	0,25	10	≤10 (15 В)
ГТ328В	p-n-p	50 (55°C)	≥300	15* (5к)	0,25	10	≤10 (15 В)
ГТ329А	n-p-n	50 (40°C)	≥1200	10	0,5	20	≤5 (10 В)
ГТ329Б	n-p-n	50 (40°C)	≥1680	10	0,5	20	≤5 (10 В)
ГТ329В	n-p-n	50 (40°C)	≥990	10	1	20	≤5 (10 В)
ГТ329Г	n-p-n	25 (60°C)	≥700	10	0,5	20	≤5 (10 В)
ГТ330Д	n-p-n	50 (45°C)	≥500	10 (20 имп.)	1,5	20	≤5 (10 В)
ГТ330Ж	n-p-n	50 (45°C)	≥1000	10 (20 имп.)	1,5	20	≤5 (10 В)
ГТ330И	n-p-n	50 (45°C)	≥500	10 (20 имп.)	1,5	20	≤5 (10 В)
ГТ335А	p-n-p	200 (45°C)	≥80	20	3	150 (250*)	≤10
ГТ335Б	p-n-p	200 (45°C)	≥80	20	3	150 (250*)	≤10
ГТ335В	p-n-p	200 (45°C)	≥80	20	3	150 (250*)	≤10
ГТ335Г	p-n-p	200 (45°C)	≥300	20	3	150 (250*)	≤10
ГТ335Д	p-n-p	200 (45°C)	≥300	20	3	150 (250*)	≤10
ГТ338А	p-n-p	100	—	20 (8**)	—	1000	≤30 (20 В)
ГТ338Б	p-n-p	100	—	20 (13**)	—	1000	≤30 (20 В)
ГТ338В	p-n-p	100	—	20 (5**)	—	1000	≤30 (20 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
30...100 (5 В; 1 мА)	≤1,8 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤50	ГТ322
50...120 (5 В; 1 мА)	≤1,8 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤100	
20...120 (5 В; 1 мА)	≤2,5 (5 В)	—	≤4 (1,6 МГц)	≤200	
50...120 (5 В; 1 мА)	≤2,5 (5 В)	—	—	—	
20...70 (5 В; 1 мА)	≤1,8 (5 В)	—	—	—	
50...120 (5 В; 1 мА)	≤1,8 (5 В)	—	—	—	
20...60 (5 В; 0,5 А)	≤30	—	—	—	ГТ323
40...120 (5 В; 0,5 А)	≤30	—	—	—	
80...200 (5 В; 0,5 А)	≤30	—	—	—	
20...200* (5 В; 4 мА)	≤1,5 (5 В)	—	≤7 (180 МГц)	≤5	ГТ328
40...200* (5 В; 3 мА)	≤1,5 (5 В)	—	≤7 (180 МГц)	≤10	
10...70* (5 В; 3 мА)	≤1,5 (5 В)	—	≤7 (180 МГц)	≤10	
15...300* (5 В; 5 мА)	≤2 (5 В)	—	≤4 (400 МГц)	≤15	ГТ329
15...300* (5 В; 5 мА)	≤3 (5 В)	—	≤6 (400 МГц)	≤30	
15...300* (5 В; 5 мА)	≤3 (5 В)	—	≤6 (400 МГц)	≤20	
15...300* (5 В; 5 мА)	≤2 (5 В)	—	≤5 (400 МГц)	≤15	
30...400* (5 В; 5 мА)	≤3 (5 В)	≤15	≤8 (400 МГц)	≤30; ≤50*	ГТ330
30...400* (5 В; 5 мА)	≤3 (5 В)	≤15	—	≤50; ≤50*	
10...400* (5 В; 5 мА)	≤3 (5 В)	≤15	≤8 (400 МГц)	≤30; ≤50*	
40...70* (3 В; 50 мА)	≤8,5	—	—	—	ГТ335
60...100* (3 В; 50 мА)	≤8,5	—	—	≤100*	
40...70* (3 В; 50 мА)	≤8,5	—	—	≤150*	
60...100* (3 В; 50 мА)	≤8,5	—	—	—	
50...100* (3 В; 50 мА)	≤8,5	—	—	≤150*	
—	≤2 (5 В)	—	—	tн≤Iнс	ГТ338
—	≤2 (5 В)	—	—	tн≤Iнс	
—	≤2 (5 В)	—	—	tн≤Iнс	

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
ГТ341А	n-p-n	35 (60°С)	≥1500	10	0,3	10	≤5 (10 В)
ГТ341Б	n-p-n	35 (60°С)	≥1980	10	0,3	10	≤5 (10 В)
ГТ341В	n-p-n	35 (60°С)	≥1500	10	0,5	10	≤5 (10 В)
ГТ346А	p-n-p	50 (55°С)	≥700	20	0,3	10	≤10 (20 В)
ГТ346Б	p-n-p	50 (55°С)	≥550	20	0,3	10	≤10 (20 В)
ГТ346В	p-n-p	50 (55°С)	≥550	20	0,3	10	≤10 (20 В)
ГТ362А	n-p-n	40	≥2400	5 (55°С)	0,2	10	≤5 (5 В)
ГТ362Б	n-p-n	40	≥2400	5 (55°С)	0,2	10	≤5 (5 В)
ГТ376А	p-n-p	35 (85°С)	≥1020	7**	0,25	10	≤5 (7В)
ГТ383А-2	n-p-n	25 (55°С)	≥2400	5* (1к)	0,5	10	≤5 (5 В)
ГТ383Б-2	n-p-n	25 (55°С)	≥1500	5* (1к)	0,5	10	≤5 (5 В)
ГТ383В-2	n-p-n	25 (55°С)	≥3600	5* (1к)	0,5	10	≤5 (5 В)
ГТ402А	p-n-p	300; 600	≥1*	25* (0,2к)	—	500	≤20 (10 В)
ГТ402Б	p-n-p	300; 600	≥1*	25* (0,2к)	—	500	≤20 (10 В)
ГТ402В	p-n-p	300; 600	≥1*	40* (0,2к)	—	500	≤20 (10 В)
ГТ402Г	p-n-p	300; 600	≥1*	40* (0,2к)	—	500	≤20 (10 В)
ГТ402Д	p-n-p	0,3 Вт; 0,6 Вт	≥1*	25* (0,2к)	—	500	≤25 (10 В)
ГТ402Е	p-n-p	0,3 Вт; 0,6 Вт	≥1*	25* (0,2к)	—	500	≤25 (10 В)
ГТ402Ж	p-n-p	0,3 Вт; 0,6 Вт	≥1*	40* (0,2к)	—	500	≤25 (10 В)
ГТ402И	p-n-p	0,3 Вт; 0,6 Вт	≥1*	40* (0,2к)	—	500	≤25 (10 В)
ГТ403А	p-n-p	4* Вт	≥0,008**	45	20	1250	≤50 (45 В)
ГТ403Б	p-n-p	4* Вт	≥0,008**	45	20	1250	≤50 (45 В)
ГТ403В	p-n-p	5* Вт	≥0,008**	60	20	1250	≤50 (60 В)
ГТ403Г	p-n-p	4* Вт	≥0,006**	60	20	1250	≤50 (60 В)
ГТ403Д	p-n-p	4* Вт	≥0,006**	60	30	1250	≤50 (60 В)
ГТ403Е	p-n-p	5* Вт	≥0,008**	60	20	1250	≤50 (60 В)
ГТ403Ж	p-n-p	4* Вт	≥0,008**	80	20	1250	≤50 (80 В)
ГТ403И	p-n-p	4* Вт	≥0,008**	80	20	1250	≤50 (80 В)
ГТ403Ю	p-n-p	4* Вт	≥0,008**	45	20	1250	≤50 (45 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^{*}_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
15...300* (5 В; 5 мА)	≤1 (5 В)	—	≤4,5 (1 ГГц)	≤10	ГТ341
15...300* (5 В; 5 мА)	≤1 (5 В)	—	≤5,5 (1 ГГц)	≤10	
15...300* (5 В; 5 мА)	≤1 (5 В)	—	≤5,5 (1 ГГц)	≤10	
10...150 (10 В; 2 мА)	≤1,3 (5 В)	—	≤6 (800 МГц)	≤3	ГТ346
10...150 (10 В; 2 мА)	≤1,3 (5 В)	—	≤8 (800 МГц)	≤5,5	
15...150 (10 В; 2 мА)	≤1,3 (5 В)	—	≤7 (200 МГц)	≤6	
10...200 (3 В; 5 мА)	≤1 (5 В)	—	≤4,5 (2,25 ГГц)	≤10	ГТ362
10...250 (3 В; 5 мА)	≤1 (5 В)	—	≤5,5 (2,25 ГГц)	≤20	
10...150* (5 В; 2 мА)	≤1,2 (5 В)	—	≤3,5 (180 МГц)	≤15	ГТ376
15...250 (3,2 В; 5 мА)	≤1 (3,2 В)	—	≤4,5 (2,25 ГГц)	≤10	ГТ383
10...250 (3,2 В; 5 мА)	≤1 (3,2 В)	—	≤4 (1 ГГц)	≤10	
15...250 (3,2 В; 5 мА)	≤1 (3,2 В)	—	≤5,5 (2,83 ГГц)	≤15	
30...80 (1 В; 3 мА)	—	—	—	—	ГТ402
60...150 (1 В; 3 мА)	—	—	—	—	
30...80 (1 В; 3 мА)	—	—	—	—	
60...150 (1 В; 3 мА)	—	—	—	—	
30...80 (1 В; 3 мА)	—	≤5	—	—	
60...150 (1 В; 3 мА)	—	≤5	—	—	
30...80 (1 В; 3 мА)	—	≤5	—	—	
30...80 (1 В; 3 мА)	—	≤5	—	—	
20...60 (5 В; 0,1 А)	—	≤1	—	—	ГТ403
50...150 (5 В; 0,1 А)	—	≤1	—	—	
20...60 (5 В; 0,1 А)	—	≤1	—	—	
50...150 (5 В; 0,1 А)	—	≤1	—	—	
50...150 (5 В; 0,1 А)	—	≤1	—	—	
30* (0,45 А)	—	≤1	—	—	
20...60 (5 В; 0.1 А)	—	≤1	—	—	
30* (0.45 А)	—	≤1	—	—	
30...60 (5 В; 0.1 А)	—	≤1	—	—	

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ проб}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
ГТ404А **ГТ404Б** **ГТ404В** **ГТ404Г** **ГТ404Д** **ГТ404Е** **ГТ404Ж** **ГТ404И**	n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n	600; 300 600; 300 600; 300 600; 300 600; 300 600; 300 600; 300 600; 300	≥1* ≥1* ≥1* ≥1* ≥1* ≥1* ≥1* ≥1*	25* (0,2к) 25* (0,2к) 40* (0,2к) 40* (0,2к) 25* (0,2к) 25* (0,2к) 40* (0,2к) 40* (0,2к)	— — — — — — — —	500 500 500 500 500 500 500 500	≤25 (10 В) ≤25 (10 В) ≤25 (10 В) ≤25 (10 В) ≤25 (10 В) ≤25 (10 В) ≤25 (10 В) ≤25 (10 В)
ГТ405А **ГТ405Б** **ГТ405В** **ГТ405Г** **ГТ406А**	p-n-p p-n-p p-n-p p-n-p p-n-p	0,6 Вт 0,6 Вт 0,6 Вт 0,6 Вт 0,6 Вт	≥1* ≥1* ≥1* ≥1* 0,006**	25* (0,2к) 25* (0,2к) 40* (0,2к) 40* (0,2к) 25	— — — — 20	500 500 500 500 1250	≤25 (10 В) ≤25 (10 В) ≤25 (10 В) ≤25 (10 В) ≤50 (25 В)
ГТС609А **ГТС609Б** **ГТС609В**	p-n-p p-n-p p-n-p	500 (43°С) 500 (43°С) 500 (43°С)	≥60 ≥60 ≥60	50 50 50	2,5 2,5 2,5	700* 700* 700*	≤40 (30 В) ≤40 (30 В) ≤40 (30 В)
ГТ612А-4	n-p-n	570	≥1500	12	0,2	120 (200*)	≤5 (12 В)
ГТ701А	p-n-p	50* Вт	≥0,05*	55* (140 имп.)	15	12 А	≤6 мА
ГТ703А **ГТ703Б** **ГТ703В** **ГТ703Г** **ГТ703Д**	p-n-p p-n-p p-n-p p-n-p p-n-p	15* Вт 15* Вт 15* Вт 15* Вт 15* Вт	≥0,010** ≥0,010** ≥0,010** ≥0,010** ≥0,010**	20 (0,05к) 20 (0,05к) 30 (0,05к) 30 (0,05к) 40 (0,05к)	10 10 10 10 10	3,5 А 3,5 А 3,5 А 3,5 А 3,5 А	≤500 ≤500 ≤500 ≤500 ≤500
ГТ705А **ГТ705Б** **ГТ705В** **ГТ705Г** **ГТ705Д**	n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n	15* Вт 15* Вт 15* Вт 15* Вт 15* Вт	≥0,010** ≥0,010** ≥0,010** ≥0,010** ≥0,010	20* 20* 20* 20* 20*	10 10 30 10 10	3,5 А 3,5 А 3,5 А 3,5 А 3,5 А	≤500 ≤3,5 мА ≤3,5 мА ≤500 ≤500

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r^{*}_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
30...80 (1 В; 3 мА)	—	≤6	—	—	ГТ404
60...150 (1 В; 3 мА)	—	≤6	—	—	
30...80 (1 В; 3 мА)	—	≤6	—	—	
60...150 (1 В; 3 мА)	—	≤6	—	—	
30...80 (1 В; 3 мА)	—	≤6	—	—	
60...150 (1 В; 3 мА)	—	≤6	—	—	
30...80 (1 В; 3 мА)	—	≤6	—	—	
60...150 (1 В; 3 мА)	—	≤6	—	—	
30...80 (1 В; 3 мА)	—	—	—	—	ГТ405
60...150 (1 В; 3 мА)	—	—	—	—	
30...80 (1 В; 3 мА)	—	—	—	—	
60...150 (1 В; 3 мА)	—	—	—	—	
50...150 (5 В; 0,1 А)	—	—	—	—	
30...200 (3 В; 0,5 А)	≤50 (10 В)	≤3,2	—	≤700*	ГТС609
50...160 (3 В; 0,5 А)	≤50 (10 В)	≤3,2	—	≤700*	
80...420 (3 В; 0,5 А)	≤50 (10 В)	≤3,2	—	≤700*	
—	≤3,5 (5 В)	—	≥0,2** Вт (2 ГГц)	≤7	ГТ612
10* (2 В; 6 А)	—	—	—	—	ГТ701
30...70* (1 В; 50 мА)	—	≤0,2	—	—	ГТ703
50...100* (1 В; 50 мА)	—	≤0,2	—	—	
30...70* (1 В; 50 мА)	—	≤0,2	—	—	
50...100* (1 В; 50 мА)	—	≤0,2	—	—	
20...45* (1 В; 50 мА)	—	≤0,2	—	—	
30...70* (1 В; 50 мА)	—	≤0,6	—	—	ГТ705
50...100* (1 В; 50 мА)	—	≤0,6	—	—	
30...70* (1 В; 50 мА)	—	≤0,6	—	—	
50...100* (1 В; 50 мА)	—	≤0,6	—	—	
90...250* (1 В; 50 мА)	—	≤0,6	—	—	

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
ГТ804А	p-n-p	15* Вт	≥10	100**	—	10 А	—
ГТ804Б	p-n-p	15* Вт	≥10	140**	—	10 А	—
ГТ804В	p-n-p	15* Вт	≥10	190**	—	10 А	—
ГТ806А	p-n-p	30* Вт	≥10*	75	1,5	15 А	—
ГТ806Б	p-n-p	30* Вт	≥10*	100	1,5	15 А	—
ГТ806В	p-n-p	30* Вт	≥10*	120	1,5	15 А	—
ГТ806Г	p-n-p	30* Вт	≥10*	50	1,5	15 А	—
ГТ806Д	p-n-p	30* Вт	≥10*	140	1,5	15 А	—
ГТ810А	p-n-p	15* Вт	≥15	200	1,4	10 А	≤20 мА
ГТ905А	p-n-p	6 Вт	≥60	75	0,4	3 А (7* А)	≤20 мА
ГТ905Б	p-n-p	6 Вт	≥60	60	0,4	3 А (7* А)	≤20 мА
ГТ906А	p-n-p	15* Вт; 300** Вт	≥30	75	1,4	6 А	≤8 мА (75 В)
ГТ906АМ	p-n-p	15* Вт; 300** Вт	≥30	75	1,4	6 А	≤8 мА (75 В)
МГТ108А	p-n-p	75	≥0,5*	10 (18 имп.)	5	50	≤10 (5 В)
МГТ108Б	p-n-p	75	≥1*	10 (18 имп.)	5	50	≤10 (5 В)
МГТ108В	p-n-p	75	≥1*	10 (18 имп.)	5	50	≤10 (5 В)
МГТ108Г	p-n-p	75	≥1*	10 (18 имп.)	5	50	≤10 (5 В)
МГТ108Д	p-n-p	75	≥1*	10 (18 имп.)	5	50	≤10 (5 В)
МП9А	n-p-n	150	≥1*	15	15	20 (150*)	30* (30 В)
МП10	n-p-n	150	≥1*	15	15	20 (150*)	30* (30 В)
МП10А	n-p-n	150	≥1*	30	30	20 (150*)	30* (30 В)
МП10Б	n-p-n	150	≥1*	30	30	20 (150*)	50* (30 В)
МП11	n-p-n	150	≥2*	15	15	20 (150*)	30* (30 В)
МП11А	n-p-n	150	≥2*	15	15	20 (150*)	30* (30 В)
МП13	p-n-p	150	≥0,5*	15	15	20 (150*)	≤30 (15 В)
МП13Б	p-n-p	150	≥1*	15	15	20 (150*)	≤30 (15 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
20...150* (10 В; 5 А) 20...150* (10 В; 5 А) 20...150* (10 В; 5 А)	— — —	— — —	— — —	≤1000 ≤1000 ≤1000	ГТ804
10...100* (10 А) 10...100* (10 А) 10...100* (10 А) 10...100* (10 А) 10...100* (10 А)	— — — — —	≤0,04 ≤0,04 ≤0,04 ≤0,04 ≤0,04	— — — — —	— — — — —	ГТ806
15*; (10 В; 5 А)	—	≤0,07	—	5*мкс	ГТ810, ГТ905
35...100* (70 В; 3 А) 35...100* (70 В; 3 А)	≤200 (30 В) ≤200 (30 В)	 ≤0,17	— —	≤300; 4*мкс ≤300; 4*мкс	
30...150* (10 В; 5 А)	—	—	—	≤5000*	ГТ906
30...150* (10 В; 5 А)	—	—	—	≤5000*	ГТ906АМ
25...50 (6 В; 1 мА) 35...80 (5 В; 1 мА) 60...130 (5 В; 1 мА) 110...250 (5 В; 1 мА) 30...120 (5 В; 1 мА)	— — — — —	— — — — —	— — — — ≤6 (1 кГц)	≤5000 ≤5000 ≤5000 ≤5000 ≤5000	МГТ108
15...45 (5 В; 1 мА) 15...30 (5 В; 1 мА) 15...30 (5 В; 1 мА) 25...50 (5 В; 1 мА)	≤60 (5 В) ≤60 (5 В) ≤60 (5 В) ≤60 (5 В)	— — — —	≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц)	— — — —	МП9, МП10, МП11, МП13
25...55 (5 В; 1 мА) 45...100 (5 В; 1 мА)	≤60 (5 В) ≤60 (5 В)	— —	≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц)	— —	
≥12 (5 В; 1 мА) 20...60 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В) ≤50 (5 В)	— —	≤150* ≤12 (1 кГц)	— —	

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
МП14	p-n-p	150	≥1*	15	15	20 (150*)	≤30 (15 В)
МП14А	p-n-p	150	≥1*	30	30	20 (150*)	≤30 (30 В)
МП14Б	p-n-p	150	≥1*	30	30	20 (150*)	≤50 (30 В)
МП14И	p-n-p	150	≥1*	30	30	20 (150*)	≤50 (30 В)
МП15	p-n-p	150	≥2*	15	15	20 (150*)	≤30 (15 В)
МП15А	p-n-p	150	≥2*	15	15	20 (150*)	≤30 (15 В)
МП15И	p-n-p	150	—	15	15	20 (150*)	—
МП16	p-n-p	200	≥1*	15	15	50 (300*)	≤25 (15 В)
МП16А	p-n-p	200	≥1*	15	15	50 (300*)	≤25 (15 В)
МП16Б	p-n-p	200	≥2*	15	15	50 (300*)	≤25 (15 В)
МП16Я1	p-n-p	150	—	15* (100)	15	300*	≤50* (15 В)
МП16Я11	p-n-p	150	—	15* (100)	15	300*	≤50* (15 В)
МП20А	p-n-p	150	≥2*	30	30	300*	≤50 (30 В)
МП20Б	p-n-p	150	≥1,5*	30	30	300*	≤50 (30 В)
МП21В	p-n-p	150	≥1,5*	40	40	300*	≤50 (40 В)
МП21Г	p-n-p	150	≥1*	60	40	300*	≤50 (60 В)
МП21Д	p-n-p	150	≥1*	60	40	300*	≤50 (50 В)
МП21Е	p-n-p	150	≥0,7*	70	40	300*	≤50 (50 В)
МП25	p-n-p	200	≥0,2*	40	40	300*	≤75 (40 В)
МП25А	p-n-p	200	≥0,2*	40	40	400*	≤75 (40 В)
МП25Б	p-n-p	200	≥0,5*	40	40	400*	≤75 (40 В)
МП26	p-n-p	200	≥0,2*	70	70	300*	≤75 (70 В)
МП26А	p-n-p	200	≥0,2*	70	70	400*	≤75 (70 В)
МП26Б	p-n-p	200	≥0,5*	70	70	400*	≤75 (70 В)
МП35	n-p-n	150	≥0,5*	15	—	20 (150*)	≤30 (5 В)
МП36А	n-p-n	150	≥1*	15	—	20 (150*)	≤30 (5 В)
МП37А	n-p-n	150	≥1*	30	—	20 (150*)	≤30 (5 В)
МП37Б	n-p-n	150	≥1*	30	—	20 (150*)	≤30 (5 В)
МП38	n-p-n	150	≥2*	15	—	20 (150*)	≤30 (5 В)
МП38А	n-p-n	150	≥2*	15	—	20 (150*)	≤30 (5 В)
МП39	p-n-p	150	≥0,5*	15* (10к)	5	20 (150*)	≤15 (5 В)
МП39Б	p-n-p	150	≥0,5*	15* (10к)	5	20 (150*)	≤15 (5 В)
МП40	p-n-p	150	≥1*	15* (10к)	5	20 (150*)	≤15 (5 В)
МП40А	p-n-p	150	≥1*	30* (10к)	5	20 (150*)	≤15 (5 В)

h_{21}, $h^*_{21Э}$	$C_к$, C^*_{12}, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
20...40 (5 В; 1 мА) 20...40 (5 В; 1 мА) 30...60 (5 В; 1 мА) 20...80 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В) ≤50 (5 В) ≤50 (5 В) ≤50 (5 В)	— — — ≤20	≤150* ≤150* ≤150* ≤150*	— — — —	МП14, МП15
30...60 (5 В; 1 мА) 50...100 (5 В; 1 мА) —	≤50 (5 В) ≤50 (5 В) —	— — ≤10	≤150* ≤150* —	— — —	
20...35 (1 В; 10 мА) 30...50 (1 В; 10 мА) 45...100 (1 В; 1 мА) 20...70 (10 В; 100 мА) 10...70 (10 В; 100 мА)	— — — — —	≤15 ≤15 ≤15 ≤6,6 ≤6,6	— — — — —	≤2000* ≤1500* ≤1000* — —	МП16, МП20
50...150 (5 В; 25 мА) 80...200 (5 В; 25 мА)	— —	≤1 ≤1	— —	— —	
20...100 (5 В; 25 мА) 20...80 (5 В; 25 мА) 60...200 (5 В; 25 мА) 30...150 (5 В; 25 мА)	— — — —	≤1 ≤1 ≤1 ≤1	— — — —	— — — —	МП21, МП25
13...25 (20 В; 2,5 мА) 20...50 (20 В; 2,5 мА) 30...80 (20 В; 2,5 мА)	≤20 (20 В) ≤20 (20 В) ≤20 (20 В)	≤2,2 ≤2 ≤1,8	— — —	≤1500*** ≤1500*** ≤1500***	
13...25 (35 В; 1,5 мА) 20...50 (35 В; 1,5 мА) 30...80 (35 В; 1,5 мА)	≤15 (35 В) ≤15 (35 В) ≤15 (35 В)	≤2,2 ≤2,2 ≤1,8	— — —	≤1500*** ≤1500*** ≤1500***	МП26, МП35
13...125 (5 В; 1 мА)	—	—	≤220*	—	
13...45 (5 В; 1 мА)	—	—	≤10 (1 кГц)	—	МП36, МП37
15...30 (5 В; 1 мА) 25...50 (5 В; 1 мА)	— —	— —	≤220* ≤220*	— —	
25...55 (5 В; 1 мА) 45...100 (5 В; 1 мА)	— —	— —	≤220* ≤220*	— —	МП38, МП39, МП40
≥12 (5 В; 1 мА) 20...60 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В) ≤50 (5 В)	— —	— ≤12 (1 кГц)	— —	
20...40 (5 В; 1 мА) 20...40 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В) ≤50 (5 В)	— —	— —	— —	

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
МП41	p-n-p	150	≥1*	15* (10к)	5	20 (150*)	≤15 (5 В)
МП41А	p-n-p	150	≥1*	15* (10к)	5	20 (150*)	≤15 (5 В)
МП42	p-n-p	200	≥2*	15* (3к)	—	150*	—
МП42А	p-n-p	200	≥1,5*	15* (3к)	—	150*	—
МП42Б	p-n-p	200	≥1*	15* (3к)	—	150*	—
П201Э	p-n-p	10* Вт	≥0,1*	45	—	1,5 А	≤0,4 мА
П201АЭ	p-n-p	10* Вт	≥0,2*	45	—	1,5 А	≤0,4 мА
П202Э	p-n-p	10* Вт	≥0,1*	70	—	2 А	≤0,4 мА
П203Э	p-n-p	10* Вт	≥0,2*	70	—	2 А	≤0,4 мА
П207	p-n-p	100* Вт	—	40**	—	25 А	≤16 мА
П207А	p-n-p	100* Вт	—	40**	—	25 А	≤16 мА
П208	p-n-p	100* Вт	—	60**	—	25 А	≤25 мА
П208А	p-n-p	100* Вт	—	60**	—	25 А	≤25 мА
П209	p-n-p	60* Вт	≥0,1**	40**	25	12 А	≤8 мА
П209А	p-n-p	60* Вт	≥0,1**	40**	25	12 А	≤8 мА
П210	p-n-p	60* Вт	≥0,1**	60**	25	12 А	≤12 мА
П210А	p-n-p	60* Вт	≥0,1**	65**	25	12 А	≤8 мА (45 В)
П210Б	p-n-p	45* Вт	≥0,1**	65	25	12 А	≤15 мА
П210В	p-n-p	45* Вт	≥0,1**	45	25	12 А	≤15 мА
П210Ш	p-n-p	60* Вт	≥0,1**	64*	25	12 А	≤8 мА (65 В)
П213	p-n-p	11,5* Вт	≥0,2*	45	15	5 А	≤0,15 мА
П213А	p-n-p	10* Вт	≥0,2*	45	10	5 А	≤1 мА
П213Б	p-n-p	10* Вт	≥0,2*	45	10	5 А	≤1 мА
П214	p-n-p	10* Вт	≥0,2*	60	15	5 А	≤0,3 мА
П214А	p-n-p	10* Вт	≥0,2*	60	15	5 А	≤0,3 мА
П214Б	p-n-p	11,5* Вт	≥0,2*	60	15	5 А	≤0,15 мА
П214В	p-n-p	10* Вт	≥0,2*	60	10	5 А	≤1,5 мА
П214Г	p-n-p	10* Вт	≥0,2*	60	10	5 А	≤1,5 мА
П215	p-n-p	10* Вт	≥0,2*	80	15	5 А	≤0,3 мА
П216	p-n-p	30* Вт	≥0,2*	40	15	7,5 А	≤0,5 мА
П216А	p-n-p	30* Вт	≥0,2*	40	15	7,5 А	≤0,5 мА
П216Б	p-n-p	24* Вт	≥0,2*	35	15	7,5 А	≤1,5 мА
П216В	p-n-p	24* Вт	≥0,2*	35	15	7,5 А	≤2 мА
П216Г	p-n-p	24* Вт	≥0,2*	50	15	7,5 А	≤2,5 мА
П216Д	p-n-p	24* Вт	≥0,2*	50	15	7,5 А	≤2 мА
П217	p-n-p	30* Вт	≥0,2*	60	15	7,5 А	≤0,5 мА
П217А	p-n-p	30* Вт	≥0,2*	60	15	7,5 А	≤0,5 мА
П217Б	p-n-p	30* Вт	≥0,2*	60	15	7,5 А	≤0,5 мА
П217В	p-n-p	24 Вт	≥0,2*	60	15	7,5 А	≤3 мА
П217Г	p-n-p	24 Вт	≥0,2*	60	15	7,5 А	≤3 мА

h_{21}, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, C^{*}_{12}, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
30...60 (5 В; 1 мА) 50...100 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В) ≤50 (5 В)	— —	— —	— —	**МП41, МП42**
20...35* (1 В; 10 мА) 30...50* (1 В; 10 мА) 458...100* (1 В; 10 мА)	— — —	≤20 ≤20 ≤20	— — —	≤2000*** ≤1500*** ≤1000***	
≥20* (10 В; 0,2 А) ≥40* (10 В; 0,2 А)	— —	≤1,25 ≤1,25	— —	— —	**П201, П202**
≥20* (10 В; 0,2 А) —	— —	≤1,25 ≤1,25	— —	— —	
5...15 5...12	— —	— —	— —	— —	**П207, П208**
≥15 ≥15	— —	— —	— —	— —	
≥15 ≥15	— —	— —	— —	— —	**П209, П210**
≥15* (2 В; 5 А) ≥15* (2 В; 5 А) ≥10* (2 В; 5 А) ≥10* (2 В; 5 А) ≥15* (2 В; 5 А)	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	
20...50* (5 В; 1 А) ≥20* (5 В; 0,2 А) ≥40* (5 В; 0,2 А)	— — —	≤0,16 — ≤1,25	— — —	— — —	**П213, П214**
20...60* (5 В; 0,2 А) 50...150* (5 В; 0,2 А) 20...150* (5 В; 0,2 А) ≥20* (5 В; 0,2 А) —	— — — — —	≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3	— — — — —	— — — — —	
20...150* (5 В; 0,2 А) ≥16 (0,75 В; 4 А) 20...80 (0,75 В; 4 А) ≥10 (3 В; 2 А) ≥30 (3 В; 2 А) ≥5 (3 В; 2 А) 15...30 (3 В; 2 А)	— — — — — — —	≤0,3 ≤0,2 ≤0,2 ≤0,25 ≤0,25 — ≤0,25	— — — — — — —	— — — — — — —	**П215, П216**
≥16 (0,75 В; 4 А) 20...60 (5 В; 1 А) ≥20 (5 В; 1 А) ≥15* (1 В; 4 А) 15...40 (3 В; 2 А)	— — — — —	≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,25 ≤0,5	— — — — —	— — — — —	**П217**

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ проб}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
П27 **П27А**	p-n-p p-n-p	30 30	≥1* ≥1*	5* (0,5к) 5* (0,5к)	— —	6 6	≤3 (5 В) ≤3 (5 В)
П28	p-n-p	30	≥5*	5* (0,5к)	—	6	≤3 (5 В)
П29 **П29А**	p-n-p p-n-p	30 30	≥5* ≥5*	10* 10*	12 12	100* 100*	≤4 (12 В) ≤4 (12 В)
П30	p-n-p	30	≥10*	12*	12	100*	≤4 (12 В)
П401 **П402**	p-n-p p-n-p	100 100	≥30 ≥50	10 10	1 1	20 20	≤10 (5 В) ≤5 (5 В)
П403 **П403А**	p-n-p p-n-p	100 100	≥100 ≥80	10 10	1 1	20 20	≤5 (5 В) ≤5 (5 В)
П416 **П416А** **П416Б**	p-n-p p-n-p p-n-p	100 (360*) 100 (360*) 100 (360*)	≥40 ≥60 ≥80	12 12 12	3 3 3	25 (120*) 25 (120*) 25 (120*)	≤3 (10 В) ≤3 (10 В) ≤3 (10 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом	$К_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
20...100 (5 В; 0,5 мА) 20...170 (5 В; 0,5 мА)	— —	— —	≤10 (1 кГц) ≤5 (1 кГц)	— —	**П27**
20...200 (5 В; 0,5 мА)	—	—	≤5 (1 кГц)	—	**П28**
20...50 (0,5 В; 20 мА) 40...100 (0,5 В; 20 мА)	≤20 (6 В) ≤20 (6 В)	10 10	— —	≤6000 ≤6000	**П29**
80...180 (0,5 В; 20 мА)	≤20 (6 В)	10	—	6000	**П30**
16...300 (5 В; 5 мА) 16...250 (5 В; 5 мА)	≤15 (5 В) ≤10 (5 В)	— —	— —	≤3500 ≤1000	**П401, П402**
30...100 (5 В; 5 мА) 16...200 (5 В; 5 мА)	≤10 (5 В) ≤10 (5 В)	— —	— —	≤500 ≤500	**П403**
20...80 (5 В; 5 мА) 60...120 (5 В; 5 мА) 90...250 (5 В; 5 мА)	≤8 (5 В) ≤8 (5 В) ≤8 (5 В)	≤40 ≤40 ≤40	— — —	≤500; ≤1000* ≤500; ≤1000* ≤500; ≤1000*	**П416**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,проб}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
П417 **П417А** **П417Б**	p-n-p p-n-p p-n-p	50 50 50	≥200 ≥200 ≥200	8 8 8	0,7 0,7 0,7	10 10 10	≤3 (10 В) ≤3 (10 В) ≤3 (10 В)
П422 **П423**	p-n-p p-n-p	100 100	≥50 ≥100	10* (1к) 10* (1к)	— —	20 20	≤5 (5 В) ≤5 (5 В)
П605 **П605А**	p-n-p p-n-p	3 Вт 3 Вт	— —	45 45	1 0,5	1500 1500	≤2000 (45 В) ≤2000 (45 В)
П606 **П606А**	p-n-p p-n-p	1,25 Вт 1,25 Вт	≥30 ≥30	35 35	1 0,5	1500 1500	≤2000 (35 В) ≤2000 (35 В)
П607 **П607А**	p-n-p p-n-p	1,5 Вт 1,5 Вт	≥60 ≥60	30 30	1,5 1,5	300 (600*) 300 (600*)	≤300 (30 В) ≤300 (30 В)
П608 **П608А**	p-n-p p-n-p	1,5 Вт 1,5 Вт	≥90 ≥90	30 30	1,5 1,5	300 (600*) 300 (600*)	≤300 (30 В) ≤300 (30 В)
П609 **П609А**	p-n-p p-n-p	1,5 Вт 1,5 Вт	≥120 ≥120	30 30	1,5 1,5	300 (600*) 300 (600*)	≤300 (30 В) ≤300 (30 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, $t^{**}_{выкл}$, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
24...100 (5 В; 5 мА) 65...200 (5 В; 5 мА) 75...250 (5 В; 5 мА)	≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤6 (5 В)	— — —	— — —	≤400 ≤400 ≤400	**П417** Ø11,5; 9; 42; К, Б, Э
24...100 (5 В; 1 мА) 24...100 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В) ≤10 (5 В)	— —	≤10 (1,6 МГц) ≤10 (1,6 МГц)	≤1000 ≤500	**П422, П423** Ø4,2; 3,2; 20; К, Б, Э
20...60 (3 В; 0,5 А) 40...120 (3 В; 5 А)	≤130 (20 В) ≤130 (20 В)	≤40 ≤40	— —	≤3000* ≤4000*	**П605** Ø15,5; 9,8; 7; Ø22; 24,8; 35; К, Б, Э
20...60 (3 В; 0,5 А) 40...120 (3 В; 5 А)	≤130 (20 В) ≤130 (20 В)	≤40 ≤40	— —	≤3000* ≤4000*	**П606** Ø15,5; 9,8; 7; Ø22; 24,8; 35; К, Б, Э
20...80* (3 В; 0,25 А) 60...200 (3 В; 0,25 А)	≤50 (10 В) ≤50 (10 В)	≤10 ≤10	— —	≤3000* ≤3000*	**П607** Ø15,5; 9,8; 7; Ø22; 24,8; 35; К, Б, Э
40...120 (3 В; 0,25 А) 80...240 (3 В; 0,25 А)	≤50 (10 В) ≤80 (10 В)	≤10 ≤10	— —	≤3000* ≤3000*	**П608** Ø15,5; 9,8; 7; Ø22; 24,8; 35; К, Б, Э
40...120 (3 В; 0,25 А) 80...240 (3 В; 0,25 А)	≤50 (10 В) ≤80 (10 В)	≤10 ≤10	— —	≤3000* ≤3000*	**П609** Ø15,5; 9,8; 7; Ø22; 24,8; 35; К, Б, Э

2.7. Биполярные кремниевые транзисторы

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$ $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ104А	p-n-p	150 (60°C)	≥5*	30**	10	50	≤1 (30 В)
КТ104Б	p-n-p	150 (60°C)	≥5*	15**	10	50	≤1 (15 В)
КТ104В	p-n-p	150 (60°C)	≥5*	15**	10	50	≤1 (15 В)
КТ104Г	p-n-p	150 (60°C)	≥5*	30**	10	50	≤1 (30 В)
КТ117А	n-база	300	0,2***	30	30	50 (1* А)	≤1 (30 В)
КТ117Б	n-база	300	0,2***	30	30	50 (1* А)	≤1 (30 В)
КТ117В	n-база	300	0,2***	30	30	50 (1* А)	≤1 (30 В)
КТ117Г	n-база	300	0,2***	30	30	50 (1* А)	≤1 (30 В)
КТ118А	p-n-p	100 (100°C)	—	15	31	50	≤0,1 (15 В)
КТ118Б	p-n-p	100 (100°C)	—	15	31	50	≤0,1 (15 В)
КТ118В	p-n-p	100 (100°C)	—	15	31	50	≤0,1 (15 В)
КТ119А	n-база	25	0,2***	20	20	10 (50*)	—
КТ119Б	n-база	25	0,2***	20	20	10 (50*)	—
КТ120А	p-n-p	10	≥1	60	10	10 (20*)	≤0,5 (60 В)
КТ120Б	p-n-p	10	≥1	30	10	10 (20*)	≤0,5 (30 В)
КТ120В	p-n-p	10	≥1	60	10	10 (20*)	≤0,5 (60 В)
КТ120А-1	p-n-p	10	—	60	10	10	≤0,5 (60 В)
КТ120В-1	p-n-p	10	—	60	10	10	—
КТ120А-5	p-n-p	10	—	60	10	10	—
КТ120В-5	p-n-p	20	—	60	10	10	—
КТ127А-1	n-p-n	15 (60°C)	≥0,1**	25	3	50	≤1 (25 В)
КТ127Б-1	n-p-n	15 (60°C)	≥0,1**	25	3	50	≤1 (25 В)
КТ127В-1	n-p-n	15 (60°C)	≥0,1**	45	3	50	≤1 (25 В)
КТ127Г-1	n-p-n	15 (60°C)	≥0,1**	45	3	50	≤1 (25 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
9...36 (5 В; 1 мА) 20...80 (5 В; 1 мА) 40...160 (5 В; 1 мА) 15...60 (5 В; 1 мА)	≤50 (5 В) ≤50 (5 В) ≤50 (5 В) ≤50 (5 В)	≤50 ≤50 ≤50 ≤50	≤120* ≤120* ≤120* ≤120*	— — — —	**КТ104**
0,5...0,7 ($U_{Б1Б2}$=10 В) 0,65...0,9 ($U_{Б1Б2}$=10 В) 0,5...0,7 ($U_{Б1Б2}$=10 В) 0,65...0,9 ($U_{Б1Б2}$=10 В)	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	**КТ117**
— — —	— — —	100 100 120	— — —	≤500** ≤500** ≤500**	**КТ118**
0,5...0,65 ($U_{Б2Б1}$=10 В) 0,6...0,75 ($U_{Б2Б1}$=10 В)	— —	— —	— —	— —	**КТ119**
20...200 (5 В; 1 мА) 20...200 (5 В; 1 мА) 20...200 (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В)	≤50 — ≤110	— — —	— — —	**КТ120**
20...200 (5 В; 1 мА) 20...200 (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В) ≤5 (5 В)	≤50 ≤110	— —	— —	**КТ120-1**
20...200 (5 В; 1 мА) 20...200 (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В) ≤5 (5 В)	≤50 ≤110	— —	— —	**КТ120-5**
15...60 (5 В; 1 мА) 40...200 (5 В; 1 мА) 15...60 (5 В; 1 мА) 40...200 (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В)	≤170 ≤170 ≤170 ≤170	— — — —	— — — —	**КТ127-1**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ132А	однопер.	300	—	—	35	2* А	12
КТ132Б		300	—	—	35	2* А	0,2
КТ133А	однопер.	300	—	—	35	1,5* А	1
КТ133Б		300	—	—	35	1,5* А	1
КТ201А	n-p-n	150 (90°C)	≥10	20	20	20 (100*)	≤1 (20 В)
КТ201Б	n-p-n	150	≥10	20	20	20 (100*)	≤1 (20 В)
КТ201В	n-p-n	150	≥10	10	10	20 (100*)	≤1 (20 В)
КТ201Г	n-p-n	150	≥10	10	10	20 (100*)	≤1 (20 В)
КТ201Д	n-p-n	150	≥10	10	10	20 (100*)	≤1 (20 В)
КТ201АМ	n-p-n	150	≥10	20	20	20 (100*)	≤1 (20 В)
КТ201БМ	n-p-n	150	≥10	20	20	20 (100*)	≤1 (20 В)
КТ201ВМ	n-p-n	150	≥10	10	10	20 (100*)	≤1 (20 В)
КТ201ГМ	n-p-n	150	≥10	10	10	20 (100*)	≤1 (20 В)
КТ201ДМ	n-p-n	150	≥10	10	10	20 (100*)	≤1 (20 В)
КТ202А-1	p-n-p	15 (55°C)	≥5	15	10	10 (25*)	≤1 (15 В)
КТ202Б-1	p-n-p	15 (55°C)	≥5	15	10	10 (25*)	≤1 (15 В)
КТ202В-1	p-n-p	15 (55°C)	≥5	30	10	10 (25*)	≤1 (30 В)
КТ202Г-1	p-n-p	15 (55°C)	≥5	30	10	10 (25*)	≤1 (30 В)
КТ202Д-1	p-n-p	15 (55°C)	≥5	15	10	10 (25*)	≤1 (15 В)
КТ203А	p-n-p	150 (75°C)	≥5*	60	30	10 (50*)	≤1 (60 В)
КТ203Б	p-n-p	150 (75°C)	≥5*	30	15	10 (50*)	≤1 (30 В)
КТ203В	p-n-p	150 (75°C)	≥5*	15	10	10 (50*)	≤1 (15 В)
КТ203АМ	p-n-p	150 (75°C)	≥5*	60	30	10 (50*)	≤1 (60 В)
КТ203БМ	p-n-p	150 (75°C)	≥5*	30	15	10 (50*)	≤1 (30 В)
КТ203ВМ	p-n-p	150 (75°C)	≥5*	15	10	10 (50*)	≤1 (15 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
0,56...0,75 0,68...0,82	— —	3,5 3,5	— —	— —	КТ132
0,56...0,75 0,7...0,85	— —	2,5 2,5	— —	— —	КТ133
20...60 (1 В; 5 мА) 30...90 (1 В; 5 мА) 30...90 (1 В; 5 мА) 70...210 (1 В; 5 мА) 30...90 (1 В; 5 мА)	≤20 (5 В) ≤20 (5 В) ≤20 (5 В) ≤20 (5 В) ≤20 (5 В)	— — — — —	— — — — ≤15 (1 кГц)	— — — — —	КТ201
20...60 (1 В; 5 мА) 30...90 (1 В; 5 мА) 30...90 (1 В; 5 мА) 70...210 (1 В; 5 мА) 30...90 (1 В; 5 мА)	≤20 (5 В) ≤20 (5 В) ≤20 (5 В) ≤20 (5 В) ≤20 (5 В)	— — — — —	— — — — ≤15 (1 кГц)	— — — — —	КТ201-М
15...70 (5 В; 1 мА) 40...160 (5 В; 1 мА) 15...70 (5 В; 1 мА) 40...160 (5 В; 1 мА) 100...300 (5 В; 1 мА)	≤25 (5 В) ≤25 (5 В) ≤25 (5 В) ≤25 (5 В) ≤25 (5 В)	≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50	— — — — —	≤1000* ≤1000* ≤1000* ≤1000* ≤1000*	КТ202-1
≥9 (5 В; 1 мА) 30...150 (5 В; 1 мА) 30...200 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В) ≤10 (5 В) ≤10 (5 В)	— ≤50 ≤25	≤300* ≤300* ≤300*	— — —	КТ203
≥9 (5 В; 1 мА) 30...150 (5 В; 1 мА) 30...200 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В) ≤10 (5 В) ≤10 (5 В)	— ≤50 ≤25	≤300* ≤300* ≤300*	— — —	КТ203М

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ206А	n-p-n	15	≥10	20* (3к)	20	20	≤1 (20 В)
КТ206Б	n-p-n	15	≥10	12* (3к)	12	20	≤1 (12 В)
КТ207А	p-n-p	15	≥5	60	30	10 (50*)	≤0,05 (60 В)
КТ207Б	p-n-p	15	≥5	30	15	10 (50*)	≤0,05 (30 В)
КТ207В	p-n-p	15	≥5	15	10	10 (50*)	≤0,05 (15 В)
КТ208А	p-n-p	200 (60°С)	≥5	20* (10к)	10	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208Б	p-n-p	200 (60°С)	≥5	20	10	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208В	p-n-p	200 (60°С)	≥5	20	10	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208Г	p-n-p	200 (60°С)	≥5	30	10	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208Д	p-n-p	200 (60°С)	≥5	30* (10к)	10	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208Е	p-n-p	200 (60°С)	≥5	30	10	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208Ж	p-n-p	200 (60°С)	≥5	45	20	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208И	p-n-p	200 (60°С)	≥5	45	20	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208К	p-n-p	200 (60°С)	≥5	45	20	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208Л	p-n-p	200 (60°С)	≥5	60	20	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ208М	p-n-p	200 (60°С)	≥5	60	20	300 (500*)	≤1 (20 В)
КТ209А	p-n-p	200 (35°С)	≥5	15	10	300 (500*)	≤1* (15 В)
КТ209Б	p-n-p	200 (35°С)	≥5	15	10	300 (500*)	≤1* (15 В)
КТ209В	p-n-p	200 (35°С)	≥5	15	10	300 (500*)	≤1* (15 В)
КТ209В2	p-n-p	200 (35°С)	≥5	15	10	300 (500*)	≤1* (15 В)
КТ209Г	p-n-p	200 (35°С)	≥5	30	10	300 (500*)	≤1* (30 В)
КТ209Д	p-n-p	200 (35°С)	≥5	30	10	300 (500*)	≤1* (30 В)
КТ209Е	p-n-p	200 (35°С)	≥5	30	10	300 (500*)	≤1* (30 В)
КТ209Ж	p-n-p	200 (35°С)	≥5	45	20	300 (500*)	≤1* (45 В)
КТ209И	p-n-p	200 (35°С)	≥5	45	20	300 (500*)	≤1* (45 В)
КТ209К	p-n-p	200 (35°С)	≥5	45	20	300 (500*)	≤1* (45 В)
КТ209Л	p-n-p	200 (35°С)	≥5	60	20	300 (500*)	≤1* (60 В)
КТ209М	p-n-p	200 (35°С)	≥5	60	20	300 (500*)	≤1* (60 В)
КТ209К9	p-n-p	200	≥4	40	25	150	≤1
КТ210А	p-n-p	25	≥10	15	10	20 (40*)	≤10 (15 В)
КТ210Б	p-n-p	25	≥10	30	10	20 (40*)	≤10 (30 В)
КТ210В	p-n-p	25	≥10	60	10	20 (40*)	≤10 (60 В)
КТ211А-1	p-n-p	25	≥10	15	5	20 (50*)	≤10 (15 В)
КТ211Б-1	p-n-p	25	≥10	15	5	20 (50*)	≤10 (15 В)
КТ211В-1	p-n-p	25	≥10	15	5	20 (50*)	≤10 (15 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^*_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
30...90* (1 В; 5 мА) 70...120* (1 В; 5 мА)	≤20 (5 В) ≤20 (5 В)	— —	— —	— —	**КТ206**
≥9 (5 В; 1 мА) 30...150 (5 В; 1 мА) 30...200 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В) ≤10 (5 В) ≤10 (5 В)	≤100 ≤100 ≤50	≤300* ≤300* ≤300*	— — —	**КТ207**
20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА) 80...240* (1 В; 30 мА) 20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА) 80...240* (1 В; 30 мА) 20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА) 80...240* (1 В; 30 мА) 20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В)	≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3	— — ≤4 (1 кГц) — — ≤4 (1 кГц) — — ≤4 (1 кГц) — —	— — — — — — — — — — —	**КТ208**
20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА) 80...240* (1 В; 30 мА) ≥200* (1 В; 30 мА) 20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА) 80...240* (1 В; 30 мА) 20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА) 80...160* (1 В; 30 мА) 20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В)	≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3	— — ≤5 (1 кГц) ≤5 (1 кГц) — — ≤5 (1 кГц) — — ≤5 (1 кГц) — —	— — — — — — — — — — — —	**КТ209**
≥30 (0,2 В; 12 мА)	≤15	≤1,1	—	—	**КТ209К9**
80...240 (5 В; 1 мА) 80...240 (5 В; 1 мА) 40...120 (5 В; 1 мА)	≤25 (5 В) ≤25 (5 В) ≤25 (5 В)	≤50 ≤50 ≤50	— — —	— — —	**КТ210**
40...120 (1 В; 40 мА) 80...240 (1 В; 40 мА) 160...480 (1 В; 40 мА)	≤20 (5 В) ≤20 (5 В) ≤20 (5 В)	— — —	≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц)	— — —	**КТ211-1**

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^*_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^*_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^*_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ214А-1	p-n-p	50	≥5	80**	30	50 (100*)	≤1 (30 В)
КТ214Б-1	p-n-p	50	≥5	80**	7	50 (100*)	≤1 (30 В)
КТ214В-1	p-n-p	50	≥5	60**	7	50 (100*)	≤1 (30 В)
КТ214Г-1	p-n-p	50	≥5	40**	7	50 (100*)	≤1 (30 В)
КТ214Д-1	p-n-p	50	≥5	30**	7	50 (100*)	≤1 (30 В)
КТ214Е-1	p-n-p	50	≥5	20**	20	50 (100*)	≤1 (30 В)
КТ215А-1	n-p-n	50	≥5	80**	5	50 (100*)	≤100* (30 В)
КТ215Б-1	n-p-n	50	≥5	80**	5	50 (100*)	≤100* (30 В)
КТ215В-1	n-p-n	50	≥5	60**	5	50 (100*)	≤100* (30 В)
КТ215Г-1	n-p-n	50	≥5	40**	5	50 (100*)	≤100* (30 В)
КТ215Д-1	n-p-n	50	≥5	30**	5	50 (100*)	≤100* (30 В)
КТ215Е-1	n-p-n	50	≥5	20**	5	50 (100*)	≤100* (30 В)
КТ216А	p-n-p	75	≥5	60	30	10	≤0,05
КТ216Б	p-n-p	75	≥5	30	15	10	≤0,05
КТ216В	p-n-p	75	≥5	30	10	10	≤1
КТ218А-9	p-n-p	200	≥5	80	30	50	≤1
КТ218Б-9	p-n-p	200	≥5	80	7	50	≤1
КТ218В-9	p-n-p	200	≥5	60	7	50	≤1
КТ218Г-9	p-n-p	200	≥5	40	7	50	≤1
КТ218Д-9	p-n-p	200	≥5	30	7	50	≤1
КТ218Е-9	p-n-p	200	≥5	20	20	50	≤1
КТ220А9	n-p-n	200	≥250	60	5	100	≤0,1
КТ220Б9	n-p-n	200	≥250	60	5	100	≤0,1
КТ220В9	n-p-n	200	≥250	60	5	100	≤0,1
КТ220Г9	n-p-n	200	≥250	60	5	100	≤0,1
КТ301	n-p-n	150 (60°С)	≥20	20	3	10 (20*)	≤10
КТ301А	n-p-n	150 (60°С)	≥20	20	3	10 (20*)	≤10
КТ301Б	n-p-n	150 (60°С)	≥20	30	3	10 (20*)	≤10
КТ301В	n-p-n	150 (60°С)	≥20	30	3	10 (20*)	≤10
КТ301Г	n-p-n	150 (60°С)	≥30	30	3	10	≤10 (20 В)
КТ301Д	n-p-n	150 (60°С)	≥30	30	3	10	≤10 (20 В)
КТ301Е	n-p-n	150 (60°С)	≥30	30	3	10	≤10 (30 В)
КТ301Ж	n-p-n	150 (60°С)	≥30	20	3	10	≤10 (20 В)
КТ302А	n-p-n	100 (50°С)	—	15	4	10	≤1 (15 В)
КТ302Б	n-p-n	100 (50°С)	—	15	4	10	≤1 (15 В)
КТ302В	n-p-n	100 (50°С)	—	15	4	10	≤1 (15 В)
КТ302Г	n-p-n	100 (50°С)	—	15	4	10	≤1 (15 В)
КТ306А	n-p-n	150 (90°С)	≥300	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)
КТ306Б	n-p-n	150 (90°С)	≥500	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)
КТ306В	n-p-n	150 (90°С)	≥300	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)
КТ306Г	n-p-n	150 (90°С)	≥500	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)
КТ306Д	n-p-n	150 (90°С)	≥200	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	C_k, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^*_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥20 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≥1200*	—	**КТ214-1, КТ215-1**
30...90 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≥1200*	—	
40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≥1200*	—	
40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≥1200*	—	
≥80 (1 В; 40 мкА)	≤50 (10 В)	≤60	≥1200*	—	
≥40 (1 В; 40 мкА)	≤50 (10 В)	≤60	≥1200*	—	
≥20 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≥1200*	—	
30...90 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≥1200*	—	
40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≥1200*	—	
40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≥1200*	—	
≥80 (1 В; 40 мА)	≤50 (10 В)	≤60	≥1200*	—	
≥40 (1 В; 40 мкА)	≤50 (10 В)	≤60	≥1200*	—	
≥9 (5 В; 1 мА)	≤10	—	—	—	**КТ216, КТ218-9**
30...150 (5 В; 1 мА)	≤10	—	—	—	
30...200 (5 В; 1 мА)	≤10	—	—	—	
≥20 (5 В; 10 мА)	≤15	—	—	—	
≥30 (5 В; 10 мА)	≤15	—	—	—	
40...120 (5 В; 10 мА)	≤15	—	—	—	
≥40 (5 В; 10 мА)	≤15	—	—	—	
≥80 (1 В; 40 мкА)	≤15	—	—	—	
≥40 (1 В; 40 мкА)	≤15	—	—	—	
90...180	—	—	—	—	**КТ220-9**
135...270	—	—	—	—	
200...400	—	—	—	—	
300...600	—	—	—	—	
20...60 (10 В; 3 мА)	≤10 (10 В)	≤300	—	—	**КТ301**
40...120 (10 В; 3 мА)	≤10 (10 В)	≤300	—	—	
10...32 (10 В; 3 мА)	≤10 (10 В)	≤300	—	—	
20...60 (10 В; 3 мА)	≤10 (10 В)	≤300	—	—	
10...32 (10 В; 3 мА)	≤10 (10 В)	≤300	—	≤2000	
20...60 (10 В; 3 мА)	≤10 (10 В)	≤300	—	≤2000	
40...120 (10 В; 3 мА)	≤10 (10 В)	≤300	—	≤2000	
80...300 (10 В; 3 мА)	≤10 (10 В)	≤300	—	≤2000	
110...250 (1 В; 0,11 мА)	—	—	≤7 (1 кГц)	—	**КТ302**
90...150 (3 В; 2 мА)	—	—	≤7 (1 кГц)	—	
110...250 (1,5 В; 0,5 мА)	—	—	≤7 (1 кГц)	—	
200...800 (3,5 В; 5 мА)	—	—	≤7 (1 кГц)	—	
20...60* (1 В; 10мА)	≤5 (5 В)	≤30	—	≤30*	**КТ306**
40...120* (1 В; 10мА)	≤5 (5 В)	≤30	—	≤30*	
20...100* (1 В; 10мА)	≤5 (5 В)	—	≤30*	≤500	
40...200* (1 В; 10мА)	≤5 (5 В)	—	≤30*	≤500	
30...150* (1 В; 10мА)	≤5 (5 В)	—	≤30*	≤300	

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ306АМ	n-p-n	150 (90°С)	≥300	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)
КТ306БМ	n-p-n	150 (90°С)	≥500	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)
КТ306ВМ	n-p-n	150 (90°С)	≥300	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)
КТ306ГМ	n-p-n	150 (90°С)	≥500	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)
КТ306ДМ	n-p-n	150 (90°С)	≥200	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)
КТ307А-1	n-p-n	15	≥250	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ307Б-1	n-p-n	15	≥250	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ307В-1	n-p-n	15	≥250	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ307Г-1	n-p-n	15	≥250	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ3101А-2	n-p-n	100 (45°С)	≥4000	15	2,5	20 (40*)	≤0,5 (15 В)
КТ3101АМ	n-p-n	100	≥4000	15	2,5	20	≤0,5 (15 В)
КТ3102А	n-p-n	250	≥150	50	5	100 (200*)	≤0,05 (50 В)
КТ3102Б	n-p-n	250	≥150	50	5	100 (200*)	≤0,05 (50 В)
КТ3102В	n-p-n	250	≥150	50	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)
КТ3102Г	n-p-n	250	≥300	20	5	100 (200*)	≤0,015 (20 В)
КТ3102Д	n-p-n	250	≥150	30	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)
КТ3102Е	n-p-n	250	≥300	20	5	100 (200*)	≤0,015 (20 В)
КТ3102Ж	n-p-n	250	≥200	50	5	100 (200*)	≤0,05 (50 В)
КТ3102И	n-p-n	250	≥200	50	5	100 (200*)	≤0,05 (50 В)
КТ3102К	n-p-n	250	≥200	30	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)
КТ3102АМ	n-p-n	250	≥150	50	5	100 (200*)	≤0,05 (50 В)
КТ3102БМ	n-p-n	250	≥150	50	5	100 (200*)	≤0,05 (50 В)
КТ3102ВМ	n-p-n	250	≥150	30	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)
КТ3102ГМ	n-p-n	250	≥300	20	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)
КТ3102ДМ	n-p-n	250	≥150	50	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)
КТ3102ЕМ	n-p-n	250	≥300	20	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)
КТ3102ЖМ	n-p-n	250	≥200	50	5	100 (200*)	≤0,05 (50 В)
КТ3102ИМ	n-p-n	250	≥200	50	5	100 (200*)	≤0,05 (50 В)
КТ3102КМ	n-p-n	250	≥200	30	5	100 (200*)	≤0,015 (30 В)
КТ3102А2	n-p-n	250	≥200	50	5	200	—
КТ3102Б2	n-p-n	250	≥200	50	5	200	—
КТ3102В2	n-p-n	250	≥200	30	5	200	—
КТ3102Г2	n-p-n	250	≥200	20	5	200	—
КТ3102Д2	n-p-n	250	≥200	30	5	200	—
КТ3102Е2	n-p-n	250	≥300	20	5	200	—
КТ3102Ж2	n-p-n	250	≥200	50	5	200	—
КТ3102И2	n-p-n	250	≥200	50	5	200	—
КТ3102К2	n-p-n	250	≥200	30	5	200	—

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
20...60* (1 В; 10мА)	≤5 (5 В)	≤30	—	≤30*	**КТ306М**
40...120* (1 В; 10мА)	≤5 (5 В)	≤30	—	≤30*	
20...100* (1 В; 10мА)	≤5 (5 В)	—	≤30*	≤500	
40...200* (1 В; 10мА)	≤5 (5 В)	—	≤30*	≤500	
30...150* (1 В; 10мА)	≤5 (5 В)	—	≤30*	≤300	
≥20 (1 В; 10 мА)	≤6 (1 В)	≤20	—	≤30*	**КТ307-1**
≥40 (1 В; 10 мА)	≤6 (1 В)	≤20	—	≤30*	
≥40 (1 В; 10 мА)	≤6 (1 В)	≤20	—	≤30*	
≥80 (1 В; 10 мА)	≤6 (1 В)	≤20	—	≤30*	
35...300 (1 В; 5 мА)	≤1,5 (5 В)	—	≤4,5 (2,25 ГГц)	≤10	**КТ3101-2**
35...300 (1 В; 5 мА)	≤1,5 (5 В)	≥8** (1 ГГц)	≤4,5 (1 ГГц)	≤10	**КТ3101М**
100...200 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	≤100	**КТ3102**
200...500 (5 В; 1 мА)	≤6 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	≤100	
200...500 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	≤100	
400...1000 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	≤100	
200...500 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	≤4 (1 кГц)	≤100	
400...1000 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	≤4 (1 кГц)	≤100	
100...250 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	—	≤100	
200...500 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	—	≤100	
200...500 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	—	≤100	
100...200 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	≤100	**КТ3102М**
200...500 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	≤100	
200...500 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	≤100	
400...1000 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	≤10 (1 кГц)	≤100	
200...500 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	≤4 (1 кГц)	≤100	
400...1000 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	≤4 (1 кГц)	≤100	
100...250 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	—	≤100	
200...500 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	—	≤100	
200...500 (5 В; 2 мА)	≤6 (5 В)	—	—	≤100	
100...200	—	—	—	—	**КТ3102-2**
200...500	—	—	—	—	
200...500	—	—	—	—	
400...500	—	—	—	—	
200...500	—	—	—	—	
400...1000	—	—	—	—	
100...250	—	—	—	—	
200...500	—	—	—	—	
200...500	—	—	—	—	

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$ $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ3104А	p-n-p	15 (35°С)	≥200	30	3,5	10	≤1 (30 В)
КТ3104Б	p-n-p	15 (35°С)	≥200	30	3,5	10	≤1 (30 В)
КТ3104В	p-n-p	15 (35°С)	≥200	30	3,5	10	≤1 (30 В)
КТ3104Г	p-n-p	15 (35°С)	≥200	15	3,5	10	≤1 (15 В)
КТ3104Д	p-n-p	15 (35°С)	≥200	15	3,5	10	≤1 (15 В)
КТ3104Е	p-n-p	15 (35°С)	≥200	15	3,5	10	≤1 (15 В)
КТ3106А-2	n-p-n	30 (50°С)	≥1000	15* (10к)	2,5	20 (40*)	≤0,5 (15 В)
КТ3106А-9	n-p-n	100	≥1000	15* (10к)	3	20 (40*)	≤0,5 (15 В)
КТ3107А	p-n-p	300	≥200	50	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)
КТ3107Б	p-n-p	300	≥200	50	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)
КТ3107В	p-n-p	300	≥200	30	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)
КТ3107Г	p-n-p	300	≥200	30	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)
КТ3107Д	p-n-p	300	≥200	30	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)
КТ3107Е	p-n-p	300	≥200	25	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)
КТ3107Ж	p-n-p	300	≥200	25	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)
КТ3107И	p-n-p	300	≥200	50	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)
КТ3107К	p-n-p	300	≥200	30	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)
КТ3107Л	p-n-p	300	≥200	25	5	100 (200*)	≤0,1 (20 В)
КТ3108А	p-n-p	300 (360*)	≥250	60* (10к)	5	200	≤0,2 (60 В)
КТ3108Б	p-n-p	300 (360*)	≥250	45* (10к)	5	200	≤0,2 (45 В)
КТ3108В	p-n-p	300 (360*)	≥300	45* (10к)	5	200	≤0,2 (45 В)
КТ3109А	p-n-p	170 (40°С)	≥800	30	3	50	≤0,1 (20 В)
КТ3109Б	p-n-p	170 (40°С)	≥800	25	3	50	≤0,1 (20 В)
КТ3109В	p-n-p	170 (40°С)	≥800	25	3	50	≤0,1 (20 В)
КТ3114Б-6	n-p-n	25 (100°С)	≥4300	5	1	15	≤0,5 (5 В)
КТ3114В-6	n-p-n	25 (100°С)	≥4300	5	1	15	≤0,5 (5 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21э}$	C_{k}, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_{ш}$, дБ; $r'^{*}_{б}$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
15...90 (1 В; 2 мА)	≤25 (5 В)	≤100	≤8 (6 МГц)	≤800	**КТ3104**
50...150 (1 В; 2 мА)	≤25 (5 В)	≤100	≤8 (6 МГц)	≤800	
70...280 (1 В; 2 мА)	≤25 (5 В)	≤100	≤8 (6 МГц)	≤800	
15...90 (1 В; 2 мА)	≤25 (5 В)	≤100	≤8 (6 МГц)	≤800	
50...150 (1 В; 2 мА)	≤25 (5 В)	≤100	≤8 (6 МГц)	≤800	
70...280 (1 В; 2 мА)	≤25 (5 В)	≤100	≤8 (6 МГц)	≤800	
≥40 (5 В; 5 мА)	≤2 (5 В)	—	≤2 (120 МГц)	—	**КТ3106-2**
≥40 (5 В; 5 мА)	≤2 (5 В)	—	≤2 (120 МГц)	≤10	**КТ3106-9**
70...140 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	**КТ3107**
120...220 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	
70...140 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	
120...220 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	
180...460 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	
120...220 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤4 (1 кГц)	—	
180...460 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤4 (1 кГц)	—	
180...460 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	
380...800 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤10 (1 кГц)	—	
380...800 (5 В; 2 мА)	≤7 (10 В)	≤20	≤4 (1 кГц)	—	
50...150 (1 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤25	≤6 (100 МГц)	≤250	**КТ3108**
50...150 (1 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤25	≤6 (100 МГц)	≤250	
100...300 (1 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤25	≤6 (100 МГц)	≤250	
≥15 (10 В; 10 мА)	≤1 (10 В)	≥15** (0,8 ГГц)	≤6 (800 МГц)	≤6	**КТ3109**
≥15 (10 В; 10 мА)	≤1 (10 В)	≥13** (0,8 ГГц)	≤7 (800 МГц)	≤10	
≥15 (10 В; 10 мА)	≤1 (10 В)	≥13** (0,8 ГГц)	≤8 (800 МГц)	≤10	
15...80 (3 В; 1 мА)	≤0,44 (3 В)	—	≤2 (400 МГц)	≤8	**КТ3114-6**
15...80 (3 В; 1 мА)	≤0,44 (3 В)	—	≤3 (400 МГц)	≤8	

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ3115А-2	n-p-n	70 (70°C)	≥5800	10* (1к)	1	8,5	≤0,5 (10 В)
КТ3115В-2	n-p-n	70 (70°C)	≥5800	10* (1к)	1	8,5	≤0,5 (10 В)
КТ3115Г-2	n-p-n	50 (85°C)	≥5800	7* (1к)	1	8,5	≤0,5 (7 В)
КТ3115Д-2	n-p-n	50 (85°C)	≥5800	7* (1к)	1	8,5	≤0,5 (5 В)
КТ3117А	n-p-n	300 (800**)	≥200	60	4	400 (800*)	≤10 (60 В)
КТ3117Б	n-p-n	300	≥200	75	4	400 (0,8* А)	≤10 (75 В)
КТ3117А-1	n-p-n	500	≥200	60	4	400 (0,8* А)	≤10 (60 В)
КТ3117А9	n-p-n	300 (800*)	≥200	60	4	400 (0,8*А)	≤10 (60 В)
КТ3117Б9	n-p-n	300	≥200	75	4	400 (0,8*А)	≤10 (75 В)
КТ312А	n-p-n	225	≥80	20	4	30 (60*)	≤10 (20 В)
КТ312Б	n-p-n	225	≥120	35	4	30 (60*)	≤10 (35 В)
КТ312В	n-p-n	225	≥120	20	4	30 (60*)	≤10 (25 В)
КТ312А1	n-p-n	225	≥80	20	4	30 (60*)	≤10 (20 В)
КТ312Б1	n-p-n	225	≥120	35	4	30 (60*)	≤10 (35 В)
КТ312В1	n-p-n	225	≥120	20	4	30 (60*)	≤10 (20 В)
КТ3120АМ	n-p-n	100	≥1800	15	3	20 (40*)	≤0,5 (15 В)
КТ3121А-6	n-p-n	25	≥100	12	2	10	≤1 (10 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	C_k, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, Ом $r^*_{БЭ\,нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≤15 (5 В; 5 мА) ≤15 (5 В; 5 мА) ≤15 (5 В; 5 мА) 70...150 (5 В; 5 мА)	≤0,6 (5 В) ≤0,6 (5 В) ≤0,6 (5 В) ≤0,6 (5 В)	≥5** (5 ГГц) ≥5** (5 ГГц) ≥4,4** (5 ГГц) ≥8** (2,25 ГГц)	≤4,6 (5 ГГц) ≤4,4 (5 ГГц) ≤5,7 (5 ГГц) ≤2,5 (2,25 ГГц)	≤3,8 ≤3,8 ≤3,8 ≤3,8	**КТ3115-2**
40...200* (5 В; 0,2 А) 100...300* (5 В; 0,2 А)	≤10 (10 В) ≤10 (10 В)	≤1,2 ≤1,2	— —	≤80* ≤80*	**КТ3117**
40...200 (5 В; 0,2 А)	≤10 (10 В)	≤1,2	—	≤80*	**КТ3117-1**
40...200* (5 В; 0,2 А) 10...300* (5 В; 0,2 А)	≤10 (10 В) ≤10 (10 В)	≤1,2 ≤1,2	— —	≤80* ≤80*	**КТ3117-9**
10...100* (2 В; 20 мА) 25...100* (2 В; 20 мА) 50...280* (2 В; 20 мА)	≤5 (10 В) ≤5 (10 В) ≤5 (10 В)	≤40 ≤40 ≤40	— — —	≤500; ≤100* ≤500; ≤130* ≤500; ≤130*	**КТ312**
10...100 (2 В; 20 мА) 25...100 (2 В; 20 мА) 50...280 (2 В; 20 мА)	≤5 (10 В) ≤5 (10 В) ≤5 (10 В)	≤40 ≤40 ≤40	— — —	≤500; ≤100* ≤500; ≤130* ≤500; ≤130*	**КТ312-1**
≥40 (1 В; 5 мА)	≤2 (5 В)	≥10** (400 МГц)	≤2 (400 МГц)	≤8	**КТ3120**
≥30 (5 В; 2 мА)	≤1 (5 В)	≥8** (1 ГГц)	≤2 (1 ГГц)	—	**КТ3121-6**

Тип прибора	Струк-тура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ3122А **КТ3122Б**	n-p-n n-p-n	150 (750**) 150 (750**)	— —	35* (2к) 35* (2к)	— —	100 (1* А) 100 (1* А)	≤1 (12 В) ≤1 (12 В)
КТ3123А-2 **КТ3123Б-2** **КТ3123В-2**	p-n-p p-n-p p-n-p	150 150 150	5000 5000 3500	15 15 10	3 3 3	30 (50*) 30 (50*) 30 (50*)	≤25 (15 В) ≤25 (15 В) ≤25 (10 В)
КТ3123АМ **КТ3123БМ** **КТ3123ВМ**	p-n-p p-n-p p-n-p	150 150 150	5000 5000 3500	15 15 10	3 3 3	30 (50*) 30 (50*) 30 (50*)	≤25 (15 В) ≤25 (15 В) ≤25 (10 В)
КТ3126А **КТ3126Б**	p-n-p p-n-p	150 (30°С) 150 (30°С)	≥500 ≥500	20 20	3 3	20 20	≤1 (15 В) ≤1 (15 В)
КТ3126А-9	p-n-p	110	≥450	35	3	30	≤1 (15 В)
КТ3127А	p-n-p	100 (35°С)	≥600	20	3	25	≤1 (15 В)
КТ3128А	p-n-p	100 (35°С)	≥800	40	3	20	≤1 (15 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
— —	≤7 (10 В) ≤7 (10 В)	— —	— —	$t_н$<1 $t_н$<1,5	**КТ3122**
40 (10 В; 10 мА) 40 (10 В; 10 мА) 40 (10 В; 10 мА)	≤1 (10 В) ≤1 (10 В) ≤1 (10 В)	≥5** (1 ГГц) ≥5** (1 ГГц) ≥5** (1 ГГц)	2,4 (1 ГГц) 3 (1 ГГц) 2,4 (1 ГГц)	≤10 ≤10 ≤10	**КТ3123-2**
40 (10 В; 10 мА) 40 (10 В; 10 мА) 40 (10 В; 10 мА)	≤1,2 (10 В) ≤1,2 (10 В) ≤1,2 (10 В)	≥5** (1 ГГц) ≥5** (1 ГГц) ≥5** (1 ГГц)	2,4 (1 ГГц) 3 (1 ГГц) 2,4 (1 ГГц)	≤10 ≤10 ≤10	**КТ3123М**
25...100 (5 В; 3 мА) 60...180 (5 В; 3 мА)	≤2,5 (10 В) ≤2,5 (10 В)	≤120 ≤120	— —	≤15 ≤15	**КТ3126**
25...100 (5 В; 3 мА)	≤2,5 (10 В)	≤120	—	≤10	**КТ3126-9**
25...150 (5 В; 3 мА)	≤1 (10 В)	—	≤5 (1 ГГц)	≤10	**КТ3127**
15...150 (5 В; 3 мА)	≤1 (10 В)	≥14** (0,2 ГГц)	≤34*	≤5	**КТ3128**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ3128А-1	p-n-p	300	≥800	40	4	30 (0,8* А)	≤0,1 (20 В)
КТ3128Б-1	p-n-p	300	≥800	40	4	30 (0,8* А)	≤0,1 (20 В)
КТ3128А-9	p-n-p	100	≥650	35	3	20	≤1 (15 В)
КТ3129А-9	p-n-p	75 (100**)	≥200	50	5	100 (200*)	≤1 (50 В)
КТ3129Б-9	p-n-p	75 (100**)	≥200	50	5	100 (200*)	≤1 (50 В)
КТ3129В-9	p-n-p	75 (100**)	≥200	30	5	100 (200*)	≤1 (30 В)
КТ3129Г-9	p-n-p	75 (100**)	≥200	30	5	100 (200*)	≤1 (30 В)
КТ3129Д-9	p-n-p	75 (100**)	≥200	20	5	100 (200*)	≤1 (20 В)
КТ313А	p-n-p	300 (1000*)	≥200	60	5	350 (700*)	≤0,5 (50 В)
КТ313Б	p-n-p	300 (1000*)	≥200	60	5	350 (700*)	≤0,5 (50 В)
КТ313А-1	p-n-p	300 (1000*)	≥200	60	5	350	≤0,5 (50 В)
КТ313Б-1	p-n-p	300 (1000*)	≥200	60	5	350	≤0,5 (50 В)
КТ313В-1	p-n-p	300 (1000*)	≥200	50	5	350	≤0,5 (50 В)
КТ313Г-1	p-n-p	300 (1000*)	≥200	30	5	700*	≤0,5 (50 В)
КТ3130А-9	n-p-n	100	≥150	50	5	100	≤0,1 (50 В)
КТ3130Б-9	n-p-n	100	≥150	50	5	100	≤0,1 (50 В)
КТ3130В-9	n-p-n	100	≥150	30	5	100	≤0,1 (30 В)
КТ3130Г-9	n-p-n	100	≥300	20	5	100	≤0,1 (20 В)
КТ3130Д-9	n-p-n	100	≥150	30	5	100	≤0,1 (30 В)
КТ3130Е-9	n-p-n	100	≥300	20	5	100	≤0,1 (20 В)
КТ3130Ж-9	n-p-n	100	≥150	30	5	100	≤0,1 (30 В)
КТ3132А-2	n-p-n	70	≥5,5 ГГц	10* (1к)	1	8,5	≤0,5 (10 В)
КТ3132Б-2	n-p-n	70	≥5,5 ГГц	10* (1к)	1	8,5	≤0,5 (10 В)
КТ3132В-2	n-p-n	70	≥5,5 ГГц	10* (1к)	1	8,5	≤0,5 (10 В)
КТ3132Г-2	n-p-n	70	≥5,5 ГГц	10* (1к)	1	8,5	≤0,5 (10 В)
КТ3132Д-2	n-p-n	70 (85°С)	≥5,5 ГГц	10* (1к)	1	8,5	≤0,5 (10 В)
КТ3132Е-2	n-p-n	70 (85°С)	≥5,5 ГГц	10* (1к)	1	8,5	≤0,5 (10 В)
КТ3139А	n-p-n	200	≥150	20	5	200	≤0,02 (20 В)
КТ3139Б	n-p-n	200	≥150	32	5	200	≤0,001 (32 В)
КТ3139В	n-p-n	200	≥150	32	5	200	≤0,001 (32 В)
КТ3139Г	n-p-n	200	≥150	32	5	200	≤0,05 (32 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^*_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
35...150 (10 В; 3 мА) 25...200 (10 В; 3 мА)	≤1 (10 В) ≤1 (10 В)	≥15** (0,2 ГГц) ≥15** (0,2 ГГц)	≤5 (0,2 ГГц) ≤5 (0,2 ГГц)	≤5 ≤5	**КТ3128-1**
15...150 (10 В; 3 мА)	≤1 (10 В)	—	≤5 (200 МГц)	—	**КТ3128-9**
30...120 (5 В; 2 мА) 80...250 (5 В; 3 мА) 80...250 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА)	≤10 (10 В) ≤10 (10 В) ≤10 (10 В) ≤10 (10 В) ≤10 (10 В)	≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20	— — — — —	— — — — —	**КТ3129-9**
30...120 (10 В; 1 мА) 80...300 (10 В; 1 мА)	≤12 (10 В) ≤12 (10 В)	≤3,3 ≤3,3	— —	≤120* ≤120*	**КТ313**
30...120 (10 В; 1 мА) 80...300 (10 В; 1 мА) 200...520 (10 В; 1 мА) 400...800 (10 В; 1 мА)	≤12 (10 В) ≤12 (10 В) ≤12 (10 В) ≤12 (10 В)	≤3,3 ≤3,3 ≤3,3 ≤3,3	— — — —	≤120* ≤120* ≤120* ≤120*	**КТ313-1**
100...250 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 400...1000 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 400...1000 (5 В; 2 мА) 100...500 (5 В; 2 мА)	≤12 (5 В) ≤12 (5 В) ≤12 (5 В) ≤12 (5 В) ≤12 (5 В) ≤12 (5 В) ≤12 (5 В)	— — — — — — —	≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤4 (1 кГц) ≤4 (1 кГц)	— — — — — — —	**КТ3130-9**
15...150 (7 В; 3 мА) 15...150 (7 В; 3 мА) 15...150 (7 В; 3 мА) 15...150 (7 В; 3 мА) 20...150 (7 В; 3 мА) 70...150 (7 В; 3 мА)	≤5,5 (7 В) ≤5,5 (7 В) ≤5,5 (7 В) ≤5,5 (7 В) ≤5,5 (7 В) ≤5,5 (7 В)	≥6** (3,6 ГГц) ≥4** (3,6 ГГц) ≥5** (5 ГГц) ≥7** (4 ГГц) ≥8,1** (2,25 ГГц) ≥8,1** (2,25 ГГц)	≤2,5 (3,6 ГГц) ≤4,8 (3,6 ГГц) ≤4,8 (3,5 ГГц) ≤3,6 (3,4 ГГц) ≤2 (2,25 ГГц) ≤2,5 (2,25 ГГц)	— — — — — —	**КТ3132-2**
≥200 (5 В; 0,2 мА) ≥60 (5 В; 2 мА) ≥120 (5 В; 2 мА) 100...310 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В) ≤4,5 (10 В) ≤4,5 (10 В) ≤4,5 (10 В)	≤50 ≤50 ≤50 ≤50	≤85** ≤85** ≤85** ≤85**	≤270*; ≤130*** ≤270* ≤270* ≤270*	**КТ3139**

Тип прибора	Структура	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{K\ max}$ $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ314А-2	n-p-n	500	≥300	55	4	60 (70*)	≤0,075 (55 В)
КТ3140А	p-n-p	200	≥150	20	5	200	≤0,02 (20 В)
КТ3140Б	p-n-p	200	≥150	32	5	200	≤0,001 (32 В)
КТ3140В	p-n-p	200	≥150	32	5	200	≤0,001 (32 В)
КТ3140Г	p-n-p	200	≥150	32	5	200	≤0,05 (32 В)
КТ3140Д	p-n-p	200	≥150	20	5	200	≤0,02 (20 В)
КТ3142А	n-p-n	360	≥500	40	4,5	200; 500*	≤0,4 (20 В)
КТ3143А	n-p-n	50	≥600	10	4	10	≤0,5 (10 В)
КТ3144А	n-p-n	50	≥1800	15	3	10	≤0,5 (15 В)
КТ3145А-9	n-p-n	200	≥125	32* (0,1к)	5	200	≤0,02 (32 В)
КТ3145Б-9	n-p-n	200	≥125	45* (0,1к)	5	200	≤1 (45 В)
КТ3145В-9	n-p-n	200	≥125	45* (0,1к)	5	200	≤1 (45 В)
КТ3145Г-9	n-p-n	200	≥125	45* (0,1к)	5	200	≤0,05 (45 В)
КТ3145Д-9	n-p-n	200	≥125	45* (0,1к)	5	200	≤0,05 (45 В)
КТ3146А-9	p-n-p	200	≥125	32* (0,1к)	5	200	≤0,02 (32 В)
КТ3146Б-9	p-n-p	200	≥125	45* (0,1к)	5	200	≤1 (45 В)
КТ3146В-9	p-n-p	200	≥125	45* (0,1к)	5	200	≤1 (45 В)
КТ3146Г-9	p-n-p	200	≥125	45* (0,1к)	5	200	≤0,05 (45 В)
КТ3146Д-9	p-n-p	200	≥125	45* (0,1к)	5	200	≤0,05 (45 В)
КТ315А	n-p-n	150 (250*)	≥250	25	6	100	≤0,5 (10 В)
КТ315Б	n-p-n	150 (250*)	≥250	20	6	100	≤0,5 (10 В)
КТ315В	n-p-n	150 (250*)	≥250	40	6	100	≤0,5 (10 В)
КТ315Г	n-p-n	150 (250*)	≥250	35	6	100	≤0,5 (10 В)
КТ315Д	n-p-n	150 (250*)	≥250	40* (10к)	6	100	≤0,6 (10 В)
КТ315Е	n-p-n	150 (250*)	≥250	35* (10к)	6	100	≤0,6 (10 В)
КТ315Ж	n-p-n	100	≥250	20* (10к)	6	50	≤0,6 (10 В)
КТ315И	n-p-n	100	≥250	60* (10к)	6	50	≤0,6 (10 В)
КТ315Н	n-p-n	150	≥250	35* (10к)	6	100	≤0,6 (10 В)
КТ315Р	n-p-n	150	≥250	35* (10к)	6	100	≤0,5 (10 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\,нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$К_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
30...120 (5 В; 0,25 мА)	≤10 (5 В)	≤10	—	≤80; ≤300*	**КТ314-2**
≥200 (5 В; 2 мА) ≥60 (5 В; 2 мА) 120...460 (5 В; 2 мА) 100...310 (5 В; 2 мА) ≥200 (5 В; 2 мА)	≤6,5 (10 В) ≤6,5 (10 В) ≤6,5 (10 В) ≤6,5 (10 В) ≤6,5 (10 В)	≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50	≤85** ≤85** ≤85** ≤85** ≤85**	≤270*; ≤400** ≤270* ≤270* ≤270* ≤270*	**КТ3140**
40...120 (1 В; 10 мА)	≤4 (10 В)	≤25	—	≤13*; ≤18**	**КТ3142А**
40...300 (5 В; 10мА)	≤3 (5 В)	≤0,4	—	≤15*	**КТ3143, КТ3144**
≥40 (1 В; 5 мА)	≤1,9 (5 В)	—	≤5 (400 МГц)	—	
≥200 (5 В; 2 мА) ≥60 (5 В; 2 мА) 120...460 (5 В; 2 мА) 100...310 (5 В; 2 мА) 120...460 (5 В; 2 мА)	≤11 ≤11 ≤11 ≤11 ≤11	≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50	— — — — —	≤1100* ≤1100* ≤1100* ≤1100* ≤1100*	**КТ3145-9**
≥200 (5 В; 2 мА) ≥60 (5 В; 2 мА) 120...460 (5 В; 2 мА) 100...310 (5 В; 2 мА) 120...460 (5 В; 2 мА)	≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12	≤50 ≤0 ≤50 ≤50 ≤50	— — — — —	≤1100* ≤1100* ≤1100* ≤1100* ≤1100*	**КТ3146-9**
30...120* (10 В; 1 мА) 50...350* (10 В; 1 мА) 30...120* (10 В; 1 мА) 50...350* (10 В; 1 мА) 20...90* (10 В; 1 мА) 50...350* (10 В; 1 мА) 30...250* (10 В; 1 мА) ≥30* (10 В; 1 мА) 50...350* (10 В; 1 мА) 150...350* (10 В; 1 мА)	≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤10 (10 В) ≤10 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В)	≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤30 ≤30 ≤25 ≤45 ≤5,5 ≤20	≤40* ≤40* ≤40* ≤40* ≤40* ≤40* — — — —	≤300 ≤500 ≤500 ≤500 ≤1000 ≤1000 ≤800 ≤950 ≤1000 ≤500	**КТ315**

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ315А-1	n-p-n	150	≥250	25	6	100	≤0,5 (10 В)
КТ315Б-1	n-p-n	150	≥250	20	6	100	≤0,5 (10 В)
КТ315В-1	n-p-n	150	≥250	40	6	100	≤0,5 (10 В)
КТ315Г-1	n-p-n	150	≥250	35	6	100	≤0,5 (10 В)
КТ315Д-1	n-p-n	150	≥250	40	6	100	≤0,5 (10 В)
КТ315Е-1	n-p-n	150	≥250	35	6	100	≤0,5 (10 В)
КТ315Ж-1	n-p-n	100	≥250	15	6	100	≤0,5 (10 В)
КТ315И-1	n-p-n	100	≥250	60	6	100	≤0,5 (10 В)
КТ315Н-1	n-p-n	150	≥250	20	6	100	≤0,5 (10 В)
КТ315Р-1	n-p-n	150	≥250	35	6	100	≤0,5 (10 В)
КТ3150Б-2	p-n-p	120 (65°C)	≥1200	35* (10к)	4	30 (50*)	≤0,5 (40 В)
КТ3151А-9	n-p-n	200	≥100	80*	5	100	≤1 (100 В)
КТ3151Б-9	n-p-n	200	≥100	80*	5	100	≤1 (90 В)
КТ3151В-9	n-p-n	200	≥100	60*	5	100	≤1 (80 В)
КТ3151Г-9	n-p-n	200	≥100	40*	5	100	≤1 (60 В)
КТ3151Д-9	n-p-n	200	≥100	30*	5	100	≤1 (30 В)
КТ3151Е-9	n-p-n	200	≥100	20*	5	100	≤1 (30 В)
КТ3153А-9	n-p-n	300	≥250	60	5	400 (0,6* А)	≤0,05 (45 В)
КТ3153А-5	n-p-n	300	≥250	60	5	0,4 А (0,6* А)	≤0,05 (45 В)
КТ3157А	p-n-p	200	≥60	250* (10к)	5	30 (100*)	≤0,1 (200 В)
КТ316А	n-p-n	150 (90°C)	≥600	10* (3к)	4	50	≤0,5 (10 В)
КТ316Б	n-p-n	150 (90°C)	≥800	10* (3к)	4	50	≤0,5 (10 В)
КТ316В	n-p-n	150 (90°C)	≥800	10* (3к)	4	50	≤0,5 (10 В)
КТ316Г	n-p-n	150 (90°C)	≥600	10* (3к)	4	50	≤0,5 (10 В)
КТ316Д	n-p-n	150 (90°C)	≥800	10* (3к)	4	50	≤0,5 (10 В)
КТ316АМ	n-p-n	150 (85°C)	≥600	10* (3к)	4	50	≤0,5 (10 В)
КТ316БМ	n-p-n	150 (85°C)	≥800	10* (3к)	4	50	≤0,5 (10 В)
КТ316ВМ	n-p-n	150 (85°C)	≥800	10* (3к)	4	50	≤0,5 (10 В)
КТ316ГМ	n-p-n	150 (85°C)	≥600	10* (3к)	4	50	≤0,5 (10 В)
КТ316ДМ	n-p-n	150 (85°C)	≥800	10* (3к)	4	50	≤0,5 (10 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^*_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
20...90 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 20...90 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 20...90 (10 В; 1 мА) 20...90 (10 В; 1 мА) 30...250 (10 В; 1 мА) 30 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 150...350 (10 В; 1 мА)	≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В)	≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 — —	≤40* ≤40* ≤40* ≤40* ≤40* ≤40* ≤40* ≤40* — —	≤300 ≤300 ≤300 ≤300 ≤300 ≤300 ≤300 ≤300 — —	**КТ315-1**
60...180* (5 В; 2,5 мА)	≤2 (10 В)	≤25	—	≤30; ≤30*	**КТ3150-2**
≥20 (5 В; 10 мА) 30...90 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) ≥80 (5 В; 10 мА) ≥40 (5 В; 10 мА)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤15 (10 В)	≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60	— — — — — —	— — — — — —	**КТ3151-9**
100...300 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤2,6	—	≤400*	**КТ3153-9**
100...300 (5 В; 2 мА)	≤4,5 (10 В)	≤2,3	—	≤400*	**КТ3153А-5**
≥50* (20 В; 25 мА)	≤3 (30 В)	≤60	—	—	**КТ3157**
20...60* (1 В; 10 мА) 40...120* (1 В; 10 мА) 40...120* (1 В; 10 мА) 20...100* (1 В; 10 мА) 60...300* (1 В; 10 мА)	≤3 (5 В) ≤3 (5 В) ≤3 (5 В) ≤3 (5 В) ≤3 (5 В)	≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40	— — — — —	≤10* ≤10* ≤15* ≤150 ≤150	**КТ316**
20...60* (1 В; 10 мА) 40...120* (1 В; 10 мА) 40...120* (1 В; 10 мА) 20...100* (1 В; 10 мА) 60...300* (1 В; 10 мА)	≤3 (5 В) ≤3 (5 В) ≤3 (5 В) ≤3 (5 В) ≤3 (5 В)	≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40	— — — — —	≤10* ≤10* ≤15* ≤150 ≤150	**КТ316М**

Тип прибора	Структура	$P_{K\ max}$, $P^*_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^*_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^*_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ3165А	p-n-p	160 (55°С)	≥750	40	3	30	≤0,1 (20 В)
КТ3165А-9	p-n-p	100	1060	40	5	30	0,5
					$U_{ЭБпр}$		
КТ3166А	n-p-n	15	≥400	15* (1к)	≥546,6 мВ	1	—
КТ3166Б	n-p-n	15	≥400	15* (1к)	≥545,1 мВ	1	—
КТ3166В	n-p-n	15	≥400	15* (1к)	≥543,6 мВ	1	—
КТ3166Г	n-p-n	15	≥400	15* (1к)	≥540,6 мВ	1	—
КТ3168А-9	n-p-n	180 (55°С)	≥3000	15* (10к)	2,5	28 (56*)	≤0,5 (15 В)
КТ3169А-9	p-n-p	200	≥750	40	3	30	≤0,1 (20 В)
КТ3169А91	p-n-p	200	≥750	40	3	30 (0,6* А)	≤0,1 (20 В)
КТ317А-1	n-p-n	15	≥100	5	3,5	15 (45*)	≤1 (5 В)
КТ317Б-1	n-p-n	15	≥100	5	3,5	15 (45*)	≤1 (5 В)
КТ317В-1	n-p-n	15	≥100	5	3,5	15 (45*)	≤1 (5 В)
КТ3170А-9	n-p-n	250	≥300	40	4	30	0,1 (20 В)
КТ3171А-9	p-n-p	200	≥150	15	4	530	≤0,1 (12 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_{к}$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_{ш}$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥25* (10 В; 3 мА)	≤0,65 (10 В)	—	≤8 (1 ГГц)	≤3	**КТ3165**
≥25 (10 В; 3 мА)	—	—	7	≤3	**КТ3165А-9**
280...1000* (5 В; 0,1 мА) 280...1000* (5 В; 0,1 мА) 280...1000* (5 В; 0,1 мА) 280...1000* (5 В; 0,1 мА)	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	**КТ3166**
60...180 (5 В; 5 мА)	≤1,5 (5 В)	≥7** (1 ГГц)	≤3 (1 ГГц)	≤10	**КТ3168А-9**
≥25 (1 В; 3 мА)	≤0,6 (10 В)	≥13** (0,8 ГГц)	≤6 (800 МГц)	—	**КТ3169-9**
≥25 (10 В; 3 мА)	≤0,6 (10 В)	≥13** (800 МГц)	≤6 (800 МГц)	—	**КТ3169-91**
25...75 (1 В; 1 мА) 35...120 (1 В; 1 мА) 80...250 (1 В; 1 мА)	≤11 (1 В) ≤11 (1 В) ≤11 (1 В)	≤30 ≤30 ≤30	— — —	≤130* ≤130* ≤130*	**КТ317-1**
≥100 (10 В; 7 мА)	≤2 (10 В)	—	—	—	**КТ3170-9, КТ3171А-9**
≥50* (2 В; 100 мА)	≤15 (15 В)	≤1,5	—	≤20	

Тип прибора	Структура	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ3172А-9	n-p-n	200	≥500	20*	4,5	200*	≤0,4 (20 В)
КТ3173А-9	p-n-p	200	≥200	30	5	530	≤0,1 (20 В)
КТ3176А-9	n-p-n	200	≥150	35	5	500	≤0,1 (35 В)
КТ3179А-9	n-p-n	200	≥150	150	5	55	≤1 (100 В)
КТ318А-1	n-p-n	15	≥430	10	3,5	20 (45*)	≤0,5 (10 В)
КТ318Б-1	n-p-n	15	≥430	10	3,5	20 (45*)	≤0,5 (10 В)
КТ318В-1	n-p-n	15	≥430	10	3,5	20 (45*)	≤0,5 (10 В)
КТ318Г-1	n-p-n	15	≥350	10	3,5	20 (45*)	≤0,5 (10 В)
КТ318Д-1	n-p-n	15	≥350	10	3,5	20 (45*)	≤0,5 (10 В)
КТ318Е-1	n-p-n	15	≥350	10	3,5	20 (45*)	≤0,5 (10 В)
КТ3180А-9	p-n-p	200	≥150	150	5	50	≤1 (150 В)
КТ3184А9	n-p-n	1200	≥200	80; 65*	6	500	≤10 (60 В)
КТ3184Б9	n-p-n	1200	≥200	80; 65*	6	500	≤10 (60 В)
КТ3186А-9	n-p-n	300	≥6 ГГц	20	2,5	50	≤0,1 (10 В)
КТ3186Б-9	n-p-n	90	≥3,2 ГГц	20	2,5	50	≤0,1 (10 В)
КТ3186В-9	n-p-n	250	≥4 ГГц	20	2,5	50	≤0,1 (10 В)
КТ3187А-9	n-p-n	200	≥4,4 ГГц	20	2	25	≤0,1 (10 В)
КТ3187А91	n-p-n	200	≥4600	20; 12*	2	20	—
КТ3187Б91	n-p-n	90	≥3200	18; 12*	2	10	—
КТ3187В91	n-p-n	200	≥3000	20	2	25	—

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\,нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥40 (1 В; 10 мА)	≤3 (10 В)	≤1	—	≤45	**КТ3172-9, КТ3173-9**
50...500 (5 В; 30 мА)	≤10 (10 В)	≤1,5	—	≤20**	
≥60 (10 В; 150 мА)	≤15 (10 В)	≤1,2	—	—	**КТ3176-9, КТ3179-9**
≥65* (5 В; 10 мА)	≤3	≤33	—	—	
30...90 (1 В; 10 мА) 50...150 (1 В; 10 мА) 70...280 (1 В; 10 мА) 30...90 (1 В; 10 мА) 50...150 (1 В; 10 мА) 70...280 (1 В; 10 мА)	≤3,5 (5 В) ≤3,5 (5 В) ≤3,5 (5 В) ≤4,5 (5 В) ≤4,5 (5 В) ≤4,5 (5 В)	≤27 ≤27 ≤27 ≤27 ≤27 ≤27	— — — — — —	≤15* ≤15* ≤15* ≤10* ≤10* ≤10*	**КТ318-1**
≥90* (5 В; 10 мА)	—	≤33	—	—	**КТ3180-9**
20...80 (5 В; 0,2 А) 50...180 (5 В; 0,2 А)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В)	≤4; 7,5* ≤4; 7,5*	≤6 (100 МГц) ≤6 (100 МГц)	≤400 ≤400	**КТ3184-9**
≥60 (5 В; 15 мА) ≥40 (3 В; 2 мА) ≥35 (5 В; 10 мА)	≤0,9 (8 В) ≤0,9 (8 В) ≤0,9 (8 В)	≥8** (2 ГГц) ≥6** (2 ГГц) ≥6** (2 ГГц)	≤3,5 (2 ГГц) ≤3 (2 ГГц) ≤4 (2 ГГц)	— — —	**КТ3186-9**
≥40 (10 В; 14 мА)	≤0,9 (10 В)	≥12** (0,8 ГГц)	≤2 (0,8 ГГц)	—	**КТ3187-9 (КТ3187-91)**
≥40 (10 В; 14 мА) ≥40 (3 В; 2 мА) ≥40 (5 В; 5 мА)	— — —	≥12** (0,8 ГГц) ≥12** (0,8 ГГц) ≥12** (0,8 ГГц)	≤2 (0,8 ГГц) ≤2 (0,8 ГГц) ≤2,5 (0,8 ГГц)	— — —	

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ3189А-9 **КТ3189Б-9** **КТ3189В-9**	n-p-n n-p-n n-p-n	225 225 225	300 300 300	50 50 50	6 6 6	100 100 100	— — —
КТ319А-1 **КТ319Б-1** **КТ319В-1**	n-p-n n-p-n n-p-n	15 15 15	≥100 ≥100 ≥100	5 5 5	3,5 3,5 3,5	15 15 15	≤1 ≤1 ≤1
КТ3191А-9	p-n-p	200	≥4500	15**	2	25	≤0,1 (20 В)
КТ3191А91	p-n-p	200	≥4500	15**	2	25	≤0,1 (20 В)
КТ3192А-9	p-n-p	200	800	40	3	30	0,1
КТ3193А **КТ3193Б** **КТ3193В** **КТ3193Г** **КТ3193Д** **КТ3193Е**	p-n-p p-n-p p-n-p p-n-p p-n-p p-n-p	200 200 200 200 200 200	≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50	50* (10к) 40* (10к) 30* (10к) 50* (10к) 40* (10к) 30* (10к)	20 20 20 5 5 5	150; 300* 150; 300* 150; 300* 150; 300* 150; 300* 150; 300*	≤50 (50 В) ≤50 (40 В) ≤50 (30 В) ≤50 (50 В) ≤50 (40 В) ≤50 (30 В)
КТ3196А-9	p-n-p	225	250	40	5	200	10
КТ3197А-9	n-p-n	225	200	60	6	200	10
КТ3198А **КТ3198Б** **КТ3198В** **КТ3198Г** **КТ3198Д** **КТ3198Е** **КТ3198Ж**	n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n	280 280 300 300 280 300 300	4600 4600 4000 4000 3000 6000 6500	15* 15* 15* 15* 20 20 20	2,5 2,5 2,5 2,2 2,5 3 2,5	25 25 50 35 30 100 50	— — — — — — —
КТ3198А9 **КТ3198Б9** **КТ3198В9** **КТ3198Г9** **КТ3198Д9** **КТ3198Е9** **КТ3198Ж9**	n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n	280 280 300 300 280 300 200	≥4200 ≥4200 ≥4000 ≥4000 ≥3000 ≥6000 ≥6500	20 20 20 15 20 20 20	2,5 2,5 2,5 2 2,5 3 2,5	30 30 50 35 30 100 50	— — — — — — —

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^{*}_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
110...220 200...450 420...800	— — —	6 6 6	10 10 10	— — —	**КТ3189-9**
15...55 (1 В; 1 мА) 45...90 (1 В; 1 мА) 80...200 (1 В; 1 мА)	≤11 (1 В) ≤11 (1 В) ≤11 (1 В)	≤30 ≤30 ≤30	— — —	≤130* ≤130* ≤130*	**КТ319-1**
≥20 (10 В; 14 мА)	≤0,9 (10 В)	≥16** (0,5 ГГц)	≤2,4 (0,5 ГГц)	—	**КТ3191-9**
≥20 (10 В; 14 мА)	≤0,9 (10 В)	≥16** (0,5 ГГц)	≤2,4 (0,5 ГГц)	—	**КТ3191-91 (КТ3192-9)**
20	—	—	6	—	
80...400 (5 В; 30 мА) 80...400 (5 В; 30 мА) 80...400 (5 В; 30 мА) 100...400 (5 В; 30 мА) 100...400 (5 В; 30 мА) 100...400 (5 В; 30 мА)	≤35 (20 В) ≤35 (20 В) ≤35 (20 В) ≤60 (20 В) ≤60 (20 В) ≤60 (20 В)	≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1	— — — — — —	≤400* ≤400* ≤400* ≤400* ≤400* ≤400*	**КТ3193**
100...300	—	2	—	—	**КТ3196-9, КТ3197-9**
100...300	—	1,5	—	—	
40 40 25 40 ≥20 (1 В; 2 мА) ≥50 (10 В; 20 мА) ≥60 (8 В; 15 мА)	— — — — — — —	≥16** (0,5 ГГц) ≥12** (0,5 ГГц) 14** ≥11** (0,8 ГГц) ≥10** (0,8 ГГц) ≥12** (0,8 ГГц) ≥13** (0,8 ГГц)	≤2,4 (0,5 ГГц) 2 1,9 1,6 ≤4 (0,8 ГГц) ≤2 (0,8 ГГц) ≤1,8 (0,8 ГГц)	— — — — — — —	**КТ3198**
≥40 (10 В; 14 мА) ≥40 (10 В; 14 мА) ≥25 (5 В; 30 мА) ≥40 (5 В; 30 мА) ≥20 (1 В; 2 мА) ≥50 (10 В; 20 мА) ≥50 (5 В; 15 мА)	— — — — — — —	≥13** (0,5 ГГц) ≥11** (0,8 ГГц) ≥13** (0,5 ГГц) ≥11** (0,8 ГГц) ≥10** (0,8 ГГц) ≥12** (0,8 ГГц) ≥16** (0,8 ГГц)	≤2,4 (0,5 ГГц) ≤2 (0,8 ГГц) ≤2,3 (0,5 ГГц) ≤2 (0,8 ГГц) ≤4 (0,8 ГГц) ≤2 (0,8 ГГц) ≤1,8 (0,8 ГГц)	— — — — — — —	**КТ3198-9**

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ3198А92	n-p-n	300	≥4500	20	2,5	30	—
КТ3198Г92	n-p-n	300	≥5000	15	2	35	—
КТ3199А9	n-p-n	300	≥6000	20	2,5	50	—
КТ3199А91	n-p-n	300	≥6000	20	2,5	50	—
КТ3199А92	n-p-n	300	≥5500	15	2	50	—
КТ3201А9	n-p-n	300	≥100	450	6	400	—
КТ3201Б9	n-p-n	300	≥100	400	6	400	—
КТ3201В9	n-p-n	300	≥100	300	6	400	—
КТ3201Г9	n-p-n	300	≥100	250	6	400	—
КТ321А	p-n-p	210 (20** Вт)	≥60	60	4	200 (2* А)	≤0,1 (60 В)
КТ321Б	p-n-p	210 (20** Вт)	≥60	60	4	200 (2* А)	≤0,1 (60 В)
КТ321В	p-n-p	210 (20** Вт)	≥60	60	4	200 (2* А)	≤0,1 (60 В)
КТ321Г	p-n-p	210 (20** Вт)	≥60	45	4	200 (2* А)	≤0,1 (45 В)
КТ321Д	p-n-p	210 (20** Вт)	≥60	45	4	200 (2* А)	≤0,1 (45 В)
КТ321Е	p-n-p	210 (20** Вт)	≥60	45	4	200 (2* А)	≤0,1 (45 В)
КТ324А-1	n-p-n	15	≥800	10	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ324Б-1	n-p-n	15	≥800	10	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ324В-1	n-p-n	15	≥800	10	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ324Г-1	n-p-n	15	≥600	10	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ324Д-1	n-p-n	15	≥600	10	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ324Е-1	n-p-n	15	≥600	10	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ325А	n-p-n	225 (85°C)	≥800	15* (3к)	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
КТ325Б	n-p-n	225 (85°C)	≥800	15* (3к)	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
КТ325В	n-p-n	225 (85°C)	≥1000	15* (3к)	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^{*}_{б}$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥35 (5 В; 10 мА) ≥40 (10 В; 14 мА)	— —	≥11** (0,8 ГГц) ≥12** (0,8 ГГц)	≤2 (0,8 ГГц) ≤3,4 (0,8 ГГц)	— —	**КТ3198-92, КТ3199-9**
≥60 (5 В; 15 мА)	—	≥15** (0,8 ГГц)	≤1,8 (0,8 ГГц)	—	
≥60 (5 В; 15 мА)	—	≥15** (0,8 ГГц)	≤1,8 (0,8 ГГц)	—	**КТ3199-91**
≥80 (8 В; 15 мА)	—	≥12** (0,8 ГГц)	≤2 (0,8 ГГц)	—	**КТ3199-92**
≥30 (10 В; 50 мА) ≥30 (10 В; 50 мА) ≥30 (10 В; 50 мА) ≥30 (10 В; 50 мА)	≤4,5 (20 В) ≤4,5 (20 В) ≤4,5 (20 В) ≤4,5 (20 В)	≤10; 1,5* ≤10; 1,5* ≤10; 1,5* ≤10; 1,5*	— — — —	— — — —	**КТ3201-9**
20...60* (3 В; 0,5 А) 40...120* (3 В; 0,5 А) 80...200* (3 В; 0,5 А) 20...60* (3 В; 0,5 А) 40...120* (3 В; 0,5 А) 80...200* (3 В; 0,5 А)	≤80 (10 В) ≤80 (10 В) ≤80 (10 В) ≤80 (10 В) ≤80 (10 В) ≤80 (10 В)	≤3,6 ≤3,6 ≤3,6 ≤3,6 ≤3,6 ≤3,6	— — — — — —	≤1000* ≤1000* ≤1000* ≤1000* ≤1000* ≤1000*	**КТ321**
20...60 (1 В; 10 мА) 40...120 (1 В; 10 мА) 80...250 (1 В; 10 мА) 40...120 (1 В; 10 мА) 20...80 (1 В; 10 мА) 60...250 (1 В; 10 мА)	≤2,5 (5 В) ≤2,5 (5 В) ≤2,5 (5 В) ≤2,5 (5 В) ≤2,5 (5 В) ≤2,5 (5 В)	≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30	— — — — — —	≤180; ≤10* ≤180; ≤10* ≤180; ≤10* ≤180; ≤10* ≤180; ≤10* ≤180; ≤10*	**КТ324-1**
30...90* (5 В; 10 мА) 70...210* (5 В; 10 мА) 160...400* (5 В; 10 мА)	≤2,5 (5 В) ≤2,5 (5 В) ≤2,5 (5 В)	— — —	— — —	≤125 ≤125 ≤125	**КТ325**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ325АМ	n-p-n	225 (85°С)	≥800	15* (3к)	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
КТ325БМ	n-p-n	225 (85°С)	≥800	15* (3к)	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
КТ325ВМ	n-p-n	225 (85°С)	≥1000	15* (3к)	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
КТ326А	p-n-p	200 (30°С)	≥250	15* (100к)	5	50	≤0,5 (20 В)
КТ326Б	p-n-p	200 (30°С)	≥400	15* (100к)	5	50	≤0,5 (20 В)
КТ326АМ	p-n-p	200 (30°С)	≥250	15* (100к)	5	50	≤0,5 (20 В)
КТ326БМ	p-n-p	200 (30°С)	≥400	15* (100к)	5	50	≤0,5 (20 В)
КТ331А-1	n-p-n	15	≥250	15* (10к)	3	20 (50*)	≤0,2 (15 В)
КТ331Б-1	n-p-n	15	≥250	15* (10к)	3	20 (50*)	≤0,2 (15 В)
КТ331В-1	n-p-n	15	≥250	15* (10к)	3	20 (50*)	≤0,2 (15 В)
КТ331Г-1	n-p-n	15	≥400	15* (10к)	3	20 (50*)	≤0,2 (15 В)
КТ332А-1	n-p-n	15	≥250	15* (10к)	3	20 (50*)	≤0,2 (15 В)
КТ332Б-1	n-p-n	15	≥250	15* (10к)	3	20 (50*)	≤0,2 (15 В)
КТ332В-1	n-p-n	15	≥250	15* (10к)	3	20 (50*)	≤0,2 (15 В)
КТ332Г-1	n-p-n	15	≥500	15* (10к)	3	20 (50*)	≤0,2 (15 В)
КТ332Д-1	n-p-n	15	≥500	15* (10к)	3	20 (50*)	≤0,2 (15 В)
КТ333А-3	n-p-n	15	≥450	10* (3к)	3,5	20 (45*)	≤0,4 (10 В)
КТ333Б-3	n-p-n	15	≥450	10* (3к)	3,5	20 (45*)	≤0,4 (10 В)
КТ333В-3	n-p-n	15	≥450	10* (3к)	3,5	20 (45*)	≤0,4 (10 В)
КТ333Г-3	n-p-n	15	≥350	10* (3к)	3,5	20 (45*)	≤0,4 (10 В)
КТ333Д-3	n-p-n	15	≥350	10* (3к)	3,5	20 (45*)	≤0,4 (10 В)
КТ333Е-3	n-p-n	15	≥350	10* (3к)	3,5	20 (45*)	≤0,4 (10 В)
КТ336А	n-p-n	50	≥250	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ336Б	n-p-n	50	≥250	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ336В	n-p-n	50	≥250	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ336Г	n-p-n	50	≥450	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ336Д	n-p-n	50	≥450	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ336Е	n-p-n	50	≥450	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
КТ337А	p-n-p	150 (60°С)	≥500	6* (10к)	4	30	≤1 (6 В)
КТ337Б	p-n-p	150 (60°С)	≥600	6* (10к)	4	30	≤1 (6 В)
КТ337В	p-n-p	150 (60°С)	≥600	6* (10к)	4	30	≤1 (6 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^*_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
30...90* (5 В; 10 мА) 70...210* (5 В; 10 мА) 160...400* (5 В; 10 мА)	≤2,5 (5 В) ≤2,5 (5 В) ≤2,5 (5 В)	— — —	— — —	≤125 ≤125 ≤125	**КТ325М**
20...70* (2 В; 10 мА) 45...160* (2 В; 10 мА)	≤5 (5 В) ≤5 (5 В)	≤30 ≤30	— —	≤450 ≤450	**КТ326**
20...70* (2 В; 10 мА) 45...160* (2 В; 10 мА)	≤5 (5 В) ≤5 (5 В)	≤30 ≤30	— —	≤450 ≤450	**КТ326М**
20...60 (5 В; 1 мА) 40...120 (5 В; 1 мА) 80...220 (5 В; 1 мА) 40...120 (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В)	— — — —	≤4,5 (100 МГц) ≤4,5 (100 МГц) ≤4,5 (100 МГц) ≤4,5 (100 МГц)	≤120 ≤120 ≤120 ≤120	**КТ331-1**
20...60 (5 В; 1 мА) 40...120 (5 В; 1 мА) 80...220 (5 В; 1 мА) 40...120 (5 В; 1 мА) 80...220 (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В)	— — — — —	≤8 (100 МГц) ≤8 (100 МГц) ≤8 (100 МГц) ≤8 (100 МГц) ≤8 (100 МГц)	≤300 ≤300 ≤300 ≤300 ≤300	**КТ332-1**
30...90 (1 В; 10 мА) 50...150 (1 В; 10 мА) 70...280 (1 В; 10 мА) 30...90 (1 В; 10 мА) 50...150 (1 В; 10 мА) 70...280 (1 В; 10 мА)	≤3,5 (5 В) ≤3,5 (5 В) ≤3,5 (5 В) ≤4,5 (5 В) ≤4,5 (5 В) ≤4,5 (5 В)	≤27 ≤27 ≤27 ≤27 ≤27 ≤27	— — — — — —	≤15* ≤15* ≤15* ≤25* ≤25* ≤25*	**КТ333-3**
20...60 (1 В; 10 мА) 40...120 (1 В; 10 мА) ≥80 (1 В; 10 мА) 20...60 (1 В; 10 мА) 40...120 (1 В; 10 мА) ≥80 (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В)	≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30	— — — — — —	≤30* ≤30* ≤50* ≤15* ≤15* ≤15*	**КТ336**
≥30* (0,3 В; 10 мА) ≥50* (0,3 В; 10 мА) ≥70* (0,3 В; 10 мА)	≤6 (5 В) ≤6 (5 В) ≤6 (5 В)	≤20 ≤20 ≤20	— — —	≤25* ≤28* ≤28*	**КТ337**

8 зак 9

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ339АМ	n-p-n	260 (55°С)	≥300	40	4	25	≤1 (40 В)
КТ339А	n-p-n	260 (55 °С)	≥300	40	4	25	≤1 (40 В)
КТ339Б	n-p-n	260 (55 °С)	≥250	25	4	25	≤1 (40 В)
КТ339В	n-p-n	260 (55 °С)	≥450	40	4	25	≤1 (40 В)
КТ339Г	n-p-n	260 (55 °С)	≥250	40	4	25	≤1 (40 В)
КТ339Д	n-p-n	260 (55 °С)	≥250	40	4	25	≤1 (40 В)
КТ340А	n-p-n	150 (85°С)	≥300	15	5	50	≤1 (15 В)
КТ340Б	n-p-n	150 (85°С)	≥300	20	5	50	≤1 (20 В)
КТ340В	n-p-n	150 (85°С)	≥300	15	5	50 (200*)	≤1 (15 В)
КТ340Г	n-p-n	150 (85°С)	≥300	15	5	75 (500*)	≤1 (15 В)
КТ340Д	n-p-n	150 (85°С)	≥300	15	5	50	≤1 (15 В)
КТ342А	n-p-n	250	≥250	35	5	50 (300*)	≤0,05 (25 В)
КТ342Б	n-p-n	250	≥300	30	5	50 (300)	≤0,05 (20 В)
КТ342В	n-p-n	250	≥300	25	5	50 (300)	≤0,05 (10 В)
КТ342Г	n-p-n	250	≥300	60* (10к)	5	50 (300*)	≤0,05 (60 В)
КТ342АМ	n-p-n	250	≥250	35	5	50 (300*)	≤0,05 (25 В)
КТ342БМ	n-p-n	250	≥300	30	5	50 (300*)	≤0,05 (20 В)
КТ342ВМ	n-p-n	250	≥300	25	5	50 (300*)	≤0,05 (10 В)
КТ342ГМ	n-p-n	250	≥150	30* (10к)	5	50 (300*)	≤0,05 (30 В)
КТ342ДМ	n-p-n	250	≥150	25* (10к)	5	50 (300*)	≤0,05 (25 В)
КТ343А	p-n-p	150 (75°С)	≥300	17* (10к)	4	50 (150*)	≤1 (10 В)
КТ343Б	p-n-p	150 (75°С)	≥300	17* (10к)	4	50 (150*)	≤1 (10 В)
КТ343В	p-n-p	150 (75°С)	≥300	9* (10к)	4	50 (150*)	≤1 (7 В)
КТ345А	p-n-p	300 (600**)	≥350	20* (10к)	5	200 (300*)	≤0,5 (20 В)
КТ345Б	p-n-p	300 (600**)	≥350	20* (10к)	5	200 (300*)	≤0,5 (20 В)
КТ345В	p-n-p	300 (600**)	≥350	20* (10к)	5	200 (300*)	≤0,5 (20 В)
КТ347А	p-n-p	150 (75°С)	≥500	15* (10к)	4	50 (110*)	≤1 (15 В)
КТ347Б	p-n-p	150 (75°С)	≥500	9* (10к)	4	50 (110*)	≤1 (9 В)
КТ347В	p-n-p	150 (75°С)	≥500	6* (10к)	4	50 (110*)	≤1 (6 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥25* (10 В; 7 мА)	≤2 (5 В)	—	—	≤25	КТ339М
≥25* (10 В; 7 мА) ≥15* (10 В; 7 мА) ≥25* (10 В; 7 мА) ≥40* (10 В; 7 мА) ≥15* (10 В; 7 мА)	≤2 (5 В) ≤2 (5 В) ≤2 (5 В) ≤2 (5 В) ≤2 (5 В)	— — — — —	— — — — —	≤25 ≤25 ≤50 ≤100 ≤150	КТ339
100...300* (1 В; 10 мА) ≥100* (1 В; 10 мА) ≥35* (2 В; 0,2 А) ≥16* (2 В; 0,5 А) ≥40* (2 В; 0,2 А)	≤3,7 (5 В) ≤3,7 (5 В) ≤3,7 (5 В) ≤3,7 (5 В) ≤6 (5 В)	≤20 ≤25 ≤2 ≤1,2 ≤30	— — — — —	≤45; ≤10* ≤40; ≤15* ≤85; ≤15* ≤85; ≤15* ≤150; ≤75*	КТ340
100...250* (5 В; 1 мА) 200...500* (5 В; 1 мА) 400...1000* (5 В; 1 мА) 50...120* (5 В; 1 мА)	≤8 (5 В) ≤8 (5 В) ≤8 (5 В) ≤8 (5 В)	≤10 ≤10 ≤10 ≤10	— — — —	≤200 ≤300 ≤700 —	КТ342
100...250* (5 В; 2 мА) 200...500* (5 В; 2 мА) 400...1000* (5 В; 2 мА) 100...250* (5 В; 2 мА) 200...500* (5 В; 2 мА)	≤8 (5 В) ≤8 (5 В) ≤8 (5 В) ≤8 (5 В) ≤8 (5 В)	≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10	— — — — —	≤200 ≤300 ≤700 — —	КТ342М
≥30* (0,3 В; 10 мА) ≥50* (0,3 В; 10 мА) ≥30* (0,3 В; 10 мА)	≤6 (5 В) ≤6 (5 В) ≤6 (5 В)	≤30 ≤30 ≤30	— — —	≤10* ≤20* ≤10*	КТ343
≥20* (1 В; 100 мА) ≥50* (1 В; 100 мА) ≥70* (1 В; 100 мА)	≤15 (5 В) ≤15 (5 В) ≤15 (5 В)	≤3 ≤3 ≤3	— — —	≤70* ≤70* ≤70*	КТ345
30...400* (0,3 В; 10 мА) 30...400* (0,3 В; 10 мА) 50...400* (0,3 В; 10 мА)	≤6 (5 В) ≤6 (5 В) ≤6 (5 В)	≤30 ≤30 ≤30	— — —	≤25* ≤25* ≤40*	КТ347

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ348А-3	n-p-n	15	≥100	5* (3к)	3,5	15 (45*)	≤1 (5 В)
КТ348Б-3	n-p-n	15	≥100	5* (3к)	3,5	15 (45*)	≤1 (5 В)
КТ348В-3	n-p-n	15	≥100	5* (3к)	3,5	15 (45*)	≤1 (5 В)
КТ349А	p-n-p	200 (35°С)	≥300	15* (10к)	4	50 (100*)	≤1 (10 В)
КТ349Б	p-n-p	200 (35°С)	≥300	15* (10к)	4	50 (100*)	≤1 (10 В)
КТ349В	p-n-p	200 (35°С)	≥300	15* (10к)	4	50 (100*)	≤1 (10 В)
КТ350А	p-n-p	300 (30°С)	≥100	20	5	600*	≤1 (10 В)
КТ351А	p-n-p	300 (30°С)	≥200	15* (10к)	5	400*	≤1 (10 В)
КТ351Б	p-n-p	300 (30°С)	≥200	15* (10к)	5	400*	≤1 (10 В)
КТ352А	p-n-p	300 (30°С)	≥200	20	5	200*	≤1 (10 В)
КТ352Б	p-n-p	300 (30°С)	≥200	20	5	200*	≤1 (10 В)
КТ354А-2	n-p-n	30	≥1100	10* (3к)	4	10 (20*)	≤0,5 (10 В)
КТ354Б-2	n-p-n	30	≥1500	10* (3к)	4	10 (20*)	≤0,5 (10 В)
КТ355А	n-p-n	225 (85°С)	≥1500	15* (3к)	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
КТ355АМ	n-p-n	225 (85°С)	≥1500	15* (3к)	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
КТ357А	p-n-p	100 (50°С)	≥300	6*	3,5	40 (80*)	≤5 (6 В)
КТ357Б	p-n-p	100 (50°С)	≥300	6*	3,5	40 (80*)	≤5 (6 В)
КТ357В	p-n-p	100 (50°С)	≥300	20*	3,5	40 (80*)	≤5 (20 В)
КТ357Г	p-n-p	100 (50°С)	≥300	20*	3,5	40 (80*)	≤5 (20 В)
КТ358А	n-p-n	100 (50°С)	≥80	15	4	30 (60*)	≤10 (15 В)
КТ358Б	n-p-n	100 (50°С)	≥120	30	4	30 (60*)	≤10 (30 В)
КТ358В	n-p-n	100 (50°С)	≥120	15	4	30 (60*)	≤10 (15 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
25...75 (1 В; 1 мА) 35...120 (1 В; 1 мА) 80...250 (1 В; 1 мА)	≤11 (1 В) ≤11 (1 В) ≤11 (1 В)	≤30 ≤30 ≤30	— — —	≤130* ≤130* ≤130*	**КТ348-3**
20...80* (1 В; 10 мА) 40...160* (1 В; 10 мА) 120...300* (1 В; 10 мА)	≤6 (5 В) ≤6 (5 В) ≤6 (5 В)	≤30 ≤30 ≤30	— — —	— — —	**КТ349**
20...200* (1 В; 0,5 А)	≤70 (5 В)	≤2	—	—	**КТ350, КТ351, КТ352**
20...80* (1 В; 0,5 А) 50...200* (1 В; 0,3 А)	≤20 (5 В) ≤20 (5 В)	≤1,5 ≤2,25	— —	— —	
25...125* (1 В; 0,2 А) 70...300* (1 В; 0,2 А)	≤15 (5 В) ≤15 (5 В)	≤3 ≤3	— —	— ≤150*	
40...200 (2 В; 5 мА) 90...360 (2 В; 5 мА)	≤1,3 (5 В) ≤1,3 (5 В)	— —	≤10* ≤10*	≤25 ≤30	**КТ354-2**
80...300* (5 В; 10 мА)	≤2 (5 В)	—	≤5,5 (60 МГц)	≤60	**КТ355**
80...300* (5 В; 10 мА)	≤2 (5 В)	—	≤5,5 (60 МГц)	≤60	**КТ355М**
20...100* (0,5 В; 10 мА) 60...300* (0,5 В; 10 мА) 20...100* (0,5 В; 10 мА) 60...300* (0,5 В; 10 мА)	≤7 (5 В) ≤7 (5 В) ≤7 (5 В) ≤7 (5 В)	≤30 ≤30 ≤30 ≤30	— — — —	≤150* ≤250* ≤150* ≤250*	**КТ357**
10...100* (5,5 В; 20 мА) 25...100* (5,5 В; 20 мА) 50...280* (5,5 В; 20 мА)	≤5 (10 В) ≤5 (10 В) ≤5 (10 В)	≤40 ≤40 ≤40	— — —	≤500 ≤500 ≤500	**КТ358**

Тип прибора	Структура	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ359А-3	n-p-n	15	≥300	15* (3к)	3,5	20	≤0,5 (15 В)
КТ359Б-3	n-p-n	15	≥300	15* (3к)	3,5	20	≤0,5 (15 В)
КТ359В-3	n-p-n	15	≥300	15* (3к)	3,5	20	≤0,5 (15 В)
КТ360А-1	p-n-p	10 (55°С)	≥300	25	5	20 (75*)	≤1 (25 В)
КТ360Б-1	p-n-p	10 (55°С)	≥400	20	4	20 (75*)	≤1 (20 В)
КТ360В-1	p-n-p	10 (55°С)	≥400	20	4	20 (75*)	≤1 (20 В)
КТ361А	p-n-p	150 (35°С)	≥250	25	4	50	≤1 (10 В)
КТ361А1	p-n-p	150	≥150	25	4	100	≤1 (10 В)
КТ361Б	p-n-p	150 (35°С)	≥250	20	4	50	≤1 (10 В)
КТ361В	p-n-p	150 (35°С)	≥250	40	4	50	≤1 (10 В)
КТ361Г	p-n-p	150 (35°С)	≥250	35	4	50	≤1 (10 В)
КТ361Г1	p-n-p	150	≥250	35	4	100	≤1 (10 В)
КТ361Д	p-n-p	150 (35°С)	≥250	40	4	50	≤1 (10 В)
КТ361Д1	p-n-p	150	≥150	40	4	50	≤1 (10 В)
КТ361Е	p-n-p	150 (35°С)	≥250	35	4	50	≤1 (10 В)
КТ361Ж	p-n-p	150	≥250	10	4	50	≤1 (10 В)
КТ361И	p-n-p	150	≥250	15	4	50	≤1 (10 В)
КТ361К	p-n-p	150	≥250	60	4	50	≤1 (10 В)
КТ361Л	p-n-p	150	≥250	20	4	100	≤1 (10 В)
КТ361М	p-n-p	150	≥250	40	4	100	≤1 (10 В)
КТ361Н	p-n-p	150	≥150	45	4	50	≤1 (10 В)
КТ361П	p-n-p	150	≥300	50	4	50	≤1 (10 В)
КТ361А-2	p-n-p	150	≥250	25	5	100	≤1 (10 В)
КТ361А-3	p-n-p	150	≥150	25	5	100	≤1 (10 В)
КТ361Б-2	p-n-p	150	≥250	20	5	50	≤1 (10 В)
КТ361В-2	p-n-p	150	≥250	40	5	50	≤1 (10 В)
КТ361Г-2	p-n-p	150	≥250	35	5	50	≤1 (10 В)
КТ361Г-3	p-n-p	150	≥250	35	5	50	≤1 (10 В)
КТ361Д-2	p-n-p	150	≥250	40	5	50	≤1 (10 В)
КТ361Д-3	p-n-p	150	≥150	40	5	50	≤1 (10 В)
КТ361Е-2	p-n-p	150	≥250	35	5	50	≤1 (10 В)
КТ361Ж-2	p-n-p	150	≥250	10	5	50	≤1 (10 В)
КТ361И-2	p-n-p	150	≥250	15	5	50	≤1 (10 В)
КТ361К-2	p-n-p	150	≥250	60	5	50	≤1 (10 В)
КТ361Л-2	p-n-p	150	≥250	20	5	100	≤1 (10 В)
КТ361М-2	p-n-p	150	≥250	40	5	100	≤1 (10 В)
КТ361Н-2	p-n-p	150	≥150	45	5	50	≤1 (10 В)
КТ361П-2	p-n-p	150	≥300	50	5	50	≤1 (10 В)
КТ363А	p-n-p	150 (45°С)	≥1200	15* (1к)	4,5	30 (50*)	≤0,5 (15 В)
КТ363Б	p-n-p	150 (45°С)	≥1500	12* (1к)	4,5	30 (50*)	≤0,5 (15 В)
КТ363АМ	p-n-p	150 (45°С)	≥1200	15* (1к)	4,5	30 (50*)	≤0,5 (15 В)
КТ363БМ	p-n-p	150 (45°С)	≥1500	12* (1к)	4,5	30 (50*)	≤0,5 (15 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	C_k, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
30...90 (1 В; 10 мА) 50...150 (1 В; 10 мА) 70...280 (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В)	≤70 ≤70 ≤70	≤6 (20 МГц) ≤6 (20 МГц) ≤6 (20 МГц)	≤100 ≤100 ≤100	**КТ359-3**
20...70 (2 В; 10 мА) 40...140 (2 В; 10 мА) 80...240 (2 В; 10 мА)	≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В)	≤35 ≤35 ≤35	— — —	≤450; ≤100* ≤450; ≤200* ≤450; ≤200*	**КТ360-1**
20...90 (10 В; 1 мА) 20...90 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 40...160 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 100...350 (10 В; 1 мА) 20...90 (10 В; 1 мА) 20...90 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) ≥250 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 70...160 (10 В; 1 мА) 20...90 (10 В; 1 мА) 100...350 (10 В; 1 мА)	≤9 (10 В) ≤9 (10 В) ≤9 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤9 (10 В) ≤9 (10 В) ≤7 (10 В) ≤9 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В)	≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 — — — —	≤40* ≤40* ≤40* ≤40* ≤40* ≤40* — — — — — — — — — —	≤500 ≤500 ≤500 ≤1000 ≤500 ≤500 ≤250 ≤250 ≤1000 ≤100 ≤1000 ≤500 — — — —	**КТ361, КТ361-1**
20...90 (10 В; 1 мА) 20...90 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 40...160 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 100...350 (10 В; 1 мА) 20...90 (10 В; 1 мА) 20...90 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 250 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 50...350 (10 В; 1 мА) 70...160 (10 В; 1 мА) 20...90 (10 В; 1 мА) 100...350 (10 В; 1 мА)	≤9 (10 В) ≤9 (10 В) ≤9 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤9 (10 В) ≤7 (10 В) ≤9 (10 В) ≤7 (10 В) ≤9 (10 В) ≤9 (10 В) ≤7 (10 В) ≤9 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В)	≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤20 ≤20 — — — —	≤40* ≤40* ≤40* ≤40* ≤40* ≤40* — — — — — — — — — —	≤500 ≤500 ≤500 ≤1000 ≤500 ≤500 ≤250 ≤250 ≤1000 ≤100 ≤1000 ≤500 — — — —	**КТ361-2, КТ361-3**
20...120* (5 В; 5 мА) 40...120* (5 В; 5 мА)	≤2 (5 В) ≤2 (5 В)	≤35 ≤35	— —	≤50 ≤75	**КТ363**
20...120* (5 В; 5 мА) 40...120* (5 В; 5 мА)	≤2 (5 В) ≤2 (5 В)	≤35 ≤35	— —	≤50 ≤75	**КТ363М**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ364А-2	p-n-p	30	≥250	25	5	200 (400*)	≤1 (25 В)
КТ364Б-2	p-n-p	30	≥250	25	5	200 (400*)	≤1 (25 В)
КТ364В-2	p-n-p	30	≥250	25	5	200 (400*)	≤1 (25 В)
КТ366А	n-p-n	30 (70°С)	≥1000	15	4,5	10 (20*)	≤0,1 (15 В)
КТ366Б	n-p-n	30 (70°С)	≥1000	15	4,5	20 (40*)	≤0,1 (15 В)
КТ366В	n-p-n	30 (70°С)	≥1000	15	4,5	45 (70*)	≤0,1 (15 В)
КТ368А	n-p-n	225 (65°С)	≥900	15	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
КТ368Б	n-p-n	225 (65°С)	≥900	15	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
КТ368А-5	n-p-n	225 (65°С)	≥900	15*	4	30 (60*)	0,5 (15 В)
КТ368А-9	n-p-n	100	≥900	15*	4	30 (60*)	0,5 (15 В)
КТ368Б-9	n-p-n	100	≥900	15*	4	30 (60*)	0,5 (15 В)
КТ368АМ	n-p-n	225 (65°С)	≥900	15	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
КТ368БМ	n-p-n	225 (65°С)	≥900	15	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
КТ368ВМ	n-p-n	225 (65°С)	≥900	15	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
КТ369А	n-p-n	50	≥200	45	4	250 (400*)	≤7 (45 В)
КТ369Б	n-p-n	50	≥200	45	4	250 (400*)	≤7 (45 В)
КТ369В	n-p-n	50	≥200	65	4	250 (400*)	≤10 (65 В)
КТ369Г	n-p-n	50	≥200	65	4	250 (400*)	≤10 (65 В)
КТ369А-1	n-p-n	50	≥200	45	4	250 (400*)	≤7 (45 В)
КТ369Б-1	n-p-n	50	≥200	45	4	250 (400*)	≤7 (45 В)
КТ369В-1	n-p-n	50	≥200	65	4	250 (400*)	≤10 (65 В)
КТ369Г-1	n-p-n	50	≥200	65	4	250 (400*)	≤10 (65 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
20...70* (1 В; 0,1 А) 40...120* (1 В; 0,1 А) 80...240* (1 В; 0,1 А)	≤15 (5 В) ≤15 (5 В) ≤15 (5 В)	≤30 ≤30 ≤30	— — —	≤500; ≤150* ≤500; ≤180* ≤500; ≤230*	**КТ364-2**
50...200 (1 В; 1 мА) 50...200 (1 В; 5 мА) 50...200 (1 В; 15 мА)	≤1,1 (0,1 В) ≤1,8 (0,1 В) ≤3,3 (0,1 В)	≤80 ≤25 ≤16	— — —	≤60; ≤50* ≤60; ≤80* ≤60; ≤120*	**КТ366**
50...300* (5 В; 10 А) 50...300* (5 В; 10 мА)	≤1,7 (5 В) ≤1,7 (5 В)	— —	≤3,3 (60 МГц) —	≤15 ≤15	**КТ368**
50...450 (1 В; 10 мА)	≤1,7 (5 В)	—	≤3,3 (60 МГц)	≤15 (10 мА)	**КТ368А-5**
50...300 (1 В; 10 мА) 50...300 (1 В; 10 мА)	≤1,7 (5 В) ≤1,7 (5 В)	— —	≤3,3 (60 МГц) —	≤15 (10 мА) ≤15 (10 мА)	**КТ368-9**
50...450* (5 В; 10 мА) 50...450* (5 В; 10 мА) 100...450* (5 В; 10 мА)	≤1,7 (5 В) ≤1,7 (5 В) ≤1,7 (5 В)	— — —	≤3,3 (60 МГц) — —	≤5 ≤15 —	**КТ368М**
20...100* (2 В; 0,15 А) 40...200* (2 В; 0,15 А) 20...100* (3 В; 10 мА) 40...200* (3 В; 10 мА)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤10 (10 В) ≤10 (10 В)	≤4 ≤4 ≤2,5 ≤2,5	— — — —	— — — —	**КТ369**
20...100* (2 В; 0,15 А) 40...200* (2 В; 0,15 А) 20...100* (3 В; 10 мА) 40...200* (3 В; 10 мА)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤10 (10 В) ≤10 (10 В)	≤4 ≤4 ≤2,5 ≤2,5	— — — —	— — — —	**КТ369-1**

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ370А-1	p-n-p	15	≥1000	15* (1к)	4	15 (30*)	≤0,5 (15 В)
КТ370Б-1	p-n-p	15	≥1200	12* (1к)	4	15 (30*)	≤0,5 (12 В)
КТ370А-9	p-n-p	30 (50°С)	1000	15* (1к)	4	15 (30*)	≤0,5 (15 В)
КТ370Б-9	p-n-p	30 (50°С)	1000	12* (1к)	4	15 (30*)	≤0,5 (12 В)
КТ371А	n-p-n	100 (65°С)	≥3000	10	3	20 (40*)	≤0,5 (10 В)
КТ371АМ	n-p-n	100 (85°С)	≥3000	10* (3к)	3	20 (40*)	≤0,5 (10 В)
КТ372А	n-p-n	50 (100°С)	≥2400	15* (10к)	3	10	≤0,5 (15 В)
КТ372Б	n-p-n	50 (100°С)	≥3000	15* (10к)	3	10	≤0,5 (15 В)
КТ372В	n-p-n	50 (100°С)	≥2400	15* (10к)	3	10	≤0,5 (15 В)
КТ373А	n-p-n	150 (55°С)	≥350	30* (10к)	5	50 (200*)	≤0,05 (25 В)
КТ373Б	n-p-n	150 (55°С)	≥300	25* (10к)	5	50 (200*)	≤0,05 (20 В)
КТ373В	n-p-n	150 (55°С)	≥300	10* (10к)	5	50 (200*)	≤0,05 (10 В)
КТ373Г	n-p-n	150 (55°С)	≥250	60* (10к)	5	50 (200*)	≤0,05 (25 В)
КТ375А	n-p-n	200 (400**)	≥250	60	5	100 (200*)	≤1 (60 В)
КТ375Б	n-p-n	200 (400**)	≥250	30	5	100 (200*)	≤1 (30 В)
КТ379А	n-p-n	25	≥250	30* (10к)	5	30 (100*)	≤0,05 (30 В)
КТ379Б	n-p-n	25	≥300	25* (10к)	5	30 (100*)	≤0,05 (25 В)
КТ379В	n-p-n	25	≥300	10* (10к)	5	30 (100*)	≤0,05 (10 В)
КТ379Г	n-p-n	25	≥250	60* (10к)	5	30 (100*)	≤0,05 (60 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_{k}, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_{ш}$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
20...70 (5 В; 3 мА) 40...120 (5 В; 3 мА)	≤2 (5 В) ≤2 (5 В)	≤35 ≤35	— —	≤50; ≤10* ≤50; ≤10*	**КТ370-1**
20...70 (5 В; 3 мА) 40...120 (5 В; 3 мА)	≤2 (5 В) ≤2 (5 В)	9,9 9,9	— —	≤10* ≤10*	**КТ370-9**
30...240 (1 В; 10 мА)	≤1,2 (5 В)	≥9** (400 МГц)	≤5 (400 МГц) ≤10*	≤15	**КТ371**
30...240 (1 В; 10 мА)	≤1,2 (5 В)	—	≤5 (400 МГц)	≤15	**КТ371М**
≥10* (5 В; 10 мА) ≥10* (5 В; 10 мА) ≥10* (5 В; 10 мА)	≤1 (5 В) ≤1 (5 В) ≤1 (5 В)	≥10** (1 ГГц) ≥10** (1 ГГц) ≥10** (1 ГГц)	≤3,5 (1 ГГц) ≤5,5 (1 ГГц) ≤5,5 (1 ГГц)	≤9 ≤9 ≤9	**КТ372**
100...250 (5 В; 1 мА) 200...600 (5 В; 1 мА) 500...1000 (5 В; 1 мА) 500...125 (5 В; 1 мА)	≤8 (5 В) ≤8 (5 В) ≤8 (5 В) ≤8 (5 В)	≤10 ≤10 ≤10 ≤20	— — — —	≤200 ≤300 ≤700 ≤200	**КТ373**
10...100* (2 В; 20 мА) 50...280* (2 В; 20 мА)	≤5 (10 В) ≤5 (10 В)	≤40 ≤40	— —	≤300 ≤300	**КТ375**
100...250 (5 В; 1 мА) 200...500 (5 В; 1 мА) 400...1000 (5 В; 1 мА) 50...125 (5 В; 1 мА)	≤8 (5 В) ≤8 (5 В) ≤8 (5 В) ≤8 (5 В)	≤10 ≤10 ≤10 ≤20	— — — —	— — — —	**КТ379**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ380А **КТ380Б** **КТ380В**	p-n-p p-n-p p-n-p	15 15 15	≥300 ≥300 ≥300	17* (10к) 17* (10к) 9* (10к)	4 4 4	10 (25*) 10 (25*) 20 (25*)	≤1 (10 В) ≤1 (10 В) ≤1 (7 В)
КТ381Б **КТ381В** **КТ381Г** **КТ381Д** **КТ381Е**	n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n	15 15 15 15 15	≥200 ≥200 ≥200 ≥200 ≥200	25 25 25 25 25	6,5 6,5 6,5 6,5 6,5	15 15 15 15 15	0,03 (5 В) 0,03 (5 В) 0,03 (5 В) 0,03 (5 В) 0,03 (5 В)
КТ382А **КТ382Б**	n-p-n n-p-n	100 (65°C) 100 (65°C)	≥1800 ≥1800	15 15	3 3	20 (40*) 20 (40*)	≤0,5 (15 В) ≤0,5 (15 В)
КТ382АМ **КТ382БМ**	n-p-n n-p-n	100 (85°C) 100 (85°C)	≥1800 ≥1800	15 15	3 3	20 (40*) 20 (40*)	≤0,5 (15 В) ≤0,5 (15 В)
КТ384А-2	n-p-n	300	≥450	30* (5к)	4	300 (500*)	≤10 (30 В)
КТ384АМ-2	n-p-n	300	≥450	30* (5к)	4	300 (500*)	≤10 (30 В)
КТ385А-2	n-p-n	300	≥200	60	4	300 (500*)	≤10 (60 В)
КТ385АМ-2 **КТ385БМ-2**	n-p-n n-p-n	300 300	≥200 ≥200	60 60	4 4	300 (500*) 300 (500*)	≤10 (60 В) ≤10 (60 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
30...90 (0,3 В; 10 мА) 50...150 (0,3 В; 10 мА) 30...90 (0,3 В; 10 мА)	≤6 (5 В) ≤6 (5 В) ≤6 (5 В)	≤30 ≤30 ≤30	— — —	10* 20* 10*	КТ380
≥40 (5 В; 10 мкА) ≥30 (5 В; 10 мкА) ≥20 (5 В; 10 мкА) ≥20 (5 В; 10 мкА) ≥20 (5 В; 10 мкА)	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —	КТ381
40...330 (1 В; 5 мА) 40...330 (1 В; 5 мА)	≤2 (5 В) ≤2 (5 В)	≥9** (400 МГц) ≥5** (400 МГц)	≤3 (400 МГц) ≤4,5 (400 МГц)	≤15 ≤10	КТ382, КТ382М
40...330 (1 В; 5 мА) 40...330 (1 В; 5 мА)	≤2 (5 В) ≤2 (5 В)	≥9** (400 МГц) ≥5** (400 МГц)	≤3 (400 МГц) ≤4,5 (400 МГц)	≤15 ≤10	
30...180* (1 В; 0,15 А)	≤4 (10 В)	≤4	—	≤15*	КТ384-2
30...180* (1 В; 0,15 А)	≤4 (10 В)	≤4	—	≤15*	КТ384М
20...200* (1 В; 0,15 А)	≤4 (10 В)	≤5	—	≤60*	КТ385-2
20...200* (1 В; 0,15 А) 20...100* (1 В; 0,15 А)	≤4 (10 В) ≤4 (10 В)	≤5 ≤5	— —	≤60* ≤60*	КТ385М

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ388Б-2	p-n-p	300 (80°C)	≥250	50	4,5	250	≤2 (50 В)
КТ388БМ-2	p-n-p	300	≥250	50	4,5	250	≤2 (50 В)
КТ389Б-2	p-n-p	300 (80°C)	≥450	25* (1к)	4,5	300	≤1 (25 В)
КТ391А-2 **КТ391Б-2** **КТ391В-2**	n-p-n n-p-n n-p-n	70 (85°C) 70 (85°C) 70 (85°C)	≥5000 ≥5000 ≥4000	15 15 10	2 2 1	10 10 10	≤0,5 (10 В) ≤0,5 (10 В) ≤0,5 (7 В)
КТ392А-2	p-n-p	120 (65°C)	≥300	40* (5к)	4	10 (20*)	≤0,5 (40 В)
КТ396А-2	n-p-n	30 (50°C)	≥2100	15	3	40	≤0,5 (15 В)
КТ396А-9	n-p-n	100	≥2100	15	3	40	≤0,5 (15 В)
КТ397А-2	n-p-n	120 (90°C)	≥500	40* (10к)	4	10 (20*)	≤1 (40 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\,нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r'_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
25...100* (1 В; 0,12 А)	≤7 (10 В)	≤5	—	60; ≤60*	**КТ388-2 (КТ388БМ-2)**
25...100* (1 В; 0,12 А)	≤7 (10 В)	≤5	—	60; ≤60*	
25...100* (1 В; 0,2 А)	≤10 (10 В)	≤3	—	≤25*; ≤180	**КТ389-2**
≥20 (7 В; 5 мА) ≥20 (7 В; 5 мА) ≥20 (7 В; 5 мА)	≤0,7 (5 В) ≤0,7 (5 В) ≤0,7 (5 В)	— — —	≤4,5 (3,6 ГГц) ≤5,5 (3,6 ГГц) ≤6 (3,6 ГГц)	≤3,7 ≤3,7 ≤3,7	**КТ391-2**
40...180* (5 В; 2,5 мА)	≤2,5 (5 В)	≤50	4,5 (100 МГц)	≤120	**КТ392-2**
40...250 (2 В; 5 мА)	≤1,5 (5 В)	≤11*	—	≤15	**КТ396-2**
40...250 (2 В; 5 мА)	≤2 (5 В)	—	—	≤15	**КТ396-9**
40...300 (5 В; 2 мА)	≤1,3 (5 В)	≤25*	—	≤40	**КТ397-2**

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^*_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^*_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$ $I^*_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ399А	n-p-n	150 (55°С)	≥1800	15**	3	20 (40*)	≤0,5 (15 В)
КТ399АМ	n-p-n	150 (55°С)	≥1800	15**	3	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
КТ501А	p-n-p	350 (35°С)	≥5	15* (10к)	10	300 (500*)	≤1* (15 В)
КТ501Б	p-n-p	350 (35°С)	≥5	15* (10к)	10	300 (500*)	≤1* (15 В)
КТ501В	p-n-p	350 (35°С)	≥5	15* (10к)	10	300 (500*)	≤1* (15 В)
КТ501Г	p-n-p	350 (35°С)	≥5	30* (10к)	10	300 (500*)	≤1* (30 В)
КТ501Д	p-n-p	350 (35°С)	≥5	30* (10к)	10	300 (500*)	≤1* (30 В)
КТ501Е	p-n-p	350 (35°С)	≥5	30* (10к)	10	300 (500*)	≤1* (30 В)
КТ501Ж	p-n-p	350 (35°С)	≥5	45* (10к)	20	300 (500*)	≤1* (45 В)
КТ501И	p-n-p	350 (35°С)	≥5	45* (10к)	20	300 (500*)	≤1* (45 В)
КТ501К	p-n-p	350 (35°С)	≥5	45* (10к)	20	300 (500*)	≤1* (45 В)
КТ501Л	p-n-p	350 (35°С)	≥5	60* (10к)	20	300 (500*)	≤1* (60 В)
КТ501М	p-n-p	350 (35°С)	≥5	60* (10к)	20	300 (500*)	≤1* (60 В)
КТ502А	p-n-p	350	5...50	40	5	150 (300*)	≤1 (40 В)
КТ502Б	p-n-p	350	5...50	40	5	150 (300*)	≤1 (40 В)
КТ502В	p-n-p	350	5...50	60	5	150 (300*)	≤1 (60 В)
КТ502Г	p-n-p	350	5...50	60	5	150 (300*)	≤1 (60 В)
КТ502Д	p-n-p	350	5...50	80	5	150 (300*)	≤1 (80 В)
КТ502Е	p-n-p	350	5...50	90	5	150 (300*)	≤1 (90 В)
КТ503А	n-p-n	350	5...50	40	5	150 (300*)	≤1 (40 В)
КТ503Б	n-p-n	350	5...50	40	5	150 (300*)	≤1 (40 В)
КТ503В	n-p-n	350	5...50	60	5	150 (300*)	≤1 (60 В)
КТ503Г	n-p-n	350	5...50	60	5	150 (300*)	≤1 (60 В)
КТ503Д	n-p-n	350	5...50	80	5	150 (300*)	≤1 (80 В)
КТ503Е	n-p-n	350	5...50	100	5	150 (300*)	≤1 (100 В)
КТ504А	n-p-n	1 (10*) Вт	≥20	400; 350*	6	1 (2*) А	≤100 (400 В)
КТ504Б	n-p-n	1 (10*) Вт	≥20	200* (0,1к)	6	1 (2*) А	≤100 (250 В)
КТ504В	n-p-n	1 (10*) Вт	≥20	275* (0,1к)	6	1 (2*) А	≤100 (300 В)
КТ505А	p-n-p	1 (5*) Вт	≥20	300* (0,1к)	5	1 (2*) А	≤100 (300 В)
КТ505Б	p-n-p	1 (5*) Вт	≥20	250* (0,1к)	5	1 (2*) А	≤100 (250 В)
КТ506А	n-p-n	0,8 (10*) Вт	≥10	800	5	2 (5*)А	≤200 (600 В)
КТ506Б	n-p-n	0,8 (10*) Вт	≥10	600	5	2 (5*) А	≤200 (600 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥40* (1 В; 5 мА)	≤1,7 (5 В)	≥11,5** (0,4 ГГц)	≤2 (400 МГц)	≤8	**КТ399**
≥40* (1 В; 5 мА)	≤1,7 (5 В)	≥11,5** (0,4 ГГц)	≤2 (4000 МГц)	≤8	**КТ399М**
20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА) 80...240* (1 В; 30 мА) 20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА) 80...240* (1 В; 30 мА) 20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА) 80...240* (1 В; 30 мА) 20...60* (1 В; 30 мА) 40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В)	≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3	— — ≤4 (1 кГц) — — ≤4 (1 кГц) — — ≤4 (1 кГц) — —	— — — — — — — — — — —	**КТ501**
40...120 (5 В; 10 мА) 80...240 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) 80...240 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В)	≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60	≤320* ≤320* ≤320* ≤320* ≤320* ≤320*	— — — — — —	**КТ502**
40...120 (5 В; 10 мА) 80...240 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) 80...240 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА)	≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В)	≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60	≤580* ≤580* ≤580* ≤580* ≤580* ≤580*	— — — — — —	**КТ503**
15...100* (5 В; 0,5 А) 15...100* (5 В; 0,5 А) 15...100* (5 В; 0,5 А)	≤30 (10 В) ≤30 (10 В) ≤30 (10 В)	≤2 ≤2 ≤2	— — —	≤2700* ≤2700* ≤2700*	**КТ504, КТ505, КТ506**
25...140* (10 В; 0,5 А) 25...140* (10 В; 0,5 А)	≤70 (5 В) ≤70 (5 В)	≤3,6 ≤3,6	— —	≤2600* ≤2600*	
30...150* (5 В; 0,3 А) 30...150* (5 В; 0,3 А)	≤40 (5 В) ≤40 (5 В)	≤2 ≤2	— —	≤1560* ≤1560*	

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ509А	p-n-p	300; 1* Вт	≥10	500	5	20	≤5 (500 В)
КТ511А9	p-n-p	1000	≥120	200*	—	1,5 А	—
КТ511Б9	p-n-p	1000	≥120	160*	—	1,5 А	—
КТ511В9	p-n-p	1000	≥120	120*	—	1,5 А	—
КТ511Г9	p-n-p	1000	≥120	90*	—	2 А	—
КТ511Д9	p-n-p	1000	≥120	70*	—	2 А	—
КТ511Е9	p-n-p	1000	≥120	50*	—	2 А	—
КТ511Ж9	p-n-p	1000	≥120	30*	—	2 А	—
КТ511И9	p-n-p	1000	≥120	20*	—	2 А	—
КТ511К9	p-n-p	1000	≥120	10*	—	2 А	—
КТ512А9	n-p-n	1000	≥120	200*	—	1,5 А	—
КТ512Б9	n-p-n	1000	≥120	160*	—	1,5 А	—
КТ512В9	n-p-n	1000	≥120	120*	—	1,5 А	—
КТ512Г9	n-p-n	1000	≥120	90*	—	2 А	—
КТ512Д9	n-p-n	1000	≥120	70*	—	2 А	—
КТ512Е9	n-p-n	1000	≥120	50*	—	2 А	—
КТ512Ж9	n-p-n	1000	≥120	30*	—	2 А	—
КТ512И9	n-p-n	1000	≥120	20*	—	2 А	—
КТ512К9	n-p-n	1000	≥120	10*	—	2 А	—
КТ513А9	p-n-p	1000	≥50	300*	—	0,5 А	—
КТ513Б9	p-n-p	1000	≥50	250*	—	0,5 А	—
КТ513В9	p-n-p	1000	≥50	200*	—	0,5 А	—
КТ513Г9	p-n-p	1000	≥50	160*	—	0,5 А	—
КТ513Д9	p-n-p	1000	≥50	120*	—	0,5 А	—
КТ514А9	n-p-n	1000	≥50	300*	—	0,5 А	—
КТ514Б9	n-p-n	1000	≥50	250*	—	0,5 А	—
КТ514В9	n-p-n	1000	≥50	200*	—	0,5 А	—
КТ514Г9	n-p-n	1000	≥50	160*	—	0,5 А	—
КТ514Д9	n-p-n	1000	≥50	120*	—	0,5 А	—
КТ515А9	p-n-p	1000	≥120	80*	—	2 А	—
КТ515Б9	p-n-p	1000	≥120	50*	—	2 А	—
КТ515В9	p-n-p	1000	≥120	25*	—	2 А	—
КТ516А9	n-p-n	1000	≥120	80*	—	2 А	—
КТ516Б9	n-p-n	1000	≥120	50*	—	2 А	—
КТ516В9	n-p-n	1000	≥120	25*	—	2 А	—
КТ517А	n-p-n	500	≥125	30; 30**	—	0,5 А	—
КТ517Б	n-p-n	500	≥125	30; 30**	—	0,5 А	—
КТ517В	n-p-n	500	≥125	40; 40**	—	0,5 А	—
КТ517Г	n-p-n	500	≥125	40; 40**	—	0,5 А	—
КТ517Д	n-p-n	500	≥125	50; 50**	—	0,5 А	—
КТ517Е	n-p-n	500	≥125	60; 60**	—	0,5 А	—

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_{k}, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_{ш}$, дБ $r'_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
10...100 (10 В; 0,1 мА)	≤2,9 (100 В)	10к	—	≤500	**КТ509**
≥20 (5 В; 0,5 А) ≥20 (5 В; 0,5 А) ≥20 (5 В; 0,5 А) ≥20 (5 В; 0,5 А) ≥20 (5 В; 0,5 А) ≥20 (5 В; 0,5 А) ≥20 (5 В; 0,5 А) ≥20 (5 В; 0,5 А) ≥20 (5 В; 0,5 А)	— — — — — — — — —	≤0,3 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,2 ≤0,2 ≤0,35 ≤0,35 ≤0,35 ≤0,35	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	**КТ511-9**
≥20 (5 В; 0,5 А) ≥20 (5 В; 0,5 А) ≥20 (5 В; 0,5 А) ≥20 (5 В; 0,5 А) ≥20 (5 В; 0,5 А) ≥20 (5 В; 0,5 А) ≥20 (5 В; 0,5 А) ≥20 (5 В; 0,5 А) ≥20 (5 В; 0,5 А)	— — — — — — — — —	≤0,3 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,2 ≤0,2 ≤0,35 ≤0,35 ≤0,35 ≤0,35	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	**КТ512-9**
40...600 (10 В; 50 мА) 40...600 (10 В; 50 мА) 40...600 (10 В; 50 мА) 40...600 (10 В; 50 мА) 40...600 (10 В; 50 мА)	— — — — —	≤10 ≤10 ≤5 ≤5 ≤5	— — — — —	— — — — —	**КТ513-9, КТ514-9**
40...600 (10 В; 50 мА) 40...600 (10 В; 50 мА) 40...600 (10 В; 50 мА) 40...600 (10 В; 50 мА) 40...600 (10 В; 50 мА)	— — — — —	≤10 ≤10 ≤5 ≤5 ≤5	— — — — —	— — — — —	
≥50 (5 В; 0,5 А) ≥50 (5 В; 0,5 А) ≥25 (5 В; 0.5 А)	— — —	≤1 ≤1 ≤1	— — —	— — —	**КТ515-9, КТ516-9**
≥50 (5 В; 0,5 А) ≥50 (5 В; 0,5 А) ≥25 (5 В; 0,5 А)	— — —	≤1 ≤1 ≤1	— — —	— — —	
≥5000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) 10000...100000 (5 В; 10мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА)	≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7	≤11 ≤11 ≤11 ≤11 ≤11 ≤11	— — — — — —	— — — — — —	**КТ517**

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ517А-1	n-p-n	800	≥125	30	—	0,5 А	—
КТ517Б-1	n-p-n	800	≥125	30	—	0.5 А	—
КТ517В-1	n-p-n	800	≥125	40	—	0,5 А	—
КТ517Г-1	n-p-n	800	≥125	40	—	0,5 А	—
КТ517Д-1	n-p-n	800	≥125	50	—	0,5 А	—
КТ517Е-1	n-p-n	800	≥125	60	—	0,5 А	—
КТ517А-9	n-p-n	300	≥125	30; 30**	—	300	—
КТ517Б-9	n-p-n	300	≥125	30	—	300	—
КТ517В-9	n-p-n	300	≥125	40	—	300	—
КТ517Г-9	n-p-n	300	≥125	40	—	300	—
КТ517Д-9	n-p-n	300	≥125	50	—	300	—
КТ517Е-9	n-p-n	300	≥125	60	—	300	—
КТ519А	p-n-p	450	≥100	50; 45**	5	100	≤0,05 (50 В)
КТ519Б	p-n-p	450	≥100	50; 45**	5	100	≤0,05 (50 В)
КТ519В	p-n-p	450	≥100	50; 45**	5	100	≤0,05 (50 В)
КТ520А	n-p-n	625	≥50	300; 300**	—	500	—
КТ520Б	n-p-n	625	≥50	200; 200**	—	500	—
КТ521А	p-n-p	625	≥50	300; 300**	—	500	—
КТ521Б	p-n-p	625	≥50	300; 300**	—	500	—
КТ523А	p-n-p	500	≥150	30; 30**	—	500	—
КТ523Б	p-n-p	500	≥150	30; 30**	—	500	—
КТ523В	p-n-p	500	≥150	40; 40**	—	500	—
КТ523Г	p-n-p	500	≥150	50; 50**	—	500	—
КТ523Д	p-n-p	500	≥150	60; 60**	—	500	—
КТ523А9	n-p-n	300	≥150	30; 30**	—	300	—
КТ523Б9	n-p-n	300	≥150	30; 30**	—	300	—
КТ523В9	n-p-n	300	≥150	40; 40**	—	300	—
КТ523Г9	n-p-n	300	≥150	50; 50**	—	300	—
КТ523Д9	n-p-n	300	≥150	60; 60**	—	300	—
КТ524А	n-p-n	1000	≥100	40; 25**	6	1500	≤0,1 (35 В)
КТ524А-5	n-p-n	1000	≥100	40; 25**	6	1500	≤0,1 (35 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥5000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) 10000...100000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА)	≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7	≤11 ≤11 ≤11 ≤11 ≤11 ≤11	— — — — — —	— — — — — —	КТ517-1
≥5000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) 10000...100000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА)	≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7	≤11 ≤11 ≤11 ≤11 ≤11 ≤11	— — — — — —	— — — — — —	КТ517-9
60...150 (5 В; 1 мА) 100...300 (5 В; 1 мА) 200...600 (5 В; 1 мА)	≤7 (10 В) ≤7 (10 В) ≤7 (10 В)	— — —	≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц)	— — —	КТ519, КТ520
≥40 (10 В; 10 мА) ≥40 (10 В; 10 мА)	≤3 ≤4	≤25 ≤20	— —	— —	
≥40 (10 В; 10 мА) ≥40 (10 В; 10 мА)	≤6 ≤8	≤25 ≤20	— —	— —	КТ521, КТ523
≥5000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА)	≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7	≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12	— — — — —	— — — — —	
≥5000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА)	— — — — —	≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12	— — — — —	— — — — —	КТ523-9
≥40 (1 В; 0,8 А)	9 (10 В)	≤0,6	—	—	КТ524
85...300 (1 В; 0,1 А)	9 (10 В)	≤0,6	—	—	КТ524-5

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ525А	n-p-n	625	—	40; 20**	5	500	≤0,1 (25 В)
КТ525А-5	n-p-n	625	—	40; 20**	5	500	≤0,1 (25 В)
КТ526А	n-p-n	450	≥150	50; 45**	5	100	≤0,05 (50 В)
КТ526А-5	n-p-n	450	≥150	50; 45**	5	100	≤0,05 (50 В)
КТ528А9 **КТ528Б9** **КТ528В9** **КТ528Г9** **КТ528Д9**	n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n	600 600 600 600 600	— — — — —	100* 80* 50* 30* 12*	— — — — —	2000 2000 2000 2000 2000	— — — — —
КТ529А	p-n-p	500	≥150	60	4	1 А	≤1 (80 В)
КТ530А	n-p-n	500	≥150	60	4	1 А	≤1 (80 В)
КТ538А	n-p-n	700	≥4	600	9	500	≤100*

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_{к}$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\,нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р}$, дБ	$K_{ш}$, дБ; $r'_{б}$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
64...202 (1 В; 50 мА)	—	≤1,2	—	—	КТ525
≥40 (1 В; 0,8 А)	—	≤1,2	—	—	КТ525-5
60...1000 (5 В; 1 мА)	≤3,5 (10 В)	≤3	≤10 (1 МГц)	—	КТ526
60...1000 (5 В; 1 мА)	≤3,5 (10 В)	≤3	≤10 (1 МГц)	—	КТ526-5
20...200 (5 В; 1 А) 20...200 (5 В; 1 А) 50...250 (5 В; 1 А) 50...250 (5 В; 1 А) 50...250 (5 В; 1 А)	— — — — —	≤0,25 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,25	300 300 300 300 300	— — — — —	КТ528-9
≥180 (5 В; 300 мА)	—	≥0,7	—	—	КТ529
≥180 (5 В; 300 мА)	—	≥0,7	—	—	КТ530
5...90	—	—	—	—	КТ538

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ601А	n-p-n	0,25 (0,5*) Вт	≥40	100*	3	30	≤50 (50 В)
КТ601АМ	n-p-n	0,5 Вт	≥40	100*	3	30	≤300* (100 В)
КТ602А	n-p-n	0,85 (2,8*) Вт	≥150	120	5	75 (500*)	≤70 (120 В)
КТ602Б	n-p-n	0,85 (2,8*) Вт	≥150	120	5	75 (500*)	≤70 (120 В)
КТ602В	n-p-n	0,85 (2,8*) Вт	≥150	80	5	75 (300*)	≤70 (80 В)
КТ602Г	n-p-n	0,85 (2,8*) Вт	≥150	80	5	75 (300*)	≤70 (80 В)
КТ602АМ	n-p-n	0,85 (2,8*) Вт	≥150	120	5	75 (500*)	≤70 (120 В)
КТ602БМ	n-p-n	0,85 (2.8*) Вт	≥150	120	5	75 (300*)	≤70 (120 В)
КТ603А	n-p-n	0,5 Вт (50°С)	≥200	30* (1к)	3	300 (600*)	≤10 (30 В)
КТ603Б	n-p-n	0,5 Вт (50°С)	≥200	30* (1к)	3	300 (600*)	≤0 (30 В)
КТ603В	n-p-n	0,5 Вт (50°С)	≥200	15* (1к)	3	300 (600*)	≤5 (15 В)
КТ603Г	n-p-n	0,5 Вт (50°С)	≥200	15* (1к)	3	300 (600*)	≤5 (15 В)
КТ603Д	n-p-n	0,5 Вт (50°С)	≥200	10* (1к)	3	300 (600*)	≤1 (10 В)
КТ603Е	n-p-n	0,5 Вт (50°С)	≥200	10* (1к)	3	300 (600*)	≤1 (10 В)
КТ603И	n-p-n	0,5 Вт (50°С)	≥200	30* (1к)	3	300 (600*)	≤10 (30 В)
КТ604А	n-p-n	0,8 (3*) Вт	≥40	300	5	200	≤50 (250 В)
КТ604Б	n-p-n	0,8 (3*) Вт	≥40	250* (1к)	5	200	≤50 (250 В)
КТ604АМ	n-p-n	0,8 (3*) Вт	≥40	250* (1к)	5	200	≤20* (250 В)
КТ604БМ	n-p-n	0,8 (3*) Вт	≥40	300	5	200	≤20 (250 В)
КТ605А	n-p-n	0,4 Вт (100°С)	≥40	300	5	100 (200*)	≤50* (250 В)
КТ605Б	n-p-n	0,4 Вт (100°С)	≥40	300	5	100 (200*)	≤50* (250 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥16 (20 В; 10 мА)	≤15 (20 В)	—	—	≤600	**КТ601**
≥16 (20 В; 10 мА)	≤15 (20 В)	—	—	≤600	**КТ601М**
20...80 (10 В; 10 мА) ≥50 (10 В; 10 мА) 15...80 (10 В; 10 мА) ≥50 (10 В; 10 мА)	≤4 (50 В) ≤4 (50 В) ≤4 (50 В) ≤4 (50 В)	≤60 ≤60 ≤60 ≤60	— — — —	≤300 ≤300 ≤300 ≤300	**КТ602**
20...80 (10 В; 10 мА) ≥50 (10 В; 10 мА)	≤4 (50 В) ≤4 (50 В)	≤60 ≤60	— —	≤300 ≤300	**КТ602М**
10...80* (2 В; 15 А) ≥60* (2 В; 0,15 А) 10...80* (2 В; 0,15 А) ≥60* (2 В; 0,15 А) 20...80* (2 В; 0,15 А) 60...200* (2 В; 0,15 А) ≥20* (2 В; 0,35 А)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤15 (10 В)	≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤3,4	— — — — — — —	≤100** ≤100** ≤100** ≤100** ≤100** ≤100** ≤100**	**КТ603, КТ604**
10...40* (40 В; 20 мА) 30...120* (40 В; 20 мА)	≤7 (40 В) ≤7 (40 В)	≤400 ≤400	— —	— —	
10...40* (40 В; 20 мА) 30...120* (40 В; 20 мА)	≤7 (40 В) ≤7 (40 В)	≤400 ≤400	— —	— —	**КТ604М**
10...40* (40 В; 20 мА) 30...120* (40 В; 20 мА)	≤7 (40 В) ≤7 (40 В)	≤400 ≤400	— —	≤250 ≤250	**КТ605**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ605АМ КТ605БМ	n-p-n n-p-n	0,4 Вт (100°С) 0,4 Вт (100°С)	≥40 ≥40	300 300	5 5	100 (200*) 100 (200*)	≤20* (250 В) ≤20* (250 В)
КТ606А КТ606Б	n-p-n n-p-n	2,5 Вт (40°С) 2,5 Вт (40°С)	≥350 ≥300	60 60	4 4	400 (800*) 400 (800*)	≤1,5* (60 В) ≤1,5* (60 В)
КТ607А-4 КТ607Б-4	n-p-n n-p-n	1,5 Вт 1,5 Вт	≥700 ≥700	40 30	4 4	150 150	≤1 (30 В) ≤1 (30 В)
КТ608А КТ608Б	n-p-n n-p-n	0,5 Вт 0,5 Вт	≥200 ≥200	60 60	4 4	400 (800*) 400 (800*)	≤10 (60 В) ≤10 (60 В)
КТ6109А КТ6109Б КТ6109В КТ6109Г КТ6109Д	p-n-p p-n-p p-n-p p-n-p p-n-p	625 625 625 625 625	≥300 ≥300 ≥300 ≥300 ≥300	40; 20* (10к) 40; 20* (10к) 40; 20* (10к) 40; 20* (10к) 40; 20* (10к)	5 5 5 5 5	500 500 500 500 500	≤0,1 мкА (25 В) ≤0,1 мкА (25 В) ≤0,1 мкА (25 В) ≤0,1 мкА (25 В) ≤0,1 мкА (25 В)
КТ610А КТ610Б	n-p-n n-p-n	1,5 Вт (50°С) 1,5 Вт (50°С)	≥1000 ≥700	26 26	4 4	300 300	≤0,5 (26 В) ≤0,5 (26 В)
КТ6102А КТ6103А	p-n-p n-p-n	1000 1000	— —	110 140	5 5	1500 1500	≤0,1 ≤0,1
КТ6104А КТ6105А	n-p-n p-n-p	1000 1000	— —	300 300	5 5	150 150	≤0,1 ≤0,1
КТ6107А КТ6108А	n-p-n p-n-p	1000 1000	— —	500 500	5 5	130 130	≤0,1 ≤0,1

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
10...40* (40 В; 20 мА) 30...120* (40 В; 20 мА)	≤7 (40 В) ≤7 (40 В)	≤400 ≤400	— —	≤250 ≤250	**КТ605М**
≥15* (10 В; 0,10 А) ≥15* (10 В; 0,10 А)	≤10 (28 В) ≤10 (28 В)	≤5 ≤5	≥0,8** (400 МГц) ≥0,6** (400 МГц)	≤10 ≤12	**КТ606**
— —	≤4 (10 В) ≤4,5 (10 В)	≥4** (1 ГГц) ≥3** (1 ГГц)	≥1** (1 ГГц) ≥1** (1 ГГц)	≤18 ≤25	**КТ607-4**
20...80* (5 В; 0,2 А) 40...160* (5 В; 0,2 А)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В)	≤2,5 ≤2,5	— —	≤120* ≤120*	**КТ608**
64...91 (1 В; 50 мА) 78...112 (1 В; 50 мА) 98...135 (1 В; 50 мА) 112...166 (1 В; 50 мА) 144...202 (1 В; 50 мА)	— — — — —	≤1,2 ≤1,2 ≤1,2 ≤1,2 ≤1,2	— — — — —	— — — — —	**КТ6109**
50...300* (10 В; 0,15 А) 20...300* (10 В; 0,15 А)	≤4,1 (10 В) ≤4,1 (10 В)	— —	6 (0,2 ГГц) 6 (0,2 ГГц)	≤55 ≤22	**КТ610**
80...250 80...250	— —	<5 <5	— —	— —	**КТ6102, КТ6104, КТ6107** **КТ6103, КТ6105, КТ6108**
80...250 80...250	— —	<5 <5	— —	— —	
80...250 80...250	— —	<5 <5	— —	— —	

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^*_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^*_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ611А	n-p-n	0,8 (3*) Вт	≥60	200	3	100	≤200 (180 В)
КТ611Б	n-p-n	0,8 (3*) Вт	≥60	200	3	100	≤200 (180 В)
КТ611В	n-p-n	0,8 (3*) Вт	≥60	180	3	100	≤100 (150 В)
КТ611Г	n-p-n	0,8 (3*) Вт	≥60	180	3	100	≤100 (150 В)
КТ611АМ	n-p-n	0,8 (3*) Вт	≥60	200	4	100	≤100 (180 В)
КТ611БМ	n-p-n	0,8 (3*) Вт	≥60	200	4	100	≤100 (180 В)
КТ6110А	n-p-n	625	—	40	5	500	≤0,1
КТ6110Б	n-p-n	625	—	40	5	500	≤0,1
КТ6110В	n-p-n	625	—	40	5	500	≤0,1
КТ6110Г	n-p-n	625	—	40	5	500	≤0,1
КТ6110Д	n-p-n	625	—	40	5	500	≤0,1
КТ6111А	n-p-n	450	150	50	5	100	≤0,05
КТ6111Б	n-p-n	450	150	50	5	100	≤0.05
КТ6111В	n-p-n	450	150	50	5	100	≤0,05
КТ6111Г	n-p-n	450	150	50	5	100	≤0,05
КТ6112А	p-n-p	450	100	50	5	100	≤0,05
КТ6112Б	p-n-p	450	100	50	5	100	≤0,05
КТ6112В	p-n-p	450	100	50	5	100	≤0,05
КТ6113А	n-p-n	400	700	30	5	50	≤0,05
КТ6113Б	n-p-n	400	700	30	5	50	≤0,05
КТ6113В	n-p-n	400	700	30	5	50	≤0,05
КТ6113Г	n-p-n	400	700	30	5	50	≤0,05
КТ6113Д	n-p-n	400	700	30	5	50	≤0,05
КТ6113Е	n-p-n	400	700	30	5	50	≤0,05
КТ6114А	n-p-n	1000	100	40	6	1500	≤0,1
КТ6114Б	n-p-n	1000	100	40	6	1500	≤0,1
КТ6114В	n-p-n	1000	100	40	6	1500	≤0,1
КТ6114Г	n-p-n	700	100	40	6	1100	≤0,1
КТ6114Д	n-p-n	700	100	40	6	1100	≤0,1
КТ6114Е	n-p-n	700	100	40	6	1100	≤0,1
КТ6115А	p-n-p	1000	100	40	6	1500	≤0,1
КТ6115Б	p-n-p	1000	100	40	6	1500	≤0,1
КТ6115В	p-n-p	1000	100	40	6	1500	≤0,1
КТ6115Г	p-n-p	1000	100	40	6	1100	≤0,1
КТ6115Д	p-n-p	1000	100	40	6	1100	≤0,1
КТ6115Е	p-n-p	1000	100	40	6	1100	≤0,1
КТ6116А	p-n-p	625	>100	160	5	600	≤0,05
КТ6116Б	p-n-p	625	>100	130	5	600	≤0,01

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
10...40* (40 В; 20 мА)	≤5 (40 В)	≤400	—	≤200	**КТ611**
30...120* (40 В; 20 мА)	≤5 (40 В)	≤400	—	≤200	
10...40* (40 В; 20 мА)	≤5 (40 В)	≤400	—	≤200	
30...120* (40 В; 20 мА)	≤5 (40 В)	≤400	—	≤200	
10...40* (40 В; 20 мА)	≤5 (40 В)	≤400	—	≤200	**КТ611М**
30...120* (40 В; 20 мА)	≤5 (40 В)	≤400	—	≤200	
64...91	—	1,2	—	—	**КТ6110, КТ6111**
78...112	—	1,2	—	—	
96...135	—	1,2	—	—	
112...166	—	1,2	—	—	
144...202	—	1,2	—	—	
60...150	—	<3	<10 (1 кГц)	—	
100...300	—	<3	<10 (1 кГц)	—	
200...600	—	<3	<10 (1 кГц)	—	
400...1000	—	<3	<10 (1 кГц)	—	
60...150	—	<7	<10 (1 кГц)	—	**КТ6112, КТ6113**
100...300	—	<7	<10 (1 кГц)	—	
200...600	—	<7	<10 (1 кГц)	—	
28...45	—	<10	—	—	
39...60	—	<10	—	—	
54...80	—	<10	—	—	
72...108	—	<10	—	—	
97...146	—	<10	—	—	
132...198	—	<10	—	—	
85...160	—	—	—	—	**КТ6114, КТ6115**
120...200	—	—	—	—	
160...300	—	—	—	—	
85...160	—	—	—	—	
120...200	—	—	—	—	
160...300	—	—	—	—	
85...160	—	—	—	—	
120...200	—	—	—	—	
160...300	—	—	—	—	
85...160	—	—	—	—	
120...200	—	—	—	—	
160...300	—	—	—	—	
60...240	—	—	≤8	—	**КТ6116**
40...180	—	—	—	—	

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ6117А	n-p-n	625	>100	180; 160*	5	600	≤0,05
КТ6117Б	n-p-n	625	>100	160; 140*	5	600	≤0,1
КТ6127А	p-n-p	600 (6 Вт**)	≥150	90	4	2 (8*)	≤20 (90)
КТ6127Б	p-n-p	600 (6 Вт**)	≥150	70	4	2 (8*)	≤20 (70)
КТ6127В	p-n-p	600 (6 Вт**)	≥150	50	4	2 (8*)	≤20 (50)
КТ6127Г	p-n-p	600 (6 Вт**)	≥150	30	4	2 (8*)	≤20 (30)
КТ6127Д	p-n-p	600 (6 Вт**)	≥150	20	4	2 (8*)	≤20 (20)
КТ6127Е	p-n-p	600 (6 Вт**)	≥150	10	4	2 (8*)	≤20 (10)
КТ6127Ж	p-n-p	600 (6 Вт**)	≥150	120	4	2 (8*)	≤20 (120)
КТ6127И	p-n-p	600 (6 Вт**)	≥150	160	4	2 (8*)	≤20 (160)
КТ6127К	p-n-p	600 (6 Вт**)	≥150	200	4	2 (8*)	≤20 (200)
КТ6128А	n-p-n	400	≥400	30; 20**	—	25	—
КТ6128Б	n-p-n	400	≥400	30; 20**	—	25	—
КТ6128В	n-p-n	400	≥400	30; 20**	—	25	—
КТ6128Г	n-p-n	400	≥400	30; 20**	—	25	—
КТ6128Д	n-p-n	400	≥400	30; 20**	—	25	—
КТ6128Е	n-p-n	400	≥400	30; 20**	—	25	—
КТ6129А-9	p-n-p	700	≥4500	20; 15*	3	100	≤0,1 (10 В)
КТ6129Б-2	p-n-p	1 Вт	≥250	50	4,5	1000	≤5 (50 В)
КТ6130А-9	n-p-n	700	≥4000	15*	—	100	—
КТ6131А	n-p-n	1,3 Вт	≥3,5 ГГц (10 В; 50 мА)	40; 20* (1к)	3	150	≤0,5 мкА (40 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
80...250 (5 В; 10 мА) 60...250 (5 В; 10 мА)	≤6 ≤6	≤4 ≤5	≤8 —	— —	**КТ6117**
≥30* (5 В; 500 мА) ≥30* (5 В; 500 мА) ≥30* (5 В; 500 мА) ≥50* (5 В; 500 мА) ≥50* (5 В; 500 мА) ≥50* (5 В; 500 мА) ≥50* (5 В; 500 мА) ≥30* (5 В; 500 мА) ≥30* (5 В; 500 мА)	≤74 (5 В) ≤74 (5 В) ≤74 (5 В) ≤74 (5 В) ≤74 (5 В) ≤74 (5 В) ≤74 (5 В) ≤74 (5 В) ≤74 (5 В)	≤0,15 ≤0,15 ≤0,15 ≤0,15 ≤0,15 ≤0,15 ≤0,2 ≤0,2 ≤0,25	— — — — — — — — —	≤250* ≤250* ≤250* ≤250* ≤250* ≤250* ≤250* ≤250* ≤250*	**КТ6127**
28...45 (5 В; 1 мА) 39...60 (5 В; 1 мА) 54...80 (5 В; 1 мА) 72...108 (5 В; 1 мА) 97...146 (5 В; 1 мА) 132...198 (5 В; 1 мА)	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	**КТ6128**
20...150* (10 В; 50 мА)	≤1,45 (10 В)	—	—	—	**КТ6129-9**
25...150 (5 В; 0,2 А)	≤25 (10 В)	≤2	—	90*	**КТ6129Б-2**
≥20	—	—	—	—	**КТ6130-9**
≥40 (10 В; 100 мА)	≤2 (10 В)	—	—	—	**КТ6131**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ6132А	p-n-p	1,3 Вт	≥3,5 ГГц (10 В; 50 мА)	40	3	150	≤0.5 мкА (40 В)
КТ6133А **КТ6133Б** **КТ6133В**	p-n-p p-n-p p-n-p	1000 1000 1000	≥100 ≥100 ≥100	25* 25* 25*	— — —	1200 1200 1200	— — —
КТ6134А **КТ6134Б** **КТ6134В**	n-p-n n-p-n n-p-n	1000 1000 1000	≥100 ≥100 ≥100	25* 25* 25*	— — —	1200 1200 1200	— — —
КТ6135А **КТ6135Б** **КТ6135В** **КТ6135Г**	n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n	800 800 800 800	≥100 ≥100 ≥100 ≥100	400* 300* 200* 100*	— — — —	500 500 500 500	— — — —
КТ6135А9 **КТ6135Б9** **КТ6135В9** **КТ6135Г9** **КТ6135Д9** **КТ6142А9**	n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n	1 Вт 1 Вт 1 Вт 1 Вт 1 Вт 600	≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 5000	400 300 200 100 50 20	6 6 6 6 5 3	500 500 500 500 500 100	— — — — — —
КТ6136А	p-n-p	625	≥250	40**	5	200	≤0,05*
КТ6137А	n-p-n	625	≥300	60; 40**	6	200	≤0,05*
КТ6138А **КТ6138Б** **КТ6138В** **КТ6138Г** **КТ6138Д**	p-n-p p-n-p p-n-p p-n-p p-n-p	500 500 500 500 500	50 50 50 50 50	300 250 200 160 120	— — — — —	100 100 100 100 100	— — — — —
КТ6139А **КТ6139Б** **КТ6139В** **КТ6139Г** **КТ6139Д**	n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n	500 500 500 500 500	50 50 50 50 50	300 250 200 160 120	— — — — —	100 100 100 100 100	— — — — —
КТ6140А	p-n-p	400	≥700	30; 15**	5	50	≤0,05 (12 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\,нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$К_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥40 (10 В; 100 мА)	≤2 (10 В)	—	—	—	**КТ6132**
85...160 120...200 160...300	— — —	— — —	— — —	— — —	**КТ6133, КТ6134, КТ6135**
85...160 120...200 160...300	— — —	— — —	— — —	— — —	
50...500 50...500 50...500 50...500	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	
≥50 (10 В; 50 мА) ≥50 (10 В; 50 мА) ≥50 (10 В; 50 мА) ≥50 (10 В; 50 мА) ≥100 (10 В; 50 мА) ≥50 (10 В; 20 мА)	— — — — — —	≤10; 16* ≤10; 16* ≤10; 16* ≤10; 16* ≤12; 16* ≥11** (0,8 ГГц)	— — — — — ≤2 (0,8 ГГц)	— — — — — —	**КТ6135-9**
100...300 (1 В; 10 мА)	≤4,5	≤8	—	—	**КТ6136, КТ6137**
100...300 (1 В; 10 мА)	≤4	≤6	—	—	
40...600 (10 В; 30 мА) 40...600 (10 В; 30 мА) 40...600 (10 В; 30 мА) 40...600 (10 В; 30 мА) 40...600 (10 В; 30 мА)	— — — — —	≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25	— — — — —	— — — — —	**КТ6138, КТ6139, КТ6140**
40...600 (10 В; 30 мА) 40...600 (10 В; 30 мА) 40...600 (10 В; 30 мА) 40...600 (10 В; 30 мА) 40...600 (10 В; 30 мА)	— — — — —	≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25	— — — — —	— — — — —	
28...198 (5 В; 1 мА)	≤1,7 (10 В)	≤50	—	—	

Тип прибора	Структура	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{K\ max}$, $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ6141А9 **КТ6141Б9**	n-p-n n-p-n	500 700	≥3200 ≥3200	20 20	3 3	50 70	— —
КТ6142А **КТ6142Б**	n-p-n n-p-n	600 600	6000 4000	20 25	3 3	70 100	— —
КТ616А **КТ616Б**	n-p-n n-p-n	0,3 Вт 0,3 Вт	≥200 ≥200	20* 20*	4 4	400 (600*) 400 (600*)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В)
КТ617А	n-p-n	0,5 Вт	≥150	30	4	400 (600*)	≤5 (30 В)
КТ618А	n-p-n	0,5 Вт	≥40	300	5	100	≤50* (250 В)
КТ620А **КТ620Б**	p-n-p p-n-p	0,225 Вт 0,5 Вт	≥200 ≥200	50 50	3 4	400 400	≤5 (50 В) ≤5 (50 В)
КТ624А-2	n-p-n	1 Вт	≥450	30	4	1000 (1300*)	≤100 (30 В)
КТ624АМ-2	n-p-n	1 Вт	≥450	30	4	1000 (1300*)	≤100 (30 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^*_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥50 (10 В; 50 мА) ≥50 (10 В; 50 мА)	— —	≥14** (0,5 ГГц) ≥9** (0,8 ГГц)	≤3,6 (0,5 ГГц) ≤4 (0,8 ГГц)	— —	**КТ6141-9**
≥50 (10 В; 50 мА) ≥40 (10 В; 50 мА)	— —	≥11** (0,8 ГГц) ≥12** (0,8 ГГц)	≤3 (0,8 ГГц) ≤3 (0,8 ГГц)	— —	**КТ6142**
≥40* (1 В; 0,5 А) ≥25* (1 В; 0,5 А)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В)	≤1,2 ≤1,2	— —	≤50* ≤15*	**КТ616**
≥30* (2 В; 0,4 А)	≤15 (10 В)	≤7	—	≤120	**КТ617, КТ618**
≥30* (40 В; 1 мА)	≤7 (40 В)	—	—	—	
100* (10 В; 10 мА) 30...100* (5 В; 0,2 А)	— —	≤2,5 ≤2,5	— —	— ≤100*	**КТ620**
30...180* (0,5 В; 0,3 А)	≤15 (5 В)	≤9	—	≤18	**КТ624**
30...180* (0,5 В; 0,3 А)	≤15 (5 В)	≤9	—	≤18	**КТ624М**

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ625А	n-p-n	1 Вт	≥200	40* (5к)	5	1000 (1300*)	≤30 (60 В)
КТ625АМ	n-p-n	1 Вт	≥200	60	5	1000 (1300*)	≤30 (60 В)
КТ625АМ-2	n-p-n	1 Вт	≥200	60	5	1000	≤30 (60 В)
КТ626А	p-n-p	6,5 Вт (60°С)	≥75	45	4	500 (1500*)	≤10 (30 В)
КТ626Б	p-n-p	6.5 Вт (60°С)	≥75	60	4	500 (1500*)	≤150 (30 В)
КТ626В	p-n-p	6,5 Вт (60°С)	≥45	80	4	500 (1500*)	≤1 мА (80 В)
КТ626Г	p-n-p	6,5 Вт (60°С)	≥45	20* (0,1к)	4	0,5 (1,5*) А	≤150 (20 В)
КТ626Д	p-n-p	6,5 Вт (60°С)	≥45	20* (0,1к)	4	0,5 (1,5*) А	≤150 (20 В)
КТ629А-2	p-n-p	1 Вт (80°С)	≥250	50	4,5	1000	≤5 (50 В)
КТ629Б-2	p-n-p	1 Вт (80°С)	≥250	50	4,5	1000	≤5 (50 В)
КТ629БМ-2	p-n-p	1 Вт	≥250	50* (1к)	4,5	1000	≤5 (50 В)
КТ630А	n-p-n	0,8 Вт	≥50	120	7	1000 (2000*)	≤1 (90 В)
КТ630Б	n-p-n	0,8 Вт	≥50	120	7	1000 (2000*)	≤1 (90 В)
КТ630В	n-p-n	0,8 Вт	≥50	150	7	1000 (2000*)	≤1 (90 В)
КТ630Г	n-p-n	0,8 Вт	≥50	100	5	1000 (2000*)	≤1 (40 В)
КТ630Д	n-p-n	0,8 Вт	≥50	60	5	1000 (2000*)	≤1 (40 В)
КТ630Е	n-p-n	0,8 Вт	≥50	60	5	1000 (2000*)	≤1 (40 В)
КТ630А-5	n-p-n	800	≥50	120	7	1 А (2* А)	≤100 (120 В)
КТ630Б-5	n-p-n	800	≥50	120	7	1 А (2* А)	≤100 (120 В)
КТ630В-5	n-p-n	800	≥50	150	7	1 А (2* А)	≤100 (120 В)
КТ630Г-5	n-p-n	800	≥50	100	5	1 А (2* А)	≤100 (100 В)
КТ632Б	p-n-p	0,5 Вт (45°С)	≥200	120* (1к)	5	100 (350*)	≤1 (120 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, C^{*}_{12}, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
20...200* (1 В; 0,5 А)	≤9 (10 В)	≤2,4	—	≤60	**КТ625**
20...200* (1 В; 0,5 А)	≤9 (10 В)	≤2,4	—	≤60	**КТ625М**
20...200 (1 В; 0,5 А)	≤9 (10 В)	≤1,3	—	≤60	
40...260* (2 В; 0,15 А)	≤150 (10 В)	≤2	—	≤500	**КТ626**
30...100* (2 В; 0,15 А)	≤150 (10 В)	≤2	—	≤500	
15...45* (2 В; 0,15 А)	≤150 (10 В)	≤2	—	≤500	
15...60* (2 В; 0,15 А)	≤150 (10 В)	≤2	—	≤500	
40...250* (2 В; 0,15 А)	≤150 (10 В)	≤2	—	≤500	
25...150* (5 В; 0,5 А)	≤25 (10 В)	≤2	—	90*	**КТ629А-2, КТ629М**
25...150* (5 В; 0,2 А)	≤25 (10 В)	≤2	—	—	
25...150* (1,2 В; 0,5 А)	≤25 (10 В)	≤2	—	90*	
40...120* (10 В; 150 мА)	≤15 (10 В)	≤2	≥5*	≤500**	**КТ630**
80...240* (10 В; 150 мА)	≤15 (10 В)	≤2	≥5*	≤500**	
40...120* (10 В; 150 мА)	≤15 (10 В)	≤2	≥5*	≤500**	
40...120* (10 В; 150 мА)	≤15 (10 В)	≤2	≥5*	≤500**	
80...240* (10 В; 150 мА)	≤15 (10 В)	≤2	≥5*	≤500**	
160...480* (10 В; 150 мА)	≤15 (10 В)	≤2	≥5*	≤500**	
40...120 (10 В; 0,1 А)	≤15 (10 В)	≤3,3	—	—	**КТ630-5**
80...240 (10 В; 0,1 А)	≤15 (10 В)	≤3,3	—	—	
40...120 (10 В; 0,1 А)	≤15 (10 В)	≤3,3	—	—	
40...120 (10 В; 0,1 А)	≤15 (10 В)	≤3,3	—	—	
≥50 (1 В; 1 мА)	≤5 (20 В)	≤25	—	≤100	**КТ632**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ632Б-1	p-n-p	350 (40°C)	>200	120* (1к)	5	100 (350*)	≤1 (120 В)
КТ632В-1	p-n-p	350 (40°C)	>200	120* (1к)	5	100 (350*)	≤1 (120 В)
КТ633А	n-p-n	1,2 Вт	≥500	30	4,5	200 (500*)	≤10 (30 В)
КТ633Б	n-p-n	1,2 Вт	≥500	30	4,5	200 (500*)	≤10 (30 В)
КТ634А-2	n-p-n	1,2 Вт	≥1500	30	3	150 (250*)	≤0,5 мА (30 В)
КТ634Б-2	n-p-n	1,3 Вт	≥1500	30	3	150 (250*)	≤1 мА (30 В)
КТ635А	n-p-n	0,5 Вт	≥200	60	5	1 (1,2*) А	≤30 (60 В)
КТ635Б	n-p-n	0,5 Вт	≥250	60	5	1 (1,2*) А	≤30 (60 В)
КТ637А-2	n-p-n	1,5 Вт	≥1300	30	2,5	200 (300*)	≤0,1 мА (30 В)
КТ637Б-2	n-p-n	1,5 Вт	≥800	30	2,5	200 (300*)	≤2 мА (30 В)
КТ638А	n-p-n	500	≥200	110	5	100 (350*)	≤0,1 мА (110 В)
КТ638А1	n-p-n	500	≥200	120	5	100	≤0,1 (120 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, Ом $r^*_{БЭ\,нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
50...350 (1 В; 1 мА) 150...450 (10 В; 1 мА)	≤5 (20 В) ≤5 (20 В)	≤25 ≤25	— —	≤100 2000*	**КТ632-1**
40...140 (1 В; 10 мА) 20...160 (1 В; 10 мА)	≤4,5 (10 В) ≤4,5 (10 В)	≤5 ≤5	≤6 (20 мГц) ≤6 (20 мГц)	≤30* ≤30*	**КТ633**
— —	≤2,5 (15 В) ≤3 (15 В)	≥1,4** (5 ГГц) ≥1,4** (5 ГГц)	≥0,2** (5 ГГц) ≥0,45** (5 ГГц)	≤2 ≤3,5	**КТ634-2**
25...150* (1 В; 0,5 А) 20...150* (1 В; 0,5 А)	≤15 (10 В) ≤10 (10 В)	≤1 ≤1	— —	≤58; ≤60** ≤58; ≤60**	**КТ635**
30...140* (5 В; 50 мА) 30...140* (5 В; 50 мА)	≤4,5 (15 В) ≤4,5 (15 В)	— —	≥0,5** (3 ГГц) ≥0,25** (3 ГГц)	≤3 ≤15	**КТ637-2**
50...350 (1 В; 10 мА)	≤8 (20 В)	≤25	—	≤25 (1* мкс)	**КТ638**
≥50 (10 В; 2 мА)	≤6	≤25			**КТ638А1**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ639А	p-n-p	1 (12,5*) Вт	≥80	45	5	1,5 А (2* А)	≤0,1 (30 В)
КТ639Б	p-n-p	1 (12,5*) Вт	≥80	45	5	1,5 А (2* А)	≤0,1 (30 В)
КТ639В	p-n-p	1 (12,5*) Вт	≥80	45	5	1,5 А (2* А)	≤0,1 (30 В)
КТ639Г	p-n-p	1 (12,5*) Вт	≥80	60	5	1,5 А (2* А)	≤0,1 (30 В)
КТ639Д	p-n-p	1 (12,5*) Вт	≥80	60	5	1,5 А (2* А)	≤0,1 (30 В)
КТ639Е	p-n-p	1 Вт (35°С)	≥80	100	5	1,5 А (2* А)	≤0,1 (30 В)
КТ639Ж	p-n-p	1 Вт (35°С)	≥80	100	5	1,5 А (2* А)	≤0,1 (30 В)
КТ639И	p-n-p	1 Вт (35°С)	≥80	30	5	1,5 А (2* А)	≤0,1 (30 В)
КТ639А-1	p-n-p	500 (30** Вт)	≥80	45	5	1,5 А (2* А)	≤0,1 (30 В)
КТ639Б-1	p-n-p	500 (30** Вт)	≥80	45	5	1,5 А (2* А)	≤0,1 (30 В)
КТ639В-1	p-n-p	500 (30** Вт)	≥80	45	5	1,5 А (2* А)	≤0,1 (30 В)
КТ639Г-1	p-n-p	500 (30** Вт)	≥80	60	5	1,5 А (2* А)	≤0,1 (30 В)
КТ639Д-1	p-n-p	500 (30** Вт)	≥80	60	5	1,5 А (2* А)	≤0,1 (30 В)
КТ639Е-1	p-n-p	500 (30** Вт)	≥80	100*	5	1,5 А (2* А)	≤0,1 (30 В)
КТ639Ж-1	p-n-p	500 (30** Вт)	≥80	100*	5	1,5 А (2* А)	≤0,1 (30 В)
КТ639И-1	p-n-p	500 (30** Вт)	≥80	30	5	1,5 А (2* А)	≤0,1 (30 В)
КТ640А-2	n-p-n	0.6 Вт (60°С)	≥3000	25	3	60	≤0,5 мА (25 В)
КТ640Б-2	n-p-n	0.6 Вт (60°С)	≥3800	25	3	60	≤0,5 мА (25 В)
КТ640В-2	n-p-n	0.6 Вт (60°С)	≥3800	25	3	60	≤0,5 мА (25 В)
КТ642А-2	n-p-n	500	—	20	2	60	≤1 мА (20 В)
КТ642А-5	n-p-n	500	—	20	2	60	≤1 мА (20 В)
КТ643А-2	n-p-n	1,1 Вт (50°С)	—	25	3	120	≤1 мА (25 В)
КТ644А	p-n-p	1 (12,5*) Вт	≥200	60	5	0,6 А; 1* А	≤0,1 (50 В)
КТ644Б	p-n-p	1 (12,5*) Вт	≥200	60	5	0,6 А; 1* А	≤0,1 (50 В)
КТ644В	p-n-p	1 (12,5*) Вт	≥200	40**	5	0,6 А; 1* А	≤0,1 (50 В)
КТ644Г	p-n-p	1 (12,5*) Вт	≥200	40**	5	0,6 А; 1* А	≤0,1 (50 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_{k}, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_{ш}$, дБ $r'^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
40...100* (2 В; 0,15 А) 63...160* (2 В; 0,15 А) 100...250* (2 В; 0,15 А) 40...100* (2 В; 0,15 А) 63...160* (2 В; 0,15 А) 40...100* (2 В; 0,15 А) 60...100* (2 В; 0,15 А) 180...400* (2 В; 0,15 А)	≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В)	≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1	— — — — — — — —	≤200* ≤200* ≤200* ≤200* ≤200* ≤200* ≤200* ≤200*	**КТ639**
40...100 (2 В; 0,15 А) 40...160 (2 В; 0,15 А) 90...160 (2 В; 0,15 А) 40...100 (2 В; 0,15 А) 63...160 (2 В; 0,15 А) 40...100 (2 В; 0,15 А) 63...160 (2 В; 0,15 А) 180...400 (2 В; 0,15 А)	≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В)	≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1	— — — — — — — —	≤200* ≤200* ≤200* ≤200* ≤200* ≤200* ≤200* ≤200*	**КТ639-1**
≥15* (5 В; 5 мА) ≥15* (5 В; 5 мА) ≥15* (5 В; 5 мА)	≤1,3 (15 В) ≤1,3 (15 В) ≤1,3 (15 В)	≥6** (7 ГГц) ≥6** (7 ГГц) ≥6** (7 ГГц)	≤8 (6 ГГц) ≥0,1** (7 ГГц) ≥0,1** (7 ГГц) ≥0,08** (7 ГГц)	0,6 1 1	**КТ640-2**
—	≤1,1 (15 В)	≥3,5** (8 ГГц)	≥0,1** (8 ГГц)	—	**КТ642-2**
—	≤1,1 (15 В)	≥3,5** (8 ГГц)	≥0,1** (8 ГГц)	—	**КТ642-5**
—	≤1,8 (15 В)	—	≥0,48** (7 ГГц)	—	**КТ643-2**
40...120* (10 В; 0,15 А) 100...300* (10 В; 0,15 А) 40...120* (10 В; 0,15 А) 100...300* (10 В; 0,15 А)	≤8 (10 В) ≤8 (10 В) ≤8 (10 В) ≤8 (10 В)	≤2,7 ≤2,7 ≤2,7 ≤2,7	— — — —	≤180* ≤180* ≤180* ≤180*	**КТ644**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ645А **КТ645Б**	n-p-n n-p-n	0,5 (1*) Вт 500	≥200 ≥200	60 40	4 4	0,3 А; 0,6* А 300 (600*)	≤10 (60 В) ≤10 (40 В)
КТ646А **КТ646Б** **КТ646В**	n-p-n n-p-n n-p-n	1 (2,5*) Вт 1 Вт 1 Вт	≥200 ≥200 ≥200	60 40 40	4(5) 4 4	1 А; 1,2 * А 1 А; 1,2* А 1 А; 1,2* А	≤10 (60 В) ≤10 (40 В) ≤10 (40 В)
КТ647А-2	n-p-n	560	—	18	2	90	≤1 мА (18 В)
КТ647А-5	n-p-n	560	—	18	2	90	≤1 мА (18 В)
КТ648А-2	n-p-n	420	—	18	2	60	≤1 мА (18 В)
КТ648А-5	n-p-n	420	—	18	2	60	≤1 мА (18 В)
КТ653А **КТ653Б**	n-p-n n-p-n	5 Вт 5 Вт	≥ 50 ≥ 50	120* 100*	7 7	1 А 1 А	10* (120 В) 10* (100 В)
КТ657А-2 **КТ657Б-2** **КТ657В-2**	n-p-n n-p-n n-p-n	375 (60°С) 375 (60°С) 375 (60°С)	≥3 ГГц ≥3 ГГц ≥3 ГГц	12* 12* 12*	2 2 2	60 60 60	≤1* мА (12 В) ≤1* мА (12 В) ≤1* мА (12 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
20...200* (2 В; 0,15 А) ≥80 (10 В; 2 мА)	≤5 (10 В) ≤5 (10 В)	≤3,3 —	— —	≤120; ≤50* —	**КТ645**
40...200* (5 В; 0,2 А) 150...200* (5 В; 0,2 А) 150...300* (5 В; 0,2 А)	≤10 (10 В) ≤10 (10 В) ≤10 (10 В)	≤1,7 ≤1,2 ≤0,06	— — —	≤120; ≤60* ≤120; ≤60* ≤120; ≤60*	**КТ646**
—	≤1,5 (15 В)	≥3** (10 ГГц)	0,2** (10 ГГц)	—	**КТ647-2**
—	≤1,5 (15 В)	≥3** (10 ГГц)	0,2** (10 ГГц)	—	**КТ647-5**
—	≤1,5 (10 В)	≥3** (12 ГГц)	0,04** (12 ГГц)	—	**КТ648-2**
—	≤1,5 (10 В)	≥3** (12 ГГц)	≥0,04** (12 ГГц)	—	**КТ648-5**
40...150 (10 В; 150 мА) 80...250 (10 В; 150 мА)	≤20 (10 В) ≤20 (10 В)	≤3,3 ≤3,3		≤1** мкс ≤1** мкс	**КТ653**
— 60...200 (6 В; 30 мА) 35...70 (6 В; 30 мА)	≤1,1 (15 В) ≤1,1 (15 В) ≤1,1 (15 В)	≥8** (2 ГГц) ≥8** (2 ГГц) ≥8** (2 ГГц)	≥0,05** (2 ГГц) ≥0,05** (2 ГГц) ≥0,05** (2 ГГц)	— — —	**КТ657-2**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^*_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^*_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ657А-5 **КТ657Б-5** **КТ657В-5**	n-p-n n-p-n n-p-n	375 375 375	≥3 ГГц ≥3 ГГц ≥3 ГГц	12* 12* 12*	2 2 2	60 60 60	≤1* мА (12 В) ≤1* мА (12 В) ≤1* мА (12 В)
КТ659А	n-p-n	1 Вт	≥300	60	6	1,2 А	≤0,5 мА (60 В)
КТ660А **КТ660Б**	n-p-n n-p-n	0,5 Вт 0,5 Вт	≥200 ≥200	50 30	5 5	0,8 А 0,8 А	≤1 (50 В) ≤1 (30 В)
КТ661А	p-n-p	0,4 Вт (1,8* Вт)	≥200	60	5	0,3 А; 0,6* А	≤0,01 мА (50 В)
КТ662А	p-n-p	0,6 Вт (3* Вт)	≥200	60	5	0,4 А; 0,6* А	≤0,01 мА (50 В)
КТ664А-9 **КТ664Б-9**	p-n-p p-n-p	300 (1* Вт) 300 (1* Вт)	≥50 ≥50	120 100	5 5	1 А (1,5* А) 1 А (1,5* А)	≤10 (100 В) ≤10 (100 В)
КТ665А-9 **КТ665Б-9**	n-p-n n-p-n	300 (1* Вт) 300 (1* Вт)	≥50 ≥50	120 100	5 5	1 А (1,5* А) 1 А (1,5* А)	≤10 (100 В) ≤10 (100 В)
КТ666А-9	n-p-n	300 (1* Вт)	≥60	300	5	20 (50*)	≤0,1 мА (300 В)
КТ667А-9	p-n-p	300 (1* Вт)	≥40	300	5	20; 50*	≤0,1 (300 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	C_k, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^*_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
— 60...200 (6 В; 30 мА) 35...70 (6 В; 30 мА)	≤1,1 (15 В) ≤1,1 (15 В) ≤1,1 (15 В)	≥8** (2 ГГц) ≥8** (2 ГГц) ≥8** (2 ГГц)	≥0,05** (2 ГГц) ≥0,05** (2 ГГц) ≥0,05** (2 ГГц)	— — —	**КТ657-5**
≥35* (1 В; 0,3 А)	≤10 (10 В)	≤9	—	≤80**	**КТ659**
110...220* (10 В; 0,2 А) 200...450* (10 В; 0,2 А)	≤10 (10 В) ≤10 (10 В)	≤1 ≤1	— —	— —	**КТ660**
100...300* (10 В; 0,15 А)	≤8 (10 В)	≤3,2	—	≤150**	**КТ661**
100...300* (10 В; 0,15 А)	≤8 (10 В)	≤3,2	—	≤200**	**КТ662**
40...250 (2 В; 0,1 А) 40...250 (2 В; 0,1 А)	≤25 (5 В) ≤25 (5 В)	≤2,3 ≤2,3	— —	≤700** ≤700**	**КТ664-9, КТ665-9**
40...250 (2 В; 0,15 А) 40...250 (2 В; 0,15 А)	≤25 (5 В) ≤25 (5 В)	≤2 ≤2	— —	— —	
≥50 (10 В; 5 мА)	—	≤80	—	—	**КТ666А-9, КТ667А-9**
≥50 (10 В; 5 мА)	—	≤80	—	—	

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ668А	p-n-p	0,5 Вт	≥200	50	5	0,1 А	≤15 нА (30 В)
КТ668Б	p-n-p	0,5 Вт	≥200	50	5	0,1 А	≤15 нА (30 В)
КТ668В	p-n-p	0,5 Вт	≥200	50	5	0,1 А	≤15 нА (30 В)
КТ680А	n-p-n	350 (85°C)	≥120	30	5	0,6 А (2* А)	≤10 (25 В)
КТ681А	p-n-p	350 (85°C)	≥120	30	5	0,6 А (2* А)	≤10 (25 В)
КТ682А-2	n-p-n	350	≥4,4 ГГц	10	1	50	≤1 (10 В)
КТ682Б-2	n-p-n	350	≥4,4 ГГц	10	1	50	≤1 (10 В)
КТ682А-5	n-p-n	350	≥4,4 ГГц	10	1	50	≤1 (10 В)
КТ682Б-5	n-p-n	350	≥4,4 ГГц	10	1	50	≤1 (10 В)
КТ683А	n-p-n	1,2 (8*) Вт	≥50	150* (3к)	7	1 А; 2* А	≤1 (90 В)
КТ683Б	n-p-n	1,2 (8*) Вт	≥50	120* (3к)	7	1 А; 2* А	≤1 (90 В)
КТ683В	n-p-n	1,2 (8*) Вт	≥50	120* (3к)	7	1 А; 2* А	≤1 (90 В)
КТ683Г	n-p-n	1,2 (8*) Вт	≥50	100* (3к)	5	1 А; 2* А	≤1 (40 В)
КТ683Д	n-p-n	1,2 (8*) Вт	≥50	60* (3к)	5	1 А; 2* А	≤1 (40 В)
КТ683Е	n-p-n	1,2 (8*) Вт	≥50	60* (3к)	5	1 А; 2* А	≤1 (40 В)
КТ684А	p-n-p	0,8 Вт	≥40	45* (1к)	5	1 А (1,5* А)	≤0,1 (30 В)
КТ684Б	p-n-p	0,8 Вт	≥40	60* (1к)	5	1 А (1,5* А)	≤0,1 (30 В)
КТ684В	p-n-p	0,8 Вт	≥40	100* (1к)	5	1 А (1,5* А)	≤0,1 (30 В)
КТ684Г	p-n-p	0,8 Вт	≥40	30	5	1 А (1,5* А)	≤0,1 (30 В)
КТ685А	p-n-p	0,6 Вт	≥200	60	5	0,6 А	≤0,02 (50 В)
КТ685Б	p-n-p	0,6 Вт	≥200	60	5	0,6 А	≤0,01 (50 В)
КТ685В	p-n-p	0,6 Вт	≥200	60	5	0,6 А	≤0,02 (50 В)
КТ685Г	p-n-p	0,6 Вт	≥200	60	5	0,6 А	≤0,01 (50 В)
КТ685Д	p-n-p	0,6 Вт	≥350	30	5	0,6 А	≤0,02 (25 В)
КТ685Е	p-n-p	0,6 Вт	≥250	30	5	0,6 А	≤0,02 (25 В)
КТ685Ж	p-n-p	0,6 Вт	≥250	30	5	0,6 А	≤0,02 (25 В)
КТ686А	p-n-p	0,625 (1,4*) Вт	≥100	50* (0)	5	0,8 А (1,5* А)	≤0,1 (45 В)
КТ686Б	p-n-p	0,625 (1,4*) Вт	≥100	50* (0)	5	0,8 А (1,5* А)	≤0,1 (45 В)
КТ686В	p-n-p	0,625 (1,4*) Вт	≥100	50* (0)	5	0,8 А (1,5* А)	≤0,1 (45 В)
КТ686Г	p-n-p	0,625 (1,4*) Вт	≥100	30* (0)	5	0,8 А (1,5* А)	≤0,1 (25 В)
КТ686Д	p-n-p	0,625 (1,4*) Вт	≥100	30* (0)	5	0,8 А (1,5* А)	≤0,1 (25 В)
КТ686Е	p-n-p	0,625 (1,4*) Вт	≥100	30* (0)	5	0,8 А (1,5* А)	≤0,1 (25 В)
КТ686Ж	p-n-p	0,625 (1,4*) Вт	≥100	30* (0)	5	0,8 А (1,5* А)	≤0,1 (25 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$С_к$, $С^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом, $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом, $К^{**}_{у.р.}$, дБ	$К_ш$, дБ, $r^{*}_б$, Ом, $Р^{**}_{вых}$, Вт	$τ_к$, пс, $t^{*}_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
75...140 (5 В; 2 мА)	≤7	≤6,5	≤10 (1кГц)	—	КТ668
125...250 (5 В; 2 мА)	≤7	≤6,5	≤10 (1кГц)	—	
220...475 (5 В; 2 мА)	≤7	≤6,5	≤10 (1кГц)	—	
85...300* (1 В; 0,5 А)	—	≤0,5	—	—	КТ680, КТ681
85...300* (1 В; 0,5 А)	—	≤0,5	—	—	
40...45 (7 В; 2 мА)	≤0,9 (10 В)	≥7** (3,6 ГГц)	≤4 (3,6 ГГц)	—	КТ682-2
80...120 (7 В; 2 мА)	≤0,9 (10 В)	≥7** (3,6 ГГц)	≤4 (3,6 ГГц)	—	
40...45 (7 В; 2 мА)	≤0,9 (10 В)	≥7** (3,6 ГГц)	4 (3,6 ГГц)	—	КТ682-5
80...120 (7 В; 2 мА)	≤0,9 (10 В)	≥7** (3,6 ГГц)	≤4 (3,6 ГГц)	—	
40...120* (10 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤3; ≤6.6*	≤8*	≤500**	КТ683
80...240* (10 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤3; ≤6.6*	≤8*	≤500**	
40...120* (10 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤3; ≤6.6*	≤8*	≤500**	
40...120* (10 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤3; ≤6.6*	≤8*	≤500**	
80...240* (10 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤3; ≤6.6*	≤8*	≤500**	
160...480* (10 В; 0,15 А)	≤15 (10 В)	≤3; ≤6.6*	≤8*	≤500**	
40...250* (2 В; 0,15 А)	≤50 (10 В)	≤1	—	—	КТ684
40...160* (2 В; 0,15 А)	≤50 (10 В)	≤1	—	—	
40...160* (2 В; 0,15 А)	≤50 (10 В)	≤1	—	—	
180...400 (2 В; 0,15 А)	≤50 (10 В)	≤1	—	—	
40...120* (10 В; 0,15 А)	≤8 (10 В)	≤2,6	—	≤80*	КТ685
40...120* (10 В; 0,15 А)	≤8 (10 В)	≤2,6	—	≤80*	
100...300* (10 В; 0,15 А)	≤8 (10 В)	≤2,6	—	≤80*	
100...300* (10 В; 0,15 А)	≤8 (10 В)	≤2,6	—	≤80*	
70...200* (1 В; 0,15 А)	≤12 (10 В)	≤2,6	—	≤80*	
40...120* (1 В; 0,3 А)	≤12 (10 В)	≤2,6	—	≤150	
100...300* (1 В; 0,3 А)	≤12 (10 В)	≤2,6	—	≤150	
100...250* (1 В; 0,1 А)	≤12 (10 В)	≤1,4	—	—	КТ686
160...400* (1 В; 0,1 А)	≤12 (10 В)	≤1,4	—	—	
250...630* (1 В; 0,1 А)	≤12 (10 В)	≤1,4	—	—	
100...250* (1 В; 0,1 А)	≤12 (10 В)	≤1,4	—	—	
160...400* (1 В; 0,1 А)	≤12 (10 В)	≤1,4	—	—	
250...630* (1 В; 0,1 А)	≤12 (10 В)	≤1,4	—	—	
100...250* (1 В; 0,1 А)	≤12 (10 В)	≤1,4	—	—	

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ692А	p-n-p	1 Вт	≥200	40	5	1 А	≤0,1 (30 В)
КТ695А	n-p-n	450	≥300	30	4	30	≤0,1 (30 В)
КТ698А	n-p-n	600	≥150	90*	4	2 А	≤20* (90 В)
КТ698Б	n-p-n	600	≥150	70*	4	2 А	≤20* (70 В)
КТ698В	n-p-n	600	≥150	50*	4	2 А	≤20* (50 В)
КТ698Г	n-p-n	600	≥150	30*	4	2 А	≤20* (30 В)
КТ698Д	n-p-n	600	≥150	12*	4	2 А	≤20* (12 В)
КТ698Е	n-p-n	600	≥150	12*	4	2 А	≤20* (12 В)
КТ698Ж	n-p-n	600	≥150	120*	4	2 А	≤20* (120 В)
КТ698И	n-p-n	600	≥150	160*	4	2 А	≤20* (160 В)
КТ698К	n-p-n	600	≥150	200*	4	2 А	≤20* (200 В)
КТ704А	n-p-n	15* Вт (50°C)	≥3	500* (1000 имп.)	4	2,5 (4*) А	≤5* мА (1000 В)
КТ704Б	n-p-n	15* Вт (50°C)	≥3	400* (700 имп.)	4	2,5 (4*) А	≤5* мА (700 В)
КТ704В	n-p-n	15* Вт (50°C)	≥3	400* (500 имп.)	4	2,5 (4*) А	≤5* мА (500 В)
КТ708А	p-n-p	5 Вт	≥3	100; 80*	5	2 А	—
КТ708Б	p-n-p	5 Вт	≥3	80; 60*	5	2 А	—
КТ708В	p-n-p	5 Вт	≥3	60; 40*	5	2А	—
КТ709А	p-n-p	30 Вт	≥3	100; 80*	5	10 А	—
КТ709Б	p-n-p	30 Вт	≥3	80; 60*	5	10 А	—
КТ709В	p-n-p	30 Вт	≥3	60; 40*	5	10 А	—
КТ710А	n-p-n	50* Вт (50°C)	—	3000* (0,01к)	5	5 (7,5*) А	≤2 мА (3000 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^{*}_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥20 (1 В; 0,5 А)	≤20 (30 В)	≤1	—	≤90**	**КТ692А**
50...200 (10 В; 1 мА)	≤1,5 (10 В)	—	—	—	**КТ695А**
≥20* (5 В; 1 А)	≤74 (5 В)	≤0,12	—	≤245*	**КТ698**
≥20* (5 В; 1 А)	≤74 (5 В)	≤0,12	—	≤245*	
≥50* (5 В; 1 А)	≤74 (5 В)	≤0,12	—	≤245*	
≥50* (5 В; 1 А)	≤74 (5 В)	≤0,12	—	≤245*	
≥50* (5 В; 1 А)	≤74 (5 В)	≤0,12	—	≤245*	
≥50* (5 В; 1 А)	≤74 (5 В)	≤0,12	—	≤245*	
≥30* (5 В; 1 А)	≤74 (5 В)	≤0,12	—	≤245*	
≥30* (5 В; 1 А)	≤74 (5 В)	≤0,15	—	≤245*	
≥30* (5 В; 1 А)	≤74 (5 В)	≤0,17	—	≤245*	
10...100* (15 В; 1 А)	≤50 (20 В)	≤2,5	—	—	**КТ704**
10...100* (15 В; 1 А)	≤50 (20 В)	≤2,5	—	—	
≥10* (15 В; 1 А)	≤50 (20 В)	≤2,5	—	—	
≥500	—	≤1			**КТ708**
≥700	—	≤1			
≥700	—	≤1			
		≤1			
		≤1			
		≤1			
≥500	—	≤1			**КТ709**
≥700	—	≤1			
≥700	—	≤1			
≥3,5 (10 В; 4 А)	—	≤0,9	—	30000*	**КТ710**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ712А **КТ712Б**	p-n-p p-n-p	1,5 (50*) Вт 1,5 (50*) Вт	≥3 ≥3	200 160	5 5	10 (15*) А 10 (15*) А	≤1 мА (200 В) ≤1 мА (160 В)
КТ715А	n-p-n	75* Вт (50°С)	≥0,45	5000	5	2 А	≤1 мА (5000 В)
КТ716А **КТ716Б** **КТ716В** **КТ716Г**	n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n	1 Вт (60 Вт*) 1 Вт (60 Вт*) 1 Вт (60 Вт*) 1 Вт (60 Вт*)	≥6 ≥6 ≥6 ≥6	100 80 60 45	5 5 5 5	8 А 8 А 8 А 8 А	≤0,1 мА ≤0,1 мА ≤0,1 мА ≤0,1 мА
КТ719А **КТ720А**	n-p-n p-n-p	10* Вт 10* Вт	≥3 ≥3	120 120	5 5	1,5 А 1,5 А	— —
КТ721А **КТ722А**	n-p-n p-n-p	25* Вт 25* Вт	≥3 ≥3	120 120	5 5	1,5 А 1,5 А	— —
КТ723А **КТ724А**	n-p-n p-n-p	60* Вт 60* Вт	≥3 ≥3	120 120	5 5	10 А 10 А	— —
КТ728А	n-p-n	115* Вт	≥2,5	60	7	15 А	≤0,7 мА (60 В)
КТ729А **КТ729Б**	n-p-n n-p-n	150* Вт 150* Вт	≥0,2 ≥0,2	50 100	5 7	30 А 20 А	≤2 мА (50 В) ≤5 мА (100 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^{*}_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥500* (5 В; 2 А) ≥400* (5 В; 2 А)	— —	≤1 ≤1	— —	— —	КТ712
≥15 (10 В; 0,2 А)	—	≤15	—	≤27500*	КТ715
≥750 (5 В; 5 А) ≥750 (5 В; 5 А) ≥750 (5 В; 5 А) ≥750 (5 В; 5 А)	150 (5 В) 150 (5 В) 150 (5 В) 150 (5 В)	≤0,4 ≤0,4 ≤0,4 ≤0,4	— — — —	≤7000* ≤7000* ≤7000* ≤7000*	КТ716
≥20 (2 В; 0,15 А) ≥20 (2 В; 0,15 А)	— —	≤1,2 ≤1,2	— —	— —	КТ719, КТ720
≥20 (2 В; 1 А) ≥20 (2 В; 1 А)	— —	≤0,6 ≤0,6	— —	— —	КТ721, КТ722
≥20 (5 В; 5 А) ≥20 (5 В; 5 А)	— —	≤0,4 ≤0,4	— —	— —	КТ723, КТ724
20...70 (5 В; 4 А)	—	≤0,3	—	—	КТ728, КТ729
15...60* (4 В; 15 А) 15...60 (4 В; 10 А)	— —	≤0,13 ≤0,14	— —	— —	

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ730А	n-p-n	150* Вт	≥0,2	160	7	16 А	≤2 мА (140 В)
КТ731А	n-p-n	1 Вт; 10* Вт	≥30	25; 20**	5	1,5 А; 3* А	≤20 (30 В)
КТ731Б	n-p-n	1 Вт; 10* Вт	≥30	40; 35**	5	1,5 А; 3* А	≤20 (30 В)
КТ731В	n-p-n	1 Вт; 10* Вт	≥30	60; 55**	5	1,5 А; 3* А	≤20 (30 В)
КТ731Г	n-p-n	1 Вт; 10* Вт	≥30	80; 70**	5	1,5 А; 3* А	≤20 (30 В)
КТ732А	n-p-n	90* Вт	≥1	160	7	16 А 20* А	0,75 мА (160 В)
КТ733А	p-n-p	90* Вт	≥1	160	7	16 А 20* А	0,75 мА (160 В)
КТ734А	n-p-n	40* Вт	≥3	40	5	3 А; 5 А*	≤0,3** (30 В)
КТ734Б	n-p-n	40* Вт	≥3	60	5	3 А; 5 А*	≤0,3* (30 В)
КТ734В	n-p-n	40* Вт	≥3	80	5	3 А; 5 А*	≤0,3* (60 В)
КТ734Г	n-p-n	40* Вт	≥3	100	5	3 А; 5 А*	≤0,3* (60 В)
КТ735А	p-n-p	40* Вт	≥3	40	5	3 А; 5 А*	≤0,3* (30 В)
КТ735Б	p-n-p	40* Вт	≥3	60	5	3 А; 5 А*	≤0,3* (30 В)
КТ735В	p-n-p	40* Вт	≥3	80	5	3 А; 5 А*	≤0,3* (60 В)
КТ735Г	p-n-p	40* Вт	≥3	100	5	3 А; 5 А*	≤0,3* (60 В)
КТ736А	n-p-n	65* Вт	≥3	40	5	6 А; 10 А*	≤0,7* (30 В)
КТ736Б	n-p-n	65* Вт	≥3	60	5	6 А; 10 А*	≤0,7* (30 В)
КТ736В	n-p-n	65* Вт	≥3	80	5	6 А; 10 А*	≤0,7* (60 В)
КТ736Г	n-p-n	65* Вт	≥3	100	5	6 А; 10 А*	≤0,7* (60 В)
КТ737А	p-n-p	65* Вт	≥3	40	5	6 А; 10 А*	≤0,7* (30 В)
КТ737Б	p-n-p	65* Вт	≥3	60	5	6 А; 10 А*	≤0,7* (30 В)
КТ737В	p-n-p	65* Вт	≥3	80	5	6 А; 10 А*	≤0,7* (30 В)
КТ737Г	p-n-p	65* Вт	≥3	100	5	6 А; 10 А*	≤0,7* (30 В)
КТ738А	n-p-n	90 Вт	≥10	70	5	10 А	1 мА (100 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, C^{*}_{12}, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
15...60* (4 В; 8 А)	—	≤0,17	—	—	**КТ730**
≥40 (10 В; 50 мА) ≥40 (10 В; 50 мА) ≥40 (10 В; 50 мА) ≥30 (10 В; 50 мА)	— — — —	≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5	— — — —	— — — —	**КТ731**
≥15 (2 В; 8 А) ≥8 (4 В; 16 А)	—	≤0,25	—	—	**КТ732**
≥15 (2 В; 8 А) ≥8 (4 В; 16 А)	—	≤0,25	—	—	**КТ733**
≥25 (4 В; 1 А) ≥25 (4 В; 1 А) ≥10 (4 В; 3 А) ≥10 (4 В; 3 А)	— — — —	≤0,4 ≤0,4 ≤0,4 ≤0,4	— — — —	— — — —	**КТ734, КТ735**
≥25 (4 В; 1 А) ≥25 (4 В; 1 А) ≥10 (4 В; 3 А) ≥10 (4 В; 3 А)	— — — —	≤0,4 ≤0,4 ≤0,4 ≤0,4	— — — —	— — — —	
≥30 (4 В; 3 А) ≥30 (4 В; 3 А) ≥15 (4 В; 3 А) ≥15 (4 В; 3 А)	— — — —	≤0,25 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,25	— — — —	— — — —	**КТ736, КТ737**
≥30 (4 В; 3 А) ≥30 (4 В; 3 А) ≥15 (4 В; 3 А) ≥15 (4 В; 3 А)	— — — —	≤0,25 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,25	— — — —	— — — —	
20...70 (4 В; 4 А)	—	≤0,3	—	≤1**	**КТ738**

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ739А	р-п-р	90 Вт	≥10	70	5	10 А	1 мА (100 В)
КТ740А	п-р-п	125* Вт	—	200	5	20 А	—
КТ740А1	п-р-п	60* Вт	—	200	5	20 А	—
КТ801А **КТ801Б**	п-р-п п-р-п	5* Вт (55°С) 5* Вт (55°С)	≥10 ≥10	80* (0,1к) 60* (0,1к)	2,5 2,5	2 А 2 А	10* мА (80 В) 10* мА (60 В)
КТ802А	п-р-п	50* Вт	≥10; ≥20	150; 180	3; 5	5 А	≤60 мА (150 В)
КТ803А	п-р-п	60* Вт	≥20	60* (0,1к)	4	10 А	≤5* мА (70 В)
КТ805А **КТ805Б**	п-р-п п-р-п	30 Вт 30 Вт	≥20 ≥20	60* (160 имп.) 60* (135 имп.)	5 5	5 (8*) А 5 (8*) А	≤15* мА (60 В) ≤15* мА (60 В)
КТ805АМ **КТ805БМ** **КТ805ВМ**	п-р-п п-р-п п-р-п	30* Вт (50°С) 30* Вт (50°С) 30* Вт (50°С)	≥20 ≥20 ≥20	60* (160 имп.) 60* (135 имп.) 60* (135 имп.)	5 5 5	5 (8*) А 5 (8*) А 5 (8*) А	≤15* мА (60 В) ≤15* мА (60 В) ≤15* мА (60 В)
КТ807А **КТ807Б**	п-р-п п-р-п	10* Вт (70°С) 10* Вт (70°С)	≥5 ≥5	100* 100*	4 4	0,5; 1,5* А 0,5; 1,5* А	≤5* мА (100 В) ≤5* мА (100 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	C_k, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r'_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^*_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
20...70 (4 В; 4 А)	—	≤0,3	—	≤0,7**	КТ739А
≥30	—	≤0,125	—	—	КТ740А
≥30	—	≤0,125	—	—	КТ740А1
15...50* (5 В; 1 А) 30...150* (5 В; 1 А)	— —	≤2 ≤2	— —	— —	КТ801
≥15* (10 В; 2 А)	—	≤1	—	—	КТ802, КТ803, КТ805
10...70* (10 В; 5 А)	≤250 (20 В)	≤0,5	—	≤190**	
≥15* (10 В; 2 А) ≥15* (10 В; 2 А)	— —	≤0,5 ≤1	— —	— —	
≥15* (10 В; 2 А) ≥15* (10 В; 2 А) ≥15* (10 В; 2 А)	— — —	≤0,5 ≤1 ≤1,25	— — —	— — —	КТ805М
15...45* (5 В; 0,5 А) 30...100* (5 В; 0,5 А)	— —	≤2 ≤2	— —	— —	КТ807

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ807АМ **КТ807БМ**	n-p-n n-p-n	10* Вт (70°С) 10* Вт (70°С)	≥5 ≥5	100* (1к) 100* (1к)	4 4	0,5 (1,5*) А 0,5 (1,5*) А	≤5* мА (100 В) ≤5* мА (100 В)
КТ808А	n-p-n	50* Вт (50°С)	≥7,2	120* (250 имп.)	4	10 А	≤3* мА (120 В)
КТ808А1 **КТ808Б1** **КТ808В1** **КТ808Г1**	n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n	70* Вт 70* Вт 70* Вт 70* Вт	≥8 ≥8 ≥8 ≥8	130* 100* 80* 70*	5 5 5 5	10 А 10 А 10 А 10 А	≤2* мА (130 В) ≤2* мА (100 В) ≤2* мА (80 В) ≤2* мА (70 В)
КТ808А3 **КТ808Б3**	n-p-n n-p-n	70* Вт 70* Вт	≥8 ≥8	130 100	5 5	10 (15*) А 10 (15*) А	≤2* мА (130 В) ≤2* мА (100 В)
КТ808АМ **КТ808БМ** **КТ808ВМ** **КТ808ГМ**	n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n	60* Вт (50°С) 60* Вт (50°С) 60* Вт (50°С) 60* Вт (50°С)	≥8 ≥8 ≥8 ≥8	130* (250 имп.) 100* (160 имп.) 80* (135 имп.) 70* (80 имп.)	5 5 5 5	10 А 10 А 10 А 10 А	≤2* мА (120 В) ≤2* мА (100 В) ≤2* мА (100 В) ≥2* мА (70 В)
КТ809А	n-p-n	40* Вт (50°С)	≥5,1	400* (0,01к)	4	3 А; 5* А	≤3* мА (400 В)
КТ8101А **КТ8101Б**	n-p-n n-p-n	2 Вт; 150* Вт 2 Вт; 150* Вт	≥10 ≥10	200 160	6 6	16 А (25* А) 16 А (25* А)	≤1 мА (200 В) ≤1 мА (160 В)
КТ8102А **КТ8102Б**	p-n-p p-n-p	2 Вт; 150* Вт 2 Вт; 150* Вт	≥10 ≥10	200 160	6 6	16 А (25* А) 16 А (25* А)	≤1 мА (200 В) ≤1 мА (180 В)
КТ8104А	p-n-p	150 Вт	≥10	350	5	20 А (25 А*)	≤0,7 мА (350 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
15...45* (5 В; 0,5 А) 30...100* (5 В; 0,5 А)	— —	≤2 ≤2	— —	— —	**КТ807М**
10...50* (3 В; 6 А)	≤500 (10 В)	—	—	≤2000*	**КТ808**
20...125 (3 В; 2 А) 20...125 (3 В; 2 А) 20...125 (3 В; 2 А) 20...125 (3 В; 2 А)	≤500 (10 В) ≤500 (10 В) ≤500 (10 В) ≤500 (10 В)	≤0,33 ≤0,33 ≤0,33 ≤0,33	— — — —	— — — —	**КТ808-1**
20...125 (3 В; 2 А) 20...125 (3 В; 2 А)	≤500 (100 В) ≤500 (100 В)	— —	— —	≤2000* ≤2000*	**КТ808-3**
20...125* (3 В; 2 А) 20...125* (3 В; 2 А) 20...125* (3 В; 2 А) 20...125* (3 В; 2 А)	≤500 (100 В) ≤500 (100 В) ≤500 (100 В) ≤500 (100 В)	≤0,33 ≤0,33 ≤0,33 ≤0,33	— — — —	≤2000* ≤2000* ≤2000* ≤2000*	**КТ808М**
15...100* (5 В; 2 А)	≤150 (20 В)	≤0,75	—	≤4000*	**КТ809**
≥20* (10 В; 2 А) ≥20* (10 В; 2 А)	≤000 (5 В) ≤1000 (5 В)	≤3,3 ≤3,3	— —	— —	**КТ8101, КТ8102**
≥20* (10 В; 2 А) ≥20* (10 В; 2 А)	≤1000 (5 В) ≤1000 (5 В)	≤3,3 ≤3,3	— —	— —	
1000 (5 В; 5 А)	—	<0,2	—	—	**КТ8104**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^*_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^*_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ8105А	n-p-n	150 Вт	≥10	200	5	20 А (25 А*)	≤0,7 мА (350 В)
КТ8106А	n-p-n	2 Вт; 125* Вт	≥1	90*	5	20 А (30* А)	—
КТ8106Б	n-p-n	2 Вт; 125* Вт	≥1	60	5	20 А (30* А)	—
КТ8107А	n-p-n	100* Вт	≥7	1500 (700*)	5	8 А (15* А)	≤0,7 мА (1500 В)
КТ8107Б	n-p-n	125* Вт	≥7	1500 (700*)	5	5 А (7,5* А)	≤0,7 мА (1500 В)
КТ8107В	n-p-n	50* Вт	≥7	1500 (600*)	5	5 А (8* А)	≤0,7 мА (1500 В)
КТ8107Г	n-p-n	100 Вт	≥7	1500	6	10 А	≤0,7 мА (1500 В)
КТ8107Д	n-p-n	100 Вт	≥7	1200	6	10 А	≤0,7 мА (1200 В)
КТ8107Е	n-p-n	100 Вт	≥7	1000	6	10 А	≤0,7 мА (1000 В)
КТ8107А2	n-p-n	100* Вт	≥7	1500 (700*)	5	8 А (15* А)	≤0,7 мА (1500 В)
КТ8107Б2	n-p-n	125* Вт	≥7	1500 (700*)	5	5 А (7,5* А)	≤0,7 мА (1500 В)
КТ8107В2	n-p-n	50* Вт	≥7	1500 (600*)	5	5 А (8* А)	≤0,7 мА (1500 В)
КТ8107Г2	n-p-n	100* Вт	>7	1500	6	10 А	≤0,7 мА (1500 В)
КТ8107Д2	n-p-n	100* Вт	>7	1200	6	10 А	≤0,7 мА (1200 В)
КТ8107Е2	n-p-n	100* Вт	>7	1000	6	10 А	≤0,7 мА (1000 В)
КТ8108А	n-p-n	70* Вт	≥15	850	5	5 (7*)	0,5 мА (850 В)
КТ8108Б	n-p-n	70* Вт	≥15	850	5	5 (7*)	0,5 мА (850 В)
КТ8108В	n-p-n	70* Вт	≥15	900	5	5 (7*)	0,5 мА (900 В)
КТ8108А-1	n-p-n	70* Вт	15	850	5	5 (7*) А	≤0,5 мА (850 В)
КТ8108Б-1	n-p-n	70* Вт	15	850	5	5 (7*) А	≤0,5 мА (850 В)
КТ8108В-1	n-p-n	70* Вт	15	900	5	5 (7*) А	≤0,5 мА (850 В)
КТ8109А	n-p-n	80* Вт	≥7	350	5	7 А (10* А)	≤3 мА (350 В)
КТ8109Б	n-p-n	80* Вт	≥7	300	5	7 А (10* А)	≤3 мА (300 В)
КТ8110А	n-p-n	2 Вт; 60* Вт	≥20	500	5	7 А (14* А)	≤1000 (500 В)
КТ8110Б	n-p-n	2 Вт; 60* Вт	≥20	500; 400**	5	7 А (14* А)	≤100 (400 В)
КТ8110В	n-p-n	2 Вт; 60* Вт	≥20	500; 350**	5	7 А (14* А)	≤100 (400 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r'^{*}_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥1000 (5 В; 5 А)	—	<0,2	—	—	**КТ8105**
750...18000 (10 В; 5 А) 750...18000 (10 В; 5 А)	≤700 (10 В) ≤700 (10 В)	≤0,4 ≤0,4	— —	≤4500** ≤4500**	**КТ8106**
≥2,25* (5 В; 4,5 А) ≥2,25* (5 В; 4,5 А) 8...12* (5 В; 1 А) — — —	— — — — — —	≤0,22 ≤0,65 ≤0,22 ≤0,22 ≤0,4 ≤0,4	— — — — — —	≤3500* ≤3500* ≤3500* — — —	**КТ8107**
≥2,25* (5 В; 4,5 А) ≥2,25* (5 В; 4,5 А) 8...12* (5 В; 1 А) — — —	— — — — — —	≤0,22 ≤0,65 ≤022 <0,22 <0,4 <0,4	— — — — — —	≤3500* ≤3500* ≤3500* — — —	**КТ8107-2, КТ8108**
10...50 (5 В; 0,5 А) 40...80 (5 В; 0,5 А) 10...50 (5 В; 0,5 А)	≤75 (15 В) ≤75 (15 В) ≤75 (15 В)	≤0,4 ≤0,4 ≤0,4	— — —	≤3000* ≤3000* ≤3000*	
10...50* (5 В; 0,5 А) 40...80* (5 В; 0,5 А) 10...50* (5 В; 0,5 А)	≤75 (5 В) ≤75 (5 В) ≤75 (5 В)	≤0,4 ≤0,4 ≤0,4	— — —	3* мкс 3* мкс 3* мкс	**КТ8108-1**
≥150* (5 В; 2,5 А) ≥150* (5 В; 2,5 А)	— —	≤0,75 ≤0,75	— —	≤3* мкс ≤3* мкс	**КТ8109**
15...30* (5 В; 0,8 А) 15...30* (5 В; 0,8 А) 15...30* (5 В; 0,8 А)	— — —	≤0,2 ≤0,2 ≤0,2	— — —	≤2500* ≤2500* ≤2500*	**КТ8110**

Тип прибора	Структура	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{K\ max}$, $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ8111А9 **КТ8111Б9** **КТ8111В9**	n-p-n n-p-n n-p-n	125* Вт 125* Вт 125* Вт	≥1 ≥1 ≥1	100 80 60	5 5 5	20 А 20 А 20 А	— — —
КТ8112А	n-p-n	1 Вт; 10* Вт	≥20	400* (1к)	5	0,5 А (1,5* А)	—
КТ8113А **КТ8113Б** **КТ8113В**	p-n-p p-n-p p-n-p	2 Вт; 65* Вт 2 Вт; 65* Вт 2 Вт; 65* Вт	≥3 ≥3 ≥3	100 80 60	6 6 6	6 (10*) А 6 (10*) А 6 (10*) А	≤700 (60 В) ≤700 (60 В) ≤700 (30 В)
КТ8114А **КТ8114Б** **КТ8114В** **КТ8114Г**	n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n	125* Вт 125* Вт 100* Вт 100* Вт	— — — —	1500* 1200* 1200* 1500*	6 6 6 6	8 А; 15* А 8 А; 15* А 8 А; 15* А 8 А; 15* А	≤0,1 мА (1500 В) ≤0,1 мА (1200 В) ≤0,1 мА (1200 В) ≤0,1 мА (1500 В)
КТ8115А **КТ8115Б** **КТ8115В**	p-n-p p-n-p p-n-p	65* Вт 65* Вт 65* Вт	≥4 ≥4 ≥4	100 80 60	5 5 5	8 (16*) А 8 (16*) А 8 (16*) А	≤0,2 мА (100 В) ≤0,2 мА (80 В) ≤0,2 мА (60 В)
КТ8116А **КТ8116Б** **КТ8116В**	n-p-n n-p-n n-p-n	65* Вт 65* Вт 65* Вт	≥4 ≥4 ≥4	100 80 60	5 5 5	8 А (16* А) 8 А (16* А) 8 А (16* А)	≤200 (100 В) ≤200 (80 В) ≤200 (60 В)
КТ8117А **КТ8117Б**	n-p-n n-p-n	100* Вт 100* Вт	≥5 ≥5	700 500	8 8	10 (20*) А 10 (20*) А	≤1 мА (400 В) ≤1 мА (400 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_{k}, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_{ш}$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
750...18000 (3 В; 10 А) 750...18000 (3 В; 10 А) 750...18000 (3 В; 10 А)	≤400 ≤400 ≤400	≤0,2 ≤0,2 ≤0,2	— — —	4,5* мкс 4,5* мкс 4,5* мкс	**КТ8111-9**
≥300 (5 В; 0,05 А)	—	≤40	—	—	**КТ8112**
15...75* (4 В; 3 А) 15...75* (4 В; 3 А) 15...75* (4 В; 3 А)	— — —	≤0,27 ≤0,27 ≤0,27	— — —	— — —	**КТ8113**
8...40* (5 В; 0,7 А) ≥6* (5 В; 0,03 А) ≥6* (5 В; 0,03 А) 8...40* (5 В; 0,7 А)	— — — —	≤0,25 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,25	— — — —	$t_{сп}$=0,5 мкс $t_{сп}$=0,5 мкс $t_{сп}$=0,5 мкс $t_{сп}$=0,5 мкс	**КТ8114**
≥1000* (3 В; 0,5...3 А) ≥1000* (3 В; 0,5...3 А) ≥1000* (3 В; 0,5...3 А)	— — —	≤0,7 ≤0,7 ≤0,7	— — —	— — —	**КТ8115**
≥1000* (3 В; 0,5 А) ≥1000* (3 В; 0,5 А) ≥1000* (3 В; 0,5 А)	— — —	≤0,7 ≤0,7 ≤0,7	— — —	— — —	**КТ8116**
≥10* (5 В; 5 А) ≥10* (5 В; 5 А)	— —	≤0,3 ≤0,3	— —	≤1,7* мкс ≤1,7* мкс	**КТ8117**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ8118А	n-p-n	50* Вт	≥15	900	5	3 А (10* А)	≤10 (800 В)
КТ812А	n-p-n	50* Вт (50°С)	≥3	400* (0,01к)	7	8 А; 12* А	≤5* мА (700 В)
КТ812Б	n-p-n	50* Вт (50°С)	≥3	300* (0,01к)	7	8 А; 12* А	≤5* мА (500 В)
КТ812В	n-p-n	50* Вт (50°С)	≥3	200* (0,01к)	7	8 А; 12* А	≤5* мА (300 В)
КТ8120А	n-p-n	60* Вт	≥20	600; 450**	5	8 А (16* А)	≤100 (450 В)
КТ8121А	n-p-n	75* Вт	≥7	1500; 700*; 400**	5	8 А (10* А)	≤2000 (700 В)
КТ8121Б	n-p-n	75* Вт	≥7	1500; 600*; 400**	5	8 А (10* А)	≤2000 (600 В)
КТ8121А-1	n-p-n	75* Вт	≥7	1500; 700*	5	8 А (10* А)	≤2000 (700 В)
КТ8121Б-1	n-p-n	75* Вт	≥7	1500; 600*	5	8 А (10* А)	≤2000 (600 В)
КТ8121А-2	n-p-n	75* Вт	≥7	1500; 700*	5	8 А (10* А)	≤2000 (700 В)
КТ8121Б-2	n-p-n	75* Вт	≥7	1500; 600*	5	8 А (10* А)	≤2000 (600 В)
КТ8123А	n-p-n	25* Вт	≥5	200	5	2 А (3* А)	≤50 (150 В)
КТ8124А	n-p-n	60* Вт	≥10	400	5	7 А (15* А)	—
КТ8124Б	n-p-n	60* Вт	≥10	400	5	7 А (15* А)	—
КТ8124В	n-p-n	60* Вт	≥10	330	5	7 А (15* А)	—
КТ8125А	n-p-n	65* Вт	≥3	100	5	6 (10*) А	≤0,4 мА (100 В)
КТ8125Б	n-p-n	65* Вт	≥3	80	5	6 (10*) А	≤0,4 мА (80 В)
КТ8125В	n-p-n	65* Вт	≥3	60	5	6 (10*) А	≤0,4 мА (60 В)
КТ8126А1	n-p-n	80* Вт	≥4	700; 400**	9	8 (16*) А	≤1 мА (700 В)
КТ8126Б1	n-p-n	80* Вт	≥4	600; 300**	9	8 (16*) А	≤1 мА (600 В)
КТ8127А	n-p-n	56* Вт	—	1500* (100 Ом)	5	5 (7,5*) А	≤0,9 мА (1500* В)
КТ8127Б	n-p-n	56* Вт	—	1200* (100 Ом)	5	5 (7,5*) А	≤0,6 мА (1800* В)
КТ8127В	n-p-n	56* Вт	—	1500* (100 Ом)	5	5 (7,5*) А	≤0,9 мА (1500* В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
10...40* (5 В; 0,2 А)	—	≤1,3	—	≤2,5* мкс	КТ8118
≥4* (2,5 В; 8 А) ≥4* (2,5 В; 8 А) ≥10* (5 В; 5 А)	≤100 (100 В) ≤100 (100 В) ≤100 (100 В)	≤0,3 ≤0,3 ≤0,3	— — —	$t_{сп}$≤1,3 мкс $t_{сп}$≤1,3 мкс $t_{сп}$≤1,3 мкс	КТ812
≥10* (5 В; 0,2 А)	—	≤0,25	—	≤2* мкс	КТ8120, КТ8121, КТ8121-1
8...60* (5 В; 2 А) 8...60* (5 В; 2 А)	— —	≤0,25 ≤0,75	— —	≤3* мкс ≤3* мкс	
8...60* (5 В; 2 А) 8...60* (5 В; 2 А)	— —	≤0,25 ≤0,75	— —	≤3* мкс ≤3* мкс	
8...60* (5 В; 2 А) 8...60* (5 В; 2 А)	— —	≤0,25 ≤0,75	— —	≤3* мкс ≤3* мкс	КТ8121-2
≥40* (10 В; 0,4 А)	—	≤2	—	—	КТ8123, КТ8124
≥10* (5 В; 5 А) ≥10* (5 В; 5 А) ≥10* (5 В; 5 А)	— — —	≤0,2 ≤0,17 ≤0,2	— — —	≤1,5* мкс ≤1,3* мкс ≤1,5* мкс	
15...75* (4 В; 3 А) 15...75* (4 В; 3 А) 15...75* (4 В; 3 А)	— — —	≤0,25 ≤0,25 ≤0,25	— — —	— — —	КТ8125, КТ8126
8...60* (5 В; 2 А) 8...60* (5 В; 2 А)	— —	≤0,5 ≤0,5	— —	1,7* мкс 1,7* мкс	
35* (5 В; 0,5 А) 35* (5 В; 0,5 А) 35* (5 В; 0,5 А)	— — —	≤0,22 ≤1,1 ≤1,1	— — —	$t_{сп}$=0,7 мкс $t_{сп}$=0,7 мкс $t_{сп}$=0,7 мкс	КТ8127

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ8127А-1 **КТ8127Б-1** **КТ8127В-1**	n-p-n n-p-n n-p-n	56* Вт 56* Вт 56* Вт	— — —	1500* (100 Ом) 1200* (100 Ом) 1500* (100 Ом)	5 5 5	5 (7,5*) А 5 (7,5*) А 5 (7,5*) А	≤0,9 мА (1500* В) ≤0,6 мА (1800* В) ≤0,9 мА (1500* В)
КТ8129А	n-p-n	60* Вт	≥4	1500	5	5 А	—
КТ8130А **КТ8130Б** **КТ8130В**	p-n-p p-n-p p-n-p	1 Вт; 20* Вт 1 Вт; 20* Вт 1 Вт; 20* Вт	≥25 ≥25 ≥25	40 60 80	5 5 5	4 А; 8* А 4 А; 8* А 4 А; 8* А	≤100 (40 В) ≤100 (60 В) ≤100 (80 В)
КТ8131А **КТ8131Б** **КТ8131В**	n-p-n n-p-n n-p-n	1 Вт; 20* Вт 1 Вт; 20* Вт 1 Вт; 20* Вт	≥25 ≥25 ≥25	40 60 80	5 5 5	4 А; 8* А 4 А; 8* А 4 А; 8* А	≤100 (40 В) ≤100 (60 В) ≤100 (80 В)
КТ8133А **КТ8133Б**	n-p-n n-p-n	60* Вт 60* Вт	≥30 ≥30	240 160	5 5	8 А 8 А	— —
КТ8134А	p-n-p	25* Вт	≥3	20	—	4 А	—
КТ8135А	n-p-n	25* Вт	≥3	20	—	4 А	—
КТ8136А	n-p-n	60* Вт	—	600	5	10 А (15 А*)	—
КТ8136А-1 с демпферным диодом между коллектором и эмиттером	n-p-n	60* Вт	—	600	5	10 А (15 А*)	—
КТ8137А	n-p-n	40* Вт	≥4	700*	9	1,5 А (3 А*)	≤1 мА (700 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≤35* (5 В; 0,5 А) ≤6* (5 В; 0,03 А) ≤6* (5 В; 0,03 А)	— — —	≤0,22 ≤1,1 ≤1,1	— — —	$t_{сп}$=0,7 мкс $t_{сп}$=0,7 мкс $t_{сп}$=0,7 мкс	**КТ8127-1**
≥2,25* (5 В; 4,5 А)	—	≤1,1	—	—	**КТ8129**
750...15000* (3 В; 0,2 А) 750...15000* (3 В; 0,2 А) 750...15000* (3 В; 0,2 А)	≤200 (10 В) ≤200 (10 В) ≤200 (10 В)	≤1 ≤1 ≤1	— — —	— — —	**КТ8130, КТ8131**
750...15000* (3 В; 0,2 А) 750...15000* (3 В; 0,2 А) 750...15000* (3 В; 0,2 А)	≤100 (10 В) ≤100 (10 В) ≤100 (10 В)	≤1 ≤1 ≤1	— — —	— — —	
300...3000 300...3000	— —	≤0,6 ≤0,6	— —	— —	**КТ8133**
40...250	—	≤0,8	—	—	**КТ8134, КТ8135**
40...250	—	≤0,8	—	—	
10...50* (5 В; 0,8 А)	—	≤0,25	—	$t_{сп}$≤0,2 мкс	**КТ8136, КТ8136-1**
10...50* (5 В; 0,8 А)	—	≤0,25	—	$t_{сп}$≤0,2 мкс	
8...40* (2 В; 0,5 А)	—	≤2	—	≤4* мкс	**КТ8137**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ8138А	n-p-n	50* Вт	20	500; 400**	7	7 А; 14* А	≤0,01 мА (500 В)
КТ8138Б	n-p-n	40* Вт	—	450 400**	10	7 А; 14* А	≤0,1 мА (450 В)
КТ8138В	n-p-n	75* Вт	≥4	700; 400**	9	4 А; 8* А	≤1 мА (700 В)
КТ8138Г	n-p-n	80* Вт	≥4	700; 400**	9	8 А; 16* А	≤1 мА (700 В)
КТ8138Д	n-p-n	60* Вт	≥10	400; 200**	6	7 А; 14* А	≤1 мА (400 В)
КТ8138Е	n-p-n, с диодом	60* Вт	≥10	400; 200**	6	7 А; 14* А	≤1 мА (400 В)
КТ8138Ж	n-p-n	60* Вт	≥10	600; 350**	6	10 А; 16* А	≤1 мА (600 В)
КТ8138И	n-p-n, с диодом	80* Вт	≥4	700; 400**	9	8 А; 16* А	≤1 мА (700 В)
КТ8140А	n-p-n	60* Вт	≥10	400	6	7 А (10 А*)	≤1 (400 В)
КТ8140А-1	n-p-n	60* Вт	≥10	400	6	7 А (10 А*)	≤1 (400 В)
с демпферным диодом между коллектором и эмиттером							
КТ8141А	n-p-n	60* Вт	≥7	100	—	8 А (12* А)	≤0,2 (100 В)
КТ8141Б	n-p-n	60* Вт	≥7	80	—	8 А (12* А)	≤0,2 (80 В)
КТ8141В	n-p-n	60* Вт	≥7	60	—	8 А (12* А)	≤0,2 (60 В)
КТ8141Г	n-p-n	60* Вт	≥7	45	—	8 А (12* А)	≤0,2 (45 В)
КТ814А	p-n-p	1 (10*) Вт	≥3	40* (0,1к)	5	1,5 (3*) А	≤0,05 мА (40 В)
КТ814Б	p-n-p	10* Вт	≥3	50* (0,1к)	5	1,5 (3*) А	≤0,05 мА (40 В)
КТ814В	p-n-p	10* Вт	≥3	70* (0,1к)	5	1,5 (3*) А	≤0,05 мА (40 В)
КТ814Г	p-n-p	10* Вт	≥3	100* (0,1к)	5	1,5 (3*) А	≤0,05 мА (40 В)
КТ8143А	n-p-n	175* Вт	—	120; 90**	6	25 А; 40* А	≤5* мА (90 В)
КТ8143Б	n-p-n	175* Вт	—	120**	6	25 А; 40* А	≤5* мА (120 В)
КТ8143В	n-p-n	175* Вт	—	180**	6	25 А; 40* А	≤5* мА (180 В)
КТ8143Г	n-p-n	175* Вт	—	400; 240**	6	25 А; 40* А	≤5* мА (400 В)
КТ8143Д	n-p-n	175* Вт	—	90**	6	32 А; 50* А	≤5* мА (90 В)
КТ8143Е	n-p-n	175* Вт	—	120**	6	32 А; 50* А	≤5* мА (120 В)
КТ8143Ж	n-p-n	175* Вт	—	180**	6	32 А; 50* А	≤5* мА (180 В)
КТ8143З	n-p-n	175* Вт	—	400; 240**	6	32 А; 50* А	≤5* мА (400 В)
КТ8143И	n-p-n	175* Вт	—	120; 90**	6	40 А; 63* А	≤5* мА (90 В)
КТ8143К	n-p-n	175* Вт	—	120**	6	40 А; 63* А	≤5* мА (120 В)
КТ8143Л	n-p-n	175* Вт	—	180**	6	40 А; 63* А	≤5* мА (180 В)
КТ8143М	n-p-n	175* Вт	—	400; 240**	6	40 А; 63* А	≤5* мА (400 В)
КТ8143Н	n-p-n	175* Вт	—	100**	6	50 А; 125* А	≤5* мА (100 В)
КТ8143П	n-p-n	175* Вт	—	150**	6	50 А; 125* А	≤5* мА (150 В)
КТ8143Р	n-p-n	175* Вт	—	400; 200**	6	50 А; 125* А	≤5* мА (400 В)
КТ8143С	n-p-n	175* Вт	—	90**	6	63 А; 150* А	≤5* мА (90 В)
КТ8143Т	n-p-n	175* Вт	—	120**	6	63 А; 150* А	≤5* мА (120 В)
КТ8143У	n-p-n	175* Вт	—	180**	6	63 А; 150* А	≤5* мА (180 В)
КТ8143Ф	n-p-n	175* Вт	—	400; 240**	6	63 А; 150* А	≤5* мА (400 В)
КТ8144А	n-p-n	175* Вт	≥5	800	8	25 А (40* А)	1 мА (800 В)
КТ8144Б	n-p-n	175* Вт	≥5	600	8	25 А (40* А)	1 мА (600 В)
КТ8145А	n-p-n	100* Вт	≥10	700	8	15 А (20* А)	≤5 мА (700 В)
КТ8145Б	n-p-n	100* Вт	≥10	500	8	15 А (20* А)	≤5 мА (500 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^{*}_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$τ_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥10* (5 В; 4 А)	—	≤0,2	—	≤2,5* мкс	**КТ8138**
≥10* (5 В; 4 А)	—	≤0,2	—	≤2,5* мкс	
8...40* (5 В; 2 А)	—	≤0,25	—	≤4* мкс	
5...30* (5 В; 5 А)	—	≤0,4	—	≤3* мкс	
≥10* (5 В; 5 А)	—	≤0,2	—	$t_{сп}$ ≤ 0,75 мкс	
≥10* (5 В; 5 А)	—	≤0,2	—	$t_{сп}$ ≤ 0,75 мкс	
≥20* (5 В; 2 А)	—	≤0,4	—	$t_{сп}$ ≤ 0,7 мкс	
5...30* (5 В; 5 А)	—	≤0,25	—	≤3* мкс	
≥10* (5 В; 5 А)	—	≤0,2	—	—	**КТ8140, КТ8141**
≥10* (5 В; 5 А)	—	≤0,2	—	—	
≥750* (3 В; 3 А)	≤120 (5 В)	≤0,66	—	5,8** мкс	
≥750* (3 В; 3 А)	≤120 (5 В)	≤0,66	—	5,8** мкс	
≥750* (3 В; 3 А)	≤120 (5 В)	≤0,66	—	5,8** мкс	
≥750* (3 В; 3 А)	≤120 (5 В)	≤0,66	—	5,8** мкс	
≥40* (2 В; 0,15 А)	≤60 (5 В)	≤1,2	—	—	**КТ814**
≥40* (2 В; 0,15 А)	≤60 (5 В)	≤1,2	—	—	
≥40* (2 В; 0,15 А)	≤60 (5 В)	≤1,2	—	—	
≥30* (2 В; 0,15 А)	≤60 (5 В)	≤1,2	—	—	
≥15* (3 В; 20 А)	—	≤0,08	—	1300*	**КТ8143**
≥15* (3 В; 20 А)	—	≤0,08	—	1300*	
≥15* (3 В; 20 А)	—	≤0,08	—	1300*	
≥15* (3 В; 20 А)	—	≤0,08	—	1300*	
≥15* (3 В; 20 А)	—	≤0,08	—	1300*	
≥15* (3 В; 32 А)	—	≤0,08	—	1300*	
≥15* (3 В; 32 А)	—	≤0,08	—	1300*	
≥15* (3 В; 32 А)	—	≤0,08	—	1300*	
≥15* (3 В; 32 А)	—	≤0,08	—	1300*	
≥15* (3 В; 32 А)	—	≤0,08	—	1300*	
≥15* (3 В; 35 А)	—	≤0,08	—	1300*	
≥15* (3 В; 35 А)	—	≤0,08	—	1300*	
≥15* (3 В; 35 А)	—	≤0,08	—	1300*	
≥15* (3 В; 35 А)	—	≤0,08	—	1300*	
≥15* (3 В; 35 А)	—	≤0,08	—	1300*	
≥15* (3 В; 35 А)	—	≤0,08	—	1300*	
≥15* (3 В; 40 А)	—	≤0,08	—	1700*	
≥15* (3 В; 40 А)	—	≤0,08	—	1700*	
≥15* (3 В; 40 А)	—	≤0,08	—	1700*	
≥4* (5 В; 20 А)	—	≤0,25	—	≤2,5* мкс	**КТ8144**
≥4* (5 В; 20 А)	—	≤0,25	—	≤2,5* мкс	
≥10* (1 В; 5 А)	—	≤0,2	—	1,7* мкс	**КТ8145**
≥10* (1 В; 5 А)	—	≤0,2	—	1,7* мкс	

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^*_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^*_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ8146А **КТ8146Б**	n-p-n n-p-n	150* Вт 150* Вт	≥5 ≥5	800 600	8 8	15 А (25* А) 15 А (25* А)	≤1 мА (800 В) ≤1 мА (600 В)
КТ8147А **КТ8147Б**	n-p-n n-p-n	100* Вт 100* Вт	≥5 ≥5	700 500	8 8	10 А (20* А) 10 А (20* А)	≤1 мА (700 В) ≤1 мА (500 В)
КТ8149А	p-n-p	115* Вт	≥4	70; 60**	7	15 А; 30* А	≤1 мА (70 В)
КТ8149А-1	p-n-p	90* Вт	≥3	70; 60**	7	15 А; 30* А	≤1 мА (70 В)
КТ8149А-2	p-n-p	75* Вт	≥3	70; 60**	7	10 А; 15* А	≤1 мА (70 В)
КТ8150А	n-p-n	115* Вт	≥4	70; 60**	7	15 А; 30* А	≤1 мА (70 В)
КТ8150А-1	n-p-n	90* Вт	≥3	70; 60**	7	15 А; 30* А	≤1 мА (70 В)
КТ8150А-2	n-p-n	75* Вт	≥3	70; 60**	7	10 А; 15* А	≤1 мА (70 В)
КТ8154А **КТ8154Б**	n-p-n n-p-n	175* Вт 175* Вт	≥5 ≥5	600; 450** 500; 400**	8 8	30 А; 60* А 30 А; 60* А	≤1 мА (600 В) ≤1 мА (500 В)
КТ8155А **КТ8155Б**	n-p-n n-p-n	175* Вт 175* Вт	≥5 ≥5	600; 450** 500; 400**	8 8	50 А; 80* А 50 А; 80* А	≤2 мА (600 В) ≤2 мА (500 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥5* (5 В; 15 А) ≥5* (5 В; 15 А)	— —	≤0,15 ≤0,15	— —	1,7* мкс 1,7* мкс	**КТ8146, КТ8147, КТ8149**
≥5* (1,5 В; 8 А) ≥5* (1,5 В; 8 А)	— —	≤0,2 ≤0,2	— —	1,7* мкс 1,7* мкс	
20...150* (4 В; 4 А)	—	≤0,27	—	—	
20...150* (4 В; 4 А)	—	≤0,27	—	—	**КТ8149-1**
20...100* (4 В; 4 А)	—	≤0,27	—	—	**КТ8149-2**
20...150* (4 В; 4 А)	—	≤0,27	—	—	**КТ8150**
20...150* (4 В; 4 А)	—	≤0,27	—	—	**КТ8150-1**
20...100* (4 В; 4 А)	—	≤0,27	—	—	**КТ8150-2**
— —	— —	— —	— —	1700* 1700*	**КТ8154, КТ8155**
— —	— —	— —	— —	— —	

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ8156А	n-p-n	60* Вт	—	330; 150**	6	8 А	—
КТ8156Б	n-p-n	60* Вт	—	200**	6	8 А	—
КТ8157А	n-p-n	150* Вт	≥5	1500	7	10 А (15* А)	3 мА (1500 В)
КТ8157Б	n-p-n	150* Вт	≥5	1500	7	10 А (15* А)	3 мА (1500 В)
КТ8158А	n-p-n	125* Вт	—	60	5	12 А	≤400 (60 В)
КТ8158Б	n-p-n	125* Вт	—	80	5	12 А	≤400 (80 В)
КТ8158В	n-p-n	125* Вт	—	100	5	12 А	≤400 (100 В)
КТ8159А	p-n-p	125* Вт	—	60	5	12 А	≤400 (60 В)
КТ8159Б	p-n-p	125* Вт	—	80	5	12 А	≤400 (80 В)
КТ8159В	p-n-p	125* Вт	—	100	5	12 А	≤400 (100 В)
КТ815А	n-p-n	10* Вт	≥3	40* (0,1к)	5	1,5 (3*) А	≤0,05 мА (40 В)
КТ815Б	n-p-n	10* Вт	≥3	50* (0,1к)	5	1,5 (3*) А	≤0,05 мА (40 В)
КТ815В	n-p-n	10* Вт	≥3	70* (0,1к)	5	1,5 (3*) А	≤0,05 мА (40 В)
КТ815Г	n-p-n	10* Вт	≥3	100* (0,1к)	5	1,5 (3*) А	≤0,05 мА (40 В)
КТ8163А	n-p-n	50* Вт	≥10	600	5	7 А; 10* А	≤100 (600 В)
КТ8164А	n-p-n	75* Вт	≥4	700	9	4 А	≤10 мА (700 В)
КТ8164Б	n-p-n	75* Вт	≥4	600	9	4 А	≤10 мА (600 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
— —	— —	— —	— —	— —	**КТ8156**
≥8* (5 В; 1 А) ≥8* (5 В; 1 А)	— —	≤0,12 ≤0,25	— —	2* мкс 2* мкс	**КТ8157**
2500 2500 2500	— — —	— — —	— — —	— — —	**КТ8158**
2500 2500 2500	— — —	— — —	— — —	— — —	**КТ8159**
≥40* (2 В; 0,15 А) ≥40* (2 В; 0,15 А) ≥40* (2 В; 0,15 А) ≥30* (2 В; 0,15 А)	≤60 (5 В) ≤60 (5 В) ≤60 (5 В) ≤60 (5 В)	≤1,2 ≤1,2 ≤1,2 ≤1,2	— — — —	— — — —	**КТ815**
10...30 (2 В; 1 А) 10...60* 10...60*	≤100 (10 В) — —	≤0,05 — —	— — —	≤1,5* мкс — —	**КТ8163, КТ8164**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ816А	p-n-p	25* Вт	≥3	40* (1к)	5	3 (6*) А	≤0,1 мА (25 В)
КТ816Б	p-n-p	25* Вт	≥3	45* (1к)	5	3 (6*) А	≤0,1 мА (45 В)
КТ816В	p-n-p	25* Вт	≥3	60* (1к)	5	3 (6*) А	≤0,1 мА (60 В)
КТ816Г	p-n-p	25* Вт	≥3	100* (1к)	5	3 (6*) А	≤0,1 мА (100 В)
КТ816А-2	p-n-p	25* Вт	≥3	40* (1к)	5	3 А (6* А)	≤100 (25 В)
КТ8165А	p-n-p	3 Вт; 50* Вт	≥20	90	5	10 (15*) А	≤3 мА (90 В)
КТ8165Б	p-n-p	3 Вт; 50* Вт	≥20	70	5	10 (15*) А	≤3 мА (70 В)
КТ8165В	p-n-p	3 Вт; 50* Вт	≥20	50	5	10 (15*) А	≤3 мА (50 В)
КТ8165Г	p-n-p	3 Вт; 50* Вт	≥20	90	5	10 (15*) А	≤3 мА (90 В)
КТ8166А	n-p-n	50 Вт	≥20	90	5	10 А (15* А)	≤3 мА (90 В)
КТ8166Б	n-p-n	50 Вт	≥20	70	5	10 А (15* А)	≤3 мА (70 В)
КТ8166В	n-p-n	50 Вт	≥20	50	5	10 А (15* А)	≤3 мА (50 В)
КТ8166Г	n-p-n	50 Вт	≥20	90	5	10 А (15* А)	≤3 мА (90 В)
КТ8167А	p-n-p	0,8 Вт; 10* Вт	≥30	100* (1к)	4,5	2 (4*) А	≤200 (100 В)
КТ8167Б	p-n-p	0,8 Вт; 10* Вт	≥30	80* (1к)	4,5	2 (4*) А	≤200 (80 В)
КТ8167В	p-n-p	0,8 Вт; 10* Вт	≥30	50* (1к)	4,5	2 (4*) А	≤200 (50 В)
КТ8167Г	p-n-p	0,8 Вт; 10* Вт	≥30	100* (1к)	4,5	2 (4*) А	≤200 (100 В)
КТ8167Д	p-n-p	0,8 Вт; 10* Вт	≥30	80* (1к)	4,5	2 (4*) А	≤200 (80 В)
КТ8168А	n-p-n	0,8 Вт; 10* Вт	≥30	100* (1к)	4,5	2 (4*) А	≤200 (100 В)
КТ8168Б	n-p-n	0,8 Вт; 10* Вт	≥30	80* (1к)	4,5	2 (4*) А	≤200 (80 В)
КТ8168В	n-p-n	0,8 Вт; 10* Вт	≥30	50* (1к)	4,5	2 (4*) А	≤200 (50 В)
КТ8168Г	n-p-n	0,8 Вт; 10* Вт	≥30	100* (1к)	4,5	2 (4*) А	≤200 (100 В)
КТ8168Д	n-p-n	0,8 Вт; 10* Вт	≥30	80* (1к)	4,5	2 (4*) А	≤200 (80 В)
КТ8170А-1	n-p-n	40* Вт	≥4	700	9	1,5 А	≤1 мА (700 В)
КТ8170Б-1	n-p-n	40* Вт	≥4	600	9	1,5 А	≤1 мА (600 В)
КТ8171А	n-p-n	100* Вт	—	350**	—	20 А	—
КТ8175А	n-p-n	20* Вт	—	700*; 400**	9	1,5 (3*) А	—
КТ8175Б	n-p-n	20* Вт	—	600*; 300**	9	1,5 (3*) А	—

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥25* (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	**КТ816, КТ816-2,**
≥25* (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	
≥25* (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	
≥25* (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	
≥200* (1 В; 0,03 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	
80...250 (5 В; 5 А)	≤1300 (10 В)	≤0,1	—	≤1000**	**КТ8165, КТ8166**
80...250 (5 В; 5 А)	≤1300 (10 В)	≤0,1	—	≤1000**	
80...250 (5 В; 5 А)	≤1300 (10 В)	≤0,1	—	≤1000**	
40...160 (5 В; 5 А)	≤1300 (10 В)	≤0,1	—	≤1000**	
80...250 (5 В; 5 А)	≤1300 (10 В)	≤0,1	—	≤1000**	
80...250 (5 В; 5 А)	≤1300 (10 В)	≤0,1	—	≤1000**	
80...250 (5 В; 5 А)	≤1300 (10 В)	≤0,1	—	≤1000**	
40...160 (5 В; 5 А)	≤1300 (10 В)	≤0,1	—	≤1000**	
80...250 (1 В; 1 А)	≤400 (5 В)	≤0,35	—	≤1,8* мкс	**КТ8167**
80...250 (1 В; 1 А)	≤400 (5 В)	≤0,35	—	≤1,8* мкс	
80...250 (1 В; 1 А)	≤400 (5 В)	≤0,35	—	≤1,8* мкс	
40...160 (1 В; 1 А)	≤400 (5 В)	≤0,35	—	≤1,8* мкс	
160...350 (1 В; 1 А)	≤400 (5 В)	≤0,35	—	≤1,8* мкс	
≥80...250 (1 В; 1 А)	≤400 (5 В)	≤0,35	—	≤1,8* мкс	**КТ8168**
≥80...250 (1 В; 1 А)	≤400 (5 В)	≤0,35	—	≤1,8* мкс	
≥80...250 (1 В; 1 А)	≤400 (5 В)	≤0,35	—	≤1,8* мкс	
≥40...160 (1 В; 1 А)	≤400 (5 В)	≤0,35	—	≤1,8* мкс	
≥160...350 (1 В; 1 А)	≤400 (5 В)	≤0,35	—	≤1,8* мкс	
5...25* (2 В; 1 А)	—	—	—	—	**КТ8170-1**
5...25* (2 В; 1 А)	—	—	—	—	
≥10000	—	—	—	—	**КТ8171**
8...40 (2 В; 1 А)	—	≤1	—	3000*	**КТ8175**
8...40 (2 В; 1 А)	—	≤1	—	3000*	

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ8175А-1	n-p-n	20* Вт	—	700*; 400**	9	1,5 (3*) А	—
КТ8175Б-1	n-p-n	20* Вт	—	600*; 300**	9	1,5 (3*) А	—
КТ8176А	n-p-n	40* Вт	≥3	60	5	3 А	—
КТ8176Б	n-p-n	40* Вт	≥3	80	5	3 А	—
КТ8176В	n-p-n	40* Вт	≥3	100	5	3 А	—
КТ8177А	p-n-p	40* Вт	≥3	60	5	3 А	—
КТ8177Б	p-n-p	40* Вт	≥3	80	5	3 А	—
КТ8177В	p-n-p	40* Вт	≥3	100	5	3 А	—
КТ817А	n-p-n	25* Вт	≥3	40* (1к)	5	3 (6*) А	≤0,1 мА (25 В)
КТ817Б	n-p-n	25* Вт	≥3	45* (1к)	5	3 (6*) А	≤0,1 мА (45 В)
КТ817В	n-p-n	25* Вт	≥3	60* (1к)	5	3 (6*) А	≤0,1 мА (60 В)
КТ817Г	n-p-n	25* Вт	≥3	100* (1к)	5	3 (6*) А	≤0,1 мА (100 В)
КТ817Б-2	n-p-n	25* Вт	≥3	45* (1к)	5	3 (6*) А	≤0,1 мА (40 В)
КТ817Г-2	n-p-n	25* Вт	≥3	100* (1к)	5	3 (6*) А	≤0,1 мА (40 В)
КТ8181А	n-p-n	50* Вт	—	700*; 400**	9	4 (8*) А	—
КТ8181Б	n-p-n	50* Вт	—	600*; 300**	9	4 (8*) А	—
КТ8182А	n-p-n	60* Вт	—	700*; 400**	9	8 (16*) А	—
КТ8182Б	n-p-n	60* Вт	—	600*; 300**	9	8 (16*) А	—
КТ8183А	n-p-n с диодом и резистором	56* Вт	—	1500; 700**	—	8 А; 15* А	—
КТ8183Б	n-p-n с диодом и резистором	56* Вт	—	1200; 600**	—	8 А; 15* А	—
КТ8183А-1	n-p-n с диодом и резистором	56* Вт	—	1500; 700**	—	8 А; 15* А	—
КТ8183Б-1	n-p-n с диодом и резистором	56* Вт	—	1200; 600**	—	8 А; 15* А	—
КТ8183А-2	n-p-n с диодом и резистором	56* Вт	—	1500; 700**	—	8 А; 15* А	—
КТ8183Б-2	n-p-n с диодом и резистором	56* Вт	—	1200; 600**	—	8 А; 15* А	—

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	C_k, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^*_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^*_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
8...40 (2 В; 1 А)	—	≤1	—	3000*	КТ8175-1
8...40 (2 В; 1 А)	—	≤1	—	3000*	
≥25* (4 В; 1 А)	—	—	—	—	КТ8176, КТ8177
≥25* (4 В; 1 А)	—	—	—	—	
≥25* (4 В; 1 А)	—	—	—	—	
≥25* (4 В; 1 А)	—	—	—	—	
≥25* (4 В; 1 А)	—	—	—	—	
≥25* (4 В; 1 А)	—	—	—	—	
≥25* (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	КТ817, КТ817-2
≥25* (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	
≥25* (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	
≥25* (2 В; 1 А)	≤60 (10 В)	≤0,6	—	—	
≥100* (5 В; 50 мА)	≤60 (10 В)	≤0,08	—	—	
≥100* (5 В; 50 мА)	≤60 (10 В)	≤0,08	—	—	
10...60* (5 В; 1 А)	—	≤0,25	—	3000*	КТ8181, КТ8182
10...60* (5 В; 1 А)	—	≤0,25	—	3000*	
8...40* (5 В; 2 А)	—	≤0,4	—	3000*	
8...40* (5 В; 2 А)	—	≤0,4	—	3000*	
≥5* (5 В; 3 А)	—	≤0,17	—	3000*	КТ8183
≥5* (5 В; 3 А)	—	≤0,17	—	3000*	
≥5* (5 В; 3 А)	—	≤0,17	—	3000*	КТ8183-1
≥5* (5 В; 3 А)	—	≤0,17	—	3000*	
≥5* (5 В; 3 А)	—	≤0,17	—	3000*	КТ8183-2 с изолированными выводами
≥5* (5 В; 3 А)	—	≤0,17	—	3000*	

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ818А	p-n-p	60* Вт	≥3	40* (0,1к)	5	10 (15*) А	≤1 мА (40 В)
КТ818Б	p-n-p	60* Вт	≥3	50* (0,1к)	5	10 (15*) А	≤1 мА (40 В)
КТ818В	p-n-p	60* Вт	≥3	70* (0,1к)	5	10 (15*) А	≤1 мА (40 В)
КТ818Г	p-n-p	60* Вт	≥3	90* (0,1к)	5	10 (15*) А	≤1 мА (40 В)
КТ818АМ	p-n-p	100* Вт	≥3	40* (0,1к)	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ818БМ	p-n-p	100* Вт	≥3	50* (0,1к)	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ818ВМ	p-n-p	100* Вт	≥3	70* (0,1к)	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ818ГМ	p-n-p	100* Вт	≥3	90* (0,1к)	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ818А-1	p-n-p	100* Вт	≥3	40* (0,1к)	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ818Б-1	p-n-p	100* Вт	≥3	50* (0,1к)	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ818В-1	p-n-p	100* Вт	≥3	70* (0,1к)	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ818Г-1	p-n-p	100* Вт	≥3	90* (0,1к)	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ8196А	n-p-n	100* Вт	—	350**	—	10 А	—
КТ8197А-2	n-p-n	2** Вт	400	—	—	0,5 А	—
КТ8197Б-2	n-p-n	5** Вт	400	—	—	1 А	—
КТ8197В-2	n-p-n	8** Вт	400	—	—	1,6 А	—
КТ8199А	p-n-p	50* Вт	—	30	5	10 А	≤10 (30 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥15* (5 В; 5 А) ≥20* (5 В; 5 А) ≥15* (5 В; 5 А) ≥12* (5 В; 5 А)	≤1000 (5 В) ≤1000 (5 В) ≤1000 (5 В) ≤1000 (5 В)	≤0,27 ≤0,27 ≤0,27 ≤0,27	— — — —	≤2500** ≤2500** ≤2500** ≤2500**	**КТ818**
≥15* (5 В; 5 А) ≥20* (5 В; 5 А) ≥15* (5 В; 5 А) ≥12* (5 В; 5 А)	≤1000 (5 В) ≤1000 (5 В) ≤1000 (5 В) ≤1000 (5 В)	≤0,27 ≤0,27 ≤0,27 ≤0,27	— — — —	≤2500** ≤2500** ≤2500** ≤2500**	**КТ818М**
≥15* (5 В; 5 А) ≥20* (5 В; 5 А) ≥15* (5 В; 5 А) ≥12* (5 В; 5 А)	≤1000 (5 В) ≤1000 (5 В) ≤1000 (5 В) ≤1000 (5 В)	≤0,4 ≤0,4 ≤0,4 ≤0,4	— — — —	≤2500** ≤2500** ≤2500** ≤2500**	**КТ818-1**
≥400	—	—	—	—	**КТ8196**
— — —	2 15 25	15** (175 МГц) 10** (175 МГц) 80** (175 МГц)	0,5** (175 МГц) 2** (175 МГц) 5** (175 МГц)	— — —	**КТ8197**
85 (1 В; 8 А)	—	≤0,125	—	—	**КТ8199**

Тип прибора	Структура	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ819А	n-p-n	1,5 Вт; 60* Вт	≥3	40* (0,1к)	5	10 (15*) А	≤1 мА (40 В)
КТ819Б	n-p-n	1,5 Вт; 60* Вт	≥3	50* (0,1к)	5	10 (15*) А	≤1 мА (40 В)
КТ819В	n-p-n	1,5 Вт; 60* Вт	≥3	70* (0,1к)	5	10 (15*) А	≤1 мА (40 В)
КТ819Г	n-p-n	1,5 Вт; 60* Вт	≥3	100* (0,1к)	5	10 (15*) А	≤1 мА (40 В)
КТ819АМ	n-p-n	2 Вт; 100* Вт	≥3	40* (0,1к)	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ819БМ	n-p-n	2 Вт; 100* Вт	≥3	50* (0,1к)	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ819ВМ	n-p-n	2 Вт; 100* Вт	≥3	70* (0,1к)	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ819ГМ	n-p-n	2 Вт; 100* Вт	≥3	100* (0,1к)	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ819А-1	n-p-n	2 Вт; 100* Вт	≥3	40* (0,1к)	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ819Б-1	n-p-n	2 Вт; 100* Вт	≥3	50* (0,1к)	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ819В-1	n-p-n	2 Вт; 100* Вт	≥3	70* (0,1к)	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ819Г-1	n-p-n	2 Вт; 100* Вт	≥3	90* (0,1к)	5	15 (20*) А	≤1 мА (40 В)
КТ8201А	n-p-n	20* Вт	—	700; 400**	9	300; 600*	≤10 (30 В)
КТ8203А	n-p-n	20* Вт	4	700; 400**	9	1,5 А; 3 А*	≤10 (30 В)
КТ8205А	n-p-n	75* Вт	—	700; 400**	9	4 А; 8 А*	≤10 (30 В)
КТ8207А	n-p-n	80* Вт	—	700; 400**	9	8 А; 16 А*	≤10 (30 В)
КТ8209А	n-p-n	100* Вт	—	700; 400**	9	12 А; 24 А*	≤10 (30 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_{к}$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_{ш}$, дБ $r'_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥15* (5 В; 5 А) ≥20* (5 В; 5 А) ≥15* (5 В; 5 А) ≥12* (5 В; 5 А)	— — — —	≤0,4 ≤0,4 ≤0,4 ≤0,4	— — — —	≤2500** ≤2500** ≤2500** ≤2500**	КТ819
≥15* (5 В; 5 А) ≥20* (5 В; 5 А) ≥15* (5 В; 5 А) ≥12* (5 В; 5 А)	— — — —	≤0,4 ≤0,4 ≤0,4 ≤0,4	— — — —	≤2500** ≤2500** ≤2500** ≤2500**	КТ819М
≥15* (5 В; 5 А) ≥20* (5 В; 5 А) ≥15* (5 В; 5 А) ≥12* (5 В; 5 А)	— — — —	≤1 ≤1 ≤1 ≤1	— — — —	≤2500** ≤2500** ≤2500** ≤2500**	КТ819-1
5...40 (2 В; 0,2 А)	—	≤5	≤0,3; ≤2*	—	КТ8201
5...25 (2 В; 1 А)	—	≤1	≤0,7; ≤4*	—	КТ8203
8...40 (5 В; 2 А)	—	≤0,25	≤0,9; ≤4*	—	КТ8205, КТ8207
5...30 (5 В; 5 А)	—	≤0,4	≤0,7; ≤3*	—	
6...30 (5 В; 8 А)	—	≤0,25	≤0,7; ≤3*	—	КТ8209

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ820А-1	p-n-p	10* Вт	≥3	50* (0,1к)	5	0,5 (1,5*) А	≤30 (40 В)
КТ820Б-1	p-n-p	10* Вт	≥3	70* (0,1к)	5	0,5 (1,5*) А	≤30 (40 В)
КТ820В-1	p-n-p	10* Вт	≥3	100* (0,1к)	5	0,5 (1,5*) А	≤30 (40 В)
КТ8212А	n-p-n	65 Вт	≥3	60	5	6 А	≤400* мА (60 В)
КТ8212Б	n-p-n	65 Вт	≥3	80	5	6 А	≤400* мА (80 В)
КТ8212В	n-p-n	65 Вт	≥3	100	5	6 А	≤400* мА (100 В)
КТ8213А	p-n-p	65 Вт	≥3	60	5	6 А	≤400* мА (60 В)
КТ8213Б	p-n-p	65 Вт	≥3	80	5	6 А	≤400* мА (80 В)
КТ8213В	p-n-p	65 Вт	≥3	100	5	6 А	≤400* мА (100 В)
КТ8214А	n-p-n	50 Вт	—	60	5	2 А	≤1000 (60 В)
КТ8214Б	n-p-n	50 Вт	—	80	5	2 А	≤1000 (80 В)
КТ8214В	n-p-n	50 Вт	—	100	5	2 А	≤1000 (100 В)
КТ8215А	p-n-p	50 Вт	—	60	5	2 А	≤1000 (60 В)
КТ8215Б	p-n-p	50 Вт	—	80	5	2 А	≤1000 (80 В)
КТ8215В	p-n-p	50 Вт	—	100	5	2 А	≤1000 (100 В)
КТ8216А	n-p-n	1,75; 40* Вт	≥3	40**	5	10 (15*) А	≤0,2 (40 В)
КТ8216Б	n-p-n	1,75; 40* Вт	≥3	60**	5	10 (15*) А	≤0,2 (60 В)
КТ8216В	n-p-n	1,75; 40* Вт	≥3	80**	5	10 (15*) А	≤0,2 (80 В)
КТ8216Г	n-p-n	1,75; 40* Вт	≥3	100**	5	10 (15*) А	≤0,2 (100 В)
КТ8216А1	n-p-n	1,75; 40* Вт	≥3	40**	5	10 (15*) А	≤0,2 (40 В)
КТ8216Б1	n-p-n	1,75; 40* Вт	≥3	60**	5	10 (15*) А	≤0,2 (60 В)
КТ8216В1	n-p-n	1,75; 40* Вт	≥3	80**	5	10 (15*) А	≤0,2 (80 В)
КТ8216Г1	n-p-n	1,75; 40* Вт	≥3	100**	5	10 (15*) А	≤0,2 (100 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^*_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥40* (2 В; 0,15 А) ≥40* (2 В; 0,15 А) ≥30* (2 В; 0,15 А)	≤65 (5 В) ≤65 (5 В) ≤65 (5 В)	≤1 ≤1 ≤1	— — —	— — —	КТ820-1
15...75 (4 В; 3 А) 15...75 (4 В; 3 А) 15...75 (4 В; 3 А)	— — —	≤0,25 ≤0,25 ≤0,25	— — —	≤0,7** ≤0,7** ≤0,7**	КТ8212
15...75 (4 В; 3 А) 15...75 (4 В; 3 А) 15...75 (4 В; 3 А)	— — —	≤0,25 ≤0,25 ≤0,25	— — —	≤0,7** ≤0,7** ≤0,7**	КТ8213
≥500 (4 В; 2 А) ≥500 (4 В; 2 А) ≥500 (4 В; 2 А)	— — —	≤1,25 ≤1,25 ≤1,25	— — —	≤4,5** ≤4,5** ≤4,5**	КТ8214
≥500 (4 В; 2 А) ≥500 (4 В; 2 А) ≥500 (4 В; 2 А)	— — —	≤1,25 ≤1,25 ≤1,25	— — —	≤4,5** ≤4,5** ≤4,5**	КТ8215
15...275 (4 В; 3 А) 20...275 (4 В; 3 А) 15...275 (4 В; 3 А) 12...275 (4 В; 3 А)	— — — —	≤0,25 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,25	— — — —	— — — —	КТ8216
15...275 (4 В; 3 А) 20...275 (4 В; 3 А) 15...275 (4 В; 3 А) 12...275 (4 В; 3 А)	— — — —	≤0,25 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,25	— — — —	— — — —	КТ8216-1

13 зак. 9

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ8217А	p-n-p	1,75; 40* Вт	≥3	40**	5	10 (15*) А	≤0,2 (40 В)
КТ8217Б	p-n-p	1,75; 40* Вт	≥3	60**	5	10 (15*) А	≤0,2 (60 В)
КТ8217В	p-n-p	1,75; 40* Вт	≥3	80**	5	10 (15*) А	≤0,2 (80 В)
КТ8217Г	p-n-p	1,75; 40* Вт	≥3	100**	5	10 (15*) А	≤0,2 (100 В)
КТ8217А1	p-n-p	1,75; 40* Вт	≥3	40**	5	10 (15*) А	≤0,2 (40 В)
КТ8217Б1	p-n-p	1,75; 40* Вт	≥3	60**	5	10 (15*) А	≤0,2 (60 В)
КТ8217В1	p-n-p	1,75; 40* Вт	≥3	80**	5	10 (15*) А	≤0,2 (80 В)
КТ8217Г1	p-n-p	1,75; 40* Вт	≥3	100**	5	10 (15*) А	≤0,2 (100 В)
КТ821А-1	n-p-n	10* Вт	≥3	50* (0,1к)	5	0,5 (1,5*) А	≤30 (40 В)
КТ821Б-1	n-p-n	10* Вт	≥3	70* (0,1к)	5	0,5 (1,5*) А	≤30 (40 В)
КТ821В-1	n-p-n	10* Вт	≥3	100* (0,1к)	5	0,5 (1,5*) А	≤30 (40 В)
КТ8218А	n-p-n	1,75; 40* Вт	≥25	40	5	4 (8*) А	≤0,1 мА (40 В)
КТ8218Б	n-p-n	1,75; 40* Вт	≥25	60	5	4 (8*) А	≤0,1 мА (60 В)
КТ8218В	n-p-n	1,75; 40* Вт	≥25	80	5	4 (8*) А	≤0,1 мА (80 В)
КТ8218Г	n-p-n	1,75; 40* Вт	≥25	100	5	4 (8*) А	≤0,1 мА (100 В)
КТ8218А1	n-p-n	1,75; 40* Вт	≥25	40	5	4 (8*) А	≤0,1 мА (40 В)
КТ8218Б1	n-p-n	1,75; 40* Вт	≥25	60	5	4 (8*) А	≤0,1 мА (60 В)
КТ8218В1	n-p-n	1,75; 40* Вт	≥25	80	5	4 (8*) А	≤0,1 мА (80 В)
КТ8218Г1	n-p-n	1,75; 40* Вт	≥25	100	5	4 (8*) А	≤0,1 мА (100 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
15...275 (4 В; 3 А)	—	≤0,25	—	—	**КТ8217**
20...275 (4 В; 3 А)	—	≤0,25	—	—	
15...275 (4 В; 3 А)	—	≤0,25	—	—	
12...275 (4 В; 3 А)	—	≤0,25	—	—	
15...275 (4 В; 3 А)	—	≤0,25	—	—	**КТ8217-1**
20...275 (4 В; 3 А)	—	≤0,25	—	—	
15...275 (4 В; 3 А)	—	≤0,25	—	—	
12...275 (4 В; 3 А)	—	≤0,25	—	—	
≥40* (2 В; 0,15 А)	≤40 (5 В)	≤1,2	—	—	**КТ821-1**
≥40* (2 В; 0,15 А)	≤40 (5 В)	≤1,2	—	—	
≥30* (2 В; 0,15 А)	≤40 (5 В)	≤1,2	—	—	
750...15000 (3 В; 2 А)	≤100 (10 В)	≤1	—	—	**КТ8218**
750...15000 (3 В; 2 А)	≤100 (10 В)	≤1	—	—	
750...15000 (3 В; 2 А)	≤100 (10 В)	≤1	—	—	
750...15000 (3 В; 2 А)	≤100 (10 В)	≤1	—	—	
750...15000 (3 В; 2 А)	≤100 (10 В)	≤1	—	—	**КТ8218-1**
750...15000 (3 В; 2 А)	≤100 (10 В)	≤1	—	—	
750...15000 (3 В; 2 А)	≤100 (10 В)	≤1	—	—	
750...15000 (3 В; 2 А)	≤100 (10 В)	≤1	—	—	

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ8219А	p-n-p	1,75; 40* Вт	≥25	40	5	4 (8* А)	≤0,1 мА (40 В)
КТ8219Б	p-n-p	1,75; 40* Вт	≥25	60	5	4 (8* А)	≤0,1 мА (60 В)
КТ8219В	p-n-p	1,75; 40* Вт	≥25	80	5	4 (8* А)	≤0,1 мА (80 В)
КТ8219Г	p-n-p	1,75; 40* Вт	≥25	100	5	4 (8* А)	≤0,1 мА (100 В)
КТ8219А1	p-n-p	1,75; 40* Вт	≥25	40	5	4 (8* А)	≤0,1 мА (40 В)
КТ8219Б1	p-n-p	1,75; 40* Вт	≥25	60	5	4 (8* А)	≤0,1 мА (60 В)
КТ8219В1	p-n-p	1,75; 40* Вт	≥25	80	5	4 (8* А)	≤0,1 мА (80 В)
КТ8219Г1	p-n-p	1,75; 40* Вт	≥25	100	5	4 (8* А)	≤0,1 мА (100 В)
КТ8220А	n-p-n	65* Вт	≥3	40	5	6 А	
КТ8220Б	n-p-n	65* Вт	≥3	60	5	6 А	
КТ8220В	n-p-n	65* Вт	≥3	80	5	6 А	
КТ8220Г	n-p-n	65* Вт	≥3	100	5	6 А	
КТ8221А	p-n-p	65* Вт	≥3	40	5	6 А	
КТ8221Б	p-n-p	65* Вт	≥3	60	5	6 А	
КТ8221В	p-n-p	65* Вт	≥3	80	5	6 А	
КТ8221Г	p-n-p	65* Вт	≥3	100	5	6 А	
КТ8224А	n-p-n	100 Вт	—	1500; 700**	7,5	8 А	≤1000
КТ8224Б	n-p-n	100 Вт	—	1500; 700**	7,5	8 А	≤1000

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$К_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
750...15000 (3 В; 2 А) 750...15000 (3 В; 2 А) 750...15000 (3 В; 2 А) 750...15000 (3 В; 2 А)	≤200 (10 В) ≤200 (10 В) ≤200 (10 В) ≤200 (10 В)	≤1 ≤1 ≤1 ≤1	— — — —	— — — —	КТ8219
750...15000 (3 В; 2 А) 750...15000 (3 В; 2 А) 750...15000 (3 В; 2 А) 750...15000 (3 В; 2 А)	≤200 (10 В) ≤200 (10 В) ≤200 (10 В) ≤200 (10 В)	≤1 ≤1 ≤1 ≤1	— — — —	— — — —	КТ8219-1
15...75 (4 В; 3 А) 15...75 (4 В; 3 А) 15...75 (4 В; 3 А) 15...75 (4 В; 3 А)	— — — —	≤0,25 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,25			КТ8220
15...75 (4 В; 3 А) 15...75 (4 В; 3 А) 15...75 (4 В; 3 А) 15...75 (4 В; 3 А)	— — — —	≤0,25 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,25			КТ8221
4...7 (5 В; 0,1 А) 23 (5 В; 0,1 А)	— —	— —	— —	— —	КТ8224

Тип прибора	Структура	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{K\ max}$, $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ8225А	n-p-n	155 Вт	—	350	5	15 А	≤100
КТ8228А	n-p-n	125 Вт	—	1500; 800*	7,5	12 А	≤100
КТ8228Б	n-p-n	125 Вт	—	1500; 800*	7,5	12 А	≤100
КТ8229А	n-p-n	125 Вт	≥3	180	5	25 А	—
КТ822А-1	p-n-p	20* Вт	≥3	45* (0,1к)	5	2 (4*) А	≤50 (40 В)
КТ822Б-1	p-n-p	20* Вт	≥3	60* (0,1к)	5	2 (4*) А	≤50 (40 В)
КТ822В-1	p-n-p	20* Вт	≥3	100* (0,1к)	5	2 (4*) А	≤50 (40 В)
КТ823А-1	n-p-n	20* Вт	≥3	45* (0,1к)	5	2 (4*) А	≤50 (45 В)
КТ823Б-1	n-p-n	20* Вт	≥3	60* (0,1к)	5	2 (4*) А	≤50 (45 В)
КТ823В-1	n-p-n	20* Вт	≥3	100* (0,1к)	5	2 (4*) А	≤50 (45 В)
КТ825Г	p-n-p	125* Вт	≥4	90	5	20 (30*) А	≤1* мА (90 В)
КТ825Д	p-n-p	125* Вт	≥4	60	5	20 (30*) А	≤1* мА (60 В)
КТ825Е	p-n-p	125* Вт	≥4	30	5	20 (30*) А	≤1* мА (30 В)
КТ826А	n-p-n	15* Вт (50°С)	≥6	700* (0,01к)	5	1 А	≤2 мА (700 В)
КТ826Б	n-p-n	15* Вт (50°С)	≥6	700* (0,01к)	5	1 А	≤2 мА (700 В)
КТ826В	n-p-n	15* Вт (50°С)	≥6	700* (0,01к)	5	1 А	≤2 мА (700 В)
КТ827А	n-p-n	125* Вт	≥4	100* (1к)	5	20 (40*) А	≤3* мА (100 В)
КТ827Б	n-p-n	125* Вт	≥4	80* (1к)	5	20 (40*) А	≤3* мА (80 В)
КТ827В	n-p-n	125* Вт	≥4	60* (1к)	5	20 (40*) А	≤3* мА (60 В)
КТ828А	n-p-n	50* Вт (50°С)	≥4	800* (0,01к)	5	5 (7,5*) А	≤5 мА (1400 В)
КТ828Б	n-p-n	50* Вт	≥4	600* (0,01к)	5	5 (7,5*) А	≤5 мА (1200 В)
КТ828В	n-p-n	50* Вт (50°С)	≥4	800* (0,01к)	5	5 (7,5*) А	≤5 мА (800 В)
КТ828Г	n-p-n	50* Вт	≥4	600* (0,01к)	5	5 (7,5*) А	≤5 мА (600 В)
КТ829А	n-p-n	60* Вт	≥4	100* (1к)	5	8 (12*) А	≤1,5* мА (100 В)
КТ829Б	n-p-n	60* Вт	≥4	80* (1к)	5	8 (12*) А	≤1,5* мА (80 В)
КТ829В	n-p-n	60* Вт	≥4	60* (1к)	5	8 (12*) А	≤1,5* мА (60 В)
КТ829Г	n-p-n	60* Вт	≥4	45* (1к)	5	8 (12*) А	≤1,5* мА (60 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_{k}, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_{ш}$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥300	—	—	—	—	**КТ8225**
5...9,5 (5 В; 0,1 А) 15...25 (5 В; 0,1 А)	— —	≤0,12 ≤0,12	— —	≤900** ≤900**	**КТ8228**
15...75 (4 В; 15 А)	—	≤0,12	—	≤800**	**КТ8229**
≥25* (2 В; 1 А) ≥25* (2 В; 1 А) ≥25* (2 В; 1 А)	≤115 (10 В) ≤115 (10 В) ≤115 (10 В)	≤0,6 ≤0,6 ≤0,6	— — —	— — —	**КТ822-1, КТ823-1**
≥25* (2 В; 1 А) ≥25* (2 В; 1 А) ≥25* (2 В; 1 А)	≤75 (10 В) ≤75 (10 В) ≤75 (10 В)	≤0,6 ≤0,6 ≤0,6	— — —	— — —	
≥750* (10 В; 10 А) ≥750* (10 В; 10 А) ≥750* (10 В; 10 А)	≤600 (10 В) ≤600 (10 В) ≤600 (10 В)	≤0,4 ≤0,4 ≤0,4	— — —	≤4,5** мкс ≤4,5** мкс ≤4,5** мкс	**КТ825, КТ826**
10...120* (10 В; 0,1 А) 5...300* (10 В; 0,1 А) 5...120* (10 В; 0,1 А)	≤25 (100 В) ≤25 (100 В) ≤25 (100 В)	≤5 ≤5 ≤5	— — —	$t_{сп}$≤1500 $t_{сп}$≤700 $t_{сп}$≤700	
750...18000* (3 В; 10 А) 750...18000* (3 В; 10 В) 750...18000* (3 В; 10 А)	≤400 (10 В) ≤400 (10 В) ≤400 (10 В)	≤0,2 ≤0,2 ≤0,2	— — —	≤4,5* мкс ≤4,5* мкс ≤4,5* мкс	**КТ827, КТ828**
≥2,25* (5 В; 4,5 А) ≥2,25* (5 В; 4,5 А) ≥2,25* (5 В; 4,5 А) ≥2,25* (5 В; 4,5 А)	— — — —	≤0,66 ≤0,66 ≤0,66 ≤0,66	— — — —	≤10* ≤10* ≤10* ≤10*	
≥750* (3 В; 3 А) ≥750* (3 В; 3 А) ≥750* (3 В; 3 А) ≥750* (3 В; 3 А)	≤120 ≤120 ≤120 ≤120	≤0,57 ≤0,57 ≤0,57 ≤0,57	— — — —	— — — —	**КТ829**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ8230А	p-n-p	125 Вт	≥3	180	5	25 А	—
КТ8231А	n-p-n	180* Вт	—	350**	—	15 А	—
КТ8231А1	n-p-n	155* Вт	—	350**	—	15 А	—
КТ8231А2	n-p-n	65* Вт	—	350**	—	15 А	—
КТ8232А1	n-p-n	125* Вт	—	350	5	20 А	—
КТ8232Б1	n-p-n	125* Вт	—	350	5	20 А	—
КТ8233А5	p-n-p	—	≥4	100	5	5 А	—
КТ8233Б5	p-n-p	—	≥4	80	5	5 А	—
КТ8233В5	p-n-p	—	≥4	60	5	5 А	—

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_{k}, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_{ш}$, дБ $r'_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
15...75 (4 В; 15 А)	—	≤0,12	—	≤800**	**КТ8230**
≥400	—	—	—	—	**КТ8231**
≥400	—	—	—	—	**КТ8231А1**
≥400	—	—	—	—	**КТ8231А2**
300...8000 (10 В; 5 А) 300...8000 (10 В; 5 А)	— —	≤0,18 ≤0,18	— —	— —	**КТ8232-1**
≥1000 (3 В; 0,5 А) ≥1000 (3 В; 0,5 А) ≥1000 (3 В; 0,5 А)	≤300 ≤300 ≤300	≤3 ≤3 ≤3	— — —	— — —	**КТ8233-5**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ8234А5	n-p-n	—	≥4	100	5	5 А	—
КТ8234Б5	n-p-n	—	≥4	80	5	5 А	—
КТ8234В5	n-p-n	—	≥4	60	5	5 А	—
КТ8235А	n-p-n БСИТ	1000	≥30	700; 400**	5	2 А	—
КТ8240А5	n-p-n	—	≥150	30	—	800	—
КТ8240Б5	n-p-n	—	≥150	30	—	800	—
КТ8240В5	n-p-n	—	≥150	40	—	800	—
КТ8240Г5	n-p-n	—	≥150	50	—	800	—
КТ8240Д5	n-p-n	—	≥150	60	—	800	—
КТ8240Е5	n-p-n	—	≥150	70	—	800	—
КТ8240Ж5	n-p-n	—	≥150	80	—	800	—
КТ8241А5	p-n-p	—	≥150	30	—	800	—
КТ8241Б5	p-n-p	—	≥150	30	—	800	—
КТ8241В5	p-n-p	—	≥150	40	—	800	—
КТ8241Г5	p-n-p	—	≥150	50	—	800	—
КТ8241Д5	p-n-p	—	≥150	60	—	800	—
КТ8241Е5	p-n-p	—	≥150	70	—	800	—
КТ8241Ж5	p-n-p	—	≥150	80	—	800	—
КТ8242А5	p-n-p	—	≥25	100	—	2000	—
КТ8242Б5	p-n-p	—	≥25	80	—	2000	—
КТ8242В5	p-n-p	—	≥25	60	—	2000	—
КТ8243А5	n-p-n	—	≥25	100	—	2000	—
КТ8243Б5	n-p-n	—	≥25	80	—	2000	—
КТ8243В5	n-p-n	—	≥25	60	—	2000	—
КТ8244А5	p-n-p	—	≥150	45	—	2000	—
КТ8244Б5	p-n-p	—	≥150	60	—	2000	—
КТ8244В5	p-n-p	—	≥150	60	—	2000	—
КТ8244Г5	p-n-p	—	≥150	80	—	2000	—
КТ8245А5	n-p-n	—	≥150	45	—	2000	—
КТ8245Б5	n-p-n	—	≥150	60	—	2000	—
КТ8245В5	n-p-n	—	≥150	60	—	2000	—
КТ8245Г5	n-p-n	—	≥150	80	—	2000	—
КТ8246А	n-p-n	60* Вт	—	100	5	15 А	—
КТ8246Б	n-p-n	60* Вт	—	120	5	15 А	—
КТ8246В	n-p-n	60* Вт	—	160	5	15 А	—
КТ8246Г	n-p-n	60* Вт	—	160	5	15 А	—

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_{к}$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\,нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_{ш}$, дБ $r'_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥1000 (3 В; 0,5 А) ≥1000 (3 В; 0,5 А) ≥1000 (3 В; 0,5 А)	≤200 ≤200 ≤200	≤3 ≤3 ≤3	— — —	— — —	**КТ8234-5**
8...40 (2 В; 0,5 А)	≤30	≤1	—	—	**КТ8235**
≥5000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА)	— — — — — — —	≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15	— — — — — — —	— — — — — — —	**КТ8240-5**
≥5000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА) ≥10000 (5 В; 10 мА)	— — — — — — —	≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15	— — — — — — —	— — — — — — —	**КТ8241-5**
≥500 (3 В; 0,5 А) ≥500 (3 В; 0,5 А) ≥500 (3 В; 0,5 А)	≤200 ≤200 ≤200	≤3 ≤3 ≤3	— — —	— — —	**КТ8242-5, КТ8243-5**
≥500 (3 В; 0,5 А) ≥500 (3 В; 0,5 А) ≥500 (3 В; 0,5 А)	≤100 ≤100 ≤100	≤3 ≤3 ≤3	— — —	— — —	
≥1000 (3 В; 0,5 А) ≥1000 (3 В; 0,5 А) ≥1000 (3 В; 0,5 А) ≥1000 (3 В; 0,5 А)	≤200 ≤200 ≤200 ≤200	≤3 ≤3 ≤3 ≤3	— — — —	— — — —	**КТ8244-5, КТ8245-5**
≥1000 (3 В; 0,5 А) ≥1000 (3 В; 0,5 А) ≥1000 (3 В; 0,5 А) ≥1000 (3 В; 0,5 А)	≤100 ≤100 ≤100 ≤100	≤3 ≤3 ≤3 ≤3	— — — —	— — — —	
≥1000 ≥1000 ≥1000 ≥1000	— — — —	≤2,5 ≤2,5 ≤2,5 ≤2,5	— — — —	— — — —	**КТ8246**

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ8247А	n-p-n	75 Вт	—	700	12	5 А	≤100*
КТ8248А1	n-p-n	90 Вт	—	1500*	7,5	5 А	—
КТ8250А КТ8250Б	n-p-n n-p-n	50* Вт 50* Вт	— —	190; 40** 190; 80**	5 5	15 А 15 А	— —
КТ8251А	n-p-n	125 Вт	—	180	5	10 А	≤100
КТ8254А	n-p-n	20 Вт	≥10	800	—	2 А	
КТ8255А	n-p-n	60 Вт	—	330	6	7 А	≤1* мА

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_{k}, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_{ш}$, дБ $r'_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥22	—	—	—	—	**КТ8247**
3,8...9	—	—	—	—	**КТ8248-1**
≥100 ≥100	— —	≤0,05 ≤0,05	— —	— —	**КТ8250**
≥1000	—	—	—	—	**КТ8251**
≥30* (5 В; 0,3 А)		≤2			**КТ8254**
≥15	—	—	—	—	**КТ8255**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^*_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^*_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^*_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ8261А	n-p-n	25 Вт	—	700	9	2 А	≤50*
КТ8270А	n-p-n	7 Вт	≥4	600	9	500	≤100*
КТ8271А	p-n-p	10 Вт	—	45	5	1500	≤0,1 (45 В)
КТ8271Б	p-n-p	10 Вт	—	60	5	1500	≤0,1 (60 В)
КТ8271В	p-n-p	10 Вт	—	80	5	1500	≤0,1 (80 В)
КТ8272А	n-p-n	10 Вт	—	45	5	1500	≤0,1 (45 В)
КТ8272Б	n-p-n	10 Вт	—	60	5	1500	≤0,1 (60 В)
КТ8272В	n-p-n	10 Вт	—	80	5	1500	≤0,1 (80 В)
КТ829А	n-p-n	60 Вт	≥4	100* (1к)	5	8 А; 12* А	≤1,5 (100 В)
КТ829Б	n-p-n	60 Вт	≥4	80* (1к)	5	8 А; 12* А	≤1,5 (80 В)
КТ829В	n-p-n	60 Вт	≥4	60* (1к)	5	8 А; 12* А	≤1,5 (60 В)
КТ829Г	n-p-n	60 Вт	≥4	45* (1к)	5	8 А; 12* А	≤1,5 (45 В)
КТ829АТ	n-p-n	50 Вт	≥4	100	5	5 А	—
КТ829АП	n-p-n	50 Вт	≥4	160	5	5 А	—
КТ829АМ	n-p-n	60 Вт	≥4	240	5	8 А	—
КТ8290А	n-p-n	100 Вт	—	700	9	10 А	≤100
КТ830А	p-n-p	5* Вт	≥4	35	5	2 А; 4* А	≤100 (35 В)
КТ830Б	p-n-p	5* Вт	≥4	60	5	2 А; 4* А	≤100 (60 В)
КТ830В	p-n-p	5* Вт	≥4	80	5	2 А; 4* А	≤100 (80 В)
КТ830Г	p-n-p	5* Вт	≥4	100	5	2 А; 4* А	≤100 (100 В)
КТ831А	n-p-n	5 Вт	≥4	35	12	2 А	—
КТ831Б	n-p-n	5 Вт	≥4	60	5	2 А	—
КТ831В	n-p-n	5 Вт	≥4	80	5	2 А	—
КТ831Г	n-p-n	5 Вт	≥4	100	5	2 А	—

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r'_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥10	—	—	—	—	КТ8261, КТ8270
5...90	—	—	—	—	
≥25 ≥25 ≥25	— — —	— — —	— — —	— — —	КТ8271, КТ8272
≥25 ≥25 ≥25	— — —	— — —	— — —	— — —	
≥750* (3 В; 3 А) ≥750* (3 В; 3 А) ≥750* (3 В; 3 А) ≥750* (3 В; 3 А)	≤120 ≤120 ≤120 ≤120	≤0,57 ≤0,57 ≤0,57 ≤0,57	— — — —	— — — —	КТ829
≥1000 ≥700 400...3000	— — —	≤0,3 ≤0,25 ≤0,66	— — —	— — —	КТ829(Т-М)
≥10	—	—	—	—	КТ8290
≥20* (1 В; 1 А) ≥20* (1 В; 1 А) ≥20* (1 В; 1 А) ≥20* (1 В; 1 А)	— — — —	≤1,2 ≤1,2 ≤1,2 ≤1,2	— — — —	≤1000* ≤1000* ≤1000* ≤1000*	КТ830
≥2 ≥5 ≥25 ≥20	— — — —	≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6	— — — —	— — — —	КТ831

Тип прибора	Структура	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ834А	n-p-n	100* Вт	≥4	500* (0,1к)	8	15 (20*) А	≤3* мА (500 В)
КТ834Б	n-p-n	100* Вт	≥4	450* (0,1к)	8	15 (20*) А	≤3* мА (450 В)
КТ834В	n-p-n	100* Вт	≥4	400* (0,1к)	8	15 (20*) А	≤3* мА (400 В)
КТ835А	p-n-p	25* Вт	≥1	30	4	3 А	≤0,1 мА (30 В)
КТ835Б	p-n-p	25* Вт	*1	45	4	7,5 А	≤0,15 мА (45 В)
КТ836А	p-n-p	5 Вт	≥4	90	5	3 А	≤100 (90 В)
КТ836Б	p-n-p	5 Вт	≥4	85	5	3 А	≤100 (85 В)
КТ836В	p-n-p	5 Вт	≥4	60	5	3 А	≤100 (60 В)
КТ837А	p-n-p	30* Вт	≥1	80	15	7,5 А	≤0,15 мА (80 В)
КТ837Б	p-n-p	30* Вт	≥1	80	15	7,5 А	≤0,15 мА (80 В)
КТ837В	p-n-p	30* Вт	≥1	80	15	7,5 А	≤0,15 мА (80 В)
КТ837Г	p-n-p	30* Вт	≥1	60	15	7,5 А	≤0,15 мА (60 В)
КТ837Д	p-n-p	30* Вт	≥1	60	15	7,5 А	≤0,15 мА (60 В)
КТ837Е	p-n-p	30* Вт	≥1	60	15	7,5 А	≤0,15 мА (60 В)
КТ837Ж	p-n-p	30* Вт	≥1	45	15	7,5 А	≤0,15 мА (45 В)
КТ837И	p-n-p	30* Вт	≥1	45	15	7,5 А	≤0,15 мА (45 В)
КТ837К	p-n-p	30* Вт	≥1	45	15	7,5 А	≤0,15 мА (45 В)
КТ837Л	p-n-p	30* Вт	≥1	80	5	7,5 А	≤0,15 мА (80 В)
КТ837М	p-n-p	30* Вт	≥1	80	5	7,5 А	≤0,15 мА (80 В)
КТ837Н	p-n-p	30* Вт	≥1	80	5	7,5 А	≤0,15 мА (80 В)
КТ837П	p-n-p	30* Вт	≥1	60	5	7,5 А	≤0,15 мА (60 В)
КТ837Р	p-n-p	30* Вт	≥1	60	5	7,5 А	≤0,15 мА (60 В)
КТ837С	p-n-p	30* Вт	≥1	60	5	7,5 А	≤0,15 мА (60 В)
КТ837Т	p-n-p	30* Вт	≥1	45	5	7,5 А	≤0,15 мА (45 В)
КТ837У	p-n-p	30* Вт	≥1	45	5	7,5 А	≤0,15 мА (45 В)
КТ837Ф	p-n-p	30* Вт	≥1	45	5	7,5 А	≤0,15 мА (45 В)
КТ838А	n-p-n	12,5* Вт (90°С)	≥3	1500	5; 7	5 (7,5*) А	≤1* мА (1500 В)
КТ838Б	n-p-n	12,5* Вт	≥3	1200	5; 7	5 (7,5*) А	≤1* мА (1200 В)
КТ839А	n-p-n	50* Вт	≥5	1500	5	10 А	≤1 мА (1500 В)
КТ840А	n-p-n	60* Вт	≥8	400*; 900	5	6 (8*) А	≤3 мА (900 В)
КТ840Б	n-p-n	60* Вт	≥8	350*; 750	5	6 (8*) А	≤3 мА (750 В)
КТ840В	n-p-n	60* Вт	≥8	800; 375*	5	6 (8*) А	≤3 мА (800 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	C_k, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^*_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^*_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
150...3000* (5 В; 5 А)	≤100 (150 В)	≤0,13	—	$t_{сп}$≤1,2 мкс	**КТ834**
150...3000* (5 В; 5 А)	≤100 (150 В)	≤0,13	—	$t_{сп}$≤1,2 мкс	
150...3000* (5 В; 5 А)	≤100 (150 В)	≤0,13	—	$t_{сп}$≤1,2 мкс	
≥25* (1 В; 1 А)	≤800 (10 В)	≤0,35	—	—	**КТ835**
10...100* (5 В; 2 А)	≤800 (10 В)	≤0,8	—	—	
20...100 (5 В; 2 А)	—	≤0,3			**КТ836**
20...100 (5 В; 2 А)	—	≤0,018			
20...100 (5 В; 2 А)	—	≤0,022			
10...40* (5 В; 2 А)	—	≤0,8	—	—	**КТ837**
20...80* (5 В; 2 А)	—	≤0,8	—	—	
50...150* (5 В; 2 А)	—	≤0,8	—	—	
10...40* (5 В; 2 А)	—	≤0,3	—	—	
20...80* (5 В; 2 А)	—	≤0,3	—	—	
50...150* (5 В; 2 А)	—	≤0,3	—	—	
10...40* (5 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	
20...80* (5 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	
50...150* (5 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	
10...40* (5 В; 2 А)	—	≤0,8	—	—	
20...80* (5 В; 2 А)	—	≤0,8	—	—	
50...150* (5 В; 2 А)	—	≤0,8	—	—	
10...40* (5 В; 2 А)	—	≤0,3	—	—	
20...80* (5 В; 2 А)	—	≤0,3	—	—	
50...150* (5 В; 2 А)	—	≤0,3	—	—	
10...40* (5 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	
20...80* (5 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	
50...150* (5 В; 2 А)	—	≤0,25	—	—	
≥4* (5 В; 3,5 А)	170 (10 В)	≤1,1	—	≤10* мкс; $t_{сп}$≤1,5	**КТ838, КТ839, КТ840**
≥4* (5 В; 3,5 А)	170 (10 В)	≤1,1	—	≤10* мкс	
≥5* (10 В; 4 А)	240 (10 В)	≤0,375	—	≤10* мкс; $t_{сп}$≤1,5	
10...60* (2,5 В; 8 А)	—	≤0,75	—	$t_{сп}$≤0,6	
≥10* (2,5 В; 8 А)	—	≤0,75	—	$t_{сп}$≤0,6	
10...100* (2,5 В; 8 А)	—	≤0,24	—	≤3500*.	

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ841А	n-p-n	3 (50*) Вт	≥10	600	5	10 (15*) А	≤3 мА (600 В)
КТ841Б	n-p-n	3 (50*) Вт	≥10	400	5	10 (15*) А	≤3 мА (400 В)
КТ841В	n-p-n	3 (50*) Вт	≥10	600	5	10 (15*) А	≤3 мА (600 В)
КТ841Г	n-p-n	100* Вт	≥7	200	5	10 (15*) А	≤3 мА (200 В)
КТ841Д	n-p-n	100* Вт	≥5	500	5	10 (15*) А	≤3 мА (500 В)
КТ841Е	n-p-n	50* Вт	≥7	800	5	10 (15*) А	≤3 мА (800 В)
КТ842А	p-n-p	3 (50*) Вт	≥20	300	5	5 (10*) А	≤1 мА (300 В)
КТ842Б	p-n-p	3 (50*) Вт	≥20	200	5	5 (10*) А	≤1 мА (200 В)
КТ842В	p-n-p	100* Вт	≥7	200	5	5 (10*) А	≤1 мА (200 В)
КТ844А	n-p-n	50* Вт (50°С)	≥7,2	250* (0,01к)	4	10 (20*) А	≤3* мА (250 В)
КТ845А	n-p-n	40* Вт (50°С)	≥4,5	400* (0,01к)	4	5 (7,5*) А	≤3* мА (400 В)
КТ846А	n-p-n	12,5* Вт (90°С)	≥2	1500* (0,01к)	5; 7	5 (7,5*) А	≤1* мА (1500 В)
КТ846Б	n-p-n	12,5* Вт (95°С)	≥2	1200	5; 7	5 (7,5*) А	≤1* мА (1200 В)
КТ846В	n-p-n	12,5* Вт (95°С)	≥2	1500	5; 7	5 (7,5*) А	≤1* мА (1500 В)
КТ847А	n-p-n	125* Вт	≥15	650* (0,01к)	8	15 (25*) А	5 мА (650 В)
КТ847Б	n-p-n	125* Вт	≥10	650* (0,01к)	8	15 (25*) А	5 мА (650 В)
КТ848А	n-p-n	35* Вт (100°С)	≥3	520	15	15 А	≤3* мА (400 В)
КТ848Б	n-p-n	35* Вт (100°С)	≥3	400	15	15 А	≤3* мА (400 В)
КТ850А	n-p-n	25* Вт	≥20	250	5	2 (3*) А	≤100 (250 В)
КТ850Б	n-p-n	25* Вт	≥20	300	5	2 (3*) А	≤500 (300 В)
КТ850В	n-p-n	25* Вт	≥20	180	5	2 (3*) А	≤500 (180 В)
КТ851А	p-n-p	25* Вт	≥20	250	5	2 (3*) А	≤100 (250 В)
КТ851Б	p-n-p	25* Вт	≥20	300	5	2 (3*) А	≤500 (300 В)
КТ851В	p-n-p	25* Вт	≥20	180	5	2 (3*) А	≤500 (180 В)
КТ852А	p-n-p	50* Вт	≥7	100	5	2,5 (4*) А	≤1 мА (100 В)
КТ852Б	p-n-p	50* Вт	≥7	80	5	2,5 (4*) А	≤1 мА (80 В)
КТ852В	p-n-p	50* Вт	≥7	60	5	2,5 (4*) А	≤1 мА (60 В)
КТ852Г	p-n-p	50* Вт	≥7	45	5	2,5 (4*) А	≤1 мА (45 В)
КТ853А	p-n-p	60* Вт	≥7	100	5	8 (12*) А	≤200 (100 В)
КТ853Б	p-n-p	60* Вт	≥7	80	5	8 (12*) А	≤200 (80 В)
КТ853В	p-n-p	60* Вт	≥7	60	5	8 (12*) А	≤200 (60 В)
КТ853Г	p-n-p	60* Вт	≥7	45	5	8 (12*) А	≤200 (45 В)
КТ854А	n-p-n	60* Вт	≥10	600	5	10 (15*) А	≤3 мА (600 В)
КТ854Б	n-p-n	60* Вт	≥10	400	5	10 (15*) А	≤3 мА (400 В)
КТ855А	p-n-p	40* Вт	≥5	250	5	5 (8*) А	≤1000 (250 В)
КТ855Б	p-n-p	40* Вт	≥5	150	5	5 (8*) А	≤1000 (150 В)
КТ855В	p-n-p	40* Вт	≥5	150	5	5 (8*) А	≤1000 (150 В)
КТ856А	n-p-n	75* Вт	≥10	800	5	10 А; 12* А	≤3 мА (800 В)
КТ856Б	n-p-n	75* Вт	≥10	700	5	10 А; 12* А	≤3 мА (600 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥12* (5 В; 5 А) ≥12* (5 В; 5 А) ≥12* (5 В; 5 А) ≥20* (5 В; 5 А) ≥20* (5 В; 2 А) ≥10* (5 В; 5 А)	≤300 (10 В) ≤300 (10 В) ≤300 (10 В) ≤300 (10 В) ≤300 (10 В) ≤300 (10 В)	≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3	— — — — — —	≤1000* ≤1000* ≤1000* ≤1000* ≤1000* ≤1000*	**КТ841, КТ842, КТ844**
≥15* (4 В; 5 А) ≥15* (4 В; 5 А) ≥20* (4 В; 5 А)	250 (10 В) 250 (10 В) 250 (10 В)	≤0,36 ≤0,36 ≤0,44	— — —	800* 800* 800*	
10...50* (3 В; 6 А)	≤300 (10 В)	≤0,4	—	≤2000*	
15...100* (5 В; 2 А)	≤45 (200 В)	≤0,75	—	≤4000*	**КТ845, КТ846, КТ847, КТ848**
— — —	≤200 — —	≤0,22 ≤1,1 ≤1,1	— — —	≤12000* ≤12000* ≤12000*	
8...25* (3 В; 15 А) 8...25* (3 В; 15 А)	≤200 (400 В) ≤200 (400 В)	≤0,1 ≤0,1	— —	≤2000* ≤3000*	
≥20* (5 В; 15 А) ≥20* (5 В; 15 А)	— —	≤0,2 ≤0,2	— —	— —	
40...200* (10 В; 0,5 А) ≥20* (10 В; 0,5 А) ≥20* (10 В; 0,5 А)	≤35 (5 В) ≤35 (5 В) ≤35 (5 В)	≤2 ≤2 ≤2	— — —	1500* 1500* 1500*	**КТ850, КТ851, КТ852**
40...200* (10 В; 0,5 А) 20...200* (10 В; 0,5 А) 20...200* (10 В; 0,5 А)	40 (5 В) 40 (5 В) 40 (5 В)	≤2 ≤2 ≤2	— — —	1400* 1400* 1400*	
≥500* (4 В; 2 А) ≥500* (4 В; 2 А) ≥1000* (4 В; 1 А) ≥1000* (4 В; 1 А)	≤28 (5 В) ≤28 (5 В) ≤28 (5 В) ≤28 (5 В)	≤1,25 ≤1,25 ≤1,25 ≤1,25	— — — —	2000** 2000** 2000** 2000**	
≥750* (3 В; 3 А) ≥750* (3 В; 3 А) ≥750* (3 В; 3 А) ≥750* (3 В; 3 А)	≤120 (5 В) ≤120 (5 В) ≤120 (5 В) ≤120 (5 В)	≤0,66 ≤0,66 ≤0,66 ≤0,66	— — — —	3300** 3300** 3300** 3300**	**КТ853, КТ854, КТ855**
≥20* (4 В; 2 А) ≥20* (4 В; 2 А)	200 (10 В) 200 (10 В)	≤0,4 ≤0,4	— —	$t_{сп}$=700 $t_{сп}$=700	
≥20* (4 В; 2 А) ≥20* (4 В; 2 А) ≥15* (4 В; 2 А)	200 (10 В) 200 (10 В) 200 (10 В)	≤0,5 ≤0,5 ≤0,5	— — —	— — —	
10...60* (5 В; 5 А) 10...60* (5 В; 5 А)	≤100 (90 В) ≤100 (90 В)	≤0,3 ≤0,3	— —	≤2* мкс ≤2* мкс	**КТ856**

Тип прибора	Струк-тура	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{K\ max}$, $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ856А-1 **КТ856Б-1**	n-p-n n-p-n	50* Вт 50* Вт	10 10	800 600	5 5	10 А; 12* А 10 А; 12* А	≤3 мА (800 В) ≤3 мА (600 В)
КТ857А	n-p-n	60* Вт	≥10	250	6	7 (10*) А	≤5 мА (250 В)
КТ858А	n-p-n	60* Вт	≥10	400	6	7 (10*) А	≤1 мА (400 В)
КТ859А	n-p-n	40* Вт	≥25	800	10	3 (4*) А	≤1 мА (800 В)
КТ862Б **КТ862В** **КТ862Г**	n-p-n n-p-n n-p-n	50* Вт 50* Вт 50* Вт	≥20 ≥20 ≥20	450 600 (350**) 600 (400**)	5 5 5	15 А; 25* А 10 А; 15* А 10 А; 15* А	≤2,5 мА (300 В) ≤3 мА (600 В) ≤3 мА (600 В)
КТ863А **КТ863Б** **КТ863В**	n-p-n n-p-n n-p-n	50* Вт 50* Вт 50* Вт	≥4 ≥4 ≥4	30 30 160	5 5 5	10 А 10 А 10 А	≤1 мА (30 В) ≤1 мА (30 В) ≤1 мА (30 В)
КТ864А	n-p-n	100* Вт	≥15	200	6	10 (15*) А	≤100 (200 В)
КТ865А	p-n-p	100* Вт	≥15	200	6	10 (15*) А	≤100 (200 В)
КТ866А **КТ866Б**	n-p-n n-p-n	30* Вт 30* Вт	25 25	200; 100** 200; 80**	4 4	15 А; 20* А 15 А; 20* А	≤25 мА (100 В) ≤25 мА (100 В)
КТ867А	n-p-n	100* Вт	≥25	200	7	25 А (40* А)	≤3 (250 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_{k}, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_{ш}$, дБ $r'_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
10...60* (5 В; 5 А) 10...60* (5 В; 5 А)	≤100 (90 В) ≤100 (90 В)	≤0,3 ≤0,3	— —	≤2* мкс ≤2* мкс	**КТ856-1**
≥7,5* (1 В; 3 А)	—	≤0,33	—	≤2500*	**КТ857, КТ858, КТ859**
≥10* (5 В; 5 А)	—	≤0,2	—	≤2500*	
≥10* (10 В; 1 А)	—	≤1,5	—	≤3500*	
12...100* (5 В; 8 А) 12...50* (5 В; 5 А) 12...50* (5 В; 5 А)	≤300 (30 В) ≤250 (10 В) ≤250 (10 В)	≤0,13 ≤0,29 ≤0,29	— — —	≤1000* ≤2000* ≤2000*	**КТ862**
≥100* (2 В; 5 А) ≥70* (2 В; 5 А) ≥70* (2 В; 5 А)	— — —	≤0,06 ≤0,1 ≤0,1	— — —	— — —	**КТ863**
40...200* (4 В; 2 А)	≤300 (5 В)	≤0,6	—	—	**КТ864, КТ865**
40...200* (4 В; 2 А)	≤300 (5 В)	≤0,3	—	—	
≥15* (10 В; 10 А) ≥15* (10 В; 10 А)	≤400 (10 В) ≤400 (10 В)	≤0,15 ≤0,15	— —	≤450** ≤450**	**КТ866**
≥10* (5 В; 20 А)	≤400 (10 В)	≤0,075	—	1,3* мкс	**КТ867**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ868А	n-p-n	70* Вт	≥8	900	5	6 (8*) А	≤3 мА (900 В)
КТ868Б	n-p-n	70* Вт	≥8	750	5	6 (8*) А	≤3 мА (750 В)
КТ872А	n-p-n	100* Вт	≥7	1500; 700*	6	8 (15*) А	≤1 мА (1500 В)
КТ872Б	n-p-n	100* Вт	≥7	1500; 700*	6	8 (15*) А	≤1 мА (1500 В)
КТ872В	n-p-n	100* Вт	≥7	1200; 600*	6	8 (15*) А	≤1 мА (1200 В)
КТ874А	n-p-n	75* Вт	≥20	150; 100* (0,01к)	5	30 А; 50* А	≤3 мА (150 В)
КТ874Б	n-p-n	75* Вт	≥20	150; 120* (0,01к)	5	30 А; 50* А	≤3 мА (150 В)
КТ878А	n-p-n	150* Вт	≥10	900* (0,01к)	5	25 (50*) А	≤3 мА (900 В)
КТ878Б	n-p-n	2 Вт; 100* Вт	≥10	800* (0,01к)	6	25 (50*) А	≤3 мА (800 В)
КТ878В	n-p-n	2 Вт; 100* Вт	≥10	600* (0,01к)	6	25 (50*) А	≤3 мА (600 В)
КТ879А	n-p-n	250* Вт	≥10	200	6	50 А; (75*) А	≤3 мА (200 В)
КТ879Б	n-p-n	250* Вт	≥10	200	6	50 А; (75*) А	≤3 мА (200 В)
КТ885А	n-p-n	150* Вт	≥15	400* (0,01к)	5	40 (60*) А	≤1 мА (500 В)
КТ885Б	n-p-n	150* Вт	≥15	500* (0,01к)	5	40 (60*) А	≤1 мА (500 В)
КТ886А-1	n-p-n	75* Вт	≥10,5	1400*(0,01к)	7	10 А; (15*) А	≤0,1 мА (1000 В)
КТ886Б-1	n-p-n	75* Вт	≥10,5	1000*(0,01к)	7	10 А; (15*) А	≤0,5 мА (1000 В)
КТ887А	p-n-p	3 Вт; 75* Вт	≥15	700	5	2 А; (5*) А	≤0,25 мА (700 В)
КТ887Б	p-n-p	3 Вт; 75* Вт	≥15	600	5	2 А; (5*) А	≤0,25 мА (600 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$С_к$, $С^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $К^{**}_{у.р.}$, дБ	$К_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $Р^{**}_{вых}$, Вт	$τ_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
10...60* (5 В; 0,6 А) 10...100* (5 В; 0,6 А)	≤100 (80 В) ≤100 (80 В)	≤0,75 ≤0,75	— —	≤3500* ≤3500*	КТ868, КТ872
≥6 (5 В; 30 мА) ≥6 (5 В; 30 мА) ≥6 (5 В; 30 мА)	≤125 (15 В) ≤125 (15 В) ≤125 (15 В)	≤0,22 ≤1,1 ≤1,1	— — —	≤7500* ≤7500* ≤7500*	
15...50* (5 В; 30 А) 10...40* (5 В; 30 А)	200 (100 В) 200 (100 В)	≤0,04 ≤0,04	— —	0,5* мкс 0,5* мкс	КТ874
12...50* (5 В; 10 А) 12...50* (5 В; 10 А) 12...50* (5 В; 10 А)	≤500 (10 В) ≤500 (10 В) ≤500 (10 В)	≤0,1 ≤0,1 ≤0,1	— — —	≤3000* ≤3000* ≤3000*	КТ878
≥20* (4 В; 20 А) ≥15* (4 В; 20 А)	≤800 (10 В) ≤800 (10 В)	≤0,06 ≤0,1	— —	1,2* мкс 1,2* мкс	КТ879
≥12* (5 В; 20 А) ≥12* (5 В; 20 А)	≤200 (100 В) ≤200 (100 В)	≤0,08 ≤0,08	— —	≤2000* ≤2000*	КТ885
6...25* (5 В; 4 А) 6...25* (5 В; 4 А)	≤135 (10 В) ≤135 (10 В)	≤0,25 ≤0,25	— —	2,5* мкс 2,5* мкс	КТ886-1
20...120* (9 В; 1 А) 20...120* (9 В; 1 А)	350 (10 В) 350 (10 В)	≤1,5 ≤1,5	— —	≤5* мкс ≤5* мкс	КТ887

Тип прибора	Структура	$P_{K\ max}$, $P^*_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^*_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{K\ max}$, $I^*_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ888А	p-n-p	0,8 Вт; 7* Вт	≥15	900	7	100 (200*)	≤10 (900 В)
КТ888Б	p-n-p	0,8 Вт; 7* Вт	≥15	600	7	100 (200*)	≤10 (600 В)
КТ890А	n-p-n	120* Вт	40	650	5	20 А	0,5** мА (350 В)
КТ890Б	n-p-n	120* ВТ	40	500	5	20 А	0,25** мА (350 В)
КТ890В	n-p-n	120* Вт	40	350	5	20 А	0,25** мА (350 В)
КТ892А	n-p-n	100* Вт	8	350* (0,01к)	5	15 (30*) А	≤3 мА (350 В)
КТ892Б	n-p-n	100* Вт	8	400* (0,01к)	5	15 (30*) А	≤3 мА (400 В)
КТ892В	n-p-n	100* Вт	8	300* (0,01к)	5	15 (30*) А	≤3 мА (300 В)
КТ893А	n-p-n	120* Вт	—	800* (0,01к)	5	6 А; 8* А	≤1* мА (800 В)
КТ896А	p-n-p	2 Вт; 125* Вт	≥4	90* (1к)	5	20 А (30* А)	—
КТ896Б	p-n-p	2 Вт; 125* Вт	≥4	60* (1к)	5	20 А (30* А)	—
КТ897А	n-p-n	3 Вт; 150* Вт	≥10	350	5	20 А (30* А)	≤250 (350 В)
КТ897Б	n-p-n	3 Вт; 150* Вт	≥10	200	5	20 А (30* А)	≤250 (200 В)
КТ898А	n-p-n	1,5 Вт; 125* Вт	≥10	350	5	20 А (30* А)	—
КТ898Б	n-p-n	1,5 Вт; 125* Вт	≥10	200	5	20 А (30* А)	—

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^{*}_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
30...120* (30 В; 30 мА) 30...120* (30 В; 30 мА)	— —	≤50 ≤50	— —	≤3* мкс ≤3* мкс	КТ888
≥200* (5 В; 5 А) ≥200* (5 В; 5 А) ≥200* (5 В; 5 А)	— — —	≤0,23 ≤0,22 ≤0,2	— — —	— — —	КТ890
≥300* (10 В; 5 А) ≥300* (10 В; 5 А) ≥300* (10 В; 5 А)	— — —	≤0,225 ≤0,225 ≤0,225	— — —	tсп≤4 мкс tсп≤4 мкс tсп≤4 мкс	КТ892
10...20*	—	≤0,6	—	≤2* мкс	КТ893
750...18000* (10 В; 5 А) 750...18000* (10 В; 5 А)	≤700 (10 В) ≤700 (10 В)	≤0,4 ≤0,4	— —	≤4500** ≤4500**	КТ896
≥400* (5 В; 5 А) ≤400* (5 В; 5 А)	— —	≤0,23 ≤0,23	— —	— —	КТ897
≥400* (5 В; 5 А) ≥400* (5 В; 5 А)	— —	≤0,23 ≤0,23	— —	— —	КТ898

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ898А-1 **КТ898Б-1**	n-p-n n-p-n	1,5 Вт; 60* Вт 1,5 Вт; 60* Вт	≥10 ≥10	350 200	5 5	20 А (30* А) 20 А (30* А)	— —
КТ899А	n-p-n	40* Вт	≥8	160	5	8 А (15* А)	≤1 (160 В)
КТ902А	n-p-n	30* Вт (50°С)	≥35	65 (110 имп.)	5	5 А	≤10 мА (70 В)
КТ902АМ	n-p-n	30* Вт (50°С)	≥35	65 (110 имп.)	5	5 А	≤10 мА (70 В)
КТ903А **КТ903Б**	n-p-n n-p-n	30* Вт (60**) 30* Вт (60**)	≥120 ≥120	60 (80 имп.) 60 (80 имп.)	4 4	3 (5*) А 3 (5*) А	≤10* мА (70 В) ≤10* мА (70 В)
КТ904А **КТ904Б**	n-p-n n-p-n	5* Вт (40°С) 5* Вт (40°С)	≥350 ≥300	60* (0,1к) 60* (0,1к)	4 4	0,8 (1,5*) А 0,8 (1,5*) А	≤1,5* мА (60 В) ≤1,5* мА (60 В)
КТ907А **КТ907Б**	n-p-n n-p-n	13,5* Вт 13,5* Вт	≥350 ≥300	60* (0,1к) 60* (0,1к)	4 4	1 (3*) А 1 (3*) А	≤3* мА (60В) ≤3* мА (60 В)
КТ908А **КТ908Б**	n-p-n n-p-n	50* Вт (50°С) 50* Вт (50°С)	≥30 ≥30	100* (0,01к) 60* (0,25к)	5 5	10 А 10 А	≤25* мА (100 В) ≤50* мА (60 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥400* (5 В; 5 А) ≥400* (5 В; 5 А)	— —	≤0,23 ≤0,23	— —	— —	**КТ898-1** **с изолированными выводами**
≥1000* (5 В; 5 А)	—	≤0,26	—	—	**КТ899**
≥15* (10 В; 2 А)	≤300 (10 В)	≤1; ≥7**	≥20** (10 МГц)	—	**КТ902**
≥15* (10 В; 2 А)	≤300 (10 В)	≤1; ≥7**	≥20** (10 МГц)	—	**КТ902М**
15...70* (10 В; 2 А) 40...180* (10 В; 2 А)	≤180 (30 В) ≤180 (30 В)	≤1,25; ≥3** ≤1,25; ≥3**	≥10** (50 МГц) ≥10** (50 МГц)	— —	**КТ903**
≥10* (5 В; 0,25 А) ≥10* (5 В; 0,25 А)	≤12 (28 В) ≤12 (28 В)	≤5; ≥2,5** ≤5; ≥2**	≥3** (400 МГц) ≥2,5** (400 МГц)	≤15 ≤20	**КТ904, КТ907**
≥10* (5 В; 0,4 А) ≥10* (5 В; 0,4 А)	≤20 (30 В) ≤20 (30 В)	≤4; ≥2** ≤4; ≥1,5**	≥8** (400 МГц) ≥6** (400 МГц)	≤15 ≤20	
8...60* (2 В; 10 А) ≥20* (4 В; 4 А)	≤700 (10 В) ≤700 (10 В)	≤0,15 ≤0,25	— —	≤2600* ≤2600*	**КТ908**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ909А **КТ909Б** **КТ909В** **КТ909Г**	n-p-n n-p-n n-p-n n-p-n	27* Вт 54* Вт 27* Вт 54* Вт	≥350 ≥500 ≥300 ≥450	60* (0,01к) 60* (0,01к) 60* (0,01к) 60* (0,01к)	3,5 3,5 3,5 3,5	2 (4*) А 4 (8*) А 2 (4*) А 4 (8*) А	30* мА (60 В) 60* мА (60 В) 30* мА (60 В) 60* мА (60 В)
КТ9101АС	n-p-n	128* Вт	≥350	50	4	7 А	≤30 мА (50 В)
КТ9104А **КТ9104Б**	n-p-n n-p-n	10** Вт 23** Вт	≥600 ≥600	50 50	4 4	1,5 А 5 А	≤10 мА (50 В) ≤20 мА (50 В)
КТ9105АС	n-p-n	133* Вт	≥660	50* (0,01к)	4	16 А	≤120* мА (50 В)
КТ9106АС-2 **КТ9106БС-2**	2Т642-5 + два 2Т996А5	300 и 2500 300 и 2500	— —	12* и 20* 12* и 20*	2 и 2,5 2 и 2,5	60 и 200 60 и 200	≤1 мА ≤1 мА
КТ9109А	n-p-n	1120** Вт	≥360	65	4	29* А	≤60 мА (65 В)
КТ9111А	n-p-n	200** Вт	≥200	120	4	10 А	≤100 мА (100 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^{*}_{б}$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
— — — —	≤30 (28 В) ≤60 (28 В) ≤35 (28 В) ≤60 (28 В)	≤0,3; ≥1,7** ≤0,18; ≥1,75** ≤0,3; ≥1,2** ≤0,18; ≥1,5**	20** (500 МГц) 40** (500 МГц) 15** (500 МГц) ≥30** (500 МГц)	≤20 ≤20 ≤30 ≤30	КТ909
—	≤150 (28 В)	≥5,5**	≥100** (0,7 ГГц)	≤45	КТ9101
— —	≤20 (28 В) ≤40 (28 В)	≥8** ≥7**	≥5** (0,7 ГГц) ≥20** (0,7 ГГц)	≤20 ≤20	КТ9104
≤160* (5 В; 0,1 А)	≤240 (28 В)	≥5**	≥100** (0,5 ГГц)	≤12	КТ9105
30...100 (5 В; 0,1 А) 60...150 (5 В; 0,1 А)	— —	— —	— —	— —	КТ9106-2
—	≤140 (50 В)	≥3,5** (820 МГц)	≥500** (820 МГц)	≤10	КТ9109
≥10* (10 В; 5 А)	≤150 (50 В)	≥10**	≥150** (80 МГц)	—	КТ9111

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ9115А	p-n-p	10* Вт	≥90	300* (10к)	5	100; 300*	≤0,05 (250 В)
КТ9115Б	p-n-p	10* Вт	≥90	150* (10к)	5	100; 300*	≤0,05 (150 В)
КТ9116А	n-p-n	46* Вт	≥240	55* (0,01к)	4	4 А	≤30 мА (55 В)
КТ9116Б	n-p-n	76,7* Вт	≥230	55* (0,01к)	4	10 А	≤100 мА (55 В)
КТ911А	n-p-n	3* Вт	≥750	55	3	0,4 А	≤5 мА (55 В)
КТ911Б	n-p-n	3* Вт	≥600	55	3	0,4 А	≤5 мА (55 В)
КТ911В	n-p-n	3* Вт	≥750	40	3	0,4 А	≤5 мА (40 В)
КТ911Г	n-p-n	3* Вт	≥600	40	3	0,4 А	≤5 мА (40 В)
КТ912А	n-p-n	30* Вт (85°С)	≥90	70* (0,01к)	5	20 А	≤50* мА (70 В)
КТ912Б	n-p-n	30* Вт (85°С)	≥90	70* (0,01к)	5	20 А	≤50* мА (70 В)
КТ9131А	n-p-n	350* Вт	≥100	100	4	25А; 40*А	≤200* мА (100 В)
КТ9132АС	n-p-n	163** Вт	—	50	4	11,2 А	—
КТ913А	n-p-n	4,7* Вт (55°С)	≥900	55	3,5	0,5 (1*) А	≤25* мА (55 В)
КТ913Б	n-p-n	8* Вт (70°С)	≥900	55	3,5	1 (2*) А	≤50* мА (55 В)
КТ913В	n-p-n	12* Вт	≥900	55	3,5	1 (2*) А	≤50* мА (55 В)
КТ9120А	p-n-p	50* Вт	≥50	45* (0,1к)	5	12 (30*) А	≤0,1 мА (45 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_{k}, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\,нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_{ш}$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥25 (10 В; 30 мА) ≥25 (10 В; 30 мА)	≤5,5 (30 В) ≤5,5 (30 В)	≤33 ≤33	— —	—	КТ9115
≥20* (5 В; 0,5 А) ≥20* (5 В; 0,5 А)	≤55 (28 В) ≤155 (28 В)	≥25** ≥10**	≥5** (225 МГц) ≥15** (225 МГц)	≤25 ≤30	КТ9116
— — — —	≤10 (28 В) ≤10 (28 В) ≤10 (28 В) ≤10 (28 В)	≤5; ≥2,5** ≤5; ≥2,6** ≤5; ≥2,2** ≤5; ≥2,2**	≥1** (1,8 ГГц) ≥1** (1 ГГц) ≥0,8** (1,8 ГГц) ≥0,8** (1 ГГц)	≤25 ≤25 ≤50 ≤100	КТ911
10...50* (10 В; 5 А) 20...100* (10 В; 5 А)	≤200 (27 В) ≤200 (27 В)	≤0,12; ≥10** ≤0,12	≥70** (30 МГц) ≥70** (30 МГц)	— —	КТ912
≥10 (10 В; 10 А)	≤800 (50 В)	≥10** (30 МГц) ≤0,1	≥400** (30 МГц)	—	КТ9131
—	—	≥3,5** раз	≥140** (650 МГц)	—	КТ9132
≥10* (10 В; 0,5 А) ≥10* (10 В; 0,5 А) ≥10* (10 В; 0,5 А)	≤6 (28 В) ≤12 (28 В) ≤14 (28 В)	≤1,1; ≥2** ≤1,1; ≥2** ≤1,1; ≥2**	≥3** (1 ГГц) ≥5** (1 ГГц) ≥10** (1 ГГц)	≤18 ≤15 ≤15	КТ913
≥40* (1 В; 4 А)	≤1900 (10 В)	≤0,75	—	≤500*	КТ9120

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ9121А	n-p-n	92** Вт	—	42	3	9,2* А	≤15 мА (42 В)
КТ9121Б	n-p-n	46** Вт	—	42	3	4,6* А	≤7,5 мА (42 В)
КТ9121В	n-p-n	11,5** Вт	—	42	3	1,15* А	≤2,5 мА (42 В)
КТ9121Г	n-p-n	130** Вт	—	42	3	13* А	≤22 мА (42 В)
КТ9125АС	n-p-n	60* Вт (40°С)	≥660	55* (10 Ом)	4	4 А	≤60* мА (55 В)
КТ9126А	n-p-n	330* Вт (50°С)	≥100	100* (0,01к)	4	30 А	≤200* мА (100 В)
КТ9127А	n-p-n	1151** Вт	—	65	3	38* А	≤60* мА (65 В)
КТ9127Б	n-p-n	524** Вт	—	65	3	19* А	≤30* мА (65 В)
КТ9128АС	n-p-n	180* Вт (50°С)	≥200	50* (10 Ом)	4	18 А	≤100* мА (50 В)
КТ9130А	n-p-n	10* Вт	≥200	250	6	150	≤1 мкА (250 В)
КТ9133А	n-p-n	130* Вт	≥225	55* (0,01к)	4	16 А	≤200* мА (55 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
— — — —	— — — —	≥6,4** ≥6,4** ≥6,4** ≥12,5**	≥35** (2,3...2,7 ГГц) ≥17** (2,3...2,7 ГГц) ≥4** (2,3...2,7 ГГц) ≥50** (2,3...2,7 ГГц)	— — — —	**КТ9121**
≤110* (5 В; 0,5 А)	≤70 (28 В)	≥6** (500 МГц)	≥50** (500 МГц)	≤20	**КТ9125**
≥10* (10 В; 5 А)	≤500 (50 В)	≥13**; ≤0,05	≥500** (1,5 МГц)	—	**КТ9126**
— —	— —	≥5,6** ≥6,2**	≥550** (1,025...1,15 ГГц) ≥250** (1,025...1,15 ГГц)	— —	**КТ9127**
≤100* (5 В; 0,5 А)	≤430 (28 В)	7** (175 МГц)	≥200** (175 МГц)	≤30	**КТ9128**
10...45 (9 В; 20 мА)	≤6 (10 В)	≤50	—	—	**КТ9130**
—	≤160 (28 В)	≥7,5**	≥30** (225 МГц)	≤30	**КТ9133**

15 зак. 9

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ9134А	n-p-n	2600** Вт	≥600	50	3	78* А	≤120 мА (50 В)
КТ9134Б	n-p-n	2100** Вт	≥600	50	3	71* А	≤120 мА (50 В)
КТ9136АС	n-p-n	700** Вт	≥300	60	4	30* А	≤140 мА (60 В)
КТ914А	p-n-p	7* Вт	≥300	65	4	0,8 (1,5* А)	2* мА (65 В)
КТ9141А	n-p-n	3* Вт	≥1 ГГц	120	3	300	≤100 (120 В)
КТ9141А-1	n-p-n	5* Вт	≥1 ГГц	120	3	400	≤0,1 (120 В)
КТ9142А	n-p-n	72* Вт	—	55	3	15 А	≤100 мА (55 В)
КТ9143А	p-n-p	3* Вт	≥1500	75	3	100 (300*)	≤1* мА (50 В)
КТ9143Б	p-n-p	3* Вт	≥1500	75	3	100 (300*)	≤1* мА (50 В)
КТ9143В	p-n-p	3* Вт	≥1000	75	3	100 (300*)	≤1* мА (50 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
— —	— —	≥6** ≥6**	≥1000** (1,4...1,6 ГГц) ≥800** (1,4...1,6 ГГц)	— —	**КТ9134**
—	≤260 (45 В)	≥7** (500 МГц)	≥500** (500 МГц)	≤20	**КТ9136**
10...60* (5 В; 0,25 А)	≤12 (28 В)	≤12	≥2,5** (400 МГц)	≤20	**КТ914**
15...45* (5 В; 50 мА)	≤2,5 (10 В)	—	—	—	**КТ9141**
15...45* (5 В; 50 мА)	≤2,5 (10 В)	—	—	—	**КТ9141-1**
≥10 (5 В; 0,5 А)	≤70 (28 В)	≥6**	50** (860 МГц)	—	**КТ9142**
≥20* (5 В; 50 мА) 20...60* (5 В; 50 мА) ≥20* (5 В; 50 мА)	≤3 (10 В) ≤3 (10 В) ≤4 (10 В)	— — —	— — —	— — —	**КТ9143**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$ $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ9144А-5 **КТ9145А-5**	p-n-p n-p-n	5* Вт 5* Вт	≥30 ≥50	500 500	5 5	50 (100*) 50 (100*)	≤1 (500 В) ≤1 (500 В)
КТ9144А-9 **КТ9145А-9**	p-n-p n-p-n	0,3 Вт; 1* Вт 0,3 Вт; 1* Вт	≥30 ≥50	500 500	5 5	50 (100*) 50 (100*)	≤1 (500 В) ≤1 (500 В)
КТ9146А	n-p-n	380** Вт	—	50	3	19* А	≤50 мА (50 В)
КТ9146Б **КТ9146В**	n-p-n n-p-n	260** Вт 65** Вт	— —	50 50	3 3	13* А 3,3* А	≤33 мА (50 В) ≤8 мА (50 В)
КТ9147АС	n-p-n	233** Вт	—	50* (10 Ом)	4	29 А	—
КТ9150А	n-p-n	50* Вт	—	40* (10 Ом)	4	5 А	≤25* мА (40 В)
КТ9151А	n-p-n	280* Вт	≥230	55	3	33 А	≤150* мА (55 В)
КТ9152А	n-p-n	246* Вт	—	55	3	24 А	≤200 мА (55 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r'_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥20* (10 В; 10 мА) 20...150 (10 В; 10 мА)	— —	≤100 ≤100	— —	— —	**КТ9144-5, КТ9145-5**
20...150 (10 В; 10 мА) 20...150 (10 В; 10 мА)	— —	≤60 ≤100	— —	— —	**КТ9144-9, КТ9145-9**
—	—	≥6**	≥200** (1,55 ГГц)	—	**КТ9146А**
— —	— —	≥6** ≥7**	≥130** (1,55 ГГц) ≥35** (1,55 ГГц)	— —	**КТ9146 (Б, В)**
—	—	≥6**	≥160** (400 МГц)	—	**КТ9147**
≥10* (5 В; 0,5 А)	≤42 (25 В)	≥8,5** (860 МГц)	≥8** (860 МГц)	—	**КТ9150**
≥10* (5 В; 0,5 А)	≤350 (28 В)	≥7** (230 МГц)	≥200** (230 МГц)	—	**КТ9151, КТ9152**
≥10* (5 В; 0,5 А)	≤100 (28 В)	≥6** (860 МГц)	≥100** (860 МГц)	—	

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ9153АС	n-p-n	50** Вт	—	50* (10 Ом)	4	4 А	—
КТ9153БС	n-p-n	94* Вт	—	50* (10 Ом)	4	10 А	≤60* мА (50 В)
КТ9155А **КТ9155Б**	n-p-n n-p-n	43* Вт 100* Вт	— —	50 50	3 3	4 А 15 А	≤25* мА (50 В) ≤25* мА (50 В)
КТ9155В	n-p-n	181* Вт	—	50	3	24 А	≤25* мА (50 В)
КТ9156АС	n-p-n	50** Вт	—	50* (10 Ом)	3	4 А	≤60** мА (50 В)
КТ9156БС	n-p-n	94* Вт	—	50* (10 Ом)	3	10 А	≤60* мА (50 В)
КТ9157А	n-p-n	1,2 Вт; 10* Вт	≥100	30	5	5 (10*) А	≤10 (30 В)
КТ9160А **КТ9160Б** **КТ9160В**	n-p-n n-p-n n-p-n	465* Вт (50°С) 465* Вт (50°С) 465* Вт (50°С)	≥60 ≥60 ≥60	140* (10 Ом) 140* (10 Ом) 140* (10 Ом)	4 4 4	30 А 30 А 30 А	≤200* мА (140 В) ≤200* мА (140 В) ≤200* мА (140 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r'_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
—	—	≥7,8**	≥15** (390...640МГц)	—	КТ9153
≥10* (5 В; 0,5 А)	≤66 (28 В)	≥7**	≥50** (615...840 МГц)	—	КТ9153, КТ9155
≥10* (5 В; 0,5 А) ≥10* (5 В; 0,5 А)	≤35 (28 В) ≤35 (28 В)	≥6,5** (860 МГц) ≥6** (860 МГц)	≥15** (860 МГц) ≥50** (860 МГц)	— —	
≥10* (5 В; 0,5 А)	≤35 (28 В)	≥5** (860 МГц)	≥100** (860 МГц)	—	КТ9155В
—	—	≥7**	≥15** (0,65...1 ГГц)	—	КТ9156
≥10* (5 В; 0,5 А)	≤66 (28 В)	≥6** (1 ГГц)	≥50** (1 ГГц)	—	КТ9156
140...450* (1 В; 0,5 А)	≤150 (5 В)	≤0,25	—	—	КТ9157
10...30* (10 В; 30 А) 20...50* (10 В; 30 А) 40...90* (10 В; 30 А)	≤700 (60 В) ≤700 (60 В) ≤700 (60 В)	≥15** (1,5 МГц) ≥15** (1,5 МГц) ≥15** (1,5 МГц)	≥700** (1,5 МГц) ≥700** (1,5 МГц) ≥700** (1,5 МГц)	— — —	КТ9160

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ9161АС	n-p-n	700* Вт	—	60	4	25 А	≤280 мА (60 В)
КТ9164А	n-p-n	—	—	—	—	—	—
КТ9166А	n-p-n	60* Вт	—	45	—	15 А	—
КТ916А **КТ916Б**	n-p-n n-p-n	30* Вт 30* Вт	≥1100 ≥900	55* (0,01к) 55	3,5 3,5	2 (4*) А 2 (4*) А	≤25* мА (55 В) ≤40* мА (55 В)
КТ9173А	n-p-n	140* Вт	—	55* (10 Ом)	4	14 А	≤250* мА (55 В)
КТ9174А	n-p-n	400* Вт	—	55* (10 Ом)	3	30 А	≤150* мА (55 В)
КТ9176А	p-n-p	10* Вт	≥90	40	5	3 (7*) А	≤1 (30 В)
КТ9177А	n-p-n	10* Вт	≥90	40	5	3 (7*) А	≤1 (30 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥20* (5 В; 0,5 А)	—	≥7** (500 МГц)	≥500** (500 МГц)	—	КТ9161
—	—	≥6** (1090 МГц)	≥300** (1090 МГц)	—	КТ9164
≥50* (1 В; 4 А)	—	≤0,06	—	—	КТ9166
35* (5 В; 0,25 А) 35* (5 В; 0,25 А)	≤20 (30 В) ≤20 (30 В)	≤0,8; ≥2,25** ≤0,8; ≥1,85**	≥20** (1 ГГц) ≥16** (1 ГГц)	≤10 ≤10	КТ916
≥20* (5 В; 0,5 А)	≤230 (28 В)	≥10** (230 МГц)	≥50** (225 МГц)	—	КТ9173
—	—	≥4** (230 МГц)	≥300** (230 МГц)	—	КТ9174
60...400* (2 В; 1 А)	45 (10 В)	≤0,25	—	—	КТ9176, КТ9177
60...400* (2 В; 1 А)	—	≤0,25	—	—	

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ9180А	p-n-p	1,5 Вт; 12,5*Вт	≥100	40	5	3 А (7* А)	≤1 (30 В)
КТ9180Б	p-n-p	12,5*Вт	≥100	60	7	3 А (7* А)	≤1 (60 В)
КТ9180В	p-n-p	12,5*Вт	≥100	80	7	3 А (7* А)	≤1 (80 В)
КТ9180Г	p-n-p	12,5*Вт	≥100	100	7	3 А (7* А)	≤1 (100 В)
КТ9181А	n-p-n	12,5*Вт	≥100	40	5	3 А (7* А)	≤1 (30 В)
КТ9181Б	n-p-n	12,5*Вт	≥100	60	7	3 А (7* А)	≤1 (60 В)
КТ9181В	n-p-n	12,5*Вт	≥100	80	7	3 А (7* А)	≤1 (80 В)
КТ9181Г	n-p-n	12,5*Вт	≥100	100	7	3 А (7* А)	≤1 (100 В)
КТ918А-2	n-p-n	2,5* Вт	≥800	30	2,5	250	≤2 мА (30 В)
КТ918Б-2	n-p-n	2,5* Вт	≥1000	30	2,5	250	≤2 мА (30 В)
КТ9182А	n-p-n	300* Вт	—	55* (10 Ом)	3	24 А	≤200 мА (55 В)
КТ9186А	n-p-n	5 Вт	≥50	100; 60*	—	1 А	—
КТ9186Б	n-p-n	5 Вт	≥50	80; 60*	—	1 А	—
КТ9186В	n-p-n	5 Вт	≥50	50; 40*	—	1 А	—
КТ9186Г	n-p-n	5 Вт	≥50	40*	—	1 А	—
КТ9186Д	n-p-n	5 Вт	≥50	40*	—	1 А	—
КТ9189А-2	n-p-n	2** Вт	1000	—	—	0,5 А	—
КТ9189Б-2	n-p-n	5** Вт	1000	—	—	1 А	—
КТ9189В-2	n-p-n	8** Вт	900	—	—	1,6 А	—
КТ919А	n-p-n	10* Вт	≥1350	45	3,5	0,7 (1,5*) А	≤10 мА (45 В)
КТ919Б	n-p-n	5* Вт	≥1350	45	3,5	0,35 (0,7*) А	≤5 мА (45 В)
КТ919В	n-p-n	3,25* Вт	≥1350	45	3,5	0,2 (0,4*) А	≤2 мА (45 В)
КТ919Г	n-p-n	10* Вт	≥1350	45	3,5	0,7 (1,5*) А	≤10 мА (45 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
60...400* (2 В; 1 А) 50...250* (1 В; 0,15 А) 50...250* (1 В; 0,15 А) 50...250* (1 В; 0,15 А)	— — — —	≤0,25 ≤0,4 ≤0,4 ≤0,4	— — — —	— — — —	**КТ9180, КТ9181**
60...400* (2 В; 1 А) 50...250* (1 В; 0,15 А) 50...250* (1 В; 0,15 А) 50...250* (1 В; 0,15 А)	— — — —	≤0,25 ≤0,4 ≤0,4 ≤0,4	— — — —	— — — —	
— —	≤4,2 (15 В) ≤4,2 (15 В)	≥2** ≥2**	≥0,25** (3 ГГц) ≥0,5** (3 ГГц)	≤15 ≤4	**КТ918-2**
—	—	≥3** (860 МГц)	≥150** (860 МГц)	—	**КТ9182**
80...250 80...250 80...250 80...250 80...250	— — — — —	≤0,2 ≤0,2 ≤0,2 ≤0,2 ≤0,2			**КТ9186**
— — —	4,5 13 20	12** (470 МГц) 10** (470 МГц) 6** (470 МГц)	0,5** (175 МГц) 2** (175 МГц) 5** (175 МГц)	— — —	**КТ9189**
	≤10 (28 В) ≤6,5 (28 В) ≤5 (28 В) ≤12 (28 В)	— — — —	≥3,5** (2 ГГц) ≥1,6** (2 ГГц) ≥0,8** (2 ГГц) ≥3** (2 ГГц)	≤2,2 ≤2,2 ≤2,2 ≤2,2	**КТ919**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ9190А	n-p-n	40** Вт	720	—	—	8 А	—
КТ9190А-4	n-p-n	40** Вт	720	—	—	8 А	—
КТ9192А-2	n-p-n	2** Вт	1200	—	—	0,5 А	—
КТ9192Б-2	n-p-n	5** Вт	1200	—	—	1,6 А	—
КТ9193А	n-p-n	23** Вт	1000	—	—	4 А	—
КТ9193Б	n-p-n	40** Вт	1000	—	—	8 А	—

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_{k}, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_{ш}$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
—	65	—	20** (470 МГц)	—	**КТ9190А**
—	65	—	20** (470 МГц)	—	**КТ9190А-4**
— —	— —	6** (900 МГц) 5** (900 МГц)	0,5** (900 МГц) 2** (900 МГц)	— —	**КТ9192-2**
— —	— —	4 (900 МГц) —	10** (900 МГц) 20** (900 МГц)	— —	**КТ9193**

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$ $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ9193А-4	n-p-n	23** Вт	1000	—	—	4 А	—
КТ9193Б-4	n-p-n	40** Вт	1000	—	—	8 А	—
КТ920А	n-p-n	5* Вт (50°С)	≥400	36	4	0,25 (1*) А	≤2* мА (36 В)
КТ920Б	n-p-n	10* Вт (50°С)	≥400	36	4	1 (2*) А	≤4* мА (36 В)
КТ920В	n-p-n	25* Вт (50°С)	≥400	36	4	3 (7*) А	≤7,5* мА (36 В)
КТ920Г	n-p-n	25* Вт (50°С)	≥350	36	4	3 (7*) А	≤7,5* (36 В)
КТ921А	n-p-n	12,5* Вт (75°С)	≥90	65* (0,1к)	4	3,5 А	≤10* мА (70 В)
КТ921Б	n-p-n	12,5* Вт (75°С)	≥90	65* (0,1к)	4	3,5 А	≤10* мА (70 В)
КТ922А	n-p-n	8* Вт (40°С)	≥300	65* (0,1к)	4	0,8 (1,5*) А	≤5* мА (65 В)
КТ922Б	n-p-n	20* Вт (40°С)	≥300	65* (0,1к)	4	1,5 (4,5*) А	≤20* мА (65 В)
КТ922В	n-p-n	40* Вт (40°С)	≥300	65* (0,1к)	4	3 (9*) А	≤40* мА (65 В)
КТ922Г	n-p-n	20* Вт (40°С)	≥300	65* (0,1к)	4	1,5 (4,5*) А	≤20* мА (65 В)
КТ922Д	n-p-n	40* Вт (40°С)	≥250	65* (0,1к)	4	3 (9*) А	≤40* мА (65 В)
КТ925А	n-p-n	5,5* Вт (40°С)	≥500	36* (0,1к)	4	0,5 (1*) А	≤7 мА (36 В)
КТ925Б	n-p-n	11* Вт (40°С)	≥500	36* (0,1к)	4	1 (3*) А	≤12 мА (36 В)
КТ925В	n-p-n	25* Вт (40°С)	≥450	36* (0,1к)	3,5	3,3 (8,5*) А	≤30 мА (36 В)
КТ925Г	n-p-n	25* Вт (40°С)	≥450	36* (0,1к)	3,5	3,3 (8,5*) А	≤30 мА (36 В)
КТ926А	n-p-n	50* Вт (50°С)	≥51	150* (0,01к)	5	15 (25*) А	≤25* мА (150 В)
КТ926Б	n-p-n	50* Вт (50°С)	≥51	150* (0,01к)	5	15 (25*) А	≤25* мА (150 В)
КТ927А	n-p-n	83,3* Вт (75°С)	≥105	70* (0И)	3,5	10 (30*) А	≤40* мА (70 В)
КТ927Б	n-p-n	83,3* Вт (75°С)	≥105	70* (0И)	3,5	10 (30*) А	≤40* мА (70 В)
КТ927В	n-p-n	83,3* Вт (75°С)	≥105	70* (0И)	3,5	10 (30*) А	≤40* мА (70 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r'_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$τ_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
— —	— —	4 (900 МГц) —	10** (900 МГц) 20** (900 МГц)	— —	**КТ9193-4**
— — — —	≤15 (10 В) ≤25 (10 В) ≤75 (10 В) ≤75 (10 В)	≥7** ≥4,5** ≥3** ≥3**	≥2** (175 МГц) ≥5** (175 МГц) ≥20** (175 МГц) ≥15** (175 МГц)	≤20 ≤20 ≤20 ≤20	**КТ920**
≥10* (10 В; 1 А) ≥10* (10 В; 1 А)	≤50 (20 В) ≤50 (20 В)	≤1,8; ≥8** ≤1,8; ≥5**	≥12,5** (60 МГц) ≥12,5** (60 МГц)	≤22; ≤300* ≤22; ≤300*	**КТ921**
— — — — —	≤15 (28 В) ≤35 (28 В) ≤65 (28 В) ≤35 (28 В) ≤65 (28 В)	≥10** ≥5,5** ≥4** ≥5** ≥3,5**	≥5** (175 МГц) ≥20** (175 МГц) ≥40** (175 МГц) ≥17** (175 МГц) ≥35** (175 МГц)	≤20 ≤20 ≤25 ≤20 ≤25	**КТ922, КТ925**
≥8* (5 В; 0,2 А) — ≥17* (5 В; 0,2 А) —	≤15 (12,6 В) ≤30 (12,6 В) ≤60 (12,6 В) ≤60 (12,6 В)	≥6,3** ≥5** ≥3** ≥2,5**	2** (320 МГц) 5** (320 МГц) 20** (320 МГц) 15** (320 МГц)	≤20 ≤35 ≤40 ≤40	
10...60* (7 В; 15 А) 10...60* (5 В; 5 А)	— —	≤0,17 ≤0,25	— —	— —	**КТ926**
≥15* (6 В; 5 А) ≥25* (6 В; 5 А) ≥40* (6 В; 5 А)	≤190 (28 В) ≤190 (28 В) ≤190 (28 В)	≤0,07; ≥13,4** ≤0,07; ≥13,4** ≤0,07; ≥13,4**	≥75* (20 МГц) ≥75** (20 МГц) ≥75** (20 МГц)	— — —	**КТ927**

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ928А	n-p-n	0,5 Вт; 2* Вт	≥250	60	5	0,8 (1,2*) А	≤5 (60 В)
КТ928Б	n-p-n	0,5 Вт; 2* Вт	≥250	60	5	0,8 (1,2*) А	≤5 (60 В)
КТ928В	n-p-n	0,5 Вт; 2* Вт	≥250	75	5	0,8 (1,2*) А	≤1 (60 В)
КТ929А	n-p-n	6* Вт (40°С)	≥700	30* (0,1к)	3	0,8 (1,5*) А	≤5* мА (30 В)
КТ930А	n-p-n	75* Вт (40°С)	≥450	50* (0,1к)	4	6* А	≤20* мА (50 В)
КТ930Б	n-p-n	120* Вт (40°С)	≥600	50* (0,1к)	4	6* А	≤100* мА (50 В)
КТ931А	n-p-n	150** Вт (40°С)	≥250	60* (0,01к)	4	15 А	≤30* мА (60 В)
КТ932А	p-n-p	20* Вт (50°С)	≥40	80	4,5	2 А	≤1,5* мА (80 В)
КТ932Б	p-n-p	20* Вт (50°С)	≥60	60	4,5	2 А	≤1,5* мА (60 В)
КТ932В	p-n-p	20* Вт (50°С)	≥40	40	4,5	2 А	≤1,5* мА (40 В)
КТ933А	p-n-p	5* Вт (50°С)	≥75	80	4,5	0,5 А	≤0,5* мА (80 В)
КТ933Б	p-n-p	5* Вт (50°С)	≥75	60	4,5	0,5 А	≤0,5* мА (60 В)
КТ934А	n-p-n	7,5* Вт	≥500	60* (0,01к)	4	0,5 А	≤7,5* мА (60 В)
КТ934Б	n-p-n	15* Вт	≥500	60* (0,01к)	4	1 А	≤15* мА (60 В)
КТ934В	n-p-n	30* Вт	≥500	60* (0,01к)	4	2 А	≤30* мА (60 В)
КТ934Г	n-p-n	15* Вт	≥450	60* (0,01к)	4	1 А	≤15* мА (60 В)
КТ934Д	n-p-n	30* Вт	≥450	60* (0,01к)	4	2 А	≤30* мА (60 В)
КТ935А	n-p-n	60* Вт (50°С)	≥51	80* (0,01к)	5	20 (30*) А	≤30* мА (80 В)
КТ936А	n-p-n	28* Вт (75°С)	—	60	3,5	3,3 А	≤10* мА (60 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
20...100* (5 В; 150 мА) 50...200* (5 В; 150 мА) 100...300* (5 В; 150 мА)	≤12 (10 В) ≤12 (10 В) ≤12 (10 В)	≤3,3 ≤3,3 ≤3,3	— — —	≤250* ≤250* ≤250*	**КТ928**
≥25* (5 В; 0,7 А)	≤20 (8 В)	≥8**	≥2** (175 МГц)	≤25	**КТ929**
40* (5 В; 0,5 А) 50* (5 В; 0,5 А)	≤80 (28 В) ≤170 (28 В)	≥5** ≥3,5**	≥40** (400 МГц) ≥75** (400 МГц)	8 11	**КТ930, КТ931**
25* (5 В; 0,5 А)	≤240 (28 В)	0,18; ≥3,5**	≥80** (175 МГц)	18	
≥15* (3 В; 1,5 А) ≥30* (3 В; 1,5 А) ≥40* (3 В; 1,5 А)	≤300 (20 В) ≤300 (20 В) ≤300 (20 В)	≤1 ≤1 ≤1	— — —	— — —	**КТ932**
≥15* (3 В; 0,4 А) ≥30* (3 В; 0,4 А)	≤70 (20 В) ≤70 (20 В)	≤3,75 ≤3,75	— —	— —	**КТ933**
50* (5 В; 0,1 А) 50* (5 В; 0,15 А) 50* (5 В; 0,25 А) — —	≤9 (28 В) ≤16 (28 В) ≤32 (28 В) ≤16 (28 В) ≤32 (28 В)	2; ≥6** 1; ≥4** 0,5; ≥3** ≥3,3** ≥2,4**	≥3** (400 МГц) ≥12** (400 МГц) ≥25** (400 МГц) ≥10** (400 МГц) ≥20** (400 МГц)	≤20 ≤20 ≤20 ≤25 ≤25	**КТ934**
20...100* (4 В; 15 А)	≤800 (10 В)	≤0,066	—	≤700**	**КТ935**
≥6* (3 В; 0,1 А)	—	—	—	—	**КТ936А**

Тип прибора	Структура	$P_{K\,max}$, $P^*_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^*_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{K\,max}$, $I^*_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ936Б	n-p-n	83,3* Вт (75°С)	—	60	3,5	10 А	≤30* мА (60 В)
КТ937А-2	n-p-n	3,6* Вт	6500	25	2,5	250	≤2 мА (25 В)
КТ937Б-2	n-p-n	7,4* Вт	6500	25	2,5	450	≤5 мА (25 В)
КТ938А-2	n-p-n	1,5* Вт	≥2000	28	2,5	180	≤1 мА (28 В)
КТ938Б-2	n-p-n	1,5* Вт	≥1800	28	2,5	180	≤1 мА (28 В)
КТ939А	n-p-n	4* Вт	≥2500	30* (0,01к)	3,5	400	≤2 мА (30 В)
КТ939Б	n-p-n	4* Вт	≥1500	30* (0,01к)	3,5	400	≤2 мА (30 В)
КТ940А	n-p-n	1,2 (10*) Вт	≥90	300* (10к)	5	0,1 (0,3*) А	≤0,05 мА (250В)
КТ940Б	n-p-n	1,2 (10*) Вт	≥90	250* (10к)	5	0,1 (0,3*) А	≤0,05 мА (200 В)
КТ940В	n-p-n	1,2 (10*) Вт	≥90	160* (10к)	5	0,1 (0,3*) А	≤0,05 мА (100 В)
КТ940А1	n-p-n	500, 10* Вт	≥90	300	5	100; 300*	≤0,05 (250 В)
КТ940Б1	n-p-n	500, 10* Вт	≥90	250	5	100; 300*	≤0,05 (200 В)
КТ940В1	n-p-n	500, 10* Вт	≥90	160	5	100; 300*	≤0,05 (100 В)
КТ940А-5	n-p-n	10* Вт	≥90	300	5	100 (300*)	≤50 мА (250 В)
КТ940Б-5	n-p-n	10* Вт	≥90	250	5	100 (300*)	≤50 мА (200 В)
КТ940В-5	n-p-n	10* Вт	≥90	160	5	100 (300*)	≤50 мА (100 В)
КТ940А9	n-p-n	1200	≥90	300	5	100	—
КТ940Б9	n-p-n	1200	≥90	250	5	100	—

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	C_k, C^*_{12}, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^*_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^*_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥6* (3 В; 0,1 А)	—	—	—	—	**КТ936Б**
— —	≤5,5 (20 В) ≤7,5 (20 В)	— —	≥1,6** (5 ГГц) ≥3,2** (5 ГГц)	0,78 0,6	**КТ937-2**
— —	≤4 (20 В) ≤4,5 (20 В)	— —	≥1** (5 ГГц) ≥1** (5 ГГц)	≤2 ≤2	**КТ938-2**
40...200* (12 В; 0,2 А) 20...200 (12 В; 0,2 А)	≤5,5 (12 В) ≤6 (12 В)	— —	— —	≤9 ≤10	**КТ939**
≥25* (10 В; 30 мА) ≥25* (10 В; 40 мА) ≥25* (10 В; 30 мА)	4,2 (30 В) 4,2 (30 В) 4,2 (30 В)	≤33 ≤33 ≤33	— — —	— — —	**КТ940**
≥25 (10 В; 30 мА) ≥25 (10 В; 30 мА) ≥25 (10 В; 30 мА)	≤4,2 (30 В) ≤4,2 (30 В) ≤4,2 (30 В)	≤3,3 ≤3,3 ≤3,3	— — —	— — —	**КТ940-1**
≥25* (10 В; 30 мА) ≥25* (10 В; 30 мА) ≥25* (10 В; 30 мА)	— — —	≤40 ≤40 ≤40	— — —	— — —	**КТ940-5**
≥25 (10 В; 30 мА) ≥25 (10 В; 30 мА)	≤4,2 (30 В) ≤4,2 (30 В)	≤3,3 ≤3,3	— —	— —	**КТ940-9**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ942В	n-p-n	25* Вт	≥1950	45	3,5	1,5 (3*) А	≤20 мА (45 В)
КТ943А	n-p-n	25* Вт	≥30	45	5	2 (6*) А	≤0,1 мА (45 В)
КТ943Б	n-p-n	25* Вт	≥30	60	5	2 (6*) А	≤0,1 мА (60 В)
КТ943В	n-p-n	25* Вт	≥30	100	5	2 (6*) А	≤0,1 мА (100 В)
КТ943Г	n-p-n	25* Вт	≥30	100	5	2 (6*) А	≤1 мА (100 В)
КТ943Д	n-p-n	25* Вт	≥30	100	5	2 (6*) А	≤1 мА (100 В)
КТ944А	n-p-n	55* Вт (90°C)	≥105	100* (0,01к)	5	12,5 (20*) А	≤80* мА (100 В)
КТ945А	n-p-n	50* Вт (50°C)	≥50	150* (10 Ом)	5	15 (25*) А	≤25* мА (150 В)
КТ945Б	n-p-n	50* Вт (50°C)	≥50	150* (10 Ом)	5	15 (25*) А	≤25* мА (150 В)
КТ945В	n-p-n	50* Вт (50°C)	≥50	150* (10 Ом)	5	10 (25*) А	≤25* мА (150 В)
КТ945Г	n-p-n	50* Вт (50°C)	≥50	150* (10 Ом)	5	15 (25*) А	≤25* мА (150 В)
КТ946А	n-p-n	37,5* Вт	≥720	50	3,5	2,5 (5*) А	≤50 мА (50 В)
КТ947А	n-p-n	200* Вт (50°C)	≥75	100* (0,01к)	5	20 (50*) А	≤100* мА (100 В)
КТ948А	n-p-n	40* Вт	≥1950	45	2	2,5 (5*) А	≤35 мА (45 В)
КТ948Б	n-p-n	20* Вт	≥1950	45	2	1,25 (2,5*) А	≤15 мА (45 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
—	≤25 (28 В)	≥2,5**	≥8** (2 ГГц)	≤3	**КТ942**
40...200* (2 В; 0,15 А) 40...160* (2 В; 0,15 А) 40...120* (2 В; 0,15 А) 20...60* (2 В; 0,15 А) 30...100* (2 В; 0,15 А)	— — — — —	≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 ≤1,2 ≤1,2	— — — — —	— — — — —	**КТ943**
10...80* (5 В; 10 А)	≤350 (28 В)	≤0,25; ≥10**	≥100** (30 МГц)	—	**КТ944**
10...60* (7 В; 15 А) 10...60 (7 В; 15 А) 10...60 (7 В; 10 А) 12...60 (7 В; 15 А)	≤200 (30 В) ≤200 (30 В) ≤200 (30 В) ≤200 (30 В)	≤0,17 ≤0,17 ≤0,25 ≤0,17	— — — —	≤1,1* мкс ≤1,1* мкс ≤1,1* мкс ≤1,1* мкс	**КТ945**
—	≤50 (10 В)	≥4**	≥27** (1 МГц)	—	**КТ946**
10...80* (5 В; 20 А)	≤850 (27 В)	≥10**	≥250** (1,5 МГц)	—	**КТ947**
— —	≤30 (28 В) ≤17 (28 В)	≥6,5** ≥6,5**	≥15** (2 ГГц) ≥8** (2 ГГц)	— —	**КТ948**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ955А	n-p-n	20* Вт (100°С)	≥100	70* (0,01к)	4	6 А	≤10 мА (60 В)
КТ956А	n-p-n	70** Вт (100°С)	≥100	100* (0,01к)	4	15 А	≤80* мА (100 В)
КТ957А	n-p-n	100** Вт (100°С)	≥100	60* (0,01к)	4	20 А	≤100* мА (60 В)
КТ958А	n-p-n	85** Вт (40°С)	≥300	36* (0,01к)	4	10 А	≤25* мА (36 В)
КТ960А	n-p-n	70** Вт (40°С)	≥600	36* (0,01к)	4	7 А	≤20* мА (36 В)
КТ961А	n-p-n	1 (12,5*) Вт	≥50	100* (1к)	5	1,5 (2*) А	≤10 (60 В)
КТ961Б	n-p-n	1 (12,5*) Вт	≥50	80* (1к)	5	1,5 (2*) А	≤10 (60 В)
КТ961В	n-p-n	1 (12,5*) Вт	≥50	60* (1к)	5	1,5 (2*) А	≤10 (60 В)
КТ961Г	n-p-n	1 (12,5*) Вт	≥50	40* (1к)	5	2 (3*) А	≤10 (60 В)
КТ961А1	n-p-n	500	≥50	100	5	1000	≤10 (60 В)
КТ961Б1	n-p-n	500	≥50	80	5	1000	≤10 (60 В)
КТ961В1	n-p-n	500	≥50	60	5	1000	≤10 (60 В)
КТ962А	n-p-n	17** Вт (40°С)	≥750	50	4	1,5 А	≤20 мА (50 В)
КТ962Б	n-p-n	27** Вт (40°С)	≥750	50	4	2,5 А	≤20 мА (50 В)
КТ962В	n-p-n	66** Вт (40°С)	≥600	50	4	4 А	≤30 мА (50 В)
КТ963А-2	n-p-n	1,1* Вт	—	18	1,5	210	≤1 мА (18 В)
КТ963Б-2	n-p-n	1,1* Вт	—	18	1,5	185	≤1 мА (18 В)
КТ963А-5	n-p-n	1,1* Вт	—	18	1,5	210	≤1 мА (18 В)
КТ963Б-5	n-p-n	1,1* Вт	—	18	1,5	185	≤1 мА (18 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
10...80* (5 В; 1 А)	≤75 (28 В)	≥20**	≥20** (30 МГц)	—	**КТ955**
10...80* (5 В; 1 А)	≤400 (28 В)	≥20**	≥100** (30 МГц)	—	**КТ956, КТ957**
10...80* (5 В; 5 А)	≤600 (28 В)	≥17**	≥125** (30 МГц)	—	
≥10* (8 В; 0,5 А)	≤180 (12 В)	0,16; ≥4**	≥40** (175 МГц)	12	**КТ958, КТ960**
—	≤120 (12 В)	0,16; ≥2,5**	≥40** (400 МГц)	12,5	
40...100* (2 В; 0,15 А) 63...160* (2 В; 0,15 А) 100...250* (2 В; 0,15 А) 20...500* (2 В; 0,15 А)	— — — —	≤1 ≤1 ≤1 ≤1	— — — —	— — — —	**КТ961**
40...100 (2 В; 0,15 А) 63...160 (2 В; 0,15 А) 100...250 (2 В; 0,15 А)	≤45 ≤45 ≤45	≤1 ≤1 ≤1	— — —	— — —	**КТ961-1**
— — —	≤20 (28 В) ≤35 (28 В) ≤50 (28 В)	≥4** ≥3,5** ≥3**	≥10** (1 ГГц) ≥20** (1 ГГц) ≥40** (1 ГГц)	≤15 ≤14 ≤11	**КТ962**
— —	1,5 (5 В) 1,5 (5 В)	≥3** (10 ГГц) ≥3** (10 ГГц)	≥0,8** (10 ГГц) ≥0,5** (10 ГГц)	— —	**КТ963-2**
— —	1,5 (5 В) 1,5 (5 В)	≥3** (10 ГГц) ≥3** (10 ГГц)	≥0,8** (10 ГГц) ≥0,8** (10 ГГц)	— —	**КТ963-5**

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ965А	n-p-n	32* Вт	≥100	36* (0,01к)	4	4 А	≤10* мА (36 В)
КТ966А	n-p-n	64* Вт	≥100	36* (0,01к)	4	8 А	≤23* мА (36 В)
КТ967А	n-p-n	100** Вт	≥180	36* (0,01к)	4	15 А	≤20* мА (36 В)
КТ969А	n-p-n	1 (6*) Вт	≥60	300	5	100 (200*)	≤0,05 (200 В)
КТ969А1	n-p-n	≥6,1* Вт	≥60	300	5	100	≤0,05 (200 В)
КТ969А-5	n-p-n	6* Вт	≥60	300	5	100 (200*)	≤50 мА (200 В)
КТ970А	n-p-n	170** Вт	≥600	50* (0,01к)	4	13 А	100* мА (50 В)
КТ971А	n-p-n	200** Вт	≥220	50* (0,01к)	4	17 А	≤60* мА (50 В)
КТ972А	n-p-n	8* Вт	≥200	60* (1к)	5	4* А	≤1* мА (60 В)
КТ972Б	n-p-n	8* Вт	≥200	45* (1к)	5	4* А	≤1* мА (45 В)
КТ972В	n-p-n	8* Вт	≥200	60* (1к)	5	2 А	≤1* мА (60 В)
КТ972Г	n-p-n	8* Вт	≥200	60* (1к)	5	2 А	≤1* мА (60 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^*_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
10...60* (5 В; 1 А)	≤100 (12,6 В)	≥13**	≥20** (30 МГц)	—	**КТ965**
—	≤250 (12,6 В)	≥16**	≥40** (30 МГц)	—	**КТ966**
10...100* (5 В; 5 А)	≤500 (12,6 В)	≥18**	≥90** (30 МГц)	—	**КТ967**
50...250* (10 В; 15 мА)	≤1,8 (30 В)	≤60	—	—	**КТ969**
50...250 (10 В; 15 мА)	≤1,8 (30 В)	≤60	—	—	**КТ969-1**
≥50* (10 В; 15 мА)	—	≤70	—	—	**КТ969-5**
— —	180 (28 В) ≤330 (28 В)	≥4** ≥3**	≥100** (400 МГц) ≤150** (175 МГц)	≤25 ≤40	**КТ970, КТ971**
≥750* (3 В; 1 А) ≥750* (3 В; 1 А) 750...5000 (3 В; 1 А) 750...5000 (3 В; 1 А)	— — — —	≤3 ≤3 ≤3 ≤1,9	— — — —	≤200* ≤200* ≤200* ≤200*	**КТ972**

Тип прибора	Структура	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ973А	p-n-p	8* Вт	≥200	60* (1к)	5	4* А	≤1* мА (60 В)
КТ973Б	p-n-p	8* Вт	≥200	45* (1к)	5	4* А	≤1* мА (45 В)
КТ973В	p-n-p	8* Вт	≥200	60* (1к)	5	2 А	≤1* мА (60 В)
КТ973Г	p-n-p	8* Вт	≥200	60* (1к)	5	2 А	≤1* мА (60 В)
КТ976А	n-p-n	75** Вт (40°C)	≥750	50	4	6 А	≤60 мА (50 В)
КТ977А	n-p-n	200** Вт (85°C)	≥600	50	3	8* А	≤25 мА (50 В)
КТ979А	n-p-n	75* Вт	—	50	3,5	5 А; 10* А	≤100 мА (50 В)
КТ980А	n-p-n	300* Вт	≥150	100* (0,01к)	4	15 А	≤100 мА (100 В)
КТ980Б	n-p-n	300* Вт	≥150	100* (0,01к)	4	15 А	≤100 мА (100 В)
КТ981А	n-p-n	70* Вт	—	36* (0,01к)	4	10 А	≤50* мА (36 В)
КТ983А	n-p-n	8,7* Вт	≥1200	40* (0,01к)	4	0,5 А	≤5* мА (40 В)
КТ983Б	n-p-n	13* Вт	≥900	40* (0,01к)	4	1 А	≤8* мА (40 В)
КТ983В	n-p-n	22,5* Вт	≥750	40* (0,01к)	4	2 А	≤18* мА (40 В)

h_{21}, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥750* (3 В; 1 А) ≥750* (3 В; 1 А) 750...5000 (3 В; 1 А) 750...5000 (3 В; 1 А)	— — — —	≤3 ≤3 ≤3 ≤2	— — — —	≤200* ≤200* ≤200* ≤200*	**КТ973**
—	≤70 (28 В)	≥2**	≥60** (1 ГГц)	≤25	**КТ976**
—	—	—	≥50** (1,5 ГГц)	—	**КТ977**
—	—	≥6**	≥50** (1,3 ГГц)	—	**КТ979**
≥15* (10 В; 5 А) ≥10 (10 В; 5 А)	≤450 (50 В) ≤450 (50 В)	≥25** (30 МГц) ≥5** (80 МГц)	≥250** (30 МГц) ≥250* (80 МГц)	— —	**КТ980**
10...90* (5 В; 5 А)	≤400 (12,6 В)	≥5**	≥50** (80 МГц)	—	**КТ981**
≥20* (5 В; 0,5 А) ≥10* (5 В; 0,5 А) ≥10* (5 В; 0,5 А)	≤8 (28 В) ≤12 (28 В) ≤24 (28 В)	≥4** ≥3,6** ≥3,2**	≥0,5** (860 МГц) ≥1** (860 МГц) ≥3,5** (860 МГц)	— — —	**КТ983**

Тип прибора	Структура	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ max}$, $U^{*}_{КЭR\ max}$, $U^{**}_{КЭО\ max}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ984А	n-p-n	1,4* Вт	≥720	65	4	7* А	≤30 мА (65 В)
КТ984Б	n-p-n	4,7* Вт	≥720	65	4	16* А	≤80 мА (65 В)
КТ985АС	n-p-n	105* Вт	≥660	50* (0,01к)	4	17 А	≤120* мА (50 В)
КТ986А	n-p-n	910** Вт	—	50	3	26* А	≤60 мА (50 В)
		910** Вт	—	50	3	26* А	≤50 мА (50 В)
КТ986Б	n-p-n						
КТ986В	n-p-n	910** Вт	—	50	3	26* А	≤50 мА (50 В)
КТ986Г	n-p-n	910** Вт	—	50	3	26* А	≤40 мА (50 В)
КТ991АС	n-p-n	67* Вт	≥600	50	4	3,7 А	≤50 мА (50 В)
КТ996А-2	n-p-n	2,5* Вт	≥4 ГГц	20	2,5	200 (0,3* А)	≤1* мА (20 В)
КТ996Б-2	n-p-n	2,5* Вт	≥4 ГГц	20	2,5	200 (0,3* А)	≤1* мА (20 В)
КТ996В-2	n-p-n	2,5* Вт	≥4 ГГц	20	2,5	200 (0,3* А)	≤1* мА (20 В)
КТ996А-5	n-p-n	2,5* Вт	≥4 ГГц	20	2,5	200 (0,3* А)	≤5 мА (20 В)
КТ996Б-5	n-p-n	2,5* Вт	≥4 ГГц	20	2,5	200 (0,3* А)	≤5 мА (20 В)
КТ996В-5	n-p-n	2,5* Вт	≥4 ГГц	20	2,5	200 (0,3* А)	≤5 мА (20 В)
КТ997А	n-p-n	50* Вт	≥51	45	5	10 (20*) А	≤10 мА (45 В)
КТ997Б	n-p-n	50* Вт	≥51	45	5	10 (20*) А	≤10 мА (45 В)
КТ997В	n-p-n	50* Вт	≥51	60	5	10 (20*) А	≤10 мА (60 В)

h_{21}, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\,нас}$, Ом $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
— —	≤35 (30 В) ≤80 (30 В)	≥5** ≥4**	≥75** (820 МГц) ≥250** (820 МГц)	≤20 ≤20	КТ984
—	≤270 (28 В)	≥3,5**	≥125** (0,4 ГГц)	≤21	КТ985
3,8 4 5 5	— — — —	≥6** ≥6** ≥7** ≥7**	≥350** (1,4...1,6 ГГц) ≥300** (1,6 ГГц) ≥350** (1,6 ГГц) ≥350** (0,8 ГГц)	— — — —	КТ986
—	≤75 (28 В)	≥6**	≥55** (0,7 ГГц)	≤6,8	КТ991
≥35* (10 В; 0,1 А) ≥70* (10 В; 0,1 А) ≥35* (10 В; 0,1 А)	≤2,3 (10 В) ≤2,3 (10 В) ≤2,3 (10 В)	— — —	— — ≥0,11** (650 МГц)	— — —	КТ996-2
≥35* (10 В; 0,1 А) ≥70* (10 В; 0,1 А) ≥35* (10 В; 0,1 А)	≤2,3 (10 В) ≤2,3 (10 В) ≤2,3 (10 В)	— — —	— — ≥0,11** (650 МГц)	— — —	КТ996-5
≥40* (1 В; 4 А) ≥20* (1 В; 4 А) ≥20* (1 В; 4 А)	≤270 (10 В) ≤270 (10 В) —	≤0,125 ≤0,125 ≤0,125	— — —	≤500* ≤500* —	КТ997

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ999А	n-p-n	1,6 Вт; 5* Вт	≥60	250	5	50 (100*)	≤0,1 (250 В)
КТД8264А	Составной n-p-n	1,5 Вт; 125*Вт	—	350* (0,1к)	5	20 А	≤0,1 (300 В)
КТД8264А5	Составной n-p-n	1,5 Вт; 125*Вт	—	350* (0,1к)	5	20 А	≤0,1 (300 В)
КТД8275А **КТД8275Б** **КТД8275В**	Составной n-p-n	125* Вт 125* Вт 125* Вт	≥15 ≥15 ≥15	100 80 60	5 5 5	20 А 20 А 20 А	— — —
КТД8276А **КТД8276Б** **КТД8276В** **КТД8276Г**	Составной n-p-n	60* Вт 60* Вт 60* Вт 60* Вт	≥15 ≥15 ≥15 ≥15	100 80 60 45	5 5 5 5	8 А 8 А 8 А 8 А	— — — —

h_{21}, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р.}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r'_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥50 (10 В; 25 мА)	≤2 (30 В)	≤66	—	—	КТ999
300 (10 В; 5 А)	—	≤0,18	—	—	КТД8264
300 (10 В; 5 А)	—	≤0,18	—	—	КТД8264-5
750...18000 750...18000 750...18000	— — —	≤0,2 ≤0,2 ≤0,2			КТД8275
≥750 ≥750 ≥750 ≥750	— — — —	≤0,66 ≤0,66 ≤0,66 ≤0,66			КТД8276

2.8. Биполярные кремниевые сборки

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,1\,max}$, $P^{**}_{К,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТС303А-2	p-n-p, n-p-n	500 (50°С)	≥300	45* (10к)	—	100 (500*)	≤0,5 (45 В)
КТС3103А	p-n-p	300 (55°С)	≥600	15* (15к)	5	20 (50*)	≤200 (15 В)
КТС3103Б	p-n-p	300 (55°С)	≥600	15* (15к)	5	20 (50*)	≤200 (15 В)
КТС3103А1	p-n-p	300	≥600	15* (15к)	5	20 (50*)	≤0,2 мА (15 В)
КТС3103Б1	p-n-p	300	≥600	15* (15к)	5	20 (50*)	≤0,2 мА (15 В)
КТС3161АС	1 n-p-n, 2 p-n-p	300	≥400	12	4	200	≤10 (12 В)
КТС3174АС-2	n-p-n	150	600	10	1	7,5	≤1 (10 В)
КТС381Б	n-p-n	15	—	25	6,5	15	≤30 (5 В)
КТС381В	n-p-n	15	—	25	6,5	15	≤30 (5 В)
КТС381Г	n-p-n	15	—	25	6,5	15	≤30 (5 В)
КТС381Д	n-p-n	15	—	25	6,5	15	≤30 (5 В)
КТС381Е	n-p-n	15	—	25	6,5	15	≤30 (5 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $h_{21э1}/h^*_{21э2}$, $U^{**}_{эб}$, мВ	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
40...180 (5 В; 1 мА)	≤8 (5 В)	≤20	≥0,7*	≤80	**КТС303-2**
40...200 (1 В; 1 мА) 40...200 (1 В; 1 мА)	≤2,5 (5 В) ≤2,5 (5 В)	≤60 ≤60	≤5 (60 МГц); ≥0,9* ≤5 (60 МГц); ≥0,8* ≤3** ≤5**	≤80 ≤80	**КТС3103**
40...200 (1 В; 1 мА) 40...200 (1 В; 1 мА)	≤2,5 (5 В) ≤2,5 (5 В)	≤60 ≤60	≥0,9* ≥0,8*	≤80 ≤80	**КТС3103-1**
≥20 (1 В; 0,1 А)	—	≤8	—	—	**КТС3161**
≥80 (5 В; 3 мА)	0,65 (6 В)	—	≤3 (100 МГц)	—	**КТС3174**
≥40 (5 В; 10 мкА) ≥30 (5 В; 10 мкА) ≥20 (5 В; 10 мкА) ≥20 (5 В; 10 мкА) ≥20 (5 В; 10 мкА)	≤1,5 (5 В) ≤1,5 (5 В) ≤1,5 (5 В) ≤1,5 (5 В) ≤1,5 (5 В)	≤5 ≤5 — ≤5 ≤5	≥0,9*; ≤4** ≥0,85*; ≤4** — ≥0,85*; ≤3** ≥0,9*	— — — — —	**КТС381**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,t\,max}$, $P^{**}_{К,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТС393А	p-n-p	20 (45°C)	≥500	10* (10к)	4	10 (20*)	≤0,1 (10 В)
КТС393Б	p-n-p	20 (45°C)	≥500	15* (10к)	4	10 (20*)	≤0,2 (15 В)
КТС393А-1	p-n-p	20	≥500	10	4	10 (20*)	≤0,1 (10 В)
КТС393Б-1	p-n-p	20	≥500	15	4	10 (20*)	≤0,2 (15 В)
КТС393А-9	p-n-p	20	≥500	10	4	10 (20*)	≤0,1 (10 В)
КТС393Б-9	p-n-p	20	≥500	15	4	10 (20*)	≤0,2 (15 В)
КТС394А-2	p-n-p	300*	≥300	45* (10к)	4	100	≤0,5 (45 В)
КТС394Б-2	p-n-p	300*	≥300	45* (10к)	4	100	≤0,5 (10 В)
КТС395А-1	n-p-n	30	≥300	45* (10к)	4	20	≤0,5 (45 В)
КТС395Б-1	n-p-n	30	≥300	45* (10к)	4	20	≤0,5 (10 В)
КТС395А-2	n-p-n	150 (500**)	≥300	45* (10к)	4	100	≤0,5 (45 В)
КТС395Б-2	n-p-n	150 (500**)	≥300	45* (10к)	4	100	45* (10к)
КТС395В-2	n-p-n	150 (500**)	≥300	45* (10к)	4	100	45* (10к)
КТС398А-1	n-p-n	30 (85°C)	≥1000	10* (10к)	4	10 (20*)	≤0,5 (10 В)
КТС398Б-1	n-p-n	30 (85°C)	≥1000	10* (10к)	4	10 (20*)	≤0,5 (10 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $h_{21э1}/h^{*}_{21э2}$, $U^{**}_{эб}$, мВ	$\tau_к$, пс, $t^{*}_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
40...180 (1 В; 1 мА) 30...140 (1 В; 1 мА)	≤2 (5 В) ≤2 (5 В)	≤60 ≤60	≤6 (60 МГц); ≥0,9* ≤6 (60 МГц); ≥0,8*	≤80 ≤80	**КТС393**
40...180 (1 В; 1 мА) 30...140 (1 В; 1 мА)	≤2 (5 В) ≤2 (5 В)	≤60 ≤60	≤6 (60 МГц) ≤6 (60 МГц)	≤80 ≤80	**КТС393-1**
40...180 (1 В; 1 мА) 30...140 (1 В; 1 мА)	≤2 (5 В) ≤2 (5 В)	≤60 ≤60	≤6 (60 МГц) ≤6 (60 МГц)	≤80 ≤80	**КТС393-9**
40...120 (5 В; 1 мА) 100...300 (5 В; 1 мА)	≤8 (10 В) ≤8 (10 В)	≤30 ≤30	≤10** —	— —	**КТС394-2**
40...120 (5 В; 1 мА) ≥350 (5 В; 1 мА)	≤8 (10 В) ≤8 (10 В)	≤30 ≤30	≤10** —	— —	**КТС395-1**
40...120 (5 В; 1 мА) 100...300 (5 В; 1 мА) ≥350 (5 В; 1 мА)	≤8 (10 В) ≤8 (10 В) ≤8 (10 В)	≤30 ≤30 ≤230	≤10** — —	— — —	**КТС395-2**
40...250 (1 В; 1 мА) 40...250 (1 В; 1 мА)	≤1,5 (5 В) ≤1,5 (5 В)	— —	0,8...1,25*; ≤1,5** 0,9...1,1*; ≤3**	≤50 ≤50	**КТС398-1**

Тип прибора	Структура	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,т\,max}$, $P^{**}_{К,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТС398А94	n-p-n	30	≥1 ГГц	10* (10к)	4	10 (20*)	≤0,5 (10 В)
КТС398Б94	n-p-n	30	≥1 ГГц	10* (10к)	4	10 (20*)	≤0,5 (10 В)
КТС613А	n-p-n	800 (50°C)	≥200	60	4	400 (800*)	≤8 (60 В)
КТС613Б	n-p-n	800 (50°C)	≥200	60	4	400 (800*)	≤8 (60 В)
КТС613В	n-p-n	800 (50°C)	≥200	40	4	400 (800*)	≤8 (40 В)
КТС613Г	n-p-n	800 (50°C)	≥200	40	4	400 (800*)	≤8 (40 В)
КТС622А	p-n-p	0,4 (10**) Вт	≥200	45* (1к)	4	400 (600*)	≤10 (45 В)
КТС622Б	p-n-p	0,4 (10**) Вт	≥200	35* (1к)	4	400 (600*)	≤20 (35 В)
КТС631А	n-p-n	4 Вт (55°C)	≥350	30	4	1 (1,3*) А	≤200 (30 В)
КТС631Б	n-p-n	4 Вт (55°C)	≥350	30	4	1 (1,3*) А	≤50 (30 В)
КТС631В	n-p-n	4 Вт (55°C)	≥350	60	4	1 (1,3*) А	≤50 (60 В)
КТС631Г	n-p-n	4 Вт (55°C)	≥350	60	4	1 (1,3*) А	≤200 (60 В)
КТ674АС	p-n-p	900	≥250	40	5	0,2 А (0,5* А)	≤0,05 (30 В)
КТ677АС	n-p-n	2500	100	60	—	1 А	≤0,05

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ $h_{21э1}/h^*_{21э2}$, $U^{**}_{эб}$, мВ	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
40...250 (1 В; 1 мА) 40...250 (1 В; 1 мА)	≤1,5 (5 В) ≤1,5 (5 В)	— —	0,8...1,25* 0,9...1,1*	≤50 ≤50	**КТС398-94**
25...100* (5 В; 0,2 А) 40...200* (5 В; 0,2 А) 20...120* (5 В; 0,2 А) 50...300* (5 В; 0,2 А)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤15 (10 В)	≤2,5 ≤2,5 ≤2,5 ≤2,5	— — — —	≤100* ≤100* ≤100* ≤100*	**КТС613**
25...150* (5 В; 0,2 А) ≥10* (5 В; 0,2 А)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В)	≤3,25 ≤3,25	— —	≤120* ≤200*	**КТС622**
20...115* (1 В; 0,3 А) 20...125* (1 В; 0,3 А) 20...125* (1 В; 0,3 А) 20...115* (1 В; 0,3 А)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤15 (10 В)	≤2,8 ≤12 ≤12 ≤2,8	— — — —	≤40; ≤30* ≤40; ≤30* ≤40; ≤60* ≤40; ≤60*	**КТС631**
75 (1 В; 10 мА)	≤4,4 (15 В)	≤25	—	≤30	**КТС674АС**
≥25	—	0,8	—	—	**КТ677АС**

Тип прибора	Структура	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,t\,max}$, $P^{**}_{K,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,max}$, $U^{*}_{КЭR\,max}$, $U^{**}_{КЭО\,max}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
КТ678АС	n-p-n	500; 1** Вт	≥250	60	5	200; 750*	≤0,05 (40 В)
КТ693АС	n-p-n	600	—	150	5	150 (200*)	≤10* (120 В)
К1НТ251	n-p-n	400 (50°С)	≥200	45* (1к)	4	400 (800*)	≤6 мА (45 В)
К1НТ661А	n-p-n	100 (50°С)	—	300	—	5 (10*)	≤30 (250 В)
К129НТ1А-1	n-p-n	15 (85°С)	≥250	15	4	10 (40*)	≤0,2 (15 В)
К129НТ1Б-1	n-p-n	15 (85°С)	≥250	15	4	10 (40*)	≤0,2 (15 В)
К129НТ1В-1	n-p-n	15 (85°С)	≥250	15	4	10 (40*)	≤0,2 (15 В)
К129НТ1Г-1	n-p-n	15 (85°С)	≥250	15	4	10 (40*)	≤0,2 (15 В)
К129НТ1Д-1	n-p-n	15 (85°С)	≥250	15	4	10 (40*)	≤0,2 (15 В)
К129НТ1Е-1	n-p-n	15 (85°С)	≥250	15	4	10 (40*)	≤0,2 (15 В)
К129НТ1Ж-1	n-p-n	15 (85°С)	≥250	15	4	10 (40*)	≤0,2 (15 В)
К129НТ1И-1	n-p-n	15 (85°С)	≥250	15	4	10 (40*)	≤0,2 (15 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ $h_{21э1}/h^{*}_{21э2}$, $U^{**}_{эб}$, мВ	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
75...230 (1 В; 10 мА)	≤4 (5 В)	≤20	—	≤510**	**КТ678АС**
≥40 (5 В; 0,1 А)	—	≤4	—	—	**КТС693АС**
≥10* (5 В; 0,2 А)	≤15 (10 В)	≤5	—	≤200*	**К1НТ251**
≥5* (5 В; 10 мА)	—	≤1000	—	—	**К1НТ661**
20...80 (5 В; 1 мА) 60...80 (5 В; 1 мА) ≥80 (5 В; 50 мкА) 20...80 (5 В; 1 мА) 60...80 (5 В; 1 мА) ≥80 (5 В; 50 мкА) 40...160 (5 В; 1 мА) 40...160 (5 В; 1 мА)	≤4 (5 В) ≤4 (5 В) ≤4 (5 В) ≤4 (5 В) ≤4 (5 В) ≤4 (5 В) ≤4 (5 В) ≤4 (5 В)	— — — — — — — —	≥0,85*; ≤3** ≥0,85*; ≤3** ≥0,85*; ≤3** ≥0,75*; ≤15** ≥0,75*; ≤15** ≥0,75*; ≤15** ≥0,85*; ≤3** ≥0,75*; ≤15**	— — — — — — — —	**К129НТ1**

2.9. Биполярные германиевые транзисторы специального назначения

Тип прибора	Структура	$T_{окр}$, °C	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
1Т101	p-n-p	-60...+70	50	2*	15	15	10	15
1Т101А	p-n-p	-60...+70	50	2*	15	15	10	15
1Т101Б	p-n-p	-60...+70	50	5*	15	15	10	15
1Т102	p-n-p	-60...+70	30	1*	5	5	6	10
1Т102А	p-n-p	-60...+70	30	1*	5	5	6	10
1Т115А	p-n-p	-60...+73	50	1	50	50	100	50
1Т115Б	p-n-p	-60...+73	50	1	50	50	100	50
1Т115В	p-n-p	-60...+73	50	1	70	50	100	50
1Т115Г	p-n-p	-60...+73	50	1	70	50	100	50
1Т116А	p-n-p	-60...+70	150	1	15*	15	50 (300*)	30
1Т116Б	p-n-p	-60...+70	150	1	15*	15	50 (300*)	30
1Т116В	p-n-p	-60...+70	150	1	15*	15	50 (300*)	30
1Т116Г	p-n-p	-60...+70	150	1	15*	15	50 (300*)	30
1Т303	n-p-n	-60...+70	100	36	10*	—	15 (120*)	6
1Т303А	n-p-n	-60...+70	100	36	10*	—	15 (120*)	6
1Т303Б	n-p-n	-60...+70	100	36	10*	—	15 (120*)	6
1Т303В	n-p-n	-60...+70	100	72	10*	—	15 (120*)	6
1Т303Г	n-p-n	-60...+70	100	72	10*	—	15 (120*)	6
1Т303Д	n-p-n	-60...+70	100	72	10*	—	15 (120*)	6
1Т305А	p-n-p	-60...+73	75	160	12**	1,5	40 (100*)	6
1Т305Б	p-n-p	-60...+73	75	140	12**	1,5	40 (100*)	6
1Т305В	p-n-p	-60...+73	75	160	12**	1,5	40 (100*)	6
1Т308А	p-n-p	-60...+70	150	100	20	3	50 (120*)	5
1Т308Б	p-n-p	-60...+70	150	120	20	3	50 (120*)	5
1Т308В	p-n-p	-60...+70	150	120	20	3	50 (120*)	5
1Т308Г	p-n-p	-60...+70	150	120	20	3	50 (120*)	5
1Т311А	n-p-n	-60...+70	150	0,45 ГГц	12	2	50	≤10
1Т311Б	n-p-n	-60...+70	150	0,3 ГГц	12	2	50	≤5
1Т311Г	n-p-n	-60...+70	150	0,3 ГГц	12	2	50	≤5
1Т311Д	n-p-n	-60...+70	150	0,45 ГГц	12	2	50	≤5
1Т311К	n-p-n	-60...+70	150	0,6 ГГц	12	2	50	≤5
1Т311Л	n-p-n	-60...+70	150	0,45 ГГц	12	2	50	≤5

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $r'_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
30...60	50	—	—	—	**1Т101, 1Т102**
20...40	50	—	—	—	
60...120	50	—	—	—	
≥20 (5 В; 1 мА)	30	—	≤7 (1 кГц)	—	
≥20 (5 В; 1 мА)	30	—	≤12 (1 кГц)	—	
20...60	50	—	—	—	**1Т115**
50...150	50	—	—	—	
20...60	—	—	—	—	
50...150	—	—	—	—	
15...65	—	—	—	—	**1Т116**
15...65	—	—	—	—	
20...65	—	—	—	—	
15...65	—	—	—	—	
15...30	10	—	—	1* мкс	**1Т303**
30...80	10	—	—	1* мкс	
60...160	10	—	—	1* мкс	
15...30	10	—	—	1* мкс	
30...80	10	—	—	1* мкс	
60...160	10	—	—	1* мкс	
25...80*	6	—	—	—	**1Т305**
60...180*	7	—	—	—	
40...120	7	—	—	—	
25...75	8	—	—	1* мкс	**1Т308**
50...120	8	—	—	1* мкс	
80...150	8	—	8	1* мкс	
100...300	8	—	6	—	
15...180	≤2,5	—	—	50*	**1Т311**
30...180	≤2,5	—	8	50*	
30...180	≤2,5	—	—	50*	
60...180	≤2,5	—	—	50*	
60...180	≤2,5	—	—	50*	
150...300	≤2,5	—	—	50*	

Тип прибора	Структура	$T_{окр}$, °C	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
1Т3110А-2	n-p-n	-60...+70	175	≥2,5 ГГц	10	0,2	17,5 (140*)	≤50
1Т313А	p-n-p	-60...+70	100	≥300	12	0,7	50	≤5
1Т313Б	p-n-p	-60...+70	100	≥450	12	0,7	50	≤5
1Т313В	p-n-p	-60...+70	100	≥350	12	0,7	50	≤5
1Т320А	p-n-p	-60...+70	200	≥160	20	3	200 (300*)	≤5
1Т320Б	p-n-p	-60...+70	200	≥160	20	3	200 (300*)	≤5
1Т320В	p-n-p	-60...+70	200	≥200	20	3	200 (300*)	≤5
1Т321А	p-n-p	-60...+70	160 (20** Вт)	≥60	60	4	200 (2000*)	≤500
1Т321Б	p-n-p	-60...+70	160 (20** Вт)	≥60	60	4	200 (2000*)	≤500
1Т321В	p-n-p	-60...+70	160 (20** Вт)	≥60	60	4	200 (2000*)	≤500
1Т321Г	p-n-p	-60...+70	160 (20** Вт)	≥60	45	2,5	200 (2000*)	≤500
1Т321Д	p-n-p	-60...+70	160 (20** Вт)	≥60	45	2,5	200 (2000*)	≤500
1Т321Е	p-n-p	-60...+70	160 (20** Вт)	≥60	45	2,5	200 (2000*)	≤500
1Т329А	n-p-n	-60...+70	50	≥1,2 ГГц	10	0,7	20	≤5
1Т329Б	n-p-n	-60...+70	50	≥1,7 ГГц	10	0,7	20	≤5
1Т329В	n-p-n	-60...+70	50	≥1 ГГц	10	1	20	≤5
1Т330А	n-p-n	-60...+70	50	≥1 ГГц	13	1,5	20	≤5
1Т330Б	n-p-n	-60...+70	50	≥1,5 ГГц	13	1,5	20	≤5
1Т330В	n-p-n	-60...+70	50	≥1 ГГц	13	1,5	20	≤5
1Т330Г	n-p-n	-60...+70	50	≥0,7 ГГц	13	1,5	20	≤5
1Т335А	p-n-p	-60...+70	200	≥300	20	3	150 (250*)	≤10
1Т335Б	p-n-p	-60...+70	200	≥300	20	3	150 (250*)	≤10
1Т335В	p-n-p	-60...+70	200	≥300	20	3	150 (250*)	≤10
1Т335Г	p-n-p	-60...+70	200	≥300	20	3	150 (250*)	≤10
1Т335Д	p-n-p	-60...+70	200	≥300	20	3	150 (250*)	≤10
1Т341А	n-p-n	-60...+70	35	≥1,5 ГГц	10	0,3	10	≤5
1Т341Б	n-p-n	-60...+70	35	≥2 ГГц	10	0,3	10	≤5
1Т341В	n-p-n	-60...+70	35	≥1,5 ГГц	10	0,5	10	≤5

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	C_k, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$К_ш$, дБ, $r'_б$, Ом, $P^{**}_{вых}$, Вт	τ_k, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс, $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
—	≤3,5	—	3 (0,5 ГГц) ≥0,05** (4 ГГц)	≤5	**1Т3110А-2**
10...230 (3 В; 15 мА) 10...75 (3 В; 15 мА) 30...230 (3 В; 15 мА)	≤2,5 ≤2,5 ≤2,5	— — —	≤8 (60 МГц) ≤8 (60 МГц) ≤8 (60 МГц)	≤75 ≤40 ≤40	**1Т313**
40...100 (1 В; 10 мА) 70...160 (1 В; 10 мА) 100...250 (1 В; 10 мА)	≤8 ≤8 ≤8	— — —	— — —	0,2* мкс 0,2* мкс 0,2* мкс	**1Т320**
20...60 (3 В; 0,5 А) 40...120 (3 В; 0,5 А) 80...200 (3 В; 0,5 А) 20...60 (3 В; 0,5 А) 40...120 (3 В; 0,5 А) 80...200 (3 В; 0,5 А)	≤80 ≤80 ≤80 ≤80 ≤80 ≤80	— — — — — —	— — — — — —	1* мкс 1* мкс 1* мкс 1* мкс 1* мкс 1* мкс	**1Т321**
15...300 (5 В; 5 мА) 15...300 (5 В; 5 мА) 15...300 (5 В; 5 мА)	≤2 ≤3 ≤3	— — —	≤4 (0,4 ГГц) ≤6 (0,4 ГГц) ≤6 (0,4 ГГц)	15 30 20	**1Т329, 1Т330**
30...400 (5 В; 5 мА) 30...400 (5 В; 5 мА) 80...400 (5 В; 5 мА) 30...400 (5 В; 5 мА)	≤2 ≤2 ≤2 ≤3	— — — —	≤5 (0,4 ГГц) ≤5 (0,4 ГГц) ≤5 (0,4 ГГц) ≤5 (0,4 ГГц)	25; 50* 50 100 30; 50*	
40...70 (3 В; 50 мА) 60...100 (3 В; 50 мА) 40...70 (3 В; 50 мА) 60...100 (3 В; 50 мА) 50...100 (3 В; 50 мА)	≤8,5 ≤8,5 ≤8,5 ≤8,5 ≤8,5	— — — — —	— — — — —	0,1* мкс — 0,15* мкс 0,15* мкс 0,15* мкс	**1Т335**
15...250 (5 В; 5 мА) 15...250 (5 В; 5 мА) 15...250 (5 В; 5 мА)	≤1 ≤1 ≤1	— — —	≤4,5 (1 ГГц) ≤5,5 (1 ГГц) ≤5,5 (1 ГГц)	— — —	**1Т341**

Тип прибора	Структура	$T_{окр}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
1Т362А	n-p-n	-60...+70	40	≥2,4 ГГц	5	0,2	10	≤5
1Т374А-6	n-p-n	-60...+125	25	≥2,4 ГГц	5	0,3	10	≤5
1Т376А	p-n-p	-60...+185	35	≥1 ГГц	7	0,25	10	≤5
1Т383А-2	n-p-n	-60...+85	25	≥2,4 ГГц	5	0,5	10	≤5
1Т383Б-2	n-p-n	-60...+85	25	≥1,5 ГГц	5	0,5	10	≤5
1Т383В-2	n-p-n	-60...+85	25	≥3,6 ГГц	5	0,5	10	≤5
1Т386А	n-p-n	-60...+70	40	≥0,45 ГГц	15	0,3	10	≤10
1Т387А-2	n-p-n	-60...+70	175	≥2,16 ГГц	10	0,2	140*	≤10
1Т387Б-2	n-p-n	-60...+70	175	≥3 ГГц	10	0,2	140*	≤10
1Т403А	p-n-p	-60...+70	4 Вт	0,008**	45	20	1,25 А	≤5** мА
1Т403Б	p-n-p	-60...+70	4 Вт	0,008**	45	20	1,25 А	≤5** мА
1Т403В	p-n-p	-60...+70	5 Вт	0,008**	69	20	1,25 А	≤5** мА
1Т403Г	p-n-p	-60...+70	4 Вт	0,008**	60	20	1,25 А	≤5** мА
1Т403Д	p-n-p	-60...+70	4 Вт	0,008**	60	30	1,25 А	≤5** мА
1Т403Е	p-n-p	-60...+70	5 Вт	0,008**	60	20	1,25 А	≤5** мА
1Т403Ж	p-n-p	-60...+70	4 Вт	0,008**	80	20	1,25 А	≤6** мА
1Т403И	p-n-p	-60...+70	4 Вт	0,008**	80	20	1,25 А	≤6** мА

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом	$К_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
10...200 (3 В: 5 мА)	≤1	—	≤4,5 (2,25 ГГц)	—	**1Т362А**
10...100 (3 В; 2 мА)	≤1	—	4,5	—	**1Т374А-6**
10...150 (5 В; 2 мА)	≤1,2	—	≤3,5 (180 МГц)	—	**1Т376А**
15...250 (3,2 В; 5 мА) 10...250 (3,2 В; 5 мА) 15...250 (3,2 В; 5 мА)	≤1 ≤1 ≤1	— — —	≤4,5 (2,25 ГГц) ≤4 (1 ГГц) ≤5,5 (2,83 ГГц)	— — —	**1Т383**
10...100 (5 В; 3 мА)	≤1,5	—	≤4 (180 МГц)	—	**1Т386А**
— —	≤3 ≤3	— —	≤5 (1 ГГц) ≤4,8 (1 ГГц) ≥0,05** (4 ГГц)	— —	**1Т387**
20...60 (5 В; 0,1 А) 50...150 (5 В; 0,1 А) 20...60 (5 В; 0,1 А) 50...150 (5 В; 0,1 А) 50...150 (5 В; 0,1 А) 30 (5 В; 0,1 А) 20...60 (5 В; 0,1 А) 30 (5 В; 0,1 А)	— — — — — — — —	≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1	— — — — — — — —	— — — — — — — —	**1Т403**

Тип прибора	Структура	$T_{окр}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
1Т612А-4	n-p-n	-55...+70	0,36 Вт	≥1,5 ГГц	12	0,2	0,2* А	≤0,005 мА
1Т614А	n-p-n	-60...+85	0,4 Вт	≥1 ГГц	12	0,5	200	≤0,01 мА
1Т615	n-p-n	-60...+70	0,7 Вт	0,4 ГГц	12	0,5	500	—
1Т702А	p-n-p	-60...+70	150* Вт	0,12	60	4	30 А	≤12 мА
1Т702Б	p-n-p	-60...+70	150* Вт	0,12	60	4	30 А	≤12 мА
1Т702В	p-n-p	-60...+70	150* Вт	0,12	40	4	30 А	≤12 мА
1Т806А	p-n-p	-60...+70	30* Вт	≥10	40**	2	20 А (25* А)	≤12 мА
1Т806Б	p-n-p	-60...+70	30* Вт	≥10	65**	2	20 А (25* А)	≤12 мА
1Т806В	p-n-p	-60...+70	30* Вт	≥10	80**	2	20 А (25* А)	≤12 мА
1Т813А	p-n-p	-60...+70	50* Вт	—	60**	2	30 А (40* А)	—
1Т813Б	p-n-p	-60...+70	50* Вт	—	35**	2	30 А (40* А)	—
1Т813В	p-n-p	-60...+70	50* Вт	—	80**	2	30 А (40* А)	—
1Т901А	p-n-p	-60...+70	15* Вт	≥30	50	—	10 А	≤8 мА
1Т901Б	p-n-p	-60...+70	15* Вт	≥30	40	—	10 А	≤8 мА
1Т905А	p-n-p	-60...+70	6* Вт	≥30	75	—	3 А (7* А)	≤2 мА
1Т906А	p-n-p	-60...+70	15* Вт	≥30	75	1,4	10 А	≤8 мА
1Т910АД	p-n-p	-60...+70	35* Вт	≥30	33	—	10 А (20* А)	≤6 мА

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_{k}, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_{ш}$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{пк}$, нс	Корпус
—	≤3,5	—	≥0,15** (2 ГГц)	≤7	1Т612, 1Т614, 1Т615
15...250 (5 В; 50 мА)	—	—	≥0,200** (0,5 ГГц)	≤15	
—	—	—	—	—	
15...100 (1,5 В; 30 А) 15...100 (1,5 В; 30 А) 15...100 (1,5 В; 30 А)	— — —	≤0,02 ≤0,04 ≤0,02	— — —	— — —	1Т702
10...100 (10 А) 10...100 (10 А) 10...100 (10 А)	— — —	≤0,03 ≤0,03 ≤0,03	— — —	≤30** мкс ≤30** мкс ≤30** мкс	1Т806, 1Т813
10...60 (20 А) 10...60 (20 А) 10...60 (20 А)	— — —	≤0,026 ≤0,026 ≤0,026	— — —	3** мкс 5** мкс 5** мкс	
20...50 (10 В; 5 А) 40...100 (10 В; 5 А)	— —	≤0,12 ≤0,12	— —	$t_{н}$≤0,7 мкс $t_{н}$≤0,7 мкс	1Т901
35...100 (10 В; 3 А)	≤250	≤0,16	—	≤4* мкс	1Т905А, 1Т906А
30...150 (10 В; 5 А)	—	≤0,1	—	≤5* мкс	
50...320 (10 В; 20 А)	—	≤0,06	—	$t_{сп}$≤1 мкс	1Т910АД

2.10. Биполярные кремниевые транзисторы специального назначения

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{K\ max}$, $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т104А	p-n-p	-60...+125	150 (60°C)	≥5*	30**	10	50	≤1 (30 В)
2Т104Б	p-n-p	-60...+125	150 (60°C)	≥5*	15**	10	50	≤1 (15 В)
2Т104В	p-n-p	-60...+125	150 (60°C)	≥5*	15**	10	50	≤1 (15 В)
2Т104Г	p-n-p	-60...+125	150 (60°C)	≥5*	30	10	50	≤1 (30 В)
2Т117А	n-база	-60...+125	300	≥0,2***	30	30	50 (1* А)	≤1 (30 В)
2Т117Б	n-база	-60...+125	300	≥0,2***	30	30	50 (1* А)	≤1 (30 В)
2Т117В	n-база	-60...+125	300	≥0,2***	30	30	50 (1* А)	≤1 (30 В)
2Т117Г	n-база	-60...+125	300	≥0,2***	30	30	50 (1* А)	≤1 (30 В)
2Т117А-5	n-база	-60...+125	30	≥0,2***	30	30	50	≤1 (30 В)
2Т118А	p-n-p	-60...+125	100 (100°C)	—	15	31	50	≤0,1 (15 В)
2Т118Б	p-n-p	-60...+125	100 (100°C)	—	15	31	50	≤0,1 (15 В)
2Т118В	p-n-p	-60...+125	100 (100°C)	—	15	31	50	≤0,1 (15 В)
2Т118А-1	p-n-p	-60...+85	30 (85°C)	—	15* (10к)	31	50	≤0,1 (15 В)
2Т118Б-1	p-n-p	-60...+85	30 (85°C)	—	15* (10к)	16	50	
2Т126А-1	p-n-p	-60...+85	15 (70°C)	≥0,1**	25	3	50	≤1 (25 В)
2Т126Б-1	p-n-p	-60...+85	15 (70°C)	≥0,1**	25	3	50	≤1 (25 В)
2Т126В-1	p-n-p	-60...+85	15 (70°C)	≥0,1**	45	3	50	≤1 (45 В)
2Т126Г-1	p-n-p	-60...+85	15 (70°C)	≥0,1**	45	3	50	≤1 (45 В)
2Т127А-1	n-p-n	-60...+125	15 (60°C)	≥0,1**	25	—	50	≤1 (30 В)
2Т127Б-1	n-p-n	-60...+125	15 (60°C)	≥0,1**	25	—	50	≤1 (30 В)
2Т127В-1	n-p-n	-60...+125	15 (60°C)	≥0,1**	45	—	50	≤1 (30 В)
2Т127Г-1	n-p-n	-60...+125	15 (60°C)	≥0,1**	45	—	50	≤1 (30 В)
2Т201А	n-p-n	-60...+125	150 (75°C)	10	20	20	20 (100*)	≤0,5 (20 В)
2Т201Б	n-p-n	-60...+125	150 (75°C)	10	20	20	20 (100*)	≤0,5 (20 В)
2Т201В	n-p-n	-60...+125	150 (75°C)	10	10	10	20 (100*)	≤0,5 (10 В)
2Т201Г	n-p-n	-60...+125	150 (75°C)	10	10	10	20 (100*)	≤0,5 (20 В)
2Т201Д	n-p-n	-60...+125	150 (75°C)	10	10	10	20 (100*)	≤0,5 (20 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^*_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
7...40 (1 В; 10 мА) 15...80 (1 В; 10 мА) 19...160 (1 В; 10 мА) 10...60 (1 В; 10 мА)	≤50 (5 В) ≤50 (5 В) ≤50 (5 В) ≤50 (5 В)	≤50 ≤50 ≤50 ≤50	≤120* ≤120* ≤120* ≤120*	— — — —	**2Т104**
0,5...0,7 ($U_{Б1Б2}$=10 В) 0,65...0,9 ($U_{Б1Б2}$=10 В) 0,5...0,7 ($U_{Б1Б2}$=10 В) 0,65...0,9 ($U_{Б1Б2}$=10 В)	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	**2Т117**
0,5...0,9 ($U_{Б1Б2}$=10 В)	—	—	—	—	**2Т117А-5**
— — —	— — —	100 100 100	— — —	≤500** ≤500** ≤500**	**2Т118**
— —	— —	30 30	— —	≤50* ≤50*	**2Т118А-1, 2Т118Б-1**
15...60 (5 В; 1 мА) 15...60 (5 В; 1 мА) 40...200 (5 В; 1 мА) 40...200 (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В)	≤166 ≤166 ≤166 ≤166	— — — —	— — — —	**2Т126**
15...60 (5 В; 1 мА) 40...200 (5 В; 1 мА) 15...60 (5 В; 1 мА) 40...200 (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В)	≤170 ≤170 ≤170 ≤170	— — — —	— — — —	**2Т127-1**
20...60 (1 В; 5 мА) 30...90 (1 В; 5 мА) 30...90 (1 В; 5 мА) 70...210 (1 В; 5 мА) 30...90 (1 В; 5 мА)	≤20 (5 В) ≤20 (5 В) ≤20 (5 В) ≤20 (5 В) ≤20 (5 В)	— — — — —	— — — — ≤15 (1 кГц)	— — — — —	**2Т201**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т202А-1	p-n-p	-60...+85	25 (35°С)	5	15	10	20 (50*)	≤1 (15 В)
2Т202Б-1	p-n-p	-60...+85	25 (35°С)	5	15	10	20 (50*)	≤1 (15 В)
2Т202В-1	p-n-p	-60...+85	25 (35°С)	5	30	10	20 (50*)	≤1 (30 В)
2Т202Г-1	p-n-p	-60...+85	25 (35°С)	5	30	10	20 (50*)	≤1 (30 В)
2Т202Д-1	p-n-p	-60...+85	25 (35°С)	5	15	10	20 (50*)	≤1 (15 В)
2Т203А	p-n-p	-60...+125	150 (75°С)	≥5*	60	30	10 (50*)	≤1 (60 В)
2Т203Б	p-n-p	-60...+125	150 (75°С)	≥5*	30	15	10 (50*)	≤1 (30 В)
2Т203В	p-n-p	-60...+125	150 (75°С)	≥5*	15	10	10 (50*)	≤1 (15 В)
2Т203Г	p-n-p	-60...+125	150 (75°С)	≥10*	60	30	10 (50*)	≤1 (60 В)
2Т203Д	p-n-p	-60...+125	150 (75°С)	≥10*	15	10	10 (50*)	≤1 (15 В)
2Т205А-3	n-p-n	-60...+125	40 (90°С)	≥20	250	3	20 (45*)	3* (250 В)
2Т205Б-3	n-p-n	-60...+125	40 (90°С)	≥20	250	3	20 (45*)	2* (200 В)
2Т208А	p-n-p	-60...+125	200 (60°С)	≥5	20* (10к)	20	150 (300*)	≤1 (20 В)
2Т208Б	p-n-p	-60...+125	200 (60°С)	≥5	20	20	150 (300*)	≤1 (20 В)
2Т208В	p-n-p	-60...+125	200 (60°С)	≥5	20	20	150 (300*)	≤1 (20 В)
2Т208Г	p-n-p	-60...+125	200 (60°С)	≥5	30	20	150 (300*)	≤1 (20 В)
2Т208Д	p-n-p	-60...+125	200 (60°С)	≥5	30* (10к)	20	150 (300*)	≤1 (20 В)
2Т208Е	p-n-p	-60...+125	200 (60°С)	≥5	30	20	150 (300*)	≤1 (20 В)
2Т208Ж	p-n-p	-60...+125	200 (60°С)	≥5	45	20	150 (300*)	≤1 (20 В)
2Т208И	p-n-p	-60...+125	200 (60°С)	≥5	45	20	150 (300*)	≤1 (20 В)
2Т208К	p-n-p	-60...+125	200 (60°С)	≥5	45	20	150 (300*)	≤1 (20 В)
2Т208Л	p-n-p	-60...+125	200 (60°С)	≥5	60	20	150 (300*)	≤1 (20 В)
2Т208М	p-n-p	-60...+125	200 (60°С)	≥5	60	20	150 (300*)	≤1 (20 В)
2Т211А-1	p-n-p	-60...+125	25 (50**)	≥10	15	5	20 (50*)	≤0,01 (15 В)
2Т211Б-1	p-n-p	-60...+125	25 (50**)	≥10	15	5	20 (50*)	≤0,01 (15 В)
2Т211В-1	p-n-p	-60...+125	25 (50**)	≥10	15	5	20 (50*)	≤0,01 (15 В)
2Т214А-1	p-n-p	-60...+100	50	≥5	100* (10к)	30	50 (100*)	≤1 (30 В)
2Т214Б-1	p-n-p	-60...+100	50	≥5	80* (10к)	7	50 (100*)	≤1 (30 В)
2Т214В-1	p-n-p	-60...+100	50	≥5	80* (10к)	7	50 (100*)	≤1 (30 В)
2Т214Г-1	p-n-p	-60...+100	50	≥5	60* (10к)	7	50 (100*)	≤1 (30 В)
2Т214Д-1	p-n-p	-60...+100	50	≥5	30* (10к)	7	50 (100*)	≤1 (30 В)
2Т214Е-1	p-n-p	-60...+100	50	≥5	30* (10к)	20	50 (100*)	≤1 (30 В)
2Т214А-5	p-n-p	-60...+100	50	≥5	94**	—	50	≤1 (30 В)
2Т214Б-5	p-n-p	-60...+100	50	≥5	94**	—	50	≤1 (30 В)
2Т214В-5	p-n-p	-60...+100	50	≥5	70**	—	50	≤1 (30 В)
2Т214Г-5	p-n-p	-60...+100	50	≥5	47**	—	50	≤1 (30 В)
2Т214Д-5	p-n-p	-60...+100	50	≥5	35**	—	50	≤1 (30 В)
2Т214Е-5	p-n-p	-60...+100	50	≥5	24**	—	50	≤1 (30 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r'^{*}_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс; $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
15...70 (5 В; 1 мА)	≤25 (3 В)	—	—	≤1000*	**2Т202-1**
40...160 (5 В; 1 мА)	≤25 (3 В)	—	—	≤1000*	
15...70 (5 В; 1 мА)	≤25 (3 В)	—	—	≤1000*	
40...160 (5 В; 1 мА)	≤25 (3 В)	—	—	≤1000*	
100...300 (5 В; 1 мА)	≤25 (3 В)	—	—	≤1000*	
≥9 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В)	—	300*	—	**2Т203А**
30...90 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В)	≤50	300*	—	
15...100 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В)	—	300*	—	
≥4 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В)	≤50	300*	—	
60...200 (5 В; 1 мА)	≤10 (5 В)	≤35	300*	—	
10...40 (10 В; 2,5 мА)	≤10 (10 В)	≤400	—	≤1000*	**2Т205А**
10...40 (10 В; 2,5 мА)	≤10 (10 В)	≤400	—	≤1000*	
20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	**2Т208**
40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
80...240* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤4 (1 кГц)	—	
20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
80...240* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤4 (1 кГц)	—	
20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
80...240* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	≤4 (1 кГц)	—	
20...60* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
40...120* (1 В; 30 мА)	≤50 (10 В)	≤1,3	—	—	
40...120 (1 В; 40 мА)	≤20 (5 В)	—	≤3 (1 кГц)	—	**2Т211-1**
80...240 (1 В; 40 мА)	≤20 (5 В)	—	≤3 (1 кГц)	—	
160...480 (1 В; 40 мА)	≤20 (5 В)	—	≤3 (1 кГц)	—	
≥20 (5 В; 10 мА)	≤30 (10 В)	≤45	≤1200*	≤5	**2Т214А-1**
30...90 (5 В; 10 мА)	≤30 (10 В)	≤45	≤1200*	≤5	
40...120 (5 В; 10 мА)	≤30 (10 В)	≤45	≤1200*	≤5	
40...120 (5 В; 10 мА)	≤30 (10 В)	≤45	≤1200*	≤5	
≥80 (1 В; 40 мкА)	≤30 (10 В)	≤45	≤1200*; ≤5 (1 кГц)	≤5	
≥40 (1 В; 40 мкА)	≤30 (10 В)	≤45	≤1200*	≤5	
≥25 (5 В; 10 мА)	≤50	≤19,5	—	—	**2Т214А-5**
36...78 (5 В; 10 мА)	≤50	≤19,5	—	—	
50...104 (5 В; 10 мА)	≤50	≤19,5	—	—	
50...104 (5 В; 10 мА)	≤50	≤19,5	—	—	
≥91 (1 В; 40 мкА)	≤50	≤19,5	—	—	
≥46 (1 В; 40 мкА)	≤50	≤19,5	—	—	

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{K\ max}$ $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т214А-9	p-n-p	-60...+85	200	≥5	80**	30	50 (100*)	≤1 (30 В)
2Т214Б-9	p-n-p	-60...+85	200	≥5	80**	7	50 (100*)	≤1 (30 В)
2Т214В-9	p-n-p	-60...+85	200	≥5	60**	7	50 (100*)	≤1 (30 В)
2Т214Г-9	p-n-p	-60...+85	200	≥5	40**	7	50 (100*)	≤1 (30 В)
2Т214Д-9	p-n-p	-60...+85	200	≥5	30**	7	50 (100*)	≤1 (30 В)
2Т214Е-9	p-n-p	-60...+85	200	≥5	20**	20	50 (100*)	≤1 (30 В)
2Т215А-1	n-p-n	-60...+100	50	≥5	80**	5	50 (100*)	≤100* (30 В)
2Т215Б-1	n-p-n	-60...+100	50	≥5	80**	5	50 (100*)	≤100* (30 В)
2Т215В-1	n-p-n	-60...+100	50	≥5	60**	5	50 (100*)	≤100* (30 В)
2Т215Г-1	n-p-n	-60...+100	50	≥5	40**	5	50 (100*)	≤100* (30 В)
2Т215Д-1	n-p-n	-60...+100	50	≥5	30**	5	50 (100*)	≤100* (30 В)
2Т215Е-1	n-p-n	-60...+100	50	≥5	20**	5	50 (100*)	≤100* (30 В)
2Т215А-5	n-p-n	-60...+100	50	≥5	94**	—	50	≤1 (30 В)
2Т215Б-5	n-p-n	-60...+100	50	≥5	94**	—	50	≤1 (30 В)
2Т215В-5	n-p-n	-60...+100	50	≥5	70**	—	50	≤1 (30 В)
2Т215Г-5	n-p-n	-60...+100	50	≥5	47**	—	50	≤1 (30 В)
2Т215Д-5	n-p-n	-60...+100	50	≥5	35**	—	50	≤1 (30 В)
2Т215Е-5	n-p-n	-60...+100	50	≥5	24**	—	50	≤1 (30 В)
2Т215А-9	n-p-n	-60...+85	200	≥5	100* (10к)	5	50 (100*)	≤1* (100 В)
2Т215Б-9	n-p-n	-60...+85	200	≥5	90* (10к)	5	50 (100*)	≤1* (90 В)
2Т215В-9	n-p-n	-60...+85	200	≥5	80* (10к)	5	50 (100*)	≤1* (80 В)
2Т215Г-9	n-p-n	-60...+85	200	≥5	60* (10к)	5	50 (100*)	≤1* (60 В)
2Т215Д-9	n-p-n	-60...+85	200	≥5	30* (10к)	5	50 (100*)	≤1* (30 В)
2Т215Е-9	n-p-n	-60...+85	200	≥5	30* (10к)	5	50 (100*)	≤1* (30 В)
2Т301Г	n-p-n	-60...+125	150 (60°C)	≥30	30	3	10 (20*)	≤5* (30 В)
2Т301Д	n-p-n	-60...+125	150 (60°C)	≥30	30	3	10 (20*)	≤5* (30 В)
2Т301Е	n-p-n	-60...+125	150 (60°C)	≥20	20	3	10 (20*)	≤5* (20 В)
2Т301Ж	n-p-n	-60...+125	150 (60°C)	≥30	20	3	10 (20*)	≤5* (20 В)
2Т306А	n-p-n	-60...+125	150 (90°C)	≥300	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)
2Т306Б	n-p-n	-60...+125	150 (90°C)	≥500	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)
2Т306В	n-p-n	-60...+125	150 (90°C)	≥300	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)
2Т306Г	n-p-n	-60...+125	150 (90°C)	≥500	15	4	30 (50*)	≤0,5 (15 В)
2Т307А-1	n-p-n	-60...+85	15	≥300	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
2Т307Б-1	n-p-n	-60...+85	15	≥300	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
2Т307В-1	n-p-n	-60...+85	15	≥300	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
2Т307Г-1	n-p-n	-60...+85	15	≥300	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
2Т3101А-2	n-p-n	-60...+125	100 (45°C)	≥4000	15	2,5	20 (40*)	≤0,5 (15 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^{*}_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс; $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
≥20 (5 В; 10 мА) 30...90 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) ≥80 (1 В; 40 мкА) ≥40 (1 В; 40 мкА)	≤30 (10 В) ≤30 (10 В) ≤30 (10 В) ≤30 (10 В) ≤30 (10 В) ≤30 (10 В)	≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60	≤1200* ≤1200* ≤1200* ≤1200* ≤1200*; ≤5 (1 кГц) ≤1200*	≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5	**2Т214А-9**
≥20 (5 В; 10 мА) 30...90 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) ≥80 (1 В; 40 мА) ≥40 (1 В; 40 мкА)	≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В)	≤0,45 ≤0,45 ≤0,45 ≤0,45 ≤0,45 ≤0,45	≤1200* ≤1200* ≤1200* ≤1200* ≤1200*; ≤5 (1 кГц) ≤1200*	≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5	**2Т215А-1**
≥25 (5 В; 10 мА) 36...78 (5 В; 10 мА) 46...104 (5 В; 10 мА) 46...104 (5 В; 10 мА) ≥91 (1 В; 40 мкА) ≥46 (1 В; 40 мкА)	≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50	≤19,5 ≤19,5 ≤19,5 ≤19,5 ≤19,5 ≤19,5	— — — — — —	— — — — — —	**2Т215-5**
≥20 (5 В; 10 мА) 30...90 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) 40...120 (5 В; 10 мА) ≥80 (1 В; 40 мкА) ≥40 (1 В; 40 мкА)	≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В) ≤50 (10 В)	≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60 ≤60	≤1200* ≤1200* ≤1200* ≤1200* ≤5 (1 кГц); ≤1200* ≤1200*	≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5	**2Т215-9**
10...32 (10 В; 3 мА) 20...60 (10 В; 3 мА) 40...120 (10 В; 3 мА) 80...300 (10 В; 3 мА)	≤10 (10 В) ≤10 (10 В) ≤10 (10 В) ≤10 (10 В)	≤300 ≤300 ≤300 ≤300	— — — —	≤4500; ≤4500* ≤4500; ≤4500* ≤4500; ≤8000* ≤2000; ≤8000*	**2Т301**
20...60* (1 В; 10мА) 40...120* (1 В; 10мА) 20...100* (1 В; 10мА) 40...200* (1 В; 10мА)	≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В) ≤5 (5 В)	≤30 ≤30 — —	≤30 (1 кГц) ≤8 (90 МГц) ≤30 ≤30	≤30* ≤30* ≤500 ≤500	**2Т306**
≥20 (1 В; 10 мА) ≥40 (1 В; 10 мА) ≥40 (1 В; 10 мА) ≥80 (1 В; 10 мА)	≤5 (1 В) ≤5 (1 В) ≤5 (1 В) ≤5 (1 В)	≤20 ≤20 ≤20 ≤20	— — — —	≤30* ≤30* ≤50 ≤50	**2Т307-1**
35...300 (1 В; 5 мА)	≤1,5 (5 В)	≥6**	≤4,5 (2,25 ГГц)	≤10	**2Т3101-2**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т3106А-2	n-p-n	-60...+125	30 (50°C)	≥900	15* (10к)	2,5	20 (40*)	≤0,5 (15 В)
2Т3108А	p-n-p	-60...+125	300 (360*)	≥250	60* (10к)	5	200	≤0,2 (60 В)
2Т3108Б	p-n-p	-60...+125	300 (360*)	≥250	45* (10к)	5	200	≤0,2 (45 В)
2Т3108В	p-n-p	-60...+125	300 (360*)	≥300	45* (10к)	5	200	≤0,2 (45 В)
2Т3114А-6	n-p-n	-60...+125	25 (100°C)	≥4300	5	1	15	≤0,5 (5 В)
2Т3114Б-6	n-p-n	-60...+125	25 (100°C)	≥4300	5	1	15	≤0,5 (5 В)
2Т3114В-6	n-p-n	-60...+125	25 (100°C)	≥4300	5	1	15	≤0,5 (5 В)
2Т3115А-2	n-p-n	-60...+125	70 (70°C)	≥5800	10* (1к)	1	8,5	≤0,5 (10 В)
2Т3115Б-2	n-p-n	-60...+125	70 (70°C)	≥5800	10* (1к)	1	8,5	≤0,5 (10 В)
2Т3115А-6	n-p-n	-60...+100	50 (85°C)	≥5800	10* (1к)	1	8,5	≤0,5 (10 В)
2Т3117А	n-p-n	-60...+125	300	≥300	60	4	400 (0,8* А)	≤5 (60 В)
2Т3117Б	n-p-n	-60...+125	300	≥300	75	4	400 (0,8* А)	≤5 (75 В)
2Т312А	n-p-n	-60...+125	225	≥80	30	4	30 (60*)	≤1 (30 В)
2Т312Б	n-p-n	-60...+125	225	≥120	30	4	30 (60*)	≤1 (30 В)
2Т312В	n-p-n	-60...+125	225	≥120	30	4	30 (60*)	≤1 (30 В)
2Т3120А	n-p-n	-60...+125	100	≥1800	15	3	20 (40*)	≤0,5 (15 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
≥40 (5 В; 5 мА)	≤2 (5 В)	≥17** (120 МГц)	≤2 (120 МГц)	—	**2Т3106-2**
50...150 (1 В; 10 мА) 50...150 (1 В; 10 мА) 100...300 (1 В; 10 мА)	≤5 (10 В) ≤5 (10 В) ≤5 (10 В)	≤25 ≤25 ≤25	≤6 (100 МГц) ≤6 (100 МГц) ≤6 (100 МГц)	≤250; ≤175* ≤250; ≤175* ≤250; ≤175*	**2Т3108**
15...80 (3 В; 1 мА) 15...80 (3 В; 1 мА) 15...80 (3 В; 1 мА)	≤0,44 (3 В) ≤0,44 (3 В) ≤0,44 (3 В)	≥11,5** (0,4 ГГц) ≥11,5** (0,4 ГГц) ≥3** (2,25 ГГц)	≤1,5 (400 МГц) ≤2 (400 МГц) ≤3 (400 МГц)	≤8 ≤8 ≤8	**2Т3114-6**
≥15 (5 В; 5 мА) ≥15 (5 В; 5 мА)	≤0,6 (5 В) ≤0,6 (5 В)	≥5** (5 ГГц) ≥6** (4 ГГц)	≤4,6 (5 ГГц) ≤4,4 (5 ГГц)	≤3,8 ≤3,8	**2Т3115-2**
≥15 (5 В; 5 мА)	≤0,6 (5 В)	≥5 (1 ГГц)	≤9** (1 ГГц)	≤3,8	**2Т3115-6**
40...200 (5 В; 0,2 А) 100...300 (5 В; 0,2 А)	≤10 (10 В) ≤10 (10 В)	≤1 ≤1	— —	≤60* ≤60*	**2Т3117**
10...100* (2 В; 20 мА) 25...100* (2 В; 20 мА) 50...280* (2 В; 20 мА)	≤5 (10 В) ≤5 (10 В) ≤5 (10 В)	≤25 ≤25 ≤17	— — —	≤500; ≤100* ≤500; ≤130* ≤500; ≤130*	**2Т312**
≥40 (1 В; 5 мА)	≤2 (5 В)	≥10** (400 МГц)	≤2 (400 МГц)	≤8	**2Т3120**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т3121А-6	n-p-n	-60...+125	25	≥100	10	2	10	≤1 (10 В)
2Т3123А-2	p-n-p	-60...+125	150	5000	15	3	30 (50*)	≤25 (15 В)
2Т3123Б-2	p-n-p	-60...+125	150	5000	15	3	30 (50*)	≤25 (15 В)
2Т3123В-2	p-n-p	-60...+125	150	3500	10	3	30 (50*)	≤25 (10 В)
2Т3124А-2	n-p-n	-60...+125	70 (85°C)	≥6* ГГц	10	1	7	≤0,5 (10 В)
2Т3124Б-2	n-p-n	-60...+125	70 (85°C)	≥6* ГГц	10	1	7	≤0,5 (10 В)
2Т3124В-2	n-p-n	-60...+125	70 (85°C)	≥6* ГГц	10	1	7	≤0,5 (10 В)
2Т3129А9	p-n-p	-60...+125	200	≥200	50	5	100 (200*)	≤1 (50 В)
2Т3129Б9	p-n-p	-60...+125	200	≥200	50	5	100 (200*)	≤1 (50 В)
2Т3129В9	p-n-p	-60...+125	200	≥200	30	5	100 (200*)	≤1 (30 В)
2Т3129Г9	p-n-p	-60...+125	200	≥200	30	5	100 (200*)	≤1 (30 В)
2Т3129Д9	p-n-p	-60...+125	200	≥200	20	5	100 (200*)	≤1 (20 В)
2Т313А	p-n-p	-60...+125	300 (1000*)	≥200	60	5	350 (700*)	≤0,5 (50 В)
2Т313Б	p-n-p	-60...+125	300 (1000*)	≥200	60	5	350 (700*)	≤0,5 (50 В)
2Т3130А-9	n-p-n	-60...+85	200	≥150	50	5	100	≤0,1 (50 В)
2Т3130Б-9	n-p-n	-60...+85	200	≥150	50	5	100	≤0,1 (50 В)
2Т3130В-9	n-p-n	-60...+85	200	≥150	30	5	100	≤0,1 (30 В)
2Т3130Г-9	n-p-n	-60...+85	200	≥300	20	5	100	≤0,1 (20 В)
2Т3130Д-9	n-p-n	-60...+85	200	≥150	30	5	100	≤0,1 (30 В)
2Т3130Е-9	n-p-n	-60...+85	200	≥300	20	5	100	≤0,1 (20 В)
2Т3132А-2	n-p-n	-60...+125	70 (85°C)	≥5,5 ГГц	10* (1к)	1	8,5	≤0,5 (10 В)
2Т3132Б-2	n-p-n	-60...+125	70 (85°C)	≥5,5 ГГц	10* (1к)	1	8,5	≤0,5 (10 В)
2Т3132В-2	n-p-n	-60...+125	70 (85°C)	≥5,5 ГГц	10* (1к)	1	8,5	≤0,5 (10 В)
2Т3132Г-2	n-p-n	-60...+125	70 (85°C)	≥5,5 ГГц	10* (1к)	1	8,5	≤0,5 (10 В)
2Т3133А	n-p-n		300	≥200	50	4	300; 700*	≤10 (50 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	C_k, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, Ом $r^*_{БЭ\,нас}$, Ом $K^{**}_{у.р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^*_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{**}_{вкл}$, нс	Корпус
30...400 (5 В; 2 мА)	≤1 (5 В)	≥8** (1 ГГц)	≤2 (1 ГГц)	—	**2Т3121-6**
20 (10 В; 10 мА) 20 (10 В; 10 мА) 20 (10 В; 10 мА)	≤1 (10 В) ≤1 (10 В) ≤1 (10 В)	≥5** (1 ГГц) ≥5** (1 ГГц) ≥5** (1 ГГц)	2,4 (1 ГГц) 3 (1 ГГц) 2,4 (1 ГГц)	≤10 ≤10 ≤10	**2Т3123-2**
15...200* (5 мА; 7 В) 15...200* (5 мА; 7 В) 15...200* (5 мА; 7 В)	0,5 0,5 0,5	≥4** (6 ГГц) ≥5** (5 ГГц) ≥6** (4 ГГц)	≤5 (6 ГГц) ≤5 (5 ГГц) ≤3,6 (4 ГГц)	≤2,5 ≤2,5 ≤2,5	**2Т3124-2**
30...120 (5 В; 2 мА) 80...250 (5 В; 3 мА) 80...250 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА)	≤10 (10 В) ≤10 (10 В) ≤10 (10 В) ≤10 (10 В) ≤10 (10 В)	≤20 ≤20 ≤20 ≤20 ≤20	— — — — —	— — — — —	**2Т3129-9**
30...120 (10 В; 1 мА) 80...300 (10 В; 1 мА)	≤12 (10 В) ≤12 (10 В)	≤3,3 ≤3,3	— —	≤120* ≤120*	**2Т313**
100...250 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 400...1000 (5 В; 2 мА) 200...500 (5 В; 2 мА) 400...1000 (5 В; 2 мА)	≤12 (5 В) ≤12 (5 В) ≤12 (5 В) ≤12 (5 В) ≤12 (5 В) ≤12 (5 В)	— — — — — —	≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤10 (1 кГц) ≤4 (1 кГц)	— — — — — —	**2Т3130-9**
15...150 (7 В; 3 мА) 15...150 (7 В; 3 мА) 15...150 (7 В; 3 мА) 15...150 (7 В; 3 мА)	≤5,5 (7 В) ≤5,5 (7 В) ≤5,5 (7 В) ≤5,5 (7 В)	≥6** (3,6 ГГц) ≥4** (6 ГГц) ≥5** (5 ГГц) ≥6** (4 ГГц)	≤2,5 (3,6 ГГц) ≤5 (6 ГГц) ≤5 (5 ГГц) ≤3,6 (4 ГГц)	— — — —	**2Т3132-2**
25...100 (3 В; 150 мА)	≤5 (10 В)	≤0,43	—	≤100*	**2Т3133**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т3133А-2	n-p-n	-60...+125	300	≥200	45* (500 Ом)	4	300; 700*	≤10 (50 В)
2Т3134А-1	n-p-n	-60...+125	30	≥1500	10	4	10; 20*	≤0,5 (10 В)
2Т3135А-1	p-n-p	-60...+125	15	≥1500	15* (1к)	4	30; 50*	≤1 (15 В)
2Т3150Б2	p-n-p	-60...+125	120 (65°C)	≥1200	35* (10к)	4	30 (50*)	≤0,5 (40 В)
2Т3152А	p-n-p	-60...+125	200 (60°C)	≥50	50*	20	150 (300*)	≤10* (50 В)
2Т3152Б	p-n-p	-60...+125	200 (60°C)	≥50	40*	20	150 (300*)	≤10* (40 В)
2Т3152В	p-n-p	-60...+125	200 (60°C)	≥50	30*	20	150 (300*)	≤10* (30 В)
2Т3152Г	p-n-p	-60...+125	200 (60°C)	≥50	50*	5	150 (300*)	≤10* (50 В)
2Т3152Д	p-n-p	-60...+125	200 (60°C)	≥50	40*	5	150 (300*)	≤10* (40 В)
2Т3152Е	p-n-p	-60...+125	200 (60°C)	≥50	30*	5	150 (300*)	≤10* (30 В)
2Т3154А-1	n-p-n	-60...+85	15	≥800	10* (3к)	4	20; 50*	≤0,5 (10 В)
2Т3156А-2	n-p-n	-60...+125	120	≥500	40* (10к)	4	10; 20*	≤1 (40 В)

$h_{21Э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^{*}_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс; $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
25...100 (3 В; 150 мА)	≤5 (10 В)	≤8*	—	≤100*	**2Т3133-2**
90...450 (2 В; 5 мА)	≤1,5 (5 В)	≤35; ≤110*	—	≤25	**2Т3134-1**
50...180 (5 В; 3 мА)	≤1,5 (10 В)	≤30; ≤110*	—	≤50; ≤10*	**2Т3135-1**
60...180* (5 В; 2,5 мА)	≤2 (10 В)	≤25	—	≤30; ≤30*	**2Т3150-2**
≥80 (5 В; 30 мА) ≥80 (5 В; 30 мА) ≥80 (5 В; 30 мА) ≥100 (5 В; 30 мА) ≥100 (5 В; 30 мА) ≥100 (5 В; 30 мА)	≤35 (20 В) ≤35 (20 В) ≤35 (20 В) ≤35 (20 В) ≤35 (20 В) ≤35 (20 В)	≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1	— — — — — —	≤400* ≤400* ≤400* ≤400* ≤400* ≤400*	**2Т3152**
40...120 (10 мА)	≤2,5 (5 В)	≤30; ≤110*	—	≤10*	**2Т3154-1**
40...300 (5 В; 2 мА)	≤1,3 (5 В)	—	—	≤40	**2Т3156-2**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{K\ max}$, $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т3158А-2	n-p-n	-60...+125	50	≥200	50; 50*	4	400; 800*	≤5 (50 В)
2Т316А	n-p-n	-60...+125	150 (75°C)	≥600	10* (3к)	4	50	≤0,5 (10 В)
2Т316Б	n-p-n	-60...+125	150 (75°C)	≥800	10* (3к)	4	50	≤0,5 (10 В)
2Т316В	n-p-n	-60...+125	150 (75°C)	≥800	10* (3к)	4	50	≤0,5 (10 В)
2Т316Г	n-p-n	-60...+125	150 (75°C)	≥600	10* (3к)	4	50	≤0,5 (10 В)
2Т316Д	n-p-n	-60...+125	150 (75°C)	≥800	10* (3к)	4	50	≤0,5 (10 В)
2Т3160А-2	n-p-n	-60...+125	300	≥200	50	4	300; 700*	≤10 (50 В)
2Т3162А	p-n-p	-60...+125	300	≥700	60* (5к)	—	150	≤0,5 (60 В)
2Т3162А5	p-n-p	-60...+125	300	≥700	60* (5к)	—	150	≤0,5 (60 В)
2Т3164А	p-n-p	-60...+125	250; 500**	≥800	15* (100к)	4		≤0,5 (20 В)
2Т3167А-7	n-p-n	-60...+125	120	≥400	40* (10к)	4	10; 20*	≤1 (40 В)
2Т317А-1	n-p-n	-60...+85	15	≥100	5	3,5	15 (45*)	≤1 (5 В)
2Т317Б-1	n-p-n	-60...+85	15	≥100	5	3,5	15 (45*)	≤1 (5 В)
2Т317В-1	n-p-n	-60...+85	15	≥100	5	3,5	15 (45*)	≤1 (5 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
50...180 (5 В; 200 мА)	≤15 (10 В)	≤0,53; ≤10*	—	≤400; ≤70*	**2Т3158-2** 3; 1; 17; Ø0.04; Коллектор База Эмиттер
20...60* (1 В; 10 мА) 40...120* (1 В; 10 мА) 40...120* (1 В; 10 мА) 20...100* (1 В; 10 мА) 60...300* (1 В; 10 мА)	≤3 (5 В) ≤3 (5 В) ≤3 (5 В) ≤3 (5 В) ≤3 (5 В)	≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40	— — — — —	≤10* ≤10* ≤15* ≤150 ≤150	**2Т316** Ø5,84; 5,3; 30; К Э Б
30...150 (3 В; 150 мА)	≤5 В (10 В)	≤4; ≤8*	—	≤100*	**2Т3160-2** 1,9; 1,1; 1,9; 17; Б К Э
60...200 (3 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤25	—	≤150; ≤100*	**2Т3162** Ø9,4; 6,6; 23; К Э Б
60...200 (3 В; 10 мА)	≤5 (10 В)	≤25	—	≤150; ≤100*	**2Т3162-5** 0,8; 0,3; 0,8
30...120 (7 В; 2 мА)	≤5 (5 В)	≤35; ≤120*	—	≤150	**2Т3164** Ø5,8; 5,3; 13,7; Э Б Корп. К
40...300 (5 В; 2 мА)	≤2 (5 В)	—	—	≤40	**2Т3167-7** 1,15; 0,95; 1,35; 15; Б К Э
25...75 (1 В; 1 мА) 35...120 (1 В; 1 мА) 80...250 (1 В; 1 мА)	≤11 (1 В) ≤11 (1 В) ≤11 (1 В)	≤30 ≤30 ≤30	— — —	≤130* ≤130* ≤130*	**2Т317-1** 1,3; 1,3; 1,1; 11; Б Э К

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т3175А	n-p-n	-60...+125	350	≥300	45* (10к)	5	100 (200*)	≤0,05 (50 В)
2Т318А-1	n-p-n	-60...+85	15	≥430	10	3,5	20 (45*)	≤0,5 (10 В)
2Т318Б-1	n-p-n	-60...+85	15	≥430	10	3,5	20 (45*)	≤0,5 (10 В)
2Т318В-1	n-p-n	-60...+85	15	≥430	10	3,5	20 (45*)	≤0,5 (10 В)
2Т318Г-1	n-p-n	-60...+85	15	≥350	10	3,5	20 (45*)	≤0,5 (10 В)
2Т318Д-1	n-p-n	-60...+85	15	≥350	10	3,5	20 (45*)	≤0,5 (10 В)
2Т318Е-1	n-p-n	-60...+85	15	≥350	10	3,5	20 (45*)	≤0,5 (10 В)
2Т318В1-1	n-p-n	-60...+85	15	≥350	10	3,5	20 (45*)	≤0,5 (10 В)
2Т3187А-9	n-p-n	-60...+85	200	≥4,4 ГГц	20	2	25	≤0,1 (10 В)
2Т3187А-91	n-p-n	-60...+85	200	4600	12*	2	25	≤0,1 (10 В)
2Т319А-1	n-p-n	-60...+85	—	≥100	5	3,5	15	≤1
2Т319Б-1	n-p-n	-60...+85	—	≥100	5	3,5	15	≤1
2Т319В-1	n-p-n	-60...+85	—	≥100	5	3,5	15	≤1
2Т321А	p-n-p	-60...+125	210 (20** Вт)	≥60	60	4	200 (2* А)	≤100 (60 В)
2Т321Б	p-n-p	-60...+125	210 (20** Вт)	≥60	60	4	200 (2* А)	≤100 (60 В)
2Т321В	p-n-p	-60...+125	210 (20** Вт)	≥60	60	4	200 (2* А)	≤100 (60 В)
2Т321Г	p-n-p	-60...+125	210 (20** Вт)	≥60	45	4	200 (2* А)	≤100 (45 В)
2Т321Д	p-n-p	-60...+125	210 (20** Вт)	≥60	45	4	200 (2* А)	≤100 (45 В)
2Т321Е	p-n-p	-60...+125	210 (20** Вт)	≥60	45	4	200 (2* А)	≤100 (45 В)
2Т324А-1	n-p-n	-60...+85	15	≥800	10	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
2Т324Б-1	n-p-n	-60...+85	15	≥800	10	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
2Т324В-1	n-p-n	-60...+85	15	≥800	10	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
2Т324Г-1	n-p-n	-60...+85	15	≥600	10	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
2Т324Д-1	n-p-n	-60...+85	15	≥600	10	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
2Т324Е-1	n-p-n	-60...+85	15	≥600	10	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
2Т325А	n-p-n	-60...+125	225 (85°C)	≥800	15* (3к)	4	60	≤0,5 (15 В)
2Т325Б	n-p-n	-60...+125	225 (85°C)	≥800	15* (3к)	4	60	≤0,5 (15 В)
2Т325В	n-p-n	-60...+125	225 (85°C)	≥1000	15* (3к)	4	60	≤0,5 (15 В)
2Т326А	p-n-p	-60...+125	250 (25°C)	≥250	15* (100к)	4	50	≤0,5 (10 В)
2Т326Б	p-n-p	-60...+125	250 (25°C)	≥400	15* (100к)	4	50	≤0,5 (10 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_{к}$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_{ш}$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
250...1000 (5 В; 2 мА)	—	—	—	—	**2Т3175**
30...90 (1 В; 10 мА) 50...150 (1 В; 10 мА) 70...280 (1 В; 10 мА) 30...90 (1 В; 10 мА) 50...150 (1 В; 10 мА) 70...280 (1 В; 10 мА) 70...280 (1 В; 10 мА)	≤3,5 (5 В) ≤3,5 (5 В) ≤3,5 (5 В) ≤4,5 (5 В) ≤4,5 (5 В) ≤4,5 (5 В) ≤4,5 (5 В)	≤27 ≤27 ≤27 ≤33 ≤33 ≤33 ≤27	— — — — — — —	≤15* ≤15* ≤15* ≤25* ≤25* ≤25* ≤10*	**2Т318-1**
≥40 (10 В; 14 мА) ≥40 (10 В; 14 мА)	≤0,9 (10 В) ≤0,9 (10 В)	≥12** (0,85 Гц) ≥12** (0,85 Гц)	≤2 (0,8 ГГц) ≤2 (0,8 ГГц)	— —	**2Т3187-91 (2Т3187-9)**
15...55 (1 В; 1 мА) 45...90 (1 В; 1 мА) 80...220 (1 В; 1 мА)	≤11 (1 В) ≤11 (1 В) ≤11 (1 В)	≤30 ≤30 ≤30	— — —	≤130* ≤130* ≤130*	**2Т319-1**
20...60* (3 В; 0,5 А) 40...120* (3 В; 0,5 А) 80...200* (3 В; 0,5 А) 20...60* (3 В; 0,5 А) 40...120* (3 В; 0,5 А) 80...200* (3 В; 0,5 А)	≤40 (10 В) ≤40 (10 В) ≤40 (10 В) ≤40 (10 В) ≤40 (10 В) ≤40 (10 В)	≤3,6 ≤3,6 ≤3,6 ≤3,6 ≤3,6 ≤3,6	— — — — — —	≤400; ≤1000* ≤400; ≤1000* ≤400; ≤1000* ≤400; ≤1000* ≤400; ≤1000* ≤400; ≤1000*	**2Т321**
20...60 (1 В; 10 мА) 40...120 (1 В; 10 мА) 80...250 (1 В; 10 мА) 40...120 (1 В; 10 мА) 20...80 (1 В; 10 мА) 60...250 (1 В; 10 мА)	≤2,5 (5 В) ≤2,5 (5 В) ≤2,5 (5 В) ≤2,5 (5 В) ≤2,5 (5 В) ≤2,5 (5 В)	≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30	— — — — — —	≤10* ≤10* ≤10* ≤15* ≤180 ≤180	**2Т324-1**
30...90* (5 В; 10 мА) 70...210* (5 В; 10 мА) 160...400* (5 В; 10 мА)	≤2,5 (5 В) ≤2,5 (5 В) ≤2,5 (5 В)	— — —	— — —	≤125 ≤125 ≤125	**2Т325**
20...70* (2 В; 10 мА) 45...160* (2 В; 10 мА)	≤5 (5 В) ≤5 (5 В)	≤30 ≤30	— —	≤450 ≤450	**2Т326**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т331А-1	n-p-n	-60...+125	15	≥250	15* (10к)	3	20; 50*	≤0,2 (15 В)
2Т331Б-1	n-p-n	-60...+125	15	≥250	15* (10к)	3	20; 50*	≤0,2 (15 В)
2Т331В-1	n-p-n	-60...+125	15	≥250	15* (10к)	3	20; 50*	≤0,2 (15 В)
2Т331Г-1	n-p-n	-60...+125	15	≥400	15* (10к)	3	20; 50*	≤0,2 (15 В)
2Т331Д-1	n-p-n	-60...+125	15	≥500	15* (10к)	3	20; 50*	≤0,2 (15 В)
2Т332А-1	n-p-n	-60...+125	15	≥250	15* (10к)	3	20; 50*	≤0,2 (15 В)
2Т332Б-1	n-p-n	-60...+125	15	≥250	15* (10к)	3	20; 50*	≤0,2 (15 В)
2Т332В-1	n-p-n	-60...+125	15	≥250	15* (10к)	3	20; 50*	≤0,2 (15 В)
2Т332Г-1	n-p-n	-60...+125	15	≥500	15* (10к)	3	20; 50*	≤0,2 (15 В)
2Т332Д-1	n-p-n	-60...+125	15	≥500	15* (10к)	3	20; 50*	≤0,2 (15 В)
2Т333А-3	n-p-n	-60...+85	15	≥450	10* (3к)	3,5	20 (45*)	≤0,4 (10 В)
2Т333Б-3	n-p-n	-60...+85	15	≥450	10* (3к)	3,5	20 (45*)	≤0,4 (10 В)
2Т333В-3	n-p-n	-60...+85	15	≥450	10* (3к)	3,5	20 (45*)	≤0,4 (10 В)
2Т333Г-3	n-p-n	-60...+85	15	≥350	10* (3к)	3,5	20 (45*)	≤0,4 (10 В)
2Т333Д-3	n-p-n	-60...+85	15	≥350	10* (3к)	3,5	20 (45*)	≤0,4 (10 В)
2Т333Е-3	n-p-n	-60...+85	15	≥350	10* (3к)	3,5	20 (45*)	≤0,4 (10 В)
2Т336А	n-p-n	-60...+85	50	≥250	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
2Т336Б	n-p-n	-60...+85	50	≥250	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
2Т336В	n-p-n	-60...+85	50	≥250	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
2Т336Г	n-p-n	-60...+85	50	≥450	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
2Т336Д	n-p-n	-60...+85	50	≥450	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
2Т336Е	n-p-n	-60...+85	50	≥450	10* (3к)	4	20 (50*)	≤0,5 (10 В)
2Т348А-3	n-p-n	-60...+85	15	≥100	5* (3к)	3,5	15 (45*)	≤1 (5 В)
2Т348Б-3	n-p-n	-60...+85	15	≥100	5* (3к)	3,5	15 (45*)	≤1 (5 В)
2Т348В-3	n-p-n	-60...+85	15	≥100	5* (3к)	3,5	15 (45*)	≤1 (5 В)
2Т354А-2	n-p-n	-60...+125	30	≥1100	10* (3к)	4	10 (20*)	≤0,5 (10 В)
2Т354Б-2	n-p-n	-60...+125	30	≥1500	10* (3к)	4	10 (20*)	≤0,5 (10 В)
2Т355А	n-p-n	-60...+125	225 (85°C)	≥1500	15* (3к)	4	30 (60*)	≤0,5 (15 В)
2Т360А-1	p-n-p	-60...+85	10 (55°C)	≥300	25	5	20 (75*)	≤1 (25 В)
2Т360Б-1	p-n-p	-60...+85	10 (55°C)	≥400	20	4	20 (75*)	≤1 (20 В)
2Т360В-1	p-n-p	-60...+85	10 (55°C)	≥400	20	4	20 (75*)	≤1 (20 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_{k}, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_{ш}$, дБ; $r^{*}_{б}$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс; $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
20...60* (1 мА; 5 В)	≤5 (5 В)	—	≤4,5 (100 МГц)	≤120	**2Т331-1**
40...120* (1 мА; 5 В)	≤5 (5 В)	—	≤4,5 (100 МГц)	≤120	
80...220* (1 мА; 5 В)	≤5 (5 В)	—	≤4,5 (100 МГц)	≤120	
40...120* (1 мА; 5 В)	≤5 (5 В)	—	≤4,5 (100 МГц)	≤120	
80...220* (1 мА; 5 В)	≤5 (5 В)	—			
20...60* (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В)	—	≤8 (100 МГц)	≤300	**2Т332-1**
40...120* (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В)	—	≤8 (100 МГц)	≤300	
80...220* (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В)	—	≤8 (100 МГц)	≤300	
40...120* (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В)	—	≤8 (100 МГц)	≤300	
80...220* (5 В; 1 мА)	≤5 (5 В)	—	≤8 (100 МГц)	≤300	
30...90 (1 В; 10 мА)	≤3,5 (5 В)	≤27	—	≤15*	**2Т333-3**
50...150 (1 В; 10 мА)	≤3,5 (5 В)	≤27	—	≤15*	
70...280 (1 В; 10 мА)	≤3,5 (5 В)	≤27	—	≤15*	
30...90 (1 В; 10 мА)	≤4,5 (5 В)	≤27	—	≤25*	
50...150 (1 В; 10 мА)	≤4,5 (5 В)	≤27	—	≤25*	
70...280 (1 В; 10 мА)	≤4,5 (5 В)	≤27	—	≤25*	
20...60 (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤30	—	≤30*	**2Т336**
40...120 (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤30	—	≤30*	
≥80 (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤30	—	≤50*	
20...60 (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤30	—	≤15*	
40...120 (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤30	—	≤15*	
≥80 (1 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤30	—	≤15*	
25...75 (1 В; 1 мА)	≤11 (1 В)	≤30	—	≤130*	**2Т348-3**
35...120 (1 В; 1 мА)	≤11 (1 В)	≤30	—	≤130*	
80...250 (1 В; 1 мА)	≤11 (1 В)	≤30	—	≤130*	
40...200 (2 В; 5 мА)	≤1,3 (5 В)	—	≤10*	≤25	**2Т354-2**
90...360 (2 В; 5 мА)	≤1,3 (5 В)	—	≤10*	≤30	
80...300* (5 В; 10 мА)	≤2 (5 В)	—	—	≤60	**2Т355**
25...70 (2 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤35	—	≤450; ≤100*	**2Т360-1**
40...120 (2 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤35	—	≤450; ≤200*	
80...240 (2 В; 10 мА)	≤5 (5 В)	≤35	—	≤450; ≤200*	

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т363А **2Т363Б**	p-n-p p-n-p	-60...+125 -60...+125	150 (45°C) 150 (45°C)	≥1000 ≥1500	15* (1к) 12* (1к)	4,5 4,5	30 (50*) 30 (50*)	≤0,5 (15 В) ≤0,5 (15 В)
2Т364А-2 **2Т364Б-2** **2Т364В-2**	p-n-p p-n-p p-n-p	-60...+85 -60...+85 -60...+85	30 30 30	≥250 ≥250 ≥250	25 25 25	5 5 5	200 (400*) 200 (400*) 200 (400*)	≤1 (25 В) ≤1 (25 В) ≤1 (25 В)
2Т366А-1 **2Т366Б-1** **2Т366В-1**	n-p-n n-p-n n-p-n	-60...+85 -60...+85 -60...+85	30 (70°C) 50 (70°C) 90 (70°C)	≥1000 ≥1000 ≥1000	15 15 15	4,5 4,5 4,5	10 (20*) 20 (40*) 45 (70*)	≤0,1 (15 В) ≤0,1 (15 В) ≤0,1 (15 В)
2Т366Б1-1	n-p-n	-60...+85	50 (70°C)	≥800	15	4,5	10 (40*)	≤0,1 (15 В)
2Т367А	n-p-n	-60...+125	100	1,5 ГГц	10	4	20 (40*)	≤0,5 (15 В)
2Т368А **2Т368Б**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	225 (65°C) 225 (65°C)	≥900 ≥900	15 15	4 4	30 (60*) 30 (60*)	≤0,5 (15 В) ≤0,5 (15 В)
2Т368А-9 **2Т368Б-9**	n-p-n n-p-n	-60...+100 -60...+100	100 (65°C) 100 (65°C)	≥900 ≥900	15 15	4 4	30 (60*) 30 (60*)	≤0,5 (15 В) ≤0,5 (15 В)
2Т370А-1 **2Т370Б-1**	p-n-p p-n-p	-60...+85 -60...+85	15 15	≥1000 ≥1200	15* (1к) 12* (1к)	4 4	15 (30*) 15 (30*)	≤0,5 (15 В) ≤0,5 (12 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, Ом $r^*_{БЭ\,нас}$, Ом $K^{**}_{у\,р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^*_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
20...120* (5 В; 5 мА) 40...120* (5 В; 5 мА)	≤2 (5 В) ≤2 (5 В)	≤35 ≤35	— —	≤50; ≤10* ≤75; ≤50*	**2Т363**
20...70* (1 В; 0,1 А) 40...120* (1 В; 0,1 А) 80...240* (1 В; 0,1 А)	≤15 (5 В) ≤15 (5 В) ≤15 (5 В)	≤3 ≤3 ≤3	— — —	≤500; ≤100* ≤500; ≤130* ≤500; ≤160*	**2Т364-2**
50...200 (1 В; 1 мА) 50...200 (1 В; 5 мА) 50...200 (1 В; 15 мА)	≤1,1 (0,1 В) ≤1,8 (0,1 В) ≤3,3 (0,1 В)	≤80 ≤25 ≤16	— — —	≤60; ≤50* ≤50; ≤80* ≤10; ≤120*	**2Т366**
50...200* (15 мА; 1 В)	≤1,8 (0,1 В)	≤25	—	≤50; ≤80*	**2Т366-1-1**
40...330 (5 В; 10 мА)	1,5	—	4,5	—	**2Т367**
50...300* (1 В; 10 А) 50...300* (1 В; 10 мА)	≤1,7 (5 В) ≤1,7 (5 В)	— —	≤3,3 (60 МГц) ≤3,3 (60 МГц)	≤15 ≤15	**2Т368**
50...300 (1 В; 10 мА) 50...300 (1 В; 10 мА)	≤1,7 (5 В) ≤1,7 (5 В)	— —	≤3,3 (60 МГц) —	≤15 ≤15	**2Т368-9**
20...70 (5 В; 3 мА) 40...120 (5 В; 3 мА)	≤2 (5 В) ≤2 (5 В)	≤35 ≤35	— —	≤50; ≤10* ≤75; ≤10*	**2Т370-1**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т370А9	p-n-p	-60...+85	30	≥1000	15* (1к)	4	15 (30*)	≤0,5 (15 В)
2Т370Б9	p-n-p	-60...+85	30	≥1200	12* (1к)	4	15 (30*)	≤0,5 (12 В)
2Т371А	n-p-n	-60...+125	100 (85°С)	≥3000	10	3	20 (40*)	≤0,5 (10 В)
2Т372А	n-p-n	-60...+125	50 (100°С)	≥2400	15* (10к)	3	10	≤0,5 (15 В)
2Т372Б	n-p-n	-60...+125	50 (100°С)	≥3000	15* (10к)	3	10	≤0,5 (15 В)
2Т372В	n-p-n	-60...+125	50 (100°С)	≥2400	15* (10к)	3	10	≤0,5 (15 В)
2Т377А-2	n-p-n	-60...+125	50	≥200	30* (1 к)	3	300 (600*)	≤3 (30 В)
2Т377Б-2	n-p-n	-60...+125	50	≥200	30* (1 к)	3	300 (600*)	≤3 (30 В)
2Т377В-2	n-p-n	-60...+125	50	≥200	30* (1 к)	3	300 (600*)	≤3 (30 В)
2Т377А1-2	n-p-n	-60...+125	50	≥200	30* (1 к)	3	300 (600*)	≤3 (30 В)
2Т377Б1-2	n-p-n	-60...+125	50	≥200	30* (1 к)	3	300 (600*)	≤3 (30 В)
2Т377В1-2	n-p-n	-60...+125	50	≥200	30* (1 к)	3	300 (600*)	≤3 (30 В)
2Т378А-2	n-p-n	-60...+125	50	≥200	60	4	400 (800*)	≤10 (60 В)
2Т378Б-2	n-p-n	-60...+125	50	≥200	60	4	400 (800*)	≤10 (60 В)
2Т378Б-2-1	n-p-n	-60...+125	50	≥200	30	4	400 (800*)	≤10 (30 В)
2Т378А1-2	n-p-n	-60...+125	50	≥200	60	4	400 (800*)	≤10 (60 В)
2Т378Б1-2	n-p-n	-60...+125	50	≥200	60	4	400 (800*)	≤10 (60 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_{к}$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_{ш}$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
20...70 (5 В; 3 мА) 40...120 (5 В; 3 мА)	≤2 (5 В) ≤2 (5 В)	≤35 ≤35	— —	≤50; ≤10* ≤75; ≤10*	**2Т370-9**
30...240 (1 В; 10 мА)	≤1,2 (5 В)	≥9** (0,4 ГГц)	≤4 (400 МГц) ≤10*	≤15	**2Т371**
10...90 (5 В; 10 мА) 10...90 (5 В; 10 мА) 10...90 (5 В; 10 мА)	≤1 (5 В) ≤1 (5 В) ≤1 (5 В)	≥10** (1 ГГц) ≥10** (1 ГГц) ≥10** (1 ГГц)	≤3,5 (1 ГГц) ≤5,5 (1 ГГц) ≤5,5 (1 ГГц)	≤9 ≤9 ≤9	**2Т372**
20...80* (150 мА; 2 В) 50...120* (150 мА; 2 В) 80...220* (150 мА; 2 В)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤15 (10 В)	≤6 ≤6 ≤6	— — —	≤400; ≤70* ≤400; ≤70* ≤400; ≤70*	**2Т377-2**
20...80* (150 мА; 2 В) 50...120* (150 мА; 2 В) 80...220* (150 мА; 2 В)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤15 (10 В)	≤6 ≤6 ≤6	— — —	≤400; ≤70* ≤400; ≤70* ≤400; ≤70*	**2Т377-1-2**
20...80* (200 мА; 5 В) 50...180* (200 мА; 5 В)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В)	≤4 ≤4	— —	≤400; ≤70* ≤400; ≤70*	**2Т378-2**
40...180* (200 мА; 5 В)	≤15 (10 В)	≤4	—	≤400; ≤70*	**2Т378-2-1**
20...80* (200 мА; 5 В) 50...180* (200 мА; 5 В)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В)	≤4 ≤4	— —	≤400; ≤70* ≤400; ≤70*	**2Т378-1-2**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т381А-1	n-p-n	-60...+70	15 (40°C)	≥200	15* (1 к)	6,5	15	≤10 мА (5 В)
2Т381Б-1	n-p-n	-60...+70	15 (40°C)	≥200	15* (1 к)	6,5	15	≤10 мА (5 В)
2Т381В-1	n-p-n	-60...+70	15 (40°C)	≥200	15* (1 к)	6,5	15	≤10 мА (5 В)
2Т381Г-1	n-p-n	-60...+70	15 (40°C)	≥200	25* (1 к)	6,5	15	≤10 мА (5 В)
2Т381Д-1	n-p-n	-60...+70	15 (40°C)	≥200	15* (1 к)	6,5	15	≤10 мА (5 В)
2Т382А	n-p-n	-60...+125	100 (65°C)	≥1800	15	3	20 (40*)	≤0,5 (15 В)
2Т382Б	n-p-n	-60...+125	100 (65°C)	≥1800	15	3	20 (40*)	≤0,5 (15 В)
2Т384А-2	n-p-n	-60...+125	300	≥450	30* (5к)	5	300 (500*)	≤10 (30 В)
2Т384АМ-2	n-p-n	-60...+125	300	≥450	30* (5к)	5	300 (500*)	≤10 (30 В)
2Т385А-2	n-p-n	-60...+125	300	≥200	60	5	300 (500*)	≤10 (60 В)
2Т385А-9	n-p-n	-60...+125	150	≥250	60	5	300	≤100 мА
2Т385АМ-2	n-p-n	-60...+125	300	≥200	60	5	300 (500*)	≤10 (60 В)
2Т388А-2	p-n-p	-60...+125	300 (80°C)	≥250	50	4,5	250	≤2 (50 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
≥50* (10 мкА; 5 В) ≥40* (10 мкА; 5 В) ≥30* (10 мкА; 5 В) ≥20* (10 мкА; 5 В) ≥20* (10 мкА; 5 В)	— — — — —	≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40	— — — — —	— — — — —	2Т381-1
40...330 (1 В; 5 мА) 40...330 (1 В; 5 мА)	≤2 (5 В) ≤2 (5 В)	≥9** (0,4 ГГц) ≥5** (0,4 ГГц)	≤3 (400 МГц) ≤4,5 (400 МГц)	≤15 ≤10	2Т382
30...180* (1 В; 0,15 А)	≤4 (10 В)	≤4	—	≤12*	2Т384-2
30...180* (1 В; 0,15 А)	≤4 (10 В)	≤4	—	≤12*	2Т384М-2
30...150* (1 В; 0,15 А)	≤4 (10 В)	≤5	—	≤60*	2Т385-2
40...150* (1 В; 0,15 А)	—	—	—	≤60*	2Т385-9
30...150* (1 В; 0,15 А)	≤4 (10 В)	≤5	—	≤60*	2Т385М-2
25...100* (1 В; 0,12 А)	≤7 (10 В)	≤5	—	60; ≤60*	2Т388-2

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т388А-5	p-n-p	-60...+125	300	≥250	50	4,5	250	≤2 (50 В)
2Т388АМ-2	p-n-p	-60...+125	300 (80°C)	≥250	50	4,5	250	≤2 (50 В)
2Т389А-2	p-n-p	-60...+125	300 (80°C)	≥450	25* (1к)	4,5	300	≤1 (25 В)
2Т391А-2 **2Т391Б-2**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	70 (85°C) 70 (85°C)	≥5000 ≥5000	15 15	2 2	10 10	≤0,5 (10 В) ≤0,5 (10 В)
2Т392А-2	p-n-p	-60...+85	120 (65°C)	≥300	40* (10 к)	4	10 (20*)	≤0,5 (40 В)
2Т396А-2	n-p-n	-60...+125	30 (50°C)	≥2100	15	3	40 (40*)	≤0,5 (15 В)
2Т397А-2	n-p-n	-60...+125	120 (90°C)	≥500	40* (10к)	4	10 (20*)	≤1 (40 В
2Т399А	n-p-n	-60...+125	150 (65°C)	≥1800	15	3	20 (40*)	≤0,5 (15 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	C_k, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
25...100* (1 В; 0,12 А)	≤7 (10 В)	≤5	—	≤60*	**2Т388-5**
25...100* (1 В; 0,12 А)	≤7 (10 В)	≤5	—	60; ≤60*	**2Т388М-2**
25...100* (1 В; 0,2 А)	≤10 (10 В)	≤3	—	≤25*; ≤180	**2Т389-2**
≥20 (7 В; 5 мА) ≥20 (7 В; 5 мА)	≤0,7 (5 В) ≤0,7 (5 В)	≥6** ≥6**	≤4,5 (3,6 ГГц) ≤5,5 (3,6 ГГц)	≤3,7 ≤3,7	**2Т391-2**
40...180* (5 В; 2,5 мА)	≤2,5 (5 В)	≤50	4,5 (100 МГц)	≤120	**2Т392-2**
40...250 (2 В; 5 мА)	≤1,5 (5 В)	≤11*	—	≤15	**2Т396-2**
40...300 (5 В; 2 мА)	≤1,3 (5 В)	≤25*	—	≤40	**2Т397-2**
≥40* (1 В; 5 мА)	≤1,7 (5 В)	≥11,5 (0,4 ГГц)	≤2 (400 МГц)	≤8	**2Т399**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т504А **2Т504Б**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	1 (10*) Вт 1 (10*) Вт	≥20 ≥20	1 (2*) А 1 (2*) А	6 6	1 (2*) А 1 (2*) А	≤100 (400 В) ≤100 (250 В)
2Т504А-5 **2Т504Б-5**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	0,025 (10*) Вт 0,025 (10*) Вт	≥20 ≥20	400; 350* 200* (0,1к)	6 6	1 (2*) А 1 (2*) А	≤100 (400 В) ≤100 (250 В)
2Т505А **2Т505Б**	p-n-p p-n-p	-60...+125 -60...+125	1 (5*) Вт 1 (5*) Вт	≥20 ≥20	300* (0,1к) 250* (0,1к)	5 5	1 (2*) А 1 (2*) А	≤100 (300 В) ≤100 (250 В)
2Т505А-5	p-n-p	-60...+125	1 (5*) Вт	≥20	300* (0,1к)	5	1 (2*) А	≤100 (300 В)
2Т506А **2Т506Б**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	0,8 (10*) Вт 0,8 (10*) Вт	≥10 ≥10	800 600	5 5	2 (5*) А 2 (5*) А	≤1000 (800 В) ≤200 (600 В)
2Т506А-5	n-p-n	-60...+125	0,8 (10*) Вт	≥10	800	5	2 (5*) А	≤1000 (800 В)
2Т509А	p-n-p	-60...+125	0,3 (1*) Вт	≥10	450* (10к)	5	20	≤5 (500 В)
2Т509А-5	p-n-p	-40...+85	0,025 (1*) Вт	≥10	450* (10к)	5	20	≤5 (500 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^*_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
15...100* (5 В; 0.5 А) 15...100* (5 В; 0.5 А)	≤30 (10 В) ≤30 (10 В)	≤2 ≤2	— —	≤2700* ≤2700*	**2Т504**
15...100* (5 В; 0.5 А) 15...100* (5 В; 0.5 А)	≤30 (10 В) ≤30 (10 В)	≤2 ≤2	— —	≤2700* ≤2700*	**2Т504-5**
25...140* (10 В; 0,5 А) 25...140* (10 В; 0,5 А)	≤70 (5 В) ≤70 (5 В)	≤3,6 ≤3,6	— —	≤2600* ≤2600*	**2Т505**
25...140* (10 В; 0,5 А)	≤70 (5 В)	≤3,6	—	≤2600*	**2Т505-5**
30...150* (5 В; 0,3 А) 30...150* (5 В; 0,3 А)	≤40 (5 В) ≤40 (5 В)	≤2 ≤2	— —	≤1560* ≤1560*	**2Т506**
30...150* (5 В; 0,3 А)	≤40 (5 В)	≤2	—	≤1560*	**2Т506-5**
15...100 (10 В; 0,1 мА)	≤2,9 (100 В)	10к	—	≤500	**2Т509**
15...100 (10 В; 0,1 мА)	≤2,9 (100 В)	10к	—	≤500	**2Т509-5**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т528А-9	n-p-n	-60...+125	600	—	100*	—	2000	—
2Т528Б-9	n-p-n	-60...+125	600	—	80*	—	2000	—
2Т528В-9	n-p-n	-60...+125	600	—	50*	—	2000	—
2Т528Г-9	n-p-n	-60...+125	600	—	30*	—	2000	—
2Т528Д-9	n-p-n	-60...+125	600	—	12*	—	2000	—
2Т602А	n-p-n	-60...+125	0,85 (2,8*) Вт	≥150	120	5	75 (500*)	≤10 (120 В)
2Т602Б	n-p-n	-60...+125	0,85 (2,8*) Вт	≥150	120	5	75 (500*)	≤10 (120 В)
2Т602АМ	n-p-n	-60...+125	0,85 (2,8*) Вт	≥150	120	5	75 (500*)	≤10 (120 В)
2Т602БМ	n-p-n	-60...+125	0,85 (2,8*) Вт	≥150	120	5	75 (500*)	≤10 (120 В)
2Т603А	n-p-n	-60...+125	0,5 Вт (50°C)	≥200	30* (1к)	3	300 (600*)	≤3 (30 В)
2Т603Б	n-p-n	-60...+125	0,5 Вт (50°C)	≥200	30* (1к)	3	300 (600*)	≤3 (30 В)
2Т603В	n-p-n	-60...+125	0,5 Вт (50°C)	≥200	15* (1к)	3	300 (600*)	≤3 (15 В)
2Т603Г	n-p-n	-60...+125	0,5 Вт (50°C)	≥200	15* (1к)	3	300 (600*)	≤3 (15 В)
2Т603И	n-p-n	-60...+125	0,5 Вт (50°C)	≥200	30* (1к)	3	300 (600*)	≤3 (30 В)
2Т606А	n-p-n	-60...+125	2,5** Вт (40°C)	≥350	65	4	400 (800*)	≤1,5* (65 В)
2Т607А-4	n-p-n	-60...+125	1,5 Вт	≥700	40	4	150	≤1 (30 В)
2Т608А	n-p-n	-60...+125	0,5 Вт	≥200	60	4	400 (800*)	≤10 (60 В)
2Т608Б	n-p-n	-60...+125	0,5 Вт	≥200	60	4	400 (800*)	≤10 (60 В)

h_{21}, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^{*}_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс; $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
20...200 (5 В; 1 А) 20...200 (5 В; 1 А) 50...250 (5 В; 1 А) 50...250 (5 В; 1 А) 50...250 (5 В; 1 А)	— — — — —	≤0,4 ≤0,4 ≤0,4 ≤0,4 ≤0,4	— — — — —	300* 300* 300* 300* 300*	2Т528-9
20...80 (10 В; 10 мА) ≥50 (10 В; 10 мА)	≤4 (50 В) ≤4 (50 В)	≤60 ≤60	— —	≤300 ≤300	2Т602
20...80 (10 В; 10 мА) ≥50 (10 В; 10 мА)	≤4 (50 В) ≤4 (50 В)	≤60 ≤60	— —	≤300 ≤300	2Т602М
20...80* (2 В; 15 А) ≥60* (2 В; 0,15 А) 20...80* (2 В; 0,15 А) ≥60* (2 В; 0,15 А) ≥20* (2 В; 0,35 А)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤15 (10 В) ≤15 (10 В)	≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤3,4	— — — — —	≤400; ≤70* ≤400; ≤70* ≤400; ≤70* ≤400; ≤70* ≤400; ≤70*	2Т603
≥15* (10 В; 0,1 А)	≤10 (28 В)	≤5; ≥2,5**	≥0,8** (0,4 ГГц)	≤10	2Т606
—	≤4 (10 В)	≥4** (1 ГГц)	≥1** (1 ГГц)	≤18	2Т607-4
25...80* (5 В; 0,2 А) 50...160* (5 В; 0,2 А)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В)	≤2,5 ≤2,5	— —	≤120* ≤120*	2Т608

Тип прибора	Структура	$T_{окр}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т610А **2Т610Б**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	1,5 Вт (50°C) 1,5 Вт (50°C)	≥1000 ≥700	26 26	4 4	300 300	≤0,5 (20 В) ≤0,5 (20 В)
2Т624А-2	n-p-n	-60...+125	1 Вт	≥450	30	4	1000 (1300*)	≤100 (30 В)
2Т624АМ-2	n-p-n	-60...+125	1 Вт	≥450	30	4	1000 (1300*)	≤100 (30 В)
2Т625А-2 **2Т625Б-2**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	1 Вт 0,7 Вт (125°C)	≥200 ≥200	40* (5к) 40* (5к)	5 5	1000 (1300*) 1 А (1,3* А)	≤30 (60 В) ≤30 (60 В)
2Т625АМ-2 **2Т625БМ-2**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	1 Вт 0,7 Вт (125°C)	≥200 ≥200	40* (5к) 40* (5к)	5	1000 (1300*) 1 А (1,3* А)	≤30 (60 В) ≤30 (60 В)
2Т629А-2	p-n-p	-60...+125	1 Вт	≥250	50* (1к)	4,5	1000	≤5 (50 В)
2Т629А-5	p-n-p	-60...+125	1000	≥250	50	4,5	1000	≤5 (50 В)
2Т629АМ-2	p-n-p	-60...+125	1 Вт	≥250	60	4,5	1А	≤5 (50 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_{k}, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_{ш}$, дБ; $r^{*}_{б}$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс; $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
50...250* (10 В; 0,15 А) 20...250* (10 В; 0,15 А)	≤4,1 (10 В) ≤4,1 (10 В)	— ≥6,4** (0,4 ГГц)	6 (0,2 ГГц) 6 (0,2 ГГц)	≤35 ≤18	2Т610
30...180* (0,5 В; 0,3 А)	≤15 (5 В)	≤9	—	≤18	2Т624-2
30...180* (0,5 В; 0,3 А)	≤15 (5 В)	≤9	—	≤18	2Т624М-2
30...120* (1 В; 0,5 А) 20...120* (500 мА; 1 В)	≤9 (10 В) ≤9 (10 В)	≤2,4 ≤1,3	— —	≤60 ≤60	2Т625-2
30...120* (1 В; 0,5 А) 20...120* (500 мА; 1 В)	≤9 (10 В) ≤9 (10 В)	≤2,4 ≤1,3	— —	≤60 ≤60	2Т625М
25...80* (1,2 В; 0,5 А)	≤20 (10 В)	≤1,6	—	≤120; 90*	2Т629А-2
25...150* (5 В; 0,5 А)	≤25 (10 В)	≤2	—	90*	2Т629А-5
25...80* (1,2 В; 0,5 А)	≤20 (10 В)	≤1,6	—	—	2Т629АМ-2

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{K\ max}$, $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т630А	n-p-n	-60...+125	0,8 Вт	≥50	120	7	1000 (2000*)	≤1 (90 В)
2Т630Б	n-p-n	-60...+125	0,8 Вт	≥50	120	7	1000 (2000*)	≤1 (90 В)
2Т630А-5	n-p-n	-60...+125	0,8 Вт	≥50	120	7	1000 (2000*)	≤0,1 (90 В)
2Т632А	p-n-p	-60...+125	0,5 Вт (40°С)	≥200	120* (1к)	5	0,1 А (0,35*А)	≤1 (120 В)
2Т633А	n-p-n	-60...+125	1,2* Вт	≥500	30	4,5	200 (500*)	≤3 (30 В)
2Т634А-2	n-p-n	-60...+125	1,2 Вт	≥1500	50	3	150 (250*)	≤1 мА (30 В)
2Т635А	n-p-n	-60...+125	0,5 Вт	≥250	60	5	1 (1,2*) А	≤10 (60 В)
2Т637А-2	n-p-n	-60...+100	1,5 Вт	≥1300	30	2,5	200 (300*)	≤0,1 мА (30 В)
2Т638А	n-p-n	-60...+125	0,5 Вт; 1** Вт	≥200	120* (1к)	5	0,1А (0,35* А)	≤0,1 мА (120 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r'_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс; $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
40...120* (10 В; 150 мА) 80...240* (10 В; 150 мА)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В)	≤2 ≤2	≥5* ≥5*	≤500** ≤500**	**2Т630**
40...120* (10 В; 150 мА)	≤15 (10 В)	≤2	≥5*	≤500**	**2Т630-5**
≥50 (1 мА; 10 В)	≤8 (20 В)	≤25	—	≤100; ≤2000*	**2Т632**
40...140 (1 В; 10 мА)	≤4,5 (10 В)	≤5	≤6 (20 МГц)	≤13*; ≤18**	**2Т633**
—	≤2,5 (15 В)	≥1,4** (5 ГГц)	≥0,45** (5 ГГц)	≤2	**2Т634-2**
25...150* (1 В; 0,5 А)	≤10 (10 В)	≤1	—	≤58; ≤60**	**2Т635**
30...140* (5 В; 50 мА)	≤4,5 (15 В)	—	≥0,5** (3 ГГц)	≤3	**2Т637-2**
≥50 (1 В; 10 мА)	≤8 (20 В)	≤25	—	≤25; 1* мкс	**2Т638**

20 зак 9

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т640А-2	n-p-n	-60...+125	0,6 Вт (60°С)	≥3 ГГц	25	3	60	≤0,5 мА (25 В)
2Т640А1-2	n-p-n	-60...+125	0,6 Вт (60°С)	≥3 ГГц	25	3	60	≤0,5 мА (25 В)
2Т640А-6	n-p-n	-60...+100	0,6 Вт (60°С)	≥3 ГГц	15	3	30	≤0,5 мА (25 В)
2Т640А-5	n-p-n	-60...+100	0,6 Вт (60°С)	≥3 ГГц	15	3	30	≤0,5 мА (25 В)
2Т642А-2	n-p-n	-60...+125	500 (75°С)	—	20	2	60	≤1 мА (20 В)
2Т642А1-2 **2Т642Б1-2**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	350 350	3600 3600	15 15	2 2	40 40	≤500 (15 В) ≤500 (15 В)
2Т642В1-2 **2Т642Г1-2**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	230 230	— —	15 15	2 2	40 40	≤0,5 мА (15 В) ≤0,5 мА (15 В)
2Т642А-5 **2Т642А1-5**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	500 500	— —	20 20	2 2	60 60	≤1 мА (20 В) ≤1 мА (20 В)
2Т643А-2	n-p-n	-60...+125	1,1 Вт (50°С)	—	25	3	120	≤1 мА (25 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
≥15* (5 В; 5 мА)	≤1,3 (15 В)	≥6** (7 ГГц)	≤8 (6 ГГц); ≥0,1**	0,6	2Т640-2
≥15* (5 В; 5 мА)	≤1,3 (15 В)	≥6** (7 ГГц)	≥65** мВт (7 ГГц)	0,6	2Т640-1-2
≥15* (5 В; 5 мА)	≤1,3 (15 В)	≥6** (7 ГГц)	≥65** мВт (7 ГГц)	0,6	2Т640-6
≥15* (5 В; 5 мА)	≤1,3 (15 В)	≥6** (7 ГГц)	≥65** мВт (7 ГГц)	0,6	2Т640-5
—	≤1,1 (15 В)	≥3,5** (8 ГГц)	≥100** мВт (8 ГГц)	—	2Т642-2, 2Т642-1-2
— —	≤1,1 (15 В) ≤1,1 (15 В)	≥9** (2,25 ГГц) ≥8** (2,25 ГГц)	≤4,5 (2,25 ГГц) ≤4,5 (2,25 ГГц)	— —	
— —	— —	≥6** (3,6 ГГц) ≥5,5** (3,6 ГГц)	≤5 (3,6 ГГц) ≤5,5 (3,6 ГГц)	— —	
— —	≤1,1 (15 В) ≤1,1 (15 В)	≥3,5** (8 ГГц) ≥3,5** (8 ГГц)	≥0,1** (8 ГГц) ≥0,07** (8 ГГц)	— —	2Т642А-5, 2Т642-1-5
—	≤1,8 (15 В)	—	≥0,48** (7 ГГц)	—	2Т643-2

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{K\ max}$, $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т643Б-2	n-p-n	-60...+125	1,1 Вт (50°C)	—	25	3	120	≤1 мА (25 В)
2Т643А-5	n-p-n	-60...+125	1,1 Вт (50°C)	—	25	3	120	≤1 мА (25 В)
2Т647А-2	n-p-n	-60...+125	0,56 Вт (80°C)	—	18	2	90	1000 (18 В)
2Т647А-5	n-p-n	-60...+125	0,56 Вт (80°C)	—	18	2	90	1000 (18 В)
2Т648А-2	n-p-n	-60...+125	420 (45°C)	—	18	2	60	≤1 мА (18 В)
2Т648А-5	n-p-n	-60...+125	420 (45°C)	—	18	2	60	≤1 мА (18 В)
2Т649А-2	n-p-n	-60...+125	1,5 Вт	≥1,3 ГГц	30	2,5	200	—
2Т652А	n-p-n	-60...+125	1 Вт (50°C)	≥200	50	4	1 А (2* А)	≤300 (50 В)
2Т652А-2	n-p-n	-60...+125	0,5 Вт (50°C)	≥200	50	4	1 А (2* А)	≤300 (50 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^{*}_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс; $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
50...150* (10 В; 50 мА)	≤1,8 (15 В)	—	≥0,48** (7 ГГц)	—	**2Т643-2**
—	≤1,8 (15 В)	—	≥0,48** (7 ГГц)	—	**2Т643-5**
—	≤1,5 (15 В)	≥3** (10 ГГц)	≥170** мВт (10 ГГц)	—	**2Т647-2**
—	≤1,5 (15 В)	≥3** (10 ГГц)	≥170** мВт (10 ГГц)	—	**2Т647-5**
—	≤1,5 (10 В)	3** (12 ГГц)	50** мВт (12 ГГц)	—	**2Т648-2**
—	≤1,5 (10 В)	3** (12 ГГц)	50** мВт (12 ГГц)	—	**2Т648-5**
20...90* (5 В; 50 мА)	≤3	3** (12 ГГц)	≥0,4** (3 ГГц)	—	**2Т649-2**
25...100* (500 мА; 3 В)	≤12 (10 В)	≤1,3	—	≤100*	**2Т652**
25...100* (500 мА; 3 В)	≤12 (10 В)	≤1,3	—	≤100*	**2Т652-2**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °С	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т653А	n-p-n	-60...+125	5 Вт (40°С)	≥50	130	7	1 А (2А*)	10* (120 В)
2Т653Б	n-p-n	-60...+125	5 Вт (40°С)	≥50	130	7	1 А (2А*)	10* (100 В)
2Т657А-2	n-p-n	-60...+125	375	≥3 ГГц	12*	2	60	≤1 мА (12 В)
2Т657Б-2	n-p-n	-60...+125	375	≥3 ГГц	12*	2	60	≤1 мА (12 В)
2Т657В-2	n-p-n	-60...+125	375	≥3 ГГц	12*	2	60	≤1 мА (12 В)
2Т658А-2	p-n-p	-60...+125	600 (60°С)	≥4 ГГц	12* (1к)	3	75 (150*)	≤0,5 мА (15 В)
2Т658Б-2	p-n-p	-60...+125	600 (60°С)	≥4 ГГц	8* (1к)	3	75 (150*)	≤0,5 мА (10 В)
2Т658В-2	p-n-p	-60...+125	600 (60°С)	≥2 ГГц	15* (1к)	3	75 (150*)	≤0,5 мА (20 В)
2Т663А	p-n-p	-60...+100	400	≥300	50*	3	250	≤0,5 (45 В)
2Т663Б	p-n-p	-60...+100	400	≥300	25*	3	250	≤0,5 (25 В)
2Т664А9-1	p-n-p	-60...+100	1* Вт	≥140	120	5	≤1 А (1,5* А)	≤10 (100 В)
2Т664Б9-1	p-n-p	-60...+100	1* Вт	≥140	100	5	≤1 А (1,5* А)	≤10 (100 В)
2Т665А9-1	n-p-n	-60...+100	1* Вт	≥50	120	5	1 А	≤10 (100 В)
2Т665Б9-1	n-p-n	-60...+100	1* Вт	≥50	100	5	1 А	≤10 (100 В)
2Т669А	n-p-n	-60...+125	500	≥200	50	4	400; 800*	≤5 (50 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_{к}$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\,нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р}$, дБ	$K_{ш}$, дБ; $r'_{б}$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс; $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
40...150 (150 мА; 10 В) 80...250 (150 мА; 10 В)	≤20 (10 В) ≤20 (10 В)	≤3,3 ≤3,3	— —	≤1** мкс ≤1** мкс	2Т653
— 60...200 (6 В; 30 мА) 35...70 (6 В; 30 мА)	≤1,1 (15 В) ≤1,1 (15 В) ≤1,1 (15 В)	≥8** (2 ГГц) ≥8** (2 ГГц) ≥8** (2 ГГц)	≥0,05** (2 ГГц) ≥0,05** (2 ГГц) ≥0,05** (2 ГГц)	— — —	2Т657-2
≥20* (50 мА; 5 В) ≥30* (50 мА; 5 В) ≥20* (50 мА; 5 В)	≤2 (10 В) ≤2 (10 В) ≤2 (10 В)	≥6** (1 ГГц) ≥6** (1 ГГц) ≥6** (1 ГГц)	≤7,8 (1 ГГц) ≤7,8 (1 ГГц) ≤7,8 (1 ГГц)	— — —	2Т658-2
20...80* (5 В; 50 мА) 20...80* (5 В; 50 мА)	≤12 ≤12	≤3; 8* ≤3; 8*	— —	— —	2Т663
40...250* (2 В; 0,1 А) 40...250* (2 В; 0,1 А)	≤25 (5 В) ≤25 (5 В)	≤2,3 ≤2,3	— —	≤700** ≤700**	2Т664-9
40...250 (2 В; 0,15 А) 40...250 (2 В; 0,15 А)	≤25 ≤25	≤2 ≤2	— —	≤500** ≤500**	2Т665-9
50...160 (5 В; 200 мА)	≤15 (10 В)	≤2,5; ≤5*	—	≤100*	2Т669

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{K\ max}$, $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т669А1	n-p-n	-60...+125	225	≥200	50	4	300; 600*	≤5 (50 В)
2Т671А-2	n-p-n	-60...+125	900	≥2 ГГц	15	1,5	150	≤1 мА (15 В)
2Т672А-2	n-p-n	-60...+125	1* Вт	≥200	50	4	1 А; 2* А	—
2Т679А-2 **2Т679Б-2**	p-n-p p-n-p	-60...+125	1,5* Вт 1,5* Вт	≥300 ≥300	50* (1к) 25* (1к)	3 3	0,5 А; 1* А 0,5 А; 1* А	≤1 (50 В) ≤1 (25 В)
2Т679А-5 **2Т679Б-5**	p-n-p p-n-p	-60...+125	1** Вт 1** Вт	≥300 ≥300	50 25	3 3	0,5 А; 1* А 0,5 А; 1* А	≤1 (50 В) ≤1 (25 В)
2Т682А-2 **2Т682Б-2**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	350 350	≥4,4 ГГц ≥4,4 ГГц	10 10	1 1	50 50	≤1 (10 В) ≤1 (10 В)
2Т687АС2 **2Т687БС2**	p-n-p p-n-p	-60...+125 -60...+125	1,5 Вт 1,5 Вт	300 300	70 60	3 3	1,5 (3*) А 1,5 (3*) А	≤2 мА (50 В) ≤2 мА (50 В)
2Т688А2 **2Т688Б2**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	750 750	— —	16 16	1 1	100 100	≤1 мА (16 В) ≤1 мА (16 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\,нас}$, Ом $K^{**}_{у.р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
40...180 (2 В; 70 мА)	≤15 (10 В)	≤9; ≤17*	—	≤150; ≤100*	**2Т669**
—	1,45 (8 В)	≥4,8**	≥0,3** (8,5 ГГц)	—	**2Т671-2**
30...120	—	—	—	—	**2Т672А-2**
20...80 (2 В; 0,5 А) 20...80 (2 В; 0,5 А)	≤30 (10 В) ≤30 (10 В)	≤1,6; ≤3* ≤1,6; ≤3*	— —	≤60*; <200** ≤60*; <200**	**2Т679-2**
20...80 (2 В; 0,5 А) 20...80 (2 В; 0,5 А)	≤30 (10 В) ≤30 (10 В)	≤1,6 ≤1,6	— —	≤60* ≤60*	**2Т679-5**
40...75 (7 В; 2 мА) 80...120 (7 В; 2 мА)	≤0,9 (10 В) ≤0,9 (10 В)	≥7** (3,6 ГГц) ≥7** (3,6 ГГц)	≤4 (3,6 ГГц) ≤4 (3,6 ГГц)	— —	**2Т682-2**
20...90* (5 В; 0,3 А) 20...90* (5 В; 0,3 А)	— —	≤3,3 ≤2,6	— —	70 70	**2Т687-2**
20...90* (5 В; 0,3 А) 20...90* (5 В; 0,3 А)	≤1,1 (8 В) ≤1,1 (8 В)	≥1,6** (15 ГГц) ≥1,6** (12 ГГц)	≥0,04** (15 ГГц) ≥0,08** (12 ГГц)	— —	**2Т688-2**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т691А2	p-n-p	-60...+125	1200	≥3 ГГц	40	3	200	≤1 мА (40 В)
2Т693АС	n-p-n	-60...+125	750	—	150*	5	150	≤10 (120 В)
2Т704А	n-p-n	-60...+100	15* Вт (50°С)	≥3	500** (1000 имп)	4	2,5 (4*) А	≤5* мА (1000 В)
2Т704Б	n-p-n	-60...+100	15* Вт (50°С)	≥3	400* (700 имп)	4	2,5 (4*) А	≤5* (700 В)
2Т708А	p-n-p	-60...+125	0,7 Вт	≥3	100* (1к)	5	2,5 А (5 А*)	≤1 мА (100 В)
2Т708Б	p-n-p	-60...+125	0,7 Вт	≥3	80* (1к)	5	2,5 А (5 А*)	≤1 мА (80 В)
2Т708В	p-n-p	-60...+125	0,7 Вт	≥3	60* (1к)	5	2,5 А (5 А*)	≤1 мА (60 В)
2Т709А	p-n-p	-60...+125	2 (30*) Вт	≥3	100	5	10 (20*) А	≤1 мА (100 В)
2Т709Б	p-n-p	-60...+125	2 (30*) Вт	≥3	80	5	10 (20*) А	≤1 мА (80 В)
2Т709В	p-n-p	-60...+125	2 (30*) Вт	≥3	60	5	10 (20*) А	≤1 мА (60 В)
2Т709А2	p-n-p	-60...+100	1 (30*) Вт	≥3	100	5	10 (20*) А	≤1 мА (100 В)
2Т709Б2	p-n-p	-60...+100	1 (30*) Вт	≥3	80	5	10 (20*) А	≤1 мА (80 В)
2Т709В2	p-n-p	-60...+100	1 (30*) Вт	≥3	60	5	10 (20*) А	≤1 мА (60 В)
2Т713А	n-p-n	-60...+100	50* Вт	≥1,5	2,5 кВ	6	3 А	≤1 мА (2,5 кВ)
2Т716А	n-p-n	-60...+125	30* Вт	≥6	100	5	10 (20*) А	≤1 мА (100 В)
2Т716Б	n-p-n	-60...+125	30* Вт	≥6	80	5	10 (20*) А	≤1 мА (80 В)
2Т716В	n-p-n	-60...+125	30* Вт	≥6	60	5	10 (20*) А	≤1 мА (60 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, C^{*}_{12}, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\,нас}$, Ом $K^{**}_{у\,р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
≥20 (10 В; 50 мА)	≤3,5 (10 В)	≥6,6**	≤4 (1 ГГц)	—	**2Т691-2**
≥40 (5 В; 0,1 А)	—	≤4	—	—	**2Т693АС**
10...100* (15 В; 1 А) 10...100* (15 В; 1 А)	≤50 (20 В) ≤50 (20 В)	≤2,5 ≤2,5	— —	— —	**2Т704**
≥500* (2 А; 5 В) ≥750* (2 А; 5 В) ≥750* (2 А; 5 В)	— — —	≤1 ≤1 ≤1	— — —	≤4** мкс ≤4** мкс ≤4** мкс	**2Т708**
≥500* (5 А; 5 В) ≥750* (5 А; 5 В) ≥750* (5 А; 5 В)	≤230 (5 В) ≤230 (5 В) ≤230 (5 В)	≤0,4 ≤0,4 ≤0,4	— — —	≤4,5** мкс ≤4,5** мкс ≤4,5** мкс	**2Т709**
≥500* (5 А; 5 В) ≥750* (5 А; 5 В) ≥750* (5 А; 5 В)	≤250 (5 В) ≤250 (5 В) ≤250 (5 В)	≤0,4 ≤0,4 ≤0,4	— — —	— — —	**2Т709-2**
5...20* (10 В; 1,5 А)	—	≤0,66	—	≤15* мкс	**2Т713**
≥750* (5 А; 5 В) ≥750* (5 А; 5 В) ≥750* (5 А; 5 В)	≤150 (5 В) ≤150 (5 В) ≤150 (5 В)	≤0,4 ≤0,4 ≤0,4	— — —	≤7000** ≤7000** ≤7000**	**2Т716**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т716А-1 **2Т716Б-1** **2Т716В-1**	n-p-n n-p-n n-p-n	-60...+100 -60...+100 -60...+100	30* Вт 30* Вт 30* Вт	≥3 ≥3 ≥3	100 80 60	5 5 5	10 А 10 А 10 А	≤1 мА (100 В) ≤1 мА (80 В) ≤1 мА (60 В)
2Т718А **2Т718Б**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	200* Вт 200* Вт	≥0,2 ≥0,2	400 300	5 5	10 (12*) А 10 (12*) А	≤0,2 мА (400 В) ≤0,2 мА (300 В)
2Т803А	n-p-n	-60...+125	60* Вт	≥20	60* (0,1к)	4	10 А	≤5* мА (70 В)
2Т808А	n-p-n	-60...+125	50* Вт (50°С)	≥8	120* (250 имп.)	4	10 А	≤3* мА (120 В)
2Т808А-2	n-p-n	-60...+125	50* Вт	≥8	120*	4	10 (15*) А	≤3* мА (120 В)
2Т809А	n-p-n	-60...+125	40* Вт (50°С)	≥5,1	400* (0,01к)	4	3 А; 5* А	≤3* мА (400 В)
2Т812А **2Т812Б**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	50* Вт (50°С) 50* Вт (50°С)	≥3 ≥3	400* (0,01к) 300* (0,01к)	6 6	10 А; 17* А 10 А; 17* А	≤5* мА (700 В) ≤5* мА (500 В)
2Т818А **2Т818Б** **2Т818В**	p-n-p p-n-p p-n-p	-60...+125 -60...+125 -60...+125	40* Вт 40* Вт 40* Вт	≥3 ≥3 ≥3	100* (0,1к) 80* (0,1к) 60* (0,1к)	5 5 5	15 А; 20* А 15 А; 20* А 15 А; 20* А	≤1* мА (100 В) ≤1* мА (80 В) ≤1* мА (60 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_{k}, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_{ш}$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
≥500* (5 А; 5 В) ≥750* (5 А; 5 В) ≥750* (5 А; 5 В)	≤150 (5 В) ≤150 (5 В) ≤150 (5 В)	≤0,4 ≤0,4 ≤0,4	— — —	≤7000** ≤7000** ≤7000**	**2Т716-1**
≥20 (4 В; 2 А) ≥20 (4 В; 2 А)	— —	≤0,2 ≤0,2	— —	≤2500* ≤2500*	**2Т718**
10...50* (10 В; 5 А)	≤500 (10 В)	0,5	—	≤2500*	**2Т803**
10...50* (3 В; 6 А)	≤500 (10 В)	—	—	≤2000*	**2Т808**
10...50* (3 В; 6 А)	≤500 (10 В)	≤0,33	—	≤2000*	**2Т808-2**
15...100* (5 В; 2 А)	≤270 (5 В)	≤0,75	—	≤3* мкс	**2Т809**
5...30* (3 В; 8 А) 5...30* (3 В; 8 А)	≤100 (100 В) ≤100 (100 В)	≤0,3 ≤0,3	— —	$t_{сп}$≤1,3 мкс $t_{сп}$≤1,3 мкс	**2Т812**
≥20* (5 В; 5 А) ≥20* (5 В; 5 А) ≥20* (5 В; 5 А)	≤100 (5 В) ≤100 (5 В) ≤100 (5 В)	≤0,2 ≤0,2 ≤0,2	— — —	≤2500** ≤2500** ≤2500**	**2Т818**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т818А-2	p-n-p	-60...+100	40* Вт	≥3	100* (0,1к)	5	15 А; 20* А	≤1* мА (100 В)
2Т818Б-2	p-n-p	-60...+100	40* Вт	≥3	80* (0,1к)	5	15 А; 20* А	≤1* мА (80 В)
2Т818В-2	p-n-p	-60...+100	40* Вт	≥3	60* (0,1к)	5	15 А; 20* А	≤1* мА (60 В)
2Т819А	n-p-n	-60...+125	100* Вт	≥3	100	5	15 (20*) А	≤1* мА (100 В)
2Т819Б	n-p-n	-60...+125	100* Вт	≥3	80	5	15 (20*) А	≤1* мА (80 В)
2Т819В	n-p-n	-60...+125	100* Вт	≥3	60	5	15 (20*) А	≤1* мА (60 В)
2Т819А-2	n-p-n	-40...+100	40* Вт	≥3	100	5	15 (20*) А	≤1* мА (100 В)
2Т819Б-2	n-p-n	-40...+100	40* Вт	≥3	80	5	15 (20*) А	≤1* мА (80 В)
2Т819В-2	n-p-n	-40...+100	40* Вт	≥3	60	5	15 (20*) А	≤1* мА (60 В)
2Т824А	n-p-n	-60...+125	50* Вт	≥3,5	400	7	10 А; 17* А	≤5 мА (700 В)
2Т824Б	n-p-n	-60...+125	50* Вт	≥3,5	350	7	10 А; 17* А	≤5 мА (500 В)
2Т824АМ	n-p-n	-60...+125	50* Вт	≥3,5	400	7	10 А; 17* А	≤5 мА (700 В)
2Т824БМ	n-p-n	-60...+125	50* Вт	≥3,5	350	7	10 А; 17* А	≤5 мА (500 В)
2Т825А	p-n-p	-60...+125	3 Вт; 125* Вт	≥4	100* (1к)	5	20 А (40* А)	≤1 мА (100 В)
2Т825Б	p-n-p	-60...+125	3 Вт; 125* Вт	≥4	80* (1к)	5	20 А (40* А)	≤1 мА (80 В)
2Т825В	p-n-p	-60...+125	3 Вт; 125* Вт	≥4	60* (1к)	5	20 А (40* А)	≤1 мА (60 В)
2Т825А-2	p-n-p	-60...+100	1 Вт; 30* Вт	≥4	100* (1к)	5	15 А (30* А)	≤1 мА (100 В)
2Т825Б-2	p-n-p	-60...+100	1 Вт; 30* Вт	≥4	80* (1к)	5	15 А (30* А)	≤1 мА (80 В)
2Т825В-2	p-n-p	-60...+100	1 Вт; 30* Вт	≥4	60* (1к)	5	15 А (30* А)	≤1 мА (60 В)
2Т825А-5	p-n-p	-60...+100	3 Вт; 125* Вт	≥4	100* (1к)	5	20 А (40* А)	≤1 мА (100 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
≥20* (5 В; 5 А) ≥20* (5 В; 5 А) ≥20* (5 В; 5 А)	≤100 (5 В) ≤100 (5 В) ≤100 (5 В)	≤0,2 ≤0,2 ≤0,2	— — —	≤2500** ≤2500** ≤2500**	**2Т818-2**
≥20* (5 В; 5 А) ≥20* (5 В; 5 А) ≥20* (5 В; 5 А)	≤1000 (5 В) ≤1000 (5 В) ≤1000 (5 В)	≤0,2 ≤0,2 ≤0,2	— — —	≤2500** ≤2500** ≤2500**	**2Т819**
≥20* (5 В; 5 А) ≥20* (5 В; 5 А) ≥20* (5 В; 5 А)	≤1000 (5 В) ≤1000 (5 В) ≤1000 (5 В)	≤0,2 ≤0,2 ≤0,2	— — —	≤2500** ≤2500** ≤2500**	**2Т819-2**
≥5* (8 А; 2,5 В) ≥5* (8 А; 2,5 В)	≤250 (100 В) ≤250 (100 В)	≤0,3 ≤0,3	— —	1,8* мкс 1,8* мкс	**2Т824**
≥5* (8 А; 2,5 В) ≥5* (8 А; 2,5 В)	≤250 (100 В) ≤250 (100 В)	≤0,3 ≤0,3	— —	1,8* мкс 1,8* мкс	**2Т824М**
500...18000* (10 А; 10 В) 750...18000* (10 А; 10 В) 750...18000* (10 А; 10 В)	≤600 (10 В) ≤600 (10 В) ≤600 (10 В)	≤0,2 ≤0,2 ≤0,2	— — —	≤4,5** мкс ≤4,5** мкс ≤4,5** мкс	**2Т825**
500...18000* (10 А; 10 В) 750...18000* (10 А; 10 В) 750...18000* (10 А; 10 В)	≤600 (10 В) ≤600 (10 В) ≤600 (10 В)	≤0,2 ≤0,2 ≤0,2	— — —	≤4,5** мкс ≤4,5** мкс ≤4,5** мкс	**2Т825-2**
500...18000* (10 А; 10 В)	≤600 (10 В)	≤0,2	—	≤4,5** мкс	**2Т825-5**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т826А	n-p-n	-60...+125	15* Вт (50°С)	≥6	700* (0,01к)	5	1 А	≤2* мА (700 В)
2Т826Б	n-p-n	-60...+125	15* Вт (50°С)	≥6	700* (0,01к)	5	1 А	≤2* мА (700 В)
2Т826В	n-p-n	-60...+125	15* Вт (50°С)	≥6	700* (0,01к)	5	1 А	≤2* мА (700 В)
2Т826А-5	n-p-n	-60...+125	15* Вт (50°С)	≥6	700* (0,01к)	5	1 А	≤2 мА (700 В)
2Т827А	n-p-n	-60...+125	125* Вт	≥4	100* (1к)	5	20 (40*) А	3* мА (100 В)
2Т827Б	n-p-n	-60...+125	125* Вт	≥4	80* (1к)	5	20 (40*) А	3* мА* (80 В)
2Т827В	n-p-n	-60...+125	125* Вт	≥4	60* (1к)	5	20 (40*) А	3* мА* (60 В)
2Т827А-5	n-p-n	-60...+125	125* Вт	≥4	100	5	20 (40*) А	≤3 мА (100 В)
2Т827А-2	n-p-n	-60...+125	125* Вт	≥4	100	5	20 (40*) А	≤3 мА (100 В)
2Т827Б-2	n-p-n	-60...+125	125* Вт	≥4	80	5	20 (40*) А	≤3 мА (80 В)
2Т827В-2	n-p-n	-60...+125	125* Вт	≥4	60	5	20 (40*) А	≤3 мА (60 В)
2Т828А	n-p-n	-60...+125	50* Вт (50°С)	≥4	800* (0,01к)	5	5 (7,5*) А	≤5* мА (800 В)
2Т828Б	n-p-n	-60...+125	50* Вт (50°С)	≥4	600* (0,01к)	5	5 (7,5*) А	≤5* мА (600 В)
2Т830А	p-n-p	-60...+125	1 Вт	≥4	35	5	2 А; 4* А	≤100 (35 В)
2Т830Б	p-n-p	-60...+125	1 Вт	≥4	60	5	2 А; 4* А	≤100 (60 В)
2Т830В	p-n-p	-60...+125	1 Вт	≥4	80	5	2 А; 4* А	≤100 (80 В)
2Т830Г	p-n-p	-60...+125	1 Вт	≥4	100	5	2 А; 4* А	≤100 (80 В)
2Т830В-1	p-n-p	-60...+100	1 (5*) Вт	≥4	80	5	2 А; 4* А	≤100 (80 В)
2Т830Г-1	p-n-p	-60...+100	1 (5*) Вт	≥4	100	5	2 А; 4* А	≤100 (80 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
10...120* (10 В; 0,1 А) 10...120* (10 В; 0,1 А) 10...120* (10 В; 0,1 А)	≤25 (100 В) ≤25 (100 В) ≤25 (100 В)	≤5 ≤5 ≤5	— — —	$t_{сп}$≤1500 $t_{сп}$≤700 —	**2Т826**
10...120* (10 В; 0,1 А)	≤25 (100 В)	≤5	—	$t_{сп}$≤1500	**2Т826-5**
750...18000* (3 В; 10 А) 750...18000* (3 В; 10 В) 750...18000* (3 В; 10 А)	≤400 (10 В) ≤400 (10 В) ≤400 (10 В)	≤0,2 ≤0,2 ≤0,2	— — —	— ≤4,5* мкс ≤4,5* мкс	**2Т827**
750...18000* (3 В; 10 А)	≤400 (10 В)	≤0,2	—	≤4,5* мкс	**2Т827-5**
750...18000* (3 В; 10 А) 750...18000* (3 В; 10 В) 750...18000* (3 В; 10 А)	≤400 (10 В) ≤400 (10 В) ≤400 (10 В)	≤0,2 ≤0,2 ≤0,2	— — —	6** мкс 6** мкс 6** мкс	**2Т827-2**
≥2,25* (5 В; 4,5 А) ≥2,25* (5 В; 4,5 А)	— —	≤0,66 ≤0,66	— —	≤10* мкс; $t_{сп}$≤1,2 мкс ≤10* мкс; $t_{сп}$≤1,2 мкс	**2Т828**
25...55* (1 А; 1 В) 25...55* (1 А; 1 В) 25...55* (1 А; 1 В) 20...50* (1 А; 1 В)	≤150 (5 В) ≤150 (5 В) ≤150 (5 В) ≤150 (5 В)	≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6	— — — —	≤1* мкс ≤1* мкс ≤1* мкс ≤1* мкс	**2Т830**
25...200* (1 А; 1 В) 25...200* (1 А; 1 В)	≤150 (5 В) ≤150 (5 В)	≤0,6 ≤0,6	— —	≤1* мкс ≤1* мкс	**2Т830-1**

21 зак. 9

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °С	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т831А	n-p-n	-60...+125	1 (5*) Вт	≥4	30* (1к)	5	2 А; 4* А	≤100 (35 В)
2Т831Б	n-p-n	-60...+125	1 (5*) Вт	≥4	50* (1к)	5	2 А; 4* А	≤100 (60 В)
2Т831В	n-p-n	-60...+125	1 (5*) Вт	≥4	70* (1к)	5	2 А; 4* А	≤100 (80 В)
2Т831Г	n-p-n	-60...+125	1 (5*) Вт	≥4	90* (1к)	5	2 А; 4* А	≤100 (80 В)
2Т831В-1	n-p-n	-60...+100	1 Вт	≥4	70* (1к)	5	2 А; 4* А	≤100 (80 В)
2Т831Г-1	n-p-n	-60...+100	1 Вт	≥4	90* (1к)	5	2 А; 4* А	≤100 (80 В)
2Т832А	n-p-n	-60...+125	10* Вт	6	1000*(10Ом)	7	100	—
2Т832Б	n-p-n	-60...+125	10* Вт	6	800*(10Ом)	7	100	—
2Т834А	n-p-n	-60...+125	100* Вт	≥4	500* (0,1к)	8	15 (20*) А	≤3* мА (500 В)
2Т834Б	n-p-n	-60...+125	100* Вт	≥4	450* (0,1к)	8	15 (20*) А	≤3* мА (450 В)
2Т834В	n-p-n	-60...+125	100* Вт	≥4	400* (0,1к)	8	15 (20*) А	≤3* мА (400 В)
2Т836А	p-n-p	-60...+125	0,7 (5*) Вт	≥4*	90	5	3 А (4* А)	≤0,1 мА (90 В)
2Т836Б	p-n-p	-60...+125	0,7 (5*) Вт	≥4*	85	5	3 А (4* А)	≤0,1 мА (85 В)
2Т836В	p-n-p	-60...+125	0,7 (5*) Вт	≥4*	85	5	3 А (4* А)	≤0,1 мА (85 В)
2Т836Г	p-n-p	-60...+125	0,7 (5*) Вт	≥4*	60	5	3 А (4* А)	≤0,1 мА (60 В)
2Т836А-5	p-n-p	-60...+125	0,7 Вт	≥4*	90	5	3 А (4* А)	≤0,1 мА (90 В)
2Т837А	p-n-p	-60...+100	30* Вт	≥3	80	15	8 А	≤5 мА (80 В)
2Т837Б	p-n-p	-60...+100	30* Вт	≥3	60	15	8 А	≤5 мА (60 В)
2Т837В	p-n-p	-60...+100	30* Вт	≥3	45	15	8 А	≤5 мА (45 В)
2Т837Г	p-n-p	-60...+100	30* Вт	≥3	80	5	8 А	≤5 мА (80 В)
2Т837О	p-n-p	-60...+100	30* Вт	≥3	60	5	8 А	≤5 мА (60 В)
2Т837П	p-n-p	-60...+100	30* Вт	≥3	45	5	8 А	≤5 мА (45 В)
2Т839А	n-p-n	-60...+100	50* Вт	5	1500	5	10 (10*) А	≤1 мА (1500 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
25...200* (1 А; 1 В) 25...200* (1 А; 1 В) 25...200* (1 А; 1 В) 25...150* (1 А; 1 В)	≤150 (5 В) ≤150 (5 В) ≤150 (5 В) ≤150 (5 В)	≤0,6 ≤0,6 ≤0,6 ≤0,6	— — — —	≤1* мкс ≤1* мкс ≤1* мкс ≤1* мкс	**2Т831**
25...200* (1 А; 1 В) 25...200* (1 А; 1 В)	≤150 (5 В) ≤150 (5 В)	≤0,6 ≤0,6	— —	≤1* мкс ≤1* мкс	**2Т831-1**
10...50* (30 мА; 10 В) 10...50* (30 мА; 10 В)	20 (5 В) 20 (5 В)	— —	— —	— —	**2Т832**
150...3000* (5 В; 5 А) 150...3000* (5 В; 5 А) 150...3000* (5 В; 5 А)	— — —	≤0,13 ≤0,13 ≤0,13	— — —	$t_{сп}$≤1,2 мкс $t_{сп}$≤1,2 мкс $t_{сп}$≤1,2 мкс	**2Т834**
20...100* (2 А; 5 В) 20...100* (2 А; 5 В) 20...100* (2 А; 5 В) 20...100* (2 А; 5 В)	≤370 (5 В) ≤370 (5 В) ≤370 (5 В) ≤370 (5 В)	≤0,3 ≤0,18 ≤0,18 ≤0,22	— — — —	≤1,6** мкс ≤1,6** мкс ≤1,6** мкс ≤1,6** мкс	**2Т836**
20...100* (2 А; 5 В)	≤370 (5 В)	≤0,3	—	≤1,6** мкс	**2Т836-5**
15...120* (5 В; 2 А) 30...150* (5 В; 2 А) 40...180* (5 В; 2 А) 15...120* (5 В; 2 А) 30...150* (5 В; 2 А) 40...180* (5 В; 2 А)	— — — — — —	≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3	— — — — — —	≤1** мкс ≤1** мкс ≤1** мкс ≤1** мкс ≤1** мкс ≤1** мкс	**2Т837**
≥5* мА (1500 В)	240 (10 В)	≤0,375	—	≤10* мкс; $t_{сп}$≤1,5 мкс	**2Т839**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т841А	n-p-n	-60...+125	3 (50*) Вт	≥10	600	5	10 (15*) А	≤3 мА (600 В)
2Т841Б	n-p-n	-60...+125	3 (50*) Вт	≥10	400	5	10 (15*) А	≤3 мА (400 В)
2Т841В	n-p-n	-60...+125	3 (50*) Вт	≥10	800	5	10 (15*) А	≤3 мА (800 В)
2Т841А-1	n-p-n	-60...+100	30* Вт	≥10	600	5	10 (15*) А	≤3 мА (600 В)
2Т841Б-1	n-p-n	-60...+100	30* Вт	≥10	400	5	10 (15*) А	≤3 мА (400 В)
2Т842А	p-n-p	-60...+125	3 (50*) Вт	≥20	300	5	5 (8*) А	≤1 мА (300 В)
2Т842Б	p-n-p	-60...+125	3 (50*) Вт	≥20	200	5	5 (8*) А	≤1 мА (200 В)
2Т842А-1	p-n-p	-60...+100	30* Вт	≥10	300	5	5 (8*) А	≤1 мА (300 В)
2Т842Б-1	p-n-p	-60...+100	30* Вт	≥10	200	5	5 (8*) А	≤1 мА (200 В)
2Т844А	n-p-n	-60...+125	50* Вт (50°С)	≥7,2	250* (0,01к)	4	10 (20*) А	≤3* мА (250 В)
2Т845А	n-p-n	-60...+125	40* Вт (50°С)	≥4,5	400* (0,01к)	4	5 (7,5*) А	≤3* мА (400 В)
2Т847А	n-p-n	-60...+100	125* Вт	≥15	650* (10 Ом)	8	15 А	≤5 мА (650 В)
2Т847Б	n-p-n	-60...+100	125* Вт	≥15	400**	8	15 А	≤5 мА
2Т848А	n-p-n	-60...+125	35* Вт	≥3	400*	7	15 А	≤250* (400 В)
2Т856А	n-p-n	-60...+125	75* Вт	≥10	1000	5	10 (12*) А	≤3 мА (1000 В)
2Т856Б	n-p-n	-60...+125	75* Вт	≥10	800	5	10 (12*) А	≤3 мА (800 В)
2Т856В	n-p-n	-60...+125	75* Вт	≥10	600	5	10 (12*) А	≤3 мА (600 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
≥12* (5 В; 5 А) ≥12* (5 В; 5 А) ≥12* (5 В; 5 А)	≤300 (10 В) ≤300 (10 В) ≤300 (10 В)	≤0,3 ≤0,3 ≤0,3	— —	≤1000* ≤1000*	2Т841
≥10* (5 В; 5 А) ≥10* (5 В; 5 А)	≤185 (10 В) ≤185 (10 В)	≤0,3 ≤0,3	— —	≤1* мкс ≤1* мкс	2Т841-1
≥15* (4 В; 5 А) ≥15* (4 В; 5 А)	≤400 (10 В) ≤400 (10 В)	≤0,36 ≤0,36	— —	800* 800*	2Т842
≥10* (4 В; 5 А) ≥10* (4 В; 5 А)	≤400 (10 В) ≤400 (10 В)	≤0,36 ≤0,36	— —	2,2* мкс 2,2* мкс	2Т842-1
10...50* (3 В; 6 А)	≤300 (10 В)	≤0,4	—	≤2000*	2Т844, 2Т845
15...100* (5 В; 2 А)	≤45 (200 В)	≤0,75	—	≤4000*	
8...25* (3 В; 15 А) 8...25* (3 В; 15 А)	≤200 (400 В) ≤200 (400 В)	≤0,1 ≤0,1	— —	≤3000* ≤3000*	2Т847, 2Т848
≥20* (5 В; 15 А)	—	≤0,2	—	—	
10...30* (5 А; 5 В) 10...60* (5 А; 5 В) 10...60* (5 А; 5 В)	≤100 (90 В) ≤100 (90 В) ≤100 (90 В)	≤0,3 ≤0,3 ≤0,3	— — —	≤2* мкс ≤2* мкс ≤2* мкс	2Т856

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °С	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{K\ max}$, $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т856Г	n-p-n	-60...+100	75* Вт	≥10	900	5	10 (12*) А	≤3 мА (900 В)
2Т860А	p-n-p	-60...+100	1 (10*) Вт	≥10	90	5	2 А (4* А)	≤0,1 мА (90 В)
2Т860Б	p-n-p	-60...+100	1 (10*) Вт	≥10	70	5	2 А (4* А)	≤0,1 мА (70 В)
2Т860В	p-n-p	-60...+100	1 (10*) Вт	≥10	40	5	2 А (4* А)	≤0,1 мА (40 В)
2Т861А	n-p-n	-60...+125	1 (10*) Вт	≥10	90	5	2 А (4* А)	≤0,1 мА (90 В)
2Т861Б	n-p-n	-60...+125	1 (10*) Вт	≥10	70	5	2 А (4* А)	≤0,1 мА (70 В)
2Т861В	n-p-n	-60...+125	1 (10*) Вт	≥10	40	5	2 А (4* А)	≤0,1 мА (40 В)
2Т862А	n-p-n	-60...+125	70* Вт	≥20	450	5	15 А (25* А)	≤2,5 мА (300 В)
2Т862Б	n-p-n	-60...+125	50* Вт	≥20	450	5	15 А; 25* А	≤2,5 мА (300 В)
2Т862В	n-p-n	-60...+125	50* Вт	≥20	600	5	10 А; 15* А	≤3 мА (600 В)
2Т862Г	n-p-n	-60...+125	50* Вт	≥20	600	5	10 А; 15* А	≤3 мА (600 В)
2Т866А	n-p-n	-60...+125	30 Вт (50°С)	25	200	4	15 А; 20* А	≤25 мА (100 В)
2Т867А	n-p-n	-60...+125	100* Вт	25	200	7	25 А (40* А)	≤3 мА (250 В)
2Т874А	n-p-n	-60...+125	75* Вт	20	150	5	30 А; 50* А	≤3 мА (150 В)
2Т874Б	n-p-n	-60...+125	75* Вт	20	150	5	30 А; 50* А	≤3 мА (150 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^{*}_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс; $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
10...30* (5 А; 5 В)	≤100 (90 В)	≤0,3	—	≤2* мкс	**2Т856**
40...160* (1 А; 2 В) 50...200* (1 А; 2 В) 80...300* (1 А; 2 В)	≤150 (5 В) ≤150 (5 В) ≤150 (5 В)	≤0,35 ≤0,35 ≤0,35	— — —	≤1** мкс ≤1** мкс ≤1** мкс	**2Т860**
40...160* (1 А; 2 В) 50...200* (1 А; 2 В) 80...300* (1 А; 2 В)	≤150 (5 В) ≤150 (5 В) ≤150 (5 В)	≤0,35 ≤0,35 ≤0,35	— — —	≤1** мкс ≤1** мкс ≤1** мкс	**2Т861**
10...100* (15 А; 5 В)	≤300 (30 В)	≤0,13	—	≤1* мкс	**2Т862**
10...100* (15 А; 5 В) 12...50* (5 А; 5 В) 12...50* (5 А; 5 В)	≤300 (30 В) ≤250 (10 В) ≤250 (10 В)	≤0,13 ≤0,19 ≤0,13	— — —	≤1* мкс ≤2* мкс ≤2* мкс	**2Т862**
15...100* (10 А; 10 В)	≤400 (10 В)	≤0,15	—	≤450**	**2Т866**
12...100* (20 А; 5 В)	≤400 (10 В)	≤0,08	—	≤1,3* мкс	**2Т867**
15...50* (5 В; 30 А) 10...40* (5 В; 30 А)	200 (100 В) 200 (100 В)	≤0,04 ≤0,04	— —	≤0,5* мкс ≤0,5* мкс	**2Т874**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т875А	n-p-n	-60...+125	50* Вт	≥20	90	5	10 А; 15* А	≤3 мА (90 В)
2Т875Б	n-p-n	-60...+125	50* Вт	≥20	70	5	10 А; 15* А	≤3 мА (70 В)
2Т875В	n-p-n	-60...+125	50* Вт	≥20	50	5	10 А; 15* А	≤3 мА (50 В)
2Т875Г	n-p-n	-60...+125	50* Вт	≥20	90	5	10 А; 15* А	≤3 мА (90 В)
2Т876А	p-n-p	-60...+125	50* Вт	≥20	90	5	10 А (15* А)	≤3 мА (90 В)
2Т876Б	p-n-p	-60...+125	50* Вт	≥20	70	5	10 А (15* А)	≤3 мА (70 В)
2Т876В	p-n-p	-60...+125	50* Вт	≥20	50	5	10 А (15* А)	≤3 мА (50 В)
2Т876Г	p-n-p	-60...+125	50* Вт	≥20	90	5	10 А (15* А)	≤3 мА (90 В)
2Т877А	p-n-p	-60...+125	50* Вт	≥100	80	5	20 А (10* А)	≤1* мА (80 В)
2Т877Б	p-n-p	-60...+125	50* Вт	≥100	60	5	20 А (10* А)	≤1* мА (60 В)
2Т877В	p-n-p	-60...+125	50* Вт	≥100	40	5	20 А (10* А)	≤1* мА (40 В)
2Т878А	n-p-n	-60...+125	10* Вт	≥10	800	6	25 А (30* А)	≤3 мА (800 В)
2Т878Б	n-p-n	-60...+125	10* Вт	≥10	600	6	25 А (30* А)	≤3 мА (600 В)
2Т878В	n-p-n	-60...+125	10* Вт	≥10	900	6	25 А (30* А)	≤3 мА (900 В)
2Т879А	n-p-n	-60...+125	250* Вт	≥10	200	6	50 А (75* А)	≤3 мА (200 В)
2Т879Б	n-p-n	-60...+125	250* Вт	≥10	200	6	50 А (75* А)	≤3 мА (200 В)
2Т880А	p-n-p	-60...+125	5* Вт	≥30	100	6	2 А (4* А)	≤0,2 мА (100 В)
2Т880Б	p-n-p	-60...+125	5* Вт	≥30	80	6	2 А (4* А)	≤0,2 мА (80 В)
2Т880В	p-n-p	-60...+125	5* Вт	≥30	50	6	2 А (4* А)	≤0,2 мА (50 В)
2Т880Г	p-n-p	-60...+125	5* Вт	≥30	100	6	2 А (4* А)	≤0,2 мА (100 В)
2Т880А-5	n-p-n	-60...+125	0,8 Вт; 5* Вт	≥30	100	4,5	2 А (4* А)	≤0,2 мА (100 В)
2Т880Б-5	n-p-n	-60...+125	0,8 Вт; 5* Вт	≥30	80	4,5	2 А (4* А)	≤0,2 мА (80 В)
2Т881А	n-p-n	-60...+125	5* Вт	≥30	100	6	2 А (4* А)	≤0,2 мА (100 В)
2Т881Б	n-p-n	-60...+125	5* Вт	≥30	80	6	2 А (4* А)	≤0,2 мА (80 В)
2Т881В	n-p-n	-60...+125	5* Вт	≥30	50	6	2 А (4* А)	≤0,2 мА (50 В)
2Т881Г	n-p-n	-60...+125	5* Вт	≥30	100	6	2 А (4* А)	≤0,2 мА (100 В)
2Т881А-5	n-p-n	-60...+125	0,8 Вт	≥30	100	4,5	2 А (4* А)	≤200 (100 В)
2Т881Б-5	n-p-n	-60...+125	0,8 Вт	≥30	80	4,5	2 А (4* А)	≤200 (80 В)
2Т882А	n-p-n	-60...+100	10* Вт	≥20	400	6	1 А (2* А)	≤0,1 мА (400 В)
2Т882Б	n-p-n	-60...+100	10* Вт	≥20	300	6	1 А (2* А)	≤0,1 мА (300 В)
2Т882В	n-p-n	-60...+100	10* Вт	≥20	250	6	1 А (2* А)	≤0,1 мА (250 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_{k}, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_{ш}$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
80...250* (5 В; 5 А) 80...250* (5 В; 5 А) 80...250* (5 В; 5 А) 40...160* (5 В; 5 А)	910 (10 В) 910 (10 В) 910 (10 В) 910 (10 В)	≤0,1 ≤0,1 ≤0,1 ≤0,1	— — — —	400** 400** 400** 400**	**2Т875, 2Т876**
80...250* (5 В; 5 А) 80...250* (5 В; 5 А) 80...250* (5 В; 5 А) ≥15* (5 В; 5 А)	910 (10 В) 910 (10 В) 910 (10 В) 910 (10 В)	≤0,1 ≤0,1 ≤0,1 ≤0,1	— — — —	≤1** мкс ≤1** мкс ≤1** мкс ≤1** мкс	
750...10000*(10 В; 10 А) 2500...18000*(10 В;10 А) 2500...18000*(10 В;10 А)	830 (20 В) 830 (20 В) 830 (20 В)	≤0,2 ≤0,2 ≤0,2	— — —	0,75* мкс 0,75* мкс 0,75* мкс	**2Т877, 2Т878**
12...50* (5 В; 10 А) 12...50* (5 В; 10 А) 12...50* (5 В; 10 А)	≤500 (10 В) ≤500 (10 В) ≤500 (10 В)	≤0,1 ≤0,1 ≤0,1	— — —	≤3* мкс ≤3* мкс ≤3* мкс	
≥20* (20 В; 4 А) ≥15* (20 В; 4 А)	≤800 (10 В) ≤800 (10 В)	≤0,06 ≤0,1	— —	≤1,2* мкс ≤1,2* мкс	**2Т879**
80...250* (1 В; 1 А) 80...250* (1 В; 1 А) 80...250* (1 В; 1 А) 40...160* (1 В; 1 А)	≤200 (5 В) ≤200 (5 В) ≤200 (5 В) ≤200 (5 В)	≤0,35 ≤0,35 ≤0,35 ≤0,35	— — — —	0,5* мкс 0,5* мкс 0,5* мкс 0,5* мкс	**2Т880**
80...250* (1 В; 1 А) 80...250* (1 В; 1 А)	≤200 (5 В) ≤200 (5 В)	≤0,35 ≤0,35	— —	0,5* мкс 0,5* мкс	**2Т880-5**
80...250* (1 В; 1 А) 80...250* (1 В; 1 А) 80...250* (1 В; 1 А) 40...160* (1 В; 1 А)	≤200 (5 В) ≤200 (5 В) ≤200 (5 В) ≤200 (5 В)	≤0,35 ≤0,35 ≤0,35 ≤0,35	— — — —	0,5* мкс 0,5* мкс 0,5* мкс 0,5* мкс	**2Т881**
80...250* (1 В; 1 А) 40...160* (1 В; 1 А)	≤200 (5 В) ≤200 (5 В)	≤0,35 ≤0,35	— —	500* 500*	**2Т881-5**
≥15* (5 В; 0,5 А) ≥15* (5 В; 0,5 А) ≥15* (5 В; 0,5 А)	≤50 (5 В) ≤50 (5 В) ≤50 (5 В)	≤2 ≤2 ≤2	— — —	≤3* мкс ≤3* мкс ≤3* мкс	**2Т882**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т883А **2Т883Б**	p-n-p p-n-p	-60...+100 -60...+100	10* Вт 10* Вт	≥20 ≥20	300 250	5 5	1 А (2* А) 1 А (2* А)	≤0,1 мА (300 В) ≤0,1 мА (250 В)
2Т884А **2Т884Б**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	15* Вт 15* Вт	≥10 ≥10	800 600	5 5	2 А (5* А) 2 А (5* А)	≤0,2 мА (800 В) ≤0,2 мА (800 В)
2Т885А **2Т885Б**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	150* Вт 150* Вт	≥15 ≥15	400* 500*	5 5	40 А (60* А) 40 А (60* А)	≤1 мА (500 В) ≤1 мА (500 В)
2Т886А **2Т886Б**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	175* Вт 175* Вт	≥10,5 ≥10,5	1400 1000	7 7	10 (15*) А 10 (15*) А	≤0,1* мА (1000 В) ≤0,1* мА (1000 В)
2Т887А **2Т887Б**	p-n-p p-n-p	-60...+125 -60...+125	75* Вт (750**) 75* Вт (750**)	≥15 ≥15	700 600	5 5	2 А; (5*) А 2 А; (5*) А	≤0,25 мА (700 В) ≤0,25 мА (700 В)
2Т888А **2Т888Б**	p-n-p p-n-p	-60...+125 -60...+125	7* Вт 7* Вт	≥15 ≥15	900 600	7 7	100 (200*) 100 (200*)	≤10 мА (900 В) ≤10 мА (600 В)
2Т891А	n-p-n	-60...+125	150* Вт (60**)	≥12	250* (0,01к)	7	40 А; 60* А	≤2 мА (250 В)
2Т903А **2Т903Б**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	30* Вт (60**) 30* Вт (60**)	≥120 ≥120	60 (80 имп.) 60 (80 имп.)	4 4	3 А; (5*) А 3 А; (5*) А	≤2* мА (70 В) ≤2* мА (70 В)
2Т904А	n-p-n	-60...+125	7* Вт (40°C)	≥350	65* (0,1к)	4	0,8 (1,5*) А	≤1* мА (65 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	C_k, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r'_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^*_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс; $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
≥25* (10 В; 0,5 А) ≥25* (10 В; 0,5 А)	≤70 (5 В) ≤70 (5 В)	≤3,6 ≤3,6	— —	≤5,2* мкс ≤5,2* мкс	2Т883, 2Т884
≥25* (5 В; 0,3 А) ≥25* (5 В; 0,3 А)	≤60 (5 В) ≤60 (5 В)	≤0,27 ≤0,27	— —	≤3* мкс ≤3* мкс	
≥12* (5 В; 20 А) ≥12* (5 В; 20 А)	≤60 (5 В) ≤60 (5 В)	≤0,08 ≤0,08	— —	≤2* мкс ≤2* мкс	2Т885
6...25* (10 В; 2 А) 6...25* (10 В; 2 А)	≤135 (10 В) ≤135 (10 В)	≤0,25 ≤0,25	— —	≤3500* ≤3500*	2Т886
20...120* (9 В; 1 А) 20...120* (9 В; 1 А)	≤400 (10 В) ≤400 (10 В)	≤1,4 ≤1,4	— —	≤5000* ≤5000*	2Т887
30...120* (3 В; 30 А) 30...120* (3 В; 30 А)	≤400 (10 В) ≤400 (10 В)	≤50 ≤50	— —	≤3000* ≤3000*	2Т888
20...50* (4 В; 5 А)	≤400 (100 В)	≤0,03	—	≤1000*	2Т891
15...70* (10 В; 2 А) 40...180* (10 В; 2 А)	≤180 (30 В) ≤180 (30 В)	≤1,25; ≥3** ≤1,25; ≥3**	≥10** (50 МГц) ≥10** (50 МГц)	≤500* ≤500*	2Т903
≥10* (5 В; 0,25 А)	≤2,6 (28 В)	≤5; ≥2,5**	≥3** (400 МГц)	—	2Т904

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т907А	n-p-n	-60...+125	16* Вт	≥350	65* (0,1к)	4	1 (3*) А	≤2* мА (65 В)
2Т908А	n-p-n	-60...+125	50* Вт (50°С)	≥30	100* (0,01к)	5	10 А	≤25* мА (100 В)
2Т909А	n-p-n	-60...+125	27** Вт	≥350	60* (0,01к)	3,5	2 (4*) А	≤25* мА (60 В)
2Т909Б	n-p-n	-60...+125	54** Вт	≥500	60* (0,01к)	3,5	4 (8*) А	≤30* мА (60 В)
2Т9101АС	n-p-n	-60...+1255	130* Вт	≥350	50	4	7,5 А	≤30 мА (50 В)
2Т9102А-2	n-p-n	-60...+125	10** Вт	≥1,35 ГГц	45	3,5	0,7 А	≤10 мА (45 В)
2Т9102Б-2	n-p-n	-60...+125	5** Вт	≥1,35 ГГц	45	3,5	0,35 А	≤5 мА (45 В)
2Т9103А-2	n-p-n	-60...+125	16,4** Вт	—	25	2	1,1 А	≤7 (25 В)
2Т9103Б-2	n-p-n	-60...+125	16,4** Вт	—	25	2	1,1 А	≤7 (25 В)
2Т9104А	n-p-n	-60...+125	10** Вт	≥600	50	4	1,5 А	≤10 мА (50 В)
2Т9104Б	n-p-n	-60...+125	23** Вт	≥600	50	4	5 А	≤20 мА (50 В)
2Т9105АС	n-p-n	-60...+125	160* Вт	≥660	50* (10 Ом)	4	16 А	≤120* мА (50 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
≥10* (5 В; 0,4 А)	≤20 (30 В)	≤4; ≥2**	≥8** (400 МГц)	—	2Т907
8...60* (2 В; 10 А)	≤700 (10 В)	≤0,15	—	≤2600*	2Т908
— —	≤30 (28 В) ≤60 (28 В)	0,36; ≥1,7** 0,18; ≥1,75**	≥17** (500 МГц) ≥35** (500 МГц)	≤20 ≤20	2Т909
—	≤150 (28 В)	≥3,5**	≥100** (0,7 ГГц)	≤45	2Т9101
— —	≤10 (28 В) ≤6,5 (28 В)	— —	≥3,5** (2 ГГц) ≥1,6** (2 ГГц)	≤2,2 ≤2,2	2Т9102
— —	— —	≥1,7** ≥1,7**	≥7** (5 ГГц) ≥10** (5 ГГц)	— —	2Т9103
— —	≤20 (28 В) ≤40 (29 В)	≥8** ≥7**	≥5** (0,7 ГГц) ≥20** (0,7 ГГц)	≤20 ≤20	2Т9104
≤160* (5 В; 0,1 А)	≤240 (28 В)	≥3**	≥100** (0,5 ГГц)	≤12	2Т9105

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °С	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т9107А-2	n-p-n	-60...+125	37,5* Вт	720	50	3,5	2,5 А (5* А)	≤50 мА (50 В)
2Т9108А-2	n-p-n	-60...+100	200** Вт	—	50	3	8* А	≤25 мА (50 В)
2Т9109А	n-p-n	-60...+125	1,12** кВт	≥360	65	4	29* А	≤60 мА (65 В)
2Т9110А-2 **2Т9110Б-2**	n-p-n n-p-n	-60...+100 -60...+100	500** Вт 200** Вт	600 600	50 50	3 3	15* А 7* А	≤50 мА (50 В) ≤25 мА (50 В)
2Т9111А	n-p-n	-60...+125	200** Вт (50°С)	≥300	120*(10 Ом)	4	10 А	≤100 мА (120 В)
2Т9112А	n-p-n	-60...+125	5* Вт	≥30	65	4	20 А	≤40 мА (65 В)
2Т9113А	n-p-n	-60...+125	82** Вт	—	150	4	3,25* А	≤30 мА (160 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
—	≤50 (10 В)	≥4**	≥27** (1 ГГц)	—	2Т9107
—	—	—	≥50** (1,5 ГГц)	—	2Т9108
—	≤140 (50 В)	≥3,5**	≥500** (0,82 ГГц)	≤10	2Т9109
— —	— —	≥6** ≥6**	≥200** (1,4...1,6 ГГц) ≥100** (1,4...1,6 ГГц)	— —	2Т9110
≥10* (10 В; 5 А)	≤150 (50 В)	≥10**	≥150** (80 МГц)	—	2Т9111
≥10* (7 В; 20 А)	—	≤0,16	—	100*	2Т9112
≥10* (5 В; 5 А)	—	≤0,16	—	—	2Т9113

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{K\ max}$, $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т9114А	n-p-n	-60...+125	325** Вт	—	50	3	13 А*	≤30 мА (50 В)
2Т9114Б	n-p-n	-60...+125	85** Вт	—	50	3	3,25 А*	≤8 мА (50 В)
2Т911А	n-p-n	-60...+125	3* Вт	≥1000	55	3	0,4 А	≤3 мА (55 В)
2Т911Б	n-p-n	-60...+125	3* Вт	≥840	55	3	0,4 А	≤3 мА (55 В)
2Т912А	n-p-n	-60...+125	30* Вт (85°С)	≥90	70* (0,01к)	5	20 А	≤50* мА (70 В)
2Т912Б	n-p-n	-60...+125	30* Вт (85°С)	≥90	70* (0,01к)	5	20 А	≤50* мА (70 В)
2Т912А-5	n-p-n	-60...+125	30* Вт	≥90	70*	5	20 А	≤50* мА
2Т912Б-5	n-p-n	-60...+125	30* Вт	≥90	70*	5	20 А	≤50* мА
2Т913А	n-p-n	-60...+125	4,7* Вт (55°С)	≥900	55	3,5	0,5 (1*) А	≤10* мА (55 В)
2Т913Б	n-p-n	-60...+125	8* Вт (70°С)	≥900	55	3,5	1 (2*) А	≤20* мА (55 В)
2Т913В	n-p-n	-60...+125	12* Вт	≥900	55	3,5	1 (2*) А	≤20* мА (55 В)
2Т9117А	n-p-n	-60...+125	6* Вт	≥50	100	4,5	1 А	≤0,1* мА (100 В)
2Т9117Б	n-p-n	-60...+125	6* Вт	≥50	80	4,5	1 А	≤0,1* мА (80 В)
2Т9117В	n-p-n	-60...+125	6* Вт	≥50	50	4,5	1 А	≤0,1* мА (50 В)
2Т9117Г	n-p-n	-60...+125	6* Вт	≥50	100	4,5	1 А	≤0,1* мА (100 В)
2Т9118А	n-p-n	-60...+125	130** Вт	≥1400	50	3,5	15* А	≤150 мА (50 В)
2Т9118Б	n-p-n	-60...+125	130** Вт	≥1400	50	3,5	15* А	≤150 мА (50 В)
2Т9118В	n-p-n	-60...+125	130** Вт	≥1400	50	3,5	15* А	≤150 мА (50 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^*_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
— —	— —	≥6** ≥6**	≥150** (1,5 ГГц) ≥40** (1,5 ГГц)	— —	**2Т9114**
≥15* (5 В; 0,2 А) ≥15* (5 В; 0,2 А)	≤10 (28 В) ≤10 (28 В)	≥2** ≥2**	≥0,8** (1,8 ГГц) ≥0,8** (1 ГГц)	≤25 ≤25	**2Т911**
10...50* (10 В; 5 А) 20...100* (10 В; 5 А)	≤200 (27 В) ≤200 (27 В)	≤0,12; ≥10** ≤0,12; ≥10**	≥70** (30 МГц) ≥70** (30 МГц)	— —	**2Т912**
10...50* (10 В; 5 А) 20...100* (10 В; 5 А)	≤200 (27 В) ≤200 (27 В)	≤0,12; ≥10** ≤0,12; ≥10**	≥70** (30 МГц) ≥70** (30 МГц)	— —	**2Т912-5**
≥10* (5 В; 0,5 А) ≥10* (5 В; 0,5 А) ≥10* (5 В; 0,5 А)	≤6 (28 В) ≤12 (28 В) ≤14 (28 В)	≤1,1; ≥2,25** ≤1,1; ≥2,25** ≤1,1; ≥2,25**	≥3** (1 ГГц) ≥5** (1 ГГц) ≥10** (1 ГГц)	≤15 ≤12 ≤15	**2Т913**
80...250* (10 В; 0,15 А) 80...250* (10 В; 0,15 А) 80...250* (10 В; 0,15 А) 40...160* (10 В; 0,15 А)	40 (5 В) 40 (5 В) 40 (5 В) 40 (5 В)	≤2 ≤2 ≤2 ≤2	— — — —	≤900** ≤900** ≤900** ≤900**	**2Т9117**
— — —	— — —	≥6** ≥6** ≥6**	≥75** (1,3 ГГц) ≥75** (1,4 ГГц) ≥75** (1,22 ГГц)	— — —	**2Т9118**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т9119А-2	n-p-n	-60...+125	3 Вт	—	20	1,5	1 А (1* А)	≤2 мА (20 В)
2Т9121А	n-p-n	-60...+125	92** Вт	—	42	3	9,2* А	≤15 мА (42 В)
2Т9121Б	n-p-n	-60...+125	46** Вт	—	42	3	4,6* А	≤7,5 мА (42 В)
2Т9121В	n-p-n	-60...+125	11,5** Вт	—	42	3	1,15* А	≤2,5 мА (42 В)
2Т9121Г	n-p-n	-60...+125	130** Вт	—	42	3	13* А	≤22 мА (42 В)
2Т9122А	n-p-n	-60...+125	133** Вт	—	40	2	6,5 А (7,5* А)	≤150 мА (45 В)
2Т9122Б	n-p-n	-60...+125	110** Вт	—	45	2	5,4 А (6* А)	≤150 мА (45 В)
2Т9123А	n-p-n	-60...+125	60* Вт	130	60* (1к)	5	12,5 А; 30* А	≤5* мА (60 В)
2Т9123Б	n-p-n	-60...+125	60* Вт	130	70* (1к)	5	12,5 А; 30* А	≤5* мА (70 В)
2Т9124А	n-p-n	-60...+125	23,5** Вт	—	30	1,5	1,5 А (2* А)	≤20 мА (30 В)
2Т9124Б	n-p-n	-60...+125	21,5** Вт	—	30	1,5	1,5 А (2* А)	≤20 мА (30 В)
2Т9125АС	n-p-n	-60...+125	64* Вт	≥660	55* (10 Ом)	4	4 А	≤60* мА (55 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^*_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^*_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс; $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
—	≤7,5 (15 В)	≥2,7**	≥4,5** (7 ГГц)	—	2Т9119-2
—	7,5 (15 В)	≥6**	≥35** (2,3...2,7 ГГц)	—	2Т9121
—	7,5 (15 В)	≥6**	≥17** (2,3...2,7 ГГц)	—	
—	7,5 (15 В)	≥6**	≥4** (2,3...2,7 ГГц)	—	
—	7,5 (15 В)	≥6**	≥50** (2,3...2,7 ГГц)	—	
—	—	≥4**	≥55** (2 ГГц)	—	2Т9122
—	—	≥4**	≥45** (2 ГГц)	—	
1800...18000 (10 В; 10 А)	—	≤0,3	—	250*	2Т9123
1600...7000 (10 В; 1 А)	—	≤1,3	—	250*	
—	—	≥3**	≥10** (3,1...3,5 ГГц)	—	2Т9124
—	—	≥3,2**	≥8** (3,1...3,5 ГГц)	—	
≤110* (5 В; 0,5 А)	≤70 (28 В)	≥4**	≥50** (500 МГц)	≤20	2Т9125

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т9126А	n-p-n	-60...+125	330* Вт	≥100	100* (0,01к)	4	30 А; 50* А	≤200* мА (100 В)
2Т9127А	n-p-n	-60...+125	1151** Вт	≥1025	65	3	38* А	≤60* мА (65 В)
2Т9127Б	n-p-n	-60...+125	524** Вт	≥1025	65	3	19* А	≤30* мА (65 В)
2Т9127В		-60...+125	1151** Вт	≥1025	65	3	38* А	≤60* мА (65 В)
2Т9127Г		-60...+125	524** Вт	≥1025	65	3	19* А	≤30* мА (65 В)
2Т9127Д		-60...+125	524** Вт	≥1025	65	3	19* А	≤30* мА (65 В)
2Т9127Е		-60...+125	524** Вт	≥1025	65	3	19* А	≤30* мА (65 В)
2Т9127Ж		-60...+125	1151** Вт	≥1025	65	3	38* А	≤30* мА (65 В)
2Т9127И		-60...+125	524** Вт	≥1025	65	3	19* А	≤30* мА (65 В)
2Т9127К		-60...+125	524** Вт	≥1025	65	3	19* А	≤30* мА (65 В)
2Т9128АС	n-p-n	-60...+125	115* Вт	≥200	50*	4	18 А	≤100* мА (50 В)
2Т9129А	n-p-n	-60...+125	47* Вт	—	30	1,5	4 А	≤30 мкА (30 В)
2Т9130А	n-p-n	-60...+125	10* Вт	≥200	250	6	150	≤1 мкА (250 В)
2Т9131А	n-p-n	-60...+125	350* Вт	≥100	100*	6	25 А; 40* А	≤200* мА (100 В)
2Т9132АС	n-p-n	-60...+125	220** Вт	≥320	50	4	11,2 А; 22* А	≤150* мА (50 В)

h_{21}, $h^{*}_{21э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
≥10* (10 В; 5 А)	≤500 (50 В)	≥13**	≥500** (1,5 МГц)	—	**2Т9126**
— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	≥5,6** ≥6,2** ≥6,2** ≥6,2** ≥6,2** ≥6,2** ≥6,2** ≥6,2** ≥6,2**	≥550** (1,025...1,15 ГГц) ≥250** (1,025...1,15 ГГц) 500** 250** 250** 125** 500** 250** 125**	— — — — — — — — —	**2Т9127**
≤100* (5 В; 0,5 А)	≤430 (28 В)	7** (175 МГц)	≥200** (175 МГц)	≤30	**2Т9128**
—	—	≥4,5**	≥20** (3,5 ГГц)	—	**2Т9129**
60...250 (9 В; 20 мА)	≤6 (10 В)	≤50	—	≤20	**2Т9130**
10...100 (10 В; 10 мА)	≤800 (50 В)	≤0,1; ≥10**	≥400** (30 МГц)	—	**2Т9131**
—	≤170 (30 В)	≥3,5**	≥140** (650 МГц)	≤20	**2Т9132**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т9133А	n-p-n	-60...+125	130* Вт (70°C)	≥240	55* (0,01к)	4	16 А	≤200* мА (55 В)
2Т9134А	n-p-n	-60...+125	2600** Вт	—	50	3	78* А	≤120* мА (50 В)
2Т9134Б	n-p-n	-60...+125	2100** Вт	—	50	3	63* А	≤120* мА (50 В)
2Т9135А-2	n-p-n	-60...+125	3,4 Вт	—	15	1,2	950	≤2 мА (15 В)
2Т9136АС	n-p-n	-60...+125	700** Вт	≥300	60	4	30* А	≤140 мА (60 В)
2Т9137А	n-p-n	-60...+125	9* Вт	≥2700	22* (0,1к)	3,5	500	≤10* мА (22 В)
2Т9137Б	n-p-n	-60...+125	16* Вт	≥2700	22* (0,1к)	3,5	1100	≤25* мА (22 В)
2Т9138А	n-p-n	-60...+125	60* Вт	≥120	200	5	8 А; 12* А	≤20 мА (200 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^{*}_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс; $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
—	≤160 (28 В)	≥7,5**	≥30** (225 МГц)	≤30	**2Т9133**
— —	— —	≥6** ≥6**	≥1000** (1,5 ГГц) ≥800** (1,5 ГГц)		**2Т9134**
—	—	≥1,7**	≥2,6**(10 ГГц)	—	**2Т9135**
—	≤260 (45 В)	≥7**	≥500** (0,5 ГГц)	≤20	**2Т9136**
— —	≤5,5 (18 В) ≤5,5 (18 В)	≥5,5** ≥3,8**	≥2,1** (0,1...2,3 ГГц) ≥4** (0,1...2,3 ГГц)	— —	**2Т9137**
30...70 (5В; 5А)	≤250 (50 В)	≤0,2; ≤0,2*	—	—	**2Т9138**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{K\ max}$, $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т9139А	n-p-n	-60...+125	23,5** Вт	—	30	1,5	2* А	≤20* мА (30 В)
2Т9139Б	n-p-n	-60...+125	21,5** Вт	—	30	1,5	1,5* А	≤20* мА (30 В)
2Т9139В	n-p-n	-60...+125	52** Вт	—	30	1,5	4* А	≤30* мА (30 В)
2Т9139Г	n-p-n	-60...+125	7,8** Вт	—	30	1,5	0,7* А	≤5* мА (30 В)
2Т9140А	n-p-n	-60...+125	176 Вт	—	50	—	10 А	—
2Т914А	p-n-p	-60...+125	7* Вт	≥300	65	4	0,8 (1,5* А)	2* мА (65 В)
2Т9143А	p-n-p	-60...+125	3* Вт	≥1500	75	3	100; 300*	≤1* (50 В)
2Т9146А	n-p-n	-60...+125	350** Вт	—	50; 45*	3	20* А	≤40 мА (50 В)
2Т9146Б	n-p-n	-60...+125	175** Вт	—	50; 45*	3	10* А	≤20 мА (50 В)
2Т9146В	n-p-n	-60...+125	70** Вт	—	50; 45*	3	4* А	≤10 мА (50 В)
2Т9146Г	n-p-n	-60...+125	350** Вт	—	50; 45*	3	20* А	≤40 мА (50 В)
2Т9146Д	n-p-n	-60...+125	175** Вт	—	50; 45*	3	10* А	≤20 мА (50 В)
2Т9146Е	n-p-n	-60...+125	70** Вт	—	50; 45*	3	4* А	≤10 мА (50 В)
2Т9146Ж	n-p-n	-60...+125	350** Вт	—	50; 45*	3	20* А	≤40 мА (50 В)
2Т9146И	n-p-n	-60...+125	175** Вт	—	50; 45*	3	10* А	≤20 мА (50 В)
2Т9146К	n-p-n	-60...+125	70** Вт	—	50; 45*	3	4* А	≤10 мА (50 В)
2Т9147АС	n-p-n	-60...+125	233* Вт	—	50* (0,01 к)	4	29 А	≤120* мА (50 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
— — — —	— — — —	≥3,5** ≥3,6** ≥3,3** ≥3,3**	≥10** (2,7...3,1 ГГц) ≥9** (2,7...3,1 ГГц) ≥20** (2,7...3,1 ГГц) ≥3** (2,7...3,1 ГГц)	— — — —	**2Т9139**
—	—	≥6,5**	≥125** (1,2...1,4 ГГц)	—	**2Т9140**
10...60* (5 В; 0,25 А)	≤12 (28 В)	≥2,5**	≥2,5** (400 МГц)	≤15	**2Т914**
≥20 (5 В; 50 А)	≤3 (10 В)	—	—	—	**2Т9143**
— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	≥6** ≥6** ≥7** ≥6** ≥6** ≥7** ≥7** ≥7** ≥7**	≥200**(1,45...1,55ГГц) ≥100**(1,45...1,55ГГц) ≥40**(1,45...1,55ГГц) ≥200**(1,45...1,55ГГц) ≥100**(1,45...1,55ГГц) ≥40**(1,45...1,55ГГц) ≥200**(1,45...1,55ГГц) ≥100**(1,45...1,55ГГц) ≥40**(1,45...1,55ГГц)	— — — — — — — — —	**2Т9146 (А, Г, Ж)** **2Т9146 (Б, В, Д, Е, И, К)**
≥10* (5 В; 0,5 А)	≤340 (28 В)	≥6,6**	≥160** (0,4 ГГц)	—	**2Т9147АС**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т9149А	n-p-n	-60...+125	100** Вт	—	45	2	4,5* А	≤100 мА (45 В)
2Т9149Б	n-p-n	-60...+125	56** Вт	—	45	2	2,1* А	≤50 мА (45 В)
2Т9153АС	n-p-n	-60...+125	50* Вт	—	50	4	4 А	≤20 мА (50 В)
2Т9153БС	n-p-n	-60...+125	94* Вт	—	50	4	10 А	≤60 мА (50 В)
2Т9155А	n-p-n	-60...+125	43* Вт	≥460	50	3	4 А	≤25* мА (50 В)
2Т9155Б	n-p-n	-60...+125	100* Вт	≥450	50	3	15 А	≤25* мА (50 В)
2Т9155В	n-p-n	-60...+125	180** Вт	≥360	50	3	24 А	≤25* мА (50 В)
2Т9156АС	n-p-n	-60...+125	50* Вт	—	50	3	4 А	≤20* мА (50 В)
2Т9156БС	n-p-n	-60...+125	94* Вт	—	50	3	10 А	≤60* мА (50 В)
2Т9158А	n-p-n	-60...+125	98** Вт	—	40	3	4,5* А	≤100 мА (40 В)
2Т9158Б	n-p-n	-60...+125	45** Вт	—	40	3	2,1* А	≤50 мА (40 В)
2Т9159А	n-p-n	-60...+125	5* Вт	≥1100	120; 80**	3	400	≤0,1 мА (120 В)
2Т9159А5	n-p-n	-60...+125	5* Вт	1100	120	3	400	≤0,1 мА (120 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у.р}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^{*}_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс; $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
— —	— —	≥4** ≥4**	≥30** (2,15...2,3 ГГц) ≥12** (2,15...2,3 ГГц)	— —	2Т9149
≥10* (5 В; 0,5 А) ≥10* (5 В; 0,5 А)	≤37 (28 В) ≤66 (28 В)	≥7,8** ≥7**	≥15**(0,39...0,84ГГц) ≥50**(0,39...0,84ГГц)	— —	2Т9153
≥10* (5 В; 0,5 А) ≥10* (5 В; 0,5 А)	≤35 (28 В) ≤35 (28 В)	≥6,5** ≥6,2**	≥15** (0,86 ГГц) ≥50** (860 МГц)	— —	2Т9155
≥10* (5 В; 0,5 А)	≤35 (28 В)	≥5**	≥100** (0,86 МГц)	—	2Т9155В
≥10* (5 В; 0,5 А) ≥10* (5 В; 0,5 А)	≤37 (28 В) ≤66 (28 В)	≥7** ≥6**	≥15** (0,65...1 ГГц) ≥50** (0,65...1 ГГц)	— —	2Т9156
— —	— —	≥5** ≥6**	≥30** (2,3...2,7 ГГц) ≥12** (2,3...2,7 ГГц)	— —	2Т9158
20...60* (5 В; 50 мА)	≤2,5 (10 В)	—	—	—	2Т9159
20...60* (5 В; 50 мА)	≤2,5 (10 В)	—	—	—	2Т9159-5

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °С	$P_{K\,max}$, $P^{*}_{K,\,т\,max}$, $P^{**}_{K,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{K\,max}$, $I^{*}_{K,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т916А	n-p-n	-60...+100	30* Вт	≥1100	55* (0,01к)	3,5	2 (4*) А	≤25* мА (55 В)
2Т9161АС	n-p-n	-60...+125	700** Вт	500	60	4	25 А	≤280 мА (60 В)
2Т9162А	n-p-n	-60...+125	1290** Вт	600	50	3	39* А	≤60 мА (50 В)
2Т9162Б	n-p-n	-60...+125	1165** Вт	600	50	3	35* А	≤60 мА (50 В)
2Т9162В	n-p-n	-60...+125	1290** Вт	600	50	3	39* А	≤60 мА (50 В)
2Т9162Г	n-p-n	-60...+125	1265** Вт	600	50	3	39* А	≤60 мА (50 В)
2Т9164А	n-p-n	-60...+125	875** Вт	—	65	—	20 А	—
2Т917А	n-p-n	-60...+125	50* Вт	≥60	150	5	10 (15*) А	≤20 мА (150 В)
2Т9175А	n-p-n	-60...+125	3,75** Вт	≥900	20* (10 Ом)	3	500	≤1,5* мА (20 В)
2Т9175Б	n-p-n	-60...+125	7,5** Вт	≥900	20* (10 Ом)	3	1 А	≤3* мА (20 В)
2Т9175В	n-p-n	-60...+125	15** Вт	≥780	20* (10 Ом)	3	2 А	≤5* мА (20 В)

h_{21}, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
35* (5 В; 0,25 А)	≤20 (30 В)	≤0,7*	≥20** (1 ГГц)	≤10	**2Т916**
≥20* (5 В; 0,5 А)	—	≥7**	≥500** (0,4...0,5 ГГц)	—	**2Т9161**
— — — —	— — — —	≥6** ≥6** ≥6** ≥7**	≥500** (1,4...1,6 ГГц) ≥400** (1,4...1,6 ГГц) ≥500** (1,4...1,6 ГГц) ≥500** (1,4...1,6 ГГц)	— — — —	**2Т9162**
—	—	≥4**	≥300** (1,03...1,09 ГГц)	—	**2Т9164**
10...60* (7 А; 5 В)	—	—	30...50** (10 МГц)	—	**2Т917**
— — —	≤10 ≤16 ≤30	≥10** раз ≥6** раз ≥4** раз	≥0,5**(200...512МГц) ≥2**(200...512МГц) ≥5**(200...512МГц)	≤18 ≤18 ≤18	**2Т9175**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т9175А-4	n-p-n	-60...+125	3,75** Вт	900	—	—	500	—
2Т9175Б-4	n-p-n	-60...+125	7,5** Вт	900	—	—	1 А	—
2Т9175В-4	n-p-n	-60...+125	15** Вт	780	—	—	2 А	—
2Т9183А-5	n-p-n БСИТ	-60...+125	—	—	70*	—	12 А	—
2Т9184А	n-p-n	-60...+125	50* Вт	≥30	70* (1к)	5	10 А; 20* А	≤1 мА (70 В)
2Т9188А	n-p-n	-60...+125	35** Вт	700	—	—	5 А	—
2Т9188А-4	n-p-n	-60...+125	35** Вт	700	—	—	5 А	—

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
— — —	≤10 ≤16 ≤30	≥10** раз ≥6** раз ≥4** раз	≥0,5**(200...512МГц) ≥2**(200...512МГц) ≥5**(200...512МГц)	— — —	**2Т9175-4**
≥100 (5 В; 6 А)	≤350	≤0,025	—	—	**2Т9183-5**
60...100 (1 В; 4 А)	—	≤0,1	—	—	**2Т9184**
—	≤50	≥5** раз	≥10** (0,2...0,47 ГГц)	—	**2Т9188**
—	≤50	≥5** раз	≥10** (0,2...0,47 ГГц)	—	**2Т9188-4**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{K\ max}$, $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т919А	n-p-n	-60...+125	10* Вт	≥1350	45	3,5	0,7 (1,5*) А	≤10 мА (45 В)
2Т919Б	n-p-n	-60...+125	5* Вт	≥1350	45	3,5	0,35 (0,7*) А	≤5 мА (45 В)
2Т919В	n-p-n	-60...+125	3,25* Вт	≥1350	45	3,5	0,2 (0,4*) А	≤2 мА (45 В)
2Т919А-2	n-p-n	-60...+125	10* Вт	≥1350	45	3,5	0,7 (1,5*) А	≤10 мА (45 В)
2Т919Б-2	n-p-n	-60...+125	5* Вт	≥1350	45	3,5	0,35 (0,7*) А	≤5 мА (45 В)
2Т919В-2	n-p-n	-60...+125	3,25* Вт	≥1350	45	3,5	0,2 (0,4*) А	≤2 мА (45 В)
2Т920А	n-p-n	-60...+125	5* Вт (50°С)	≥400	36	4	0,25 (1*) А	≤1* мА (36 В)
2Т920Б	n-p-n	-60...+125	10* Вт (50°С)	≥400	36	4	1 (2*) А	≤2* мА (36 В)
2Т920В	n-p-n	-60...+125	25* Вт (50°С)	≥400	36	4	3 (7*) А	≤5* мА (36 В)
2Т921А	n-p-n	-60...+125	12,5* Вт (75°С)	≥90	65* (0,1к)	4	3,5 А	≤10* мА (70 В)
2Т921А-4	n-p-n	-60...+125	12,5* Вт (75°С)	≥90	65* (0,1к)	4	3,5 А	≤1* мА (70 В)
2Т922А	n-p-n	-60...+125	8* Вт (40°С)	≥300	65* (0,1к)	4	0,8 (1,5*) А	≤2* мА (65 В)
2Т922Б	n-p-n	-60...+125	20* Вт (40°С)	≥300	65* (0,1к)	4	1,5 (4,5*) А	≤10* мА (65 В)
2Т922В	n-p-n	-60...+125	40* Вт (40°С)	≥300	65* (0,1к)	4	3 (9*) А	≤20* мА (65 В)
2Т925А	n-p-n	-60...+125	5,5* Вт (40°С)	≥600	36* (0,1к)	4	0,5 (1*) А	≤5 мА (36 В)
2Т925Б	n-p-n	-60...+125	11* Вт (40°С)	≥600	36* (0,1к)	4	1 (3*) А	≤10 мА (36 В)
2Т925В	n-p-n	-60...+125	25* Вт (40°С)	≥500	36* (0,1к)	3,5	3,3 (8,5*) А	≤30 мА (36 В)
2Т926А	n-p-n	-60...+125	50* Вт (50°С)	≥51	150* (0,01к)	5	15 (25*) А	≤25* мА (150 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r'_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс; $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
— — —	≤10 (28 В) ≤6,5 (28 В) ≤5 (28 В)	— — —	≥3,5** (2 ГГц) ≥1,6** (2 ГГц) ≥0,8** (2 ГГц)	≤2,2 ≤2,2 ≤2,2	**2Т919**
— — —	≤10 (28 В) ≤6,5 (28 В) ≤5 (28 В)	≥4,1** ≥3,2** ≥4**	≥4,1** (2 ГГц) ≥1,6** (2 ГГц) ≥0,8** (2 ГГц)	≤2,2 ≤2,2 ≤2,2	**2Т919-2**
≤30* мА (5 В; 50 мА) ≤40* мА (5 В; 100 мА) ≤25* мА (5 В; 250 мА)	≤15 (10 В) ≤25 (10 В) ≤75 (10 В)	≥7** ≥4,5** ≥3**	≥2** (175 МГц) ≥7** (175 МГц) ≥20** (175 МГц)	≤20 ≤20 ≤20	**2Т920**
≥10* (10 В; 1 А)	≤50 (20 В)	≥8**	≥12,5** (60 МГц)	≤300*	**2Т921**
≥10* (10 В; 1 А)	≤50 (20 В)	≥8**	≥12,5** (60 МГц)	≤300*	**2Т921-4**
≥10* (0,5 В; 1 А) ≥10* (0,5 В; 0,25 А) ≥10* (0,5 В; 0,5 А)	≤15 (28 В) ≤35 (28 В) ≤65 (28 В)	≥10** ≥5,5** ≥4**	≥5** (175 МГц) ≥20** (175 МГц) ≥40** (175 МГц)	≤20 ≤20 ≤25	**2Т922**
≥8* (5 В; 0,2 А) ≥10* (5 В; 0,2 А) ≥17* (5 В; 0,2 А)	≤15 (12,6 В) ≤30 (12,6 В) ≤60 (12,6 В)	≥6,3** ≥4** ≥3**	2** (320 МГц) 7** (320 МГц) 20** (320 МГц)	≤20 ≤35 ≤40	**2Т925**
12...60* (7 В; 15 А)	—	≤0,17	—	—	**2Т926**

23 зак 9

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^*_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^*_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^*_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^*_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^*_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т928А	n-p-n	-60...+125	0,5 Вт (2*) Вт	≥300	60	5	0,8 (1,2*) А	≤1 (60 В)
2Т928Б	n-p-n	-60...+125	0,5 Вт (2*) Вт	≥300	60	5	0,8 (1,2*) А	≤1 (60 В)
2Т929А	n-p-n	-60...+125	6 Вт (40°C)	≥700	30* (0,1к)	3	0,8 (1,5*) А	≤500 (30 В)
2Т930А	n-p-n	-60...+125	75* Вт (40°C)	≥450	50* (0,1к)	4	6 А	≤20* мА (50 В)
2Т930Б	n-p-n	-60...+125	120* Вт (40°C)	≥600	50* (0,1к)	4	10 А	≤100* мА (50 В)
2Т931А	n-p-n	-60...+125	150 Вт (40°C)	≥250	60* (0,01к)	4	15 А	≤20* мА (60 В)
2Т932А	p-n-p	-60...+125	20* Вт (50°C)	≥30	80	4,5	2 А	≤1,5* мА (80 В)
2Т932Б	p-n-p	-60...+125	20* Вт (50°C)	≥50	60	4,5	2 А	≤1,5* мА (60 В)
2Т933А	p-n-p	-60...+125	5* Вт (50°C)	≥75	80	4,5	0,5 А	≤0,5* мА (80 В)
2Т933Б	p-n-p	-60...+125	5* Вт (50°C)	≥75	60	4,5	0,5 А	≤0,5* мА (60 В)
2Т934А	n-p-n	-60...+125	7,5* Вт	≥500	60* (0,01к)	4	0,5 А	≤5* мА (60 В)
2Т934Б	n-p-n	-60...+125	15* Вт	≥500	60* (0,01к)	4	1 А	≤10* мА (60 В)
2Т934В	n-p-n	-60...+125	30* Вт	≥500	60* (0,01к)	4	2 А	≤20* мА (60 В)
2Т935А	n-p-n	-60...+125	60* Вт (50°C)	≥51	80* (0,01к)	5	20 (30*) А	≤30* мА (80 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	$C_к$, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^{*}_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс; $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
30...100* (5 В; 150 мА) 50...200* (5 В; 150 мА)	≤12 (10 В) ≤12 (10 В)	≤2 ≤2	— —	≤225* ≤225*	**2Т928**
≥25* (5 В; 0,7 А)	≤20 (8 В)	≥10**	≥2** (175 МГц)	≤25	**2Т929**
40* (5 В; 0,5 А) 50* (5 В; 0,5 А)	≤80 (28 В) ≤170 (28 В)	≥6** ≥4**	≥40** (400 МГц) ≥75** (400 МГц)	8 11	**2Т930**
25* (5 В; 0,5 А)	≤240 (28 В)	0,18; ≥4**	≥80** (175 МГц)	18	**2Т931**
≥15* (3 В; 1,5 А) ≥30* (3 В; 1,5 А)	≤300 (20 В) ≤300 (20 В)	≤1 ≤1	— —	— —	**2Т932**
≥15* (3 В; 0,4 А) ≥30* (3 В; 0,4 А)	≤100 (20 В) ≤100 (20 В)	≤3,75 ≤3,75	— —	— —	**2Т933**
50* (5 В; 0,1 А) 50* (5 В; 0,15 А) 50* (5 В; 0,25 А)	≤9 (28 В) ≤16 (28 В) ≤32 (28 В)	2; ≥6** 1; ≥4** 0,5; ≥3**	≥3** (400 МГц) ≥12** (400 МГц) ≥25** (400 МГц)	≤20 ≤20 ≤20	**2Т934**
20...100* (4 В; 15 А)	≤800 (10 В)	≤0,66	—	≤700**	**2Т935**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т935А-5	n-p-n	-60...+125	60* Вт	≥51	80*	5	20 А	≤30* мА
2Т937А-2	n-p-n	-60...+125	3,6** Вт	6500	25	2,5	250	≤2* мА (25 В)
2Т937Б-2	n-p-n	-60...+100	7,4** Вт	6500	25	2,5	450	≤5* мА (25 В)
2Т937А-5	n-p-n	-60...+125	3,6** Вт	6500	25	2,5	250	≤2 мА (25 В)
2Т938А-2	n-p-n	-60...+125	1,5* Вт	≥2000	28	2,5 В	180	≤1 мА (28 В)
2Т939А	n-p-n	-60...+125	4* Вт	≥2500	30* (0,01к)	3,5	400	≤2 мА (30 В)
2Т939Б	n-p-n	-60...+125	4* Вт	≥1500	30* (0,01к)	3,5	400	≤2 мА (30 В)
2Т939А1	n-p-n	-60...+125	4* Вт	≥2500	30* (0,01к)	3,5	400	≤1 мА (30 В)
2Т941А	p-n-p	-60...+125	4* Вт	≥1500	30	3	500	≤300 (30 В)
2Т942А	n-p-n	-60...+125	25** Вт	≥1950	45	3,5	1,5 А	≤20 мА (45 В)
2Т942Б	n-p-n	-60...+125	22** Вт	≥1950	45	3,5	1,5 А	≤20 мА (45 В)
2Т942А-5	n-p-n	-60...+125	25** Вт	≥1950	45	3,5	1,5 А	≤20 мА (45 В)
2Т942Б-5	n-p-n	-60...+125	22** Вт	≥1950	45	3,5	1,5 А	≤20 мА (45 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	C_k, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^*_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
20...100* (4 В; 15 А)	≤800 (10 В)	≤0,66	—	≤700**	2Т935-5
— —	≤5,5 (20 В) ≤7,5 (20 В)	≥1,6** ≥1,8**	≥1,6** (5 ГГц) ≥3,6** (5 ГГц)	0,78 0,6	2Т937
—	≤5,5 (20 В)	≥1,6**	≥1,6** (5 ГГц)	0,78	2Т937-5
—	≤4 (20 В)	≥2**	≥1** (5 ГГц)	≤2	2Т938-2
40...200* (12 В; 0,2 А) 20...200* (12 В; 0,2 А)	≤5,5 (12 В) ≤6 (12 В)	— —	— —	≤9 ≤10	2Т939 (2Т939А1)
40...200* (12 В; 0,2 А)	—	—	—	—	
≥20* (5 В; 0,1 А)	≤5 (20 В)	≤6	—	≤15	2Т941
— —	≤20 (28 В) ≤20 (28 В)	≥2,5** ≥2,5**	≥8** (2 ГГц) ≥6** (2 ГГц)	≤2,2 ≤2,5	2Т942
— —	≤20 (28 В) ≤20 (28 В)	≥2,5** ≥2,5**	≥8** (2 ГГц) ≥6** (2 ГГц)	≤2,2 ≤2,5	2Т942-5

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т944А	n-p-n	-60...+125	55* Вт (90°С)	≥105	100* (0,01к)	5	12,5 (20*) А	≤80* мА (100 В
2Т945А	n-p-n	-60...+125	50* Вт (50°С)	≥51	200* (100 Ом)	5	15 (25*) А	≤25* мА (200 В)
2Т945Б	n-p-n	-60...+125	50* Вт (50°С)	≥51	150* (100 Ом)	5	15 (25*) А	≤25* мА (150 В)
2Т945В	n-p-n	-60...+125	50* Вт (50°С)	≥51	150* (100 Ом)	5	10 (20*) А	≤25* мА (150 В)
2Т945А-5	n-p-n	-60...+125	50* Вт (50°С)	≥51	200* (100 Ом)	5	15 (25*) А	≤25* мА (200 В)
2Т946А	n-p-n	-60...+125	37,5** Вт	≥720	50	3,5	2,5 (5*) А	≤50 мА (50 В)
2Т947А	n-p-n	-60...+125	200* Вт (50°С)	≥75	100* (0,01к)	5	20 (50*) А	≤100* мА (100 В)
2Т948А	n-p-n	-60...+125	40* Вт	≥1950	45	2	2,5 (5*) А	≤30 мА (45 В)
2Т948Б	n-p-n	-60...+125	20* Вт	≥1950	45	2	1,25 (2,5*) А	≤15 мА (45 В)
2Т949А	n-p-n	-60...+125	60* Вт	180	60*	5	20 А	≤50 мА
2Т950А	n-p-n	-60...+125	84 Вт	≥150	60*	4	10 А	≤30 мА* (60 В)
2Т950Б	n-p-n	-60...+125	60 Вт	≥90	65*	4	7 А	≤30 мА* (60 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
10...80* (5 В; 10 А)	≤350 (28 В)	≤0,25; ≥10**	≥100** (30 МГц)	—	**2Т944**
10...60* (7 В; 15 А) 10...60* (7 В; 15 А) 10...60* (7 В; 10 А)	≤200 (30 В) ≤200 (30 В) ≤200 (30 В)	≤0,17 ≤0,17 ≤0,17	— — —	≤1,1* мкс ≤1,1* мкс ≤1,1* мкс	**2Т945**
10...60* (7 В; 15 А)	≤200 (30 В)	≤0,17	—	≤1,1* мкс	**2Т945-5**
—	≤50 (10 В)	≥4**	≥27** (1 ГГц)	—	**2Т946**
10...80* (5 В; 20 А)	≤850 (27 В)	≥10**	≥250** (1,5 МГц)	—	**2Т947**
— —	≤30 (28 В) ≤17 (28 В)	— —	≥15** (2 ГГц) ≥8** (2 ГГц)	— —	**2Т948**
10...90* (10 В; 15 А)	550	—	—	140**	**2Т949**
15...100 (5 А; 10 В) 10...100 (5 А; 10 В)	≤165 (28 В) ≤220 (28 В)	0,15; ≥7** 0,15; ≥10**	≥70** (80 МГц) ≥50** (30 МГц)	— —	**2Т950**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т951А **2Т951Б** **2Т951В**	n-p-n n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125 -60...+125	45 Вт** 30 Вт** 6,3 Вт**	≥150 ≥90 ≥150	60* 65* 60*	4 4 4	5 А 3 А 0,5 А	≤20 мА (60 В) ≤20 мА (60 В) ≤5 мА (60 В)
2Т955А	n-p-n	-60...+125	20* Вт (100°С)	≥100	70* (0,01к)	4	6 А	≤10* мА (60 В)
2Т956А	n-p-n	-60...+125	70** Вт (100°С)	≥100	100* (0,01к)	4	15 А	≤80* мА (100 В)
2Т957А	n-p-n	-60...+125	100** Вт (100°С)	≥100	60* (0,01к)	4	20 А	≤100* мА (60 В)
2Т958А	n-p-n	-60...+125	85** Вт (40°С)	≥400	36* (0,01к)	4	10 А	≤15* мА (36 В)
2Т960А	n-p-n	-60...+125	70** Вт (40°С)	≥600	36* (0,01к)	4	7 А	≤20* мА (36 В)
2Т962А **2Т962Б** **2Т962В**	n-p-n n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125 -60...+125	17** Вт (40°С) 27** Вт (40°С) 66** Вт (40°С)	≥750 ≥750 ≥600	50 50 50	4 4 4	1,5 А 2,5 А 4 А	≤20 мА (50 В) ≤20 мА (50 В) ≤30 мА (50 В)
2Т963А-2 **2Т963Б-2**	n-p-n n-p-n	-60...+125 -60...+125	1,1* Вт 1,1* Вт	— —	18 18	1,5 1,5	210 185	≤1 мА (18 В) ≤1 мА (18 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
15...100 (2 А; 10 В) 10...100 (2 А; 10 В) 30...200 (2 А; 10 В)	≤70 (28 В) ≤70 (28 В) ≤12 (28 В)	≥8,3** ≥10** ≥15**	≥25** (80 МГц) ≥20** (30 МГц) ≥3** (80 МГц)	— — —	**2Т951**
10...80* (5 В; 1 А)	≤75 (28 В)	≥20** раз	≥20** (30 МГц)	—	**2Т955**
10...80* (5 В; 1 А)	≤4005 (28 В)	≥20**	≥100** (30 МГц)	—	**2Т956**
10...80* (5 В; 5 А)	≤600 (28 В)	≥17**	≥125** (30 МГц)	—	**2Т957**
≥10* (8 В; 0,5 А)	≤180 (12 В)	≥4**	≥40** (175 МГц)	12	**2Т958**
—	≤120 (12 В)	≥2,5**	≥40** (400 МГц)	12,5	**2Т960**
— — —	≤20 (28 В) ≤35 (28 В) ≤50 (28 В)	≥4** ≥3,5** ≥3**	≥10** (1 ГГц) ≥20** (1 ГГц) ≥40** (1 ГГц)	≤15 ≤14 ≤11	**2Т962**
— —	1,5 (5 В) 1,5 (5 В)	≥3** (10 ГГц) ≥3** (10 ГГц)	≥0,8** (10 ГГц) ≥0,5** (10 ГГц)	— —	**2Т963**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т963А-5	n-p-n	-60...+125	1,1* Вт	10 ГГц	18	1,5	185	≤1 мА (18 В)
2Т964А	n-p-n	-60...+125	200* Вт (50°C)	≥150	80*(100 Ом)	4	10 А	≤100 мА (80 В)
2Т965А	n-p-n	-60...+125	32* Вт	≥100	36* (0,01к)	4	4 А	≤10* мА (36 В)
2Т966А	n-p-n	-60...+125	64* Вт	≥100	36* (0,01к)	4	8 А	≤23* мА (36 В)
2Т967А	n-p-n	-60...+125	100** Вт	≥180	36* (0,01к)	4	15 А	≤20* мА (36 В)
2Т968А	n-p-n	-60...+125	4 Вт* (40°C)	≥90	300	5	100 (200*)	≤0,5* мА (250 В)
2Т968А-5	n-p-n	-60...+125	4 Вт* (40°C)	≥90	300	5	100 (200*)	≤0,5* мА (250 В)
2Т970А	n-p-n	-60...+125	170** Вт	≥600	50* (0,01к)	4	13 А	100* мА (50 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом; $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом; $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ; $r^{*}_б$, Ом; $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс; $t^{*}_{рас}$, нс; $t^{**}_{выкл}$, нс; $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
—	1,5 (5 В)	—	≥0,8** (10 ГГц)	—	**2Т963-5**
10...50* (5 А; 10 В)	≤290 (40 В)	≥5**	≥150** (80 МГц)	—	**2Т964**
10...60* (5 В; 1 А)	≤100 (12,6 В)	≥13**	≥20** (30 МГц)	—	**2Т965**
—	≤250 (12,6 В)	≥16**	≥40** (30 МГц)	—	**2Т966**
10...100* (5 В; 5 А)	≤500 (12,6 В)	≥18**	≥90** (30 МГц)	—	**2Т967**
35...320* (30 мА; 10 В)	≤2,8 (30 В)	≤33**	—	≤2**	**2Т968**
35...320* (30 мА; 10 В)	≤2,8 (30 В)	≤33**	—	≤2**	**2Т968-5**
—	180 (28 В)	≥4**	≥100** (400 МГц)	≤25	**2Т970**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{K\ max}$, $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т971А	n-p-n	-60...+125	200** Вт	≥220	50* (0,01к)	4	17 А	≤60* мА (50 В)
2Т974А	p-n-p	-60...+125	5* Вт (50°С)	≥450	80	3	2 А (10* А)	≤5 мА (80 В)
2Т974Б	p-n-p	-60...+125	5* Вт (50°С)	≥450	60	3	2 А (10* А)	≤5 мА (60 В)
2Т974В	p-n-p	-60...+125	5* Вт (50°С)	≥450	50	3	2 А (10* А)	≤5 мА (50 В)
2Т974Г	p-n-p	-60...+125	5* Вт (50°С)	≥450	60	3	2 А (10* А)	≤5 мА (60 В)
2Т975А	n-p-n	-60...+125	500** Вт (85°С)	—	50	3	15* А	≤40* мА (45 В)
2Т975Б	n-p-n	-60...+125	200** Вт (85°С)	—	50	3	7* А	≤20* мА (45 В)
2Т976А	n-p-n	-60...+125	75** Вт (40°С)	≥750	50	4	6 А	≤60 мА (50 В)
2Т977А	n-p-n	-60...+125	200** Вт (85°С)	≥600	50	3	8* А	≤25 мА (50 В)
2Т978А	n-p-n	-60...+125	40* Вт	≥75	300* (100 Ом), 120**	5	10 А (15* А)	≤2 мА (300 В)
2Т978Б	n-p-n	-60...+125	40* Вт	≥75	300* (100 Ом), 150**	5	10 А (15* А)	≤2 мА (300 В)
2Т979А	n-p-n	-60...+125	75* Вт	—	50	3,5	5 А; 10* А	≤100 мА (50 В)
2Т980А	n-p-n	-60...+125	300* Вт (30°С)	≥150	100* (0,01к)	4	15 А	≤100 мА (100 В)
2Т980Б	n-p-n	-60...+125	300* Вт (30°С)	≥150	100* (0,01к)	4	15 А	≤100 мА (100 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\,нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\,нас}$, Ом $K^{**}_{у.р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r^{*}_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
—	≤330 (28 В)	≥3**	≥150** (175 МГц)	≤40	**2Т971**
5...50 (5 А; 5 В) 5...50 (7 А; 5 В) 5...50 (5 А; 5 В) ≥10* (7 А; 5 В)	80 (30 В) 80 (30 В) 80 (30 В) 80 (30 В)	≤1 ≤0,6 ≤1 ≤0,6	— — — —	≤0,2 мкс ≤0,2 мкс ≤0,2 мкс ≤0,2 мкс	**2Т974**
— —	— —	≥6** ≥6**	200** (1,4...1,6 ГГц) 100** (1,4...1,6 ГГц)	≤0,2 мкс —	**2Т975**
—	≤70 (28 В)	≥2**	≥60** (1 ГГц)	≤25	**2Т976**
—	—	—	≥50** (1,5 ГГц)	—	**2Т977**
≥15* (5 А; 5 В) ≥15* (5 А; 5 В)	≤120 (50 В) ≤120 (50 В)	≤0,2 ≤0,2	— —	≤1,2* мкс ≤1,2* мкс	**2Т978**
—	—	≥6**	≥50** (1,3 ГГц)	—	**2Т979**
15...60* (10 В; 5 А) 10...60* (10 В; 5 А)	≤450 (50 В) ≤450 (50 В)	≥16** раз ≥16** раз	≥250** (30 МГц) ≥250** (80 МГц)	— —	**2Т980**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{K\ max}$, $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т981А	n-p-n	-60...+125	70* Вт	≥300	36* (0,01к)	4	10 А	≤50* мА (36 В)
2Т982А-2	n-p-n	-60...+125	5,8** Вт	—	20	1,5	600	≤1 мА (20 В)
2Т982А-5	n-p-n	-60...+125	5,8** Вт	—	20	1,5	600	≤1 мА (20 В)
2Т983А	n-p-n	-60...+125	8,7* Вт	≥1200	40* (0,01к)	4	0,5 А	≤5* мА (40 В)
2Т983Б	n-p-n	-60...+125	13* Вт	≥900	40* (0,01к)	4	1 А	≤8* мА (40 В)
2Т983В	n-p-n	-60...+125	22,5* Вт	≥750	40* (0,01к)	4	2 А	≤18* мА (40 В)
2Т984А	n-p-n	-60...+125	1,4* Вт	720	65	4	7* А	≤30 мА (65 В)
2Т984Б	n-p-n	-60...+125	4,7* Вт	720	65	4	16* А	≤80 мА (65 В)
2Т985АС	n-p-n	-60...+125	185* Вт	≥660	50* (10 Ом)	4	17 А	≤120 мА (50 В)
2Т986А	n-p-n	-60...+125	910** Вт	—	50	3	26* А	≤60 мА (50 В)
2Т986Б	n-p-n	-60...+125	775** Вт	—	50	3	26* А	≤50 мА (50 В)
2Т986В	n-p-n	-60...+125	910** Вт	—	50	3	26* А	≤40 мА (50 В)
2Т986Г	n-p-n	-60...+125	910** Вт	—	50	3	26* А	≤50 мА (50 В)
2Т987А	n-p-n	-60...+125	93* Вт	1000	50	3,5	5 А	100 мА (50 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_{k}, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_{ш}$, дБ $r^{*}_{б}$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_{к}$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
10...90* (5 В; 5 А)	≤400 (12,6 В)	≥5**	≥50** (80 МГц)	—	2Т981
—	≤6 (15 В)	2,5**	≥3,2** (7 ГГц)	—	2Т982
—	≤6 (15 В)	2,5**	≥3,2** (7 ГГц)	—	2Т982-5
≥20* (5 В; 0,5 А) ≥10* (5 В; 0,5 А) ≥10* (5 В; 0,5 А)	≤8 (28 В) ≤12 (28 В) ≤24 (28 В)	≥4** ≥3,6** ≥3,2**	≥0,5** (860 МГц) ≥1** (860 МГц) ≥3,5** (860 МГц)	— — —	2Т983
— —	≤35 (30 В) ≤80 (30 В)	≥5** ≥4**	≥75** (820 МГц) ≥250** (820 МГц)	5 5	2Т984
—	≤270 (28 В)	≥3,5**	≥125** (0,4 ГГц)	≤21	2Т985
— — — —	— — — —	≥6** ≥6** ≥7** ≥7**	≥350** (1,4...1,6 ГГц) ≥300** (1,6 ГГц) ≥350** (1,6 ГГц) ≥350** (0,6...0,8 ГГц)	— — — —	2Т986
—	—	≥6**	≥45** (1 ГГц)	—	2Т987

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т988А	n-p-n	-60...+125	43* Вт	—	50	3,5	2,5 А	≤50 мА (50 В)
2Т988Б	n-p-n	-60...+125	33* Вт	—	50	3,5	1,7 А	≤30 мА (50 В)
2Т989А	n-p-n	-60...+125	40* Вт (115°С)	—	45	2	5 А (7,5* А)	≤100 мА (45 В)
2Т989Б	n-p-n	-60...+125	30* Вт (115°С)	—	45	2	4 А (5* А)	≤100 мА (45 В)
2Т989В	n-p-n	-60...+125	14* Вт (115°С)	—	45	2	1,7 А	≤30 мА (45 В)
2Т989Г	n-p-n	-60...+125	25* Вт (115°С)	—	45	2	2,5 А	≤50 мА (45 В)
2Т990А-2	n-p-n	-60...+100	25* Вт	1,95 ГГц	45	3,5	1,5 А (3* А)	≤20 мА (45 В)
2Т991АС	n-p-n	-60...+125	67* Вт	≥540	50	4	3,7 А	≤50 мА (50 В)
2Т993А	n-p-n	-60...+125	50* Вт	≥180	150	4	5 А (10* А)	30 мА (150 В)
2Т994А-2	n-p-n	-60...+125	1290** Вт (85°С)	—	50	3	39* А	≤60 мА (50 В)
2Т994Б-2	n-p-n	-60...+125	1165** Вт (85°С)	—	50	3	35* А	≤60 мА (50 В)
2Т994В-2	n-p-n	-60...+125	1290** Вт (85°С)	—	50	3	39* А	≤60 мА (50 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	C_k, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у\ р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
— —	— —	≥6** ≥7,8**	≥15** (0,7 ГГц) ≥18** (1,4 ГГц)	— —	**2Т988**
— — — —	— — — —	≥3,2** ≥4,3** ≥7** ≥7**	≥35** (2 ГГц) ≥26** (2 ГГц) ≥12** (2 ГГц) ≥25** (1,7 ГГц)	— — — —	**2Т989**
—	≤22 (28 В)	—	≥8** (2 ГГц)	≤2,5	**2Т990-2**
—	≤75 (28 В)	≥6**	≥55** (0,7 ГГц)	≤6,8	**2Т991**
10...70* (5 В; 5 А)	375	—	—	—	**2Т993**
— — —	≤120 (45 В) ≤120 (45 В) ≤120 (45 В)	≥6** ≥6** ≥7**	≥500** (1,4...1,6ГГц) ≥400** (1,4...1,6ГГц) ≥500** (1,4...1,6ГГц)	— — —	**2Т994**

24 зак 9

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2Т995А-2	n-p-n	-60...+125	3* Вт	10 ГГц	18	1,5	600	≤2 мА (18 В)
2Т996А-2	n-p-n	-60...+125	2,5* Вт	≥4 ГГц	20	2,5	200 (0,3* А)	≤5* мА (20 В)
2Т996Б-2	n-p-n	-60...+125	2,5* Вт	≥4 ГГц	20	2,5	200 (0,3* А)	≤5* мА (20 В)
2Т996В-2	n-p-n	-60...+125	2,5* Вт	≥4 ГГц	20	2,5	200; 300*	≤1* мА (20 В)
2Т996Г-2	n-p-n	-60...+125	2,5* Вт	≥4 ГГц	20	2,5	200; 300*	≤1* мА (20 В)
2Т996А-5	n-p-n	-60...+125	2,5* Вт	≥4 ГГц	20	2,5	200 (0,3* А)	≤5* мА (20 В)
2Т996Б-5	n-p-n	-60...+125	2,5* Вт	≥4 ГГц	20	2,5	200 (0,3* А)	≤5* мА (20 В)
2Т998А	n-p-n	-60...+125	2,5* Вт	—	100	4	30 А	≤60 мА (100 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, Ом $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом $K^{**}_{у.р}$, дБ	$K_ш$, дБ $r'_б$, Ом $P^{**}_{вых}$, Вт	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс $t^{***}_{вкл}$, нс	Корпус
—	—	≥1,5**	≥1,5** (10 ГГц)	—	**2Т995**
≥35* (10 В; 0,1 А) ≥70* (10 В; 0,1 А) ≥35* (10 В; 0,1 А) ≥35* (10 В; 0,1 А)	≤2,3 (10 В) ≤2,3 (10 В) ≤2,3 (10 В) ≤2,3 (10 В)	— — ≥3,8** ≥4,5**	— — ≥0,115** (650 МГц) ≥0,135** (650 МГц)	— — — —	**2Т996**
≥35* (10 В; 0,1 А) ≥70* (10 В; 0,1 А)	≤2,3 (10 В) ≤2,3 (10 В)	— —	— —	— —	**2Т996-5**
≥10* (5 В; 15 А)	≤2,3 (10 В)	≤0,2	—	—	**2Т998**

2.11. Биполярные кремниевые сборки специального назначения

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\ max}$, $P^{*}_{К,\ т\ max}$, $P^{**}_{К,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{К\ max}$, $I^{*}_{К,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2ТС303А-2	n-p-n, p-n-p	-60...+125	500 (60°C)	300	45* (10к)	—	100 (500*)	≤0,5 (45 В)
2ТС3103А	p-n-p	-60...+125	300 (55°C)	≥600	15* (15к)	5	20 (50*)	≤0,2 (15 В)
2ТС3103Б	p-n-p	-60...+125	300 (55°C)	≥600	15* (15к)	5	20 (50*)	≤0,2 (15 В)
2ТС3111А-1	n-p-n	-60...+125	10	≥250	30	7	1000	≤10 мА (25 В)
2ТС3111Б-1	n-p-n	-60...+125	10	≥250	30	7	1000	≤10 мА (25 В)
2ТС3111В-1	n-p-n	-60...+125	10	≥250	30	7	1000	≤10 мА (25 В)
2ТС3111Г-1	n-p-n	-60...+125	10	≥250	30	7	1000	≤10 мА (25 В)
2ТС3111Д-1	n-p-n	-60...+125	10	≥250	30	7	1000	≤10 мА (25 В)
2ТС3136А-1	n-p-n	-60...+100	50 (100°C)	≥500	15	4	20	≤0,1 (15 В)
2Т3155АС-1	n-p-n		30	≥1000	10* (10к)	4	10; 20*	≤0,5 (10 В)
2Т3155БС-1	n-p-n		30	≥1000	10* (10к)	4	10; 20*	≤0,5 (10 В)
2ТС393А-1	p-n-p	-60...+85	20 (45°C)	≥500	10* (5к)	4	10 (20*)	≤0,1 (10 В)
2ТС393Б-1	p-n-p	-60...+85	20 (45°C)	≥500	10* (5к)	4	10 (20*)	≤0,2 (15 В)
2ТС393А-9	p-n-p	-60...+85	20	≥500	10	4	10	≤100 мА
2ТС393Б-9	p-n-p	-60...+85	20	≥500	15	4	10	≤100 мА
2ТС398А-1	n-p-n	-60...+100	30 (85°C)	≥1000	10* (10к)	4	10 (20*)	≤0,5 (10 В)
2ТС398Б-1	n-p-n	-60...+100	30 (85°C)	≥1000	10* (10к)	4	10 (20*)	≤0,5 (10 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$К_ш$, дБ $h_{21э1}$ / $h^*_{21э2}$, $\Delta U^{**}_{эб}$, мВ	$\tau_к$, пс $t^*_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
40...180 (5 В; 1 мА)	≤8 (5 В)	≤20	≥0,7* ≤30**	≤80	**2ТС303А-2**
40...200 (1 В; 1 мА) 40...200 (1 В; 1 мА)	≤2,5 (5 В) ≤2,5 (5 В)	≤60 ≤60	≤5 (60 МГц); ≥0,9* ≤5 (60 МГц); ≥0,8*	≤80 ≤80	**2ТС3103**
150...400* (10 мкА; 5 В) 100...400* (10 мкА; 5 В) 50...400* (10 мкА; 5 В) 20...400* (10 мкА; 5 В) 20...400* (10 мкА; 5 В)	≤2,5 (1 В) ≤2,5 (1 В) ≤2,5 (1 В) ≤2,5 (1 В) ≤2,5 (1 В)	— — — — —	— — — — —	— — — — —	**2ТС3111-1**
70...180 (5 В; 5 мА)	≤2 (5 В)	≤50	≤1*; ≤5**	≤40	**2ТС336-1**
40...250 (1 В; 1 мА) 40...250 (1 В; 1 мА)	≤1,5 (5 В) ≤1,5 (5 В)	— —	0,8...1,25*; ≤1,5** 0,9...1,1*; ≤3**	≤50 ≤50	**2Т3155-1**
40...180 (1 В; 1 мА) 30...140 (1 В; 1 мА)	≤2 (5 В) ≤2 (5 В)	— —	≤6 (60 МГц) ≤6 (60 МГц)	≤80 ≤80	**2ТС393-1**
40...180 30...140	— —	≤60 ≤60	≤3** ≤5**	— —	**2ТС393-9**
40...250 (1 В; 1 мА) 40...250 (1 В; 1 мА)	≤1,5 (5 В) ≤1,5 (5 В)	— —	0,8...1,25*; ≤1,5** 0,9...1,1*; ≤3**	≤50 ≤50	**2ТС398-1**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{К\,max}$, $P^{*}_{К,\,т\,max}$, $P^{**}_{К,\,и\,max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\,проб}$, $U^{*}_{КЭR\,проб}$, $U^{**}_{КЭО\,проб}$, В	$U_{ЭБО\,max}$, В	$I_{К\,max}$, $I^{*}_{К,\,и\,max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2ТС398А-94	n-p-n	-60...+100	30	≥1 ГГц	10	4	10	≤0,5
2ТС398Б-94	n-p-n	-60...+100	30	≥1 ГГц	10	4	10	≤0,5
2ТС613А	n-p-n	-60...+125	800 (50°C)	≥200	60	4	400 (800*)	≤8 (60 В)
2ТС613Б	n-p-n	-60...+125	800 (50°C)	≥200	60	4	400 (800*)	≤8 (60 В)
2ТС622А	p-n-p	-60...+125	0,4 (10**) Вт	≥200	45* (1к)	4	400 (600*)	≤10 (45 В)
2ТС622Б	p-n-p	-60...+125	0,4 (10**) Вт	≥200	35* (1к)	4	400 (600*)	≤20 (35 В)
2ТС622Б-1	p-n-p	-60...+125	0,4 Вт	≥200	45	4	400 (600*)	10
2Т670АС	n-p-n		800; 3200**	≥200	50; 40*(10к)	4	400; 800*	≤5 (50 В)

$h_{21э}$, $h^{*}_{21Э}$	C_k, $C^{*}_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^{*}_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ $h_{21э1}$ / $h^{*}_{21э2}$, $\Delta U^{**}_{эб}$, мВ	$\tau_к$, пс $t^{*}_{рас}$, нс $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
40...250 40...250	— —	— —	≤1,5** ≤3**	— —	**2ТС398-94**
25...100* (5 В; 0,2 А) 40...200* (5 В; 0,2 А)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В)	— —	— —	≤100* ≤100*	**2ТС613**
25...150* (5 В; 0,2 А) 25...150* (5 В; 0,2 А)	≤15 (10 В) ≤15 (10 В)	— —	— —	≤120* ≤200*	**2ТС622**
25...150*	15	—	—	—	**2ТС622Б-1**
40...200* (5 В; 0,2 А)	≤15 (10 В)	≤2,5; ≤5*	—	≤100*	**2Т670**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{K\ max}$, $P^{*}_{K,\ т\ max}$, $P^{**}_{K,\ и\ max}$, мВт	$f_{гр}$, $f^{*}_{h21б}$, $f^{**}_{h21э}$, f^{***}_{max}, МГц	$U_{КБО\ проб}$, $U^{*}_{КЭR\ проб}$, $U^{**}_{КЭО\ проб}$, В	$U_{ЭБО\ max}$, В	$I_{K\ max}$, $I^{*}_{K,\ и\ max}$, мА	$I_{КБО}$, $I^{*}_{КЭR}$, $I^{**}_{КЭО}$, мкА
2ТС687АС-2 **2ТС687БС-2**	p-n-p p-n-p		1,5 Вт 1,5 Вт	≥450 ≥450	60; 50* 70; 60*	3 3	1,5 А; 4,5*А 1,5 А; 3,5*А	— —
2Т689АС	p-n-p		400; 6000*	≥300	45	4	300; 600*	≤7 (45 В)
2ТС843А	n-p-n	-60...+125	25* Вт (100°С)	—	120	4	12 А (25* А), 3 А (6* А)	≤12 мА (120 В)
2ТС941А-2	p-n-p, n-p-n	-60...+125	5* Вт	≥300	60	4	800 (1500*)	≤5 мА (60 В)

$h_{21э}$, $h^*_{21Э}$	$C_к$, $C^*_{12э}$, пФ	$r_{КЭ\ нас}$, $r^*_{БЭ\ нас}$, Ом	$K_ш$, дБ, $h_{21э1}$ / $h^*_{21э2}$, $\Delta U^{**}_{эб}$, мВ	$\tau_к$, пс, $t^*_{рас}$, нс, $t^{**}_{выкл}$, нс	Корпус
≥10 (5 В; 3,5 А) ≥10 (5 В; 3,5 А)	— —	≤2,6 ≤3,3	— —	— —	**2ТС687-2**
50..150 (5 В; 80 мА)	≤20 (10 В)	≤4; ≤6*	—	≤90*	**2Т689АС**
10...50 (12 А; 5 В)	—	≤0,2	—	≤2* мкс	**2ТС843А**
40...150 (5 В; 0,1 А)	12 (28 В)	≤3,3	≥0,7	≤90; ≤500*	**2ТС941А-2**

Раздел 3
ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

3.1. Буквенные обозначения параметров полевых транзисторов

Буквенное обозначение		Параметр
отечественное	международное	
$I_{\text{З}}$	I_G	Ток затвора (постоянный).
$I_{\text{З отс}}$	I_{GSX}	Ток отсечки затвора.
$I_{\text{З пр}}$	I_{GF}	Прямой ток затвора.
$I_{\text{З ут}}$	I_{GSS}	Ток утечки затвора.
$I_{\text{ЗИО}}$	I_{GSO}	Обратный ток перехода затвор-исток.
$I_{\text{ЗСО}}$	I_{GDO}	Обратный ток перехода затвор-сток.
$I_{\text{И}}$	I_S	Ток истока (постоянный).
$I_{\text{И нач}}$	I_{SDS}	Начальный ток истока.
$I_{\text{И ост}}$	I_{SDX}	Остаточный ток истока.
$I_{\text{С}}$	I_D	Ток стока (постоянный).
$I_{\text{С нагр}}$	I_{DSR}	Ток стока при нагруженном затворе.
$I_{\text{С нач}}$	I_{DSS}	Начальный ток стока.
$I_{\text{С ост}}$	I_{DSX}	Остаточный ток стока.
$I_{\text{П}}$	I_B, I_U	Ток подложки.
$U_{\text{ЗИ}}$	U_{GS}	Напряжение затвор-исток (постоянное).
$U_{\text{ЗИ обр}}$	U_{GSR}	Обратное напряжение затвор-исток (постоянное).
$U_{\text{ЗИ отс}}$	$U_{GS(OFF)}$, $U_{GS(off)}$	Напряжение отсечки транзистора — напряжение между затвором и истоком (полевого транзистора с р-п-переходом и с изолированным затвором).
$U_{\text{ЗИ пор}}$	U_{GST}, $U_{GS(th)}$, $U_{GS(TO)}$	Пороговое напряжение транзистора — напряжение между затвором и истоком (у полевого транзистора с изолированным затвором).
$U_{\text{ЗИ пр}}$	U_{GSF}	Прямое напряжение затвор-исток (постоянное).
$U_{\text{З проб}}$	$U_{(BR)\ GSS}$	Пробивное напряжение затвора — напряжение пробоя затвор-исток при замкнутых стоке и истоке.
$U_{\text{ЗП}}$	U_{GB}, U_{GU}	Напряжение затвор-подложка (постоянное).
$U_{\text{ЗС}}$	U_{GD}	Напряжение затвор-сток (постоянное).
$U_{\text{ИП}}$	U_{SB}, U_{SU}	Напряжение исток-подложка (постоянное).
$U_{\text{СИ}}$	U_{DS}	Напряжение сток-исток (постоянное).
$U_{\text{СП}}$	U_{DB}, U_{DU}	Напряжение сток-подложка (постоянное).
$U_{\text{З1}}$-$U_{\text{З2}}$	U_{G1}-U_{G2} .	Напряжение затвор-затвор (для приборов с двумя затворами).
$P_{\text{СИ}}$	P_{DS}	Рассеиваемая мощность сток-исток (постоянная).
$P_{\text{СИ, т max}}$	—	Максимальная рассеиваемая мощность сток-исток с теплоотводом (постоянная).
S	g_{ms}	Крутизна характеристики.

Продолжение буквенных обозначений

Буквенное обозначение		Параметр
отечественное	международное	
$R_{ЗИ}$	r_{GS}, r_{gs}	Сопротивление затвор-исток.
$R_{ЗС}$	r_{GD}, r_{gd}	Сопротивление затвор-сток.
$R_{ЗСО}$	r_{GSS}, r_{gss}	Сопротивление затвора (при U_{DS} = 0 или U_{ds} = 0).
$R_{СИ}$	r_{DS}, r_{ds}	Сопротивление сток-исток.
$R_{СИ\ отк}$	$r_{DS(ON)}$, $r_{ds(on)}$, $r_{DS\ on}$	Сопротивление сток-исток в открытом состоянии — сопротивление между стоком и истоком в открытом состоянии транзистора при заданном напряжении сток-исток.
$R_{СИ\ закр}$	$r_{DS(OFF)}$, $r_{ds(off)}$, $r_{DS\ off}$	Сопротивление сток-исток в закрытом состоянии — сопротивление между стоком и истоком в закрытом состоянии транзистора при заданном напряжении сток-исток.
$C_{ЗИО}$	C_{gso}	Емкость затвор-исток — емкость между затвором и истоком при разомкнутых по переменному току остальных выводах.
$C_{ЗСО}$	C_{gdo}	Емкость затвор-сток — емкость между затвором и стоком при разомкнутых по переменному току остальных выводах.
$C_{СИО}$	C_{dso}	Емкость сток-исток — емкость между стоком и истоком при разомкнутых по переменному току остальных выводах.
$C_{11и}$, $C_{вх,\ и}$	C_{iss}, C_{11ss}	Входная емкость транзистора — емкость между затвором и истоком.
$C_{12и}$	C_{rss}, C_{12ss}	Емкость обратной связи в схеме с общим истоком при коротком замыкании на входе по переменному току.
$C_{22и}$	C_{oss}, C_{22ss}	Выходная емкость транзистора — емкость между стоком и истоком.
$C_{22с}$	C_{ods}, C_{22ds}	Выходная емкость в схеме с общим стоком при коротком замыкании на входе (при коротком замыкании цепи затвор-сток по переменному току).
$g_{11и}$	g_{iss}, g_{11s}	Активная составляющая входной проводимости транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на выходе).
$g_{22и}$	g_{oss}, g_{22s}	Активная составляющая выходной проводимости транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на входе).
$Y_{11и}$	Y_{is}, Y_{11s}	Полная входная проводимость транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на выходе).
$Y_{12и}$	Y_{rs}, Y_{12s}	Полная проводимость обратной передачи транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на входе).
$Y_{21и}$	Y_{fs}, Y_{21s}	Полная проводимость прямой передачи транзистора (в схеме с общим истоком при коротком замыкании на выходе; $Y_{fs} = g_{fs} + g_{bfs} = I_D/U_{GS}$; на НЧ $\|Y_{fs}\| = g_{fs}$).
$Y_{22и}$	Y_{os}, Y_{22s}	Полная выходная проводимость транзистора (при коротком замыкании на входе).
$K_{у.\ P}$	G_P	Коэффициент усиления по мощности.
$f_{Y21и}$	f_{Yfs}	Частота отсечки в схеме с общим истоком.
$E_{ш}$	U_n	Шумовое напряжение транзистора.
$K_{ш}$	F	Коэффициент шума транзистора.
—	α_{ID}	Температурный коэффициент тока стока.
—	α_{rds}	Температурный коэффициент сопротивления сток-исток.
$t_{вкл}$	t_{on}	Время включения транзистора.
$t_{выкл}$	t_{off}	Время выключения транзистора.
$t_{зд,вкл}$	$t_{d(on)}$	Время задержки включения.
$t_{зд,выкл}$	$t_{d(off)}$	Время задержки выключения.

Окончание буквенных обозначений

Буквенное обозначение		Параметр
отечественное	международное	
$t_{нр}$	t_r	Время нарастания.
$t_{сп}$	t_f	Время спада.
Для сдвоенных полевых транзисторов:		
$I_{З(ут)1}$-$I_{З(ут)2}$	I_{GSS1}-I_{GSS2}	Разность токов утечки затвора (для полевых транзисторов с изолированным затвором) и разность токов отсечки затвора (для полевых транзисторов с р-п-переходом).
$I_{С\ нач1}/I_{С\ нач2}$	I_{DSS1}/I_{DSS2}	Отношение токов стока при нулевом напряжении затвор-исток.
$U_{ЗИ1}$-$U_{ЗИ2}$	U_{GS1}-U_{GS2}	Разность напряжений затвор-исток.
$\|\Delta U_{ЗИ1}$-$U_{ЗИ2})\|/\Delta T$	$\|\Delta(U_{GS1}$-$U_{GS2})\|/\Delta T$	Изменение разности напряжений затвор-исток между двумя значениями температуры.
$g_{22и1}$-$g_{22и2}$	g_{os1}-g_{os2}	Разность выходных проводимостей в режиме малого сигнала в схеме с общим истоком.
$g_{21и1}/g_{21и2}$	g_{fs1}/g_{fs2}	Отношение полных проводимостей прямой передачи в режиме малого сигнала в схеме с общим истоком.

3.2. Параметры и характеристики полевых транзисторов

К полевым транзисторам относятся полупроводниковые приборы, принцип действия которых основан на использовании эффекта внешнего электрического поля для управления проводимостью транзистора. Такие транзисторы называются также униполярными, так как перенос тока в них осуществляется только одним типом носителя заряда: в n-канальных — электронами; в р-канальных — дырками (в отличие от биполярных транзисторов, где ток переносится двумя типами носителей — основными и неосновными, т. е. и дырками, и электронами).

Для управления током в униполярных транзисторах либо меняется концентрация носителей полупроводникового слоя, либо его площадь под действием электрического поля (эффект поля). Отсюда название «полевые транзисторы». Проводящий слой, по которому проходит ток, называют каналом (канальные транзисторы). Каналы могут быть приповерхностными (обогащенные слои из-за наличия доноров в диэлектрике, либо инверсионные слои, образующиеся под действием внешнего поля) или объемными (участки однородного полупроводника, отделенные от поверхности обедненным слоем).

Транзистор с приповерхностным слоем называют МОП-транзистором (металл—окисел—полупроводник). За рубежом его называют MOSFET. У транзисторов с объемным каналом обедненный слой создается с помощью р-п-перехода, поэтому их называют транзисторами с р-п-переходом (или просто полевыми), за рубежом — JFET.

Структуры полевых транзисторов приведены на рис. 3.1.

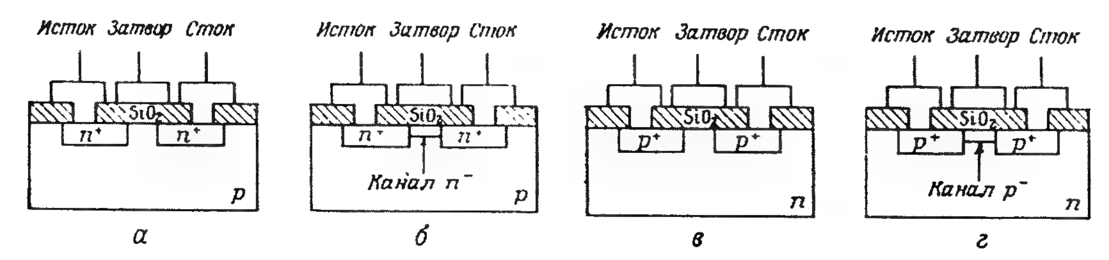


Рис. 3.1. Структуры МОП-транзисторов: *а* — *n*-канальная обогащенного типа; *б* — *n*-канальная обедненного типа; *в* — *р*-канальная обогащенного типа; *г* — *р*-канальная обедненного типа

Полевой транзистор с р-п-переходом состоит из полупроводниковой пластинки (стержня), которая образует канал, с омическими выводами от каждого ее конца (стока и истока) и на поверхности

которой с противоположных сторон формируется p-n-переход параллельно направлению тока, вывод от которого называется затвором — электродом, управляющим сопротивлением (движением зарядов) между стоком и истоком. Затвор отделен от канала между стоком и истоком p-n-переходом. Входной импеданс затвора является импедансом обратно смещенного p-n-перехода, что значительно ниже импеданса МОП-приборов.

Сопротивление между стоком и истоком изменяется с изменением напряжения на затворе.

Через запертый переход затвор-канал протекает ток утечки, который экспоненциально изменяется с температурой и который, проходя через резистор цепи затвора, может изменить напряжение смещения, если сопротивление резистора велико (особенно при высоких температурах). Этот эффект отсутствует у МОП-транзисторов. Их называют также транзисторами с изолированным затвором, так как у них затвор электрически изолирован от канала исток-сток тонким слоем диэлектрика: диэлектрическими пленками двуокиси кремния (SiO_2), нитрида кремния и окиси алюминия, поэтому они сохраняют высокое входное сопротивление независимо от величины и полярности $U_{ЗИ}$. Условия, возникающие на поверхности раздела Si-SiO_2 таковы, что все приборы с каналом n-типа в исходном состоянии, т. е. при $U_{ЗИ} = 0$ открыты, а с каналом p-типа закрыты.

Каждый МОП-транзистор состоит из подложки, двух противоположно легированных подложке областей (истока и стока) и металлического затвора, лежащего сверху над тонким слоем окисла. Напряжение затвора регулирует движение зарядов в канале между истоком и стоком.

Слой диэлектрика тонкий, поэтому при подаче напряжения на затвор в нем возникает сильное электрическое поле, которое вызывает образование инверсионного слоя (поверхностный канал), где основными носителями являются электроны в p-подложке. Падение напряжения между затвором и подложкой в основном происходит в диэлектрике, и направление поля вызывает увеличение инверсионного слоя. На границе раздела образуется поверхностный заряд. Когда $U_З > 0$, поле притягивает электроны (неосновные носители материала p-типа) и появляется отрицательный заряд. Образуется обедненный слой (неподвижные ионы акцепторов). Если $U_З > 0$, то происходит обогащение первоначального инверсионного слоя (увеличивается концентрация электронов на поверхности), если $U_З < 0$, то происходит его обеднение (концентрация электронов у поверхности ниже, чем в объеме, так как они отталкиваются от поверхности).

В режиме инверсии приповерхностный слой кремния отличается от его объема типом электропроводности. В режиме обеднения концентрация дырок будет превышать концентрацию электронов, т. е. тип электропроводности слоя изменится на противоположный (произойдет инверсия типа проводимости).

Потенциал затвора изменяет ширину канала (концентрацию электронов), т. е. образуется канал с регулируемой электронной проводимостью (она увеличивается при увеличении $U_З$).

В зависимости от типа исходного материала полевые транзисторы имеют каналы n-типа или p-типа. Например, nМОП-транзисторы имеют электронную проводимость (носители зарядов — электроны), а pМОП-транзисторы — дырочную проводимость (носители зарядов — дырки). У n-канальных приборов ток канала тем меньше, чем меньше потенциал затвора, а к выводу истока прикладывается больший отрицательный потенциал, чем к выводу стока (т. е. полярность напряжения стока положительная), а у p-канальных — наоборот.

Таким образом существуют два основных режима работы: обеднения (проводимость канала может быть увеличена или уменьшена в зависимости от полярности приложенного напряжения $U_{ЗИ}$) и обогащения. У транзисторов обедненного типа при напряжении на затворе $U_{ЗИ} = 0$ протекает небольшой ток, а транзисторы обогащенного типа закрыты при значениях $U_{ЗИ}$, близких к нулю. Такие приборы соответственно называются нормально открытыми и нормально закрытыми. В частности, полевые транзисторы с управляющим p-n-переходом (с диффузионным каналом) являются нормально открытыми: они закрываются (т. е. ток стока имеет минимальное значение) при определенном напряжении, называемом напряжением отсечки — это такое напряжение $U_{ЗИ}$, которое необходимо, чтобы уменьшить ток стока $I_С$ от $I_{Снач}$ до 0.

По конструктивно-технологическим признакам полевые приборы делятся на транзисторы с встроенным каналом и транзисторы с индуцированным каналом. Встроенный канал создается технологически путем, а индуцированный канал наводится в поверхностном слое полупроводника в результате воздействия поперечного электрического поля.

В транзисторах со встроенным каналом (например, КП305, КП313) уменьшение тока на выходе вызывается подачей напряжения на затвор с полярностью, соответствующей знаку носителей заряда в канале (для p-канала $U_{ЗИ} > 0$, для n-канала $U_{ЗИ} < 0$), что вызывает обеднение канала носителями

заряда и ток Iс уменьшается. При соответствующем изменении полярности напряжения на затворе произойдет обогащение канала носителями и выходной ток Iс увеличится. Такие приборы могут работать при обеих полярностях Uзи как в режимах обеднения, так и обогащения. Для них вводится понятие «пороговое напряжение» (напряжение открывания). Это такое Uз, при котором электроны равновесного инверсионного слоя отталкиваются от поверхности и встроенный канал исчезает (концентрация электронов в слое под окислом затвора становится равной концентрации дырок в объеме кремния).

В транзисторах с индуцированным каналом, имеющих наибольшее распространение, при напряжении Uз = 0 канал отсутствует и только при Uз, равном пороговому напряжению, образуется (индуцируется) канал. Такие приборы работают только в режиме обогащения (нормально закрытый прибор) при одной полярности Uзи.

В полевых транзисторах с управляющим p-n-переходом канал существует при Uз = 0, т. е. они имеют встроенный канал, но могут работать только в режиме обеднения носителями заряда (нормально открытый прибор). У приборов обедненного типа канал имеет тот же тип проводимости, что и сток с истоком, у приборов обогащенного типа канал легирован противоположной примесью по отношению к стоку и истоку.

На рис. 3.2, 3.3, 3.4 приведены выходные вольт-амперные характеристики (ВАХ) полевых транзисторов (зависимость тока стока Iс от напряжения на стоке Uс) при различных напряжениях на затворе Uз). Они напоминают характеристики усилительных пентодов.

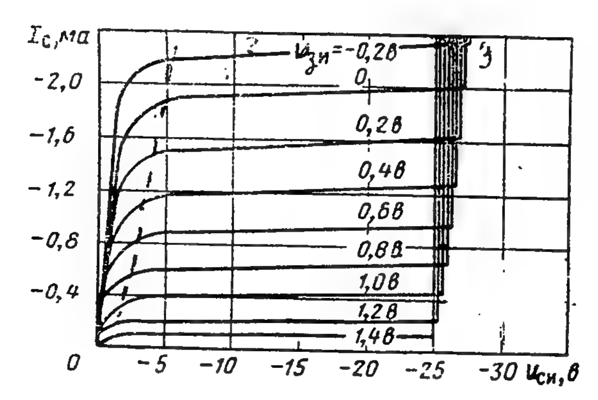


Рис. 3.2. Стоковые характеристики схемы с общим истоком (с p-n-переходом)

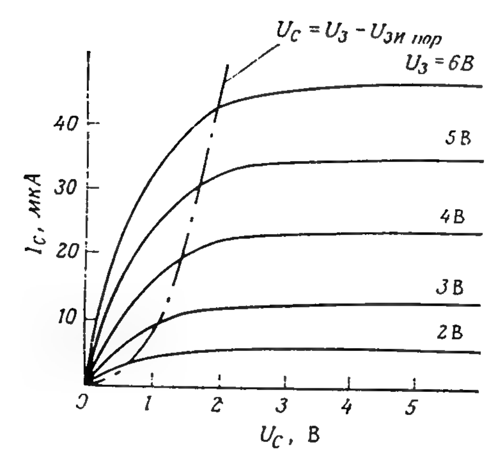


Рис. 3.3. Типичные вольт-амперные характеристики n-канального МОП-транзистора обогащенного типа

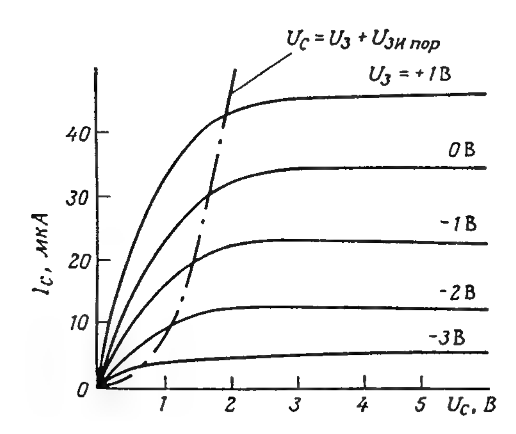


Рис. 3.4. Типичные вольт-амперные характеристики n-канального МОП-транзистора обедненного типа

Ток Iс зависит как от величины, так и полярности напряжений Uси и Uзи. Из ВАХ следует, что при изменении Uзи ток Iс сначала линейно возрастает (линейная область), затем выходит на пологий участок (область насыщения) и затем резко возрастает (область пробоя) (см. рис. 3.2).

В линейной области при $U_C < U_{ОТС}$ проводимость между истоком и стоком является функцией $U_{ЗИ}$ (с изменением $U_{ЗИ}$ изменяется проводимость канала). В области насыщения, если $U_C > U_{ОТС}$, транзистор входит в режим насыщения (канал перекрывается), причем для каждого $U_{ЗИ}$ насыщение будет происходить при разном U_C. При увеличении $|U_{ЗИ}| < 0$ ток I_C падает. В области пробоя при увеличении U_C ток резко возрастает из-за лавинного пробоя обратно смещенного диода стока.

Проходные (передаточные) ВАХ (зависимость тока стока от напряжения на затворе при неизменном напряжении на стоке) полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом и МОП-транзисторов с каналами n- и p-типов проводимости приведены на рис. 3.5, 3.6.

В отличие от транзисторов с управляющим p-n-переходом, у которых рабочая область составляет от 0 вольт до запирания $U_{ЗИотс}$, МОП-транзисторы сохраняют высокое входное сопротивление при любых значениях напряжения на затворе, которое ограничено напряжением пробоя изолятора затвора.

При графических обозначениях транзисторы с индуцированным каналом (у них при $U_{ЗИ} = 0$, $I_c = 0$) имеют пунктирную линию в обозначении канала, а со встроенным каналом (у них при $U_{ЗИ} = 0$ течет ток $I_{Снач}$) — сплошную (рис. 3.6, *б*); стрелки определяют тип канала: направлена к каналу — канал n-типа, от канала — канал p-типа.

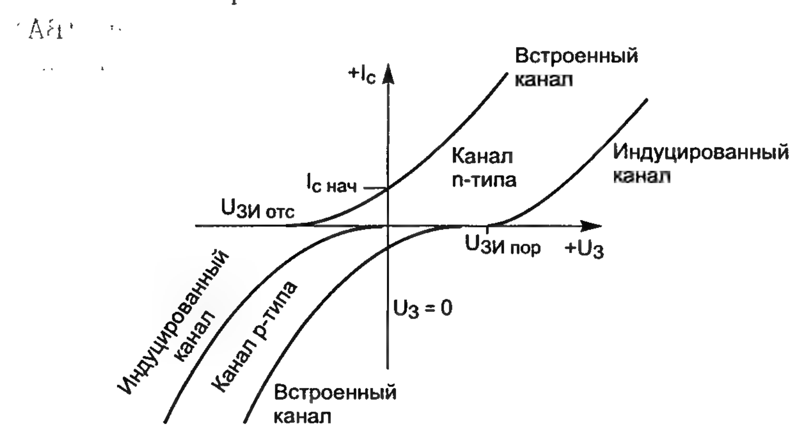


Рис. 3.5. Квадратичные передаточные характеристики МОП-транзисторов

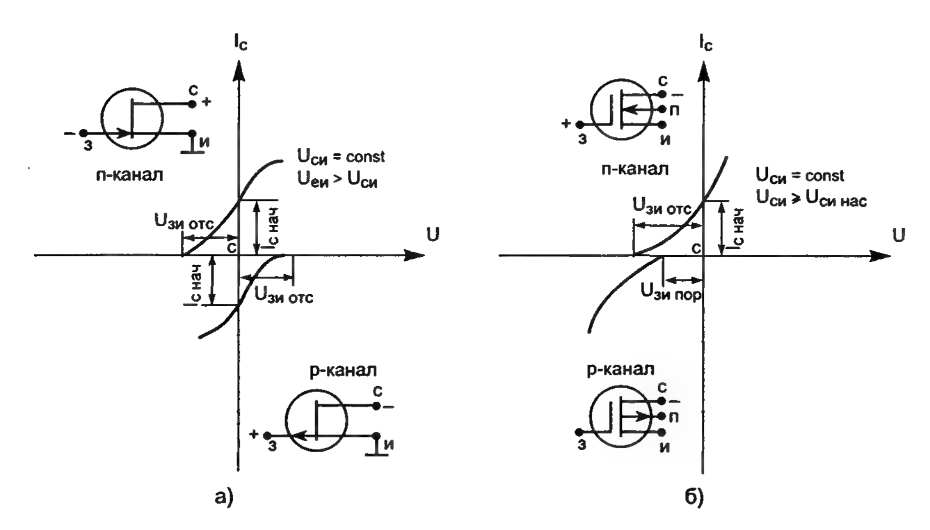


Рис. 3.6. Передаточные характеристики полевых транзисторов: *а* — с *n*-каналом и *p*-каналом и их условные графические обозначения; *б* — передаточные характеристики МОП-транзисторов с встроенным каналом (с обеднением) с *n*-каналом и *p*-каналом и их условные графические обозначения

В МОП-транзисторах иногда делается четвертый вывод (кроме выводов истока, стока и затвора) от подложки, которая, как и затвор, может выполнять управляющие функции, но от канала она отделена только p-n-переходом. Обычно вывод подложки соединяется с выводом истока. Если же требуется иметь два управляющих электрода, то используются МОП-транзисторы с двумя затворами (МОП-тетроды — КП322, КП327, КП346, КП350). Они имеют малую емкость обратной связи, не тре-

буют цепей нейтрализации и более устойчивы к паразитным колебаниям. Транзистор КП306 имеет нормированную квадратичность переходной характеристики менее 2,5 В при ослаблении комбинированных составляющих третьего порядка не менее 80 дБ.

Слой окисла между затвором и подложкой очень тонкий, поэтому МОП-транзисторы чувствительны к действию статического электричества, которое может привести их к пробою. Для их защиты между затворами и подложкой иногда включают защитные диоды (стабилитроны). МОП-транзисторы имеют более высокий коэффициент шума на низких частотах по сравнению с полевыми транзисторами с p-n-переходом, поэтому они используются в малошумящих усилителях на высоких частотах.

Среди мощных полевых транзисторов с управляющим p-n-переходом необходимо отметить **биполярные транзисторы со статической индукцией (БСИТ)** с вертикальным нормально закрытым каналом, например, КП801, КП810. Они имеют выходные характеристики (рис. 3.7), подобные ламповому триоду: хорошие параметры переключения и линейность; в области токов, используемых в усилителях звуковой частоты, у них отсутствует тепловая нестабильность, так как при больших токах стока температурный коэффициент имеет отрицательное значение; низкий уровень шумов; низкое выходное сопротивление, что хорошо согласуется энергетически с низкоомной нагрузкой; они имеют более высокий коэффициент усиления, низкое напряжение насыщения и устойчивость ко второму пробою по сравнению с биполярными транзисторами.

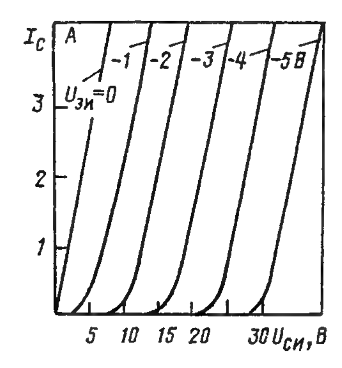


Рис. 3.7. Выходные вольт-амперные характеристики (ВАХ) БСИТ

Схемы включения БСИТ аналогичны схемам включения биполярных транзисторов.

ВАХ биполярного транзистора со статической индукцией (БСИТ) не имеет области насыщения тока стока (без пологой части), т. е. $R_{вых}$ очень маленькое, что повышает энергетические показатели линейных усилителей мощности. У него, если $U_З = 0$, то сопротивление канала минимально (БСИТ — нормально открытый транзистор) и с ростом $U_{СИ}$ ток $I_С$ увеличивается, но его ограничения не наступает. Выходные ВАХ при малых токах $I_С$ приближенно описываются экспонентой. При больших токах $I_С$ выходные ВАХ приближаются к линейной. $R_{вых}$ у них меньше, чем у МОП-типа, что обеспечивает хорошее согласование с низкоомной нагрузкой и повышает КПД усилителя; динамический диапазон шире, что снижает нелинейные искажения, рабочая температура выше.

Биполярный транзистор с изолированным затвором (БТИЗ), например КП730, КЕ702, представляет собой p-n-p транзистор, управляемый низковольтным МОП-транзистором с индуцированным каналом (рис. 3.8, 3.9) и объединяет в себе достоинства как биполярных (малое падение напряжения в открытом состоянии, высокие коммутируемые напряжения), так и МОП-транзисторов (малая мощность управления, высокие скорости коммутации), потери у него растут пропорционально току, а не квадрату тока, как у полевых транзисторов. По быстродействию уступает МОП-транзисторам, но превосходит биполярные. Остаточное напряжение у них слабо зависит от температуры. На рис. 3.10 представлена ВАХ БТИЗ.

Усилительные свойства БТИЗ характеризуются крутизной S, которая определяется усилительными свойствами МОП- и биполярного транзисторов в структуре. Значение S для БТИЗ (зарубежное название IGBT) более высокое по сравнению с биполярными и МОП-транзисторами.

БТИЗ применяются в высоковольтных силовых преобразователях, для управления маломощными приводами для регулирования скорости вращения, в стиральных машинах, инверторных кондиционерах, в качестве высоковольтных ключей для электронного зажигания автомобилей, импульсных блоках питания.

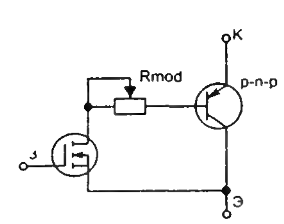


Рис. 3.8. Эквивалентная схема БТИЗ-транзистора

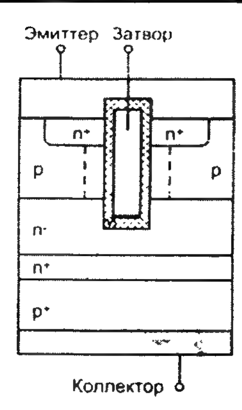


Рис. 3.9. Структура БТИЗ-транзистора

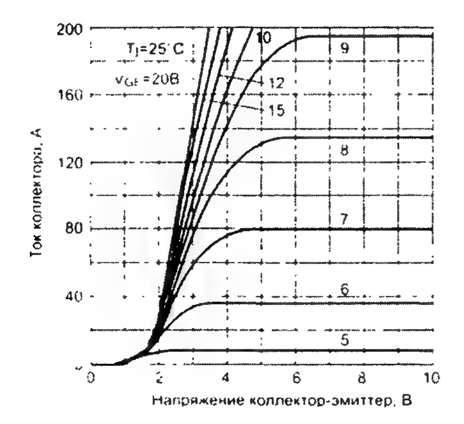


Рис. 3.10. Выходные вольт-амперные характеристики БТИЗ-транзистора

Эксплуатационным недостатком БСИТ является эффект «защелки», который связан с наличием триггерной схемы, образованной биполярной частью структуры и паразитным n-p-n транзистором, который при определенных условиях работы, открывается, триггер опрокидывается, происходит защелкивание и лавинообразный выход прибора из строя.

Для ограничения тока короткого замыкания при аварийном режиме рекомендуется включение между затвором и эмиттером параллельно цепи затвор-эмиттер последовательно соединенных диода Шоттки и конденсатора, заряженного до напряжения +15...16 В. Допускается применение в качестве защитного элемента стабилитрона на напряжение 15...16 В.

Максимально допустимое напряжение затвор-эмиттер не должно превышать +20 В, чтобы исключить пробой изоляции затвора. Не рекомендуется работа БТИЗ-транзистора и при «подвешенном» затворе, так как в противном случае возможно ложное включение прибора.

С целью снижения динамических потерь и увеличения частоты коммутации необходимо обеспечить малое время переключения прибора (100...10000 нс). Необходимо также уменьшать отрицательную обратную связь, которая может возникнуть из-за индуктивности слишком длинного соединительного проводника к эмиттеру прибора.

Монтажные работы с БТИЗ необходимо производить при наличии антистатического браслета, а непосредственно в схеме необходимо параллельно цепи затвор-эмиттер подключить резистор сопротивлением 10...20 кОм.

Необходимо отметить, что МОП-транзисторы в ряде применений предпочтительнее биполярных. Управляющая цепь у них потребляет ничтожную энергию, так как входное сопротивление велико (до 10^{17} Ом). Усиление мощности и тока в МОП-транзисторах много больше, чем в биполярных. Из-за того, что управляющая цепь изолирована от выходной цепи, значительно повышаются надежность работы и помехоустойчивость схем на МОП-транзисторах. Они имеют низкий уровень собственных шумов, что связано с отсутствием инжекции и свойственных ей флюктуации, обладают более высоким собственным быстродействием, так как в них нет инерционных процессов накопления и рассасывания носителей заряда.

МОП-транзисторы имеют и недостатки: вследствие относительно высокого сопротивления канала в открытом состоянии падение напряжения на открытом МОП-транзисторе заметно больше, чем падение напряжения на насыщенном биполярном транзисторе, температурная зависимость сопротивления канала сильнее, чем зависимость от температуры напряжения насыщения биполярного транзистора (сопротивление канала открытого МОП-транзистора в диапазоне температур 25...150 °С увеличивается в 2 раза, а напряжение насыщения биполярного транзистора – примерно в 1,5 раза). МОП-транзисторы имеют существенно меньшее значение предельной температуры структуры $T_{п\,max}$, равное 150 °С (для кремниевых биполярных транзисторов $T_{п\,max}$ = 200 °С), что ограничивает их применение в режимах эксплуатации с повышенной температурой окружающей среды (около 100 °С).

Преимущества применения мощных полевых транзисторов в выходных каскадах усилителей звуковой частоты (усилителях мощности):

- простота управления, так как для управления мощным полевым транзистором требуется ничтожный по мощности сигнал;
- высокая линейность передаточных характеристик полевых транзисторов, что позволяет существенно снизить уровень нелинейных искажений;
- крутизна мощных полевых транзисторов $S = \Delta I_C / \Delta U_{ЗИ}$ при U_C = const – основной параметр усилительного режима эксплуатации практически не зависит от мощности выходного сигнала.

Однако пороговое напряжение МОП-транзисторов зависит от температуры:

$$U_{ЗИпор}\,(T_{окр}) = U_{ЗИпор}\,(20\,°C) - TKU_{ЗИпор} \cdot \Delta T,$$

где $TKU_{ЗИпор}$ — температурный коэффициент порогового напряжения, равный (–5...–10) мВ/°С (при сильном увеличении температуры МОП-транзистор превращается в прибор с встроенным каналом), что нежелательно для двухтактных усилителей.

3.3. Назначение отдельных типов полевых транзисторов

АП320 (А-2, Б-2) — бескорпусные на керамическом кристаллодержателе арсенидгаллиевые планарные с барьером Шотки полевые транзисторы с каналом n-типа. Предназначены для применения в малошумящих СВЧ усилителях ($K_ш \le$ 4,5...6 дБ на 8 ГГц, $K_{у,р} \ge$ 3 дБ) в составе ГИС. Диапазон рабочих температур окружающей среды –60...+85 °С.

АП325А-2 — бескорпусные на керамическом кристаллодержателе арсенид-галлиевые планарные с барьером Шотки полевые транзисторы с каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах малошумящих СВЧ усилителей ($K_ш \le$ 2 дБ на 8 ГГц) в составе ГИС.

АП328А-2 — бескорпусные на керамическом кристаллодержателе арсенид-галлиевые планарные с барьером Шотки полевые транзисторы с двумя затворами и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах малошумящих СВЧ усилителей ($K_ш \le$ 4,5 дБ на 8 ГГц, $K_{у,р} \ge$ 9 дБ) в составе ГИС.

АП362А9 — арсенид-галлиевые полевые транзисторы с каналом n-типа в корпусе для поверхностного монтажа. Предназначены для применения в малошумящих усилительных и преобразовательных СВЧ устройствах. Диапазон рабочих температур окружающей среды –60...+70 °С.

АП379А9 — арсенид-галлиевые полевые транзисторы с двумя затворами и каналом n-типа в корпусе для поверхностного монтажа. Предназначены для применения в приемно-усилительных телевизионных устройствах (включая спутниковое телевидение) на частотах 100...2000 МГц. Диапазон рабочих температур окружающей среды –60...+70 °С.

АП602(А-2—Д-2) — бескорпусные на керамическом кристаллодержателе арсенид-галлиевые эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с барьером Шотки и каналом n-типа. Предназначены для применения в усилителях мощности, генераторах и преобразователях частоты в диапазоне частот 3...12 ГГц в герметизированной аппаратуре. Диапазон рабочих температур окружающей среды –60...+85 °С.

АП603 — арсенид-галлиевые эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с барьером Шотки и каналом n-типа. Предназначены для применения в усилителях мощности, автогенераторах, преобразователях частоты в составе ГИС с напряжением питания 8 В и на частотах до 12 ГГц.

АП605 — бескорпусные на керамическом кристаллодержателе арсенид-галлиевые планарные полевые транзисторы с барьером Шотки и каналом n-типа. Предназначены для применения в малошумящих СВЧ усилителях в составе ГИС. Диапазон рабочих температур окружающей среды –60...+85 °С.

АП606 — арсенид-галлиевые планарные полевые транзисторы с барьером Шотки и каналом n-типа. Предназначены для применения в усилителях мощности, автогенераторах и преобразователях частоты до 12 ГГц в составе ГИС с напряжением питания 8 В.

АП608 — арсенид-галлиевые планарные полевые транзисторы с барьером Шотки и каналом n-типа. Предназначены для применения в выходных каскадах СВЧ усилителей и генераторов в составе ГИС с напряжением питания 7 В в диапазоне частот до 26 и 37 ГГц.

АП967 — арсенид-галлиевые полевые транзисторы с барьером Шотки и каналом n-типа с внутренними цепями согласования. Предназначены для применения в широкополосных СВЧ усилителях мощности в составе ГИС с напряжением питания 8 В.

КП101(Г—Е) — малошумящие диффузионно-планарные (ДП) полевые транзисторы с затвором на основе p-n перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды −45...+85 °С.

КП103(Е—М) — малошумящие диффузионно-планарные полевые транзисторы с затвором на основе p-n перехода и каналом p-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды −55...+85 °С.

КП201(Е-1—Л-1) — бескорпусные (с гибкими выводами) малошумящие диффузионно-планарные полевые транзисторы с затвором на основе p-n-перехода и каналом p-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением в составе гибридных интегральных микросхем. Диапазон рабочих температур окружающей среды −40...+85 °С.

КП202(Д-1—Е-1) — бескорпусные (с гибкими выводами) малошумящие эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с затвором на основе p-n-перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением в составе гибридных интегральных микросхем. Диапазон рабочих температур окружающей среды −40...+85 °С.

КП301(Б—Г) — малошумящие планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом p-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей и нелинейных малосигнальных каскадах с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды −45...+70 °С.

КП302(А—Г, АМ—ГМ) — высокочастотные малошумящие планарные полевые транзисторы с затвором на основе p-n-перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения в широкополосных усилителях на частотах до 150 МГц, в переключающих и коммутирующих устройствах. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+100 °С.

КП303(А—И) — высокочастотные малошумящие эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с затвором на основе p-n-перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей с высоким входным сопротивлением (КП303Г — в зарядочувствительных усилителях и других устройствах ядерной спектрометрии). Диапазон рабочих температур окружающей среды −40...+85 °С.

КП304А — диффузионно-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом p-типа. Предназначены для применения в переключающих и усилительных каскадах с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды −45...+85 °С.

КП305(Д—И) — высокочастотные малошумящие диффузионно-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом n-типа. Предназначены для применения в усилителях высокой и низкой частот с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+125 °С.

КП306(А—В) — малошумящие СВЧ диффузионно-планарные полевые транзисторы с двумя изолированными затворами и каналом n-типа. Предназначены для применения в преобразовательных и усилительных каскадах с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+125 °С.

КП307(А—Ж) — малошумящие эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с затвором на основе p-n-перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей высокой и низкой частот с высоким входным сопротивлением (КП307Ж — в зарядочувствительных усилителях и устройствах ядерной спектроскопии). Диапазон рабочих температур окружающей среды −40...+85 °С.

КП308(А—Д) — бескорпусные (с гибкими выводами) малошумящие эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с затвором на основе p-n перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения: КП308(А—В) — во входных каскадах усилителей низкой частоты и постоянного тока; КП308(Г—Д) — в коммутаторах, переключающих устройствах с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+85 °С.

КП310(А, Б) — малошумящие СВЧ диффузионно-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом n-типа. Предназначены для применения в приемно-передающих устройствах СВЧ диапазона. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+125 °С.

КП312(А, Б) — малошумящие СВЧ эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с затвором на основе p-n перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных усилителях и преобразовательных каскадах СВЧ диапазона. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+100 °С.

КП313(А—В) — малошумящие СВЧ диффузионно-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом n-типа. Предназначены для применения в усилительных каскадах с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды −45...+85 °С.

КП314А — малошумящие планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с затвором на основе p-n-перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения в охлаждаемых каскадах предварительных усилителей устройств ядерной спектрометрии. Диапазон рабочих температур окружающей среды −170...+85 °С.

КП322А — малошумящие планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с двумя затворами на основе p-n-перехода и каналом n-типа. Предназначены для работы в усилительных и смесительных каскадах высокочастотного диапазона. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+85 °С.

КП323(А-2, Б-2) — бескорпусные (на керамическом кристаллодержателе) с полосковыми выводами и приклеиваемой керамической крышкой эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с затвором на основе p-n-перехода и каналом n-типа. Предназначены для работы в малошумящих усилительных каскадах на частотах до 400 МГц. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+70 °С.

КП327(А—Г) — кремниевые планарные полевые транзисторы с двумя изолированными затворами (МДП-тетрод), защитными диодами и каналом n-типа. Предназначены для работы в селекторах телевизоров метрового и дециметрового диапазонов для улучшения чувствительности, избирательности и глубины регулирования сигналов с малыми перекрестными искажениями. Диапазон рабочих температур окружающей среды −45...+85 °С.

КП329(А, Б) — высокочастотные малошумящие полевые транзисторы на основе p-n перехода с каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей на частотах до 200 МГц и в переключательных и коммутирующих устройствах с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+100 °С.

КП341(А, Б) — малошумящие планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы на основе p-n-перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+125 °С.

КП346(А9, Б9) — малошумящие СВЧ планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с двумя изолированными затворами и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей. Транзисторы имеют корпус КТ-48, предназначенный для поверхностного монтажа. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+85 °С.

КП347А2 — малошумящий полевой транзистор МОП-типа с двумя изолированными затворами, двумя защитными диодами и каналом n-типа. Предназначен для работы во входных каскадах радиоприемников в составе ГИС. Диапазон рабочих температур окружающей среды −45...+85 °С.

КП350(А—В) — диффузионно-планарные полевые транзисторы с двумя изолированными затворами и каналом n-типа. Предназначены для применения в усилительных, генераторных и преобразовательных каскадах СВЧ (на частотах до 700 МГц). Диапазон рабочих температур окружающей среды −45...+85 °С.

КП401(АС, БС) — сборка из двух комплементарных пар эпитаксиально-планарных МДП-транзисторов (1-й и 3-й транзисторы с n-каналом; 2-й и 4-й транзисторы с p-каналом). Предназначены для работы в переключающих и импульсных устройствах Диапазон рабочих температур окружающей среды −45...+85 °С.

КП402А — полевой ДМОП-транзистор с каналом p-типа. Предназначен для работы в высоковольтных усилителях. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+70 °С.

КП403А — полевой ДМОП-транзистор с каналом n-типа. Предназначен для работы в высоковольтных усилителях. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+70 °С.

КП601(А, Б) — сверхвысокочастотные малошумящие средней мощности планарные полевые транзисторы с затвором на основе p-n-перехода и каналом n-типа. Предназначены для работы во входных и выходных каскадах усилителей, генераторах и преобразователях высокой частоты. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+85 °С.

КП704(А, Б) — эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом n-типа. Предназначены для применения во вторичных источниках электропитания, в выходных каскадах графических дисплеев и быстродействующих импульсных устройствах. Диапазон рабочих температур окружающей среды −45...+85 °С.

КП705(А-В) — мощные МДП-полевые транзисторы с вертикальной структурой и каналом n-типа. Предназначены для работы в переключающих и импульсных устройствах, вторичных источниках электропитания. Диапазон рабочих температур окружающей среды −40...+85 °С.

КП707(А-В) — мощные планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом n-типа. Предназначены для применения в переключающих устройствах, импульсных и непрерывных вторичных источниках электропитания и схемах управления электродвигателями. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+100 °С.

КП709(А, Б) — мощные эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом n-типа. Предназначены для применения в импульсных и переключательных устройствах, импульсных вторичных источниках электропитания телевизоров и схемах управления электродвигателями. Диапазон рабочих температур окружающей среды −45...+100 °С.

КП712(А—В) — мощные эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом p-типа. Предназначены для применения в импульсных и переключательных устройствах. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+100 °С.

КП734 и **КП735** — полевые nМОП-транзисторы, предназначены для применения в устройствах автомобильной электроники и других схемах с низким уровнем питания, где требуется быстрое переключение, низкие потери мощности в линии и устойчивость к переходным процессам.

КП759, **КП760**, **КП761** — полевые транзисторы, предназначены для применения в устройствах, где уровень мощности рассеяния достигает 50 Вт. Все транзисторы имеют внутренний диод между истоком и стоком для подавления воздействий переходного процесса.

КП759, **КП760**, **КП761** — полевые транзисторы имеют нормированное значение энергии однократного и повторяющегося лавинного пробоя (соответственно 210 и 5 мДж, 280 и 7,4 мДж, 510 и 13 мДж), пиковое значение скорости восстановления защитного диода 3,5 В/нс, ток лавинного пробоя (2,5, 4,5 и 8 А соответственно), суммарный заряд затвора (соответственно 24, 38 и 60 нКл), а также внутренние индуктивности стока и истока (4,5 и 7,5 нГн). Конструктивно эти транзисторы изготавливаются в корпусном и бескорпусном исполнениях.

КП814 — полевые транзисторы, предназначены для работы в переключающих устройствах, ключевых стабилизаторах, преобразователях напряжения.

КП523, **КП731**, **КП(739—753)**, **КП(775—781)**, **КП(783—787)** — полевые транзисторы, предназначены для применения в усилительных, импульсных и переключательных схемах, источниках электропитания, схемах управления электродвигателями и выходных каскадах графических дисплеев.

КП7130(А, А2, А9) — полевые ДМОП транзисторы со встроенным обратным диодом, предназначены для применения в источниках электропитания, электросварочном оборудовании, в стиральных машинах и пылесосах, в схемах управления электродвигателями, имеют возможность параллельного включения и стойкость к статическому электричеству (1 кВ).

КП7132(А, Б и А9, Б9), **КП7150(А, А2, А9)** — полевые ДМОП транзисторы со встроенным обратным диодом и **КП7132(А1, Б1 и А91, Б91)** со встроенным обратным диодом и стабилитронами защиты предназначены для применения в источниках электропитания аппаратуры связи, управления, светотехнике, автомобильной электронике, системах внутреннего и автономного электроснабжения в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве, в аппаратуре управления и защиты.

КП7133(А, А9) — полевые ДМОП транзисторы со встроенным обратным диодом, применяются, кроме указанных для КП7132 областей, в преобразователях напряжения DC—DC, в высокочастотных преобразователях.

КП7138(А, А9, А91) — полевые ДМОП транзисторы со встроенным обратным диодом применяются в источниках электропитания, бытовой технике, осветительных приборах, схемах управления электродвигателями.

КП801(А—Г) — мощные эпитаксиально-планарные со статической индукцией транзисторы (СИТ) с затвором на основе p-n перехода и каналом n-типа. Имеют характеристики, подобные ламповому триоду. Предназначены для работы в выходных каскадах усилителей звуковоспроизводящей аппаратуры. По сравнению с МДП-транзисторами СИТ характеризуются более высокой линейностью, крутизной и низким сопротивлением насыщения. Диапазон рабочих температур окружающей среды −40...+85 °С.

КП802(А, Б) — мощные высоковольтные эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с каналом n-типа. Предназначены для работы в преобразователях постоянного напряжения, ключевых и линейных устройствах. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+85 °С.

КП804А — эпитаксиально-планарный полевой транзистор с изолированным затвором и каналом n-типа. Предназначен для применения в быстродействующих импульсных и переключательных устройствах. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+85 °С.

КП805(А—В) — мощные МДП-полевые транзисторы с каналом n-типа. Предназначены для применения в импульсных вторичных источниках электропитания. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+85 °С.

КП901(А, Б) — мощные планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом n-типа. Предназначены для работы в усилительных и генераторных каскадах в диапазоне коротких и ультракоротких длин волн. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+125 °С.

КП902(А—В) — мощные планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом n-типа. Предназначены для работы в приемно-передающих устройствах на частотах до 400 МГц. Диапазон рабочих температур окружающей среды −45...+85 °С.

КП903(А—В) — мощные планарно-эпитаксиальные транзисторы с затвором на основе p-n перехода и каналом n-типа. Предназначены для работы в приемно-передающих устройствах на частотах до 30 МГц. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+100 °С.

КП904(А, Б) — мощные планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом n-типа. Предназначены для работы в усилительных, преобразовательных и генераторных каскадах в диапазонах коротких и ультракоротких волн. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+125 °С.

КП905(А, Б) — мощные СВЧ планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом n-типа. Предназначены для работы в усилительных и генераторных каскадах на частотах до 1,5 ГГц. Диапазон рабочих температур окружающей среды −40...+85 °С.

КП907(А, Б) — мощные СВЧ полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом n-типа. Предназначены для работы в усилительных и генераторных каскадах на частотах до 1,5 ГГц. Диапазон рабочих температур окружающей среды −40...+85 °С.

КП908(А, Б) — планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом n-типа. Предназначены для применения в СВЧ усилителях и генераторах в диапазоне частот до 2,25 ГГц и быстродействующих переключательных устройствах наносекундного диапазона. Диапазон рабочих температур окружающей среды −40...+85 °С.

КП921А — мощный эпитаксиально-планарный полевой транзистор с изолированным затвором и индуцированным каналом n-типа. Предназначен для применения в быстродействующих переключающих устройствах. Диапазон рабочих температур окружающей среды −45...+85 °С.

КП923(А—Г) — мощные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом n-типа. Предназначены для применения в СВЧ усилителях и генераторах с выходной мощностью 17...50 Вт на частоте 1 ГГц.

КП928(А, Б) — мощные генераторные СВЧ эпитаксиально-планарные полевые МДП-транзисторы. Предназначены для работы в генераторах и усилителях мощности сигналов на частотах до 400 МГц, а также в импульсных и быстродействующих переключающих устройствах. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+125 °С.

КП937(А, А-5) — мощные планарные полевые транзисторы с p-n переходом и вертикальным каналом n-типа. Предназначена для применения во вторичных источниках электропитания, преобразователях напряжения, импульсных генераторах. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+125 °С.

КП938(А—Д) — мощные эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с p-n-переходом и вертикальным каналом n-типа. Предназначены для применения в импульсных вторичных источниках электропитания, схемах управления электродвигателями, в мощных коммутаторах и усилителях низкой частоты. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+125 °С.

КП944(А, Б) — мощные эпитаксиально-планарные МДП-транзисторы с каналом p-типа. Предназначены для применения в схемах управления накопителями ЭВМ на жестких и гибких магнитных дисках. Диапазон рабочих температур окружающей среды −45...+85 °С.

КП945(А, Б) — мощные МДП-транзисторы с каналом n-типа. Предназначены для применения в импульсных и переключательных схемах.

КП951(А2—В2) — бескорпусные на металлокерамическом держателе мощные эпитаксиально-планарные полевые транзисторы с изолированным затвором и каналом n-типа. Предназначены для применения в СВЧ усилителях и генераторах. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+85 °С.

КПС104(А—Е) — сдвоенные планарно-эпитаксиальные ионно-легированные полевые транзисторы с затвором на основе p-n перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах малошумящих дифференциальных и операционных усилителей низкой частоты и усилителей постоянного тока с высоким входным сопротивлением. Диапазон рабочих температур окружающей среды −45...+85 °С.

КПС202(А2—Г2) — сдвоенные бескорпусные планарно-эпитаксиальные ионно-легированные малошумящие полевые транзисторы с затвором на основе p-n перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах усилителей, дифференциальных и операционных усилителей низкой частоты, а также усилителей постоянного тока с высоким входным сопротивлением (например, в медико-биологической аппаратуре и малошумящих балансных каскадах). При монтаже транзисторов не допускается использование материалов, вступающих в химическое взаимодействие с защитным покрытием. Должна быть исключена возможность соприкосновения выводов с кристаллом (минимальное расстояние от места изгиба выводов до кристалла 1 мм, радиус закругления не менее 0,5 мм). При монтаже тепловое сопротивление кристалл-корпус должно быть не более 3 °С/мВт. При пайке выводов (на расстоянии не менее 1 мм) и при заливке компаундами нагрев кристалла не должен превышать +125 °С. Диапазон рабочих температур окружающей среды −40...+70 °С.

КПС203(А1—Г1) — сдвоенные бескорпусные с гибкими выводами без кристаллодержателя малошумящие планарно-диффузионные полевые транзисторы с затвором на основе p-n-перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах высокоточных и малошумящих дифференциальных и операционных усилителей и малошумящих балансных каскадах с высоким входным сопротивлением. При монтаже и пайке расстояние от края транзистора до места изгиба должно быть не менее 1 мм, радиус изгиба — не менее 0,5 мм, расстояние до места пайки — не менее 1,5 мм. Не допускается нагрев транзисторов свыше +125 °С. Диапазон рабочих температур окружающей среды −45...+85 °С.

КПС315(А, Б) — сдвоенные планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с затвором на основе p-n-перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах дифференциальных усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Диапазон рабочих температур окружающей среды −60...+100 °С.

КПС316(Д1—И1) — сдвоенные бескорпусные с гибкими выводами без кристаллодержателя планарно-эпитаксиальные полевые транзисторы с затвором на основе p-n-перехода и каналом n-типа. Предназначены для применения во входных каскадах дифференциальных усилителей и балансных каскадов с высоким входным сопротивлением. Типономинал прибора указывается на индивидуальной или групповой таре. Диапазон рабочих температур окружающей среды −40...+85 °С.

3.4. Полевые транзисторы

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
Параметры арсенид-галлиевых полевых транзисторов							
АП320А-2 **АП320Б-2**	С n-каналом	80 80	— —	4; 8* 4; 8*	5 5	— —	— —
АП324А-2 **АП324Б-2** **АП324В-2**	С n-каналом	80 80 80	— — —	4 4 4	3 3 3	— — —	— — —
АП324Б-5	С n-каналом	80	—	4	3	—	—
АП325А-2	С барьером Шотки, с n-каналом	25	4	2 6*	4,5	—	—
АП326А-2 **АП326Б-2**	С n-каналом	30 30	— —	2,5; -5,5* 2,5; 5,5*	4 4	— —	— —

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у.р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_ш$, дБ $U^{*}_ш$, мкВ $E^{**}_ш$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°C	Корпус
Параметры арсенид-галлиевых полевых транзисторов					
5...16 5...16	0,18; 0,15* 0,15*; 0,18**	≥3* (8 ГГц) ≥5* (8 ГГц)	≤4,5 (8 ГГц) ≤6 (8 ГГц)	— —	**АП320-2**
— — —	— — —	≥6* (12 ГГц) ≥6* (12 ГГц) ≥6* (12 ГГц)	≤1,5 (12 ГГц) ≤2 (12 ГГц) ≤2,5 (12 ГГц)	— — —	**АП324-2**
—	—	≥6* (12 ГГц)	≤2 (12 ГГц)	—	**АП324-5**
≥5 (1,5 В; 10 мА)	—	≥4,5* (8 ГГц)	≤2 (8 ГГц)	—	**АП325-2**
≥8 (2 В; 8 мА) ≥8 (2 В; 8 мА)	— —	≥3* (17,4 ГГц) ≥3* (17,4 ГГц)	≤4,5 (17,4 ГГц) ≤5,5 (17,4 ГГц)	— —	**АП326-2**

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
АП328А-2	С барьером Шотки, с двумя затворами с n-каналом	50	4	6	4; 6	—	—
АП330А-2 АП330Б-2 АП330В-2 АП330В1-2 АП330В2-2 АП330В3-2	С барьером Шотки, с n-каналом	30 30 30 100 100 100	— — — — — —	3; -6* 3; -6* 3; -6* 5; -7* 5; -7* 5; -7*	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —
АП331А-2	С барьером Шотки, с n-каналом	250	2,5...5	5; -8*	—	—	—
АП331А-5	с n-каналом	250 (70°С)	2,5...5	5; 8*	4	—	≥100 (3 В)
АП339А-2	С барьером Шотки, с n-каналом	250	—	5,5; -7*	—	—	—
АП343А-2 АП343А1-2 АП343А2-2 АП343А3-2	С барьером Шотки, с n-каналом	35 35 35 35	2...4 2...4 2...4 2...4	3,5; -6* 3,5; -6* 3,5; -6* 3,5; -6*	3 3 3 3	— — — —	≥20 (2 В) ≥20 (2 В) ≥20 (2 В) ≥20 (2 В)

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у.Р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$К_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс f^{**}_{p}, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥7 (4 В; 8 мА) ≥4 (4 В; 8 мА)	—	≥9* (8 ГГц)	≤4,5 (8 ГГц)	—	**АП328-2**
≥5 (5 кГц) ≥5 (5 кГц) ≥5 (5 кГц) ≥20 (5 кГц) ≥20 (5 кГц) ≥20 (5 кГц)	— — — — — —	≥3* (17,4 ГГц) ≥3* (25 ГГц) ≥6* (25 ГГц) ≥8* (17,4 ГГц) ≥8* (17,4 ГГц) ≥8* (17,4 ГГц)	≤6 (25 ГГц) ≤4,5 (25 ГГц) ≤3,5 (25 ГГц) ≤2 (17,4 ГГц) ≤1,5 (17,4 ГГц) ≤1 (17,4 ГГц)	— — — — — —	**АП330-2**
≥15 (5 кГц)	—	≥8* (10 ГГц) ≥0,03** (10 ГГц)	≤2,5 (10 ГГц)	—	**АП331-2**
≥15 (4 В; 40 мА)	—	≥5,5* (10 ГГц) ≥0,03** (10 ГГц)	≤2,5 (10 ГГц)	—	**АП331-5**
≥10 (5 кГц)	—	≥5* (17,4 ГГц) ≥0,015** (17,4 ГГц)	≤4 (17,4 ГГц)	—	**АП339-2**
≥10 (5 кГц) ≥20 (5 кГц) ≥20 (5 кГц) ≥20 (5 кГц)	— — — —	≥8,5* (12 ГГц) ≥8,5* (12 ГГц) ≥8,5* (12 ГГц) ≥8,5* (12 ГГц)	≤2 (12 ГГц) ≤1,5 (12 ГГц) ≤1,1 (12 ГГц) ≤0,9 (12 ГГц)	— — — —	**АП343-2**

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\,max}$, мВт $P^*_{СИ\,т\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^*_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^*_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\,Н}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^*_{С\,ост}$, мА
АП344А-2	С барьером Шотки, с n-каналом	100	—	4,5; -7*	4	—	—
АП344А1-2		100	—	5; -7*	4	—	—
АП344А2-2		100	—	5; -7*	4	—	—
АП344А3-2		100	—	5; -7*	4	—	—
АП344А4-2		100	—	5; -7*	4	—	—
АП354А-5	С n-каналом	100	—	3,5; -5*	-2,5	≤50	—
АП354Б-5	С n-каналом	100	—	3,5; -5*	-2,5	7...40	—
АП354В-5	С n-каналом	100	—	3,5; -5*	-2,5	7...40	—
АП355А-5	С n-каналом	70	—	3,5; -5*	-2,5	20	—
АП355Б-5	С n-каналом	70	—	3,5; -5*	-2,5	5...20	—
АП355В-5	С n-каналом	70	—	3,5; -5*	-2,5	5...20	—
АП356А-5	С n-каналом	40	—	3,5	-2,5	≤20	—
АП356Б-5	С n-каналом	40	—	3,5	-2,5	3...15	—
АП356В-5	С n-каналом	40	—	3,5	-2,5	3...15	—
АП357А-5	С n-каналом	30	—	3,5	-2	2...8	—
АП357Б-5	С n-каналом	30	—	3,5	-2	2...8	—
АП357В-5	С n-каналом	30	—	3,5	-2	2...8	—
АП358А-5	С n-каналом	30	—	3,5; -4,5*	-2	2...8	—
АП358Б-5	С n-каналом	30	—	3,5	-2	2...8	—
АП358В-5	С n-каналом	30	—	3,5	-2	2...8	—
АП362А-9	С двумя затворами, n-каналом	90	—	4,5; -7*	-4	—	—
АП362Б-9		90	—	4,5; -4,5*	4	—	—

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{у.р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_ш$, дБ $U^{*}_ш$, мкВ $E^{**}_ш$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_р$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥15 (5 кГц) ≥40 (5 кГц) ≥40 (5 кГц) ≥40 (5 кГц) ≥40 (5 кГц)	— — — — —	≥10 (4 ГГц) ≥10 (4 ГГц) ≥10 (4 ГГц) ≥10 (4 ГГц) ≥15 (1 ГГц)	≤1 (4 ГГц) ≤0,7 (4 ГГц) ≤0,5 (4 ГГц) ≤0,3 (4 ГГц) ≤0,3 (1 ГГц)	— — — — —	**АП344-2**
≥50 (2,5 В) ≥50 (2,5 В) ≥50 (2,5 В)	— — —	≥13* ≥13* ≥13*	≤1 (3,6 ГГц) ≤0,8 (3,6 ГГц) ≤0,6 (3,6 ГГц)	— — —	**АП354-5**
≥30 ≥30 ≥30	— — —	≥10* ≥10* ≥10*	≤1,55 (8 ГГц) ≤1,3 (8 ГГц) ≤1 (8 ГГц)	— — —	**АП355-5**
≥20 ≥20 ≥20	— — —	≥7,5* ≥7,5* ≥7,5*	≤2,04 (12 ГГц) ≤1,70 (12 ГГц) ≤1,46 (12 ГГц)	—	**АП356-5**
≥15 ≥15 ≥15	— — —	≥6,5* ≥6,5* ≥7*	≤2,5 (18 ГГц) ≤1,95 (18 ГГц) ≤1,76 (18 ГГц)	— — —	**АП357-5**
≥7 (3 В) ≥7 (3 В) ≥7 (3 В)	— — —	≥5* ≥5* ≥5,5*	≤5,5 (37 ГГц) ≤4,3 (37 ГГц) ≤3,4 (37 ГГц)	— — —	**АП358-5**
≥15 (3 В; 20 мА) ≥20 (3 В; 20 мА)	— —	≥9* (1 ГГц) ≥9* (1 ГГц)	≤1 (1 ГГц) ≤1 (1 ГГц)	— —	**АП362-9**

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\,max}$, мВт $P^*_{СИ\,т\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^*_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^*_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_{С}$, $I^*_{С,\,И}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^*_{С\,ост}$, мА
АП379А-9 **АП379Б-9**	С двумя затворами с n-каналом	240 240	— —	10; 6* 8; -8*	— —	— —	— —
АП381А-5	С n-каналом	80	—	3; -6*	-3	60	—
АП602А-2	С n-каналом	900	—	7	3,5	—	≥220 (3 В)
АП602Б-2		900	—	7	3,5	—	≥180 (3 В)
АП602В-2		900	—	7	3,5	—	≥110 (3 В)
АП602Г-2		1800	—	7,5	3,5	—	≥440 (3 В)
АП602О-2		1800	—	7,5	3,5	—	≥360 (3 В)
АП603А-2	С барьером Шотки, с n-каналом	2,5*	—	—	3,5	—	400; 5*
АП603Б-2		2,5*	—	—	3,5	—	400; 5*
АП603А-1-2	С барьером Шотки, с n-каналом	2,5*	—	—	3,5	—	400; 5*
АП603Б-1-2		2,5*	—	—	3,5	—	400; 5*
АП603А-5 **АП603Б-5**	С n-каналом С n-каналом	2,5* 2,5*	— —	— —	3,5 3,5	— —	400; 5* 450; 5*
АП604А-2	С n-каналом	900	—	7	-3	—	—
АП604Б-2	С n-каналом	900	—	7	-3	—	—
АП604В-2	С n-каналом	500	—	7	-3	—	—
АП604Г-2	С n-каналом	500	—	7	-3	—	—

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{у.р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥20 (5 В; 10 мА) ≥20 (5 В; 10 мА)	— —	≥16* (0,8 ГГц) ≥16* (0,8 ГГц) ≥14* (1750 МГц)	≤1,4 (1 ГГц) ≤1,4 (1 ГГц) ≤2,1 (1750 МГц)	— —	АП379-9
15...35 (2,5 В)	—	≥9*	≤0,8 (6,5 ГГц)	—	АП381-5
20...100 (2 В) 20...80 (2 В) 20...70 (2 В) 40...200 (2 В) 40...160 (2 В)	— — — — —	≥0,18** (12 ГГц) ≥2,6* (12 ГГц) ≥0,1** (12 ГГц) ≥3* (12 ГГц) ≥0,2** (8 ГГц) ≥3* (8 ГГц) ≥0,4** (10 ГГц) ≥2,6* (10 ГГц) ≥0,5** (8 ГГц) ≥3* (8 ГГц)	— — — — —	— — — — —	АП602
≥50 (3 В; 0,4 А) ≥80 (3 В; 0,4 А)	— —	≤4 ≥3* (12 ГГц) ≥0,5** (12 ГГц) ≤4; ≥3*; ≥1**	— —	0,24 0,24	АП603-2
≥50 (3 В; 0,4 А) ≥80 (3 В; 0,4 А)	— —	≤4 ≥3* (12 ГГц) ≥0,5** (12 ГГц) ≤4 ≥3* (12 ГГц); ≥1**	— —	0,24 0,24	АП603-1-2
≥50 (3 В; 0,4 А) ≥80 (3 В; 0,4 А)	— —	— —	— —	0,24 0,24	АП603-5
20...40 (3 В; 0,1 А) 15...40 (3 В; 0,1 А) 10...20 (3 В; 50 мА) 10...20 (3 В; 50 мА)	— — — —	≥3* (17,4 ГГц) ≥0,2** (17,4 ГГц) ≥3 (17,4 ГГц) ≥0,125** (17,4 ГГц) ≥3* (17,4 ГГц) ≥0,075** (17,4 ГГц) ≥3* (17,4 ГГц) ≥0,005** (17,4 ГГц)	— — — —	— — — —	АП604-2

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\,max}$, мВт $P^*_{СИ\,т\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^*_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^*_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\,И}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^*_{С\,ост}$, мА
АП604А1-2 АП604Б1-2 АП604В1-2 АП604Г1-2	С n-каналом С n-каналом С n-каналом С n-каналом	900 900 500 500	— — — —	8 8 8 8	-3 -3 -3 -3	— — — —	— — — —
АП605А-2	С барьером Шотки, с n-каналом	450	≤5,5	6; -4*	—	—	≥150 (3 В)
АП605А1-2 АП605А2-2	С n-каналом	450 450	— —	6; -8* 6; -8*	— —	— —	— —
АП606А-2 АП606Б-2 АП606В-2	С барьером Шотки, с n-каналом	2* 2* 2*	— — —	8 8 8	-3,5 -3,5 -3,5	— — —	160; 5* 160; 5* 160; 5*
АП606А-5 АП606Б-5 АП606В-5	С барьером Шотки, с n-каналом	2* 2* 2*	— — —	8 8 8	-3,5 -3,5 -3,5	— — —	160; 5* 160; 5* 160; 5*
АП607А-2	С n-каналом	3,5*	—	8	5	—	≤1600; ≤5*

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у.Р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
20...40 (3 В; 0,1 А) 15...40 (3 В; 0,1 А) 10...20 (3 В; 50 мА) 10...20 (3 В; 50 мА)	— — — —	≥0,2** (17,4 ГГц) ≥0,125** (17,4 ГГц) ≥0,075** (17,4 ГГц) ≥0,05** (17,4 ГГц)	— — — —	— — — —	**АП604-1-2**
≥30 (4 В; 30 мА)	—	≤3,5 (8 ГГц) ≥8* (8 ГГц) ≥0,1** (8 ГГц)	≤3,5 (8 ГГц)	—	**АП605-2**
— —	— —	≥6* (8 ГГц) ≥0,1** (8 ГГц) ≥7* (8 ГГц) ≥0,15** (8 ГГц)	≤2 (8 ГГц) ≤1,5 (8 ГГц)		**АП605 (А1-2, А2-2)**
≥70 (3 В; 0,25 А) ≥90 (3 В; 0,25 А) ≥100 (3 В; 0,25 А)	3 (5 В) 3 (5 В) 3 (5 В)	≥4* (12 ГГц) ≥0,4** (12 ГГц) ≥6* (12 ГГц) ≥0,4** (12 ГГц) ≥5* (12 ГГц) ≥0.75** (12 ГГц)	— — —	$t_{н}$=100 $t_{н}$=100 $t_{н}$=100	**АП606-2**
≥70 (3 В; 0,25 А) ≥90 (3 В; 0,25 А) ≥100 (3 В; 0,25 А)	3 (5 В) 3 (5 В) 3 (5 В)	≥4* ≥0,4** (12 ГГц) ≥6* ≥0,4** (12 ГГц) ≥5* (12 ГГц) ≥0,75** (12 ГГц)	— — —	$t_{н}$=100 $t_{н}$=100 $t_{н}$=100	**АП606-5**
≥80 (3 В)	—	≥1** (10 ГГц); ≥4,5*	—	—	**АП607-2**

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^{*}_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^{*}_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^{*}_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_{С}$, $I^{*}_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^{*}_{С\ ост}$, мА
АП608А-2	С барьером Шотки, с n-каналом	0,6*	—	—	-3	—	—
АП608Б-2		1,1*	—	—	-3	—	—
АП608В-2		1*	—	—	-3	—	—
АП608А-5	С барьером Шотки, с n-каналом	30	—	—	-3	—	—
АП608О-5		30	—	—	-3	—	—
АП608П-5		10	—	—	-3	—	—
АП915А-2	С барьером Шотки, с n-каналом	12*	—	7	-5	—	—
АП915Б-2		12*	—	7	-5	—	—
АП925А-2	С n-каналом	7*	—	9	5	—	3 А
АП925Б-2		16*	—	9	5	—	≥3,6 А (3 В)
АП925В-2		7*	—	9	5	—	3 А
АП930А-2	С барьером Шотки, с n-каналом	21*	—	8	-5	—	≤4,5; ≤15*
АП930Б-2		21*	—	8	-5	—	≤4,5; ≤15*
АП930В-2		21*	—	8	-5	—	≤4,5; ≤15*
АП967А-2	С барьером Шотки, с n-каналом, с внутренними цепями согласования	14*	—	8	-5	—	—
АП967Б-2		14*	—	8	-5	—	—
АП967В-2		7*	—	8	-5	—	—
АП967Г-2		7*	—	8	-5	—	—
АП967О-2		7*	—	8	-5	—	—
АП967П-2		14*	—	8	-5	—	—
АП967Т-2		14*	—	8	-5	—	—

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{уР}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥15 (3 В; 50 мА)	—	≥3,5* (26 ГГц) ≥0,1** (26 ГГц)	—	—	**АП608-2**
≥20 (3 В; 100 мА)	—	≥4* (26 ГГц) ≥0,15** (26 ГГц)	—	—	
≥20 (3 В; 100 мА)	—	≥4* (26 ГГц) ≥0,15** (26 ГГц)	—	—	
≥15 (3 В; 50 мА)	—	≥4* (37 Гц) ≥0,03** (37 ГГц)	—	—	**АП608-5**
≥15 (3 В; 50 мА)	—	≥3,5* (37 ГГц) ≥0,15** (37 ГГц)	—	—	
≥15 (3 В; 50 мА)	—	≥4* (37 ГГц) ≥0,01* (37 ГГц)	—	—	
≥350 (1,5 В; 0,5 А)	—	≥5** (8 ГГц); ≥3*	—	—	**АП915-2**
≥300 (1,5 В; 0,5 А)	—	≥3** (8 ГГц); ≥3*	—	—	
≥500 (3 В; 1,8 А)	—	≥2** (3,7...4,2 ГГц)	—	—	**АП925-2**
≥500 (3 В; 1,8 А)	—	≥7* (3,7...4,2 ГГц) ≥5** (3,7...4,2 ГГц)	—	—	
≥500 (3 В; 1,8 А)	—	≥4,5** (4,3...4,8 ГГц)	—	—	
≥1000 (3 В; 4 А)	—	≥5** (5,7...6,3 ГГц)	—	—	**АП930-2**
≥1000 (3 В; 4 А)	—	≥7,5** (5,7...6,3 ГГц)	—	—	
≥1000 (3 В; 4 А)	—	≥10** (5,7...6,3 ГГц)	—	—	
—	—	≥7* ≥4** (5,9...6,4 ГГц)	—	—	**АП967-2**
—	—	≥7* ≥5** (3,7...4,2 ГГц)	—	—	
—	—	≥6* ≥2** (3,7...4,2 ГГц)	—	—	
—	—	≥6* ≥2** (4,3...4,8 ГГц)	—	—	
—	—	≥6* ≥2** (3,4...3,9 ГГц)	—	—	
—	—	≥7* ≥4** (5,6...6,2 ГГц)	—	—	
—	—	≥7* ≥5** (3,4...3,9 ГГц)	—	—	

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^{*}_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^{*}_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^{*}_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_{С}$, $I^{*}_{С,И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^{*}_{С\ ост}$, мА
Параметры кремниевых полевых транзисторов							
КЕ702А	БТИЗ	75 Вт	$U_{КБ}$=600	—	—	$I_{К}$=50 А	—
КЕ702Б		75 Вт	$U_{КБ}$=1000	—	—	$I_{К}$=33 А	—
КЕ702В		75 Вт	$U_{КБ}$=900	—	—	$I_{К}$=25 А	—
КЕ707А	БТИЗ	—	$U_{КБ}$=600	—	—	$I_{К}$=34 А	—
КЕ707Б		—	$U_{КБ}$=600	—	—	$I_{К}$=23 А	—
КЕ707А2	БТИЗ	—	$U_{КБ}$=600	—	—	$I_{К}$=34 А	—
КЕ707Б2		—	$U_{КБ}$=600	—	—	$I_{К}$=23 А	—
КП101Г	С р-n-переходом и р-каналом	50	5	10	10	2	0,15...2
КП101Д		50	6	10	10	5	0,3...4
КП101Е		50	6	10	10	5	0,5...5
КП103Е	С р-n-переходом и р-каналом	7	0,4...1,5	10	—	—	0,3...2,5
КП103Ж		12	0,5...2,2	10	—	—	0,35...3,8
КП103И		21	0,8...3	12	—	—	0,8...1,8
КП103К		38	1,4...4	10	—	—	1...5,5
КП103Л		66	2...6	12	—	—	1,8...6,6
КП103М		120	2,8...7	10	—	—	3...12
КП103ЕР1	С р-n-переходом и р-каналом	7	0,4...1,5	10	—	—	0,3...2,5
КП103ЖР1		12	0,5...2,2	10	—	—	0,35...3,8
КП103ИР1		21	0,8...3	12	—	—	0,8...1,8
КП103КР1		38	1,4...4	10	—	—	1...5,5
КП103ЛР1		66	2...6	12	—	—	1,8...6,6
КП103МР1		120	2,8...7	10	—	—	3...12
КП103Е9	С р-n-переходом и n-каналом	7	0,4...1,5	15	30	—	0,3...2,5
КП103Ж9		12	0,5...2,2	15	30	—	0,35...3,8
КП103И9		21	0,6...3	15	30	—	0,8...1,8
КП103К9		38	1...4	15	30	—	1...5,5
КП103Л9		66	2...6	17	30	—	1,8...6,6
КП103М9		120	2,6...7	17	30	—	3...12

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{УР}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
Параметры кремниевых полевых транзисторов					
— — —	— — —	0,35 0,4 0,4	— — —	— — —	**КЕ702**
— —	— —	0,12 0,06	— —	22; 540* 17; 78*	**КЕ707**
— —	— —	0,12 0,06	— —	22; 540* 17; 78*	**КЕ707-2**
≥0,15 (5 В) ≥0,4 (5 В) ≥0,3 (5 В)	≤10; ≤0,4** ≤10; ≤0.4** ≤10; ≤0.4**	— — —	≤4 (1 кГц) ≤7 (1 кГц) ≤7 (1 кГц)	— — —	**КП101**
0,4...2,4 (5 В) 0,5...2,8 (5 В) 0,8...2,6 (5 В) 1...3 (5 В) 1,8...3,8 (5 В) 1,3...4,4 (5 В)	≤20; ≤8* ≤20; ≤8* ≤20; ≤8* ≤20; ≤8* ≤20; ≤8* ≤20; ≤8*	— — — — — —	≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц)	3** 3** 3** 3** 3** 3**	**КП103**
0,4...2,4 0,5...2,8 0,8...2,6 1...3 1,8...3,8 1,3...4,4	≤20; ≤8* ≤20; ≤8* ≤20; ≤8* ≤20; ≤8* ≤20; ≤8* ≤20; ≤8*	— — — — — —	≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц)	— — — — — —	**КП103Р**
0,4...2,4 (10 В) 0,5...2,8 (10 В) 0,8...2,6 (10 В) 1...3,3 (10 В) 1,8...3,8 (10 В) 1,3...4,4 (10 В)	≤8* ≤8* ≤8* ≤8* ≤8* ≤8*	— — — — — —	— —	≤80* ≤80*	**КП103-9**

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП150	nМОП	150*	2*...4*	100	±20	38 (140*) А	≤25* мкА (100 В)
КП201Е-1 **КП201Ж-1** **КП201И-1** **КП201К-1** **КП201Л-1**	С p-n-переходом и p-каналом	60 60 60 60 60	≤1,5 ≤2,2 ≤3 ≤4 ≤6	10; 15* 10; 15* 10; 15* 10; 15* 10; 15*	-0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5	— — — — —	0,3...0,65 0,55...1,2 1...2,1 1,7...3 3...6
КП202Д-1 **КП202Е-1**	С p-n-переходом и p-каналом	60 60	0,4...2 1...3	15; 20* 15; 20*	0,5 0,5	— —	≤1,5 1,1...3
КП214А-9	С n-каналом	200	1...2,5*	60	±40	115	0,1*
КП240	nМОП	125*	2...4*	200	±20	18 (72*) А	≤25* мкА (200 В)
КП250	nМОП	150*	2...4*	200	±20	30 (120*) А	≤25* мкА (200 В)
КП301Б **КП301В** **КП301Г**	С изолированным затвором, с индуцированным p-каналом	200 200 200	2,7...5,4* 2,7...5,4* 2,7...5,4*	20 20 20	30 30 30	15 15 15	≤0,5 мкА (15 В) ≤0,5 мкА (15 В) ≤0,5 мкА (15 В)
КП302А **КП302Б** **КП302В** **КП302Г**	С p-n-переходом и n-каналом	300 300 300 300	1...5 2,5...7 3...10 2...7	20 20 20 20	10 10 12 10	24 43 — —	≤24; 6* ≤43; 6* ≤33; 6* ≤65; 6*

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у.Р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥13·10^{3} (25 В; 25 А)	≤2800; 1100**	≤0,055	—	$t_{сп}$=81	**КП150**
≥0,4 (10 В) ≥0,7 (10 В) ≥0,8 (10 В) ≥1,4 (10 В) ≥1,8 (10 В)	≤20; ≤8* ≤20; ≤8* ≤20; ≤8* ≤20; ≤8* ≤20; ≤8*	— — — — —	≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц)	— — — — —	**КП201-1**
≥0,65 ≥1	≤6; ≤2* ≤6; ≤2*	— —	— —	— —	**КП202-1**
80	—	7,5	—	—	**КП214-9**
≥6,9·10^{3} (25 В; 11 А)	≤1300; 130**	≤0,18	—	$t_{сп}$=36	**КП240, КП250**
≥12·10^{3} (25 В; 18 А)	≤2800; 780**	≤0,085	—	$t_{сп}$=62	
1...2,6 (15 В; 5 мА) 2...3 (15 В; 5 мА) 0,5...1,6 (15 В; 5 мА)	≤3,5; ≤1*; ≤3,5** ≤3,5; ≤1*; ≤3,5** ≤3,5; ≤1*; ≤3,5*	— — —	≤9,5 (100 МГц) ≤9,5 (100 МГц) ≤9,5 (100 МГц)	100** 100** 100**	**КП301**
5...12 (7 В) 7...14 (7 В) — 7...14 (7 В)	≤20; ≤8* ≤20; ≤8* ≤20; ≤8* ≤20; ≤8*	— ≤150 ≤100 ≤150	≤3 (1 кГц) — — —	≤4; ≤5* ≤4; ≤5* ≤4; ≤5* ≤4; ≤5*	**КП302**

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП302АМ	С p-n-переходом и n-каналом	300	1...5	20	10	24	≤24; 6*
КП302БМ		300	2,5...7	20	10	43	≤43; 6*
КП302ВМ		300	3...10	20	12	—	≤33; 6*
КП302ГМ		300	2...7	20	10	—	≤65; 6*
КП303А	С p-n-переходом и n-каналом	200	0,5...3	25; 30*	30	20	≤2,5; 5*
КП303Б		200	0,5...3	25; 30*	30	20	≤2,5; 5*
КП303В		200	1...4	25; 30*	30	20	≤5; 5*
КП303Г		200	≤8	25; 30*	30	20	≤12; 5*
КП303Д		200	≤8	25; 30*	30	20	≤9; 5*
КП303Е		200	≤8	25; 30*	30	20	≤20; 5*
КП303Ж		200	0,3...3	25; 30*	30	20	≤3; 5*
КП303И		200	0,5...2	25; 30*	30	20	≤5; 5*
КП303А9	С p-n-переходом и n-каналом	200	0,5...3	30*	30	—	20
КП303Б9		200	0,5...3	30*	30	—	20
КП303В9		200	1...4	30*	30	—	20
КП303Г9		200	≤8	30*	30	—	20
КП303Д9		200	≤8	30*	30	—	20
КП303Е9		200	≤8	30*	30	—	20
КП303Ж9		200	0,3...3	30*	30	—	20
КП303И9		200	0,5...2	30*	30	—	20
КП304А	С изолированным затвором и индуцированным каналом p-типа	200	≥5*	25; 30*	30	30 (60*)	≤0,2 мкА
КП305Д	С изолированным затвором и n-каналом	150	≥6	15; ±15*	±15	15	—
КП305Е		150	≥6	15; ±15*	±15	15	—
КП305Ж		150	≥6	15; ±15*	±15	15	—
КП305И		150	≥6	15; ±15*	±15	15	—
КП306А	С двумя изолированными затворами и n-каналом	150	≤4	20	20	20	≤0,005
КП306Б		150	≤4	20	20	20	≤0,005
КП306В		150	≤6	20	20	20	≤0,005

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у.Р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
5...12 (7 В) 7...14 (7 В) — 7...14 (7 В)	≤20; ≤8* ≤20; ≤8* ≤20; ≤8* ≤20; ≤8*	— ≤150 ≤100 ≤150	≤3 (1 кГц) — — —	≤4; ≤5* ≤4; ≤5* ≤4; ≤5* ≤4; ≤5*	**КП302М**
1...4 (10 В) 1...4 (10 В) 2...5 (10 В) 3...7 (10 В) ≥2,6 (10 В) ≥4 (10 В) 1...4 (10 В) 2...6 (10 В)	≤6; ≤2* ≤6; ≤2* ≤6; ≤2* ≤6; ≤2* ≤6; ≤2* ≤6; ≤2* ≤6; ≤2* ≤6; ≤2*	— — — — — — — —	≤30** (20 Гц) ≤20** (1 кГц) ≤20** (1 кГц) ≤(6·10^-17)*** ≤4 (100 МГц) ≤4 (100 МГц) ≤100** (1 кГц) ≤100** (1 кГц)	— — — — — — — —	**КП303**
1...4 (10 В) 1...4 (10 В) 2...5 (10 В) 3...7 (10 В) ≥2,6 (10 В) ≥4 (10 В) 1...4 (10 В) 2...6 (10 В)	≤2* ≤2* ≤2* ≤2* ≤2* ≤2* ≤2* ≤2*	— — — — — — — —	— — — — — — — —	≤500; ≤100* ≤500; ≤130* ≤500; ≤130* — — — — —	**КП303-9**
≥4 (10 В; 10 мА)	≤9; ≤2*; ≤6**	≤100	—	—	**КП304**
5,2...10,5 (10 В; 5 мА) 4...8 (10 В; 5 мА) 5,2...10,5 (10 В; 5 мА) 4...10,5 (10 В; 5 мА)	≤5; ≤0,8* ≤5; ≤0,8* ≤5; ≤0,8* ≤5; ≤0,8*	≥13* (250 МГц) — ≥13* (250 МГц) —	≤7,5 (250 МГц) — ≤7,5 (250 МГц) —	— — — —	**КП305**
4...8 ($U_{32И}$=10 В) 4...8 ($U_{32И}$=10 В) 4...8 ($U_{32И}$=10 В)	≤5; ≤0,07* ≤5; ≤0,07* ≤5; ≤0,07*	— — —	≤6 (200 МГц, $U_{32И}$=10 В) ≤6 (200 МГц) ≤6 (200 МГц)	800** 800** 800**	**КП306**

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\,max}$, мВт $P^*_{СИ\,т\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^*_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^*_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_С$, $I^*_{С.И}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^*_{С\,ост}$, мА
КП307А	С p-n-переходом и n-каналом	250	0,5...3	25; 27*	27	25	≤9
КП307Б		250	1...5	25; 27*	27	25	≤15
КП307В		250	1...5	25; 27*	27	25	≤15
КП307Г		250	1,5...6	25; 27*	27	25	24
КП307Д		250	1,5...6	25; 27*	27	25	8...24
КП307Е		250	≤2,5	25; 27*	27	25	≤5
КП307Ж		250	≤7	25; 27*	27	25	≤25
КП307А1	С p-n-переходом и n-каналом	250	0,5...3	27*	27	25	—
КП307Б1		250	1...5	27*	27	25	—
КП307Г1		250	1,5...6	27*	27	25	—
КП307Е1		250	≤2,5	27*	27	25	—
КП307Ж1		250	≤7	27*	27	25	—
КП308А-1	С p-n-переходом и n-каналом	60	0,2...1,2	25; 30*	30	20	≤1
КП308Б-1		60	0,3...1,8	25; 30*	30	20	≤1,6
КП308В-1		60	0,4...2,4	25; 30*	30	20	≤3
КП308Г-1		60	1...6	25; 30*	30	20	—
КП308Д-1		60	1...3	25; 30*	30	20	—
КП310А	С изолированным затвором и каналом n-типа	80	—	8; 10*	10	20	≤5; ≤0,1*
КП310Б		80	—	8; 10*	10	20	≤5; ≤0,1*
КП312А	С p-n-переходом и n-каналом	100	2...8	20; 25*	25	25	≤25
КП312Б		100	0,8...6	20; 25*	25	25	≤7
КП313А	С изолированным затвором и n-каналом	75	≥6	15; 15*	10	15	—
КП313Б		75	≥6	15; 15*	10	15	—
КП313В		75	≥6	15; 15*	10	15	—
КП314А	С p-n-переходом и n-каналом	200	—	25	30	20	2,5...20
КП322А	С двумя затворами, с p-n-переходом и n-каналом	200	2,2...12	20	20	—	≤42

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у,Р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
4...9 (10 В)	≤5; ≤1,5*	—	≤20** (1 кГц)	—	КП307
5...10 (10 В)	≤5; ≤1,5*	—	≤2,5** (100 кГц)	—	
5...10 (10 В)	≤5; ≤1,5*	—	≤2,5** (100 кГц)	—	
6...12 (10 В)	≤5; ≤1,5*	—	≤6 (400 МГц)	—	
6...12 (10 В)	≤5; ≤1,5*	—	≤6 (400 МГц)	—	
3...8 (10 В)	≤5; ≤1,5*	—	≤20** (1 кГц)	—	
4...14 (10 В)	≤5; ≤1,5*	—	≤($4 \cdot 10^{-17}$)***	—	
4...9 (10 В)	—	—	—	—	КП307-1
5...10 (10 В)	—	—	—	—	
6...12 (10 В)	—	—			
3...8 (10 В)	—	—			
4...14 (10 В)	—	—			
1...4 (10 В)	≤6; ≤2**	—	≤20** (1 кГц)	—	КП308-1
1...4 (10 В)	≤6; ≤2**	—	≤20** (1 кГц)	—	
2...6,5 (10 В)	≤6; ≤2**	—	≤20** (1 кГц)	—	
—	≤6; ≤2**	≤250	—	≤20; ≤20*	
—	≤6; ≤2**	≤250	—	≤20; ≤20*	
3...6 (5 В; 5 мА)	≤2,5; ≤0,5*	≥5* (1 ГГц)	≤6 (1 ГГц)	—	КП310
3...6 (5 В; 5 мА)	≤2,5; ≤0,5*	≥5* (1 ГГц)	≤7 (1 ГГц)	—	
4...5,8 (15 В)	≤4; ≤1*	≥2* (400 МГц)	≤4 (400 МГц)	—	КП312
2...5 (15 В)	≤4; ≤1*	≥2* (400 МГц)	≤6 (400 МГц)	—	
4,5...10,5 (10 В; 5 мА)	≤7; ≤0,9*	≥10* (250 МГц)	≤7,5 (250 МГц)	300**	КП313
4,5...105 (10 В; 5 мА)	≤7; ≤0,9*	≥10* (250 МГц)	≤7,5 (250 МГц)	300**	
4,5...10,5 (10 В; 5 мА)	≤7; ≤0,9*	≥10* (250 МГц)	≤7,5 (250 МГц)	300**	
≥4 (10 В)	≤6; ≤2*	—	≤ ($1{,}35 \cdot 10^{-17}$)***	≥100**	КП314
3,2...6,3 (10 В)	≤6; ≤0,2*	—	≤6 (250 МГц)	—	КП322

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С.И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП323А-2 **КП323Б-2**	С p-n-переходом и n-каналом	100 100	0,74...6 0,74...6	20 20	25 25	12 12	3...12 3...12
КП327А **КП327Б** **КП327В** **КП327Г**	С двумя изолированными затворами и защитными диодами, с n-каналом	200 200 200 200	≤2,7 ≤2,7 — —	18 18 14; 16* 14; 16*	6 6 5 5	30 30 30 30	≤10 ≤10 ≤17 ≤17
КП329А **КП329Б**	С p-n-переходом и n-каналом	250 250	≥1,5 ≥1,5	50 40	45 35	— —	≥1 ≥1
КП333А **КП333Б**	С p-n-переходом и n-каналом	250 250	1...8 0,6...4	50; 50* 40; 40*	45 35	— —	≤1 мкА ≤1 мкА
КП340	nМОП	125*	2...4*	400	±20	10 (38*) А	≤25* мкА (400 В)
КП341А **КП341Б**	С p-n-переходом и каналом n-типа	150 (60°С) 150 (60°С)	≤3 ≤3	15; 15* 15; 15*	10 10	— —	≤20 ≤30
КП346А-9 **КП346Б-9** **КП346В-9**	С двумя изолированными затворами и n-каналом	200 200 200	— — —	14; 16* 14; 16* 14; 16*	10 10 10	30 30 30	2...20 ≤20 2...20

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{у\,р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{у}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
4...5,8 (10 В) 4...5,8 (10 В)	≤4; ≤1,2* ≤4; ≤1,2*	— —	≤5** ≤5**	400** 400**	**КП323-2**
≥11 (10 В; 10 мА) ≥11 (10 В; 10 мА) ≥9,5 (10 В; 10 мА) ≥9,5 (10 В; 10 мА)	≤2,5 ≤2,5 ≤2,5; ≤1,6* ≤3,6; ≤3*	≥12* (0,8 ГГц) ≥18* (250 МГц) ≥12* (0,8 ГГц) ≥18* (0,2 ГГц)	≤4,5 (0,8 ГГц) ≤3 (0,2 ГГц) ≤4,5 (0,8 ГГц) ≤3 (0,2 ГГц)	— — — —	**КП327**
≥3 (10 В) ≥1 (10 В)	≤6 ≤6	≤1500 ≤1500	≤20** ≤20**	200** 200**	**КП329**
4...5,8 (10 В) 2...5 (10 В)	≤6 (10 В) ≤6 (10 В)	≤1500 ≤1500	— ≤20**	— —	**КП333**
≥7,7·10^{3} (50 В; 6 А)	≤1400; 130*	≤0,55	—	$t_{сл}$=24	**КП340**
15...30 (5 В) 18...32 (5 В)	≤5; 1*; 1,6** ≤5; 1*; 1,6**	— —	2,8 (400 МГц) ≤1,2** (100 кГц) 1,8 (200 МГц) ≤1,2** (100 кГц)	— —	**КП341**
≥12 (10 В; 10 мА) ≥10 (10 В; 10 мА) ≥12 (10 В; 10 мА)	≤2,6; ≤0,035*; ≤1,3** ≤3; ≤0,035*; ≤1,5** ≤2,6; ≤0,035*; ≤1,3**	≥15* (0,8 ГГц) ≤13 (0,8 ГГц) ≥21 (200 МГц)	≤3,5 (0,8 ГГц) ≤4,5 (800 МГц) ≤1,9 (200 МГц)	— — —	**КП346-9**

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С.Н}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП347А-2	С n-каналом, с двумя изолированными затворами, с двумя защитными диодами	200	3	14	5	—	≤5
КП350	nМОП	150*	2...4*	400	±20	14 (56*) А	≤25* мкА (400 В)
КП350А **КП350Б** **КП350В**	С двумя изолированными затворами и встроенным n-каналом	200 200 200	0,17...6 0,17...6 0,17...6	15 15 15	15 15 15	30 30 30	≤3,5 ≤3,5 ≤3,5
КП361А	n-канал, для электретных микрофонов	150	—	20	—	10	≤1,2
КП364А **КП364Б** **КП364В** **КП364Г** **КП364Д** **КП364Е** **КП364Ж** **КП364И**	С p-n-переходом, n-каналом	200 200 200 200 200 200 200 200	0,5...3 0,5...3 1...4 ≤8 ≤8 ≤8 0,3...3 0,5...2	25; 30* 25; 30* 25; 30* 25; 30* 25; 30* 25; 30* 25; 30* 25; 30*	30 30 30 30 30 30 30 30	20 20 20 20 20 20 20 20	0,5...2,5 0,5...2,5 1,5...5 3...12 3...9 5...20 0,3...3 1,5...5
КП365А **КП365Б**	С p-n-переходом, n-каналом	150 150	-0,4...-3 -0,4...-3	20 20	20 20	— —	4,5...20 12...35
КП382А	nМОП, с двумя затворами	—	2,7	15	—	—	≤20

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{уР}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_ш$, дБ $U^{*}_ш$, мкВ $E^{**}_ш$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_р$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥10 (10 В; 10 мА)	≤3,5 (10 В) 0,04*	≥18* (200 МГц)	≤2,5 (200 МГц)	—	КП347А-2
≥10·10^{3} (25 В; 25 А)	≤2600; 250*	≤0,3	—	$t_{сп}$=47	КП350
≥6 (10 В; 10 мА) ≥6 (10 В; 10 мА) ≥6 (10 В; 10 мА)	≤6; ≤0,07*; ≤6** ≤6; ≤0,07*; ≤6** ≤6; ≤0,07*; ≤6**	— — —	≤6 (400 МГц) ≤5 (100 МГц) ≤8 (400 МГц)	— — —	КП350А
—	—	—	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	КП361
1...4 (10 В) 1...4 (10 В) 2...5 (10 В) 3...7 (10 В) ≥2,6 (10 В) ≥4 (10 В) 1...4 (10 В) 2...6 (10 В)	≤6; ≤2 ≤6; ≤2 ≤6; ≤2 ≤6; ≤2 ≤6; ≤2 ≤6; ≤2 ≤6; ≤2 ≤6; ≤2	— — — — — — — —	≤30** (20 Гц) ≤20** (1 кГц) ≤20** (1 кГц) — ≤4 (100 МГц) ≤4 (100 МГц) ≤100** (1 кГц) ≤100** (1 кГц)	— — — — — — — —	КП364
≥15 ≥18	— —	— —	1,5* 1,8*	—	КП365
≥10	—	≥13*	3	—	КП382

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП383А-9	С двумя изолир. затворами, n-каналом	200	—	14; 16*	±5	30	≤0,5 (30 В)
КП401АС **КП401БС**	Сборка из четырех транзисторов 1 и 3 с n-каналами, 2 и 4 с р-каналами	420 420	≥0,8 ≥0,8	30 30	20 20	— —	3 (1 и 3) 1 (2 и 4)
КП402А	С р-каналом	—	(0,8...2,8)	200	—	150	≤60
КП403А	С n-каналом	—	(0,8...2,8)	200	—	300	≤60
КП440	nМОП	125*	2...4*	500	±20	8 (30*) А	≤25* мкА (500 В)
КП450	nМОП	150*	2...4*	500	±20	12 (52*) А	≤25* мкА (500 В)
КП501А **КП501Б** **КП501В**	С изолированным затвором и n-каналом	500 500 500	1...3* 1...3* 1...3*	240 200 200	±20 ±20 ±20	180 180 180	10 мкА 10 мкА 10 мкА

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у.Р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥13 (10 В; 10 мА)	≤2,5 (10 В)	≥13* (0,8 ГГц)	≤3 (0,8 ГГц)	—	**КП383-9**
≥280 (1 и 3) ≥130 (2 и 4)	— —	≤1,2 (п-кан.); ≤2,5 (р-кан.) ≤2 (п-кан.); ≤5 (р-кан.)	— —	— —	**КП401**
≥60 (25 В; 0,1 А)	—	≤20	—	—	**КП402А**
≥60 (25 В; 0,1 А)	—	≤6	—	—	**КП403А**
≥5,3 (25 В; 5 А)	≤1300; 120*	≤0,85	—	$t_{сп}$=20	**КП440, КП450**
≥9,3 (25 В; 7,75 А)	≤2600; 720**	≤0,4	—	$t_{сп}$=44	
≥100 ≥100 ≥100	10 10 15	— — —	— — —	— — —	**КП501**

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП502А	С изолированным затвором и n-каналом	1000	1,5...2,5*	400	±10	120	1 мкА
КП503А		1000	-1,8...-0,7*	240	±10	150	1 мкА
КП504А		1000	0,6...1,2*	240	±10	250	1 мкА
КП504Б		1000	0,6...1,2*	240	±10	250	1 мкА
КП504В		1000	0,6...1,2*	200	±10	250	1 мкА
КП505А		1000	0,8...2*	50	±10	1400	1 мкА
КП505Б		1000	0,8...2*	50	±10	1400	1 мкА
КП505В		1000	0,8...2*	60	±10	1400	1 мкА
КП505Г		700	0,4...0,8*	8	±10	500	1 мкА
КП507А	С p-каналом	1000	-0,8...-2	-50	±20	1100	1*
КП508А	С p-каналом	1000	-0,8...-2	-240	±20	150	—
КП509А-9	С n-каналом	360	0,8...2*	240	±14	100	—
КП509Б-9	С n-каналом	500	0,6...1,2*	240	±14	250	—
КП509В-9	С n-каналом	360	0,8...2*	200	±14	100	—
КП510	nМОП	43*	2...4*	100	±20	5,6 (20*) А	≤25* мкА (100 В)
КП510А9	С n-каналом	540	0,7...1,6*	20	±12	1200	—

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом; $K^{*}_{у.Р}$, дБ; $P^{**}_{вых}$, Вт; $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ; $U^{*}_{ш}$, мкВ; $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$; Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс; $t^{*}_{выкл}$, нс; $f^{**}_{р}$, МГц; $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥0,1 А/В ≥0,14 А/В ≥0,14 А/В ≥0,14 А/В ≥0,14 А/В ≥0,5 А/В ≥0,5 А/В ≥0,5 А/В ≥0,5 А/В	— — — — — — — — —	28 20 8 8 8 0,3 0,3 0,3 1,2	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	**КП502, КП503, КП504, КП505**
250	—	0,8	—	—	**КП507**
—	—	20	—	—	**КП508**
160 140 60	— — —	16 8 16	— — —	— — —	**КП509-9**
≥1300 (50 В; 3,4 А)	180; 15*	≤0,54	—	$t_{сп}$=9,4	**КП510**
1300	—	0,25	—	—	**КП510-9**

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^{*}_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^{*}_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^{*}_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_{С}$, $I^{*}_{С.\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^{*}_{С\ ост}$, мА
КП511А **КП511Б**	С n-каналом С n-каналом	750 750	0,8...2 0,8...2	350 400	±20 ±20	140 140	— —
КП520	nМОП	60*	2...4*	100	±20	9,2 (37*) А	≤25* мкА (100 В)
КП523А **КП523Б** **КП523В** **КП523Г**	nМОП nМОП nМОП nМОП	1 Вт 1 Вт 700 700	0,8...2 0,8...2 0,8...2 0,8...2	200 200 200 200	±20 ±14 ±20 ±14	480 480 480 480	1* 1* 1* 1*
КП530	nМОП	88*	2...4*	100	±20	14 (56*) А	≤25* мкА (100 В)
КП540	nМОП	150*	2...4*	100	±20	28 (110*) А	≤25* мкА (100 В)
КП601А **КП601Б**	С p-n-переходом и n-каналом	500; 2* 500; 2*	4...9 6...12	20; 20* 20; 20*	15 15	— —	≤400 ≤400
КП610	nМОП	36*	2...4*	200	±20	3,3 (10*) А	≤25* мкА (200 В)
КП620	nМОП	50*	2...4*	200	±20	5,2 (18*) А	≤25* мкА (200 В)
КП630	nМОП	74*	2...4*	200	±20	9 (36*) А	≤25* мкА (200 В)
КП640	nМОП	125*	2...4*	200	±20	18 (72*) А	≤25* мкА (200 В)
КП704А **КП704Б**	С изолированным затвором, с n-каналом	75* 75*	1,5...4* 1,5...4*	200 200	±20 ±20	10 А; 30* А 10 А; 30* А	≤0,8 ≤1

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{уР}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{у}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
125 125	— —	22 22	— —	— —	**КП511**
≥2700 (50 В; 5,5 А)	360; 150**	≤0,27	—	$t_{сп}$=20	**КП520**
≥500 (0,45 А) ≥500 (0,45 А) ≥500 (0,45 А) ≥500 (0,45 А)	— — — —	2 4 2 4	— — — —	— — — —	**КП523**
≥5100 (50 В; 8,4 А)	670; 60*	≤0,16	—	$t_{сп}$=24	**КП530, КП540**
≥8700 (50 В; 17 А)	1700; 120*	≤0,077	—	$t_{сп}$=43	
40...87 (10 В) 40...87 (10 В)	≤6* ≤6*	— —	≤6 (400 МГц) ≤6 (400 МГц)	— —	**КП601**
≥800 (50 В; 2 А)	140; 15*	≤1,5	—	$t_{сп}$=8,9	**КП610, КП620, КП630, КП640, КП704**
≥1500 (50 В; 3,1 А)	260; 30*	≤0,8	—	$t_{сп}$=13	
≥3800 (50 В; 3,4 А)	950; 76*	≤0,4	—	$t_{сп}$=25	
≥6700 (50 В; 11 А)	1600; 130*	≤0,18	—	$t_{сп}$=40	
1000...2500 (1 А) 1000...2500 (1 А)	250** 250**	≤0,35 ≤0,5	— —	≤100; ≤100* ≤100; ≤100*	

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\,max}$, мВт $P^*_{СИ\,т\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^*_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^*_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\,и}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^*_{С\,ост}$, мА
КП705А	с n-каналом	125*	—	1000; 1010*	30	5,4 А; 6* А	≤7; ≤10*
КП705Б		125*	—	800; 840*	30	5,4 А; 7* А	≤7; ≤10*
КП705В		125*	—	800; 800*	30	5,4 А; 7* А	≤15; ≤5*
КП706А	nМОП	100*	—	500	30	22 А	1; 4* (500 В)
КП706Б		100*	—	400	30	22 А	1; 4* (400 В)
КП706В		100*	—	400	30	22 А	1; 4* (400 В)
КП707А	С изолированным затвором, с n-каналом	100*	5	400	±20	25* А	≤25; ≤1*
КП707Б		100*	5	600	±20	16,5* А	≤25; ≤1*
КП707В		100*	5	750	±20	12,5* А	≤25; ≤1*
КП707Г		100*	2...5	700	±20	8* А	≤0,1
КП707Д		100*	2...5	500	±20	8* А	≤0,1
КП707Е		100*	2...5	750	±20	8* А	≤0,1
КП707А1	nМОП	60*	2...5	400	±20	6 (25*) А	≤25* мкА (400 В)
КП707Б1		60*	2...5	600	±20	4 (16,5*) А	≤25* мкА (600 В)
КП707В1		55*	2...5	800	±20	3 (12,5*) А	≤25* мкА (750 В)
КП707Г1		60*	2...5	700	±20	8* А	≤25* мкА (400 В)
КП707Д1		60*	2...5	500	±20	12* А	≤25* мкА (600 В)
КП707Е1		50*	2...5	750	±20	8* А	≤25* мкА (750 В)
КП707А2	nМОП	50*	—	350	±20	2 А	≤0,1; ≤0,1*
КП707В2		50*	2...4,5	800	±20	3,5 (9*) А	≤25* мкА (800 В)
КП708А	С изолированным затвором и n-каналом	75*	2...4,5*	500	±20	4,5 А	0,5
КП708Б		75*	2...4,5*	500	±20	4,5 А	0,5
КП709А	С изолированным затвором, с n-каналом	75*	2...4	600	±20	4,5 А; 18* А	≤0,5
КП709Б		75*	2...4	600	±20	4,5 А; 14* А	≤0,5
КП709В		75*	2...5	600	±20	3,5 А; 16* А	≤0,25 (20 В)
КП709Г		75*	2...5	500	±20	4,5 А; 18* А	≤0,25 (20 В)
КП709Д		75*	2...5	500	±20	4 А; 14* А	≤0,25 (20 В)
КП710	nМОП	36*	2...4	400	±20	2 (6*) А	≤25* мкА (400 В)

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом; $K^{*}_{у.р}$, дБ; $P^{**}_{вых}$, Вт; $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_ш$, дБ; $U^{*}_ш$, мкВ; $E^{**}_ш$, нВ/$\sqrt{Гц}$; Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс; $t^{*}_{выкл}$, нс; $f^{**}_р$, МГц; $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥1000 (30 В; 2 А)	1500 (50 В); 20*	≤4,3	—	≤60; ≤80*	КП705
≥1000 (30 В; 2 А)	1500 (50 В); 20*	≤3,3	—	≤60; ≤80*	
≥1000 (30 В; 2 А)	1500 (50 В); 20*	≤3,3	—	≤60; ≤80*	
2300 (30 В; 2 А)	2500; 300**	0,65	—	70; 100*	КП706
2300 (30 В; 2 А)	2500; 300**	0,44	—	70; 100*	
2300 (30 В; 2 А)	2500; 300**	0,6	—	70; 100*	
≥1600 (20 В; 3 А)	≤1600 (25 В); ≤45*	≤1	—	≤80*	КП707
≥1600 (20 В; 3 А)	≤1600 (25 В); ≤45*	≤2,5	—	≤80*	
≥1600 (20 В; 3 А)	≤1600 (25 В); ≤45*	≤3	—	≤80*	
≥1600 (20 В; 3 А)	≥1200	≤2,5	—	—	
≥1600 (20 В; 3 А)	≥1200	≤1,5	—	—	
≥1600 (20 В; 3 А)	≥1200	≤5	—	—	
≥1600 (20 В; 3 А)	≤2600; 95*	≤1	—	≤80*	КП707-1, КП707-2
≥1600 (20 В; 3 А)	≤2600; 95*	≤2,5	—	≤80*	
≥1600 (20 В; 3 А)	≤2600; 95*	≤3	—	≤80*	
≥1600 (20 В; 3 А)	≤1200	≤2,5	—	—	
≥1600 (20 В; 3 А)	≤2600	≤1,5	—	—	
≥1600 (20 В; 3 А)	≤2600	≤5	—	—	
≥1500	1200; 200**	≤5	—	—	
≥1600 (20 В; 3 А)	1200; 200**	≤2,8			
≥2000 (25 В; 2 А)	≤650; ≤70*	≤0,75	—	≤50	КП708, КП709, КП710
≥2000 (25 В; 2 А)	≤650; ≤70*	≤1	—	≤50	
≥2000 (25 В; 2 А)	≤650 (25 В); ≤70*	≤4,6	—	≤50	
≥2000 (25 В; 2 А)	≤650 (25 В); ≤70*	≤2	—	≤50	
1500 (25 В; 2,5 А)	≤950 (25 В)	≤2,5		≤30; 150*	
1500 (25 В; 2,5 А)	≤950 (25 В)	≤1,5		≤30; 150*	
1500 (25 В; 2,5 А)	≤950 (25 В)	≤2		≤30; 150*	
≥1 (50 В; 1,2 А)	170; 6,3*	≤0,36	—	$t_{сп}$=11	

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^{*}_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^{*}_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^{*}_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_{С}$, $I^{*}_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^{*}_{С\ ост}$, мА
КП7128	С р-каналом	200 Вт	-2...-4*	-100	±20	40 А	—
КП712А	С изолированным затвором, с р-каналом	50*	-2...-5	-80	±20	10 А	≤1
КП712Б		50*	-2...-5	-100	±20	10 А	≤1
КП712В		50*	-2...-5	-100	±20	8 А	≤1
КП7130А	ДМОП, с n-каналом, с обратным диодом	125* Вт	2...4*	600	±30	6,2 А	≤0,1
КП7130Б		125* Вт	2...4*	600	±30	6,2 А	≤0,1
КП7130В		125* Вт	2...4*	550	±30	6,2 А	≤0,1
КП7130А2	ДМОП, с n-каналом, с обратным диодом		2...4*	600	±30	6,8 А	≤0,1
КП7130А9	ДМОП, с n-каналом, с обратным диодом		2...4*	600	±30	6,2 А	≤0,1
КП7131А-9	Сдвоенный, n-канал	2 Вт	1...3*	20	—	3,5 А	—

S, мА/В	$C_{11и}$, $C_{12и}^{*}$, $C_{22и}^{**}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K_{у.р}^{*}$, дБ $P_{вых}^{**}$, Вт $\Delta U_{ЗИ}^{***}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U_{ш}^{*}$, мкВ $E_{ш}^{**}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t_{выкл}^{*}$, нс $f_{р}^{**}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
—	—	0,06	—	—	**КП7128**
≥2000 (4 В; 2 А) ≥2000 (4 В; 2 А) ≥1800 (4 В; 2 А)	≤1800 (25 В); 100* ≤1800 (25 В); 100* ≤1800 (25 В); 100*	≤0,25 ≤0,3 ≤0,4	— — —	130; 350* 130; 350* 130; 350*	**КП712**
4700 4700 4700	1300; 160** 1300; 160** 1300; 160**	1,2 1,5 1,2	— — —	— — —	**КП7130**
4700	1300; 160**	1,2	—	—	**КП7130-2**
4700	1300; 160**	1,2	—	—	**КП7130-9**
≥1100	—	0,1	—	—	**КП7131-9**

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^{*}_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^{*}_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^{*}_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_{С}$, $I^{*}_{С,\ и}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^{*}_{С\ ост}$, мА
КП7132А **КП7132Б**	ДМОП, с n-каналом, с обратным диодом	45* 45*	2...4* 2...4*	70 55	±20 ±20	15 А 15 А	≤1 мкА ≤1 мкА
КП7132А1 **КП7132Б1**	ДМОП, с n-каналом, с обратным диодом и стабилитронами защиты	45* 45*	2...4* 2...4*	70 55	±20 ±20	15 А 15 А	≤1 мкА ≤1 мкА
КП7132А9 **КП7132Б9**	ДМОП, с n-каналом, с обратным диодом	45* 45*	2...4* 2...4*	70 55	±20 ±20	15 А 15 А	≤1 мкА ≤1 мкА
КП7132А91 **КП7132Б91**	ДМОП, с n-каналом, с обратным диодом и стабилитронами защиты	45* 45*	2...4* 2...4*	70 55	±20 ±20	15 А 15 А	≤1 мкА ≤1 мкА
КП7133А	ДМОП, с n-каналом, с обратным диодом	125*	2...4*	200	±20	18 А	—

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у.Р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
—	250; 100** 250; 100**	≤0,09 ≤0,09	—	—	КП7132, КП7132-1
—	250; 160** 250; 160**	≤0,09 ≤0,09	—	—	КП7132 КП7132-1
—	250; 100** 250; 100**	≤0,09 ≤0,09	—	—	КП7132-9, КП7132-91
—	250; 160** 250; 160**	≤0,09 ≤0,09	—	—	КП7132-9 КП7132-91
6700	1300; 430**	≤0,18	—	—	КП7133

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С.\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП7133А9	ДМОП, с n-каналом, с обратным диодом	125*	2...4*	200	±20	18 А	—
КП7134А	С n-каналом	82*	2...4*	200	—	9,3 А	—
КП7135А	С n-каналом	50*	2...4*	200	—	5,2 А	—
КП7136А	С n-каналом	125*	2...4*	400	—	10 А	—
КП7137А	С n-каналом	125*	2...4*	500	—	8 А	—
КП7138А	ДМОП, с n-каналом, с обратным диодом	35*	2...4*	600	±30	1,4 А	≤0,025

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у.P}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
6700	1300; 430**	≤0,18	—	—	**КП7133**
3000	—	0,3	—	—	**КП7134, КП7135**
1300	—	0,8	—	—	
5600	—	0,55	—	—	**КП7136**
4900	—	0,85	—	—	**КП7137**
—	229; 32,5**	≤7	—	—	**КП7138**

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С.\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП7138А9	ДМОП, с n-каналом, с обратным диодом	35*	2...4*	600	±30	1,4 А	≤0,025
КП7138А91	ДМОП, с n-каналом, с обратным диодом	35*	2...4*	600	±30	1,4 А	≤0,025
КП7150А	ДМОП, с n-каналом, с обратным диодом	35*	2...4*	60	±20	50 А	≤0,025
КП7150А2	ДМОП, с n-каналом, с обратным диодом	35*	2...4*	60	±20	50 А	≤0,025
КП7150А9	ДМОП, с n-каналом, с обратным диодом	35*	2...4*	60	±20	50 А	≤0.025

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом; $K^{*}_{у.P}$, дБ; $P^{**}_{вых}$, Вт; $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ; $U^{*}_{ш}$, мкВ; $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$; Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс; $t^{*}_{выкл}$, нс; $f^{**}_{р}$, МГц; $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
—	229; 32,5**	≤7	—	—	КП7138-9
—	229; 32,5**	≤7	—	—	КП7138-91
—	1900; 920**	≤0,028	—	—	КП7150А
—	1900; 920**	≤0,028	—	—	КП7150А2
—	1900; 920**	≤0,028	—	—	КП7150А9

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\,max}$, мВт $P^*_{СИ\,т\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^*_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^*_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\,И}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^*_{С\,ост}$, мА
КП717А	nМОП	150*	—	350	±20	15 А	0,25*
КП717Б		150*	—	400	±20	15 А	0,25*
КП717В		150*	—	350	±20	13 А	0,25*
КП717Г		150*	—	400	±20	13 А	0,25*
КП717Д		150*	—	350	±20	11 А	0,25*
КП717Е		150*	—	400	±20	11 А	0,25*
КП717А1	nМОП	170*	—	350	±20	15 А	0,25*
КП717Б1		170*	—	400	±20	15 А	0,25*
КП717В1		170*	—	350	±20	13 А	0,25*
КП717Г1		170*	—	400	±20	13 А	0,25*
КП717Д1		170*	—	350	±20	11 А	0,25*
КП717Е1		170*	—	400	±20	11 А	0,25*
КП718А	nМОП	125*	—	500	±20	9,6 А	0,25*
КП718Б		125*	—	450	±20	9,6 А	0,25*
КП718В		125*	—	500	±20	8,3 А	0,25*
КП718Г		125*	—	450	±20	8,3 А	0,25*
КП718Д		125*	—	500	±20	10 А	0,25*
КП718Е		125*	—	450	±20	10 А	0,25*
КП718А1	nМОП	125*	—	500	±20	9,6 А	0,25*
КП718Б1		125*	—	450	±20	9,6 А	0,25*
КП718В1		125*	—	500	±20	8,3 А	0,25*
КП718Г1		125*	—	450	±20	8,3 А	0,25*
КП718Д1		125*	—	500	±20	10 А	0,25*
КП718Е1		125*	—	450	±20	10 А	0,25*
КП720	nМОП	50*	2...4	400	±20	3,3 (13*) А	≤25* мкА (400 В)
КП722А	nМОП	125*	—	200	±20	22 А	0,25*
КП723А	nМОП	150*	—	60	±20	35 А	0,25*
КП723Б		150*	—	50	±20	35 А	0,25*
КП723В		150*	—	60	±20	35 А	0,25*
КП723Г		150*	—	50	±20	35 А	0,25*
КП724А	nМОП	125*	—	600	±20	6 А	0,25*
КП724Б		125*	—	500	±20	6 А	0,25*
КП725А	nМОП	125*	—	500	±20	13 А	0,25*

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ отк}$, Ом; $K^{*}_{у.Р}$, дБ; $P^{**}_{вых}$, Вт; $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_ш$, дБ; $U^{*}_ш$, мкВ; $E^{**}_ш$, нВ/$\sqrt{Гц}$; Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс; $t^{*}_{выкл}$, нс; $f^{**}_р$, МГц; $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
$8 \cdot 10^3$	—	0,3	—	—	КП717
8000	—	0,3	—	—	
7000	—	0,35	—	—	
7000	—	0,35	—	—	
6000	—	0,4	—	—	
6000	—	0,4	—	—	
$8 \cdot 10^3$	—	0,3	—	—	КП717-1
8000	—	0,3	—	—	
7000	—	0,35	—	—	
7000	—	0,35	—	—	
6000	—	0,4	—	—	
6000	—	0,4	—	—	
2700	—	0,6	—	—	КП718
2700	—	0,6	—	—	
2700	—	0,8	—	—	
2700	—	0,8	—	—	
2700	—	0,5	—	—	
2700	—	0,5	—	—	
2700	—	0,6	—	—	КП718-1
2700	—	0,6	—	—	
2700	—	0,8	—	—	
2700	—	0,8	—	—	
2700	—	0,5	—	—	
2700	—	0,5	—	—	
≥1700 (50 В; 2 А)	490; 47*	≤1,8	—	$t_{сп}$=15	КП720, КП722
9000	—	0,12	—	—	
10000	—	0,028	—	—	КП723, КП724
10000	—	0,028	—	—	
10000	—	0,035	—	—	
10000	—	0,035	—	—	
2000	—	1,2	—	—	
2000	—	1	—	—	
7800	—	0,4	—	—	КП725

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП726А КП726Б	nМОП	75* 75*	2...4* 2...4*	600 600	±20 ±20	4 А; 16* А 4,5 А; 18* А	0,25* (600 В) 0,25* (600 В)
КП726А1 КП726Б1	nМОП	75* 75*	2...4* 2...4*	600 600	±20 ±20	4 А; 16* А 4,5 А; 18* А	0,25* (600 В) 0,25* (600 В)
КП727А КП727Б КП727В КП727Г КП727Д	nМОП	40* 90* 90* 90* 75*	2...4 2...4 2...4 2...4 2...4	50 50 50 50 50	±20 ±20 ±20 ±20 ±20	14 А 2,6 А 3 А 4 А 3,3 А	≤0,25* ≤0,25* ≤0,25* ≤0,25* ≤0,25*
КП727Е КП727Ж	nМОП	90* 90*	2...4 2...4	50 50	±20 ±20	3 А 2,6 А	≤0,25* ≤0,25*

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{у\,Р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
2500 (25 В; 2,8 А) 2500 (25 В; 2,8 А)	≤1050 ≤1050	≤2 ≤1,6	— —	≤150* ≤150*	**КП726**
2500 (25 В; 2,8 А) 2500 (25 В; 2,8 А)	≤1050 ≤1050	≤2 ≤1,6	— —	≤150* ≤150*	**КП726-1**
≥9300 ≥1000 ≥1000 ≥1500 ≥2100	— — — — —	≤0,1 ≤4 ≤3 ≤2 ≤3	— — — — —	— — — — —	**КП727 (А-Д)**
≥1000 ≥1000	— —	≤3 ≤4	— —	— —	**КП727 (Е, Ж)**

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП728А	пМОП	75*	2...4*	800	±20	3 А	≤0,25*
КП728Г1 КП728С1 КП728Е1	пМОП пМОП пМОП	75* 75* 75*	2...4* 2...4* 2...4*	700 650 600	±20 ±20 ±20	3 А 3 А 3,3 А	— — —
КП728Г2 КП728С2 КП728Е2	пМОП пМОП пМОП	75* 75* 75*	2...4* 2...4* 2...4*	700 650 600	±20 ±20 ±20	3 А 3 А 3,3 А	— — —
КП730	пМОП	74*	2...4	400	±20	5,5 (22*) А	≤25* мкА (400 В)
КП730А	Биполярный транзистор с изолированным затвором с n-каналом	200*	3...5,5	$U_{КЭ}$=1200	$U_{ЗЭ}$=±20	$I_К$=45 (90*) А	≤25* (1200 В)
КП731	Биполярный транзистор с изолированным затвором с n-каналом	160*	3...5,5	$U_{КЭ}$=600	$U_{ЗЭ}$=±20	$I_К$=40 (80*) А	≤25* (600 В)

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{уР}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥1000	—	≤3	—	—	**КП728**
— — —	— — —	5 4 3	— — —	— — —	**КП728 (Г1-Е1)**
— — —	— — —	5 4 3	— — —	— — —	**КП728 (Г2-Е2)**
≥2900 (50 В; 3,3 А)	≤2600; 95*	≤1	—	$t_{сп}$=15	**КП730**
≥7500 (100 В; 25 А)	≤2400; 28*	$U_{КЭН}$=≤0,116	—	≤480*	**КП730А, КП731**
≥9200 (100 В; 24 А)	≤1500; 20*	$U_{КЭН}$=≤0,15	—	≤410*	

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^{*}_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^{*}_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^{*}_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_{С}$, $I^{*}_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^{*}_{С\ ост}$, мА
КП731А **КП731Б** **КП731В**	С изолированным затвором, n-каналом, с защитным диодом	36 Вт 36 Вт 36 Вт	2...4 2...4 2...4	400 350 400	±20 ±20 ±20	2 А 2 А 1,7 А	≤0,25 (400 В) ≤0,25 (350 В) ≤0,25 (400 В)
КП733А **КП733Б** **КП733Г** **КП733Д**	nМОП	125* 125* 125* 125*	2...4* 1...2* 2...4* 2...4*	400 400 600 650	±20 ±20 ±20 ±20	1,5 (6*) А 1,5 (6*) А 5* А 4* А	≤0,1* ≤0,1* ≤0,1* ≤0,1*
КП733В-1	nМОП	1*	2...4*	550	±20	500 (2000*)	≤0,1* (550 В)
КП734А **КП734Б** **КП734В**	nМОП nМОП nМОП	72* 72* 72*	1...2 1...2 1...2	60; 60* 60; 60* 15; 15*	±10 ±10 ±10	19 А 18 А 19 А	≤0,25 ≤0,25 ≤0,25
КП734А-1 **КП734Б-1**	nМОП nМОП	72* 72*	1...2 1...2	60; 60* 60; 60*	±10 ±10	19 А 18 А	≤0,25 ≤0,25

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{у.Р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥1000 (25 В; 1,2 А)	≤250; 20*	≤3,6	—	≤45*	КП731
≥1000 (25 В; 1,2 А)	≤250; 20*	≤3,6	—	≤45*	
≥1000 (25 В; 1,2 А)	≤250; 20*	≤5	—	≤45*	
≥500 (20 В; 1 А)	≤400; 15*	≤3,6	—	$t_{сп}$≤80	КП733
≥500 (20 В; 1 А)	≤400; 15*	≤3,6	—	$t_{сп}$≤80	
≥500 (20 В; 1 А)	≤400; 15*	≤4,4	—	$t_{сп}$≤80	
≥500 (20 В; 1 А)	≤400; 15*	≤5	—	$t_{сп}$≤80	
≥500 (20 В; 1 А)	≤150** (25 В); ≤15* (25 В);	≤10	—	$t_{сп}$≤80	КП733-1
—	≤1000; 400**	≤0,05	—	—	КП734
—	≤1000; 400**	≤0,06	—	—	
—	≤1000; 400**	≤0,02	—	—	
			—	—	
			—	—	
			—	—	
			—	—	
			—	—	
—	≤1000; 400**	≤0,05	—	—	КП734-1
—	≤1000; 200*	≤0,06	—	—	
			—	—	
			—	—	
			—	—	

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С.И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП735А **КП735Б** **КП735В** **КП735Г**	пМОП пМОП пМОП пМОП	100* 100* 100* 100*	2...4 2...4 2...4 2...4	60; 60* 60; 60* 50; 50* 50; 50*	±20 ±20 ±20 ±20	48 А 42 А 48 А 42 А	≤0,25 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,25
КП737А **КП737Б** **КП737В** **КП737Г**	С изолированным затвором, n-каналом, с защитным диодом	74 Вт 74 Вт 74 Вт 74 Вт	2...4 2...4 2...4 1...2*	200 250 250 200	±20 ±20 ±20 ±10	9 А 8,1 А 6,5 А 9 А	≤0,25 (200 В) ≤0,25 (250 В) ≤0,25 (250 В) —
КП739А **КП739Б** **КП739В**	С изолированным затвором, n-каналом, с защитным диодом	43 Вт 43 Вт 43 Вт	2...4 2...4 2...4	60 60 60	±20 ±20 ±20	10 А 10 А 8,3 А	— — —
КП740	пМОП	125*	2...4	400	±20	10 (40*) А	≤25* мкА (400 В)
КП740А **КП740Б** **КП740В**	С изолированным затвором, n-каналом, с защитным диодом	60 Вт 60 Вт 60 Вт	2...4 2...4 2...4	60 50 60	±20 ±20 ±20	17 А 17 А 14 А	— — —

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{у.р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_ш$, дБ $U^{*}_ш$, мкВ $E^{**}_ш$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_р$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°C	Корпус
— — — —	≤1800; 800* ≤1800; 800* ≤1800; 800* ≤1800; 800*	≤0,025 ≤0,028 ≤0,025 ≤0,025	— — — — —	— — — — —	КП735
≥3800 (25 В; 5,4 А) ≥3600 (25 В; 5,1 А) ≥2500 (25 В; 4,1 А) —	≤1300 (25 В) ≤1300 (25 В) ≤1300 (25 В) —	≤0,4 ≤0,45 ≤0,68 0,4	— — — —	≤59* ≤62* ≤62* —	КП737
≥6000 (6 В) ≥2400 (50 В; 6 А) ≥2400 (50 В; 5,8 А)	— — —	≤0,2 ≤0,2 ≤0,3	— — —	— — —	КП739
≥5800 (50 В; 6 А)	≤1400; 120*	≤0,55	—	$t_{сп}$=24	КП740
≥4500 (25 В; 10 А) ≥5000 (1,5 В; 9 А) —	— — —	≤0,1 ≤0,1 ≤0,12	— — —	— — —	КП740 (А-В)

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП741А КП741Б	С изолированным затвором, n-каналом, с защитным диодом	190 Вт 150 Вт	2...4 2...4	60 50	±20 ±20	50 А 50 А	— —
КП742А КП742Б	С изолированным затвором, n-каналом, с защитным диодом	200 Вт 200 Вт	2...4 2...4	60 50	±20 ±20	75 А 80 А	— —
КП743А КП743Б КП743В	nМОП nМОП nМОП	43 Вт 43 Вт 43 Вт	2...4 2...4 2...4	100 80 100	±20 ±20 ±20	5,6 А 5,6 А 4,9 А	— — —
КП743А1	nМОП	40 Вт	2...4*	100	±20	5,5 А	—
КП744А КП744Б КП744В КП744Г	nМОП nМОП nМОП nМОП	60 Вт 60 Вт 60 Вт 60 Вт	2...4 2...4 2...4 1...2	100 80 100 100	±20 ±20 ±20 ±10	9,2 А 9,2 А 8 А 9,2 А	— — — —
КП745А КП745Б КП745В КП745Г	nМОП nМОП nМОП nМОП	88 Вт 88 Вт 88 Вт 88 Вт	2...4 2...4 2...4 1...2	100 80 100 100	±20 ±20 ±20 ±10	14 А 14 А 12 А 15 А	— — — —

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{у.р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс f^{**}_{p}, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥27000 (25 В; 43 А) ≥27000 (25 В; 32 А)	— —	≤0,018 ≤0,024	— —	— —	КП741
≥25000 (40 А) —	— —	≤0,014 ≤0,012	— —	— —	КП742
≥1300 (50 В; 3,4 А) ≥1300 (50 В; 3,4 А) ≥1300 (50 В; 3,4 А)	— — —	≤0,54 ≤0,54 ≤0,74	— — —	— — —	КП743
—	—	0,54	—	—	КП743-1
≥1500 (24 В; 4 А) ≥2700 (50 В; 5,6 А) ≥2700 (50 В; 5,6 А) ≥3200 (50 В; 5,5 А)	— — — —	≤0,27 ≤0,27 ≤0,36 ≤0,27	— — — —	— — — —	КП744, КП745
≥5100 (50 В; 8,3 А) ≥5100 (50 В; 8,3 А) ≥5100 (50 В; 8,3 А) ≥6400 (50 В; 9 А)	— — — —	≤0,16 ≤0,16 ≤0,23 ≤0,22	— — — —	— — — —	

Тип прибора	Структура	$P_{СИ max}$, мВт $P^{*}_{СИ т max}$, Вт	$U_{ЗИ отс}$, $U^{*}_{ЗИ пор}$, В	$U_{СИ max}$, $U^{*}_{ЗС max}$, В	$U_{ЗИ max}$, В	$I_{С}$, $I^{*}_{С, И}$, мА	$I_{С нач}$, $I^{*}_{С ост}$, мА
КП746А	пМОП	150 Вт	2...4	100	±20	28 А	—
КП746Б	пМОП	150 Вт	2...4	80	±20	28 А	—
КП746В	пМОП	150 Вт	2...4	100	±20	25 А	—
КП746Г	пМОП	150 Вт	1...2	100	±10	28 А	—
КП746А1	С п-каналом	150 Вт	2...4*	100	±20	28 А	—
КП746Б1	С п-каналом	150 Вт	2...4*	80	±20	28 А	—
КП746В1	С п-каналом	150 Вт	2...4*	100	±20	25 А	—
КП746Г1	С п-каналом	150 Вт	1...2*	100	±10	28 А	—
КП747А	пМОП	230 Вт	2...4	100	±20	41 А	—
КП748А	пМОП	50 Вт	2...4	200	±20	3,3 А	—
КП748Б	пМОП	50 Вт	2...4	150	±20	3,3 А	—
КП748В	пМОП	50 Вт	2...4	200	±20	2,6 А	—
КП749А	пМОП	50 Вт	2...4	200	±20	5,2 А	—
КП749Б	пМОП	50 Вт	2...4	150	±20	5,2 А	—
КП749В	пМОП	50 Вт	2...4	200	±20	4 А	—
КП750А	пМОП	125 Вт	2...4	200	±20	18 А	—
КП750Б	пМОП	125 Вт	2...4	150	±20	18 А	—
КП750В	пМОП	125 Вт	2...4	200	±20	16 А	—
КП750Г	пМОП	125 Вт	1...2	200	±10	18 А	—

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^*_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^*_{у.Р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_ш$, дБ $U^*_ш$, мкВ $E^{**}_ш$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^*_{выкл}$, нс $f^{**}_р$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥8700 (50 В; 17 А) ≥8700 (50 В; 17 А) ≥8700 (50 В; 17 А) ≥12000 (50 В; 17 А)	— — — —	≤0,077 ≤0,077 ≤0,1 ≤0,077	— — — —	— — — —	КП746
≥8700 (50 В; 17 А) ≥8700 (50 В; 17 А) ≥8700 (50 В; 17 А) —	— — — —	≤0,077 ≤0,077 ≤0,1 ≤0,077	— — — —	— — — —	КП746-1
≥1300 (20 А)	—	≤0,055	—	—	КП747
≥800 (50 В; 1,6 А) ≥800 (50 В; 1,6 А) ≥800 (50 В; 1,6 А)	— — —	≤1,5 ≤1,5 ≤2,4	—	—	КП748
≥1300 (2,5 А) ≥1300 (2,5 А) ≥1300 (2,5 А)	— — —	≤0,8 ≤0,8 ≤1,2	—	—	КП749, КП750
≥6700 (50 В; 10 А) ≥6700 (50 В; 10 А) ≥6700 (50 В; 10 А) ≥9000 (5 В; 8 А)	— — — —	≤0,18 ≤0,18 ≤0,22 ≤0,18	— — — —	— — — —	

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	I_C, $I^*_{С\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП750А1	С n-каналом	125 Вт	2...4*	200	±20	18 А	—
КП750Б1	С n-каналом	125 Вт	2...4*	150	±20	18 А	—
КП750В1	С n-каналом	125 Вт	2...4*	200	±20	16 А	—
КП751А	nМОП	50 Вт	2...4*	400	±20	3,3 А	—
КП751Б	nМОП	50 Вт	2...4*	350	±20	3,3 А	—
КП751В	nМОП	50 Вт	2...4*	400	±20	2,8 А	—
КП751А1	nМОП	50 Вт	2...4*	400	±20	3,3 А	—
КП751Б1	nМОП	50 Вт	2...4*	350	±20	3,3 А	—
КП751В1	nМОП	50 Вт	2...4*	400	±20	2,8 А	—
КП752А	nМОП	74 Вт	2...4	400	±20	5,5 А	—
КП752Б	nМОП	74 Вт	2...4	350	±20	5,5 А	—
КП752В	nМОП	74 Вт	2...4	400	±20	4,5 А	—
КП753А	nМОП	74 Вт	2...4	500	±20	4,5 А	—
КП753Б	nМОП	74 Вт	2...4	450	±20	4,5 А	—
КП753В	nМОП	74 Вт	2...4	500	±20	4 А	—

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{у.р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥6700 (50 В; 10 А) ≥6700 (50 В; 10 А) ≥6700 (50 В; 10 А)	— — —	≤0,18 ≤0,18 ≤0,22	— — —	— — —	КП750-1
≥1800 (50 В; 1,8 А) ≥1800 (50 В; 1,8 А) ≥1800 (50 В; 1,8 А)	— — —	≤1,8 ≤1,8 ≤2,5	— — —	— — —	КП751
≥1800 (50 В; 1,8 А) ≥1800 (50 В; 1,8 А) ≥1800 (50 В; 1,8 А)	— — —	≤1,8 ≤1,8 ≤2,5	— — —	— — —	КП751-1
≥2900 (50 В; 3 А) ≥2900 (50 В; 3 А) ≥2900 (50 В; 3 А)	— — —	≤1 ≤1 ≤1,5	— — —	— — —	КП752
≥2700 (50 В; 2,5 А) ≥2700 (50 В; 2,5 А) ≥2700 (50 В; 2,5 А)	— — —	≤1,5 ≤1,5 ≤2	— — —	— — —	КП753

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^{*}_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^{*}_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^{*}_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_{С}$, $I^{*}_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^{*}_{С\ ост}$, мА
КП759А	пМОП	50*	2...4	500	±20	2,5 А	—
КП759Б	пМОП	50*	2...4	450	±20	2,5 А	—
КП759В	пМОП	50*	2...4	500	±20	2,5 А	—
КП759Г	пМОП	50*	2...4	450	±20	2,5 А	—
КП760А	пМОП	74*	2...4	500	±20	4,5 А	—
КП760Б	пМОП	74*	2...4	450	±20	4,5 А	—
КП760В	пМОП	74*	2...4	500	±20	4,5 А	—
КП760Г	пМОП	74*	2...4	450	±20	4,5 А	—
КП761А	пМОП	125	2...4	500	±20	8 А	—
КП761Б	пМОП	125	2...4	450	±20	8 А	—
КП761В	пМОП	125	2...4	500	±20	8 А	—
КП761Г	пМОП	125	2...4	450	±20	8 А	—
КП771А	С п-каналом	150 Вт	2...4*	100	±20	40 А	—
КП771Б	С п-каналом	150 Вт	2...4*	100	±20	35 А	—
КП771В	С п-каналом	150 Вт	2...4*	125	±20	30 А	—
КП775А	пМОП	200 Вт	1...2	60	±20	50 А	—
КП775Б	пМОП	200 Вт	1...2	55	±20	50 А	—
КП775В	пМОП	200 Вт	1...2	60	±20	50 А	—
КП776А	пМОП	125 Вт	2...4	400	±20	10 А	—
КП776Б	пМОП	125 Вт	2...4	350	±20	10 А	—
КП776В	пМОП	125 Вт	2...4	400	±20	8,3 А	—
КП776Г	пМОП	125 Вт	2...4	450	±20	8,8 А	—
КП777А	пМОП	125 Вт	2...4	500	±20	8 А	—
КП777Б	пМОП	125 Вт	2...4	450	±20	8 А	—
КП777В	пМОП	125 Вт	2...4	500	±20	7 А	—

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{уР}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$К_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
— — — —	360; 92** 360; 92** 360; 92** 360; 92**	≤3 ≤3 ≤4 ≤4	— — —	— — —	КП759, КП760
— — — —	610; 68* 610; 160** 610; 68* 610; 160**	≤1,5 ≤1,5 ≤2 ≤2	— — —	— — —	
— — — —	1300; 120* 1300; 310** 1300; 120* 1300; 310**	≤0,85 ≤0,85 ≤1,1 ≤1,1	— — — — — —	— — — — — —	КП761, КП771
— — —	— — —	0,04 0,055 0,077	— — —	— — —	
— — —	— — —	≤0,09 ≤0,09 ≤0,011	— — —	— — —	КП775
≥5800 (50 В; 5,2 А) ≥5800 (50 В; 5,2 А) ≥5800 (50 В; 5,2 А) ≥4500 (50 В; 5,3 А)	— — — —	≤0,55 ≤0,55 ≤0,8 ≤0,63	— — — —	— — — —	КП776
≥4900 (50 В; 4,4 А) ≥4900 (50 В; 4,4 А) ≥4900 (50 В; 4,4 А)	— — —	≤0,85 ≤0,85 ≤1,1	— — —	— — —	КП777

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП778А	пМОП	190 Вт	2...4	200	±20	30 А	—
КП779А	пМОП	190 Вт	2...4	500	±20	14 А	—
КП780А **КП780Б** **КП780В**	пМОП пМОП пМОП	50 Вт 50 Вт 50 Вт	2...4* 2...4* 2...4*	500 450 500	±20 ±20 ±20	2,5 А 2,5 А 2,2 А	— — —
КП780АС1	С п-каналом	50 Вт	2...4*	500	±20	2,4 А	—
КП781А	пМОП	190 Вт	2...4	400	±20	16 А	—

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ отк}$, Ом $K^{*}_{у.Р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{Ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс f^{**}_{p}, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°C	Корпус
—	—	≤0,085	—	—	КП778
≥9000 (15 В; 19 А)	—	≤0,4	—	—	КП779
≥5500 (15 В; 7,5 А) ≥1500 (15 В; 1,4 А) —	— — —	≤3 ≤3 ≤4	— — —	— — —	КП780
—	—	3	—	—	КП780-1
≥8000 (8 А)	—	≤0,3	—	—	КП781

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\,max}$, мВт $P^*_{СИ\,т\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^*_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^*_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\,И}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^*_{С\,ост}$, мА
КП783А	пМОП	200 Вт	2...4	55	±20	70 А	—
КП784А	рМОП	88 Вт	-2...-4	-60	±20	18 А	—
КП785А	рМОП	150 Вт	-2...-4	-100	±20	19 А	—
КП786А	пМОП	100 Вт	2...4	800	±20	4 А	—
КП787А	пМОП	150 Вт	2...4	600	±20	8 А	—
КП796А	С р-каналом	74*	-(2...4*)	-250	±20	4,1 А	—
КП801А **КП801Б** **КП801В** **КП801Г**	С р-п-переходом и п-каналом	60* 60* 100* 100*	-30 -30 -30 -30	75; 110* 75; 90* 110; 150* 140; 180*	-35 -35 -40 -40	5 А 5 А 8 А 8 А	4500 4500 3500 3000

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у\ р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{Ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥44000 (25 В; 59 А)	—	≤0,008	—	—	КП783, КП784
≥5900 (25 В; 11 А)	—	≤0,14	—	—	
≥6200 (50 В; 11 А)	—	≤0,2	—	—	КП785, КП786
≥1000 (25 В; 1,5 А)	—	≤3	—	—	
≥5000 (25 В; 5 А)	—	≤0,9	—	—	КП787
2200	—	1	—	—	КП796
≥600 (15 В; 4 А) ≥450 (15 В; 3 А) ≥800 (20 В; 4 А) ≥600 (20 В; 4 А)	— — — —	≤2,2 ≤4,4 ≤2,2 ≤2,2	— — — —	— — — —	КП801

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП802А КП802Б	С p-n-переходом и n-каналом	40* 40*	-25 -28	500; 535* 450: 480*	-35 -30	2,5 А 2,5 А	0,5* 0,5*
КП804А	С изолированным затвором, с n-каналом	2*	≤4*	60	20	1 А	≤0,25; ≤1*
КП805А КП805Б КП805В	С изолированным затвором, с n-каналом	60* 60* 60*	≤4* ≤4* ≤4*	600: 600* 600; 600* 500: 500*	±20 ±20 ±20	4 А 4 А 4 А	≤1; ≤3* ≤1; ≤3* ≤1; ≤3*
КП809А КП809Б КП809В КП809Г КП809Д КП809Е КП809К	nМОП	100* 100* 100* 100* 100* 100* 150*	1,5...5 — — — — — —	400 500 600 700 800 750 400	±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20	9,6 (35*) А 9,6 (35*) А 9,6 (35*) А 9,6 (35*) А 9,6 (35*) А 9,6 (35*) А 20* А	≤1 мА (400 В) ≤0,25; ≤1* ≤0,25: ≤1* ≤0,25; ≤1* ≤0,25: ≤1* ≤0,25: ≤1* ≤0,25: ≤1*
КП809А1 КП809Б1 КП809В1 КП809Г1 КП809Д1 КП809Е1	nМОП	50* 50* 50* 50* 50* 50*	— — — — — —	400 500 600 700 800 750	±20 ±20 ±20 ±20 ±20 ±20	9,6 (35*) А 9,6 (35*) А 9,6 (35*) А 9,6 (35*) А 9,6 (35*) А 9,6 (35*) А	≤0,25; ≤1* ≤0,25; ≤1* ≤0,25; ≤1* ≤0,25; ≤1* ≤0,25; ≤1* ≤0,25; ≤1*
КП810А КП810Б КП810В	Биполярный со статической индукцией, n-канал	50* 50* 50*	— — —	1500 1300 1100	5 5 5	7 А 7 А 5 А	— — —
КП812А1 КП812Б1 КП812В1	nМОП	125* 80* 70*	2...4* 2...4* 2...4*	60 60 60	±20 ±20 ±20	50 (200*) А 35 (68*) А 30 (120*) А	≤0,25*(60 В) ≤0,25*(60 В) ≤0,25*(60 В)

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{уР}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_ш$, дБ $U^{*}_ш$, мкВ $E^{**}_ш$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_р$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥800 (20 В; 3,5 А)	—	≤3	—	≤80;≤30*	**КП802**
≥800 (20 В; 3,5 А)	—	≤3	—	≤80;≤30*	
≥800 (10 В; 0,8 А)	≤200 (25 В) ≤25*; ≤100**	≤0,6	—	≤54; ≤45*	**КП804**
≥2500 (20 В; 2 А)	≤1300 (20 В); ≤40*	≤2	—	≤180; ≤220*	**КП805**
≥2500 (20 В; 2 А)	≤1300 (20 В); ≤40*	≤2	—	≤180; ≤220*	
≥2500 (20 В; 2 А)	≤1300 (20 В); ≤40* ≤130**	≤2,5	—	≤180; ≤220*	
≥1500 (20 В; 3 А)	≤3000; ≤220*	≤0,3	—	$t_{сп}$≤100	**КП809**
≥1500 (20 В; 3 А)	≤3000; ≤220*	≤0,6	—	$t_{сп}$≤100	
≥1500 (20 В; 3 А)	≤3000; ≤220*	≤1,2	—	$t_{сп}$≤100	
≥1500 (20 В; 3 А)	≤3000; ≤220*	≤1,5	—	$t_{сп}$≤100	
≥1500 (20 В; 3 А)	≤3000; ≤220*	≤1,8	—	$t_{сп}$≤100	
≥1500 (20 В; 3 А)	≤3000; ≤220*	≤2,5	—	$t_{сп}$≤100	
≥1500 (20 В; 3 А)	≤3000; ≤220*	≤0,15	—	$t_{сп}$≤100	
≥1500 (20 В; 3 А)	≤3000; ≤220*	≤0,3	—	$t_{сп}$≤100	**КП809-1, КП810**
≥1500 (20 В; 3 А)	≤3000; ≤220*	≤0.6	—	$t_{сп}$≤100	
≥1500 (20 В; 3 А)	≤3000; ≤220*	≤1,2	—	$t_{сп}$≤100	
≥1500 (20 В; 3 А)	≤3000; ≤220*	≤1,5	—	$t_{сп}$≤100	
≥1500 (20 В; 3 А)	≤3000; ≤220*	≤1,8	—	$t_{сп}$≤100	
≥1500 (20 В; 3 А)	≤3000; ≤220*	≤2,5	—	$t_{сп}$≤100	
—	—	0,2	—	200	
—	—	0,2	—	200	
—	—	0,2	—	200	
≥15000 (25 В; 31 А)	1900; 920**	≤0,028	—	$t_{сп}$=92	**КП812-1**
≥5500 (25 В; 24 А)	640; 360**	≤0,035	—	$t_{сп}$=42	
≥9300 (25 В; 18 А)	1200; 600**	≤0,05	—	$t_{сп}$=52	

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП813А **КП813Б** **КП813Г**	С изолированным затвором и n-каналом	150* 150* 150*	2,1...4 2,1...4 2,1...4	200 200 200	±20 ±20 ±20	22 (88*) А 22 (88*) А 20 А	≤0,25*(200 В) ≤0,25*(200 В) ≤0,25*(200 В)
КП813А1 **КП813Б1**	С изолированным затвором и n-каналом	125* 125*	2,1...4 2,1...4	200 200	±20 ±20	22 (88*) А 22 (88*) А	≤0,25*(200 В) ≤0,25*(200 В)
КП813А1-5 **КП813Б1-5**	С изолированным затвором и n-каналом	125* 125*	2,1...4 2,1...4	200 200	±20 ±20	22 (88*) А 22 (88*) А	≤0,25*(200 В) ≤0,25*(200 В)
КП814А	МОП, n-канал	—	—	300	25	10 А	≤6
КП814Б	МОП, n-канал	—	—	300	25	12 А	≤6
КП814В	МОП, n-канал	—	—	400	25	8 А	≤6
КП814Г	МОП, n-канал	—	—	400	25	10 А	≤6
КП814Д	МОП, n-канал	—	—	500	25	7 А	≤6
КП814Е	МОП, n-канал	—	—	500	25	10 А	≤6
КП814Ж	МОП, n-канал	—	—	600	25	6 А	≤6
КП814И	МОП, n-канал	—	—	600	25	8 А	≤6
КП814К	МОП, n-канал	—	—	700	25	5 А	≤6
КП814Л	МОП, n-канал	—	—	700	25	6 А	≤6
КП814М	МОП, n-канал	—	—	800	25	3 А	≤6
КП814Н	МОП, n-канал	—	—	800	25	4 А	≤6
КП814П	МОП, n-канал	—	—	900	25	3 А	≤6
КП814Р	МОП, n-канал	—	—	900	25	3,8 А	≤6
КП814С	МОП, n-канал	—	—	950	25	3 А	≤6
КП814Т	МОП, n-канал	—	—	950	25	3,6 А	≤6
КП814У	МОП, n-канал	—	—	1000	25	3 А	≤6
КП814Ф	МОП, n-канал	—	—	1000	25	3,6 А	≤6
КП817А	pМОП	—	—	30	—	200*	—
КП817Б	pМОП	—	—	40	—	150*	—
КП817В	pМОП	—	—	60	—	100*	—

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у\ р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥9000 (20 В; 10 А) ≥9000 (20 В; 10 А) ≥9000 (20 В; 10 А)	2700; 540** 2700; 540** 2700; 540**	≤0,12 ≤0,12 ≤0,06	— — —	$t_{сп}$≤140 $t_{сп}$≤140 $t_{сп}$≤140	**КП813**
≥5500 (20 В; 10 А) ≥5500 (20 В; 10 А)	2700; 540** 2700; 540**	≤0,12 ≤0,18	— —	$t_{сп}$≤140 $t_{сп}$≤140	**КП813-1**
≥5500 (20 В; 10 А) ≥5500 (20 В; 10 А)	2700; 540** 2700; 540**	≤0,12 ≤0,18	— —	$t_{сп}$≤140 $t_{сп}$≤140	**КП813-5**
1300...3000(30В;2,5А) 1300...3000(30В;2,5А) 1300...3000(30В;2,5А) 1300...3000(30В;2,5А) 1300...3000(30В;2,5А) 1300...3000(30В;2,5А) 1300...3000(30В;2,5А) 1300...3000(30В;2,5А) 1300...3000(30В;2,5А) 1300...3000(30В;2,5А) 1300...3000(30В;2,5А) 1300...3000(30В;2,5А) 1300...3000(30В;2,5А) 1300...3000(30В;2,5А) 1300...3000(30В;2,5А) 1300...3000(30В;2,5А) 1300...3000(30В;2,5А) 1300...3000(30В;2,5А)	— — — — — — — — — — — — — — — — — —	≤1 ≤0,8 ≤1,5 ≤1,2 ≤2 ≤1,3 ≤2,3 ≤1,8 ≤3 ≤2,5 ≤4,2 ≤3 ≤4,5 ≤4 ≤4,5 ≤4 ≤4,7 ≤4	— — — — — —	— — — — — —	**КП814**
— — —	— — —	≤0,04 ≤0,05 ≤0,15	— — — — — —	— — — — — —	**КП817**

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^{*}_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^{*}_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^{*}_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_{С}$, $I^{*}_{С\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^{*}_{С\ ост}$, мА
КП820	nМОП	50*	2...4	500	±20	2,5 (8*) А	≤0,25*(500 В)
КП830		74*	2...4	500	±20	4,5 (18*) А	≤0,25*(500 В)
КП840		125*	2...4	500	±20	8 (32*) А	≤0,25*(500 В)
КП901А	С изолированным затвором и индуцированным n-каналом	20*	—	70; 85*	30	4 А	≤200; ≤50*
КП901Б		20*	—	70; 85*	30	4 А	≤200; ≤50*
КП902А	С изолированным затвором и n-каналом	3,5*	—	50	30	200	≤10; ≤0,5*
КП902Б		3,5*	—	50	30	200	≤10; ≤0,5*
КП902В		3,5*	—	50	30	200	≤10; ≤0,5*
КП903А	С p-n-переходом и n-каналом	6*	5...12	20; 20*	15	700	≤700; ≤0,05*
КП903Б		6*	1...6,5	20; 20*	15	700	≤480; ≤0,05*
КП903В		6*	1...10	20; 20*	15	700	≤600; ≤0,05*
КП904А	С изолированным затвором и индуцированным n-каналом	75*	—	70; 90*	30	5 А	≤350; ≤200*
КП904Б		75*	—	70; 90*	30	3 А	≤350; ≤200*
КП905А	С изолированным затвором и n-каналом	4*	—	60; 70*	±30	350	≤20; ≤1*
КП905Б		4*	—	60; 70*	±30	350	≤20; ≤1*
КП905В		4*	—	60; 70*	±30	350	≤20; ≤1*
КП907А	С изолированным затвором и n-каналом	11,5*	—	60; 70*	±30	2,7 А	≤100; ≤10*
КП907Б		11,5*	—	60; 70*	±30	1,7 А	≤100; ≤10*
КП907В		11,5*	—	60; 70*	±30	1,3 А	≤100; ≤10*

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у\ р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{Ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥1500 (50 В; 1,5 А) ≥2500 (50 В; 2,7 А) ≥4900 (50 В; 4,8 А)	360; 92** 610; 160** 1300; 310**	≤3 ≤1,5 ≤0,85	— — —	$t_{сп}$=16 $t_{сп}$=16 $t_{сп}$=20	**КП820, КП830, КП840**
50...160 (20 В; 0,5 А) 60...170 (20 В; 0,5 А)	≤100; ≤10* ≤10*	≥7* (100 МГц) ≥10** (100 МГц) ≥6,7** (100 МГц)	— —	— —	**КП901**
10...25 (20 В; 50 мА) 10...25 (20 В; 50 мА) 10...25 (20 В; 50 мА)	≤11; ≤0,6*; ≤11** ≤11; ≤0,6*; ≤11** ≤11; ≤0,8*; ≤11**	≥6,6* (250 МГц) ≥0,8** (60 МГц) ≥0,8** (60 МГц) ≥0,8** (60 МГц)	≤6 (250 МГц) — ≤8 (250 МГц)	— — —	**КП902**
85...140 (8 В) 50...130 (8 В) 60...140 (8 В)	≤18 ≤18 ≤18	≥0,09** (30 МГц); ≤10; ≥7,6* ≥0,09* (30 МГц); ≤10; ≥7,6* ≥0,09** (30 МГц); ≤10; ≥7,6*	≤5** (100 кГц) ≤5* (100 кГц) ≤5** (100 кГц)	— — —	**КП903**
250...510 250...510	≤300 (30 В) ≤300 (30 В)	≥50** (60 МГц) ≥30** (60 МГц) ≥13* (60 МГц)	— —	— —	**КП904**
18...39 (20 В; 50 мА) 18...39 (20 В; 50 мА) 18...39 (20 В; 50 мА)	≤7; ≤0,6*; ≤4** ≤11; ≤0,6*; ≤4** ≤13; ≤0,8*; ≤6**	≥1**; ≥8* (1 ГГц) ≥6* (1 ГГц) ≥4* (1 ГГц)	— ≤6,5 (1000 МГц) —	— — —	**КП905, КП907**
110...200 (20 В; 0,5 А) 100...200 (20 В; 0,5 А) 80...110 (20 В; 0,5 А)	≤3* (25 В) ≤3* (25 В) ≤3* (25 В)	≥4** (1 ГГц) ≥3** (1 ГГц) ≥5** (0,4 ГГц)	— — —	≤2; ≤2* ≤2; ≤2* ≤2; ≤2*	

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С.\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП908А	С изолированным затвором и индуцированным n-каналом	3,5*	—	40; 50*	20	280	≤25; ≤0,5*
КП908Б		3,5*	—	40; 50*	20	200	≤25; ≤0,2*
КП921А	С изолированным затвором и индуцированным каналом n-типа	15*	—	45	40 (имп.)	10 А	≤2,5 (40 В)
КП921Б		15*	2...8	40	±40	7 А	≤2,5 (40 В)
КП922А	С изолированным затвором и индуцированным n-каналом	60*	2...8*	100	±30	10 А	2
КП922Б		60*	2...8*	100	±30	10 А	2
КП922В		60*	2...8*	100	±30	10 А	2
КП922А1	С изолированным затвором и индуцированным n-каналом	60*	2...8*	100	±30	10 А	2
КП922Б1		60*	2...8*	100	±30	10 А	2
КП922В1		60*	2...8*	100	±30	10 А	2
КП922Г1		60*	2...8*	100	±30	10 А	2
КП923А	С изолированным затвором и n-каналом	100*	—	50; 60*	20	12 А	≤50; ≤50*
КП923Б		100*	—	50; 60*	20	8 А	≤50; ≤50*
КП923В		50*	—	50; 60*	20	6 А	≤25; ≤25*
КП923Г		50*	—	50; 60*	20	4А	≤25; ≤25*
КП928А	С изолированным затвором и каналом n-типа	250*	—	50; 60*	25	21 А	≤150; ≤150*
КП928Б		250*	—	55; 65*	25	16 А	≤150; ≤150*

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{у.Р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥24 (20 В; 80 мА) ≥24 (20 В; 80 мА)	≤4,5 (25 В); ≤0,6* ≤6,5 (25 В); ≤0,6*	≥1** (1,76 ГГц) ≤25	— —	— —	КП908
800...1500 (25 В; 1 А) ≥800 (25 В; 1 А)	— ≤2000; ≤280**	≤0,13 ≤0,2	— —	— ≤100*	КП921
1000...2100 (1 А) 1000...2100 (1 А) 1000...2100 (1 А)	≤2000 (20 В) ≤2000 (20 В) ≤2000 (20 В)	≤0,2 ≤0,4 ≤1	— — —	≤100; ≤100* ≤100; ≤100* ≤100; ≤100*	КП922
1000...2100 (1 А) 1000...2100 (1 А) 1000...2100 (1 А) 1000...2100 (1 А)	≤2000 (20 В) ≤2000 (20 В) ≤2000 (20 В) ≤2000 (20 В)	≤0,2 ≤0,4 ≤1 ≤0,17	— — — —	≤100; ≤100* ≤100; ≤100* ≤100; ≤100* ≤100; ≤100*	КП922-1
≥1000 (20 В; 3 А) ≥700 (20 В; 3 А) ≥550 (20 В; 2 А) ≥350 (20 В; 2 А)	≤400 (10 В) ≤400 (10 В) ≤220 (10 В) ≤220 (10 В)	≥50** (1 ГГц); ≥4* ≥25** (1 ГГц) ≥4* ≤1; ≥25** (1 ГГц) ≥4* ≤3; ≥17** (1 ГГц) ≥4*	— — — —	— — — —	КП923
1800 (20 В; 3 А) 1800 (20 В; 3 А)	530 (10 В); 50* 530 (10 В); 50*	≤0,4; ≥6,2* ≥250** (0,4 ГГц) ≤0,4; ≥6* ≥200** (0,4 ГГц)	— —	— —	КП928

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С.\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП931А	nМОП	20*	800	—	5 А	—	—
КП931Б	nМОП	20*	600	—	5 А	—	—
КП931В	nМОП	20*	450	—	5 А	—	—
КП932А	nМОП	10*	250	—	300	0,1	0,1
КП934А	Со статической индукцией, с каналом n-типа	40*	—	450	5	15 А	—
КП934Б		40*	—	300	5	15 А	—
КП934В		40*	—	400	5	15 А	—
КП934А1	Со статической индукцией, с каналом n-типа	20*	—	450	5	15 А	—
КП934Б1		20*	—	300	5	15 А	—
КП934В1		20*	—	400	5	15 А	—
КП936А	С изолированным затвором, с n-каналом	75 Вт	—	350	30	10 А	≤1,4 (280 В)
КП936Б		75 Вт	—	400	30	7 А	≤1,4 (320 В)
КП936В		75 Вт	—	350	30	10 А	≤1,4 (280 В)
КП936Г		75 Вт	—	400	30	7 А	≤1,4 (280 В)
КП936Д		75 Вт	—	300	30	10 А	≤1,4 (260 В)
КП936Е		75 Вт	—	400	30	7 А	≤1,4 (320 В)
КП936А-5	С изолированным затвором, с n-каналом	75 Вт	—	350	30	10 А	≤1,4 (280 В)
КП936Б-5		75 Вт	—	400	30	7 А	≤1,4 (320 В)
КП936В-5		75 Вт	—	350	30	10 А	≤1,4 (280 В)
КП936Г-5		75 Вт	—	400	30	7 А	≤1,4 (280 В)
КП936Д-5		75 Вт	—	300	30	10 А	≤1,4 (260 В)
КП936Е-5		75 Вт	—	400	30	7 А	≤1,4 (320 В)

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{уР}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥20 ≥20 ≥20	— — —	— — —	— — —	400 400 400	**КП931**
55...93	—	—	—	—	**КП932**
$h_{21Э}$=10...80 (5 А) $h_{21Э}$=10...80 (5 А) $h_{21Э}$=10...80 (5 А)	— — —	≤0,1 ≤0,1 ≤0,1	— — —	≤100; ≤2500* ≤100; ≤2500* ≤100; ≤2500*	**КП934**
$h_{21Э}$=10...80 (5 А) $h_{21Э}$=10...80 (5 А) $h_{21Э}$=10...80 (5 А)	— — —	≤0,1 ≤0,1 ≤0,1	— — —	≤100; ≤2500* ≤100; ≤2500* ≤100; ≤2500*	**КП934-1**
800...2500 (1 А) 800...2500 (1 А) 800...2500 (1 А) 800...2500 (1 А) 800...2500 (1 А) 800...2500 (1 А)	≤2300 (25 В) ≤2300 (25 В) ≤2300 (25 В) ≤2300 (25 В) ≤2300 (25 В) ≤2300 (25 В)	≤0,5 ≤0,85 ≤1,1 ≤1,1 ≤0,4 ≤0,6	— — — — — —	≤120* ≤120* ≤120* ≤120* ≤120* ≤120*	**КП936**
800...2500 (1 А) 800...2500 (1 А) 800...2500 (1 А) 800...2500 (1 А) 800...2500 (1 А) 800...2500 (1 А)	≤2300 (25 В) ≤2300 (25 В) ≤2300 (25 В) ≤2300 (25 В) ≤2300 (25 В) ≤2300 (25 В)	≤0,5 ≤0,85 ≤1,1 ≤1,1 ≤0,4 ≤0,6	— — — — — —	≤120* ≤120* ≤120* ≤120* ≤120* ≤120*	**КП936-5**

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\,max}$, мВт $P^{*}_{СИ\,т\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^{*}_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^{*}_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_{С}$, $I^{*}_{С,\,И}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^{*}_{С\,ост}$, мА
КП937А	С p-n-переходом и n-каналом	50*	-15	450; 475*	20	17,5 А	—
КП937А-5	С p-n-переходом и n-каналом	50*	-15	450; 475*	20	17,5 А	—
КП938А	С p-n-переходом и n-каналом	50*	—	500; 500*	-5	12 А	≤3*
КП938Б		50*	—	500; 500*	-5	12 А	≤3*
КП938В		50*	—	450; 450*	-5	12 А	≤3*
КП938Г		50*	—	400; 400*	-5	12 А	≤3*
КП938Д		50*	—	300; 300*	-5	12 А	≤3*
КП944А	С изолированным затвором и p-каналом	30*	-1,5...-4,5	50; 50*	20	15 А	≤0,5; ≤1*
КП944Б		30*	-1,5...-4,5	60; 60*	20	10 А	≤0,5; ≤1*
КП945А	С изолированным затвором и n-каналом	30*	1,5...4,5	50; 50*	20	15 А	≤0,5; ≤1*
КП945Б		30*	1,5...4,5	70; 70*	20	10 А	≤0,5; ≤1*
КП946А	БСИТ n-канал	40*	—	400	5	15 А	—
КП946Б		40*	—	200	5	15 А	
КП948А	БСИТ n-канал	20*	—	400	5	5 А	—
КП948Б		20*	—	300	5	5 А	—
КП948В		20*	—	370	5	5 А	—
КП948Г		20*	—	250	5	5 А	—
КП951А-2	С изолированным затвором, с n-каналом	3*	≤6*	36; 41*	20	600	≤1; ≤2*
КП951Б-2		3*	≤6*	36; 41*	20	600	≤2; ≤4*
КП951В-2		3*	≤6*	36; 41*	20	600	≤2; ≤8*

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у\ р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
20* (5 В; 5 А)	—	≤0,07	—	—	**КП937**
≥20* (5 В; 5 А)	—	≤0,07	—	—	**КП937-5**
h21э≥20* (5 В; 5 А) h21э≥20* (5 В; 5 А) h21э≥20* (5 В; 5 А) h21э≥20* (5 В; 5 А) h21э≥20* (5 В; 5 А)	— — — — —	≤0,07 ≤0,07 ≤0,1 ≤0,1 ≤0,1	— — — — —	≤200 ≤200 ≤200 ≤200 ≤200	**КП938**
≥3000 (10 В; 4 А) ≥3000 (10 В; 4 А)	700 (20 В; 1 МГц) 80* (20 В) 700 (20 В; 1 МГц) 80* (20 В)	≤0,3 ≤0,4	— —	90; 120* 90; 120*	**КП944, КП945**
≥2300 (3 В; 2 А) ≥2300 (3 В; 2 А)	600 (25 В; 1 МГц) 150* 600 (25 В; 1 МГц) 300**	≤0,1 ≤0,15	— —	60; 180* 60; 180*	
—	—	0,1 0,1	— —	80 80	**КП946, КП948**
— — — —	— — — —	0,15 0,15 0,15 0,15	— — — —	80 80 80 80	
≥200 (10 В; 0,5 А) ≥500 (10 В; 1,5 А) ≥1000 (10 В; 3 А)	— — —	≥3** (0,4 ГГц) ≥5** (0,4 ГГц) ≥15** (0,4 ГГц)	— — —	— — —	**КП951-2**

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП953А	БСИТ n-канал	50*	—	450	5	15 А	—
КП953Б		50*	—	300	5	15 А	—
КП953В		50*	—	450	5	15 А	—
КП953Г		50*	—	300	5	15 А	—
КП953Д		50*	—	450	5	15 А	—
КП954А	БСИТ n-канал	40*	—	150	5	20 А	—
КП954Б		40*	—	100	5	20 А	—
КП954В		40*	—	60	5	20 А	—
КП954Г		40*	—	20	5	20 А	—
КП954Д		40*	—	60	5	20 А	—
КП955А	БСИТ n-канал	70*	—	700	5	20 А	—
КП955Б		70*	—	450	5	20 А	—
КП956А	БСИТ n-канал	10*	—	350	5	2 А	—
КП956Б		10*	—	200	5	2 А	—
КП957А	БСИТ n-канал	10*	—	800	5	1 А	—
КП957Б		10*	—	800	5	1 А	—
КП957В		10*	—	700	5	1 А	—
КП958А	БСИТ n-канал	70*	—	150	5	30 А	—
КП958Б		70*	—	100	5	30 А	—
КП958В		70*	—	60	5	30 А	—
КП958Г		70*	—	20	5	20 А	—
КП959А	БСИТ n-канал	7*	—	220	5	200	—
КП959Б		7*	—	200	5	200	—
КП959В		7*	—	120	5	200	—

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом; $K^{*}_{у.р}$, дБ; $P^{**}_{вых}$, Вт; $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ; $U^{*}_{ш}$, мкВ; $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$; Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс; $t^{*}_{выкл}$, нс; $f^{**}_{р}$, МГц; $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
—	—	0,06	—	150; 50**	**КП953**
—	—	0,06	—	150; 50**	
—	—	0,06	—	150; 50**	
—	—	0,06	—	150; 50**	
—	—	0,064	—	150; 50**	
—	—	≤0,03	—	50; 100**	**КП954**
—	—	≤0,03	—	50; 100**	
—	—	≤0,025	—	50; 100**	
—	—	≤0,025	—	50; 100**	
—	—	≤0,05	—	50; 100**	
—	—	0,04	—	100; 100**	**КП955**
—	—	0,003	—	100; 100**	
—	—	0,6	—	100; 50**	**КП956, КП957**
—	—	0,6	—	100; 50**	
—	—	0,8	—	80; 50**	
—	—	0,8	—	80; 50**	
—	—	0,8	—	80; 50**	
—	—	0,02	—	80; 100**	**КП958**
—	—	0,02	—	80; 100**	
—	—	0,02	—	80; 100**	
—	—	0,02	—	80; 100**	
—	—	57	—	200**	**КП959**
—	—	57	—	200**	
—	—	57	—	200**	

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП960А **КП960Б** **КП960В**	БСИТ р-канал	7* 7* 7*	— — —	220 200 120	5 5 5	200 200 200	— — —
КП961А **КП961Б** **КП961В** **КП961Г** **КП961Д** **КП961Е**	БСИТ n-канал	10* 10* 10* 10* 10* 10*	— — — — — —	120 80 60 40 20 10	5 5 5 5 5 5	5 А 5 А 5 А 5 А 5 А 5 А	— — — — — —
КП962А	СИТ, n-канал	10*	-15	400	-20	2; 8* А	—
КП962А-5	СИТ, n-канал	10*	-15	400	-20	2; 8* А	—
КП963А	СИТ, n-канал	40*	—	150	-5	15; 50* А	—
КП963А-5	СИТ, n-канал	40*	—	150	-5	15; 50* А	—
КП964А **КП964Б** **КП964В** **КП964Г**	БСИТ р-канал	40* 40* 40* 40*	— — — —	150 100 60 20	5 5 5 5	20 А 20 А 20 А 20 А	— — — —

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у\ р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
— — —	— — —	57 57 57	— — —	150** 150** 150**	КП960
— — — — — —	— — — — — —	0,16 0,13 0,11 0,10 0,10 0,8	— — — — — —	40; 100** 40; 100** 40; 100** 40; 100** 40; 100** 40; 100**	КП961
—	—	≤0,5	—	≤100*	КП962
—	—	≤0,5	—	100	КП962-5
≤0,03 (10 А)	—	0,9	—	400	КП963
≤0,03 (10 А)	—	0,9	—	400	КП963-5
— — — —	— — — —	0,03 0,03 0,025 0,025	— — — —	50; 100** 50; 100** 50; 100** 50; 100**	КП964

Тип прибора	Структура	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С\ и}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
КП965А	БСИТ р-канал	10*	—	250	5	5 А	—
КП965Б		10*	—	160	5	5 А	—
КП965В		10*	—	120	5	5 А	—
КП965Г		10*	—	60	5	5 А	—
КП965О		10*	—	20	5	5 А	—
КП971А	БСИТ п-канал	100*	—	900	5	25 А	—
КП971Б		100*	—	800	5	25 А	—
КП973А	БСИТ п-канал	100*	—	700	5	30 А	—
КП973Б		100*	—	600	5	30 А	—
КПС104А	Сдвоенные, с р-п-переходом и п-каналом	45	0.2...1	25; 30*	-30; 0,5	—	≤0,8
КПС104Б		45	0,2...1	25; 30*	-30; 0,5	—	≤0,8
КПС104В		45	0,4...2	25; 30*	-30; 0,5	—	≤0,8
КПС104Г		45	0.4...2	25; 30*	-30; 0,5	—	≤0,8
КПС104Д		45	0,8...3	25; 30*	-30; 0,5	—	≤0,8
КПС104Е		45	0,8...3	25; 30*	-30; 0,5	—	≤0,8
КПС202А-2	Сдвоенные, с р-п-переходом и п-каналом	60	0,4...2	15; 20*	0,5	—	≤1,5
КПС202Б-2		60	0,4...2	15; 20*	0,5	—	≤1,5
КПС202В-2		60	0,4...2	15; 20*	0,5	—	≤1,5
КПС202Г-2		60	1...3	15; 20*	0,5	—	≤3
КПС203А-1	Сдвоенные, с р-п-переходом и р-каналом	30 (55°С)	0,2...2	15; 20*	0,5	—	0,25...1,5
КПС203Б-1		30 (55°С)	0,2...2	15; 20*	0,5	—	0,25...1,5
КПС203В-1		30 (55°С)	0,4...2	15; 20*	0,5	—	0,35...1,5
КПС203Г-1		30 (55°С)	1...3	15; 20*	0,5	—	1,1...3
КПС315А	Сдвоенные, с р-п-переходом и каналом п-типа	300	1...5	25; 30*	30	—	1...20
КПС315Б		300	0,4...2	25; 30*	30	—	1...20
КПС316Д-1	Сдвоенные, с р-п-переходом и каналом п-типа	60	0,3...2,2	25; 25*	25	—	—
КПС316Е-1		60	0,3...2,2	25; 25*	25	—	—
КПС316Ж-1		60	1,3...4	25; 25*	25	—	—
КПС316И-1		60	2,5...6	25; 25*	25	—	—

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у\ р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_ш$, дБ $U^{*}_ш$, мкВ $E^{**}_ш$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс f^{**}_p, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
—	—	0,8	—	40; 200**	**КП965**
—	—	0,6	—	40; 200**	
—	—	0,6	—	40; 200**	
—	—	0,4	—	40; 200**	
—	—	0,4	—	40; 200**	
—	—	0,04	—	200	**КП971, КП973**
—	—	0,04	—	150	
—	—	0,03	—	150	
—	—	0,03	—	150	
≥0,35 (10 В)	≤4,5; ≤1,5*	≤30***	≤0,4* (10 Гц)	≤50***	**КПС104**
≥0,35 (10 В)	≤4,5; ≤1,5*	≤30***	≤1* (10 Гц)	≤150***	
≥0,65 (10 В)	≤4,5; ≤1,5*	≤50***	≤5* (10 Гц)	≤150***	
≥1 (10 В)	≤4,5; ≤1,5*	≤50***	≤1* (10 Гц)	≤100***	
≥1 (10 В)	≤4,5; ≤1,5*	≤30***	≤5* (10 Гц)	≤150***	
≥0,65 (10 В)	≤4,5; ≤1,5*	≤20***	—	≤20***	
≥0,5 (5 В)	≤6; ≤2*	≤10***	—	30**	**КПС202-2**
≥0,5 (5 В)	≤6; ≤2*	≤10***	—	30**	
≥0,65 (5 В)	≤6; ≤2*	≤30***	—	30**	
≥1 (5 В)	≤6; ≤2*	≤30***	—	30**	
≥0,5 (10 В)	≤6 (10 В); ≤2*	≤10***	≤2,5* (10 Гц)	≤40***	**КПС203-1**
≥0,5 (10 В)	≤6 (10 В); ≤2*	≤10***	≤12* (10 Гц)	≤40***	
≥0,65 (10 В)	≤6 (10 В); ≤2*	≤30***	—	≤150***	
≥1 (10 В)	≤6 (10 В); ≤2*	≤30***	—	≤150***	
≥2,8 (5 В)	≤8 (10 В)	≤30***	—	≤30***; 60**	**КПС315**
≥1...5 (5 В)	≤8 (10 В)	≤30***	—	≤30***; 60**	
≥0,5 (5 В; 0,3 мА)	≤6 (10 В); ≤2*	≤50***	—	≤40***	**КПС316**
≥0,5 (5 В; 0,3 мА)	≤6 (10 В); ≤2*	≤50***	—	≤40***	
≥0,5 (5 В; 0,3 мА)	≤6 (10 В); ≤2*	≤50***	—	≤40***	
≥0,5 (5 В; 0,3 мА)	≤6 (10 В); ≤2*	≤50***	—	≤40***	

3.5. Полевые транзисторы специального назначения

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С.И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
Параметры арсенид-галлиевых полевых транзисторов								
3П320А-2 **3П320Б-2**	С n-каналом	-60...+85 -60...+85	80 80	— —	4; 8* 4; 8*	5 5	— —	— —
3П321А-2	С n-каналом	-60...+70	30	1,5...4,5	3; 4*	3*	—	—
3П324А-2 **3П324Б-2** **3П324В-2**	С n-каналом	-60...+85 -60...+85 -60...+85	80 80 80	— — —	4 4 4	3 3 3	— — —	— — —
3П325А-2	С барьером Шотки, с n-каналом	-60...+85	25	4	2,5; 5*	3,5	—	—

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{уР}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{Ш}$, дБ $U_{Ш}^{*}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
Параметры арсенид-галлиевых полевых транзисторов					
5...16 (1,5 В) 5...16 (1,5 В)	0,18; 0,15* 0,15*; 0,18**	≥3* (8 ГГц) ≥5* (8 ГГц)	≤4,5 (8 ГГц) ≤6 (8 ГГц)	— —	**3П320-2**
≥5 (2 В; 8 мА)	—	≥3* (8 ГГц)	2,8 (8 ГГц)	—	**3П321А-2**
15...40 (15 мА) 15...40 (15 мА) 15...40 (15 мА)	— — —	≥6* (12 ГГц) ≥6* (12 ГГц) ≥6* (12 ГГц)	≤1,5 (12 ГГц) ≤2 (12 ГГц) ≤2,5 (12 ГГц)	— — —	**3П324-2**
≥8 (1,5 В; 10 мА)	—	≥5* (8 ГГц)	≤2 (8 ГГц)	—	**3П325А-2**

Тип прибора	**Структура**	**$T_{окр.}$, °C**	**$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт**	**$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В**	**$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В**	**$U_{ЗИ\ max}$, В**	**$I_С$, $I^*_{С.\ Н}$, мА**	**$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА**
3П325А-5	С барьером Шотки, с n-каналом	-60...+85	25	4	2,5; 5*	3,5	—	—
3П326А-2 **3П326Б-2**	С n-каналом	-60...+85 -60...+85	30 30	1...4 1...4	2,5; 5,5* 2,5; 5,5*	4 4	— —	— —
3П326А-5	С барьером Шотки, с n-каналом	-60...+85	30	1...4	2,5; 5,5*	4	—	—
3П328А-2	С барьером Шотки, с двумя затворами с n-каналом	-60...+85	50	4	6	4; 6	—	—
3П328А-5	С барьером Шотки, с двумя затворами с n-каналом	-60...+85	50	4	6	4; 6	—	—
3П330А-5	С барьером Шотки, с n-каналом	-60...+85	30	1,5...4,5	3; 6*	4	15...50	—
3П330А-2 **3П330Б-2** **3П330В-2**	С барьером Шотки, с n-каналом	-60...+85 -60...+85 -60...+85	30 30 30	1,5...4,5 1,5...4,5 1,5...4,5	3; 6* 3; 6* 3; 6*	4 4 4	15...50 15...50 15...50	— — —

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{у.р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_ш$, дБ $U_ш^{*}$, мкВ $E^{**}_ш$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_р$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥8 (1,5 В; 10 мА)	—	≥5* (8 ГГц)	≤2 (8 ГГц)	—	**3П325А-5**
≥8* (2 В; 8 мА) ≥8* (2 В; 8 мА)	— —	≥3* (17,4 ГГц) ≥3* (17,4 ГГц)	≤4,5 (17,4 ГГц) ≤5,5 (17,4 ГГц)	— —	**3П326-2**
≥8* (2 В; 8 мА)	—	≥3* (17,4 ГГц)	≤4,5 (17,4 ГГц)	—	**3П326А-5**
≥8* (4 В; 8 мА)	—	≥9* (8 ГГц)	≤3,5 (8 ГГц)	—	**3П328А-2**
≥8* (4 В; 8 мА)	—	≥10* (8 ГГц)	≤1,4 (1 ГГц)	—	**3П328А-5**
≥5 (5 кГц)	—	—	≤3 (17,4 ГГц)	—	**3П330А-5**
≥5 (5 кГц) ≥5 (5 кГц) ≥5 (5 кГц)	— — —	≥3* (17,4 ГГц) ≥3* (25 ГГц) ≥6* (25 ГГц)	≤6 (25 ГГц) ≤4,5 (25 ГГц) ≤3,5 (25 ГГц)	— — —	**3П330А-2**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\,max}$, мВт $P^*_{СИ\,т\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^*_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^*_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_С$, $I^*_{С.\,И}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^*_{С\,ост}$, мА
3П330В1-2 **3П330В2-2** **3П330В3-2**	С барьером Шотки, с n-каналом	-60...+85 -60...+85 -60...+85	100 100 100	1,5...4,5 1,5...4,5 1,5...4,5	5; 7* 5; 7* 5; 7*	4 4 4	15...50 15...50 15...50	— — —
3П331А-2	С барьером Шотки, с n-каналом	-60...+85	250	2,5...5	5,5; 8*	5	—	100...150
3П331А-5	С n-каналом	-60...+85	250	2,5...5	5,5; 8*	5	—	≥100 (3 В)
3П339А-2	С барьером Шотки, с n-каналом	-60...+85	250	5	5,5; 7*	5	—	50...90
3П343А-2 **3П343А1-2** **3П343А2-2** **3П343А3-2**	С барьером Шотки, с n-каналом	-60...+85 -60...+85 -60...+85 -60...+85	35 35 35 35	2...4 2...4 2...4 2...4	3,5; 6* 3,5; 6* 3,5; 6* 3,5; 6*	3 3 3 3	— — — —	≥20 (2 В) ≥20 (2 В) ≥20 (2 В) ≥20 (2 В)
3П344А-2 **3П344А1-2** **3П344А2-2** **3П344А3-2** **3П344А4-2**	С барьером Шотки, с n-каналом	-60...+85 -60...+85 -60...+85 -60...+85 -60...+85	100 100 100 100 100	— — — — —	4,5; 7* 5; 7* 5; 7* 5; 7* 5; 7*	4 4 4 4 4	— — — — —	— — — — —

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^*_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^*_{у.Р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_ш$, дБ $U_ш^*$, мкВ $E_ш^{**}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^*_{выкл}$, нс $f^{**}_р$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°C	Корпус
≥20 (5 кГц) ≥20 (5 кГц) ≥20 (5 кГц)	— — —	≥8* (17,4 ГГц) ≥8* (17,4 ГГц) ≥8* (17,4 ГГц)	≤2 (17,4 ГГц) ≤1,5 (17,4 ГГц) ≤1 (17,4 ГГц)	— — —	3П330В1-2
≥25 (5 кГц)	—	≥5* (10 ГГц) ≥45** (10 ГГц)	≤2,8 (10 ГГц)	—	3П331А-2
≥15* (4 В; 40 мА)	—	≥5,5* (10 ГГц) ≥45** (10 ГГц)	≤2,8 (10 ГГц)	—	3П331А-5
≥10 (5 кГц)	—	≥5* (17,4 ГГц) ≥15** (17,4 ГГц)	≤4 (17,4 ГГц)	—	3П339А-2
≥10 (5 кГц) ≥20 (5 кГц) ≥20 (5 кГц) ≥20 (5 кГц)	— — — —	≥8,5* (12 ГГц) ≥8,5* (12 ГГц) ≥8,5* (12 ГГц) ≥8,5* (12 ГГц)	≤2 (12 ГГц) ≤1,1 (12 ГГц) ≤1,1 (12 ГГц) ≤0,9 (12 ГГц)	— — — —	3П343-2
≥15 (5 кГц) ≥40 (5 кГц) ≥40 (5 кГц) ≥40 (5 кГц) ≥40 (5 кГц)	— — — — —	≥10 (4 ГГц) ≥10 (4 ГГц) ≥10 (4 ГГц) ≥10 (4 ГГц) ≥15 (1 ГГц)	≤1 (4 ГГц) ≤0,7 (4 ГГц) ≤0,5 (4 ГГц) ≤0,3 (4 ГГц) ≤0,3 (1 ГГц)	— — — — —	3П344-2

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^{*}_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^{*}_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^{*}_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_{С}$, $I^{*}_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^{*}_{С\ ост}$, мА
3П345А-2 3П345Б-2	С барьером Шотки, с n-каналом	-60...+85 -60...+85	80 80	— —	4 4	2 2	— —	20...60 20...60
3П345А-5	С барьером Шотки, с n-каналом, с двумя затворами	-60...+85	80	—	4	2	—	20...60
3П348А-2	С n-каналом	-60...+85	250	5; -7*	-4	—	—	—
3П351А-2	С барьером Шотки, с n-каналом, с двумя затворами	-60...+85	75	2...4	5,5	-9	—	20...50
3П351А-5	С барьером Шотки, с n-каналом	-60...+85	75	—	5,5	9	—	—
3П351А1-2	С одним затвором, n-каналом	-60...+85	75	2...4	5,5; -9	-9	—	20...50

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{ур}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U_{ш}^{*}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥15 (2 В; 20 мА) ≥25 (2 В; 20 мА)	≤0,35 (2 В) ≤0,35 (2 В)	— —	≤2,8** (30 МГц) ≤2,5** (30 МГц)	— —	3П345-2
≥15 (2 В; 20 мА)	≤0,35 (2 В)	—	≤2,8** (30 МГц) ≤1,4** (0,1 ГГц)	—	3П345А-5
≥15 (2 В; 20 мА)	—	≥10* (4 ГГц) ≥0,04** (4 ГГц)	≤1 (4 ГГц)	—	3П348А-2
≥8 (3 В; 10 мА)		≥9*	≤4,5 (12 ГГц)		3П351А-2
		≥8*	≤5,5 (17,5 ГГц)	—	3П351А-5
≥8 (3 В; 10 мА)	—	≥8* (17,4 ГГц)	≤5,5 (17,4 ГГц)	—	3П351А1-2

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\,max}$, мВт, $P^*_{СИ\,т\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^*_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^*_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\,И}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^*_{С\,ост}$, мА
3П353А-5	С барьером Шотки, с n-каналом	-60...+85	30	-1...-2,5	4; 4,5*	—	—	—
3П372А-2	HEMT с n-каналом	-60...+125	60	—	3; 6*	3	—	—
3П373А-2	С барьером Шотки, с n-каналом	-60...+85	100	—	4,5; -7	3	—	—
3П373Б-2		-60...+85	100	—	4,5; -7	3	—	—
3П373В-2		-60...+85	100	—	4,5; -7	3	—	—
3П376А-5	HEMT с n-каналом	-60...+125	40	—	3	1,5	—	—
3П384А-5	HEMT с n-каналом	-60...+125	550	—	—	3	—	—
3П385А-2	С n-каналом	-60...+85	35	0,5...2,5	3,5; -6	-2,5	—	10...30
3П385Б-2	С n-каналом	-60...+85	35	0,5...2,5	3,5; -6	-2,5	—	10...30
3П385В-2	С n-каналом	-60...+85	35	0,5...2,5	3,5; -6	-2,5	—	10...30
3П385А-5	С n-каналом	-60...+85	35	0,5...2,5	3,5; -6	-2,5	—	10...30
3П385Б-5	С n-каналом	-60...+85	35	0,5...2,5	3,5; -6	-2,5	—	10...30
3П385В-5	С n-каналом	-60...+85	35	0,5...2,5	3,5; -6	-2,5	—	10...30
3П602А-2	С n-каналом	-60...+85	900	—	7	3,5	—	≥220 (3 В)
3П602Б-2		-60...+85	900	—	7	3,5	—	≥180 (3 В)
3П602В-2		-60...+85	900	—	7	3,5	—	≥110 (3 В)
3П602Г-2		-60...+85	1800	—	7,5	3,5	—	≥440 (3 В)
3П602Д-2		-60...+85	1800	—	7,5	3,5	—	≥360 (3 В)

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{уР}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_ш$, дБ $U_ш^{*}$, мкВ $E^{**}_ш$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_р$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
8...13 (3 В; 8 мА)	—	≥6*	≤4 (37 ГГц)	—	**3П353А-5**
10...35 (2,5В; 10мА)	—	≥7*	≤1,5 (15 ГГц)	—	**3П372А-2, 3П373-2**
≥30 (3 В; 20 мА)	—	≥12,5* (4 ГГц)	≤0,4 (4 ГГц)	—	
≥30 (3 В; 20 мА)	—	≥12* (4 ГГц)	≤0,5 (4 ГГц)	—	
≥30 (3 В; 20 мА)	—	≥11* (4 ГГц)	≤0,6 (4 ГГц)	—	
≥12 (3 В)	—	≥5*	≤4 (60 ГГц)	—	**3П376А-5**
30...42 (3 В; 50 мА)	—	≥0,06** (37 ГГц) ≥4*		—	**3П384А-5**
≥15 (3 В; 8 мА)	—	≥9,5* (17,4 ГГц)	≤0,8 (17,4 ГГц)	—	**3П385-2**
≥15 (3 В; 8 мА)	—	≥10* (17,4 ГГц)	≤1 (17,4 ГГц)		
≥15 (3 В; 8 мА)	—	≥8,5* (17,4 ГГц)	≤1,2 (17,4 ГГц)		
≥15 (3 В; 8 мА)	—	≥9,5* (17,4 ГГц)	≤0,8 (17,4 ГГц)	—	**3П385-5**
≥15 (3 В; 8 мА)	—	≥10* (17,4 ГГц)	≤1 (17,4 ГГц)		
≥15 (3 В; 8 мА)	—	≥8,5* (17,4 ГГц)	≤1,2 (17,4 ГГц)		
20...100 (2 В)	—	≥0,18** (12 ГГц) ≥2,6* (12 ГГц)	—	—	**3П602-2**
20...80 (2 В)	—	≥0,1** (12 ГГц) ≥3* (12 ГГц)	—	—	
20...70 (2 В)	—	≥0,2** (8 ГГц) ≥3* (8 ГГц)	—	—	
40...200 (2 В)	—	≥0,4** (10 ГГц) ≥2,6* (10 ГГц)	—	—	
40...160 (2 В)	—	≥0,5** (8 ГГц) ≥3* (8 ГГц)	—	—	

31 зак 9

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^{*}_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^{*}_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^{*}_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_{С}$, $I^{*}_{С,\ Н}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^{*}_{С\ ост}$, мА
3П602Б-5	С n-каналом	-60...+85						
3П602Д-5		-60...+85						
3П603А-2	С n-каналом	-60...+125	2,5*	—	—	3,5	—	400; 5*
3П603Б-2	С n-каналом	-60...+125	2,5*	—	—	3,5	—	400; 5*
3П603А1-2	С n-каналом	-60...+125	2,5*	—	—	3,5	—	400; 5*
3П603Б1-2	С n-каналом	-60...+125	2,5*	—	—	3,5	—	400; 5*
3П603А-5	С n-каналом	-60...+125	2,5*	—	—	3,5	—	400; 5*
3П603Б-5	С n-каналом	-60...+125	2,5*	—	—	3,5	—	400; 5*
3П604А-2	С n-каналом	-60...+125	900	—	7	-3	—	—
3П604Б-2	С n-каналом	-60...+125	900	—	7	-3	—	—
3П604В-2	С n-каналом	-60...+125	500	—	7	-3	—	—
3П604Г-2	С n-каналом	-60...+125	500	—	7	-3	—	—
3П604А1-2	С n-каналом	-60...+100	900	—	7	-3	—	—
3П604Б1-2	С n-каналом	-60...+100	900	—	7	-3	—	—
3П604В1-2	С n-каналом	-60...+100	500	—	7	-3	—	—
3П604Г1-2	С n-каналом	-60...+100	500	—	7	-3	—	—
3П604А-5	С n-каналом	-60...+100	900	—	7	-3	—	—
3П604Б-5	С n-каналом	-60...+100	900	—	7	-3	—	—
3П604В-5	С n-каналом	-60...+100	500	—	7	-3	—	—
3П604Г-5	С n-каналом	-60...+100	500	—	7	-3	—	—

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{у.р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U_{ш}^{*}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
20...100 (2 В) 40...160 (2 В)	— —	— —	— —	— —	**3П602-5**
≥50 (3 В; 0,4 А) ≥80 (3 В; 0,4 А)	— —	≤4 ≥3* (12 ГГц) ≥0,5** (12 ГГц) ≤4; ≥3*; ≥1**	— —	0,24 0,24	**3П603-2**
≥50 (3 В; 0,4 А) ≥80 (3 В; 0,4 А)	— —	≤4 ≥3* (12 ГГц) ≥0,5** (12 ГГц) ≤4; ≥3*; ≥1**	— —	0,24 0,24	**3П603-1-2**
≥50 (3 В; 0,4 А) ≥80 (3 В; 0,4 А)	— —	≤4 ≥3* (12 ГГц) ≥0,5** (12 ГГц) ≤4; ≥3*; ≥1**	— —	0,24 0,24	**3П603-5**
20...40 (3 В; 0,1 А) 15...40 (3 В; 0,1 А) 10...20 (3 В; 50 мА) 10...20 (3 В; 50 мА)	— — — —	≥3* (17,4 ГГц) ≥0,2** (17,4 ГГц) ≥3 (17,4 ГГц) ≥0,125** (17,4 ГГц) ≥3* (17,4 ГГц) ≥0,075** (17,4 ГГц) ≥3* (17,4 ГГц) ≥0,005** (17,4 ГГц)	— — — —	— — — —	**3П604-2**
20...40 (3 В; 0,1 А) 15...40 (3 В; 0,1 А) 10...20 (3 В; 50 мА) 10...20 (3 В; 50 мА)	— — — —	≥3* (17,4 ГГц) ≥0,2** (17,4 ГГц) ≥3 (17,4 ГГц) ≥0,125** (17,4 ГГц) ≥3* (17,4 ГГц) ≥0,075** (17,4 ГГц) ≥3* (17,4 ГГц) ≥0,005** (17,4 ГГц)	— — — —	— — — —	**3П604-1-2** с керамическим колпачком
20...40 (3 В; 0,1 А) 15...40 (3 В; 0,1 А) 10...20 (3 В; 50 мА) 10...20 (3 В; 50 мА)	— — — —	≥3* (17,4 ГГц) ≥0,2** (17,4 ГГц) ≥3 (17,4 ГГц) ≥0,125** (17,4 ГГц) ≥3* (17,4 ГГц) ≥0,075** (17,4 ГГц) ≥3* (17,4 ГГц) ≥0,005** (17,4 ГГц)	— — — —	— — — —	**3П604-5**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\ max}$, мВт, $P^{*}_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^{*}_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^{*}_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_{С}$, $I^{*}_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^{*}_{С\ ост}$, мА
3П605А-2	С n-каналом	-60...+85	450	≤5,5	6,8	—	—	≥150 (3 В)
3П605А-5	С n-каналом	-60...+85	450	≤5,5	6,8	—	—	≥150 (3 В)
3П606А-2	С барьером Шотки, с n-каналом	-60...+125	2*	—	8	-3,5	—	160; 5*
3П606Б-2		-60...+125	2*	—	8	-3,5	—	160; 5*
3П606В-2		-60...+125	2*	—	8	-3,5	—	160; 5*
3П606Б-5	С барьером Шотки, с n-каналом	-60...+125	2*	—	8	-3,5	—	160; 5*
3П606В-5		-60...+125	2*	—	8	-3,5	—	160; 5*
3П607А-2	С n-каналом	-60...+125	3,5*	—	8	-3,5	—	≤160; 5*
3П608А-2	С n-каналом	-60...+125	3,5*	—	—	-3	—	
3П608Б-2		-60...+125	3,5*	—	—	-3	—	
3П608В-2		-60...+125	3,5*	—	—	-3	—	
3П608Г-2		-60...+125	3,5*	—	—	-3	—	
3П608А-5	С n-каналом	-60...+125	3,5*	—	—	—	—	
3П608Д-5		-60...+125	3,5*	—	—	—	—	
3П608Е-5		-60...+125	3,5*	—	—	—	—	

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у.р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_ш$, дБ $U_ш^{*}$, мкВ $E^{**}_ш$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_р$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥30 (4 В; 30 мА)	—	≤3,5 (8 ГГц) ≥8* (8 ГГц) ≥0,1** (8 ГГц)	≤3,5 (8 ГГц)	—	3П605А-2
≥30 (4 В; 30 мА)	—	≤3,5 (8 ГГц) ≥8* (8 ГГц) ≥0,1** (8 ГГц)	≤3,5 (8 ГГц)	—	3П605А-5
≥70 (3 В; 0,25 А) ≥90 (3 В; 0,25 А) ≥100 (3 В; 0,25 А)	3 (5 В) 3 (5 В) 3 (5 В)	≥4* (12 ГГц) ≥0,4** (12 ГГц) ≥6* (12 ГГц) ≥0,4** (12 ГГц) ≥5* (12 ГГц) ≥0.75** (12 ГГц)	— — —	$t_б$=100 $t_б$=100 $t_б$=100	3П606-2
≥90 (3 В; 0,25 А) ≥100 (3 В; 0,25 А)	3 (5 В) 3 (5 В)	≥6* (12 ГГц) ≥0,4** (12 ГГц) ≥5* (12 ГГц) ≥0.75** (12 ГГц)	— —	$t_б$=100 $t_б$=100	3П606-5
≥80 (3 В)	—	≥1** (10 ГГц); ≥4,5*	—	—	3П607А-2
≥15 (3 В; 50 мА) ≥15 (3 В; 50 мА) ≥15 (3 В; 50 мА) ≥15 (3 В; 50 мА)	— — — —		— — — —	— — — —	3П608-2
≥15 (3 В; 50 мА) ≥15 (3 В; 50 мА) ≥15 (3 В; 50 мА)	— — —	≥4* (37 Гц) ≥0,03** (37 ГГц) ≥3,5* (37 ГГц) ≥0,15** (37 ГГц) ≥4* (37 ГГц) ≥0,01* (37 ГГц)	— — —	— — —	3П608-5

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\,max}$, мВт; $P^*_{СИ\,т\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^*_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^*_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\,И}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^*_{С\,ост}$, мА
3П910А-2	С барьером Шотки,	-60...+85	3*	—	7	3,5	—	800...2000
3П910Б-2	с n-каналом	-60...+85	3*	—	7	3,5	—	800...2000
3П910А-5	С барьером Шотки,	-60...+85	3*	—	7	3,5	—	800...2000
3П910Б-5	с n-каналом	-60...+85	3*	—	7	3,5	—	800...2000
3П915А-2	С барьером Шотки,	-60...+85	12*	—	7	-5	—	—
3П915Б-2	с n-каналом	-60...+85	12*	—	7	-5	—	—
3П925А-2	С барьером Шотки,	-60...+125	7*	—	9	5	—	1800...3000
3П925Б-2	с n-каналом	-60...+125	7*	—	9	5	—	1800...3000
3П925В-2		-60...+125	16*	—	9	5	—	3600...6000
3П925А-5	С барьером Шотки, с n-каналом	-60...+125	7*	—	9	5	—	≤3 А
3П927А-2	С n-каналом	-60...+125	2,5*	7	—	3	—	—
3П927Б-2	С n-каналом	-60...+125	2,5*	7	—	3	—	—
3П927В-2	С n-каналом	-60...+125	2,5*	7	—	3	—	—
3П927Г-2	С n-каналом	-60...+125	2,5*	7	—	3	—	—
3П927Д-2	С n-каналом	-60...+125	2,5*	7	—	3	—	—
3П929А-2	С n-каналом	-60...+125	14*	—	8	-5	—	≥3,5 А; 15*

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у,P}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U_{ш}^{*}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥50 (3 В) ≥200 (3 В)	— —	≥3*; ≥0,5** (8 ГГц) ≥3*; ≥1** (8 ГГц)	— —	— —	3П910
≥100 (3 В) ≥100 (3 В)	— —	≥3*; ≥0,5** (8 ГГц) ≥3*; ≥1** (8 ГГц)	— —	— —	3П910-5
≥350 (1,5 В; 0,5 А) ≥300 (1,5 В; 0,5 А)	— —	≥5** (8 ГГц); ≥3* ≥3** (8 ГГц); ≥3*	— —	— —	3П915
— — —	— — —	≥2** (3,7...4,2 ГГц) ≥2** (4,3...4,8 ГГц) ≥5** (3,7...4,2 ГГц)	— — —	— — —	3П925-2
500 (3 В; 1,8 А)	—	≥3** (4,2 ГГц) ≥7* (4,2 ГГц)	—	—	3П925-5
50...150 (3 В; 0,4 А) 50...200 (3 В; 0,4 А) 50...200 (3 В; 0,4 А) 50...200 (3 В; 0,4 А) 50...200 (3 В; 0,4 А)	— — — — —	≥3*; ≥0,5** (17,4ГГц) ≥5*; ≥0,5** (17,4ГГц) ≥5*; ≥0,6** (17,4ГГц) ≥3*; ≥0,7** (17,4ГГц) ≥3*; ≥0,5** (17,4ГГц)	— — — — —	— — — — —	3П927
≥1000 (3 В; 4 А)	—	≥4,5*; ≥4** (8,4 ГГц)	—	—	3П929А-2

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °С	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\ Н}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
3П930А-2		-60...+125	21*	—	8	-5	—	≤4,5; ≤15*
3П930Б-2		-60...+125	21*	—	8	-5	—	≤4,5; ≤15*
3П930В-2		-60...+125	21*	—	8	-5	—	≤4,5; ≤15*
Параметры кремниевых полевых транзисторов								
2Е701А	БТИЗ с n-каналом	-60...+125		2...4*	$U_{КЭ}$=500	$U_{ЗЭ}$=20	$I_К$=25 А	
2Е701Б		-60...+125		2...4*	$U_{КЭ}$=700	$U_{ЗЭ}$=20	$I_К$=25 А	
2Е701В		-60...+125		2...4*	$U_{КЭ}$=500	$U_{ЗЭ}$=20	$I_К$=25 А	
2Е701Г		-60...+125		2...4*	$U_{КЭ}$=700	$U_{ЗЭ}$=20	$I_К$=25 А	
2П101А	р-канал	-60...+125	50	5	10	10	—	0,3...1
2П101Б	р-канал	-60...+125	50	5	10	10	—	0,7...2,2
2П101В	р-канал	-60...+125	50	8	10	10	—	0,5...5
2П103А	р-канал	-60...+85	120	0,5...2,2	10; 15*	10	—	0,55...1,2
2П103Б	р-канал	-60...+85	120	0,8...3	10; 15*	10	—	1...2,1
2П103В	р-канал	-60...+85	120	1,4...4	10; 15*	10	—	1,7...3,8
2П103Г	р-канал	-60...+85	120	2...6	10; 17*	10	—	3...6,6
2П103Д	р-канал	-60...+85	120	2,8...7	10; 17*	10	—	5,4...12
2П103АР	р-канал	-60...+85	120	0,5...2,2	10	10	—	0,55...1,2
2П103БР	р-канал	-60...+85	120	0,8...3	10	10	—	1...2,1
2П103ВР	р-канал	-60...+85	120	1,4...4	10	10	—	1,7...3,8
2П103ГР	р-канал	-60...+85	120	2...6	10	10	—	3...6,6
2П103ДР	р-канал	-60...+85	120	2,8...7	10	10	—	5,4...12
2П201А-1	р-канал	-60...+85	60	0,4...1,4	10	15	—	0,3...0,65
2П201Б-1	р-канал	-60...+85	60	0,5...2,2	10	15	—	0,55...1,2
2П201В-1	р-канал	-60...+85	60	0,8...3	10	15	—	1...2,1
2П201Г-1	р-канал	-60...+85	60	1,4...4	10	15	—	1,7...3,8
2П201Д-1	р-канал	-60...+85	60	2...6	10	15	—	3...6
2П201Е-1	р-канал	-60...+85	60	2...6	10	15	—	2,1
2П201Ж-1	р-канал	-60...+85	60	2...6	10	15	—	3,8

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{УР}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U^{*}_{ш}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥1000 (3 В; 4 А) ≥1000 (3 В; 4 А) ≥1000 (3 В; 4 А)	— — —	≥5** (5,7...6,3 ГГц) ≥7,5** (5,7...6,3 ГГц) ≥10** (5,7...6,3 ГГц)	— — —	— — —	**3П930**
Параметры кремниевых полевых транзисторов					
≥12000 (5 В; 10 А) ≥12000 (5 В; 10 А) ≥12000 (5 В; 10 А) ≥12000 (5 В; 10 А)	≤1700 (30 В) ≤1700 (30 В) ≤1700 (30 В) ≤1700 (30 В)	0,25 0,25 0,25 0,25		≤250 ≤250 ≤250 ≤250	**2Е701**
0,3 0,3 0,5	12; 2,7* 12; 2,9* 12; 3*	— — —	≤5 (1 кГц) ≤5 (1 кГц) ≤10 (1 кГц)	— — —	**2П101**
0,7...2,1 0,8...2,6 1,4...5,5 1,8...5,8 2...4,4	17 17 17 17 17	— — — — —	4 4 4 4 4	3** 3** 3** 3** 3**	**2П103**
0,7...2,1 0,8...2,6 1,4...3,5 1,8...3,8 2...4,4	17 17 17 17 17	— — — — —	4 4 4 4 4	250*** 250*** 300*** 300*** 300***	**2П103Р**
0,4...1,8 0,7...2,1 0,8...2,6 1,4...3,5 1,8...3,8 1...2,6 1,4...3,5	17; 8* 17; 8* 17; 8* 17; 8* 17; 8* 17; 8* 17; 8*	— — — — — — —	≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц) ≤3 (1 кГц)	— — — — — — —	**2П201-1**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\ max}$, мВт, $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С.И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
2П202Д-1	n-канал	-60...+125	60	—	15	20	—	1,5
2П202Е-1	n-канал	-60...+125	60	—	15	20	—	3
2П301А	p-канал	-60...+85	200	2,7...5,4*	20	30	15	≤0,5 мкА
2П301Б	p-канал	-60...+85	200	2,7...5,4*	20	30	15	≤0,5 мкА
2П301В	p-канал	-60...+85	200	≥2,7*	20	30	15	≤0,5 мкА
2П301А-1	p-канал	-60...+85	200	2,7...5,4*	20	30	15	≤0,5 мкА
2П301Б-1	p-канал	-60...+85	200	2,7...5,4*	20	30	15	≤0,5 мкА
2П301В-1	p-канал	-60...+85	200	2,7*	20	30	15	≤0,5 мкА
2П301А-5	p-канал	-60...+85	200	2,7...5,4*	20	30	15	≤0,5 мкА
2П302А	n-канал	-60...+125	300	≤5	20	10	24	3...24
2П302Б	n-канал	-60...+125	300	≤7	20	10	43	18...43
2П302В	n-канал	-60...+125	300	≤10	20	12	—	33...66
2П302А-1	n-канал	-60...+125	300	≤5	20	10	24	3...24
2П302Б-1	n-канал	-60...+125	300	≤7	20	10	43	18...43
2П302В-1	n-канал	-60...+125	300	≤10	20	12	—	33...66
2П303А	n-канал	-60...+125	200	0,5...3	25; 30*	30	20	0,5...2.5
2П303Б	n-канал	-60...+125	200	0,5...3	25; 30*	30	20	0,5...2.5
2П303В	n-канал	-60...+125	200	1...4	25; 30*	30	20	1,5...5
2П303Г	n-канал	-60...+125	200	≤8	25; 30*	30	20	3...12
2П303Д	n-канал	-60...+125	200	≤8	25; 30*	30	20	3...9
2П303Е	n-канал	-60...+125	200	≤8	25; 30*	30	20	5...20
2П303И	n-канал	-60...+125	200	1...3	25; 30*	30	20	1,5...5

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{у,Р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U_{ш}^{*}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс f^{**}_{p}, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
0.65 1	6 6	— —	— —	— —	**2П202-1**
1...2,6 1...2,6 ≥1 (15 В; 5 мА)	≤3,5 ≤3,5 ≤3,5	— — —	≤5 (100 МГц) — —	— — —	**2П301**
1...2,6 1...2,6 ≥1	≤3,5 ≤3,5 ≤3,5	— — —	≤5 (100 МГц) — —	— — —	
≥1	≤3,5	—	≤5 (100 МГц)	—	**2П301-5**
5...12 7...14 —	20** 20** 20**	≤150 ≤150 ≤150	≤2,75 (1 кГц) ≤2,75 (1 кГц) ≤2,75 (1 кГц)	≤4; ≤5* ≤4; ≤5* ≤4; ≤5*	**2П302А**
5...12 7...14 —	20** 20** 20**	≤150 ≤150 ≤150	≤2,75 (1 кГц) ≤2,75 (1 кГц) ≤2,75 (1 кГц)	≤4; ≤5* ≤4; ≤5* ≤4; ≤5*	**2П302-1**
1...4 1...4 2...5 3...7 ≥2,6 ≥4 2...6	≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6 ≤6	— — — — — — —	30** (20 Гц) 20** (1 кГц) 20** (1 кГц) ≤($6\cdot10^{-17}$)*** ≤4 (100 МГц) ≤4 (100 МГц) ≤4 (100 МГц)	— — — — — — —	**2П303А**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
2П304А	С изолированным затвором и каналом р-типа	-60...+125	200	≥5*	25; 30*	30	30	≤0,2 мкА
2П305А	n-канал	-60...+125	150	≥6	15; ±30*	±30	15	1* мкА
2П305Б	n-канал	-60...+125	150	≥6	15; ±30*	±30	15	1* мкА
2П305В	n-канал	-60...+125	150	≥6	15; ±30*	±30	15	1* мкА
2П305Г	n-канал	-60...+125	150	≥6	15; ±30*	±30	15	1* мкА
2П305А-2	n-канал	-60...+85	80	≥6	15; ±30*	±30	15	1* мкА
2П305Б-2	n-канал	-60...+85	80	≥6	15; ±30*	±30	15	1* мкА
2П305В-2	n-канал	-60...+85	80	≥6	15; ±30*	±30	15	1* мкА
2П305Г-2	n-канал	-60...+85	80	≥6	15; ±30*	±30	15	1* мкА
2П306А	n-канал	-60...+125	150	0,8...4	20	20	20	≤5* мкА
2П306Б	n-канал	-60...+125	150	0,2...4	20	20	20	≤5* мкА
2П306В	n-канал	-60...+125	150	1,3...6	20	20	20	≤5* мкА
2П306Г	n-канал	-60...+125	150	0,8...4	20	20	20	≤5* мкА
2П306Д	n-канал	-60...+125	150	0,2...4	20	20	20	≤5* мкА
2П306Е	n-канал	-60...+125	150	1,3...6	20	20	20	≤5* мкА
2П307А	n-канал	-60...+125	250	0,5...3	25; 30*	30	30	3...9
2П307Б	n-канал	-60...+125	250	1...5	25; 30*	30	30	5...15
2П307В	n-канал	-60...+125	250	1...5	25; 30*	30	30	5...15
2П307Г	n-канал	-60...+125	250	1,5...6	25; 30*	30	30	8...24
2П307Д	n-канал	-60...+125	250	1,5...6	25; 30*	30	30	8...24
2П308А	n-канал	-60...+125	60	0,2...1,2	25	30	20	0,4...1
2П308Б	n-канал	-60...+125	60	0,3...1,8	25	30	20	0,8...1,6
2П308В	n-канал	-60...+125	60	0,4...2,4	25	30	20	1,4...3
2П308Г	n-канал	-60...+125	60	1...6	25	30	20	—
2П308Д	n-канал	-60...+125	60	1...3	25	30	20	—
2П308А-1	n-канал	-60...+85	60	0,2...1,2	25	30	20	0,4...1
2П308Б-1	n-канал	-60...+85	60	0,3...1,8	25	30	20	0,8...1,6
2П308В-1	n-канал	-60...+85	60	0,4...2,4	25	30	20	1,4...3
2П308Г-1	n-канал	-60...+85	60	1...6	25	30	20	—
2П308Д-1	n-канал	-60...+85	60	1...3	25	30	20	—

S, мА/В	$C_{11и}$, $C_{12и}^{*}$, $C_{22и}^{**}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K_{уP}^{*}$, дБ $P_{вых}^{**}$, Вт $\Delta U_{ЗИ}^{***}$, мВ	$K_ш$, дБ $U_ш^{*}$, мкВ $E_ш^{**}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t_{выкл}^{*}$, нс f_p^{**}, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥4 (10 В; 10 мА)	≤9; ≤6**	≤100	—	—	2П304
6...10 (10 В; 5 мА)	≤5	≥13 (250 МГц)	≤6,5 (250 МГц)	—	2П305
6...10 (10 В; 5 мА)	≤5	≥13 (250 МГц)	—	—	
6...10 (10 В; 5 мА)	≤5	≥13 (250 МГц)	≤6,5 (250 МГц)	—	
6...10 (10 В; 5 мА)	≤5	≥13 (250 МГц)	—	—	
6...10 (10 В; 5 мА)	6,8	12*	≤6 (250 МГц)	—	2П305-2
6...10 (10 В; 5 мА)	6,8	12*	≤6 (250 МГц)	—	
6...10 (10 В; 5 мА)	6,8	12*	≤6 (250 МГц)	—	
6...10 (10 В; 5 мА)	6,8	12*	≤6 (250 МГц)	—	
3...8 (15 В; 5 мА)	5	10*	≤6 (200 МГц)	—	2П306
3...8 (15 В; 5 мА)	5	10*	≤6 (200 МГц)	—	
3...8 (15 В; 5 мА)	5	10*	≤6 (200 МГц)	—	
3...8 (15 В; 5 мА)	5	10*	≤8 (200 МГц)	—	
3...8 (15 В; 5 мА)	5	10*	≤8 (200 МГц)	—	
3...8 (15 В; 5 мА)	5	10*	≤8 (200 МГц)	—	
4...9	5	—	≤6 (0,4 ГГц) ≤20** (1 кГц)	—	2П307
5...10	5	—	≤2,5** (1 кГц)	—	
5...10	5	—	≤6 (0,4 ГГц)	—	
6...12	5	—	≤2,5** (1 кГц)	—	
6...12	5	—	≤6 (0,4 ГГц)	—	
1...4	6	—	20**	—	2П308
1...4	6	—	20**	—	
2...5	6	—	20**	—	
—	6	≤250	—	≤20	
—	6	≤500	—	≤20	
1...4	6	—	20**	—	2П308-1
1...4	6	—	20**	—	
2...5	6	—	—	—	
—	6	≤250	—	≤20	
—	6	≤500	—	≤20	

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_{С}$, $I^*_{С.\ Н}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
2П308А-9	n-канал	-60...+100	80	0,2...1,2	25	30	20	0,4...1
2П308Б-9	n-канал	-60...+100	80	0,3...1,8	25	30	20	1,4...3
2П308В-9	n-канал	-60...+100	80	0,4...2,4	25	30	20	1,4...3
2П308Г-9	n-канал	-60...+100	80	1...6	25	30	20	—
2П308Д-9	n-канал	-60...+100	80	1...3	25	30	20	—
2П308Е-9	n-канал	-60...+100	80	0,2...6	25	30	20	6
2П310А	С изолированным затвором и каналом n-типа	-60...+125	80	—	8; 10*	10	20	0,35...5
2П310Б		-60...+125	80	—	8; 10*	10	20	0,35...5
2П312А	n-канал	-60...+125	100	2...8	20	25	25	8...25
2П312Б	n-канал	-60...+125	100	0,8...6	20	25	25	1,5...7
2П312А-5	n-канал	-60...+125	50	2...8	20; 25*	25	25	8...25
2П312Б-5	n-канал	-60...+125	50	0,8...6	20; 25*	25	25	1,5...7
2П313А	n-канал	-60...+85	120	≥6	15	10	15	—
2П313Б	n-канал	-60...+85	120	≥6	15	10	15	—
2П313В	n-канал	-60...+85	120	≥6	15	10	15	—
2П322А	С двумя затворами, с p-n-переходом и n-каналом	-45...+85	200	—	20	25	—	5...42
2П333А	n-канал	-60...+125	250	1...8	50	45	10	≤1 мкА
2П333Б	n-канал	-60...+125	250	0,6...4	40	35	10	≤1 мкА
2П333В	n-канал	-60...+125	250	1...8	50	45	10	≤1 мкА
2П333Г	n-канал	-60...+125	250	0,6...4	40	35	10	≤1 мкА
2П334А	С p-n-переходом, с n-каналом	-60...+125	200	0,3...2	25; 30*	30	—	—
2П334Б		-60...+125	200	2...8	25; 30*	30	—	—

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у.Р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	Kш, дБ Uш*, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q***, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
1...4 1...4 2...5 — — ≥1	6 6 6 6 6 6	— — — ≤250 ≤500 —	20** 20** 20** — — —	— — — ≤20 ≤20 —	2П308-9
3...6 3...6	≤2,5 ≤2,5	≥5* (1 ГГц) ≥5* (1 ГГц)	≤6 (1 ГГц) ≤7 (1 ГГц)	— —	2П310
4...5,8 2...5	4 4	≥2* ≥2*	≤4 (0,4 ГГц) ≤6 (0,4 ГГц)	— —	2П312
≥4 ≥2	≤4 ≤4	≥2* (400 МГц) ≥2* (400 МГц)	≤4 (400 МГц) ≤6 (400 МГц)	— —	2П312А-5
5...10 5...10 5...10	≤6,8; 0,8* ≤6,8; 0,8* ≤6,8; 0,8*	— — —	— — —	300** 300** 300**	2П313
4...6,3	≤6; ≤0,2*	—	≤6 (250 МГц)	—	2П322
4...5,8 (10 В) 2...5 4...5,8 2...5	≤6 (10 В) ≤6 (10 В) ≤6 (10 В) ≤6 (10 В)	— — — —	20** (75 Гц) 20** (75 Гц) ≤14** (1 кГц) ≤14** (1 кГц)	200** 200** 200** 200**	2П333, 2П334
4...16,5 (10 В) 6...21 (10 В)	≤6 (10 В) ≤6 (10 В)	— —	≤20** (1 кГц) ≤5,5**(200 МГц)	— —	

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
2П335А-2 2П335Б-2	С р-n-переходом, с n-каналом	-60...+125 -60...+125	100 100	2...8 0,8...6	20; 25* 20; 25*	25 25	25 25	8...25 1,5...7
2П336А-1 2П336Б-1	С р-n-переходом, с n-каналом	-60...+125 -60...+125	60 60	0,4...2,5 1,5...6	25 25	30 30	— —	— —
2П337АР 2П337БР	С р-n-переходом, с n-каналом	-60...+125 -60...+125	200 200	2...6 2...6	25; 30* 25; 30*			20...87 20...87
2П338АР-1	С р-n-переходом, с n-каналом	-60...+125	60	0,2...4,5	20			2
2П340А-1 2П340Б-1	С р-n-переходом, с n-каналом	-60...+125 -60...+125	60 60	0,4...2,5 1,5...6	25 25	30 30	5 5	— —
2П341А 2П341Б	n-канал n-канал	-60...+125 -60...+125	150 150	0,4...3 0,4...3	15; 15* 15; 15*	10 10	— —	4,5...20 16...30
2П347А-2	С двумя изолированными затворами, с n-каналом	-60...+125	200	-0,1...-0,3*	14; 16*	5	—	≤5
2П350А 2П350Б	С двумя изолированными затворами и встроенным n-каналом	-60...+85 -60...+85	200 200	≤6 ≤6	15 15	15 15	30 30	≤3,5 ≤3,5

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у\ р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U_{ш}^{*}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°C	Корпус
≥4 ≥2	≤4; ≤1* ≤4	≥1,8* ≥1,8*	≤4 (400 МГц) ≤6 (400 МГц)	— —	**2П335-2**
≥4 (10 В) ≥4 (10 В)	6 (10 В) 6 (10 В)	— —	≤20** (1 кГц) —	— —	**2П336-1**
≥10 ≥10	≤5,5 ≤5,5	≤200*** ≤200***	≤1,5**(100 кГц) ≤3,5**(100 кГц)	≤400*** ≤400***	**2П337Р**
≥5	≤5	—	≤5**(1 кГц)	—	**2П338Р-1**
≥4 (10 В) ≥2 (10 В)	6 6	— —	≤20** (1 кГц) ≤20** (1 кГц)	— —	**2П340-1**
≥15 (5 В) ≥18 (5 В)	≤5 ≤5	— —	≤1,2** (100 кГц) 1,8 (200 МГц)	— —	**2П341А**
≥10 (10 В; 10 мА)	≤3,5; ≤0,04*	≥12* (0,8 ГГц)	≤3,9 (800 МГц)	—	**2П347А-2**
6...11 6...11	≤6 ≤6	— —	≤6 (400 МГц) ≤6 (400 МГц)	— —	**2П350**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\,max}$, мВт $P^*_{СИ\,т\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^*_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^*_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\,И}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^*_{С\,ост}$, мА
2П601А 2П601Б	n-канал n-канал	-60...+125 -60...+125	2* 2*	4...9 6...12	20; 20* 20; 20*	15 15	— —	169...400 169...400
2П601А9	С p-n-переходом и n-каналом	-60...+125	1 Вт	4...12	25	25	190	169...400
2П609А 2П609Б	n-канал n-канал	-60...+125 -60...+125	1,2* 1,2*	6...8 3...6	25 20	25 20	190 190	100...190 60...110
2П609А-5 2П609Б-5	n-канал n-канал	-60...+125 -60...+125	1,2* 1,2*	6...8 3...6	25 20	25 20	190 190	100...190 60...110
2П701А 2П701Б	С изолированным затвором, с n-каналом	-60...+125 -60...+125	40* 40*	— —	500 400	25 25	5...17 А 5...17 А	30; ≤35* 30; ≤35*
2П702А	С изолированным затвором, с n-каналом	-60...+125	50*	—	300; 320*	30	8...16 А	10
2П703А 2П703Б	С изолированным затвором, с p-каналом	-60...+125 -60...+125	60* 60*	4...9* 4...9*	-150 -100	30 30	12...25 А 12...25 А	5; 10* 5; 10*

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у\ р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_ш$, дБ $U_ш^{*}$, мкВ $E^{**}_ш$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс f^{**}_p, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
50...87 50...87	≤6 ≤6	— —	≤2** (100 кГц) ≤2** (100 кГц)	— —	2П601
50...87	≤10; ≤3,2*	—	5 (400 МГц); 3 (200 МГц)	—	2П601А9
≥30 ≥25	≤10; ≤3,2* ≤10; ≤3,2*	— —	5 (400 МГц); 3 (200 МГц) 5 (400 МГц); 3 (200 МГц)	— —	2П609
≥30 ≥25	≤10; ≤3,2* ≤10; ≤3,2*	— —	5 (400 МГц); 3 (200 МГц) 5 (400 МГц); 3 (200 МГц)	— —	2П609-5
800...2100 (2,5 А) 800...2100 (2,5 А)	≤30* (10 МГц) ≤30* (10 МГц)	≤3,5 ≤3,5	— —	30; 40* 30; 40*	2П701
800...2100 (2,5 А)	7*	≤1	—	60; 80*	2П702А
≥800 (30 В; 1 А) ≥800 (30 В; 1 А)	≤1500; ≤30* ≤1500; ≤30*	≤1,1 ≤0,9	— —	— —	2П703

Тип прибора	Структура	$T_{окр}$, °C	$P_{СИ\,max}$, мВт $P^*_{СИ\,т\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^*_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^*_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\,И}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^*_{С\,ост}$, мА
2П706А **2П706Б** **2П706В**	С изолированным затвором, с n-каналом	-60...+125 -60...+125 -60...+125	100* 100* 100*		500 400 400	30 30 30	15 А 15 А 15 А	10; 4* (500 В) 10; 4* (400 В) 10; 4* (400 В)
2П7102А	МОП, с p-каналом	-60...+125	125*	2...4*	60	±20	50 А	≤0,025
2П7102А91	МОП, с p-каналом	-60...+125	125*	2...4*	60	±20	50 А	≤0,025
2П7118А **2П7118Б** **2П7118В** **2П7118Г** **2П7118Д** **2П7118Е** **2П7118Ж** **2П7118И** **2П7118К** **2П7118Л**	МДП, с n-каналом	-60...+125 -60...+125 -60...+125 -60...+125 -60...+125 -60...+125 -60...+125 -60...+125 -60...+125 -60...+125	80* 80* 80* 80* 60* 60* 80* 80* 80* 80*	1,5...5* 1,5...5* 1,5...5* 1,5...5* 1,5...5* 1,5...5* 1,5...5* 1,5...5* 1,5...5* 1,5...5*	30 40 50 60 100 100 150 150 200 200	— — — — — — — — — —	35 А; 100*А 35 А; 100*А 35 А; 100*А 30 А; 100*А 30 А; 100*А 30 А; 100*А 25 А; 100*А 25 А; 100*А 20 А; 100*А 20 А; 100*А	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2П712А **2П712Б** **2П712В**	С изолированным затвором, с p-каналом	-60...+125 -60...+125 -60...+125	50* 50* 50*	-2...-5* -2...-5* -2...-5*	-80 -100 -100	±20 ±20 ±20	18...27 А 18...27 А 18...27 А	≤1 ≤1 ≤1
2П712А-5 **2П712Б-5** **2П712В-5**	С изолированным затвором, с p-каналом	-60...+125 -60...+125 -60...+125	50* 50* 50*	-2...-5* -2...-5* -2...-5*	-80 -100 -100	±20 ±20 ±20	18...27 А 18...27 А 18...27 А	≤1 ≤1 ≤1

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у.р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{Ш}$, дБ $U_{Ш}^{*}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°C	Корпус
≥1500 (30 В; 2 А) ≥1500 (30 В; 2 А) ≥1500 (30 В; 2 А)	2500; 300* 2500; 300* 2500; 300*	≤0,8 ≤0,5 ≤0,65	— — —	70; 100* 70; 100* 70; 100*	**2П706**
≥15000 (25 В; 31 А)	1900; 920**	≤0,028	—	—	**2П7102**
≥15000 (25 В; 31 А)	1900; 920**	≤0,028	—	—	**2П7102-91**
— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	0,025 0,035 0,04 0,05 0,075 0,085 0,1 0,12 0,16 0,2	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	**2П7118**
≥2000 (4 В; 2 А)	≤1800 (25 В); 100* ≤1800 (25 В); 100* ≤1800 (25 В); 100*	0,25 0,3 0,4	— — —	130; 350* 130; 350* 130; 350*	**2П712**
≥2000 (4 В; 2 А) ≥2000 (4 В; 2 А) ≥1800 (4 В; 2 А)	≤1800 (25 В); 100* ≤1800 (25 В); 100* ≤1800 (25 В); 100*	0,25 0,3 0,4	— — —	130; 350* 130; 350* 130; 350*	**2П712-5**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\,max}$, мВт $P^*_{СИ\,т\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^*_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^*_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_С$, $I^*_{С.Н}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^*_{С\,ост}$, мА
2П7140А	МОП, с n-каналом	-60...+125	—	—	50	—	3 А	—
2П7141А	МОП, с р-каналом	-60...+125	150*	—	100	—	40 А	—
2П7142А	МОП, с р-каналом	-60...+125	—	—	30	20	4,9 А	—
2П7143А	МОП, с р-каналом	-60...+125	—	—	30	20	10 А	—
2П7144А	МОП, с р-каналом	-60...+125	125*	—	100	20	19 А	—
2П7145А	МОП, с n-каналом	-60...+125	190*	—	200	20	30 А	—
2П762А	С изолированным	-60...+125	80*	2...5*	100	15	30 А; 100* А	≤2
2П762В	затвором,	-60...+125	80*	2...5*	100	15	30 А; 100* А	≤2
2П762Д	с n-каналом	-60...+125	80*	2...5*	150	15	30 А; 100* А	≤2
2П762Ж		-60...+125	80*	2...5*	150	15	20 А; 80* А	≤2
2П762К		-60...+125	60*	1,5...4*	100	15	15 А; 40* А	≤1
2П762Л		-60...+125	60*	1,5...4*	200	15	10 А; 40* А	≤1
2П762М		-60...+125	80*	2...5*	60	15	30 А; 110* А	≤2
2П762Н		-60...+125	80*	2...5*	200	15	20 А; 80* А	≤2

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом; $K^{*}_{у.Р}$, дБ; $P^{**}_{вых}$, Вт; $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ; $U_{ш}^{*}$, мкВ; $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$; Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс; $t^{*}_{выкл}$, нс; $f^{**}_{р}$, МГц; $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥3800 (15 В; 3 А)	—	≤0,13	—	—	2П7140, 2П7141
≥10000 (50 В; 21 А)	—	≤0,06	—	—	
≥7700 (15 В; 4,9 А)	—	≤0,058	—	—	2П7142, 2П7143
≥5600 (10 В; 5,6 А)	—	≤0,02	—	—	
≥6200 (10 В; 11 А)	—	≤0,2	—	—	2П7144
≥12000 (50 В; 18 А)	—	≤0,085	—	—	2П7145
—	≤3330 (20 В)	≤0,085	—	40; 80*	2П762
—	≤3330 (20 В)	≤0,1	—	40; 80*	
—	≤3330 (20 В)	≤0,1	—	40; 80*	
—	≤3330 (20 В)	≤0,2	—	40; 80*	
—	≤1600 (20 В)	≤0,2	—	30; 60*	
—	≤1600 (20 В)	≤0,5	—	30; 60*	
—	≤3330 (20 В)	≤0,5	—	40; 80*	
—	≤3330 (20 В)	≤0,2	—	40; 80*	

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С.\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
2П762И2	С изолированным затвором, с n-каналом	-60...+125	80*	2...5*	200; 200*	15	20 А; 80* А	≤2
2П762Б1	n-канал	-60...+125	80*	2...5*	100; 100*	15	30 А	≤2
2П762Г1	n-канал	-60...+125	80*	2...5*	100; 100*	15	30 А	≤2
2П762Е1	n-канал	-60...+125	80*	2...5*	150; 150*	15	30 А	≤2
2П762Г1-5	С изолированным затвором, с n-каналом	-60...+125	80*	2...5*	100; 100*	15	30 А; 100* А	≤2
2П762Е1-5		-60...+125	80*	2...5*	150; 150*	15	30 А; 100* А	≤2
2П762И2-5		-60...+125	80*	2...5*	200; 200*	15	20 А; 80*А	≤2
2П771А	МОП, с n-каналом	-60...+125	150*	2...4*	100	±20	40 А	—
2П797Г		-60...+125	150*	2...4*	100	±20	28 А	—
2П771А91	МОП, с n-каналом	-60...+125	150*	2...4*	100	±20	40 А	—
2П797Г91		-60...+125	150*	2...4*	100	±20	28 А	—
2П802А	n-канал	-60...+125	40*	-25	500	-35	2,5 А	0,5* (400 В)

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{у.Р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U_{ш}^{*}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
—	≤3330; ≤650**	≤0,25	—	40; 80*	**2П762-2**
— — —	≤3330 (20 В) ≤3330 (20 В) ≤3330 (20 В)	≤0,085 ≤0,1 ≤0,1	— — — — —	40; 80* 40; 80* 40; 80* ≤80; ≤30*	**2П762-1**
— — —	≤3330; ≤650** ≤3330; ≤650** ≤3330; ≤650**	≤0,2 ≤0,2 ≤0,5	—	40; 80* 40; 80* 40; 80*	**2П762-5**
≥14000 (20 А) ≥8700 (50 В; 17 А)	— —	≤0,045 ≤0,077	— —	— —	**2П771, 2П797**
≥14000 (20 А) ≥8700 (50 В; 17 А)	— —	≤0,045 ≤0,077	— —	— —	**2П771-91, 2П797-91**
≥800	—	—			**2П802**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\,max}$, мВт $P^{*}_{СИ\,т\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^{*}_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^{*}_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_{С}$, $I^{*}_{С,И}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^{*}_{С\,ост}$, мА
2П803А **2П803Б**	С изолированным затвором, с n-каналом	-60...+125 -60...+125	60* 60*	— —	1000 800	30 30	2,6...3,5 А 3...4 А	≤7; ≤10* ≤7; ≤10*
2П815А **2П815Б** **2П815В** **2П815Г**	С изолированным затвором, с n-каналом	-60...+125 -60...+125 -60...+125 -60...+125	125* 125* 125* 125*	2...7* 2...7* 2...7* 2...7*	400 500 400 500	20 20 20 20	20 А 20 А 15 А 15 А	2; 5* 2; 5* 2; 5* 2; 5*
2П816А **2П816Б** **2П816В** **2П816Г**	С изолированным затвором, с n-каналом	-60...+125 -60...+125 -60...+125 -60...+125	125* 125* 125* 125*	5 5 5 5	800 800 1000 1000	25 25 25 25	25 А 25 А 25 А 25 А	2; 5* 2; 5* 1; 5* 1; 5*
2П901А **2П901Б**	n-канал n-канал	-60...+125 -60...+125	20* 20*	— —	70 70	30 30	4 А 4 А	200 200
2П901А-5 **2П901Б-5**	n-канал n-канал	-60...+125 -60...+125	20* 20*	— —	70 70	30 30	4 А 4 А	200 200
2П902А	С изолированным затвором и n-каналом	-60...+125	3,5*	—	50	30	200	≤10; ≤0,5*
2П902Б		-60...+125	3,5*	—	50	30	200	≤10; ≤0,5*
2П903А	С p-n-переходом и n-каналом	-60...+125	6*	5...12	20; 20*	15	700	≤700; ≤0,05*
2П903Б		-60...+125	6*	1...6,5	20; 20*	15	700	≤500; ≤0,05*
2П903В		-60...+125	6*	1...10	20; 20*	15	700	≤600; ≤0,05*

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{у\,P}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	Кш, дБ $U_{ш}^{*}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс f^{**}_{p}, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥750 (30 В; 1 А) ≥750 (30 В; 1 А)	≤3100; ≤20* ≤3100; ≤20*	≤5 ≤4,5	— —	— —	2П803
≥4500 (25 В; 2 А) ≥4500 (25 В; 2 А) ≥4500 (25 В; 2 А) ≥4500 (25 В; 2 А)	≤5600 (20 В) ≤130* ≤440** ≤440**	≤0,3 ≤0,8 ≤0,5 ≤1	— — — —	40; 160* 40; 160* 40; 160* 40; 160*	2П815
≥10000 (25 В; 10 А) ≥10000 (25 В; 10 А) ≥10000 (25 В; 10 А) ≥10000 (25 В; 10 А)	≤2600 (20 В) ≤150* ≤400** ≤400**	≤1 ≤1 ≤1,2 ≤1,2	— — — —	≤90; ≤110* ≤90; ≤110* ≤90; ≤110* ≤90; ≤110*	2П816
50...160 60...170	≤100 ≤100	≥10**; 7* (100 МГц) ≥6,7**; 7* (100 МГц)	— —	— —	2П901
50...160 60...170	≤100 ≤100	≥10**; 7* (100 МГц) ≥6,7**; 7* (100 МГц)	— —	— —	2П901-5
10...26 (20 В; 50 мА) 10...26 (20 В; 50 мА)	≤11; ≤0,6* ≤11; ≤0,6*	≥6,6* (250 МГц) ≥0,8* (60 МГц)	≤6 (250 МГц) ≤6 (250 МГц)	— —	2П902
85...140 (8 В) 50...130 (8 В) 60...140 (8 В)	≤18 ≤18 ≤18	≥0,09** (30 МГц); ≤10; ≥7,6* ≥0,09* (30 МГц); ≤10; ≥7,6* ≥0,09** (30 МГц); ≤10; ≥7,6*	≤1** (100 кГц) ≤2,5** (100 кГц) ≤4,6** (100 кГц)	— — —	2П903

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\,max}$, мВт; $P^*_{СИ\,т\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^*_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^*_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,И}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^*_{С\,ост}$, мА
2П903А-5	С p-n-переходом и n-каналом	-60...+125	6*	5...12	20; 20*	15	700	≤700; ≤0,05*
2П903Б-5		-60...+125	6*	1...6,5	20; 20*	15	700	≤480; ≤0,05*
2П903В-5		-60...+125	6*	1...10	20; 20*	15	700	≤600; ≤0,05*
2П904А	С изолированным затвором и индуцированным n-каналом	-60...+125	75*	—	70; 90*	30	5 А	≤350; ≤200*
2П904Б		-60...+125	75*	—	70; 90*	30	3 А	≤350; ≤200*
2П905А	С изолированным затвором и n-каналом	-60...+125	4*	—	60; 70*	±30	350	20*; 1*
2П905Б		-60...+125	4*	—	60; 70*	±30	350	20*; 1*
2П905А-5	С изолированным затвором и n-каналом	-60...+125	4*	—	60; 70*	±30	350	20*; 1*
2П907А	С изолированным затвором и n-каналом	-60...+125	11,5*	—	60; 70*	±30	2,7 А	≤100; ≤10*
2П907Б		-60...+125	11,5*	—	60; 70*	±30	1,7 А	≤100; ≤10*
2П908А	С изолированным затвором и индуцированным n-каналом	-60...+125	3,5*	—	40; 50*	20	280	≤25; ≤0,5*
2П908Б		-60...+125	3,5*	—	40; 50*	20	200	≤25; ≤0,2*
2П909А	С изолированным затвором и индуцированным n-каналом	-60...+125	60	—	50; 60*	25	6,5 А	200; 100*
2П909Б		-60...+125	60	—	50; 60*	25	6,5 А	200; 100*
2П909В		-60...+125	40	—	50; 60*	25	6,5 А	200; 100*
2П909Г			40	—	50; 60*	25	6,5 А	30; 30*
2П911А	С изолированным затвором и индуцированным n-каналом	-60...+125	30	—	50; 60*	25	6,5 А	1...150; 50*
2П911Б		-60...+125	30	—	50; 60*	25	6,5 А	1...70; 30*
2П912А	С изолированным затвором, n-канал	-60...+125	40*	—	100; 110*	20	8 А	0,1...20
2П912Б		-60...+125	40*	—	60; 70*	20	12 А	0,1...20

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^*_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^*_{у.р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_ш$, дБ $U_ш^*$, мкВ $E^{**}_ш$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^*_{выкл}$, нс $f^{**}_р$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
85...140 (8 В)	≤18	≥0,09** (30 МГц); ≤10; ≥7,6*	≤1** (100 кГц)	—	2П903-5
50...130 (8 В)	≤18	≥0,09* (30 МГц); ≤10; ≥7,6*	≤2,5** (100 кГц)	—	
60...140 (8 В)	≤18	≥0,09** (30 МГц); ≤10; ≥7,6*	≤4,6** (100 кГц)	—	
250...510 250...510	≤300 (30 В) ≤300 (30 В)	≥50** (60 МГц) ≥30** (60 МГц) ≥13* (60 МГц)	— —	— —	2П904
18...39 18...39	≤7 (25 В) ≤11 (25 В)	≥1** (1 ГГц) ≥6** (1 ГГц)	≤6 (1 ГГц) ≤6,5 (1 ГГц)	— —	2П905
18...39	≤7 (25 В)	≥1** (1 ГГц)	≤6 (1 ГГц)	—	2П905А-5
110...200 (20 В; 0,5 А)	≤3* (25 В)	≥4** (1 ГГц)	—	≤2; ≤2*	2П907
110...200 (20 В; 0,5 А)	≤3* (25 В)	≥3** (1 ГГц)	—	≤2; ≤2*	
≥24 (20 В; 80 мА) ≥24 (20 В; 80 мА)	≤4,5 (25 В); ≤0,6* ≤6,5 (25 В); ≤0,6*	≥1** (1,76 ГГц) ≤25	— —	— —	2П908
350...1000 350...1000 350...1000 350...1000	≤225 (5 В) ≤225 (5 В) ≤225 (5 В) ≤225 (5 В)	≥50** (0,4 ГГц) ≥30** (0,4 ГГц) ≥30** (0,4 ГГц) ≤1,6	— — — —	4; 4* 4; 4* 4; 4* 4; 4*	2П909, 2П911
200...600 200...600	80 (-5 В) 80 (-5 В)	≥10** (1 ГГц) ≤3,5	— —	— 3; 5*	
800...2200 800...2200	500 (5 В) 16* (-5 В)	≤0,8 ≤0,4	— —	30; 30* 30; 30*	2П912

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^{*}_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^{*}_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^{*}_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_{С}$, $I^{*}_{С,\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^{*}_{С\ ост}$, мА
2П913А **2П913Б**	С изолированным затвором, n-канал	-60...+125 -60...+125	100* 100*	— —	50; 60* 50; 60*	20 20	14 А 10 А	≤200*; ≤300* ≤200*; ≤300*
2П914А	С p-n-переходом, n-каналом	-60...+125	2,5*	8...30	50; 80*	-30	100	≤250*; ≤0,01*
2П917А **2П917Б**	С изолированным затвором, n-канал	-60...+125 -60...+125	30* 30*	— —	300; 310* 150; 160*	25 25	5 А 5 А	— —
2П918А **2П918Б**	С изолированным затвором, n-канал	-60...+125 -60...+125	45* 45*	— —	45; 55* 45; 55*	20 20	6 А 4 А	60; 50* 60; 50*
2П920А **2П920Б**	С изолированным затвором, n-канал	-60...+125 -60...+125	130* 130*	— —	50; 60* 50; 60*	25 25	15 А 12 А	100; 100* 100; 100*
2П922А **2П922Б**	С изолированным затвором и индуцированным n-каналом	-60...+125 -60...+125	75* 75*	2...8* 2...8*	100 100	±30 ±30	10 А 10 А	2 2
2П922А-5 **2П922Б-5**	С изолированным затвором и индуцированным n-каналом	-60...+125 -60...+125	75* 75*	2...8* 2...8*	100 100	±30 ±30	10 А 10 А	2 2

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^{*}_{у.р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$К_{ш}$, дБ $U_{ш}^{*}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
1000...2500 1000...2500	≤390 (25 В) ≤390 (25 В)	≥100** (0,4 ГГц) ≥70** (0,4 ГГц), ≥4* (0,4 ГГц)	— —	— —	2П913
10...30 (10 В)	≤10; ≤2,5*	≥3* (200 МГц)	≤6 (200 МГц)	—	2П914А
200...1700 200...1700	— —	— —	— —	— —	2П917А
550...700 350...600	≤130 (-5 В) ≤130 (-5 В)	≥25** (1 ГГц) ≥17** (1 ГГц)	— —	— —	2П918
1000...2300 1000...2000	≤160** ≤7*	≥150** (0,4 ГГц) ≥120** (0,4 ГГц)	— —	— —	2П920
1000...2100 (1 А) 1000...2100 (1 А)	≤2000 (20 В) ≤2000 (20 В)	≤0,2 ≤0,4	— —	≤100; ≤100* ≤100; ≤100*	2П922
1000...2100 (1 А) 1000...2100 (1 А)	≤2000 (20 В) ≤2000 (20 В)	≤0,2 ≤0,4	— —	≤100; ≤100* ≤100; ≤100*	2П922-5

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\,max}$, мВт $P^*_{СИ\,т\,max}$, Вт	$U_{ЗИ\,отс}$, $U^*_{ЗИ\,пор}$, В	$U_{СИ\,max}$, $U^*_{ЗС\,max}$, В	$U_{ЗИ\,max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\,И}$, мА	$I_{С\,нач}$, $I^*_{С\,ост}$, мА
2П923А	С изолированным затвором и n-каналом	-60...+125	100*	—	50; 60*	20	12 А	≤50; ≤50*
2П923Б		-60...+125	100*	—	50; 60*	20	8 А	≤50; ≤50*
2П923В			50*	—	50; 60*	20	6 А	≤25; ≤25*
2П923Г			50*	—	50; 60*	20	4 А	≤25; ≤25*
2П926А	С p-n-переходом, n-каналом	-60...+125	50*	-15	450; 475*	-25	16,5 А	—
2П926Б		-60...+125	50*	-15	400; 420*	-20	16,5 А	—
2П928А	С изолированным затвором и n-каналом	-60...+125	250*	—	50; 60*	25	21 А	≤150; ≤150*
2П928Б		-60...+125	250*	—	55; 65*	25	16 А	≤150; ≤150*
2П933А	С изолированным затвором и каналом n-типа	-60...+125	160*	—	45; 55*	20	9 А	75; 75*
2П933Б		-60...+125	160*	—	45; 55*	20	7,5 А	75; 75*
2П934А	СИТ, n-канал	-60...+125	50*	—	450	-5	15 А	—
2П934Б		-60...+125	50*	—	300	-5	15 А	—
2П938А	С p-n-переходом и n-каналом	-60...+125	50*	—	500; 505*	-5	15 А	≤3* ($U_{ЗИ}$ = 0)
2П938Б		-60...+125	50*	—	500; 505*	-5	15 А	≤3* ($U_{ЗИ}$ = -3 В)
2П938В		-60...+125	50*	—	450; 455*	-5	15 А	≤3* ($U_{ЗИ}$ = -3 В)
2П938Г		-60...+125	50*	—	400; 405*	-5	15 А	≤3* ($U_{ЗИ}$ = -3 В)
2П938Д		-60...+125	50*	—	300; 305*	-5	15 А	≤3* ($U_{ЗИ}$ = -3 В)

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^*_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\,отк}$, Ом $K^*_{у.Р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_ш$, дБ $U_ш^*$, мкВ $E^{**}_ш$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^*_{выкл}$, нс $f^{**}_р$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥1000 (20 В; 3 А) ≥700 (20 В; 3 А) ≥550 (20 В; 2 А) ≥350 (20 В; 2 А)	≤400 (10 В) ≤400 (10 В) ≤220 (10 В) ≤220 (10 В)	≥50** (1 ГГц) ≥30** (1 ГГц) ≥25** (1 ГГц) ≥17** (1 ГГц)	— — — —	— — — —	**2П923**
≥2000 (20 В; 4 А) ≥2000 (20 В; 4 А)	— —	≤0,1 ≤0,1	— —	100; 100* 100; 100*	**2П926**
1800 (20 В; 3 А) 1800 (20 В; 3 А)	≥150** (20 В) ≥150** (20 В)	≥250** (0,4 ГГц) ≥200** (0,4 ГГц)	— —	— —	**2П928**
≥650 (20 В; 2 А) ≥550 (20 В; 2 А)	210 (10 В) 210 (10 В)	≥70** (1 ГГц) ≥60** (1 ГГц)	— —	— —	**2П933**
$h_{21Х}$≥20 (5 В; 5 А) $h_{21Х}$≥20 (5 В; 5 А)	— —	≤0,07 ≤0,07	— —	100; 2500* 100; 2500*	**2П934А**
$h_{21Э}$≥20* (5 В; 5 А) $h_{21Э}$≥20* (5 В; 5 А) $h_{21Э}$≥20* (5 В; 5 А) $h_{21Э}$≥20* (5 В; 5 А) $h_{21Э}$≥20* (5 В; 5 А)	— — — — —	≤0,07 ≤0,07 ≤0,07 ≤0,07 ≤0,07	— — — — —	≤200 ≤200 ≤200 ≤200 ≤200	**2П938**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С.\ И}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
2П941А	С изолированным затвором и n-каналом	-60...+125	3*	—	36; 41*	20	600	≤10; ≤2*
2П941Б	С изолированным затвором и n-каналом	-60...+125	15*	—	36; 41*	20	3 А	≤20; ≤8*
2П941В **2П941Г** **2П941Д**	С изолированным затвором и n-каналом, сдвоенный	-60...+125 -60...+125 -60...+125	30* 30* 30*	— — —	36; 41* 36; 41* 36; 41*	20 20 20	6 А 5 А 3 А	≤30; ≤16* ≤30; ≤16* ≤20; ≤8*
2П942А **2П942Б** **2П942В**	СИТ с n-каналом	-60...+125 -60...+125 -60...+125	40* 40* 40*	— — —	800; -10* 700; -10* 600; -10*	-25 -25 -25	10 А; 30* А 10 А; 30* А 10 А; 30* А	— — —
2П942А-5 **2П942Б-5** **2П942В-5**	СИТ с n-каналом	-60...+125 -60...+125 -60...+125	40* 40* 40*	— — —	800; -10* 700; -10* 600; -10*	-25 -25 -25	10 А; 30* А 10 А; 30* А 10 А; 30* А	— — —
Сборки полевых транзисторов								
2ПС104А **2ПС104Б** **2ПС104В** **2ПС104Г** **2ПС104Д** **2ПС104Е**	Сдвоенный, с p-каналом	-60...+125 -60...+125 -60...+125 -60...+125 -60...+125 -60...+125	45 45 45 45 45 45	-(0,2...1) -(0,2...1) -(0,4...2) -(0,8...3) -(0,8...3) -(0,4...2)	25; 30* 25; 30* 25; 30* 25; 30* 25; 30* 25; 30*	-30; +0,5 -30; +0,5 -30; +0,5 -30; +0,5 -30; +0,5 -30; +0,5	— — — — — —	0,1...0,8 0,1...0,8 0,35...1,5

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у.р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U_{ш}^{*}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс f^{**}_{p}, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
200...400 (0,5 А)	≤20 (12 В)	≥7,5*; ≥3** (0,4 ГГц)	—	—	**2П941А**
600...1800 (2 А)	≤100 (12 В)	≥4,3*; ≥15** (0,4 ГГц)	— — —	— — —	**2П941Б**
1200...3600 (4 А) 1000...3600 (4 А) ≥600 (2 А)	≤200 (12 В) ≤200 (12 В) ≤200 (12 В)	≥5*; ≥30** (0,4 ГГц) ≥4,5*;≥25** (0,4 ГГц) ≥5*; ≥30** (0,4 ГГц)	—	—	**2П941(В, Г, Д)**
$h_{21э}$≥8 (5 А) $h_{21э}$≥8 (5 А) $h_{21э}$≥8 (5 А)	— — —	— — —	— — —	— — —	**2П942А**
$h_{21э}$≥8 (5 А) $h_{21э}$≥8 (5 А) $h_{21э}$≥8 (5 А)	— — —	— — —	— — —	— — —	**2П942А-5**
Сборки полевых транзисторов					
≥0,35 (10 В) ≥0,35 (10 В) ≥0,65 (10 В) ≥1 (10 В) ≥1 (10 В) ≥0,65 (10 В)	≤4,5 (10 В); 1,5* ≤4,5 (10 В); 1,5* ≤4,5 (10 В); 1,5* ≤4,5 (10 В); 1,5* ≤4,5 (10 В); 1,5* ≤4,5 (10 В); 1,5*	≤30*** ≤30*** ≤50*** ≤50*** ≤20*** ≤20***	≤0,4*(10 Гц) ≤1*(10 Гц) ≤5*(10 Гц) ≤1*(10 Гц) ≤5*(10 Гц) —	≤50*** ≤150*** ≤150*** ≤100*** ≤150*** ≤20***	**2ПС104**

Тип прибора	Структура	$T_{окр.}$, °C	$P_{СИ\ max}$, мВт $P^*_{СИ\ т\ max}$, Вт	$U_{ЗИ\ отс}$, $U^*_{ЗИ\ пор}$, В	$U_{СИ\ max}$, $U^*_{ЗС\ max}$, В	$U_{ЗИ\ max}$, В	$I_С$, $I^*_{С,\ н}$, мА	$I_{С\ нач}$, $I^*_{С\ ост}$, мА
2ПС202А-2	С p-n-переходом, с n-каналом	-60...+125	30	0,4...1	15; 20*	0,5	—	0,35...0,8
2ПС202Б-2		-60...+125	30	0,4...2	15; 20*	0,5	—	0,35...1,5
2ПС202В-2		-60...+125	30	1...3	15; 20*	0,5	—	1,1...3
2ПС202Г-2		-60...+125	30	1...3	15; 20*	0,5	—	1,1...3
2ПС202Д-1	С p-n-переходом, с n-каналом	-60...+125	60	0,4...2	15; 20*	0,5	—	0,35...1,5
2ПС202Е-1		-60...+125	60	1...3	15; 20*	0,5	—	1,1...3
2ПС316А-1	С p-n-переходом, с n-каналом	-60...+125	60	0,3...2	25; 25*	25	—	—
2ПС316Б-1		-60...+125	60	0,3...2	25; 25*	25	—	—
2ПС316В-1		-60...+125	60	1,3...4	25; 25*	25	—	—
2ПС316Г-1		-60...+125	60	2,5...6	25; 25*	25	—	—

S, мА/В	$C_{11и}$, $C^{*}_{12и}$, $C^{**}_{22и}$, пФ	$R_{СИ\ отк}$, Ом $K^{*}_{у.р}$, дБ $P^{**}_{вых}$, Вт $\Delta U^{***}_{ЗИ}$, мВ	$K_{ш}$, дБ $U_{ш}^{*}$, мкВ $E^{**}_{ш}$, нВ/$\sqrt{Гц}$ Q^{***}, Кл	$t_{вкл}$, нс $t^{*}_{выкл}$, нс $f^{**}_{р}$, МГц $\Delta U_{ЗИ}/\Delta T^{***}$, мкВ/°С	Корпус
≥0,65 (5 В)	≤6 (10В); ≤2*(10В)	≤30***	≤20**	30**;≤50***	2ПС202-2
≥0,65 (5 В)	≤6 (10В); ≤2*(10В)	≤30***	≤20**	30**;≤150***	
≥1 (5 В)	≤6 (10В); ≤2*(10В)	≤30***	≤20**	30**;≤100***	
≥1 (5 В)	≤6 (10В); ≤2*(10В)	≤30***	—	30**;≤150**	
≥0,65 (5 В)	≤6 (10В); ≤2*(10В)	≤30***	—	30**	2ПС202-1
≥1 (5 В)	≤6 (10В); ≤2*(10В)	≤30***	—	30**	
≥0,5 (5 В; 0,3 мА)	≤6 (10 МГц); ≤2*	≤50***	—	≤15***	2ПС316-1
≥0,5 (5 В; 0,3 мА)	≤6 (10 МГц); ≤2*	≤50***	—	≤30***	
≥0,5 (5 В; 0,3 мА)	≤6 (10 МГц); ≤2*	≤50***	—	≤30***	
≥0,5 (5 В; 0,3 мА)	≤6 (10 МГц); ≤2*	≤50***	—	≤30***	

Раздел 4
КОРПУСА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

4.1. Конструкции корпусов транзисторов

Корпус прибора должен защищать кристалл от механических повреждений и воздействия внешних факторов, эффективно отводить тепло, обеспечивать электрическую изоляцию токопроводящих выводов и их надежное соединение с внешними электрическими цепями, а также простое и удобное крепление в аппаратуре.

При производстве полупроводниковых приборов используются типовые (базовые) унифицированные конструкции корпуса. Конструктивное оформление приборов обусловлено максимальными мощностью рассеяния и током, частотными свойствами, особенностями технологии изготовления и условиями эксплуатации.

Для сборки кристаллов применяются цельно- и металлостеклянные, металлические с проходным изолятором, металлокерамические, керамические с компаундной (пластмассовой) герметизацией и пластмассовые корпуса различных форм и размеров. Выпускаются также бескорпусные приборы.

Металлостеклянный корпус обычно состоит из ножки (фланца) и баллона (колпачка), герметично соединяемых друг с другом электроконтактной и холодной сваркой или пайкой. Наружные металлические детали корпуса в зависимости от типа прибора могут иметь металлическое (золочение, никелирование и др.) или лакокрасочное покрытие. Наличие поверхности баллона (колпачка) цилиндрической формы допускает применение радиаторов, позволяющих увеличить рассеиваемую мощность приборов.

Выводы корпусов могут иметь одно- или двухстороннее расположение и находиться с той стороны, которой прибор прижимается к теплоотводу или шасси (направляться вниз), например в корпусах КТ-9 (ТО-3); могут располагаться со стороны, противоположной контактирующей (обычно в мощных приборах), например в корпусах КТ-4 (ТО-60, ТО-63) а также могут иметь радиальное расположение (обычно у ВЧ- и СВЧ-транзисторов).

Один из выводов прибора (от базы, эмиттера или коллектора) может быть электрически связан с корпусом или все выводы могут быть электрически изолированы от него. Для улучшения теплоотвода с одновременной электрической изоляцией кристалла от корпуса часто используется держатель из бериллиевой керамика, напаиваемый на фланец корпуса. Окись бериллия является хорошим изолятором и в то же время обладает высокой теплопроводностью.

Отвод тепла от кристалла зависит от теплофизических свойств материала корпуса. Так как у транзисторов отвод тепла обычно осуществляется через область коллектора, связанного электрически с корпусом, а работа прибора предпочтительнее в схеме с ОЭ, то корпус прибора изолируется от шасси с помощью прокладки (из слюды, окиси бериллия и др.). Имеются конструкции, где отвод тепла осуществляется через коллектор, электрически изолированный от корпуса, например корпус КТ-4 (ТО-60). Иногда для улучшения отвода тепла в транзисторах малой и средней мощности внутренний объем корпуса заполнятся теплоотводящим наполнителем. Фланцевые корпуса обеспечивают лучший отвод тепла, чем корпуса с монтажным винтом.

В различных странах проведены стандартизация и унификация конструкций корпусов полупроводниковых приборов. Это дает возможность, в частности, стандартизировать теплоотводы (радиаторы) для приборов. Габаритные и присоединительные размеры корпусов отечественных диодов и транзисторов стандартизированы и устанавливаются ГОСТ 18472—88. По габаритно-присоединительным размерам конструкции корпусов с учетом международной стандартизации должны отвечать рекомендациям МЭК № 191-2. В нашей стране имеется ряд корпусов транзисторов и диодов, соответствующих этому документу:

- металлостеклянный корпус типа КТ-1 с двумя, тремя (аналогичный зарубежный корпус типа ТО-18), четырьмя (ТО-72) или пятью выводами для транзисторов с рабочей частотой до 1,5 ГГц;

- металлостеклянный корпус типа КТ-2 (ТО-5, ТО-39, ТО-33) для транзисторов малой и средней мощности (до 15 Вт);
- металлокерамический корпус типа КТ-4 (ТО-60), имеющий три изолированных вывода, крепящий болт и предназначенный для мощных ВЧ- и СВЧ-транзисторов;
- металлокерамические корпуса типов КТ-6, КТ-7 (ТО-61, ТО-63 соответственно) для транзисторов большой мощности (до 200 Вт) с двумя (для низкочастотных транзисторов) или тремя (для высокочастотных транзисторов) изолированными от корпуса выводами;
- металлостеклянные корпуса типов КТ-8, КТ-9 (ТО-66, ТО-3 соответственно) для транзисторов большой мощности.

Корпус типа КТ-9 (ТО-3) обычно используется для работы на частотах до 100...150 МГц, типа КТ-4 (ТО-60) — до 500 МГц; для работы на более высоких частотах применяются специальные конструкции (КТ-15, КТ-20, КТ-30, КТ-32).

На высоких частотах на электрические параметры приборов начинают влиять паразитные параметры корпуса: межэлектродные емкости, емкости электродов относительно корпуса и индуктивности выводов. Для работы на СВЧ (более 1 ГГц) индуктивность выводов должна быть менее 1 нГн.

В отличие от низкочастотных приборов, у высокочастотных выводы делаются короткими, толстыми, широкими и далеко расположенными друг от друга. Были разработаны коаксиальный корпус и различные модификации корпуса с полосковыми выводами (для сопряжения с полосковыми линиями). Например, у коаксиального корпуса индуктивность общего вывода 0,1 нГн, у керамического полоскового корпуса типа L-5 индуктивность эмиттерного вывода 0,275 нГн.

Для ВЧ- и СВЧ-транзисторов существуют два способа монтажа кристалла в корпус: для схем с ОЭ (эмиттер электрически связан с корпусом) и с ОБ. Наилучшие результаты работы усилительных транзисторов в полосковых корпусах получены в схеме с ОБ (класс С), так как при этом получаются высокие $K_{ур}$ и достигается лучшая стабильность усилителя. Транзисторы, включаемые по схеме с ОЭ, являются оптимальными для генераторов, так как паразитные параметры корпуса оказываются включенными в цепь обратной связи.

4.2. Особенности пластмассовых корпусов и бескорпусные приборы

Бескорпусные приборы в виде кристаллов (пластин) с шариковыми, балочными, проволочными или ленточными выводами, на керамических держателях, а малогабаритных пластмассовых корпусах КТ-46, КТ-47 (SOT-23, SOT-89) применяются в составе гибридных интегральных микросхем. При этом осуществляется общая герметизация всей интегральной микросхемы для защиты приборов от влияния окружающей среды.

Разработка полупроводниковых приборов в пластмассовом корпусе позволила снизить их стоимость и упростить технологию герметизации по сравнению с аналогичными по электрическим параметрам приборами в металлостеклянном корпусе. Это произошло за счет автоматизации операций монтажа, герметизации, сборки и классификации приборов, а также вследствие снижения некоторых требований к приборам (например, у приборов в пластмассовом корпусе более узкий рабочий диапазон температур). Использование пластмассовых корпусов — это также экономия керамики и металлов, в том числе дорогостоящих. Ряд конструкций корпусов создан лишь благодаря специфическим свойствам полимерных материалов.

Технологически процессы изготовления этих приборов не отличаются от аналогичных процессов изготовления приборов в обычном корпусе, только вместо ножки здесь используется центральный (обычно коллекторный) вывод и вместо металлического корпуса — заливка всей структуры полимерами.

Герметизация полимерами, применяемая как для маломощных, так и для мощных приборов, осуществляется либо в виде монолитной конструкции (герметизирующий материал контактирует с кристаллом), созданной путем погружения в жидкий полимер, заливкой в формах, литьем, опрессовкой или формовкой, либо в вице капсульной конструкции, при которой контакт кристалла с герметизирующим материалом отсутствует. Герметизация может быть односторонней (для мощных приборов) или двусторонней (для маломощных приборов). В качестве заливочных компаундов (полимеров) используются эпоксидная, полиэфирная или фенольная смола, кремнийорганические материалы с различными наполнителями.

Стабильность параметров и надежность приборов, герметизированных полимерами, связаны с различными серьезными проблемами и определяются изменениями, которые происходят на поверхности кристаллов. Эти изменения обусловлены наличием примесей в полимерном материале, проникновением влаги через выводы и полимер на поверхность кристалла, внутренними напряжениями, возникающими в герметизирующем слое, адгезией пластмассы с материалом выводов, наличием электролиза контактов при проникновении влаги. Состав материала корпуса и метод герметизации оказываются наиболее важными факторами, связанными с надежностью приборов. Дефекты пластмассового корпуса могут вызвать большие токи утечки, электрохимические процессы разрушения (металлизации и выводов), термомеханические разрушения (из-за различия коэффициентов расширения пластмассы и металлических выводов). Поэтому пластмасса должна иметь высокие электроизоляционные свойства (для снижения токов утечки), минимальные усадку и старение в течение длительного срока службы, быть влагонепроницаемой, термостойкой до температуры пайки и выше. Кроме того, она должна быть светонепроницаемой и пожаробезопасной (не должна самовоспламеняться).

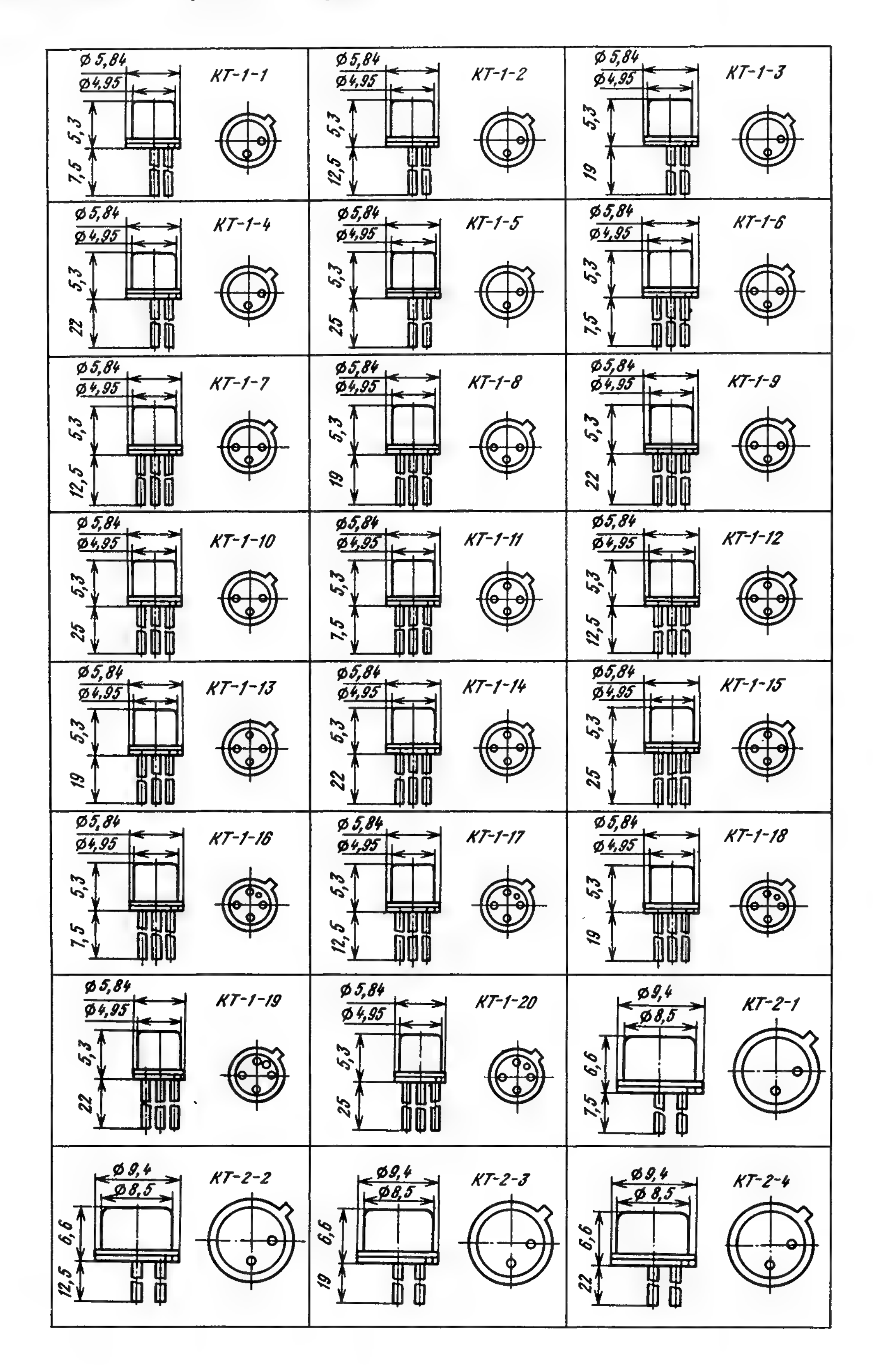
Пластмассовые приборы имеют высокую механическую прочность, вибро- и ударопрочность. Однако пластмассовое покрытие недостаточно герметично, имеет плохой отвод тепла. В ряде случаев при использовании пластмассовых приборов в радиоэлектронной аппаратуре требуется дополнительная магнитная и электрическая экранировка их корпуса.

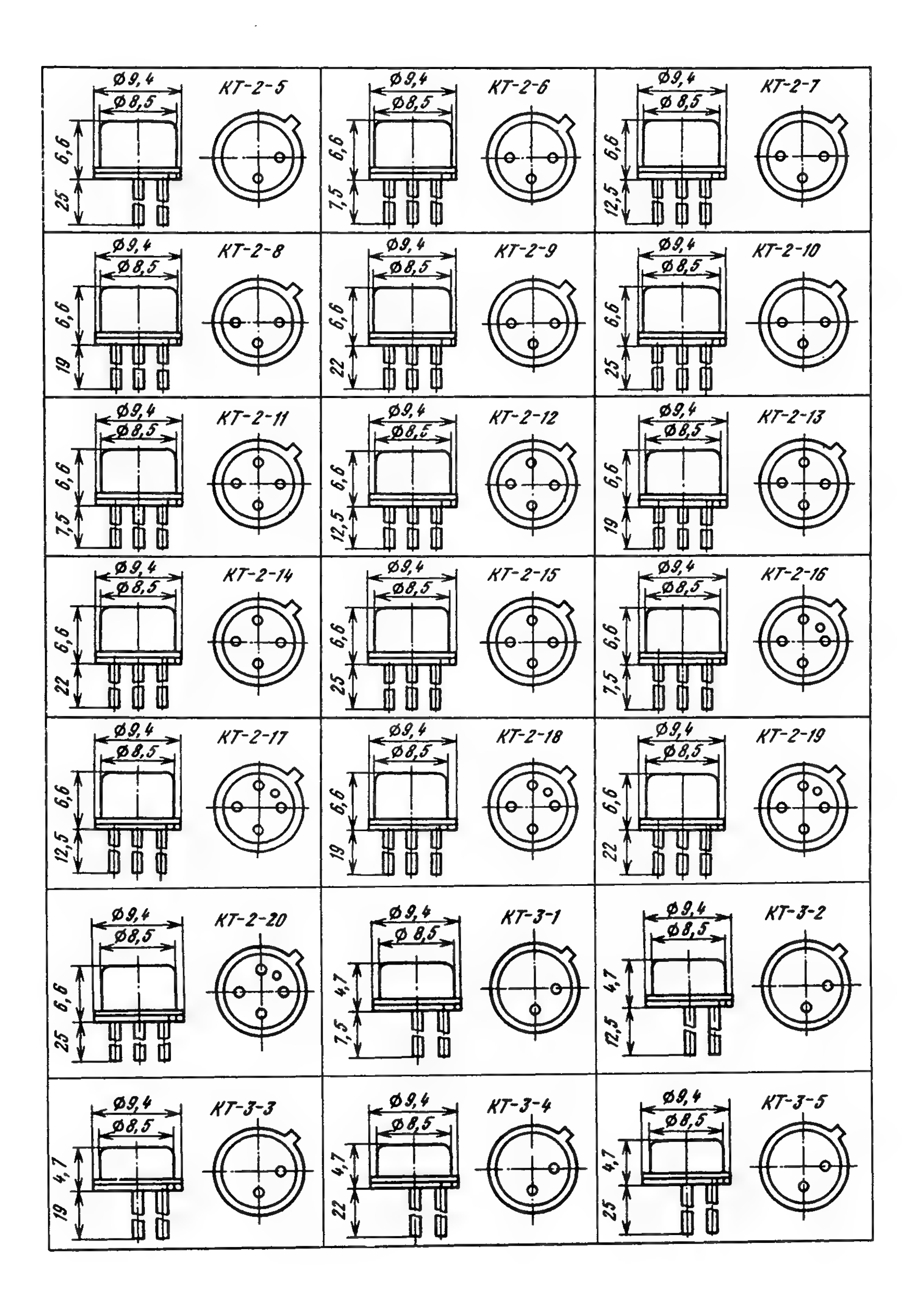
Для мощных приборов в качестве основания пластмассового корпуса и теплоотвода служит металлическая пластина (например, медная), на которую непосредственно монтируется кристалл прибора и запрессовывается пластмассой.

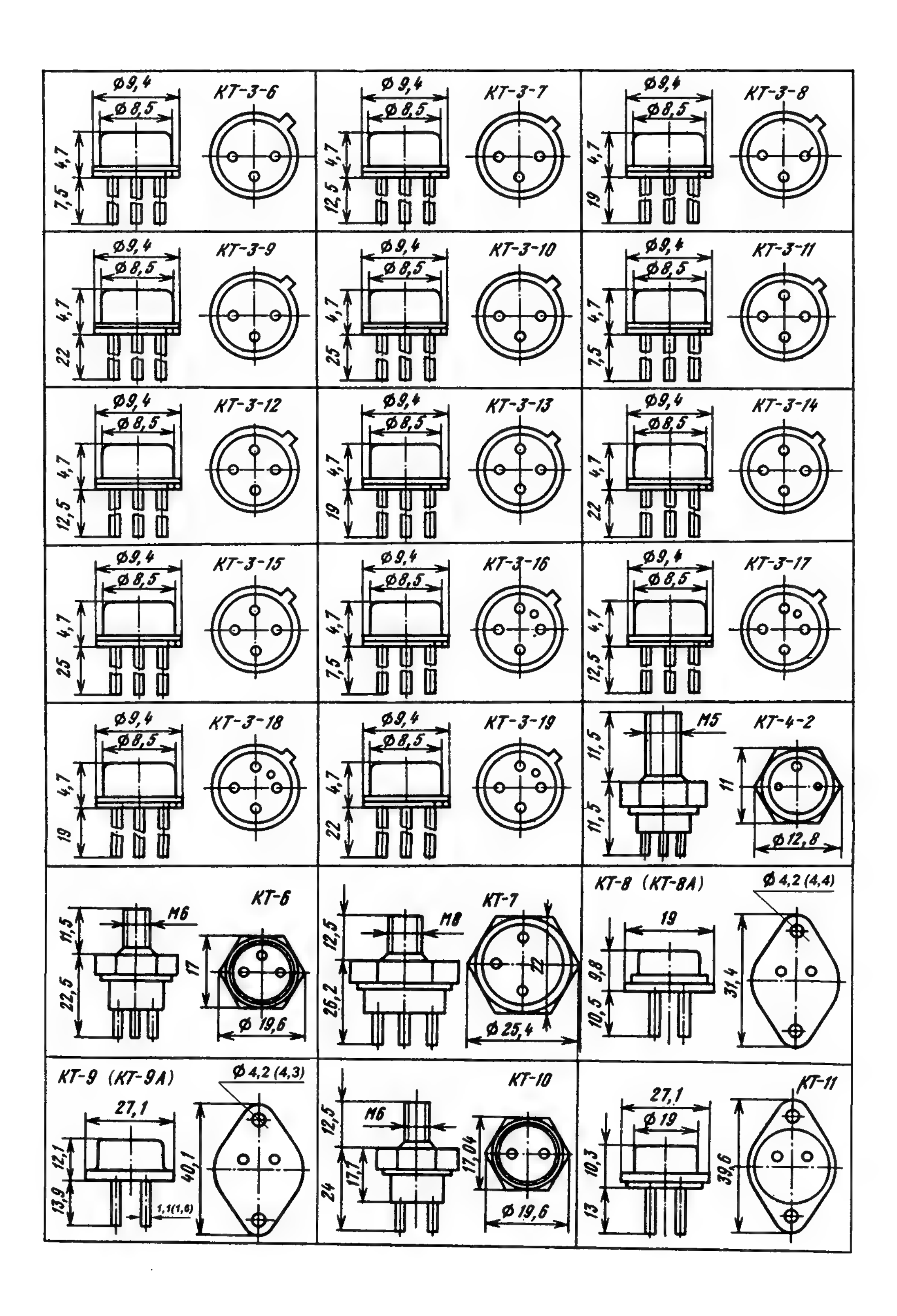
Следует отметить, что транзисторы в корпусах ТО-202 (SOT-128) по сравнению с аналогичными транзисторами в корпусах КТ-27 (ТО-126) или SOT-32 имеют рассеиваемую мощность примерно на 20% больше за счет имеющегося металлического радиатора с площадью поверхности 250 мм^2, т. е. при эксплуатации в одинаковых режимах температура переходов у них будет примерно на 20% ниже, поэтому прогнозируемый срок их службы выше.

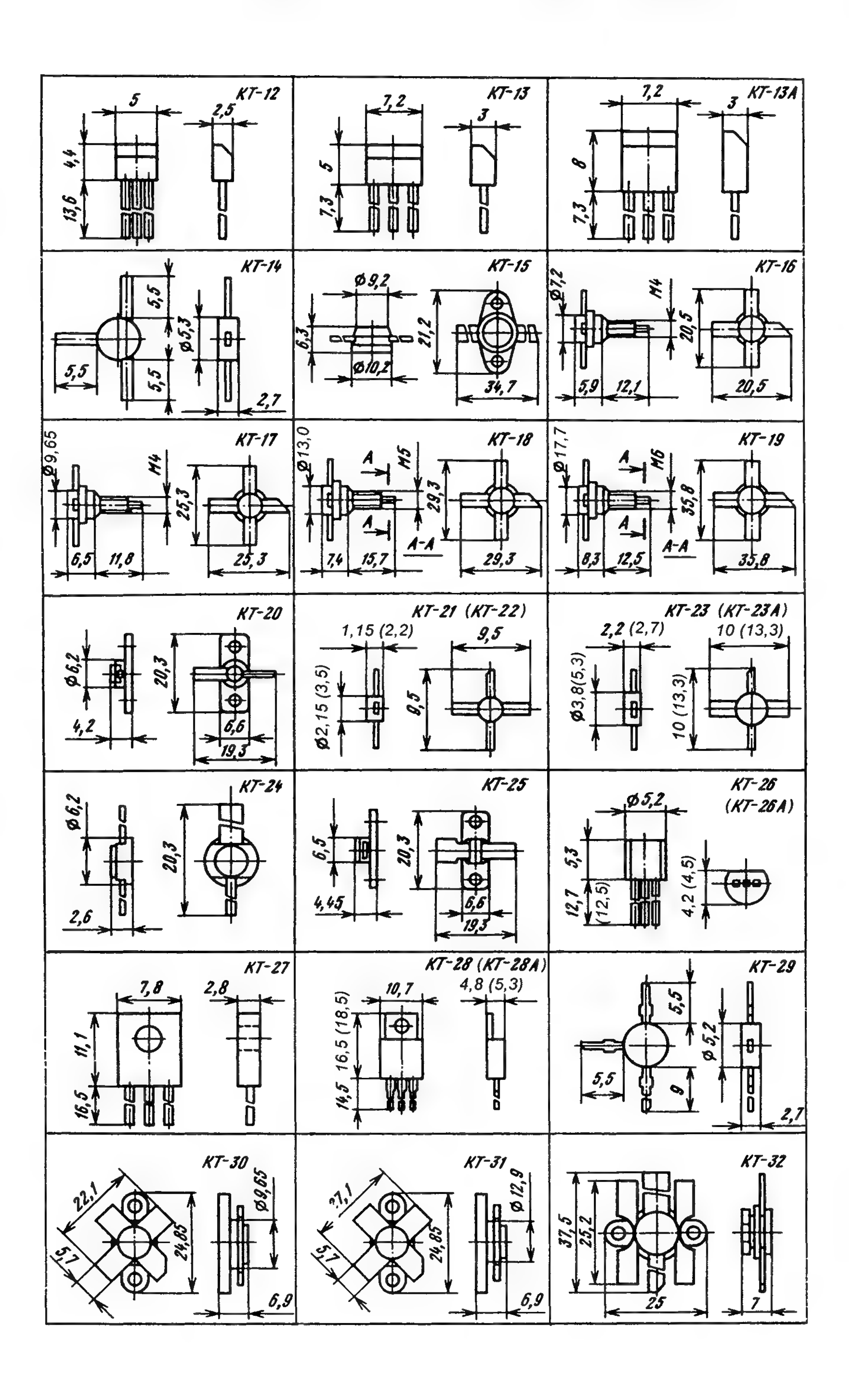
Существуют три способа монтажа приборов в аппаратуре: навесной, печатный и поверхностный. Для поверхностного монтажа применяются специальные малогабаритные пластмассовые корпуса, например, отечественные КТ-46, КТ-47, КТ-89 (зарубежные SOT-23, SOT-89, ТО-252, SOT-143), которые позволяют более эффективно использовать поверхность платы. Технология поверхностного монтажа (SMT — Surfoce mount technology) дает возможность при автоматизированном процессе сборки повысить плотность монтажа в 3 раза и уменьшить размеры плат, т. е. уменьшить массогабаритные показатели аппаратуры, исключить технологический процесс изготовления отверстий на печатных платах, сократить время монтажа по сравнению с монтажом на платах со сквозными отверстиями.

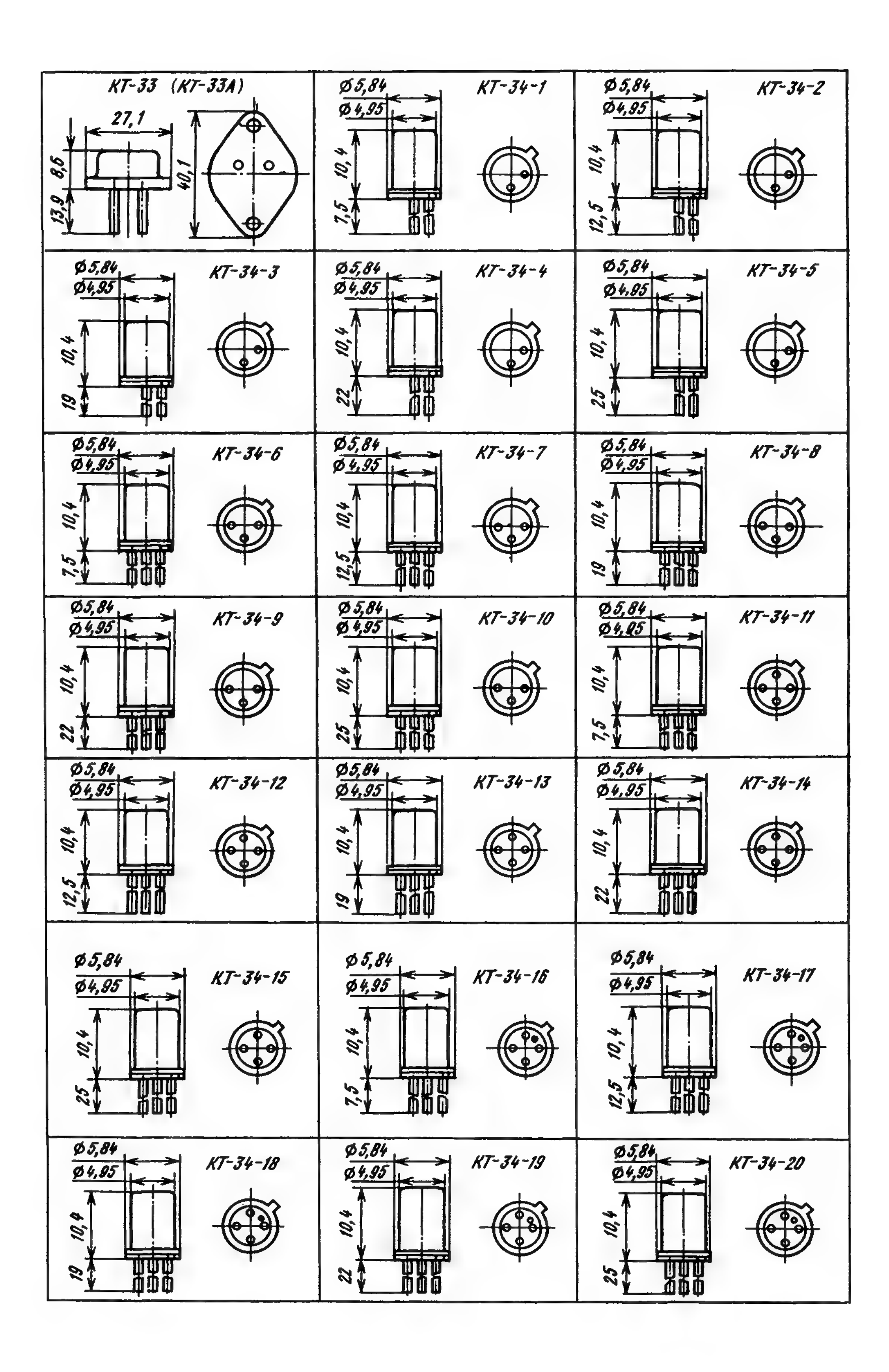
4.3. Конструктивное исполнение стандартизованных корпусов отечественных транзисторов

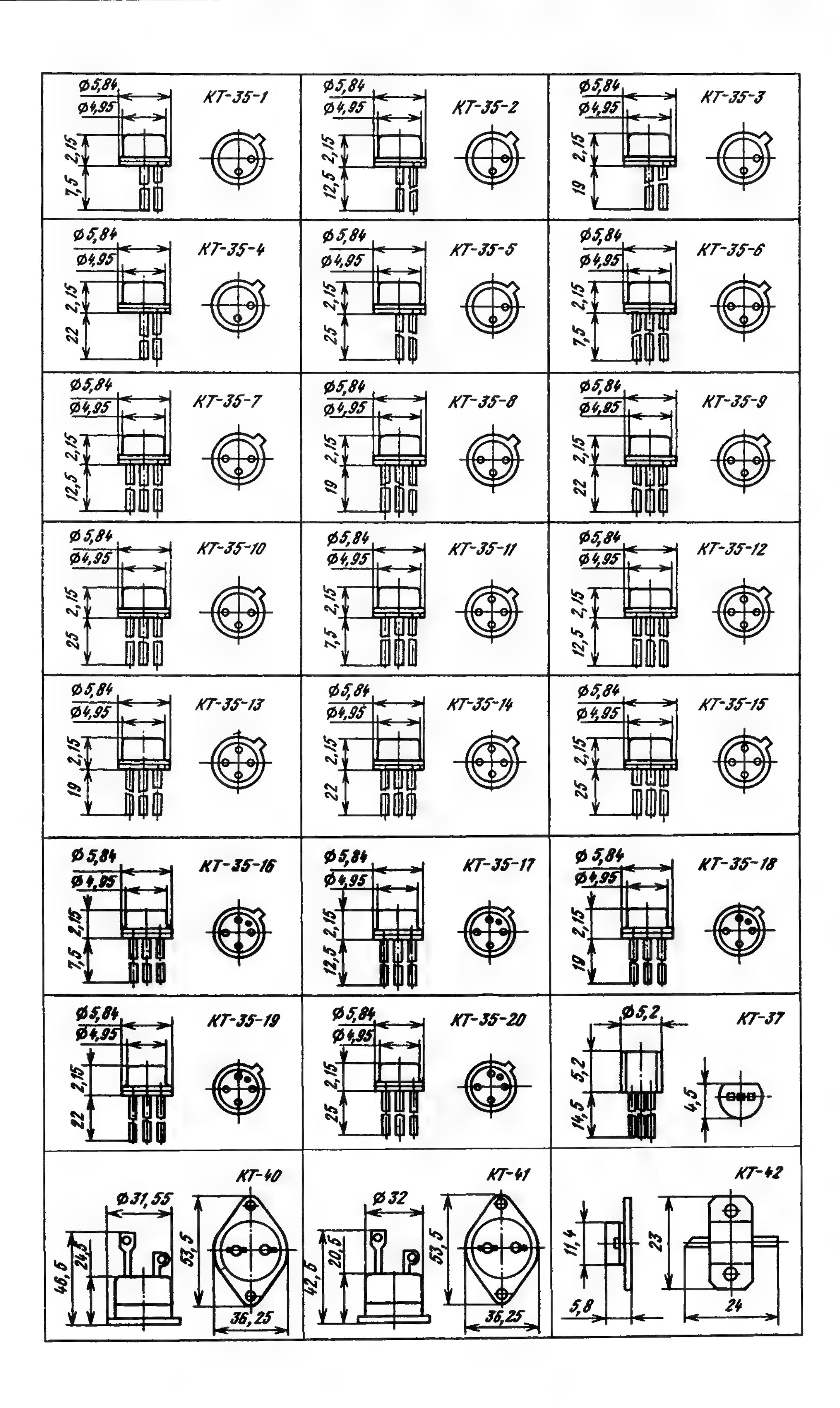


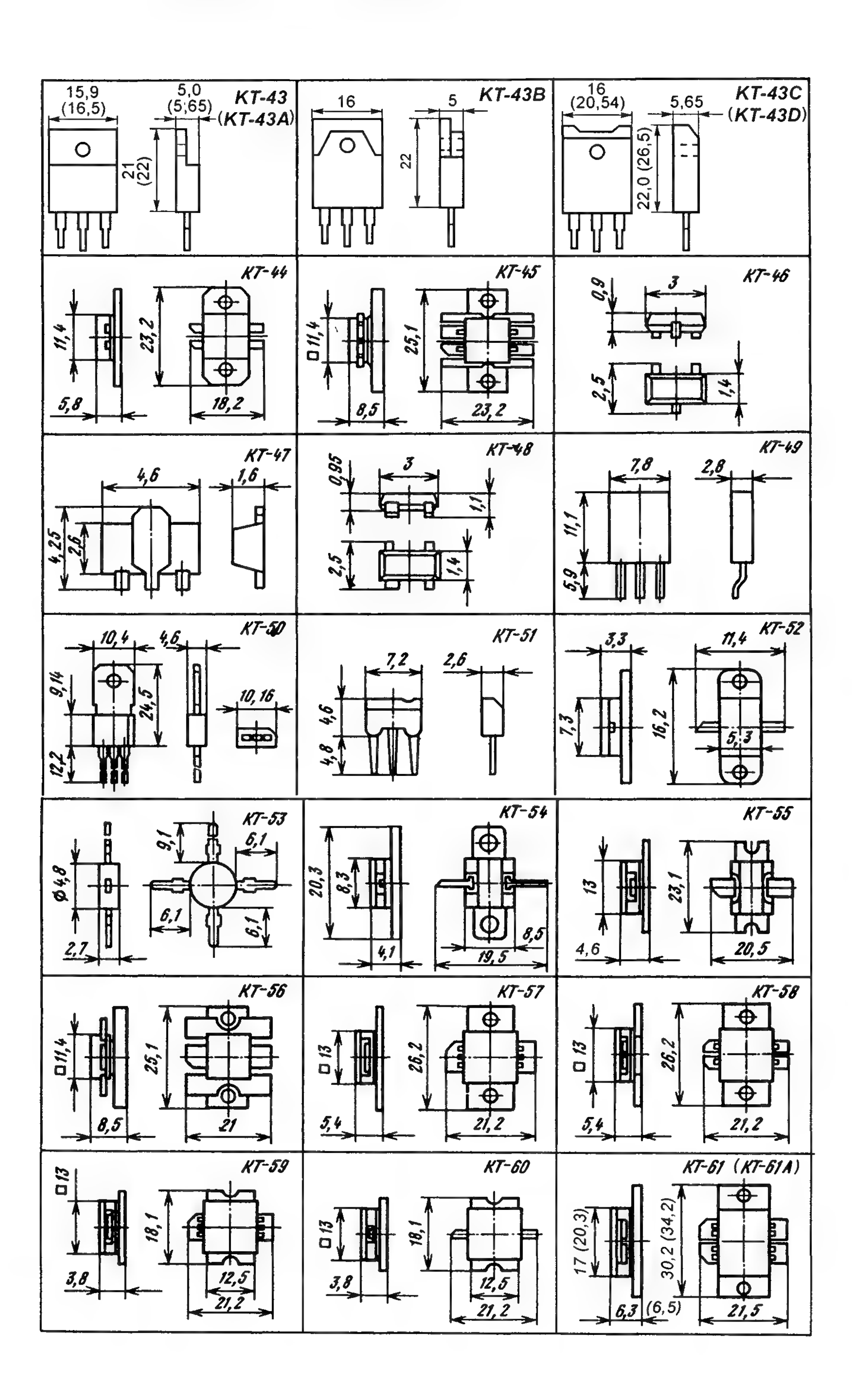

КТ-2-5
Ø9,4
Ø8,5
6,6
25
КТ-2-6
Ø9,4
Ø8,5
6,6
7,5
КТ-2-7
Ø9,4
Ø8,5
6,6
12,5
КТ-2-8
Ø9,4
Ø8,5
6,6
19
КТ-2-9
Ø9,4
Ø8,5
6,6
22
КТ-2-10
Ø9,4
Ø8,5
6,6
25
КТ-2-11
Ø9,4
Ø8,5
6,6
7,5
КТ-2-12
Ø9,4
Ø8,5
6,6
12,5
КТ-2-13
Ø9,4
Ø8,5
6,6
19
КТ-2-14
Ø9,4
Ø8,5
6,6
22
КТ-2-15
Ø9,4
Ø8,5
6,6
25
КТ-2-16
Ø9,4
Ø8,5
6,6
7,5
КТ-2-17
Ø9,4
Ø8,5
6,6
12,5
КТ-2-18
Ø9,4
Ø8,5
6,6
19
КТ-2-19
Ø9,4
Ø8,5
6,6
22
КТ-2-20
Ø9,4
Ø8,5
6,6
25
КТ-3-1
Ø9,4
Ø8,5
4,7
7,5
КТ-3-2
Ø9,4
Ø8,5
4,7
12,5
КТ-3-3
Ø9,4
Ø8,5
4,7
19
КТ-3-4
Ø9,4
Ø8,5
4,7
22
КТ-3-5
Ø9,4
Ø8,5
4,7
25


КТ-3-6
Ø9,4
Ø8,5
4,7
7,5
КТ-3-7
Ø9,4
Ø8,5
4,7
12,5
КТ-3-8
Ø9,4
Ø8,5
4,7
19
КТ-3-9
Ø9,4
Ø8,5
4,7
22
КТ-3-10
Ø9,4
Ø8,5
4,7
25
КТ-3-11
Ø9,4
Ø8,5
4,7
7,5
КТ-3-12
Ø9,4
Ø8,5
4,7
12,5
КТ-3-13
Ø9,4
Ø8,5
4,7
19
КТ-3-14
Ø9,4
Ø8,5
4,7
22
КТ-3-15
Ø9,4
Ø8,5
4,7
25
КТ-3-16
Ø9,4
Ø8,5
4,7
7,5
КТ-3-17
Ø9,4
Ø8,5
4,7
12,5
КТ-3-18
Ø9,4
Ø8,5
4,7
19
КТ-3-19
Ø9,4
Ø8,5
4,7
22
КТ-4-2
М5
11,5
11,5
11
Ø12,8
КТ-6
М6
11,5
22,5
17
Ø19,6
КТ-7
М8
12,5
26,2
22
Ø25,4
КТ-8 (КТ-8А)
Ø4,2 (4,4)
19
9,8
10,5
31,4
КТ-9 (КТ-9А)
Ø4,2 (4,3)
27,1
12,1
13,9
40,1
1,1(1,6)
КТ-10
М6
12,5
24
17,7
17,04
Ø19,6
КТ-11
27,1
Ø19
10,3
13
39,6

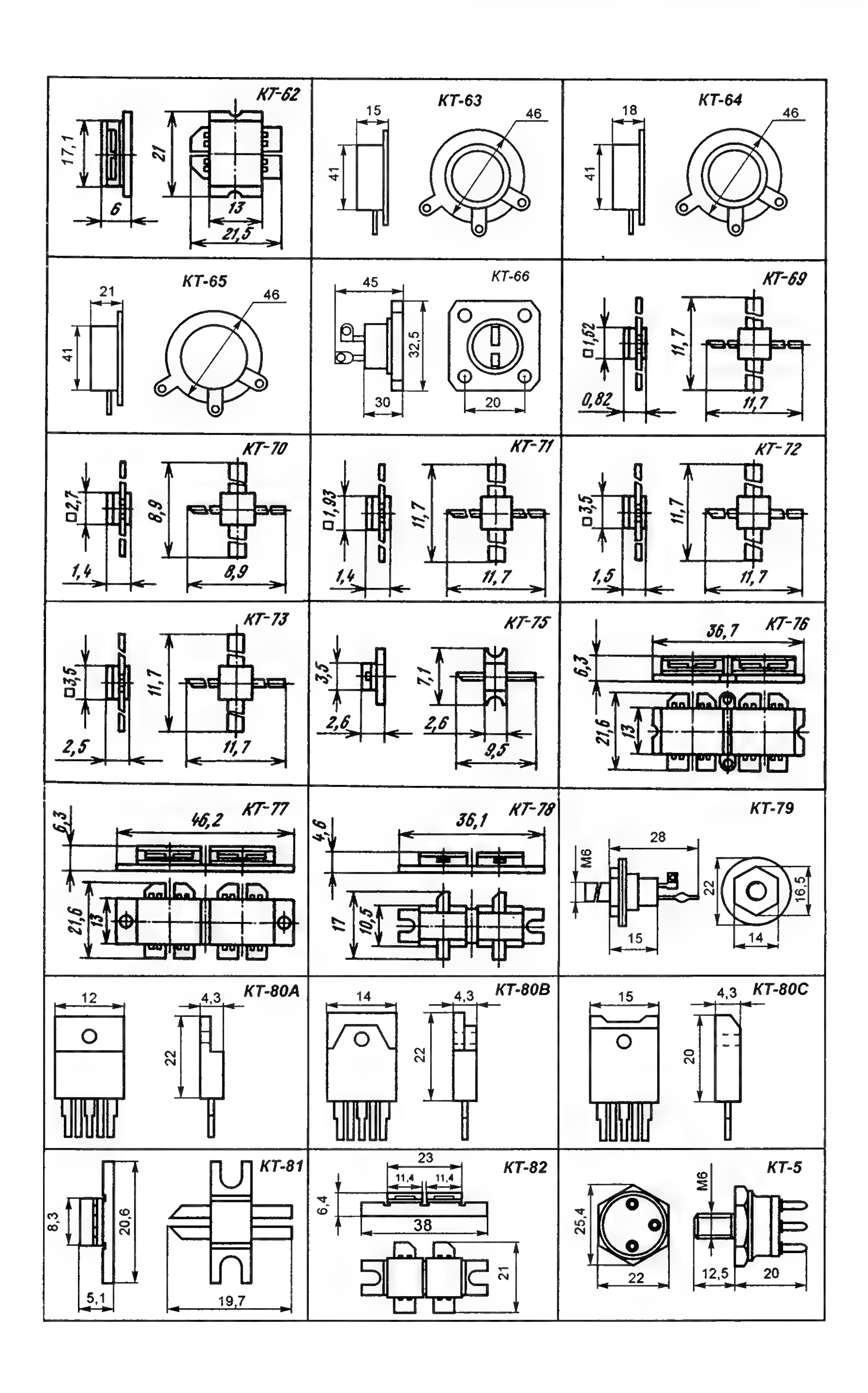

КТ-12
КТ-13
КТ-13А
КТ-14
КТ-15
КТ-16
КТ-17
КТ-18
КТ-19
КТ-20
КТ-21 (КТ-22)
КТ-23 (КТ-23А)
КТ-24
КТ-25
КТ-26 (КТ-26А)
КТ-27
КТ-28 (КТ-28А)
КТ-29
КТ-30
КТ-31
КТ-32


КТ-33 (КТ-33А)
27,1
8,6
13,9
40,1
КТ-34-1
КТ-34-2
КТ-34-3
КТ-34-4
КТ-34-5
КТ-34-6
КТ-34-7
КТ-34-8
КТ-34-9
КТ-34-10
КТ-34-11
КТ-34-12
КТ-34-13
КТ-34-14
КТ-34-15
КТ-34-16
КТ-34-17
КТ-34-18
КТ-34-19
КТ-34-20
Ø5,84
Ø4,95
10,4
7,5
12,5
19
22
25


КТ-35-1
КТ-35-2
КТ-35-3
КТ-35-4
КТ-35-5
КТ-35-6
КТ-35-7
КТ-35-8
КТ-35-9
КТ-35-10
КТ-35-11
КТ-35-12
КТ-35-13
КТ-35-14
КТ-35-15
КТ-35-16
КТ-35-17
КТ-35-18
КТ-35-19
КТ-35-20
КТ-37
КТ-40
КТ-41
КТ-42
Ø5,84
Ø4,95
2,15
Ø5,2
Ø31,55
Ø32
36,25
53,5
46,6
42,6
24,5
20,5
11,4
23
5,8
24

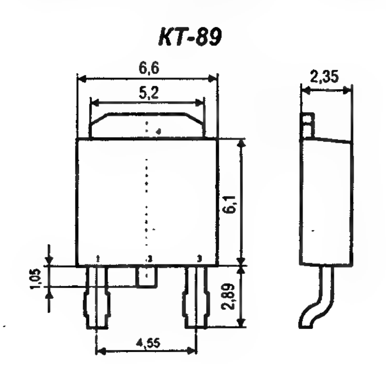


KT-43 (KT-43A)
15,9 (16,5)
5,0 (5;65)
21 (22)
KT-43B
16
5
22
KT-43C (KT-43D)
16 (20,54)
5,65
22,0 (26,5)
KT-44
11,4
23,2
5,8
18,2
KT-45
□11,4
25,1
8,5
23,2
KT-46
0,9
3
2,5
1,4
KT-47
4,6
1,6
4,25
2,6
KT-48
0,95
3
1,1
2,5
1,4
KT-49
7,8
2,8
11,1
5,9
KT-50
10,4
4,6
9,14
24,5
10,16
12,2
KT-51
7,2
2,6
4,6
4,8
KT-52
3,3
11,4
7,3
16,2
5,3
KT-53
9,1
6,1
Ø4,8
6,1
6,1
2,7
KT-54
20,3
8,3
4,1
8,5
19,5
KT-55
13
23,1
4,6
20,5
KT-56
□11,4
25,1
8,5
21
KT-57
□13
26,2
5,4
21,2
KT-58
□13
26,2
5,4
21,2
KT-59
□13
18,1
3,8
12,5
21,2
KT-60
□13
18,1
3,8
12,5
21,2
KT-61 (KT-61A)
17 (20,3)
30,2 (34,2)
6,3 (6,5)
21,5

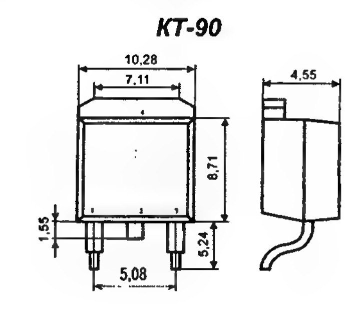


KT-62
17,1
6
21
13
21,5
KT-63
15
46
41
KT-64
18
46
41
KT-65
21
46
41
KT-66
45
32,5
30
20
KT-69
□1,62
0,82
11,7
11,7
KT-70
□2,7
1,4
8,9
8,9
KT-71
□1,93
1,4
11,7
11,7
KT-72
□3,5
1,5
11,7
11,7
KT-73
□3,5
2,5
11,7
11,7
KT-75
3,5
2,6
7,1
2,6
9,5
KT-76
36,7
6,3
21,6
13
KT-77
46,2
6,3
21,6
13
KT-78
36,1
4,6
17
10,5
KT-79
M6
28
22
15
16,5
14
KT-80A
12
4,3
22
KT-80B
14
4,3
22
KT-80C
15
4,3
20
KT-81
8,3
20,6
5,1
19,7
KT-82
23
11,4
11,4
6,4
38
21
KT-5
M6
25,4
22
12,5
20

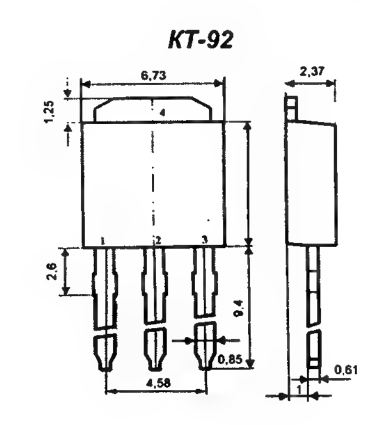
КТ-89



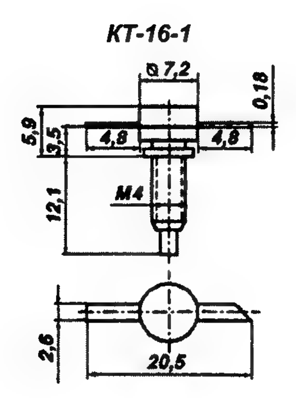
КТ-90



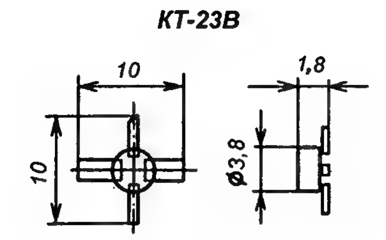
КТ-92



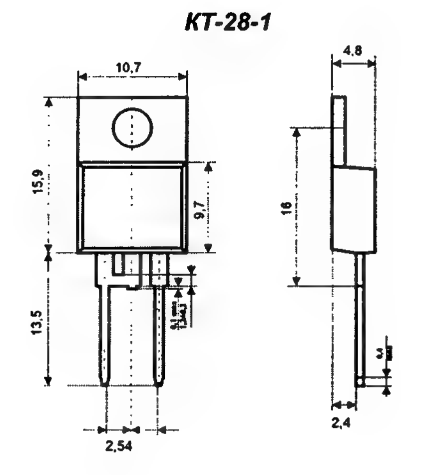
КТ-16-1



КТ-23В

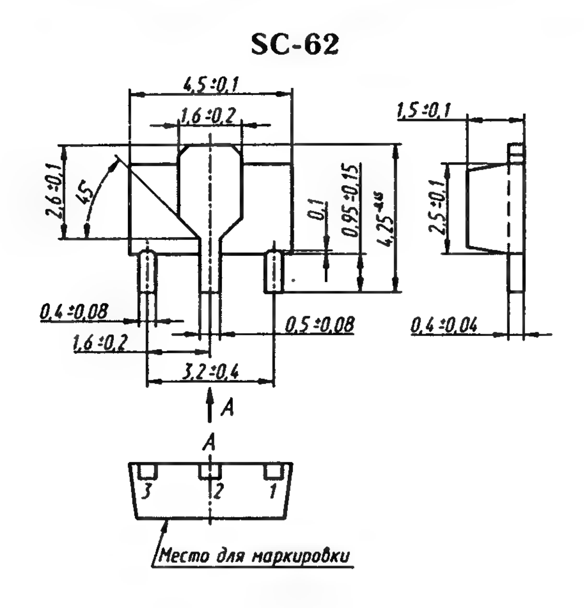


КТ-28-1

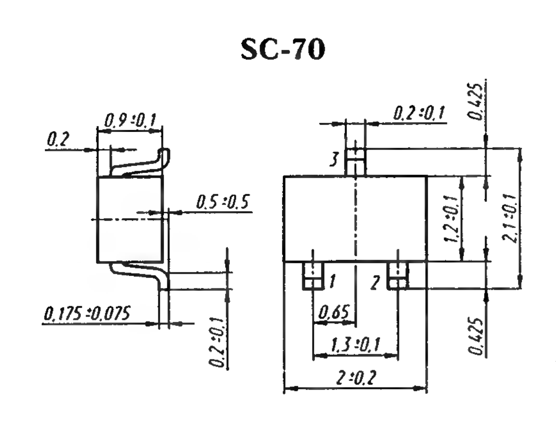


4.4. Конструктивное исполнение стандартизованных корпусов зарубежных транзисторов

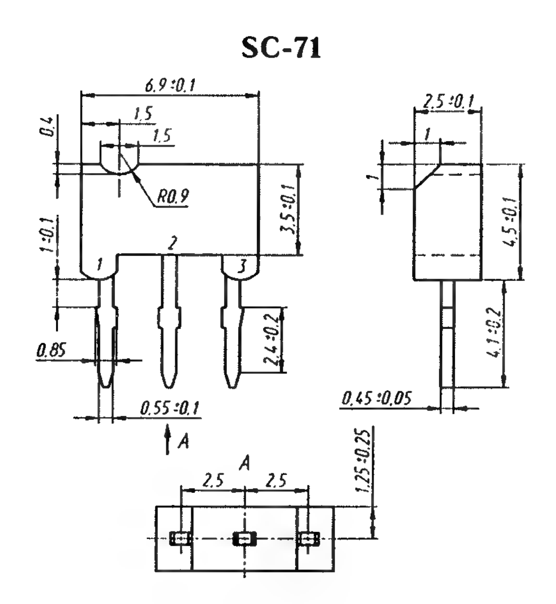
SC-62



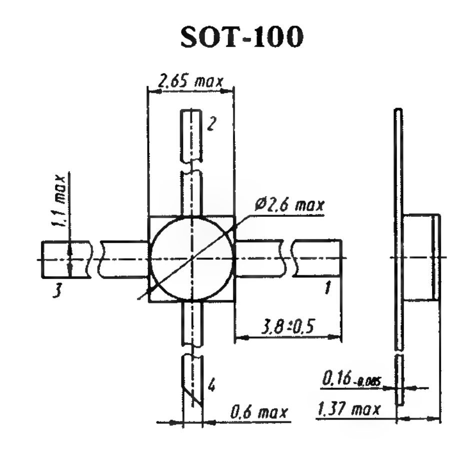
SC-70



SC-71

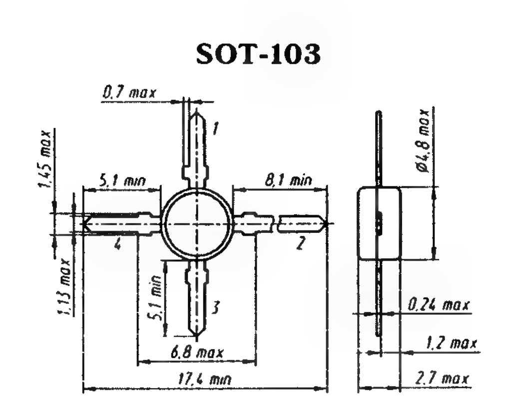


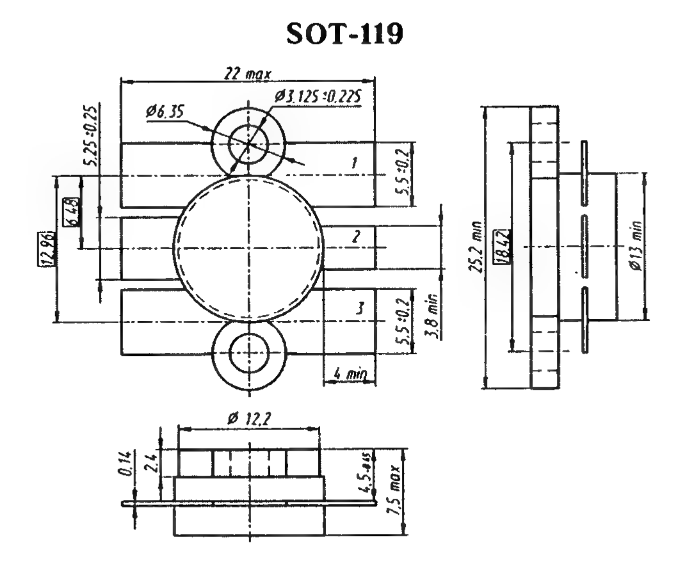
SOT-100



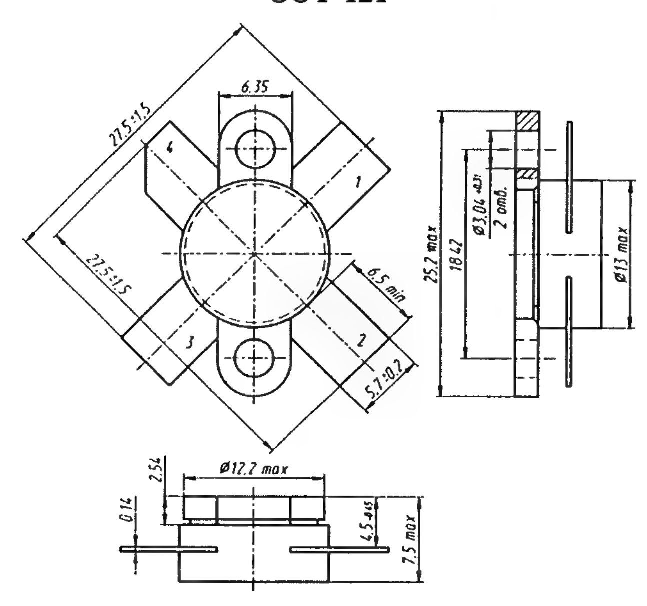
SOT-119

SOT-103

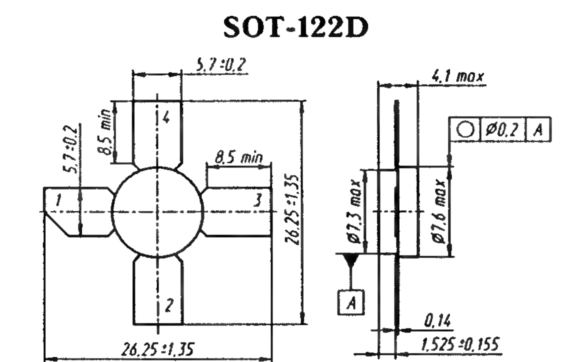




SOT-121

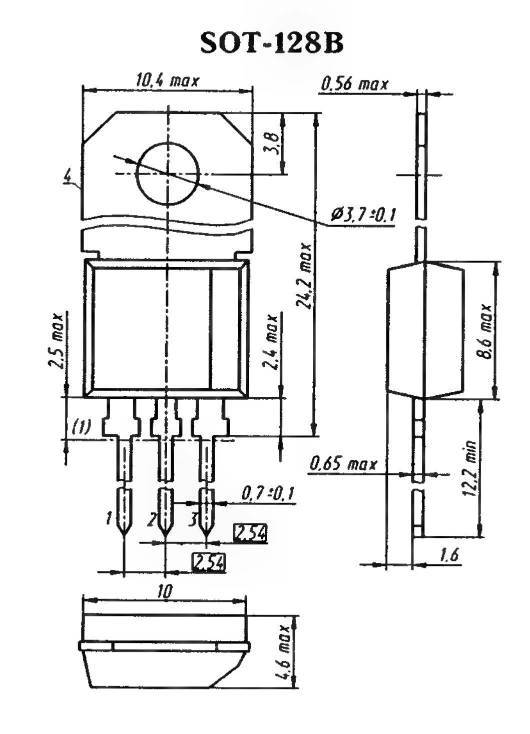


SOT-122D

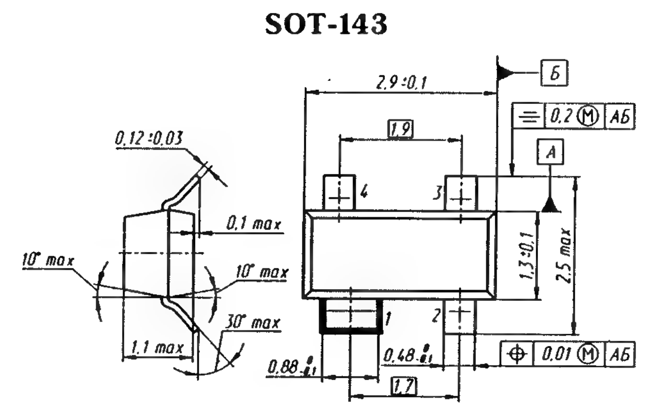


SOT-123

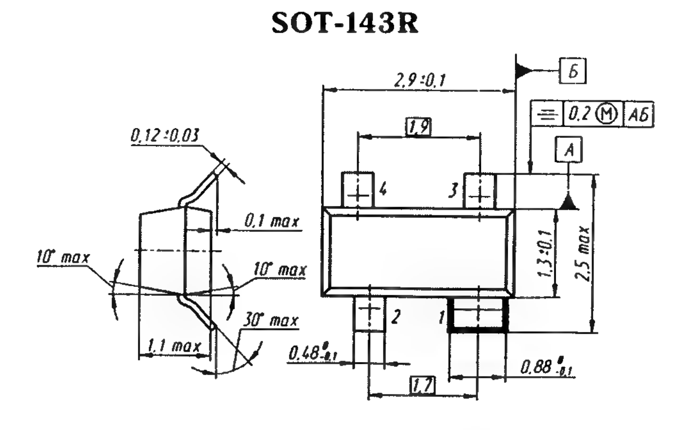
SOT-128B



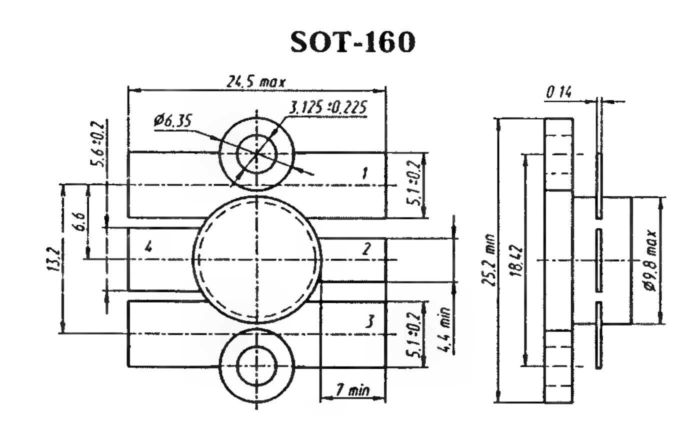
SOT-143



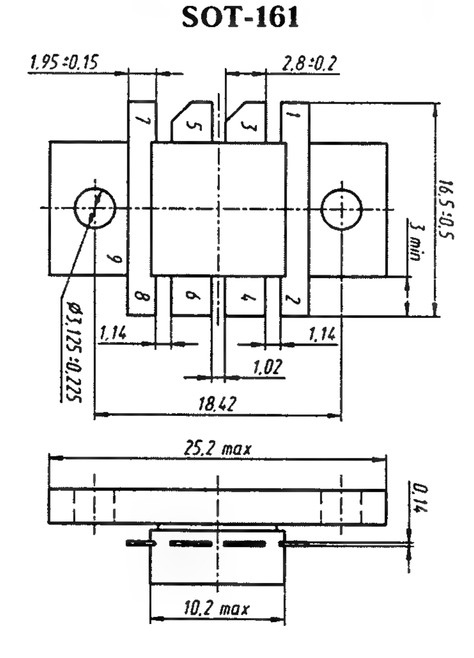
SOT-143R



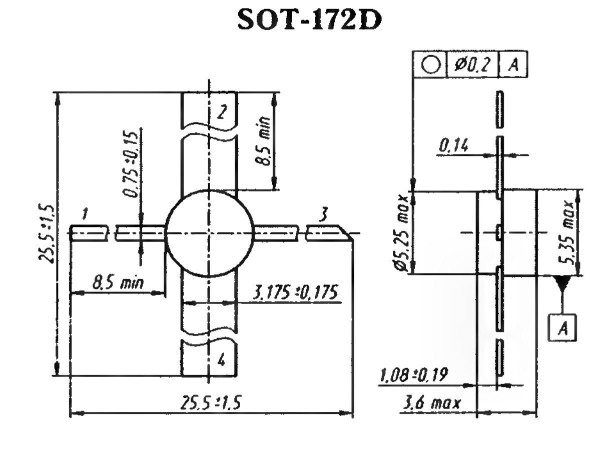
SOT-160



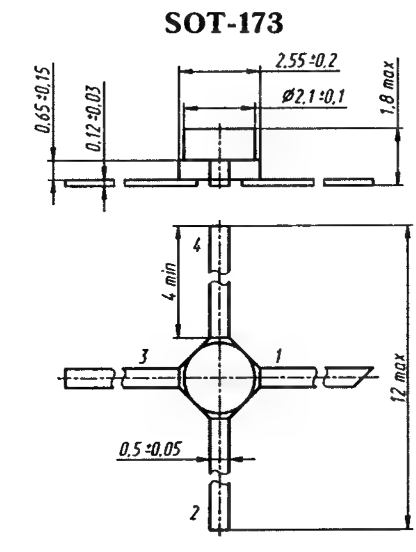
SOT-161



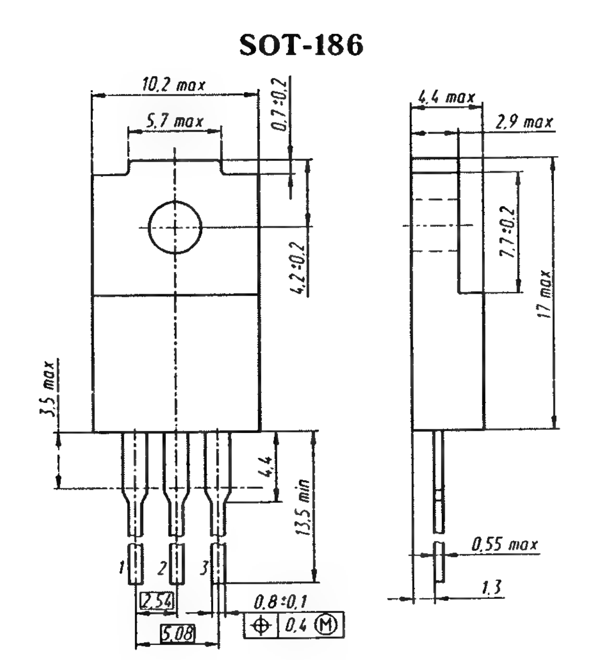
SOT-172D



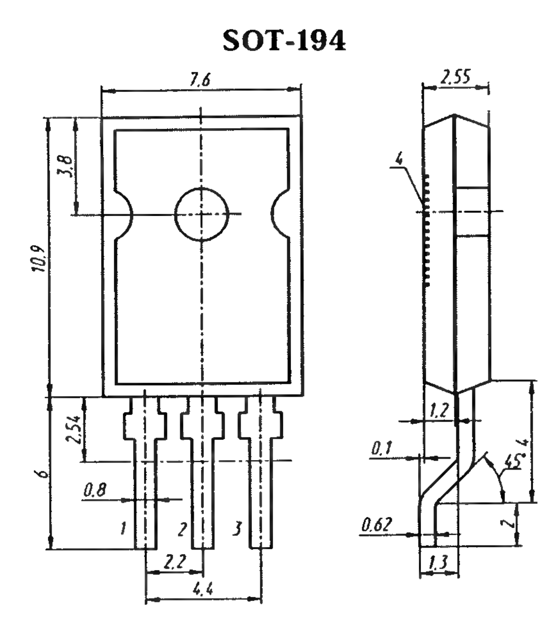
SOT-173



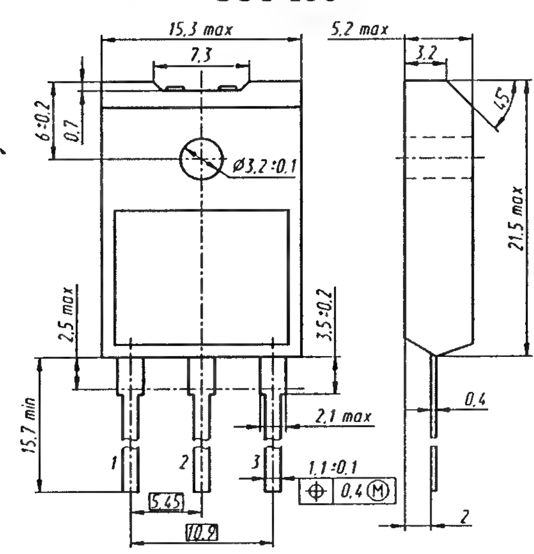
SOT-186



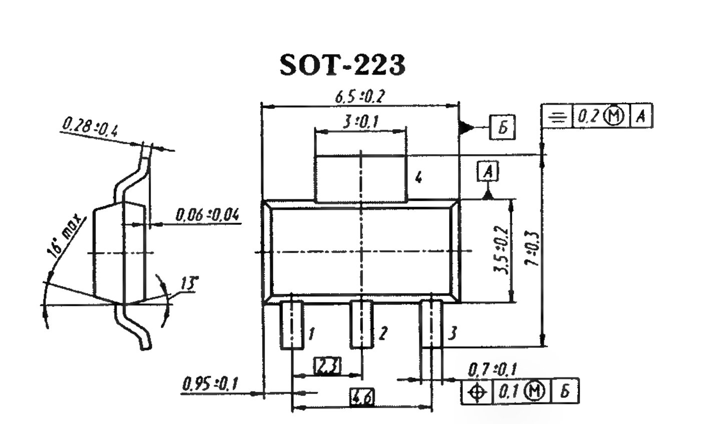
SOT-194



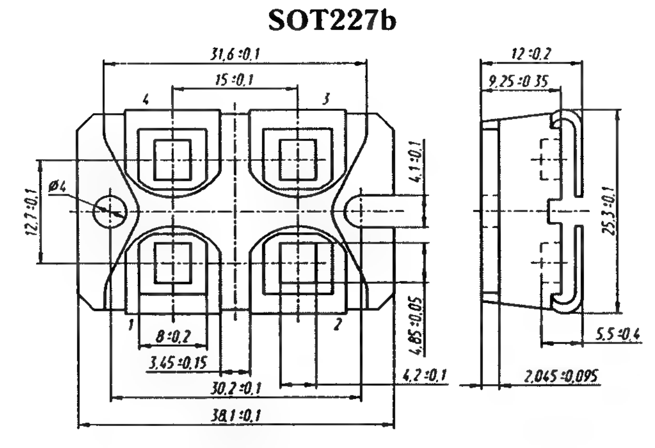
SOT-199



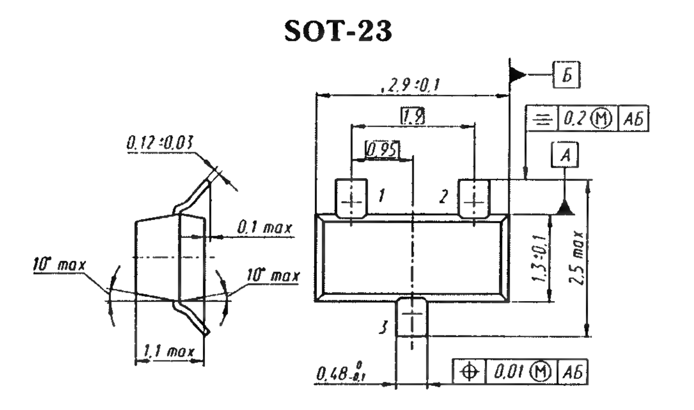
SOT-223



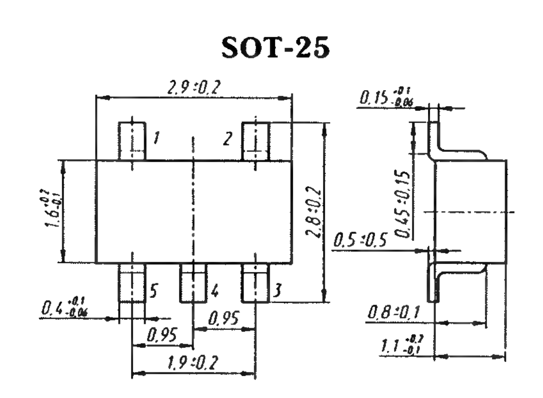
SOT227b



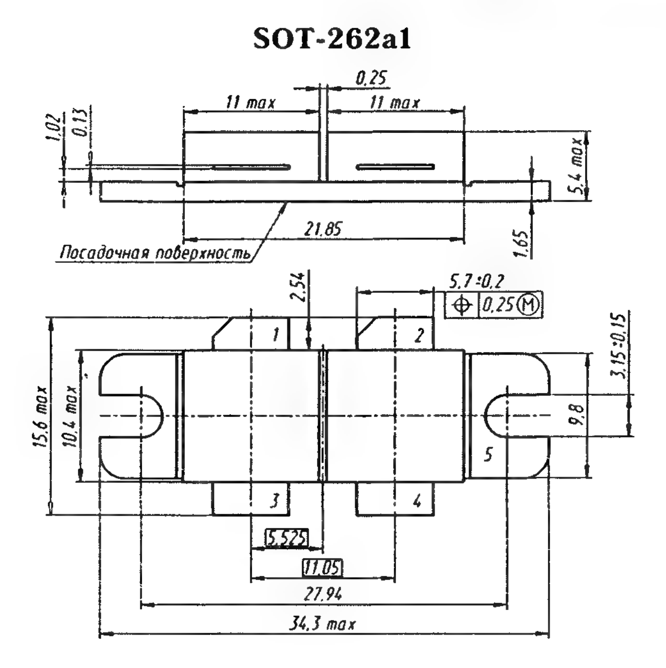
SOT-23



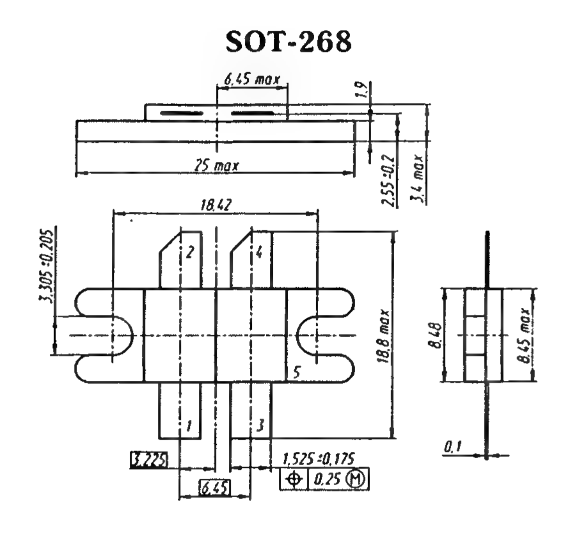
SOT-25



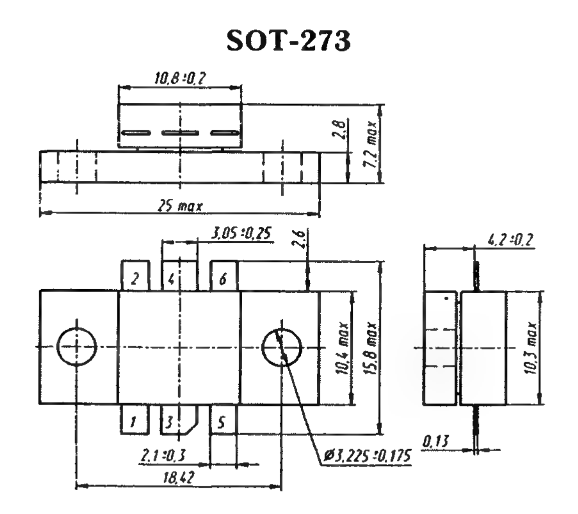
SOT-262a1



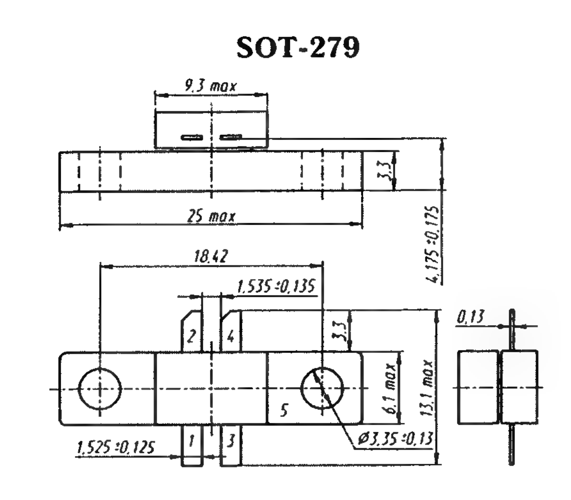
SOT-268



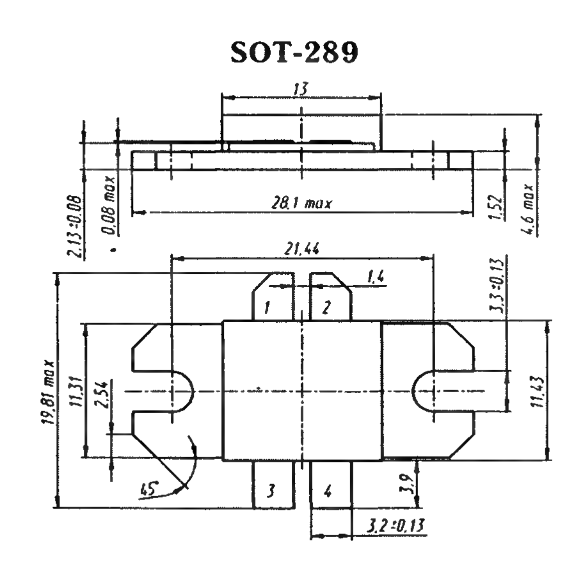
SOT-273



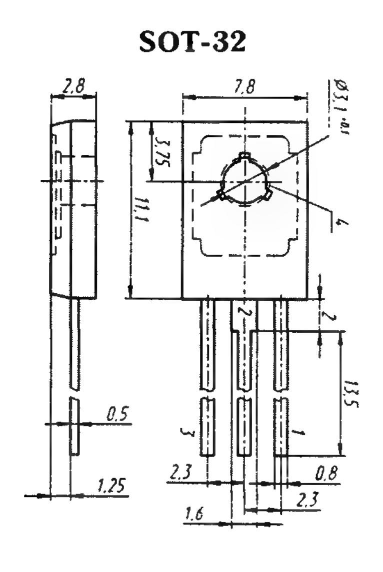
SOT-279



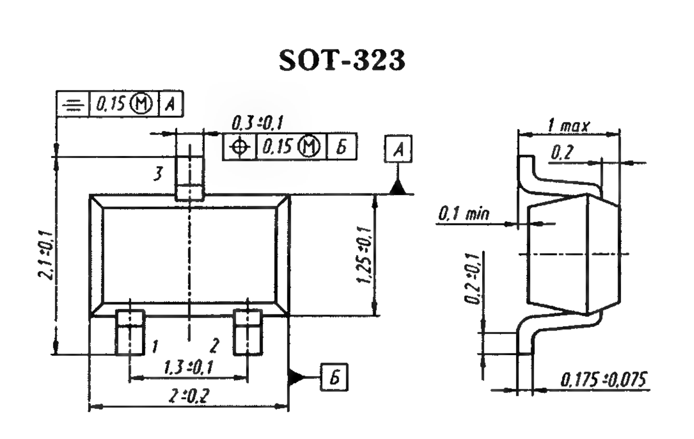
SOT-289



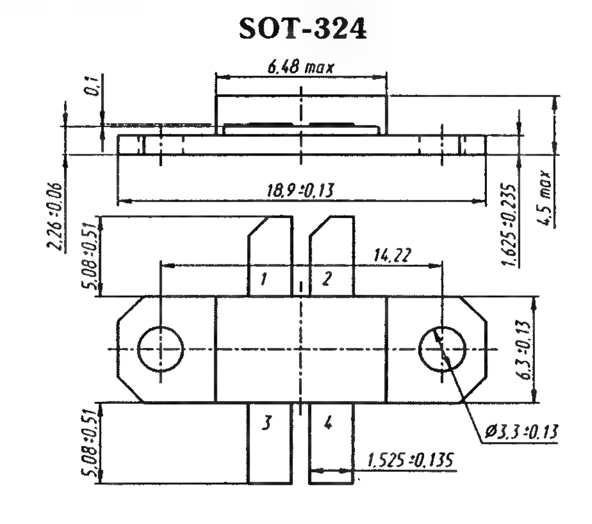
SOT-32



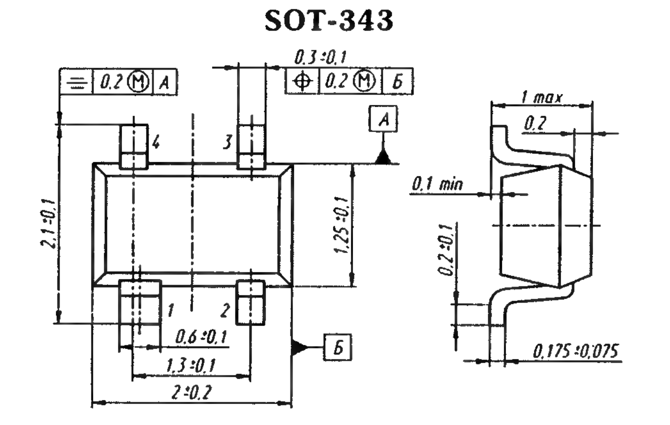
SOT-323



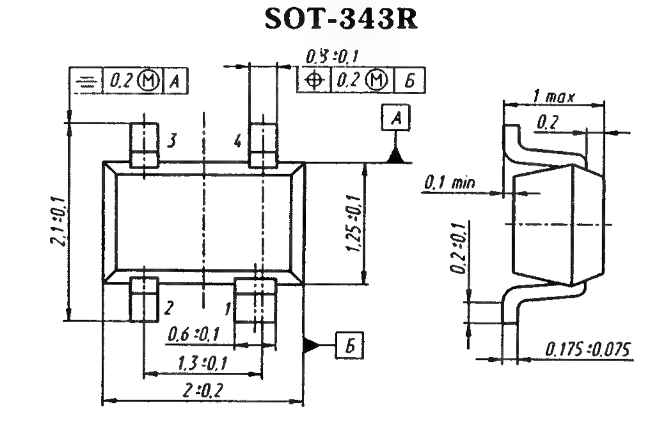
SOT-324



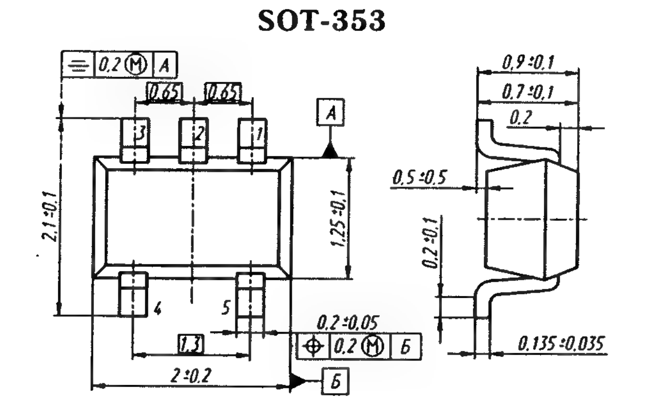
SOT-343



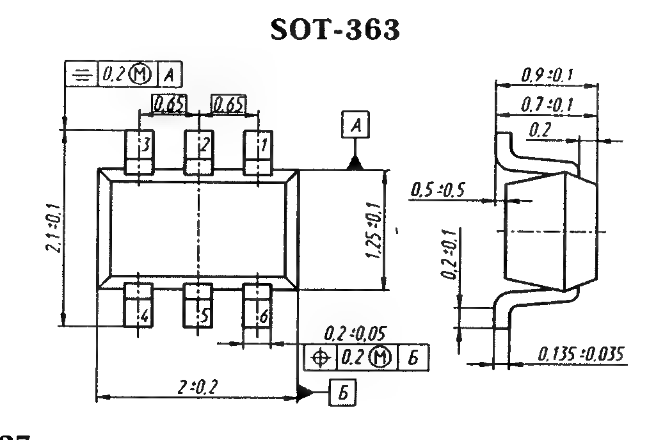
SOT-343R



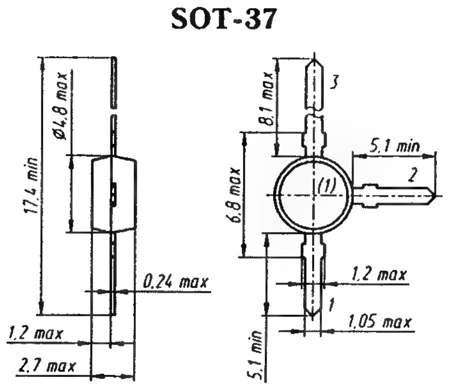
SOT-353



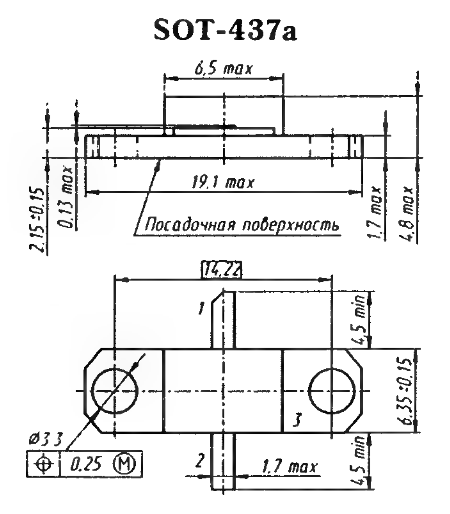
SOT-363



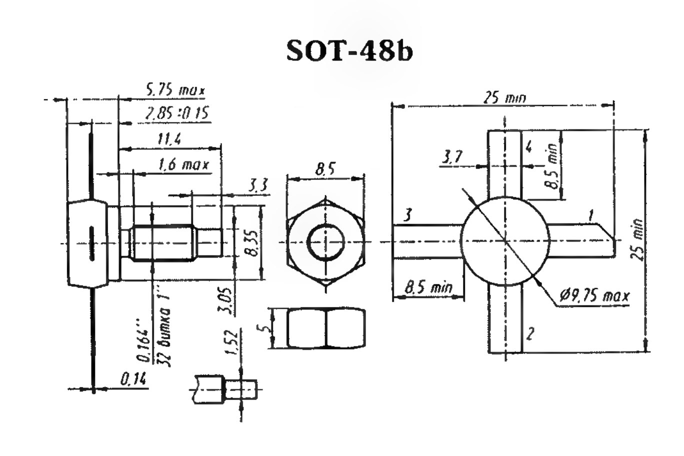
SOT-37



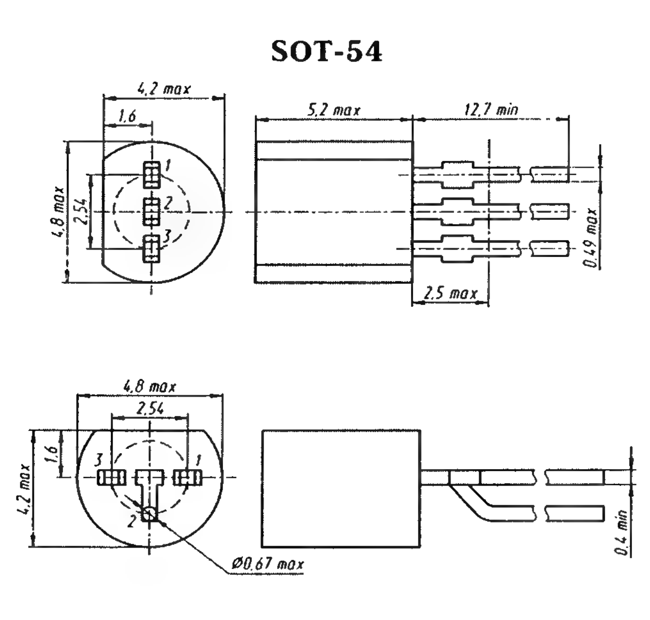
SOT-437a



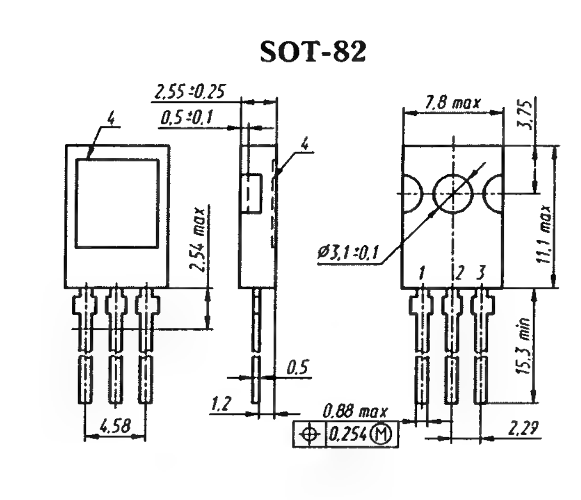
SOT-48b



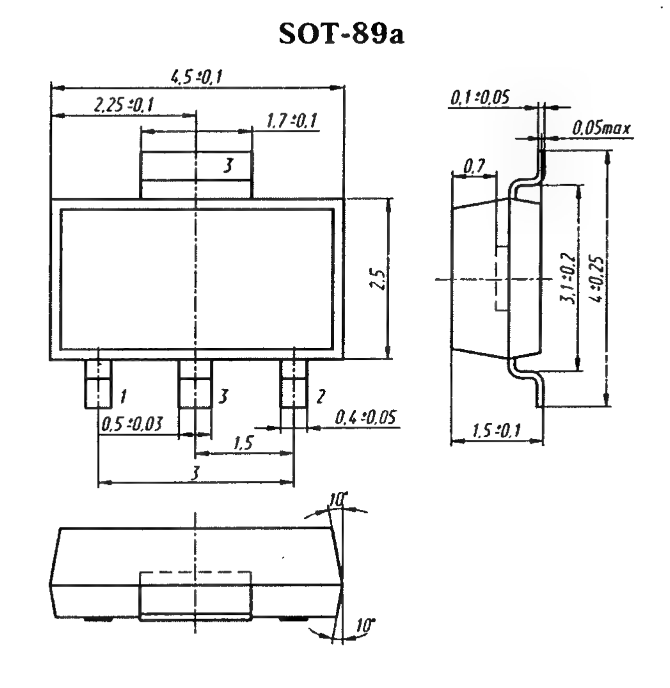
SOT-54



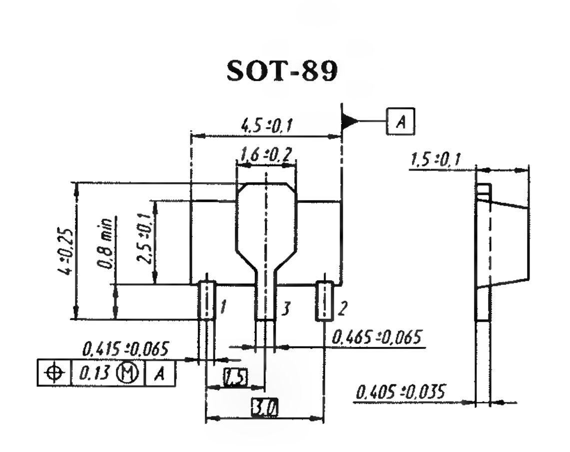
SOT-82



SOT-89a

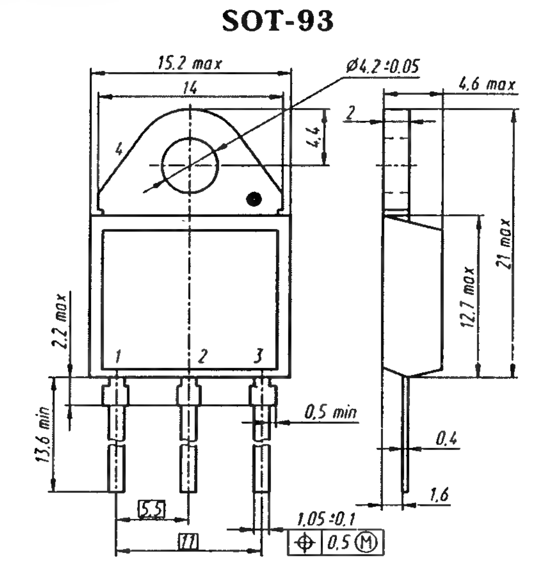


SOT-89

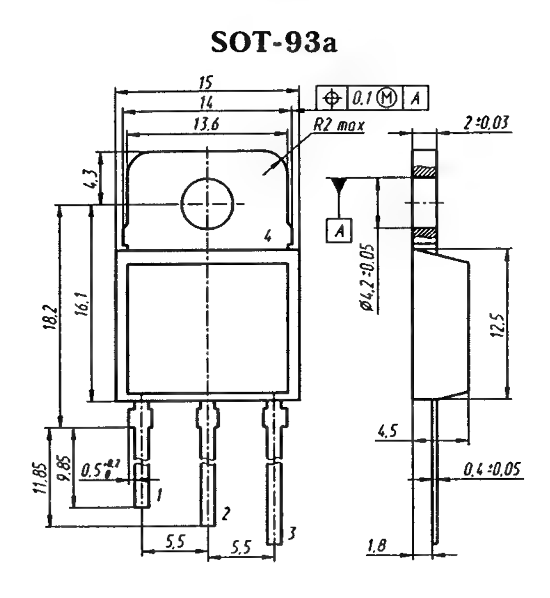


SOT-9

SOT-93

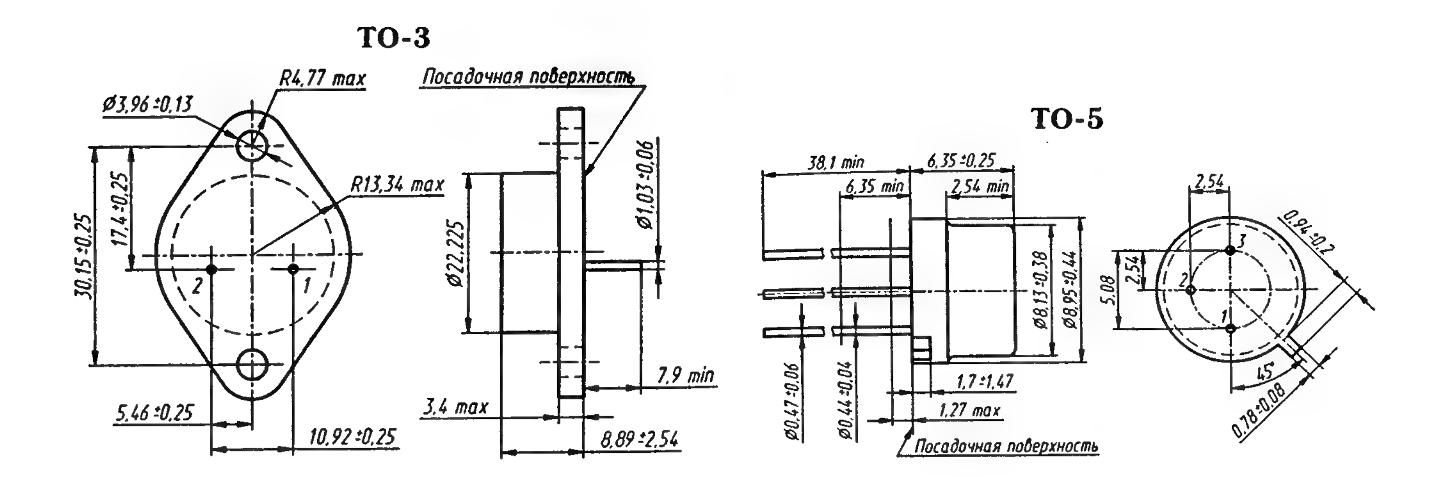


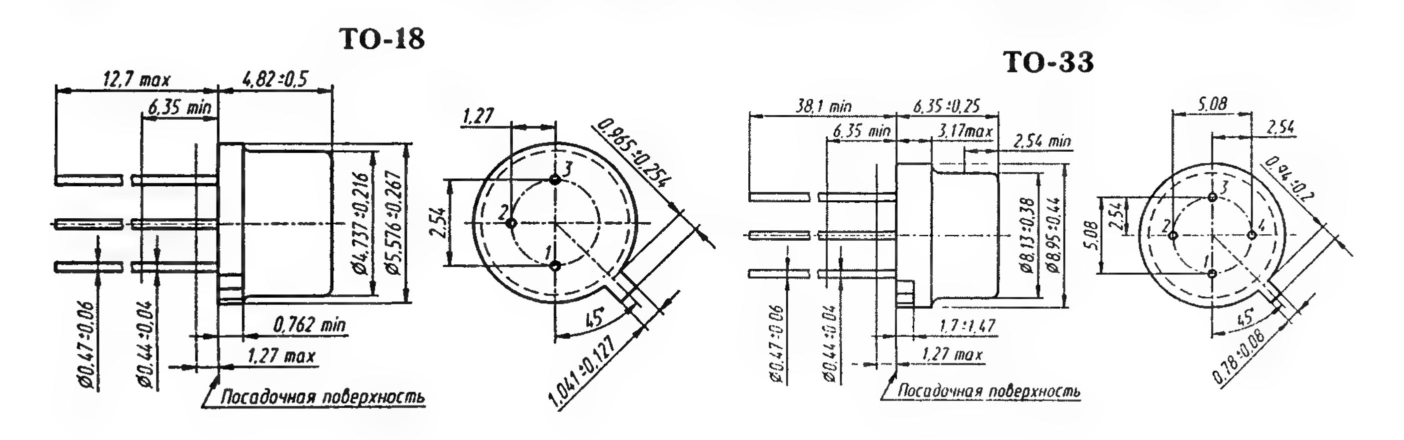
SOT-93a

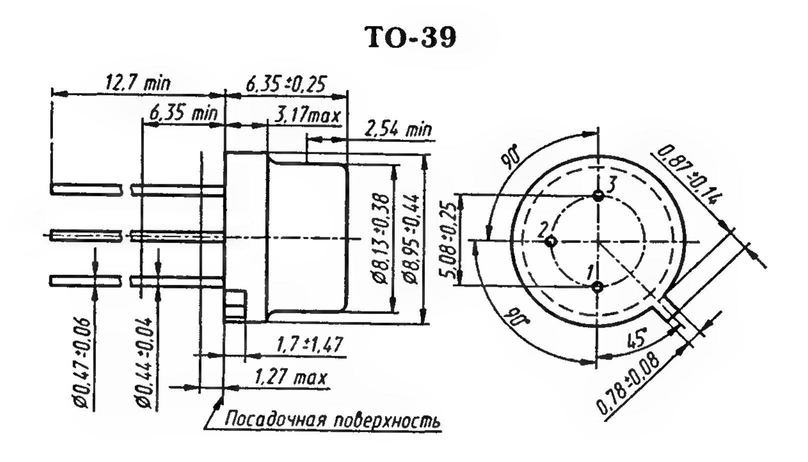


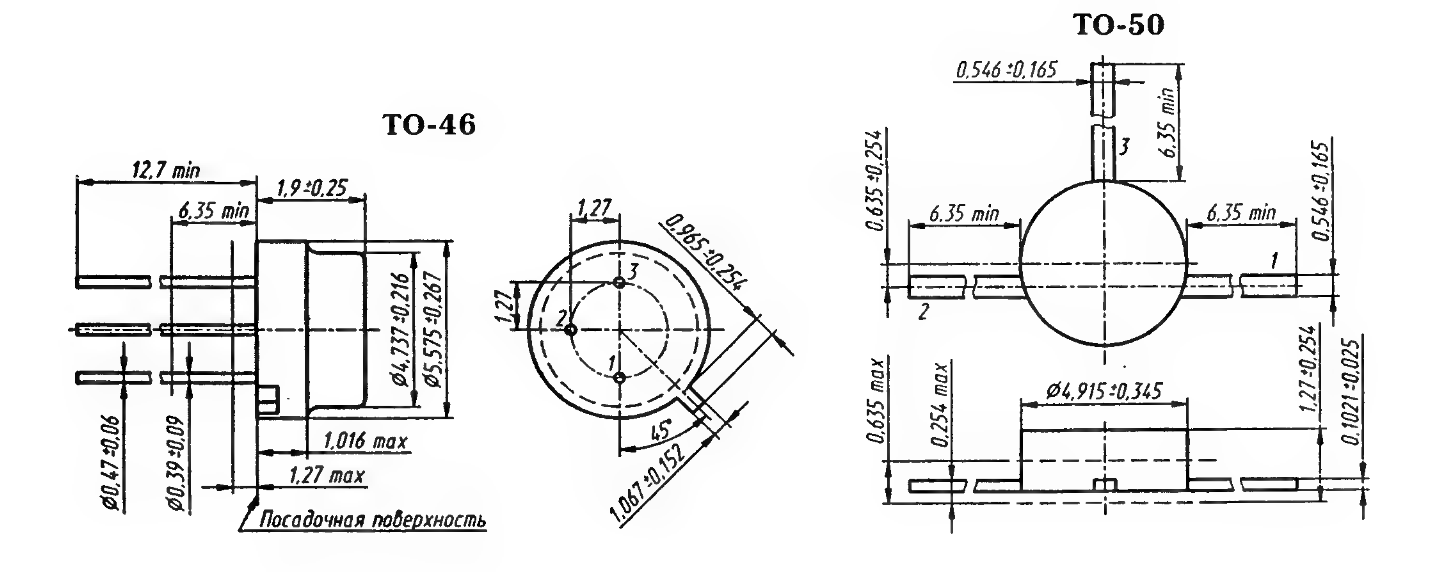
TO-3

TO-5

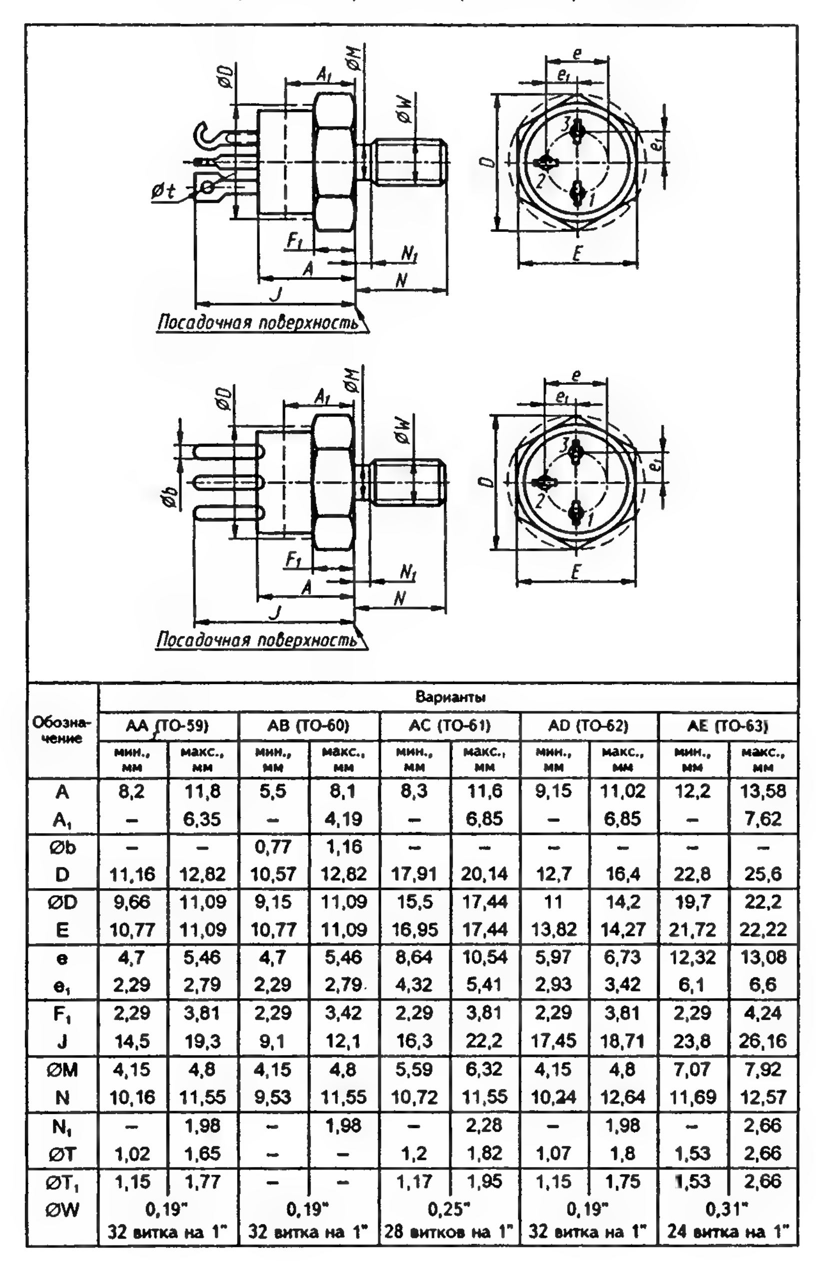



TO-18
12,7 max
4,82 ±0,5
6,35 min
1,27
0,965 ±0,254
2,54
Ø4,737 ±0,216
Ø5,576 ±0,267
0,762 min
1,27 max
Ø0,47 ±0,06
Ø0,44 ±0,04
45°
1,041 ±0,127
Посадочная поверхность
TO-33
38,1 min
6,35 ±0,25
6,35 min
3,17max
2,54 min
5,08
2,54
0,94 ±0,2
Ø8,13 ±0,38
Ø8,95 ±0,44
1,7 ±1,47
1,27 max
Ø0,47 ±0,06
Ø0,44 ±0,04
45°
0,78 ±0,08
Посадочная поверхность


TO-39
12,7 min
6,35 ±0,25
6,35 min
3,17max
2,54 min
Ø8,13 ±0,38
Ø8,95 ±0,44
5,08 ±0,25
90°
0,87 ±0,14
1,7 ±1,47
1,27 max
Ø0,47 ±0,06
Ø0,44 ±0,04
45°
0,78 ±0,08
Посадочная поверхность

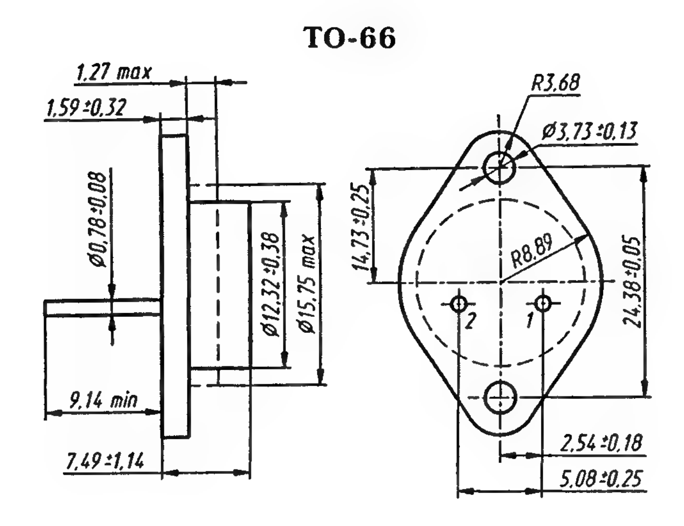

TO-46
12,7 min
1,9 ±0,25
6,35 min
1,27
0,965 ±0,254
Ø4,737 ±0,216
Ø5,575 ±0,267
1,016 max
1,27 max
Ø0,47 ±0,06
Ø0,39 ±0,09
45°
1,067 ±0,152
Посадочная поверхность
TO-50
0,546 ±0,165
6,35 min
0,635 ±0,254
6,35 min
6,35 min
0,546 ±0,165
Ø4,915 ±0,345
0,635 max
0,254 max
1,27 ±0,254
0,1021 ±0,025

TO-59, TO-60, TO-61, TO-62, TO-63

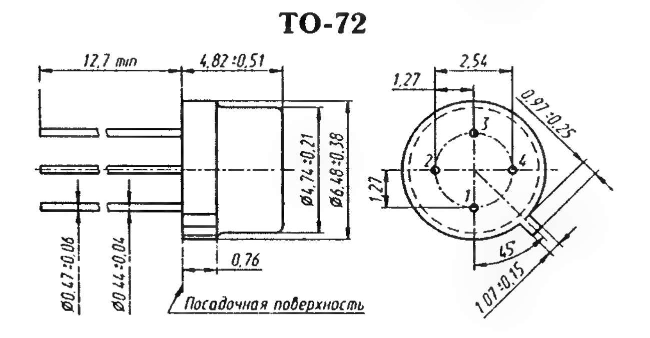


Обозначение	Варианты									
	AA (TO-59)		AB (TO-60)		AC (TO-61)		AD (TO-62)		AE (TO-63)	
	мин., мм	макс., мм	мин., мм	макс., мм	мин., мм	макс., мм	мин., мм	макс., мм	мин., мм	макс., мм
A	8,2	11,8	5,5	8,1	8,3	11,6	9,15	11,02	12,2	13,58
A_1	–	6,35	–	4,19	–	6,85	–	6,85	–	7,62
Øb	–	–	0,77	1,16	–	–	–	–	–	–
D	11,16	12,82	10,57	12,82	17,91	20,14	12,7	16,4	22,8	25,6
ØD	9,66	11,09	9,15	11,09	15,5	17,44	11	14,2	19,7	22,2
E	10,77	11,09	10,77	11,09	16,95	17,44	13,82	14,27	21,72	22,22
e	4,7	5,46	4,7	5,46	8,64	10,54	5,97	6,73	12,32	13,08
e_1	2,29	2,79	2,29	2,79	4,32	5,41	2,93	3,42	6,1	6,6
F_1	2,29	3,81	2,29	3,42	2,29	3,81	2,29	3,81	2,29	4,24
J	14,5	19,3	9,1	12,1	16,3	22,2	17,45	18,71	23,8	26,16
ØM	4,15	4,8	4,15	4,8	5,59	6,32	4,15	4,8	7,07	7,92
N	10,16	11,55	9,53	11,55	10,72	11,55	10,24	12,64	11,69	12,57
N_1	–	1,98	–	1,98	–	2,28	–	1,98	–	2,66
ØT	1,02	1,65	–	–	1,2	1,82	1,07	1,8	1,53	2,66
$ØT_1$	1,15	1,77	–	–	1,17	1,95	1,15	1,75	1,53	2,66
ØW	0,19" 32 витка на 1"		0,19" 32 витка на 1"		0,25" 28 витков на 1"		0,19" 32 витка на 1"		0,31" 24 витка на 1"	

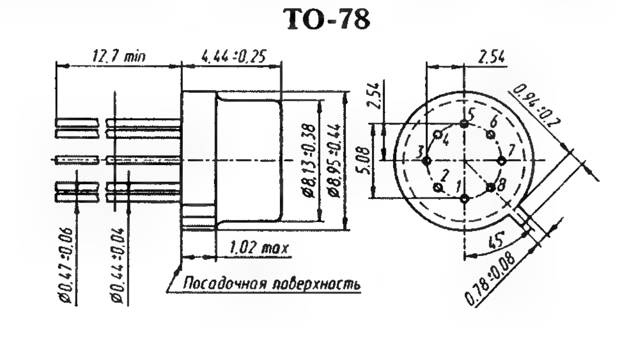
TO-66



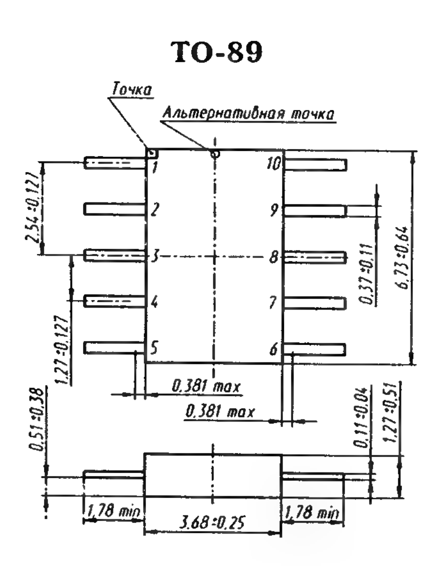
ТО-72



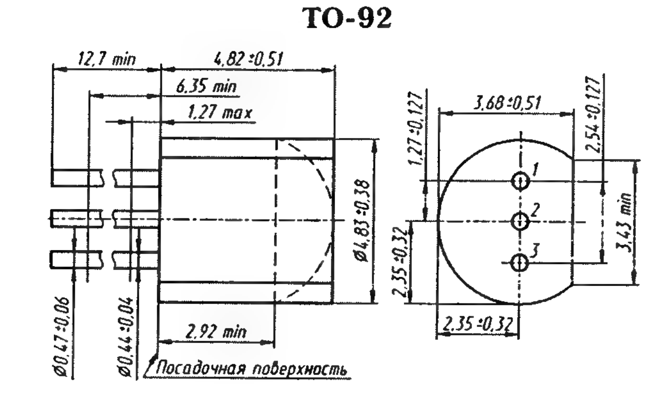
ТО-78



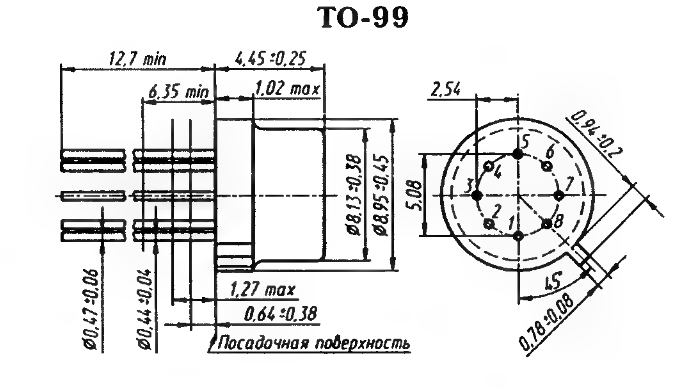
ТО-89



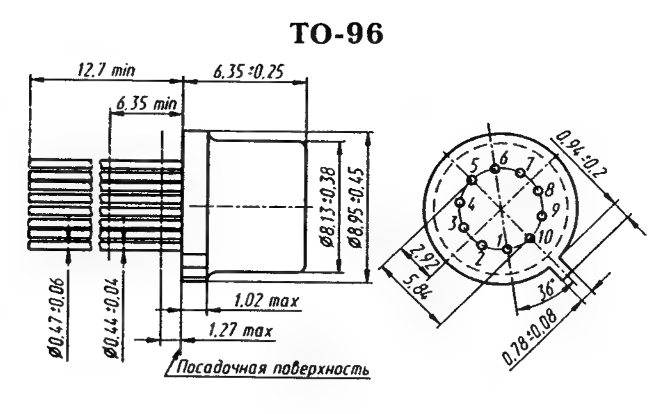
ТО-92



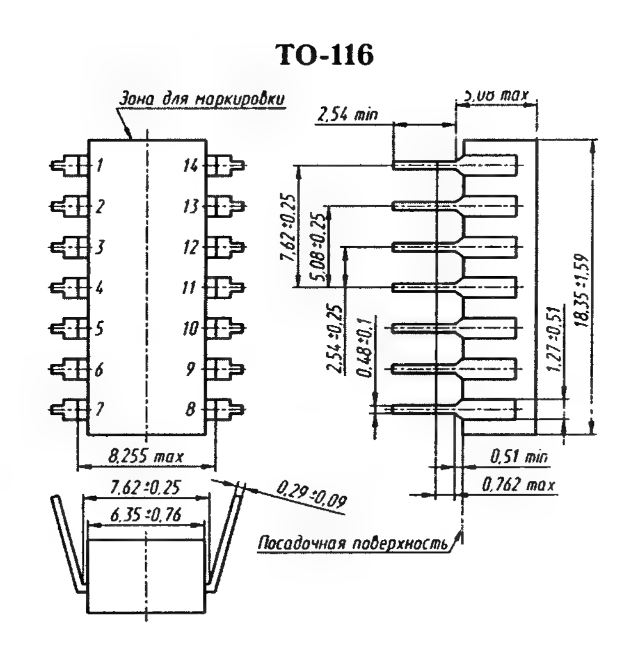
ТО-99

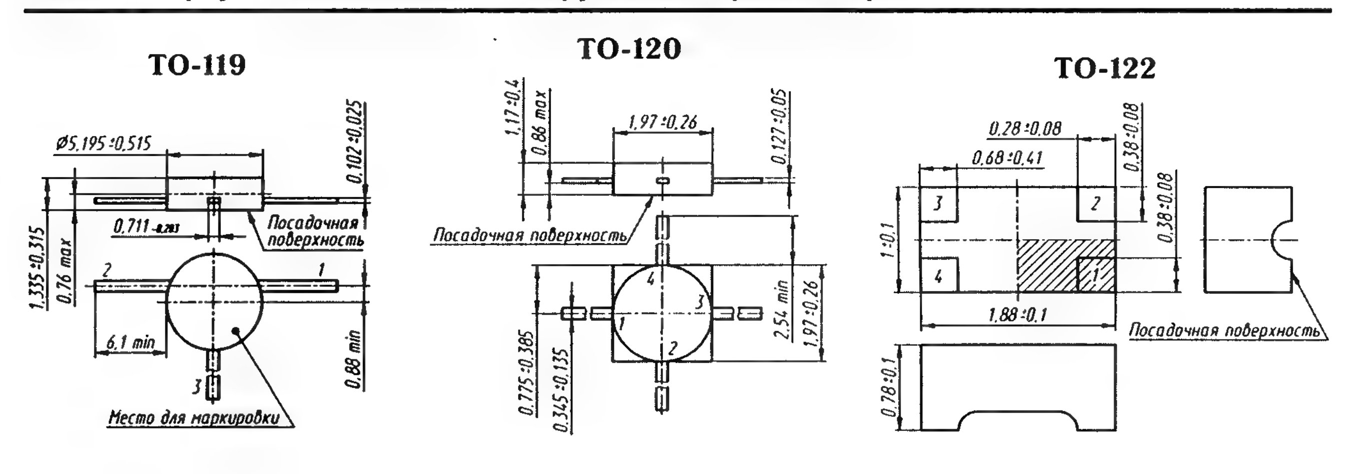


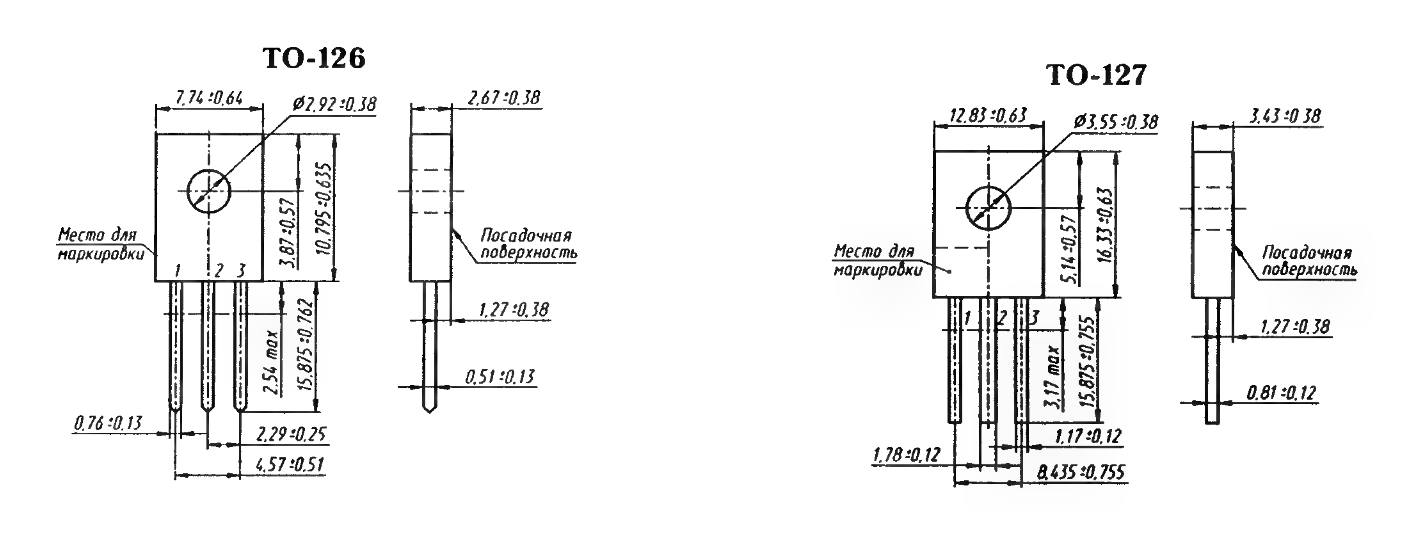
ТО-96

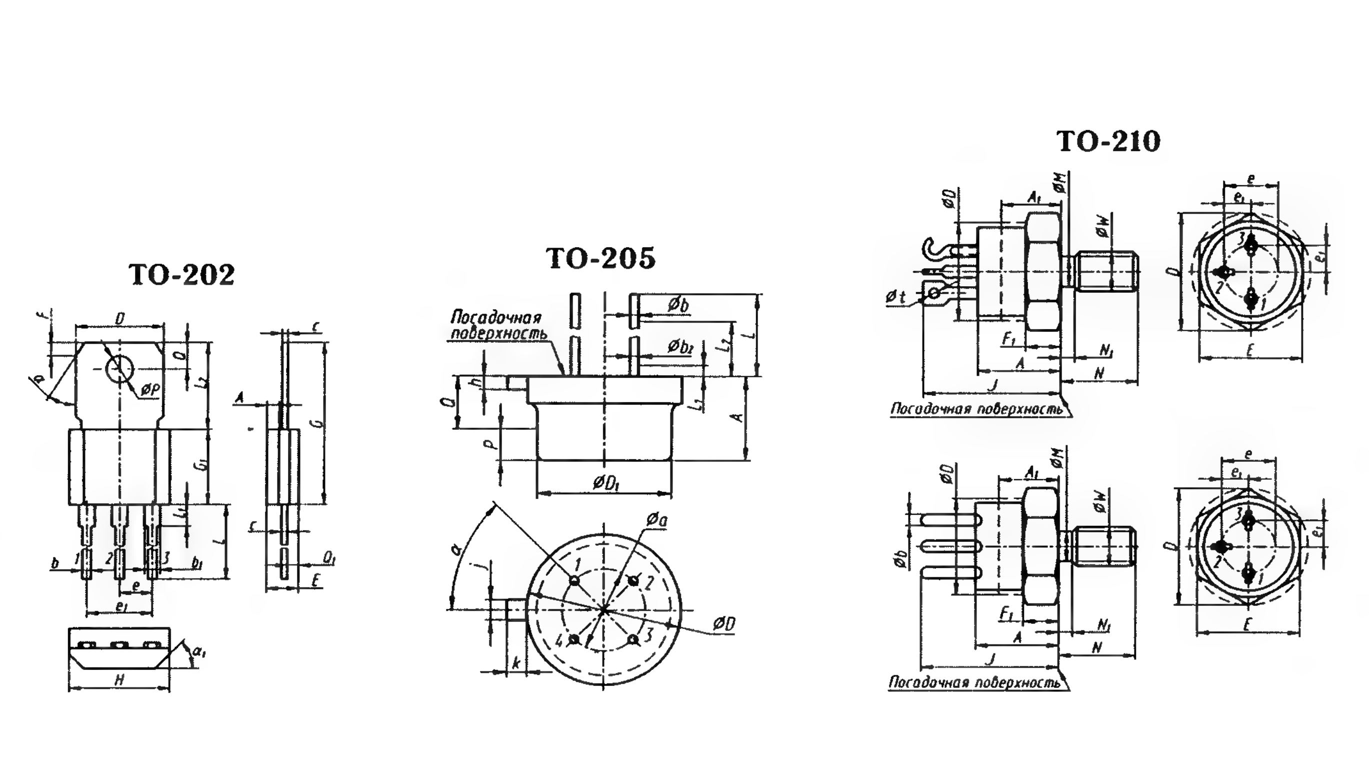


ТО-116

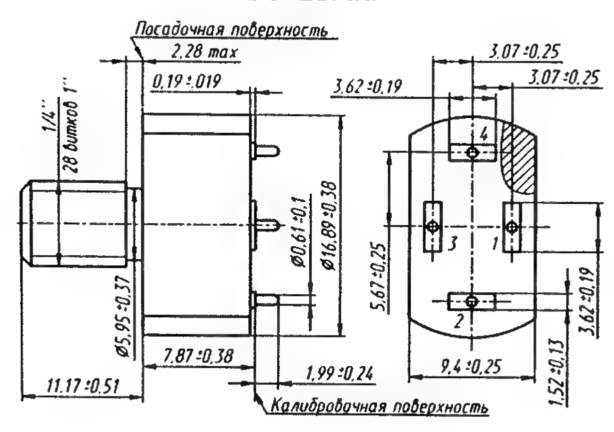



TO-119
Ø5,195 ±0,515
0,102 ±0,025
0,711
Посадочная поверхность
1,335 ±0,315
0,76 max
6,1 min
0,88 min
Место для маркировки
TO-120
1,17 ±0,4
0,86 max
1,97 ±0,26
0,127 ±0,05
Посадочная поверхность
0,775 ±0,385
0,345 ±0,135
2,54 min
1,97 ±0,26
TO-122
0,28 ±0,08
0,68 ±0,41
0,38 ±0,08
0,38 ±0,08
1 ±0,1
1,88 ±0,1
Посадочная поверхность
0,78 ±0,1

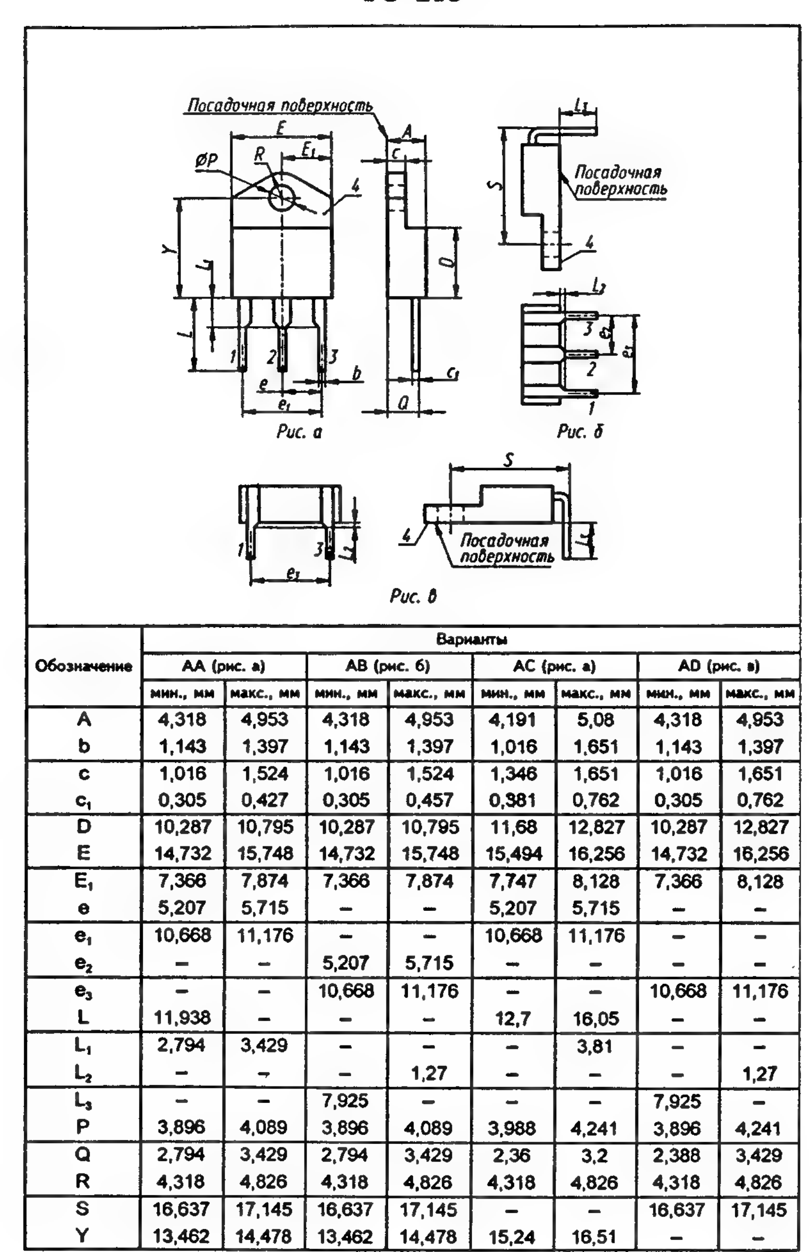

TO-126
7,74 ±0,64
Ø2,92 ±0,38
2,67 ±0,38
Место для маркировки
3,87 ±0,57
10,795 ±0,635
Посадочная поверхность
1,27 ±0,38
2,54 max
15,875 ±0,762
0,51 ±0,13
0,76 ±0,13
2,29 ±0,25
4,57 ±0,51
TO-127
12,83 ±0,63
Ø3,55 ±0,38
3,43 ±0,38
Место для маркировки
5,14 ±0,57
16,33 ±0,63
Посадочная поверхность
1,27 ±0,38
3,17 max
15,875 ±0,755
0,81 ±0,12
1,17 ±0,12
1,78 ±0,12
8,435 ±0,755


TO-202
TO-205
Посадочная поверхность
Øb
Øb₂
ØD₁
Øa
ØD
TO-210
Посадочная поверхность
Посадочная поверхность

TO-217aa

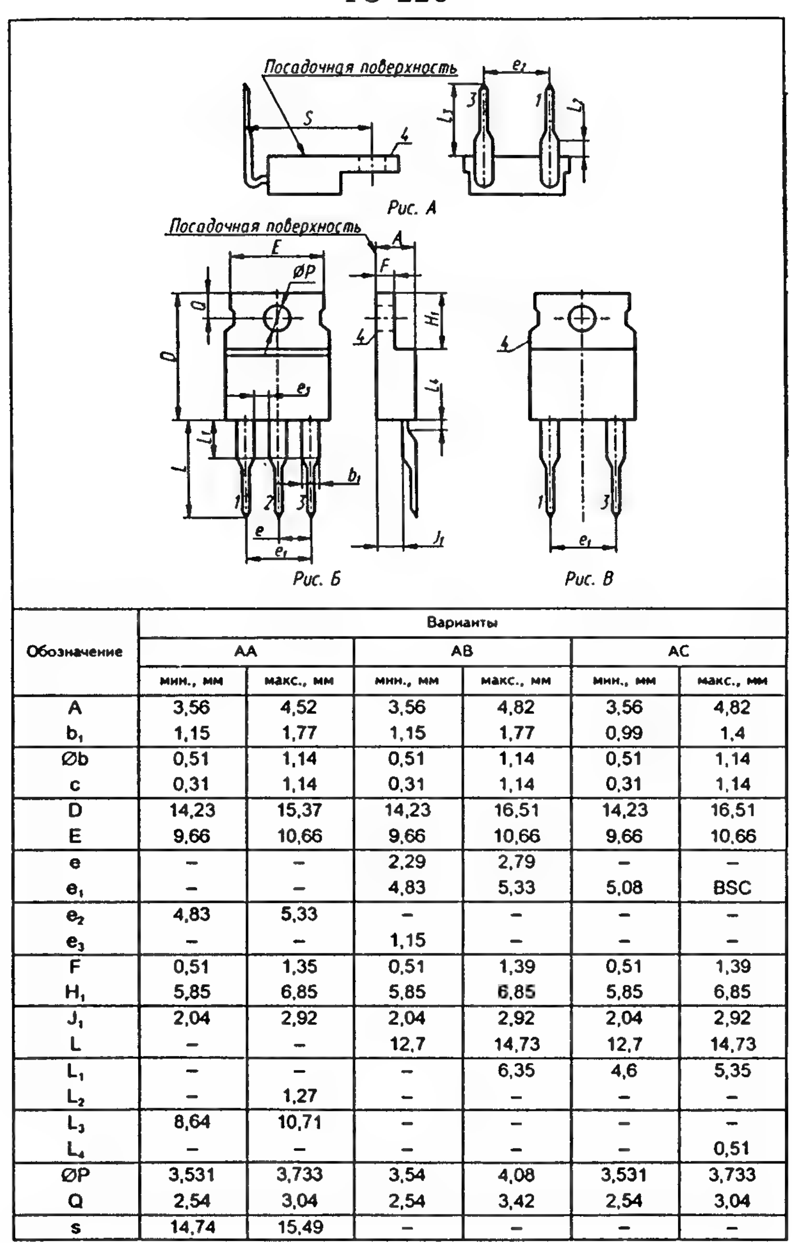


TO-218



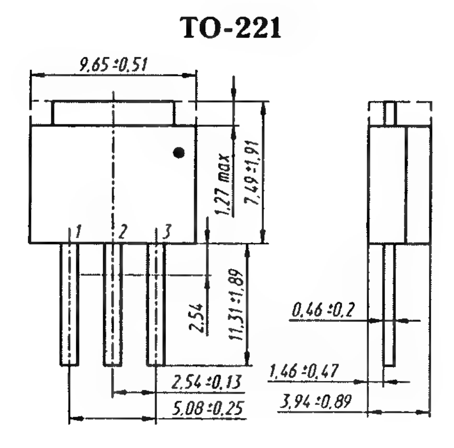
Обозначение	Варианты							
	AA (рис. а)		AB (рис. б)		AC (рис. а)		AD (рис. в)	
	мин., мм	макс., мм	мин., мм	макс., мм	мин., мм	макс., мм	мин., мм	макс., мм
A	4,318	4,953	4,318	4,953	4,191	5,08	4,318	4,953
b	1,143	1,397	1,143	1,397	1,016	1,651	1,143	1,397
c	1,016	1,524	1,016	1,524	1,346	1,651	1,016	1,651
c_1	0,305	0,427	0,305	0,457	0,381	0,762	0,305	0,762
D	10,287	10,795	10,287	10,795	11,68	12,827	10,287	12,827
E	14,732	15,748	14,732	15,748	15,494	16,256	14,732	16,256
E_1	7,366	7,874	7,366	7,874	7,747	8,128	7,366	8,128
e	5,207	5,715	–	–	5,207	5,715	–	–
e_1	10,668	11,176	–	–	10,668	11,176	–	–
e_2	–	–	5,207	5,715	–	–	–	–
e_3	–	–	10,668	11,176	–	–	10,668	11,176
L	11,938	–	–	–	12,7	16,05	–	–
L_1	2,794	3,429	–	–	–	3,81	–	–
L_2	–	–	–	1,27	–	–	–	1,27
L_3	–	–	7,925	–	–	–	7,925	–
P	3,896	4,089	3,896	4,089	3,988	4,241	3,896	4,241
Q	2,794	3,429	2,794	3,429	2,36	3,2	2,388	3,429
R	4,318	4,826	4,318	4,826	4,318	4,826	4,318	4,826
S	16,637	17,145	16,637	17,145	–	–	16,637	17,145
Y	13,462	14,478	13,462	14,478	15,24	16,51	–	–

TO-220

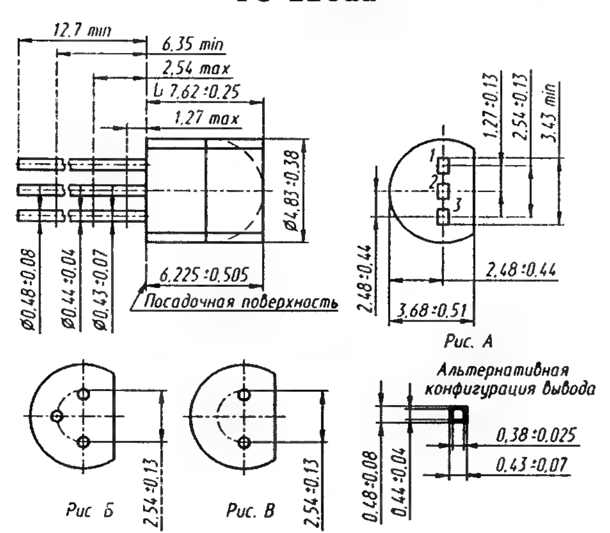


Обозначение	Варианты					
	AA		AB		AC	
	мин., мм	макс., мм	мин., мм	макс., мм	мин., мм	макс., мм
A	3,56	4,52	3,56	4,82	3,56	4,82
b_1	1,15	1,77	1,15	1,77	0,99	1,4
Øb	0,51	1,14	0,51	1,14	0,51	1,14
c	0,31	1,14	0,31	1,14	0,31	1,14
D	14,23	15,37	14,23	16,51	14,23	16,51
E	9,66	10,66	9,66	10,66	9,66	10,66
e	–	–	2,29	2,79	–	–
e_1	–	–	4,83	5,33	5,08	BSC
e_2	4,83	5,33	–	–	–	–
e_3	–	–	1,15	–	–	–
F	0,51	1,35	0,51	1,39	0,51	1,39
H_1	5,85	6,85	5,85	6,85	5,85	6,85
J_1	2,04	2,92	2,04	2,92	2,04	2,92
L	–	–	12,7	14,73	12,7	14,73
L_1	–	–	–	6,35	4,6	5,35
L_2	–	1,27	–	–	–	–
L_3	8,64	10,71	–	–	–	–
L_4	–	–	–	–	–	0,51
ØP	3,531	3,733	3,54	4,08	3,531	3,733
Q	2,54	3,04	2,54	3,42	2,54	3,04
s	14,74	15,49	–	–	–	–

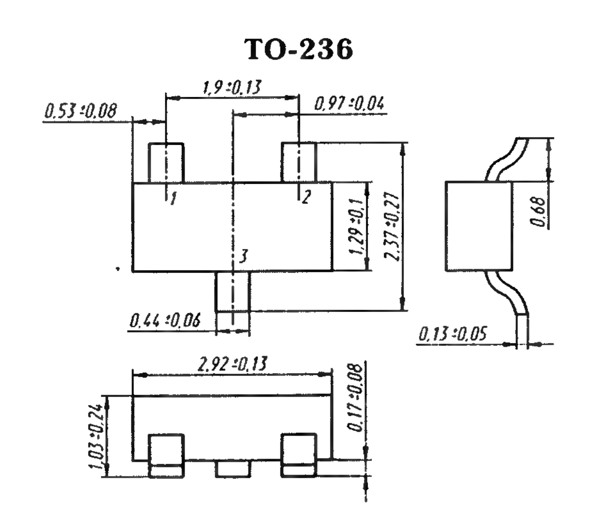
TO-221



TO-226aa



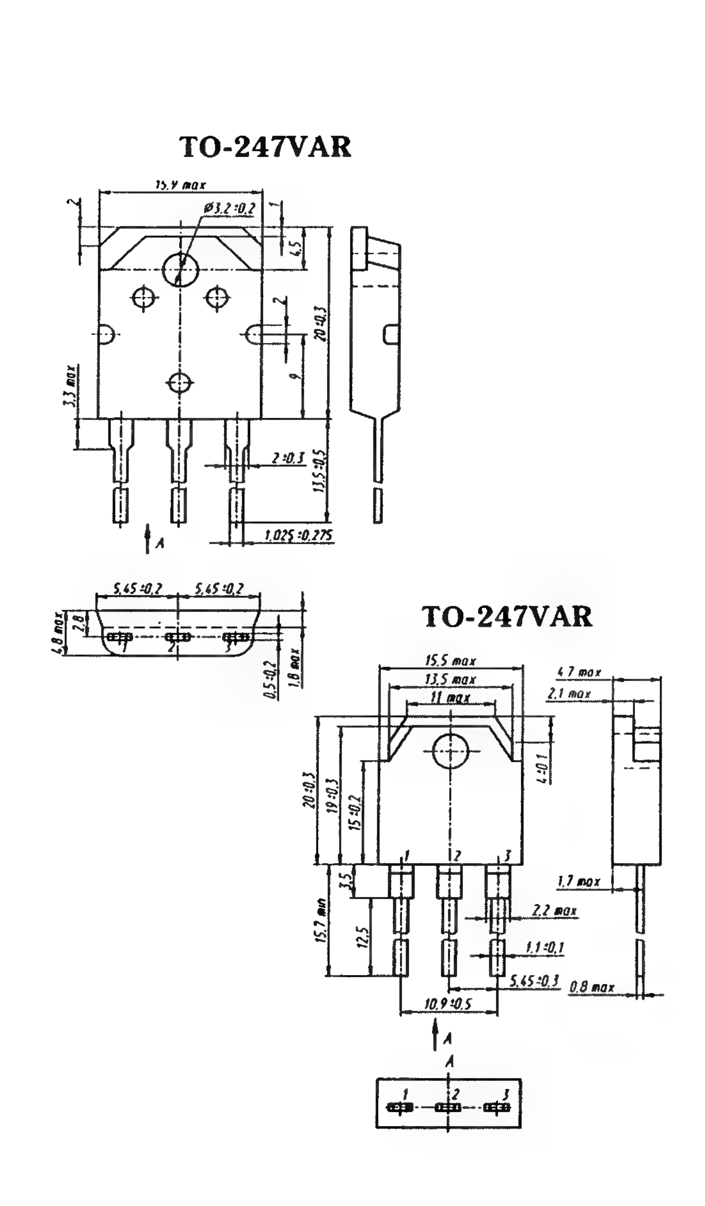
TO-236



TO-243

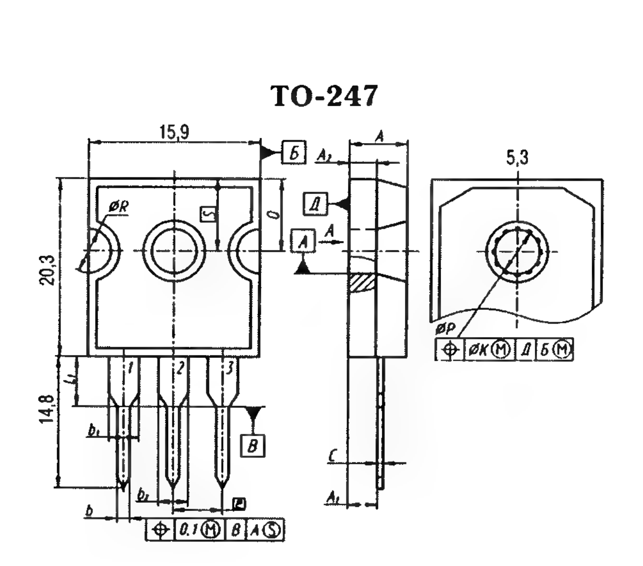
4,5 ±0,1
1,73 ±0,1
1,5 ±0,1
0,39 ±0,05
4,1 ±0,15
2,45 ±0,15
1,05 ±0,15
0,42 ±0,06
0,5 ±0,06
1,5
3
2,21 ±0,08

TO-247VAR

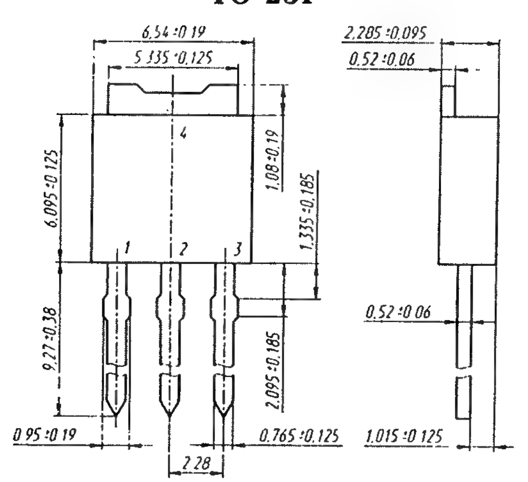


TO-247VAR

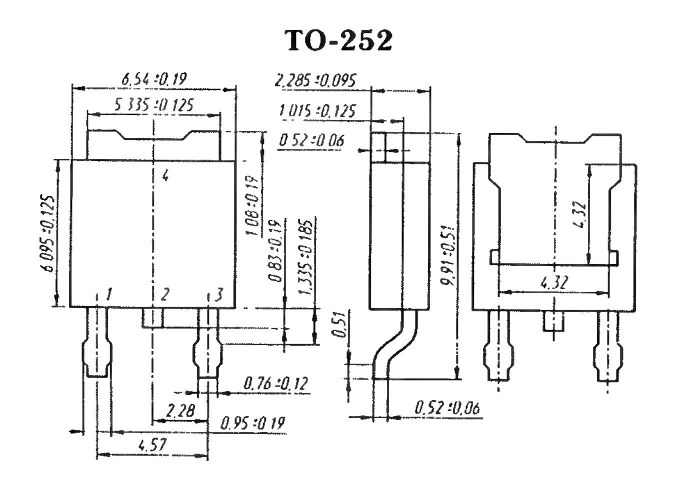
TO-247



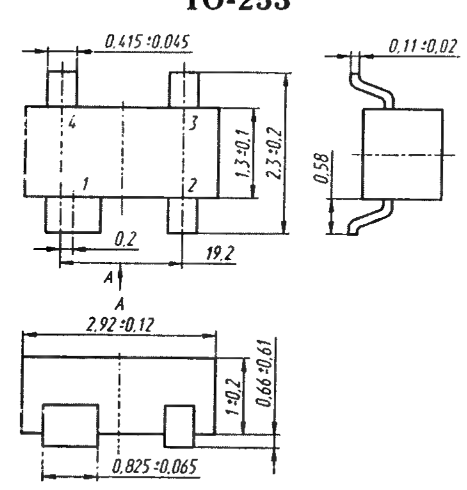
TO-251



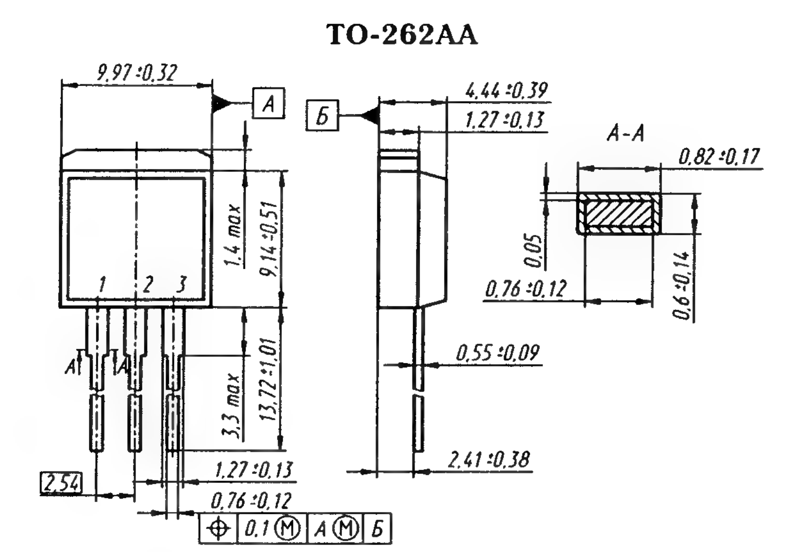
TO-252



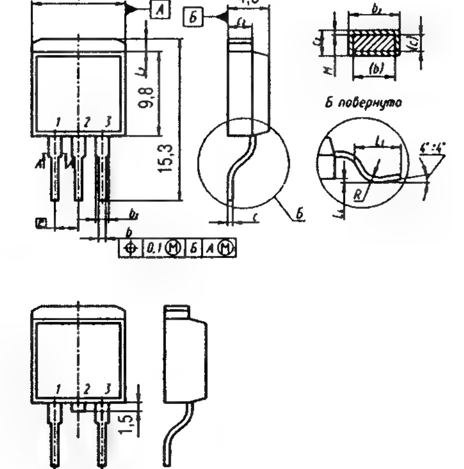
TO-253



TO-262AA



TO-263



4.5. Соответствие отечественных корпусов зарубежным

Транзисторы	
КТ-1-7	TO-18
КТ-1-12	TO-72
КТ-2-7	TO-39
КТ-2-10	TO-5
КТ-2-12	TO-12
КТ-2-13	TO-205AB
КТ-2-15	TO-33
КТ-4-2	TO-60
КТ-6	TO-61
КТ-7	TO-63
КТ-8	SOT-9, TO-66
КТ-9	TO-3
КТ-14	TO-119
КТ-17	SOT-48
КТ-24	FO-93
КТ-26	TO-92
КТ-27	TO-126, SOT-32, SOT-82
КТ-28	TO-220, SOT-78
КТ-29	SOT-37
КТ-30	SOT-123
КТ-31	SOT-121
КТ-35-7	TO-46
КТ-43	TO-218, SOT-93
КТ-43С	SOT-199
КТ-44	SOT-279
КТ-45	SOT-161
КТ-46	SOT-23, SC-70
КТ-47	SOT-89, TO-243, SC-62
КТ-48	SOT-143, TO-253
КТ-50	SOT-128, TO-205AC
КТ-51	SC-71
КТ-53	SOT-103
КТ-54	FO-83
КТ-55	FO-91
КТ-58	SOT-289
КТ-82	SOT-262A1

Раздел 5
АНАЛОГИ ТРАНЗИСТОРОВ

5.1. О взаимозаменяемости транзисторов

Вопросы, связанные с взаимозаменяемостью отечественных и зарубежных полупроводниковых приборов, возникают при необходимости замены вышедшего из строя прибора в конкретной аппаратуре, а также при определении возможности воспроизведения интересующего устройства (схемы).

Полная аналогичность (эквивалентность) отечественных и зарубежных полупроводниковых приборов предполагает совпадение их функционального назначения, электрических параметров и характеристик, конструктивного оформления, габаритных и присоединительных размеров.

Однако полного совпадения получить практически невозможно, так как процесс создания полупроводниковых приборов — это технологический комплекс, характерный для каждой фирмы-изготовителя.

Принципы и методы определения наиболее вероятных значений и установление норм и допусков электрических параметров, принятые в разных странах, неодинаковы.

Очевидно, что в ряде случаев нормы, устанавливаемые на параметры, могут значительно отличаться от их реальных значений.

Режимы, условия, методы проведения различных видов электрических, механических и климатических испытаний, нормы на параметры — критерии годности при испытаниях, методы измерений, от которых в общем зависят устанавливаемые параметры, многообразны, принципиально различны и не универсальны. Кроме того, значения параметров приборов зависят не только от режима работы и температуры, но и изменяются со временем (дрейф параметров во время работы и при хранении).

Эксплуатационные свойства транзисторов описываются большим числом параметров, поэтому можно считать, что практически полная тождественность отечественных и зарубежных транзисторов недостижима и не во всех случаях необходима. Целесообразнее говорить о частичной (неполной) или приближенной их эквивалентности. Подбор аналогов должен проводиться с учетом конкретной электрической схемы, а не только путем формального сравнения всех параметров приборов (показателей функционирования) в совпадающем или близком режимах измерений. При воспроизведении технических показателей схемы (узла, каскада) должны удовлетворяться, прежде всего, требования к выходным параметрам. Поэтому не все параметры транзисторов будут одинаково важными, а только те, по которым должна быть обеспечена взаимозаменяемость.

Взаимозаменяемость отечественных и зарубежных приборов зависит не только от их свойств, условий эксплуатации и режимов применения, но и от рационально разработанной схемы, учитывающей номинальный разброс параметров и не требующей специального подбора приборов. При замене зарубежного прибора отечественным, даже лучшим по параметрам, может потребоваться подстройка схемы, чтобы не ухудшилась работа каскада и не возникла паразитная генерация.

Подбор аналогов должен осуществляться сравнением электрических параметров (показателей функционирования) отечественных и зарубежных приборов из справочников, стандартов или технических условий на эти приборы, где указывается основное (целевое) назначение приборов, технология изготовления, структура (p-n-p или n-p-n), предельные (предельно допустимые) параметры, данные об электрических параметрах и их изменениях от режима и температуры, тип корпуса и другие сведения.

Полупроводниковые приборы, изготавливаемые в едином технологическом процессе, иногда разделяются по каким-либо параметрам на группы и собираются в различных корпусах. Например, транзисторы BC107-BC109 имеют металлостеклянный корпус TO-18, приборы с таким же сочетанием параметра BC107P-BC109P, BC147-BC149, BC207-BC209, PBC107-PBC109 имеют соответственно корпуса X-55, MM-12, RO-110, TO-98. Многие приборы в металлостеклянном корпусе имеют эквиваленты в пластмассовом корпусе.

5.2. Условные обозначения и классификация зарубежных приборов

За рубежом существуют различные системы обозначений полупроводниковых приборов. Наиболее распространенной является система обозначений JEDEC, принятая объединенным техническим советом по электронным приборам США. По этой системе приборы обозначаются индексом (кодом, маркировкой), в котором первая цифра соответствует числу p-n переходов: 1 — диод; 2 — транзистор; 3 — тетрод (тиристор). За цифрой следуют буква N и серийный номер, который регистрируется ассоциацией предприятий электронной промышленности (EIA). За номером могут стоять одна или несколько букв, указывающих на разбивку приборов одного типа на типономиналы по различным параметрам или характеристикам. Однако цифры серийного номера не определяют тип исходного материала, частотный диапазон, мощность рассеяния или область применения.

Фирма-изготовитель, приборы которой по своим параметрам подобны приборам, зарегистрированным EIA, может представлять свои приборы с обозначением, принятым по системе JEDEC.

В Европе кроме JEDEC широко используется система, по которой обозначения полупроводниковым приборам присваиваются организацией Association Pro Electron. По этой системе приборы для бытовой аппаратуры широкого применения обозначаются двумя буквами и тремя цифрами, для промышленной и специальной аппаратуры — тремя буквами и двумя цифрами. Так, у приборов широкого применения после двух букв стоит трехзначный порядковый номер от 100 до 999. У приборов, применяемых в промышленной и специальной аппаратуре, третий знак — буква (буквы используются в обратном алфавитном порядке: Z, Y, X и т. д.), за которой следует порядковый номер от 10 до 99.

Если в одном корпусе имеется несколько одинаковых приборов, то обозначение производится в соответствии с кодом (маркировкой) для одиночных дискретных приборов. При наличии в одном корпусе нескольких разных приборов в качестве второй буквы обозначения используется буква G. К основному обозначению может добавляться буква, указывающая на отличие прибора от основного типа по каким-либо параметрам или корпусу.

В системе Pro Electron приняты следующие условные обозначения:

Первый элемент

Исходный материал	Ширина запрещенной зоны, эВ	Условное обозначение
Германий	0,6...1	A
Кремний	1...1,3	B
Арсенид галлия	Более 1,3	C
Антимонид индия	Менее 0,6	D

Примечание. Приборы на основе других полупроводниковых материалов обозначаются буквой R.

Второй элемент

Подкласс приборов	Условное обозначение
Транзисторы низкочастотные маломощные (R_{thja} > 15 °C/Вт)	C
Транзисторы низкочастотные мощные (R_{thja} < 15 °C/Вт)	D
Транзисторы высокочастотные маломощные (R_{thja} > 15 °C/Вт)	F
Транзисторы высокочастотные мощные (R_{thja} < 15 °C/Вт)	L
Транзисторы переключающие маломощные	S
Транзисторы переключающие мощные	U

По существующей в настоящее время в Японии системе стандартных обозначений (стандарт JIS-C-7012, принятый ассоциацией EIAJ — Electronic Industries Association of Japan) можно определить класс прибора (диод или транзистор), его назначение, тип проводимости. Вид полупроводникового материала в этой системе не отражается. Условное обозначение состоит из пяти элементов.

Первый элемент

Класс приборов	Условное обозначение
Фотодиоды, фототранзисторы	0
Транзисторы	2
Четырехслойные приборы	3

Второй элемент, указывающий на то, что данный прибор является полупроводниковым, обозначается буквой S (Semiconductor).

Третий элемент

Подкласс приборов	Условное обозначение
Транзисторы р-п-р высокочастотные	A
Транзисторы р-п-р низкочастотные	B
Транзисторы п-р-п высокочастотные	C
Транзисторы п-р-п низкочастотные	D
Однопереходные транзисторы	H
Полевые транзисторы с р-каналом	J
Полевые транзисторы с п-каналом	K

Четвертый элемент обозначает регистрационный номер и начинается с числа 11.

Пятый элемент отражает усовершенствование (A и B — первая и вторая модификации).

После маркировки могут быть дополнительные индексы (N, M, S), отражающие требования специальных стандартов.

Кроме вышеуказанных систем стандартных обозначений, изготовители приборов широко используют внутренние (внутрифирменные) обозначения. В этом случае за основу буквенного обозначения чаще всего берется принцип сокращенного названия фирмы, коды материала и применения.

5.3. Сокращенные обозначения зарубежных фирм

Обозначение	Фирма, страна
Acr	Acrian. Inc., США
AEG	Amperex Electronic Corp., США
AEI	Amex Electronics, Inc., США
AI	Avantek, Inc., США
AII	Alpha Industries, Inc., США
AM	American Microsemiconductor, США
AMI	American Microsemiconductor, Inc., США
Amp	Amperex Electronic Corp., США
AMS	American Microsystems, Inc., США
APD	American Power Devices, США
AS	Ansaldo S. p. A. Италия
ASI	Advanced Semiconductors, Inc., США
Atl	Atlantic Semiconductors, Inc., США
BB	Brown Boveri, Германия
BE	Boeing Electronics. Швейцария
BEL	Bharat Electronics., Ltd., Индия
CD	Compensated Devices, Inc., США
GDI	Continental Device India, Ltd., Индия
CEIL	Calbert Electronics Inter., Ltd., США
Cherry	Cherry Semiconductor Corp., США
CODI	CODI Semiconductor Corp., США
CSC	Crimson Semiconductor Corp., США

Обозначение	Фирма, страна
CSD	Central Semiconductor Div., США
CSDG	Conditioning Semiconductor Devices Corp., США
CSR	CSR Industries, Inc., США
DI	Dionics, Inc., США
DII	Datel-Intersil, Inc., США
DTC	Diode Transistor Comp., США
EC	Eastron Corp., США
ED	EETECH Div., США
EDI	Electronics Devices, Inc, США
EE	Електронни Элементи, БНР
EI	Elektronska Industrija (Iskra). Югославия
EII	Edal Ind., Inc., США
ESPI	Elite Semiconductor Products, Inc., США
ETC	Electronic Transistors Corp., США
FE	Fagar Electrotechnica, Испания
FEL	Ferranti Electronics, Ltd., Англия
FEG	Fujitsu Electric, Япония
FS	Fairchild Semiconductor Corp., США
GDC	General Diode Corp., США
GE	General Electric Corp., США
GIC	General Instrument Corp., США
GPD	Germanium Power Devices Corp., США

Обозначение	Фирма, страна
GS	Gentron Corp., США
GSI	General Semiconductor Industries, Inc., США
CSS	Gold Star Semiconductors, Ltd., Ю. Корея
GTC	General Transistor Corp., США
Harris	Harris Semiconductor, США
HL	Hitachi Ltd., Япония
HP	Hewlett Packard, США
HS	Hybrid Semiconductors, США
HSE	Hybrid Semiconductor Electronic, Inc., США
HVS	High Voltage Semiconductor, США
IC	Interfet Corp., США
IDG	International Diode Corp., США
IDI	International Devices, Inc.
II	Intersil, Inc., США
IPS	International Power Semiconductors, Индия
IR	International Rectifier Semiconductor, США
IRC	International Rectifier Corp., США
ITT	Intermetall (der Deutsche ITT), Германия
KMG	KMG Semiconductor Corp., США
KPD	Keltron Power Devices, Индия
LEC	Lucas Electrical Comp., Англия
LS	Lambda Semiconductors, США
LT	Lansdale Transistor, США
MA	Microwave Associates, США
MDP	Mallory Distributor Products, США
ME	Mitsubishi Electric Corp., Япония
MEG	Matsushita Electronics Corp., Япония
MECJ	Mitsubishi Electric Corp., Япония
MED	Marconi Electronic Devices, Англия
MEL	Microelectronics, Ltd., Гонконг
MENA	Murata-Erie North American Corp., США
MIS	Mistral SPA, Италия
Mist	Mistral, Италия
ML	Milliard, Ltd., Англия
Mot	Motorola Semiconductor Products, Inc., США
MPS	Micro Power Systems, США
MS	Microsemiconductor Corp., США
NAE	NAE, Inc., США
NAS	North American Semiconductor, Германия
NEC	Nippon Electric Comp., Япония
NEI	National Electronics Inc., США
NJRG	New Japan Radio Comp., Япония
NJS	New Jersey Semiconductor Prod., США
NSC	National Semiconductor Corp., США
OEC	Origin Electric Comp., Япония
PEC	Philips Electronic Comp., Нидерланды
Philco	Philco Radio Televisao, Бразилия
PI	Parametric Ind., США
PIC	Piher International Corp., Испания
PPC	PPC Products Corp., США
PPI	Pecor President Interprises Corp., США
PS	Piher Semiconductors, Испания
PSDI	Punjal Semiconductor Devices, Ltd., Индия
PSE	Plessey Semiconductors, Англия
PSI	Power Semiconductors, Inc., США
PTI	Power Tech, Inc., США
QC	Quantrad Corp., США
RC	Raytheon Comp., США
RCA	RCA Corp., США
RCC	Rectifier Component Corp., США
RFT	RFT, ГДР
RL	Rectron Ltd., Китай
Rohm	Rohm Corp., Япония
RS	Raytheon Semiconductor, США
RTG	RTC La Radiotechnique, Франция
SA	Siemens Aktiengesellschaft, Германия
Samtech	Samtech Corp., Япония
San	Sanyo Electric Comp., США
SC	Sony Corp., Япония
SCL	Semitron Cricklade, Ltd., Англия
SDI	Solitrori Devices, Inc., США
SE	Sanken Electric Comp., США
Semicoa	Semicoa, США
SEC	Spraque Electric Comp., США
SECI	Swampscott Electronics Comp., США
SEM	Shindengen Electric Mfg., Япония
Sem	Semicon, Inc., США
SGS	SGS-Ates, Италия
SI	Siliconix, Inc., США
SII	Semikron International, Inc., США
SL	Semiconductors, Ltd., Индия
SMC	Schauer Manufacturing Corp., США
SPC	Solid Power Corp., США
SPE	Space Power Electronics, Inc., США
SSD	Sensitron Semiconductor Div., США
SSDI	Solid State Devices, Inc., США
SSE	Solid State Electronics Comp., США
SSI	Solid State Industries, Inc., США
SSII	Solid State Industries, Inc., США
SSS	Solid State Systems, США
STC	Silicon Transistor Corp., США
STI	Semiconductor Technology, Inc., США
STSI	ST-Semicon, Inc., США
Supertex	Supertex, Inc., США
Syn	Syntar Inductries, Inc., США
TAG	TAG Semiconductor, Ltd., Швейцария
TC	Toshiba Corp., Япония
TCI	Teledyne Crystalonics, Inc., США
TEI	Teccor Electronics, Inc., США
Tel	Telefunken Electronic, Германия
Tesla	Tesla, Чехия
Thom	Thomson-CSF, Франция
TI	Texas Instruments, Inc., США
TRW	TRW Semiconductor, Inc., США
TS	Teledyne Semiconductor, США
TSI	Transistor Specialtys, Inc., США
UA	United Aircraft, США
UC	Unitrode Corp., США
Unitra	Unitra, Польша
UPI	UPI Semiconductors, США
V	Valvo, Германия
VEG	Victory Engineering Corp., США
VSI	Varo Semiconductor, Inc., США
WDI	Walbern Devices, Inc., США
WEC	Westinghouse Electric Corp., США
WS	Westcode Semiconductors, Англия

5.4. Буквенные обозначения зарубежных транзисторов

Обозначение транзистора	Фирма
A	AEC
AC	BEL, CSD, EI, GPD, ML, PEC, RTC, SA, V, WDI
ACY	CSD, EI, GPD, HSE, THOM, SA
AD	ASI, BEL, CSD, EI, GPD, ML, PEC, RTC, SA, V, WDI
ADP	UNITRA
ADY	GPD
ADZ	CSD, GPD
AF	EI, GTC, HSE, IDI, ML, PEC, RTC, UNITRA, V
AFY	WDI
AL	CSD, GPD
AM	AMI
AMF	AMI
AP	ACR, ASC
ASY	CSD, GPD, UNITRA
ASZ	BEL, CSD, GPD, WDI
AT	AI
AU	CSD, GPD
AUY	CSD, GPD, HSE
B	AI, STI, THOM
BAL	AI
BAM	AI
BAP	AI
BC	AEC, ASI, BEL, CDI, EI,, CSC, CSD, FEL, IDI, ITT, KRD, MEL, ML, PEC, RTC, SA, SGS, THOM, UNITRA, V
BCE	UNITRA
BCF	AEC, ML, PEC, RTC, THOM, V
BCP	UNITRA
BCV	AEC, FEL, ML, RTC, THOM, SA, V
BCW	АПС, ASI, CSC, FEL, ML, PEC, RTC, SEC, SA, THOM, UNITRA, V, WDI
BCX	AEC, ASI, CSD, CSC, FEL, ITT, ML, PEC, RTC, SEC, SA, THOM, V, WDI
BCY	AEC, ASI, CSD, CSC, ML, PEC, RTC, V, WDI
BD	ASI, BEL, CSD, CSC, ML, PEC, RTC, RFT, SA, UNITRA
BDP	UNITRA
BDV	ML, PEC, RTC, SGS, V
BDW	CSD, IPS, ML, PEC, RTC, SGS, SSE, SDI
BDX	BEL, CSC, CSD, FEL, IPS, ML, SGS, RTC, PEC, V
BDY	IPS, HSE, ML, PEC, RTC SDI, TEL, SGS, UNITRA, V
BE	BE
BEL	BEL
BF	RFT, RTC, TEL, V, WDI, CSD, ACR, CSC, EI, IDI, AEC, ASI, BEL, FEL, CDI, KRD, IC, HSE, MIS, PEC, UNITRA

Обозначение транзистора	Фирма
BFE	UNITRA
BFN	RTC, SA
BFP	SA, UNITRA, TI
BFQ	AEC, FEL, ML, RTC, PEC, V
BFR	AEC, ASI, CSD, IC, ML, PEC, RTC, SA, THOM, UNITRA, V, WDI
BFS	AEC, ASI, FEL, HSE, ML, PEC, RTC, THOM, UNITRA, SA, V, WDI
BFT	ASI, FEL, ML, PEC, RTC, SA, SGS, TEL, THOM, V
BFV	TI
BFW	A UNITRA, V, WDI EC, ASI, BEL, CDI, CSC, CSD, ML, PEC, RTC,
BFX	ASI, CDI, CSD, CSC, FEL, IDI, HSE, DTC, ML, PEC, RTC, SGS, TEL, V, WDI
BFY	ASI, CSD, CSC, CDI, HSE, IDI, FEL, ML, PEC, SGS, TEL, V, WDI
BGY	ML, PEC, RTC
BLU	ML, PEC, RTC, V
BLV	ML, PEC, RTC, V
BLW	ML, PEC, RTC, V
BLX	ML, PEC, RTC, SDI, V
BLY	HSE, ML, PEC, RTC, V
BM	SII
BP	SII
BR	MEL, SDI
BRT	SEM, TRW
BRY	ML, PEC, RTC, V
BS	ITT, ML, PEC, RTC, V
BSJ	EI
BSR	AEC, ML, PEC, RTC, THOM, V
BSS	AEC, ASI, CSD, FEL, IDI, ML, PEC, RTC, SA, V, WDI
BST	AEC, ML, PEC, RTC, V
BSV	AEC, CSD, ML, PEC, RTC, SA, SGS, FEL, THOM, V, WDI, TEL
BSW	AEC, ML, MIS, PEC, RTC, SGS, TEL, UNITRA, V
BSX	ASI, CDI, CSC, CSD, EI, HSE, IDI, ML, MIS, PEC, RTC, SGS, TEL, UNITRA, V, WDI
BSXP	UNITRA
BSY	ASI, CDI, CSC, HSE, IDI, FEL, ML, PEC, RTC, SGS, TEL, V
BT	RS
BU	ASI, CSD, DTC, GTC, HSE, KPD, ML, NEC, PPI, RTC, SDI, SGS, TEL, THOM, UNITRA, V, WDI
BUC	MOT
BUP	UNITRA
BUR	SGS, SEM

Обозначение транзистора	Фирма
BUS	ML, PEC, RTC, THOM, V
BUT	ML, PEC, RTC, SGS, TEL, V
BUV	ML, PEC, RTC, SGS, SDI, TEL, THOM, V
BUW	CSD, ML, PEC, RTC, SGS, SDI, THOM, V
BUX	CSD, FEL, KPD, ML, PEC, RTC, SGS, SDI, TEL, THOM, UNITRA, UC, V, WDI
BUYP	PPI, UNITRA
BUY	ASI, FEL, CSD, HSE, RTC, SGS, SDI, WDI
BUZ	ML, PEC, RTC, SGS, SA, V
BZW	SA
C	ASI, ACR, TCI, TI, WDI
CA	GPD
CD	SII
CDT	GPD
CF	SII
CIL	CDI
CK	STI
CM	TCI
CP	TCI
CQT	GPD
CS	ASI, NSC, WDI
CST	GPD
CT	SEC
CTR	STI, GPD
CV	SEM
CX	ASI, WDI
D	ACR, CSC, GE, MOT, NSC, SGS, PPI, STI, TI, WEC
DA	GPD, WEC
DB	WEC
DC	DI
DD	AMS
DI	DI
DM	AMS
DMP	ML, PEC, RTC, V
DN	DI, SI
DP	DI
DQN	DI
DT	MED
DTA	MEC
DTG	ASI, DTC, GPD, STI, WDI
DTN	DI
DTS	ASI, CSD, DTC, SPC, SSI, TI, WDI
DV	SI
DVD	SI
П	NSC, SDI, WDI
ПС	UA
ED	NSC
EN	ASI, CSD, IDI, STI, WDI
ERS	ETC
ESM	MIS, THOM
ETP	ETC
FC	SEC
FGT	FEL
FMMT	FEL
FM	ACR, NSC

Обозначение транзистора	Фирма
FN	SI
FOS	FS
FT	FS. MOT, STI
FTR	FS
GC	RFT, TESLA
GD	RFT, TESLA
GE	CSC, CSD. GE
GET	GE
GF	RFT. TESLA
GFY	TESLA
GS	RFT. TESLA
GSDB	GSI
GSDS	GSI
GSDU	GSI
GSRU	GSI
GSTU	GSI
GT	GDC, HSE
H	SII
HA	GDC
HEP	MOT
HEPE	MOT
HEPS	MOT
HP	HP
HS	GE, SEC
HSE	HSE
HT	FEL
HV	BEL
IDA	IDI
IDB	IDI
IDC	IDI
IDD	IDI
IDI	IDI
IMF	II, NSC
IR	IR
IRF	FS, IR, MOT, RCA, SGS, SI
IRFD, IRFB	IR
IRFF	IR
IRFZ. IRG	IR
IT	II
ITE	II. NSC
J	IC, II. MOT. NSC, SI, SDI
JA	ITT
JC	ITT
JE	NEC
JH	SDI
JO	TRW
K	ASI, HSE, WDI, KMC
KA	TESLA
KB	WEC
KC	TESLA
KD	KMC, TESLA, WEC
KE	NSC. SDI, WDI. WEC
KF	MAI, TESLA
KFY	TESLA
KJ	MAI
KM	ASI, WDI
KN	KPD
KP	KPD
KS, KSC	TESLA, WEC, Samsung
KSP	PPS
KSY	TESLA
KU	TESLA
KUY	TESLA
L	ASI, WDI
LDA	AEC
LOT	TRW
LS	SI
LT	NSC
M	ASI, II, WDI
MA	ASI, HSE, MEL, MOT, STI, WDI
MC	PI
MD	CSC, MOT, PI
MDS	MOT
MEM	GI, SDI
MEU	MEL
MF	MOT, PI, STI
MFE	CSC, MOT, SDI, SI
MFEC	MOT
MG	TC
MGM	MOT
MGP	MOT
MH	MEL, WDI
MHA	FS
MJ	ASI, CSC, CSD, IDI, GTC, IPS, MOT, PPI, RCA, SGS, STC, STI, TI, WDI
MJE	ASI, CSD, CSC, GTC, IDI, MEC, MOT, NSC, PPI, SGS, STI, THOM, WDI
MJEC	MOT
MJH	MOT
MM	ASI, CSC, HSE, MOT, STI, WDI
MMBA	MOT, SEC
MMBC	MOT, SEC
MMBF	MOT, NSC
MMBPU	MOT
MMBR	MOT
MMBT	MOT, NSC, SEC
MMBTA	MOT, SEC
MMBTH	MOT, NSC
MMBTS	MOT
MMC	MOT
MMCF	MOT
MMFF	MOT
MMCM	MOT
MMT	MOT
MN	STI
MP	GPD, MPS, MEL, STC
MPF	MEL, MOT, NSC, SDI, SI, WDI
MPS	FEL, FS, CSC, SCD, IDI, GE, MOT, NSC, RC, SEC, STI, TI, THOM, WDI
MPSA	FEL, FS, CSD, GE, IDI, STI, MEL, MOT, NSC, RC, SEC, TI, THOM, WDI
MPSC	MOT
MPSD	CSC, CSD, GE, MEL, MOT, RC, SEC, STI, WDI
MPSH	CSC, CSD, FS, GE, IDI, MEL, MOT, NSC, SEC, STI, WDI
MPSK	CSC, SEC
MPSL	CSC, FS, GE, IDI, MOT, NSC, SEC, STI, TI, WDI
MPSU	MOT, SPE, WDI
MPSUC	MOT
MPSW	MOT. NSC
MPU	GE. MOT
MPX	MOT
MRF	DTC, MOT
MRFC	MOT
MS	TI
MSA	FS
MSB	WDI
MSP	HSE, STI
MST	HSE, STI
MT	FS, MEL, PTI
MTA	MOT
MTE	MOT
MTH	MOT
MTM	MOT, SGS
MTP	FS, MOT. SGS
MTS	MOT
MTU	MEL
MU	GE, MOT
N	CHERRY, KPD, TI
NA	NSC
NB	NSC
NDF	NSC
NF	II. MEL. NSC, SI. TS
NKT	HSE
NPC	THOM
NPD	NSC
NR	NSC
NS	NSC
NSD	NSC, WDI
NSDU	NSC
NSE	NSC
NT	NEC
NTM	NEC
OC	GPD, HSE, GTC, STI, TI
ON	ML, PEC, RTC, V
P	CHERRY, NSC, SDI, SI, S, SD, WDI
PA	PHILCO
PB	PHILCO
PBM	PHILCO
PC	PHILCO
PD	DI, PHILCO
PE	FS, PHILCO, NSC, PPI
PEC	PPI
PET	STI
PF	NSC
PG	SEC
PH	AEC, ML, PEC, RTC, V
PL	TI
PMD	CSD, LS
PMS	LS
PN	CSD, CSC. FS. MEL. NSC. RC. SSD. SSI
PT	BEL, PTI, SSD, TRW
Q	HSE
R	WDI
RCA	RCA
RCP	STI
RCS	RCA
RFD	FEL
RFH	RCA
RFK	RCA
RFL	RCA
RFM	RCA

Обозначение транзистора	Фирма
RFP	RCA
RRF	RCA
RT	RTC
S	ACR. SSD. TC, UA
SC	GPD, RFT, PI
SCA	PI
SD	ML, RFT, RTC, TEL, SI, THOM, V
SDF	SDI
SDG	GPD
SDM	SDI
SDN	STC
SDP	STC
SDT	CSC. GPD, SDI, SSD
SE	ASI, CSD, FS, IDI, GTC, MOT, NSC, SEC, STI, WDI
SFMN	PI, RFT
SFN	SDI
SFT	MIS, PI, THOM
SGS	SGS
SGSP	SGS
SHA	SSI
SK	RCA, STI
SL	PS
SM	RFT
SMBT	SA
SO	THOM
SOR	THOM
SP	RS, SDI
SPC	SPC
SPK	SDI
SPM	SDI
SPT	SSI
SQ	SEM
SQD	SEM
SRF	FEL
SRL	STC
SRLP	STC
SRM	STC
SRS	STC. STI
SS	RFT, SSI
SSP	SSI
SSX	PI
ST	NSC, STI, TC, IR
STA	STC
STC	PTI
STI	STI
STIP	STI
STM	STI
STP	STI
STS	STC

Обозначение транзистора	Фирма
SU	RFT, SGS, TSC
SV	NSC
SVN	SDI
SVT	SDI, SSD, STI, TRW
SWT	SECI
T	SEM
TBC	TC
TBF	TC
TC	MED
TCH	TAG
TCS	TI
TEC	TC
TED	TC
TF	MED
TG	UNITRA
TH	SEC, THOM
THA	THOM
THB	THOM
THX	THOM
THY	THOM
TI	HSE, STI, TI, WDI
TIP	ASI, CSC, CSD, FEL, GTC, IDI, MEC, MEL, MOT, ML, SC, PPI, PEC, RCA, RTC, NSGS, SDI, STI, TI, V, WDI
TIPC	MOT
TIPL	TI
TIS	DIC, IDI, MEL, NSC, SDI, STI, TI, WDI
TIX	TI
TIXM	TI
TIXP	PTI
TIXS	TI
TL	THOM
TMP	SEC
TN	NSC, MEL, SUPERTEX, TCI, TI
TP	SEC
TPE	SEC
TPP	SEC
TPS	SEC
TPV	TPW
TQ	SEC
TR	GDC, HSE, NVS, ME, STI
TRF	TI
TRL	GDC, HSE, STI
TRM	GDC, HVS, HSE, STI
TRS	GDC, HSE, HVS, SSD, STI
TRSP	GDC, HSE, NVS, SSD, STI
TRW	TRW
TS	TI

Обозначение транзистора	Фирма
TSB	TC
TZ	SEC
U	IFC, II, NSC, MOT, SI, SDI, UC, WDI
UC	MOT. SDI
UMIL	ACR
UMT	UC
UPT	UC
UTV	ACR
V	SGS, UA
VAM	ACR
VCR	II, SI
VMIL	ACR
VMOB	ACR
VMP	SI
VN	II, SDI, SI, SUPERTEX
VNM	SDI
VNN	SDI
VNP	SDI
VP	SDI, SUPERTEX
VQ	SUPERTEX
VTV	ACR
W	WDI
WT	WEC
XGS	GSI
XGSA	GSI
XGSQ	GSI
XGSR	GSI
ZDT	FEL
ZT	FEL
ZTX	FEL
ZVN	FEL
2NU	TESLA
3NU	TESLA
4NU	TESLA
5NU	TESLA
6NU	TESLA
7NU	TESLA
101NU	TESLA
102NU	TESLA
103NU	TESLA
104NU	TESLA
105NU	TESLA
106NU	TESLA
107NU	TESLA
152NU	TESLA
153NU	TESLA
154NU	TESLA
155NU	TESLA
156NU	TESLA
2T	ПП

5.5. Зарубежные транзисторы и их отечественные аналоги

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
101NU70	МП35
102NU70	МП35
103NU70	МП37
104NU70	МП36А
105NU70	МП36А
106NU70	МП36А
106NU70	МП37А
107NU70	МП36А, МП38А
152NU70	МП36А, МП38
153NU70	МП36А
154NU70	МП38
27AM05	2Т9121Б
2N1024	КТ104Б
2N1027	КТ104Б
2N1028	КТ104А
2N1036	2Т214А9
2N104	МП40А
2N105	ГТ109Б
2N1051	КТ601А
2N107	ГТ115А
2N109	МП20Б
2N1175	МП20Б
2N1204	КТ312Г
2N1204A	КТ312Г
2N1218	ГТ705Г
2N1219	КТ104Г
2N1220	КТ104А
2N1221	КТ104Г
2N1222	КТ104А
2N1223	КТ104А
2N123	МП42Б
2N128	ГТ310Д
2N1292	ГТ305В
2N130	МГТ108А
2N1300	ГТ308А
2N1301	ГТ308А
2N1303	МП20А
2N130A	ГТ108А
2N131	МГТ108Б
2N131A	МГТ108Б
2N132	МГТ108В
2N1321	ГТ705В
2N1329	ГТ705В
2N132A	МГТ108В
2N133	МГТ108Б
2N1353	МП42А
2N1354	МП42Б
2N1366	ГТ122В
2N1384	ГТ321Е, ГТ321Г
2N1384	ГТ321Д
2N1387	КТ301Б
2N139	ГТ109Е
2N1390	КТ301Д
2N1413	МП39Б, МП20А
2N1414	МП39Б, МП20А
2N1415	МП39Б, МП20А
2N1420	КТ630Е
2N1494A	ГТ321Г
2N1499A	ГТ305А

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2N1499B	ГТ305Б
2N1500	ГТ305Г
2N1507	КТ630Е
2N1524	П422
2N1526	П422
2N1564	КТ601А
2N1565	КТ601А
2N1566	П307Б, КТ602Г
2N1566A	КТ602Б
2N1572	П309
2N1573	П308, 2Т215А1
2N1574	П308
2N1585	ГТ311Ж
2N1613	КТ630Г
2N1643	КТ104А
2N1655	2Т214Б9
2N1671	КТ119А
2N1681	МП42Б
2N1683	ГТ308Б
2N1700	КТ801Б
2N1701	П702
2N1702	КТ803А
2N1711	КТ603 (Е, Г)
2N1714	П701А
2N1716	П701А
2N1726	П417А
2N1727	П417
2N1728	П417А
2N1742	ГТ313Б
2N1743	ГТ313А
2N1745	ГТ305Б
2N1746	П417
2N1747	П417
2N1748	ГТ305В
2N175	П27
2N1752	П417
2N1754	ГТ305А
2N1777	КТ665Б9
2N178	П216Б
2N1785	П417А
2N1786	П417
2N1787	П417
2N1838	КТ617А
2N1839	КТ617А
2N1840	КТ617А
2N1854	ГТ308Б
2N1864	П417
2N1865	П417Б
2N186A	МП25Б, МП20А
2N1889	КТ630Г
2N189	МП25А
2N1890	КТ630Б
2N1893	КТ630А
2N190	МП25А
2N1902	КТ926А
2N1904	КТ926Б
2N191	МП25Б
2N1923	2Т215Б1
2N1924	МП21Г

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2N1925	МП21Г
2N1926	МП21Д
2N193	МП38
2N1958	КТ608А
2N1959	КТ608Б
2N2020	КТ3117А
2N2048	ГТ308Б, 1Т308В
2N2048A	ГТ308Б
2N206	МГТ108А
2N207	МГТ108Г
2N207A	МГТ108Г
2N207B	МГТ108Г
2N2089	П403, П416А
2N2102	КТ630А
2N2102A	КТ630А
2N2121	КТ3117А
2N2121A	КТ3117Б
2N2137	ГТ701А
2N2138A	ГТ701А
2N2142A	ГТ701А
2N2143	ГТ701А
2N2147	ГТ905А
2N2148	ГТ905Б
2N215	МП40А
2N218	ГТ109Е
2N2192	КТ630Е
2N2192A	КТ630Е
2N2193	КТ630Г
2N2193A	КТ630Г
2N2194	КТ630Д
2N2194A	КТ630Д
2N2195	КТ630Д
2N2199	ГТ305А
2N220	П27А
2N2200	ГТ305Б
2N2217	КТ928А
2N2218	КТ928Б
2N2218A	КТ928Б
2N2219	КТ928Б
2N2219A	КТ928Б
2N2221	КТ3117А
2N2221A	КТ3117А
2N2222	КТ3117А
2N2222	КТ3117Б
2N2224	КТ608Б
2N2236	КТ617А
2N2237	КТ608Б
2N2237	КТ603Б
2N2242	КТ340В
2N2243	КТ630А
2N2243A	КТ630А
2N2246	КТ3151Е9
2N2270	КТ630Д
2N2273	ГТ305Б
2N2274	КТ203Б
2N2275	КТ203Б
2N2276	КТ203В
2N2277	КТ203В
2N2297	КТ630Г

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2N233A	ГТ122Б
2N2360	ГТ376А
2N2361	ГТ376А
2N2368	КТ633Б
2N2369	КТ633А, КТ3142А
2N237	МП40А
2N2372	КТ203В
2N2373	КТ203В
2N2400	ГТ308Б
2N2405	КТ630Б
2N2410	КТ928А
2N2411	КТ352А
2N2412	КТ352А
2N2415	ГТ376А
2N2416	ГТ376А
2N2428	МП41А
2N2432	КТ201Б
2N2432A	КТ201Б
2N2475	КТ316Б
2N2482	ГТ311И
2N2483	КТ3102Б
2N2484	КТ3102Д
2N2537	КТ928Б
2N2538	КТ928Б
2N2539	КТ3117А
2N2615	КТ325А
2N2616	КТ325Б
2N2617	КТ201А
2N2635	ГТ320В
2N2646	КТ132А
2N2647	КТ117Б, КТ132Б
2N265	МГТ108Г
2N2659	П214А
2N2660	П215
2N2661	П215
2N2665	П214А
2N2666	П214А
2N2667	П215
2N2696	КТ351А
2N2708	КТ325Б
2N2711	КТ315Т
2N2712	КТ315Б
2N2725	КТ635Б
2N2727	КТ504Б
2N273	МП39А
2N2784	КТ316Б
2N2811	КТ908Б
2N2813	КТ908А
2N283	МП40А
2N2835	П213
2N2836	ГТ703Д
2N2844	КПС104Б
2N2857	КТ399А
2N2868	КТ630Д
2N2890	КТ801А
2N2891	КТ801А
2N2894	КТ347Б
2N2904AL	КТ620Б
2N2905A	КТ662А
2N2906	КТ313А
2N2906A	КТ313А
2N2907	КТ313Б

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2N2907A	КТ313Б, КТ661А
2N2932	КТ201ГМ
2N2933	КТ201ДМ
2N2947	КТ903А
2N2948	КТ903А
2N2958	КТ608Б
2N2987	КТ630Г
2N2988	КТ630В
2N2989	КТ630Г
2N2990	КТ630В
2N2999	ГТ341В
2N3010	КТ316Б
2N3012	КТ347Б
2N3015	КТ928А
2N3019	КТ630В
2N3020	КТ630В
2N3033	КТ3122А
2N3053	КТ608Б
2N3053	КТ630Д
2N3054	КТ805Б
2N3054A	КТ803А
2N3055	КТ819ГМ, КТ8150А
2N3055E	КТ819ГМ
2N3107	КТ630Б
2N3108	КТ630Г
2N3109	КТ630Б
2N3110	КТ630Г
2N3114	КТ611Г
2N3121	КТ315А
2N3127	ГТ328А, ГТ376А
2N3204	КТ836А, 2Т836А
2N3209	КТ347А
2N3210	КТ616Б
2N3237	КТ729А
2N3240	КТ730А
2N3245	КТ629А2, 2Т629А2
2N3248	КТ351А
2N3249	КТ345Б
2N3250	КТ3108А, КТ313Б
2N3250A	КТ313Б, КТ3108В
2N3251	КТ3108Б
2N326	ГТ705В
2N3267	ГТ376А
2N3279	ГТ328А
2N3280	ГТ328А
2N3281	ГТ328Б
2N3282	ГТ328В
2N3283	ГТ328А
2N3284	ГТ328В
2N3286	ГТ328Б
2N3299	КТ608Б
2N3301	КТ3117А
2N3302	КТ3117А
2N3303	КТ624А2, 2Т624А2
2N3304	КТ337А
2N331	МП39Б
2N3329	КП103Е, 2П103А
2N3375	КТ904А
2N3390	КТ373В
2N3391	КТ373В
2N3392	КТ373А
2N3393	КТ373А

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2N3394	КТ373Г
2N3397	КТ315Е
2N3399	ГТ346Б
2N3439	КТ504А
2N3440	КТ504Б
2N3440S	КТ940А
2N3441	КТ802А
2N3442	КТ945А
2N3451	КТ337А
2N3467	КТ629Б2. 2Т629Б2
2N3495	КТ632Б, 2Т632А
2N3497	2Т632А
2N3506	КТ8168В
2N3507	КТ8168Б
2N3511	КТ384А2, 2Т384А2
2N3545	КТ343Б
2N3546	КТ363А
2N3565	КТ201АМ
2N3570	КТ399А
2N3571	КТ399А
2N3572	КТ399А
2N3576	КТ347А
2N3583	КТ704В
2N3584	КТ809А
2N3585	КТ704Б
2N3585	КТ704А
2N3600	КТ368А
2N3605	КТ375Б
2N3606	КТ375Б
2N3607	КТ375Б
2N3611	ГТ701А
2N3613	ГТ701А
2N3638	КТ686Г
2N3638A	КТ686Ж
2N3671	КТ620А
2N368	МП40А
2N369	МП41А
2N3702	КТ345Б
2N3703	КТ685Е
2N3709	КТ358А, КТ373А
2N3710	КТ358В. КТ373А
2N3711	КТ3102В
2N3712	КТ611Г
2N3717	КТ692А
2N3719	КТ8167В
2N3720	КТ8167Д
2N3722	КТ608Б
2N3724	КТ608Б
2N3725	КТ635Б, КТ659А
2N3730	ГТ810А
2N3732	ГТ905А
2N3733	КТ907А
2N3737	КТ659А
2N3738	КТ809А
2N3739	КТ809А
2N3740	КТ932Б
2N3741	КТ932А
2N3742	КТ604Б
2N3766	КТ805Б
2N3767	КТ805Б
2N3771	КТ729А
2N3772	КТ729Б

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2N3773	КТ730А
2N3821	КП303Т, КП329Б
2N3822	КП303И
2N3823	КП303А, КП329Д
2N3824	КП302БМ
2N3839	КТ399А, КТ396А2, 2Т396А2
2N3866	КТ939А
2N3878	КТ908А
2N3879	КТ908А
2N3880	КТ399А
2N3883	ГТ320Б
2N3903	КТ375А
2N3904	КТ375 (А, Б)
2N3905	КТ361Г, КТ361В2
2N3906	КТ361Г, КТ361Г2
2N3953	КТ3123А2
2N3964	КТ3107Л
2N3971	КП302А, КП302АМ
2N3972	КП302ВМ
2N3974	КТ3172А9
2N4030	КТ933Б
2N4031	КТ933А
2N4034	КТ326Б
2N4034	КТ347А
2N4036	КТ933А
2N4037	КТ933Б
2N4038	КП301Б
2N404	МП42Б
2N4046	КТ608Б
2N405	МП39А
2N4058	КТ3193Б
2N406	МП39А
2N4077	ГТ705Д
2N4092	КП905А
2N4093	КП302Г
2N4123	КТ3102А
2N4124	КТ3102Д
2N4125	КТ361Б, КТ361А3
2N4126	КТ3107Ж, КТ361А2, КТ313В1
2N4127	КТ922Г
2N4128	КТ922Д
2N4130	2Т875Б
2N4138	КТ201Б
2N4207	КТ337Б
2N4208	КТ337Б
2N4209	КТ363А,
2N4220	КП307Б
2N4223	КП305Д, КП307Б
2N4224	КП305Е, КП307В, 2П305Б
2N4231	П702
2N4232	П702
2N4233	П702
2N4234	КТ830А, КТ692А
2N4235	КТ830Б
2N4236	КТ830В, КТ830Г
2N4237	КТ801А
2N4238	КТ801Б
2N4239	КТ801А
2N4240	КТ704 (А, Б)
2N4254	КТ316АМ
2N4255	КТ316ГМ

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2N4258A	КТ363АМ
2N4260	КТ363А
2N4261	КТ363Б
2N4268	КП304А
2N4271	2Т653А
2N4291	КТ684Б
2N43	МП25Б
2N4300	КТ8168А, КТ831А, 2Т831А
2N4301	КТ908А
2N4314	КТ933А
2N4360	КП103МР1
2N438	ГТ122А
2N4391	2П914А
2N4393	КП302ГМ, КП333А, 2П333А
2N44	МП25Б
2N4400	КТ645А
2N4401	КТ385А2
2N4411	КТ3126А, КТ3127А
2N4416	КП323А2, 2П312Б
2N4429	КТ911Б
2N4430	КТ913А
2N4431	КТ913Б
2N444	МП35
2N4440	КТ907Б
2N444A	МП35
2N445	МП38
2N445A	МП37
2N44A	МП40А
2N45	МП40А
2N456	П210В
2N457	П210Б
2N458	П210Б
2N45A	МП40А
2N4870	КТ133А
2N4871	КТ133Б
2N4889	КТ686Ж
2N4891	КТ117Б
2N4893	КТ117В
2N4898	КТ932В
2N4898	КТ932В
2N4899	КТ932Б
2N4900	КТ932А
2N4910	П702А
2N4911	П702
2N4912	П702
2N4913	КТ808А
2N4914	КТ808А
2N4915	КТ808А
2N4923	КТ807БМ
2N4924	КТ611Г
2N4925	КТ611Г
2N4926	КТ604Б
2N4927	КТ604Б
2N4933	КТ927А
2N4960	КТ928Б, КТ635А
2N4964	КТ3193Б
2N497	КТ630Д
2N4976	КТ911А
2N498	КТ630Г
2N499A	ГТ305А, 1Т305А
2N501	ГТ305А
2N502A	ГТ313А

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2N502B	ГТ313А
2N503	ГТ310Б
2N5031	КТ399А
2N5032	КТ399А
2N5043	ГТ329Б
2N5044	ГТ329А
2N5050	КТ802А
2N5051	КТ802А
2N5052	КТ802А
2N5056	КТ347Б
2N506	ГТ115Б
2N5067	КТ803А
2N5068	КТ803А
2N5069	КТ803А
2N5070	КТ912А
2N5090	КТ606А
2N5104	КП329А
2N5146	КТС622А
2N5149	2Т880В
2N5150	2Т881Б
2N5161	КТ914А
2N5177	КТ909А
2N5178	КТ909Б
2N5179	КТ399А
2N5188	КТ603Б
2N5190	КТ817А
2N5191	КТ817В
2N5192	КТ817Г
2N5193	КТ816А, КТ818А
2N5194	КТ816В, КТ818В
2N5195	КТ816Г, КТ818Г
2N5196	КПС104В
2N5202	КТ908А
2N5209	КТ3102Д
2N5210	КТ3102Е
2N5219	КТ375Б
2N5221	КТ351А
2N5223	КТ375Б
2N5226	КТ350А
2N5228	КТ357А
2N5236	КТ3122Б
2N5239	КТ812Б
2N5240	КТ812А
2N5270	КТ3122А
2N5313	КТ908А
2N5315	КТ908А
2N5317	КТ908А
2N5319	КТ908А
2N5320	КТ8168Г
2N5321	КТ8168Д, 2Т881Г
2N5333	КТ8167Г
2N5334	КТ685Е
2N5354	КТ351А
2N5356	КТ685Ж, 2Т685Ж
2N535A	ГТ115В
2N535B	ГТ115В
2N536	ГТ115Г
2N5365	КТ351А
2N5366	КТ351Б
2N5373	КТ686А
2N5394	КП307А
2N5397	КП302Б

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2N5400	КТ6116Б, КТ6138Д
2N5401	КТ6116А
2N5401	КТ6138Г
2N5427	КТ808А
2N5427	КТ808ГМ
2N5429	КТ808А
2N5447	КТ345Б
2N5452	КПС104А
2N5456	КТ389Б2, 2Т389Б2
2N5468	2Т809А
2N5481	КТ911А
2N5483	КТ919В
2N5490	КТ819Б
2N5492	КТ819В
2N5494	КТ819В
2N5496	КТ819Г
2N554	П216В
2N5540	КТ854А
2N555	П216В
2N5550	КТ6117Б. КТ6139Д
2N5551	КТ6117А. КТ61395
2N5556	КП303Б
2N5589	КТ934Г. КТ920А
2N5590	КТ934Д
2N5591	КТ920В
2N5596	КТ916А, КТ919А
2N560	П307В
2N5621	2Т876Б
2N5625	2Т876В
2N5626	2Т875А
2N5641	КТ922А
2N5642	КТ922Б
2N5643	КТ922В
2N5650	2Т3114В6
2N5652	КТ372В
2N5653	2Т504Б
2N5672	КТ874А, 2Т974Б
2N5675	КТ8167А
2N5681	КТ630Г
2N5682	КТ630А
2N5707	КТ921А
2N5709	КТ936А
2N5719	КТ929А
2N5764	КТ913А
2N5765	КТ913Б
2N5768	КТ919Б
2N5769	КТ3142А
2N5770	КТ325ВМ
2N5771	КТ363АМ
2N5781	КТ830А, 2Т830А
2N5805	КТ840В
2N581	МП42А
2N5838	КТ840Б
2N5839	КТ840Б
2N5840	КТ840А
2N5842	КТ355А
2N5845	КТ645А
2N5851	КТ355А
2N5852	КТ355А
2N5867	КТ818ВМ
2N5887	ГТ701А, П216
2N5888	ГТ701А, П216

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2N5889	ГТ701А, П216
2N5890	ГТ701А, П216Г
2N5891	ГТ701А, П217
2N59	МП20А
2N591	ГТ115Г
2N5995	КТ920Г
2N5996	КТ920Г
2N59А	МП20А
2N59В	МП21Д
2N59С	МП21Д
2N60	МП20Б
2N6011	КТ825Б
2N6013	КТ685Д
2N6015	КТ685А, 2Т685А
2N602	П416
2N603	П416
2N6034	КТ8130А, КТ8219А
2N6035	КТ8130Б
2N6036	КТ8130В
2N6037	КТ8131А
2N6038	КТ8131Б
2N6039	КТ8131В
2N604	П416А
2N6047	КТ947А
2N6050	КТ825Д
2N6051	КТ825Г
2N6052	КТ825Г
2N6057	КТ827В
2N6058	КТ827Б
2N6059	КТ827А
2N6077	КТ812Б
2N6078	КТ812Б
2N6079	КТ812А
2N6080	КТ920Б
2N6081	КТ920Г
2N6093	КТ912Б, КТ927Б
2N6099	КТ819В
2N60А	МП21В
2N60В	МП21Д
2N60С	МП21Г
2N61	МП20А
2N6101	КТ819Г
2N6106	КТ837Б
2N6107	КТ818Г
2N6108	КТ837Д
2N6110	КТ837К
2N6111	КТ818А
2N6121	КТ817А
2N6122	КТ817В
2N6123	КТ817Г
2N6124	КТ837Ф
2N6125	КТ837С
2N6126	КТ837Н
2N6129	КТ819Б
2N6130	КТ819В, 2Т819А2
2N6131	КТ819Г
2N6132	КТ818Б, КТ837Ж
2N6133	КТ818В
2N6134	КТ818Г
2N6135	КТ610А
2N6178	КТ943Д
2N6179	КТ943Б

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2N6180	КТ932А
2N6181	КТ932А
2N61А	МП20В
2N61В	МП21Д
2N61С	МП21Г
2N6202	КТ934А
2N6203	КТ934Б
2N6204	КТ934В
2N6208	КТ916Б
2N6216	КТ684А
2N6246	КТ818ВМ
2N6247	КТ818ГМ
2N6248	КТ818ГМ
2N6253	КТ819БМ
2N6260	КТ805Б
2N6263	КТ802А
2N6264	КТ802А
2N6266	КТ919В
2N6278	КТ879Б
2N6279	КТ879А
2N6282	КТ827В
2N6283	КТ827Б
2N6284	КТ827А
2N6285	КТ825Д, 2Т825В, 2Т877Б
2N6286	КТ825Г, 2Т825Б, 2Т877А
2N6287	КТ825Г, 2Т825А
2N6288	КТ819А
2N6289	КТ819А
2N6290	КТ819В
2N6291	КТ819В
2N6292	КТ819Г
2N6293	КТ819Г
2N6303	КТ8167Б
2N6304	КТ399А
2N6305	КТ399А
2N6310	КТ818В
2N6341	КТ867А
2N6362	КТ930А
2N6364	КТ930Б
2N6369	КТ931А
2N6371	КТ819БМ
2N6372	КТ808ГМ
2N6373	КТ808ГМ
2N6374	КТ808БМ
2N6427	КТ517В
2N6448	КТ684А
2N6469	КТ818БМ
2N6470	КТ819БМ
2N6471	КТ819ВМ
2N6472	КТ819ГМ
2N6477	КТ8123А. КТ850В
2N6499	КТ8110А
2N65	МП20А
2N6515	КТ6139В
2N653	МП20А
2N654	МП20А
2N6542	КТ840Б
2N6543	КТ840А
2N6546	КТ878Б
2N655	МП20Б
2N6553	2Т9117А
2N656	КТ630Д

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2N6560	КТ841А, 2Т862А
2N657	КТ630Г
2N6575	КТ8146А
2N6617	КТ3132А
2N6658	2П912Б
2N6669	КТ863А, КТ997А, 2Т863А
2N6672	КТ847А, 2Т862Б
2N6678	КТ847А, КТ878В, 2Т878Б
2N6730	2Т880Б
2N6755	2П912Б
2N6764	КП747А
2N6766	КП250
2N6767	КП717В
2N6768	КП717Б
2N6769	КП717А
2N6770	КП450
2N6772	КТ8175Б1
2N6773	КТ8175А1
2N6928	КТ8120А
2N6929	КТ8138Ж
2N6930	КТ8138И
2N6931	КТ8117Б
2N6932	КТ856Б1
2N696	КТ630Д
2N697	КТ630Д
2N698	КТ630А
2N699	КТ630А
2N700	ГТ313Б, ГТ376А
2N700A	ГТ376А
2N702	КТ312А
2N703	КТ312В
2N705	ГТ320В
2N706A	КТ340В
2N708	КТ340В
2N709	КТ316Б
2N709A	КТ316Б
2N710	ГТ320В
2N711	ГТ320В
2N711A	ГТ320Б
2N711Б	ГТ320Б
2N7200LT1	КП214А9
2N726	КТ349А
2N727	КТ349Б
2N728	КТ312В
2N729	КТ312Б
2N734	П307, КТ601А
2N735	П307А, КТ601А
2N735	КТ601А, П307А
2N738	П309
2N739	П308
2N741	ГТ313В
2N741A	ГТ313А
2N743	КТ340В
2N744	КТ340В
2N753	КТ340Б
2N754	П307В
2N755	П308
2N77	ГТ109Б
2N780	КТ312Б
2N784A	КТ340В
2N795	ГТ308А
2N796	ГТ308Б

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2N797	ГТ311И
2N797	ГТ308А
2N834	КТ340В
2N835	КТ340В
2N842	КТ301Д
2N843	КТ301 (В, Ж)
2N844	П307В, КТ601А
2N845	П308, КТ601А
2N869	КТ352А
2N869A	КТ347А
2N914	КТ616Б
2N915	КТ342Г
2N916	КТ342А
2N917	КТ368Б
2N918	КТ368А
2N919	КТ340В
2N920	КТ340В
2N923	КТ203Б
2N924	КТ203Б
2N929	КТ342А
2N930	КТ342А
2N94	МП38
2N943	КТ203Б
2N944	КТ203Б
2N955	ГТ311И
2N955A	ГТ311И
2N978	КТ350А
2N979	ГТ305А
2N980	ГТ305А
2N987	ГТ322Б
2N990	ГТ322В
2N991	ГТ322В
2N993	ГТ322В
2N995	КТ352А
2N996	КТ352А
2NL234B	КП902Б
2NU72	ГТ403Б
2NU73	ГТ703Б
2NU74	ГТ701А, П210А
2S2466	П201АЭ
2S3640	КТ3126Б
2S564	КТ686Г
2SA1009	КТ851Б
2SA101	ГТ322В
2SA1015	КТ3107Б
2SA1016F	КТ6138Д
2SA102	ГТ322В
2SA1021	КТ722А
2SA1029B	КТ3107Г
2SA1029C	КТ3107Д
2SA1029D	КТ3107И
2SA103	ГТ322В
2SA1030	КТ668В, КТ3193А
2SA1030B	КТ668Б
2SA1030B	КТ3107Б, КТ668В
2SA1030C	КТ3107Д, КТ668В
2SA1031B	КТ3107Г
2SA1031C	КТ3107Ж
2SA1031D	КТ3107Ж
2SA1032	КТ668А
2SA1033B	КТ3107Г
2SA1033C	КТ3107Д

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2SA1033D	КТ3107К
2SA104	ГТ322Б
2SA105	ГТ310Е
2SA1052B	КТ3129Б9
2SA1052C	КТ3129Г9
2SA1052D	КТ3129Г9
2SA106	ГТ310Е
2SA107	ГТ310Д
2SA1073	КТ865А
2SA108	П422
2SA109	П422
2SA1090	КТ313Б, КТ3193А
2SA1091	КТ6138А
2SA110	П422
2SA1106	КТ8101Б
2SA111	П422
2SA112	П422
2SA116	ГТ310В
2SA1160A	КТ686Д
2SA1160B	КТ686Е
2SA117	ГТ310Д
2SA118	ГТ310Д
2SA1180	КТ865А
2SA1213	КТ511Е9
2SA1214	КТ511Ж9
2SA1224	2Т691А2
2SA1274	КТ684В
2SA1320	КТ3157А
2SA1356	КТ626Г, КТ626Д
2SA1356	КТ626А
2SA1376	КТ6138В
2SA1416R	КТ511В9
2SA1515	КТ686Б
2SA1544	КТ6138Б
2SA1584	КТ9144А9
2SA173	ГТ125Б
2SA174	ГТ125Б
2SA195	ГТ124А
2SA204	ГТ125Б
2SA205	ГТ125Д
2SA206	ГТ125Б
2SA211	ГТ125А
2SA212	ГТ125А
2SA219	ГТ322В
2SA221	ГТ322Б
2SA223	ГТ322В
2SA229	ГТ313А
2SA230	ГТ313А
2SA234	ГТ309Б
2SA235	ГТ309Б
2SA236	ГТ322В
2SA237	ГТ322В
2SA246	ГТ305В
2SA254	ГТ109Е
2SA255	ГТ109Д
2SA256	ГТ322Б
2SA257	ГТ322В
2SA2570	КТ6142Б
2SA258	ГТ322В
2SA259	ГТ322В
2SA260	ГТ310А
2SA266	ГТ309Г

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2SA267	ГТ309Г
2SA268	ГТ309Д
2SA269	ГТ303Д
2SA270	ГТ309Г
2SA271	ГТ309Г
2SA272	ГТ309А
2SA277	ГТ124В
2SA279	П416Б, ГТ305Б
2SA282	ГТ125 (В, Г)
2SA285	ГТ322Б
2SA286	ГТ322Б
2SA287	ГТ322Б
2SA312	ГТ321Д
2SA321	ГТ322В
2SA322	ГТ322В
2SA3355	КТ6142А
2SA338	ГТ322В
2SA339	ГТ322Б
2SA340	ГТ322Б
2SA341	ГТ322Б
2SA342	ГТ322Б
2SA343	ГТ309Б
2SA350	П422
2SA351	П422
2SA352	П422
2SA354	П422
2SA355	П422
2SA374	П609А
2SA391	ГТ125В
2SA396	ГТ125Г
2SA40	ГТ124Б
2SA400	ГТ309Г
2SA412	ГТ308Б
2SA414	ГТ125Б
2SA416	П606А
2SA422	ГТ346Б
2SA440	ГТ313А
2SA467	КТ351Б
2SA479	ГТ331А
2SA49	ГТ109Е
2SA490	КТ816Б
2SA494G	КТ349В
2SA495	КТ357Г
2SA495G	КТ357Г
2SA496	КТ639Б
2SA50	П30
2SA500	КТ352А
2SA504	КТ933А
2SA505	КТ639Д
2SA52	ГТ109Е
2SA522	КТ326Б
2SA53	ГТ109Д
2SA530	КТ313Б
2SA537	КТ933Б
2SA550	КТ3193Д
2SA555	КТ361Е, КТ361Е2
2SA556	КТ361Е
2SA559	КТ352А
2SA564	КТ3107Д
2SA564A	КТ3107И
2SA568	КТ345В
2SA58	ГТ322Б
2SA60	ГТ322Б
2SA603	КТ313Б
2SA628	КТ357Г
2SA640	КТ3107 (К, И)
2SA641	КТ3107Л
2SA65	ГТ125В
2SA670	КТ816В
2SA671	КТ816Б
2SA673	КТ350А
2SA69	ГТ309Е
2SA70	ГТ309Е
2SA71	ГТ309Е
2SA715B	КТ639И
2SA715B	КТ639В
2SA715C	КТ639В
2SA715D	КТ639В
2SA718	КТ313Б
2SA72	ГТ322В
2SA73	ГТ322В
2SA733	КТ3107И
2SA738B	КТ639В
2SA738C	КТ639В
2SA738D	КТ639В
2SA740	КТ851В, 2Т851В
2SA741H	КТ352А
2SA743	КТ639Г
2SA743A	КТ639Ж
2SA743A	КТ639Г, КТ639Ж
2SA750	КТ3107К
2SA755A	КТ932Б
2SA755B	КТ932Б
2SA768	КТ816В
2SA769	КТ816Г
2SA779K	КТ639В
2SA78	ГТ321Д
2SA78	ГТ321В
2SA780AK	КТ639Д
2SA781K	КТ345Б
2SA794	КТ9115Б
2SA811C5	КТ3129Б9
2SA811C6	КТ3129Г9
2SA812M4	КТ3129Б9
2SA812M5	КТ3129Б9
2SA815	КТ814Г
2SA844C	КТ3107И
2SA844D	КТ3107И
2SA876H	КТ313Б
2SA891	КТ529А
2SA92	ГТ322Б
2SA93	ГТ322В
2SA952K	КТ6115Е, КТ686Е
2SA952L	КТ6115Д, КТ686Д
2SA952M	КТ6115Г
2SA962A	КТ639Д
2SA966Y	КТ686В
2SA967	КТ3123АМ
2SA983	КТ3109А
2SA999	КТ3107И
2SA999L	КТ3107И
2SB1016	КТ818Г
2SB1017	КТ818Г
2SB1018	КТ818Г
2SB1019	КТ818В
2SB110	ГТ124А
2SB111	ГТ124Б
2SB112	ГТ124В
2SB113	ГТ124В
2SB114	ГТ124Б
2SB115	ГТ124В
2SB116	ГТ124Г
2SB117	ГТ124Г
2SB12	ГТ124А
2SB120	МП41А
2SB1214	КТ8219Б
2SB1220Q	КТ3180А9
2SB1286	КТ852А
2SB13	ГТ124А
2SB130	П201АЭ
2SB1316A	КТ8219В1
2SB135	ГТ124В
2SB136	МП25А, МП20Б
2SB136A	МП25А, МП20Б
2SB1452Q	КТ8217Г1
2SB1474A	КТ8219Б1
2SB15	ГТ125А
2SB170	МП39А, МП40А
2SB171	МП40А
2SB172	МП20А, МП25Б
2SB173	МП39А
2SB175	МП41А
2SB176	МП25Б, МП20Б
2SB180A	П201АЭ
2SB181A	П202Э
2SB200	МП25Б, МП20А
2SB201	МП25Б, МП20А
2SB261	ГТ115А
2SB262	ГТ115В
2SB263	МП25Б
2SB302	ГТ109Е
2SB303	ГТ115Г
2SB32	МП39А
2SB33	МП41А
2SB335	МГТ108В
2SB336	МГТ108В
2SB361	ГТ806А
2SB362	ГТ806Б
2SB367	П201АЭ
2SB368	П201АЭ
2SB37	МП41А
2SB39	ГТ115А
2SB40	МП42Б
2SB400	МГТ108Г
2SB43	ГТ125В
2SB434	КТ837Р
2SB434G	КТ837Р
2SB435	КТ837У
2SB435G	КТ837Р
2SB435U	КТ816А2
2SB439	МП41А, МП39Б
2SB44	ГТ124В
2SB440	МП41А, МП39Б
2SB443A	МГТ108Г
2SB443B	МГТ108Г
2SB444A	МГТ108Г

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2SB444B	МГТ108Г
2SB448	П201АЭ
2SB456	П202Э
2SB467	П202Э
2SB468	ГТ810А
2SB47	МГТ108 (Д, Г)
2SB473	П201АЭ
2SB48	ГТ125Б
2SB481	П201АЭ
2SB49	ГТ125В
2SB497	МГТ108Б
2SB506A	КТ842А
2SB54	ГТ124Г
2SB546	КТ851В, 2Т851В
2SB546A	КТ851А
2SB55	ГТ125Г
2SB551H	КТ932Б
2SB553	КТ818В
2SB558	КТ818ГМ
2SB56	ГТ125Г
2SB57	МГТ108Б
2SB595	КТ816Г
2SB596	КТ816Г
2SB60	МП41А
2SB61	МП41А
2SB630A	КТ851А
2SB650H	КТ825Г
2SB678	2Т708А
2SB693H	КТ825Г
2SB709	КТ3129Д9
2SB709	КТ3129Д9
2SB709A	КТ3129Г9
2SB710	КТ3173А9
2SB75	ГТ125В
2SB750A	КТ852Б
2SB754	КТ818Б
2SB772	КТ9176А
2SB834	КТ835Б, КТ837В
2SB883	КТ8106Б
2SB90	ГТ109Г
2SB906	КТ835Б, КТ837В
2SB906	КТ835А
2SB97	ГТ109В
2SB970	КТ3171А9
2SB973A	КТ852В
2SB996	КТ816Г
2SC1000GTM	КТ3102Б
2SC1001	КТ925Г
2SC1008	КТ630Д
2SC1008A	КТ630Б
2SC1009A	КТ3151Д9
2SC101A	КТ902А
2SC1044	КТ355А
2SC105	КТ312Б
2SC1056	КТ605Б
2SC1080	КТ683А
2SC108A	КТ630Г
2SC1090	КТ372А
2SC109A	КТ928Б
2SC1111	КТ802А
2SC1112	КТ802А
2SC1113	КТ808А

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2SC1114	КТ812Б
2SC1115	2Т875Г
2SC11172B	КТ839А
2SC1141	КТ8154А
2SC1144	КТ8154Б
2SC1145	КТ809БМ
2SC1172	КТ839А
2SC1172A	КТ839А
2SC1173	КТ943А
2SC1188	КТ325БМ
2SC1215	КТ325АМ
2SC1236	КТ3101АМ, 2Т3101А2
2SC1254	КТ3106А2, 2Т3106А2
2SC1260	КТ399А
2SC1262	КТ939А
2SC1308	КТ841Г
2SC131	КТ616Б
2SC1317	КТ645А
2SC132	КТ616Б
2SC133	КТ616Б
2SC134	КТ616А
2SC135	КТ616А
2SC137	КТ616Б
2SC1395	КТ325ВМ
2SC1440	КТ945А
2SC1454	КТ812Б
2SC1504	КТ809А
2SC1515K	К1НТ661А
2SC151H	КТ603А
2SC1550	КТ940Б
2SC1566	КТ940Б
2SC1569	КТ940А
2SC1576	КТ812А, КТ828Б
2SC1617	КТ812Б
2SC1618	КТ808А
2SC1618	КТ808БМ
2SC1619	КТ808А
2SC1619A	КТ808А
2SC1619A	КТ808АМ
2SC1622D6	КТ3130Б9
2SC1622D7	КТ3130Б9
2SC1623L	КТ3130А9
2SC1624	КТ943В
2SC1625	КТ943В
2SC170	КТ306Д
2SC171	КТ306Д
2SC172	КТ306Д
2SC1789	КТ399АМ
2SC1805	КТ916А
2SC1815	КТ3102Б
2SC1826	КТ817Г2
2SC1826	КТ817Т
2SC1827	КТ817Г
2SC1828	КТ828А
2SC1846	КТ645А
2SC188	КТ617А
2SC1894	КТ839А
2SC1895	КТ839А
2SC1896	КТ839А
2SC1950	КТ640Б2
2SC2001K	КТ6144Е
2SC2001L	КТ6144Д

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2SC2036	КТ646А
2SC2042	КТ909В
2SC2068	КТ940А
2SC2121	КТ828А
2SC2122	КТ841А
2SC2137	КТ812А, КТ828Б
2SC2138	КТ812А
2SC216B	КТ850А
2SC2173	КТ909Г
2SC2188	КТ3126А9
2SC2231	КТ940В
2SC2231A	КТ940В
2SC2242	КТ940А
2SC2258	КТ940Б
2SC2270	КТ9157А
2SC2295	КТ3170А9
2SC2333	КТ8175А1
2SC2335	КТ8138А
2SC2351	КТ3168А9
2SC2368	КТ3123В2
2SC2369	КТ3123Б2
2SC2404	КТ3130Г9
2SC2405	КТ3130Г9
2SC2431	КТ945А
2SC2456	КТ940А
2SC247	КТ602Г
2SC2481	КТ683Б
2SC249	КТ602Б
2SC2516	КТ863Б
2SC253	КТ325А
2SC2562	КТ805АМ
2SC2611	КТ604БМ
2SC2688N	КТ9130А
2SC2790	КТ828А
2SC2790A	КТ828А
2SC2791	КТ828А
2SC2794	КТ943Б
2SC281	КТ312В
2SC282	КТ312В
2SC2873	КТ528В9
2SC3056	КТ8138Б
2SC3057	КТ8138Д
2SC306	КТ630Д
2SC3061	КТ886А1, 2Т886А
2SC307	КТ630Г
2SC308	КТ630Г
2SC309	КТ630А
2SC310	КТ630В
2SC3150	КТ8118А
2SC3217	КТ9155А
2SC3218	КТ9142А, КТ9155Б, 2Т9142А
2SC3257	КТ854А
2SC3277	КТ856Б1
2SC33	КТ312Б, КТ312Б1
2SC3306	КТ8117А
2SC3335	КТ940Б
2SC3356	КТ3198Е9
2SC3357	КТ6142А9
2SC3358	КТ3198Е
2SC3419	КТ646А
2SC3422	КТ805АМ

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2SC3422	КТ940В
2SC3423	КТ940В
2SC3424	КТ940Б
2SC3450	КТ856А1
2SC3459	КТ8127В1
2SC3480	КТ8127Б1
2SC3568M	КТ863В
2SC3607	КТ911Г
2SC3637	КТ886Б1
2SC3647	КТ512В9
2SC3660	КТ9152А
2SC366G	КТ645А
2SC367G	КТ645А
2SC3688	КТ8157А
2SC370	КТ375Б
2SC371	КТ375Б
2SC372	КТ375Б
2SC3801	КТ368БМ
2SC3812	КТ9151А
2SC3827	КТ368Б9
2SC3840	КТ8175Б
2SC390	КТ368А
2SC395A	КТ616А
2SC40	КТ316Г
2SC400	КТ306В
2SC4001	КТ9130А
2SC401	КТ358В
2SC402	КТ358В
2SC403	КТ358Б
2SC404	КТ358В
2SC408	2Т945Б
2SC41	КТ802А
2SC4106	КТ8138А, КТ8110Б
2SC4106L	КТ8110В
2SC4109	КТ8145Б
2SC42	КТ802А
2SC4242	КТ8138Б, КТ8110А
2SC43	КТ802А
2SC44	КТ803А
2SC4468	КТ8218Б1
2SC4542	КТ8138В
2SC454B	КТ3102В, КТ342АМ
2SC454C	КТ3102В
2SC454D	КТ3102В
2SC458	КТ3102В
2SC458KB	КТ3102В
2SC458KC	КТ3102В
2SC458KD	КТ3102В
2SC458LGB	КТ3102Д
2SC458LGC	КТ3102Д
2SC458LGD	КТ3102Д
2SC4756	КТ8121Б
2SC481	КТ630Д
2SC482	КТ617А
2SC493	КТ803А
2SC495	КТ646А
2SC497	КТ630Б
2SC498	КТ630Б
2SC503	КТ630Г
2SC504	КТ630Г
2SC505	КТ618А
2SC506	КТ611Б

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2SC507	КТ611Г
2SC508	КТ802А
2SC510	КТ630В
2SC512	КТ630Г
2SC517	КТ903А
2SC519A	КТ802А, КТ945А
2SC520A	КТ802А
2SC521A	КТ803А
2SC525	П701А
2SC538	КТ3102Г
2SC538A	КТ3102Б
2SC543	КТ907Б
2SC549	КТ904Б
2SC553	КТ907Б
2SC563	КТ339Г
2SC583	КТ368Б
2SC589	КТ638А, 2Т638А
2SC594	КТ608А
2SC598	КТ904А
2SC601	КТ306Б
2SC612	КТ325В
2SC618	КТ325А
2SC620	КТ375А
2SC633	КТ315Б
2SC634	КТ315Г
2SC635	КТ904Б
2SC64	КТ601А
2SC641	КТ315Г
2SC642	КТ904А
2SC65	КТ611В
2SC66	КТ611Г
2SC67	КТ340В
2SC68	КТ340В
2SC712	КТ375Б
2SC727	П307Б
2SC752GTM	КТ645А
2SC779	КТ809А
2SC784	2Т397А2
2SC788	КТ618А
2SC790	КТ817Б
2SC793	КТ803А
2SC796	КТ603А
2SC809	КТ325В
2SC815	КТ645А
2SC825	КТ809А
2SC828	КТ3102В
2SC828A	КТ3102Б
2SC829	КТ358Б
2SC893	П701А
2SC900	КТ3102Г
2SC923	КТ3102Г
2SC923K	КТ3102ЕМ
2SC945	КТ3102Д
2SC959S	КТ630Б
2SC976	КТ911Г
2SC977	КТ913А
2SC978	КТ913Б
2SD1111	КТ517Е
2SD1174	КТ8129А
2SD127	ГТ404Б
2SD127	ГТ404Е
2SD1279	КТ839А

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2SD128	ГТ404И
2SD1287	КТ8105А, 2Т8105А
2SD128A	ГТ404И
2SD1308	КТ939Б
2SD1348	КТ9181Б
2SD1354	КТ817В
2SD1356	КТ817Г
2SD1406	КТ817В
2SD1408	КТ817Г
2SD146	П702А
2SD147	П702
2SD148	П702
2SD1513K	КТ6114Е
2SD1513L	КТ6114Д
2SD1577F1	КТ8127А1
2SD1624	КТ528В9
2SD1627	КТ512Е9
2SD1742	КТ3171А9
2SD195	МП38А
2SD201	КТ808А
2SD202	КТ808А
2SD203	КТ808А
2SD2200Q	КТ8218Г1
2SD234	КТ817А
2SD235	КТ817Б
2SD292	КТ817В
2SD31	МП35
2SD312	КТ826Б
2SD312	КТ826Б
2SD32	МП38А
2SD33	МП38А
2SD350	КТ8157А
2SD37	МП37А
2SD372	КТ8143И, КТ8143С
2SD373	КТ8143Л, КТ8143Р
2SD374	КТ8143М
2SD380	КТ839А
2SD414	КТ683В
2SD415	КТ683Д
2SD418	КТ841Д
2SD467D	КТ660В
2SD47	КТ908А
2SD526	КТ817Г
2SD536	КТ864А
2SD601	КТ3130Ж9
2SD601	КТ3130В9
2SD601A	КТ3130Б9
2SD602	КТ3176А9
2SD605	КТ834А
2SD610	КТ850А
2SD621	КТ710А, КТ715А
2SD630	КТ729А
2SD640	КТ828Б, КТ828Г
2SD668	КТ611БМ, КТ602АМ
2SD668A	КТ611БМ
2SD675A	КТ945А
2SD68	КТ902А
2SD685	КТ834А
2SD686	КТ829А
2SD691	КТ829А
2SD692	КТ829А
2SD716	КТ819ГМ

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
2SD72	ГТ404И
2SD75	МП38, МП36А
2SD75A	МП37А, МП36А
2SD814	КТ3179А9
2SD820	КТ839А
2SD821	КТ839А
2SD822	КТ839А
2SD838	КТ710А
2SD841	КТ859А
2SD843	КТ819ГМ
2SD867	КТ808АМ
2SD877	КТ802А
2SD880	КТ817В
2SD880	КТ817Б2
2SD882	КТ9177А
2SD995	КТ715А
2SK1057	КП727Г
2SK1087	КП727Д
2SK123	АП324А2
2SK124	АП324В2
2SK133	КП801Г
2SK134	КП801В
2SK1409	КП937А
2SK1616	АП343А1-2
2SK215	КП802А
2SK2498A	КП775А
2SK2498B	КП775Б
2SK28	КП722А
2SK298	КП707А
2SK313	КП717А
2SK316	КП323Б2, КП341А
2SK506	КП341Б
2SK60	КП801А
2SK700	КП727Е
2SK757	КП704А
2SK76A	КП801Б
2T3531	П308, КТ602А
2T3532	П308, КТ602А
2T3674	КТ355А
2T3841	КТ343А
3N105	КТ118А
3N106	КТ118Б
3N107	КТ118В
3N140	КП350А
3N169	КП908А
3N225	КП310А
3N74	КТ118А
3NU72	ГТ403Б
3NU73	ГТ703Г
3NU74	ГТ701А, П201А
40675	КТ912Б
4NU72	ГТ403Б
4NU73	ГТ703Д
4NU74	ГТ701А, П210А
5NU72	ГТ403Е
5NU73	П213
5W74	ГТ701А, П210А
6NU73	П215
6NU74	П210Б, ГТ701А
714U74	П210Б, ГТ701А
7NU73	П215
A50-12	КТ981А

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
A70-28	2Т964А, 2Т950А
AC116	МП25А
AC117	ГТ402И
AC121	МП20А
AC122	ГТ115Г
AC124	ГТ403И
AC125	МП20Б
AC126	МП20Б
AC127	ГТ404Б
AC128	ГТ402И
AC132	МП20Б, ГТ402Е
AC138	ГТ402И
AC139	ГТ402И
AC141	ГТ404Б
AC141B	ГТ404Б
AC142	ГТ402И
AC150	МГТ108Д
AC152	ГТ402И
AC160	П28
AC170	МГТ108Г
AC171	МГТ108Г
AC176	ГТ404А
AC181	ГТ404Б
AC182	МП20Б
AC183	МП36А, МП38А
AC184	ГТ402И
AC185	ГТ404Г
AC187	ГТ404Б
AC188	ГТ402Е
AC540	МП39Б
AC541	МП39Б
AC542	МП39Б, МП41А
ACY24	МП26Б
ACY33	ГТ402И
AD1202	П213Б
AD1203	П214Б
AD130	П217
AD131	П217
AD132	П217
AD138	П216
AD139	П213
AD142	П210Б
AD143	П210В
AD145	П210В, П216В
AD148	ГТ703В
AD149	ГТ703В
AD150	ГТ703Г
AD152	ГТ403Б
AD155	ГТ403Е
AD161	ГТ705Д
AD162	ГТ703Г
AD163	П217
AD164	ГТ403Б
AD169	ГТ403Е
AD262	П213
AD263	П214А
AD301	ГТ703Г
AD302	П216
AD303	П217
AD304	П217
AD312	П216
AD313	П217

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
AD314	П217, ГТ701А
AD325	П210Б, ГТ701А
AD431	П213
AD436	П213
AD438	П214А
AD439	П215
AD457	П214А
AD465	П213Б
AD467	П214А
AD469	П215
AD542	П217, ГТ701А
AD545	П210Б
ADP665	ГТ403Б
ADP666	ГТ403Г
ADP670	П201АЭ
ADP671	П201АЭ
ADP672	П202Э
ADY27	ГТ703В
AF106	ГТ328Б
AF106A	ГТ328В
AF109R	ГТ328А
AF124	ГТ322А
AF139	ГТ346Б
AF178	ГТ309Б
AF200	ГТ328А
AF201	ГТ328А
AF202	ГТ328А
AF239	ГТ346А
AF239S	ГТ346А
AF240	ГТ346Б
AF251	ГТ346А
AF252	ГТ346А
AF253	ГТ346А
AF256	ГТ346Б
AF260	П29А
AF261	П30
AF266	МП42Б, МП20А
AF271	ГТ322В
AF272	ГТ322В
AF275	ГТ322Б
AF279	ГТ330Ж
AF280	ГТ330И
AF426	ГТ322Б
AF427	ГТ322Б
AF428	ГТ322Б
AF429	ГТ322Б
AF430	ГТ322В
AFY11	ГТ313А
AFY12	ГТ328Б
AFY13	ГТ305В
AFY15	П30
AFY29	ГТ305Б
AFZ11	ГТ309Б
AL100	ГТ806В
AL102	ГТ806А
AL103	ГТ806Б
ALF3000	АП355А5
AM1416-200	КТ9146А, 2Т994А2
AM82731-45	КТ9121А, 2Т9121А
AM83135-40	2Т9129А
AMPAC1214-125	2Т975А
AP1009	КТ887Б, 2Т887А

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
ASX11	МП42Б
ASX12	МП42Б
ASY26	МП42А, МП20А
ASY26	МП20А
ASY31	МП42А
ASY33	МП42А, МП20А
ASY34	МП42А, МП20А
ASY35	МП42Б, МП20А
ASY70	МП42
ASY76	ГТ403Б
ASY77	ГТ403Г
ASY80	ГТ403Б
ASZ1015	П217В
ASZ1016	П217В
ASZ1017	П217В
ASZ1018	П217В
ASZ15	П217А, ГТ701А
ASZ16	П217А
ASZ17	П217А
ASZ18	П217В, ГТ701А
AT1065-1	АП356А5
AT270	МП42Б, МП20А
AT275	МП42Б, МП20А
AT41485	КТ642А2
AT8040	АП324В2
AT8041	АП326А2
AT8110	3П349А2
AT8250	АП605А2-2
ATF0135	АП344А2-2
AU103	ГТ810А
AU104	ГТ810А
AU107	ГТ810А
AU108	ГТ806Б
AU110	ГТ806Д
AU113	ГТ810А
AUY10	П608А, ГТ905А
AUY18	П214А
AUY19	П217
AUY20	П217
AUY21	П210Б
AUY21A	П210Б
AUY22	П210Б
AUY22A	П210Б
AUY28	П217
AUY35	ГТ806А
AUY38	ГТ806В
B2-8Z	КТ929А
B850-35	КП904А
BAL0102-150	КТ9128АС
BAL0105-100	КТ9105АС
BAL0105-50	КТ9125АС, КТ991АС
BAL0204-125	КТ985АС
BAL0710-75	2Т987А
BC100	КТ605А
BC101	КТ301П
BC107A	КТ342А
BC107AP	КТ3102А
BC107B	КТ342Б
BC107BP	КТ3102Б
BC108A	КТ342А
BC108AP	КТ3102В
BC108B	КТ342Б

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
BC108BP	КТ3102В
BC108C	КТ342В
BC108CP	КТ3102Г
BC109B	КТ342Б
BC109BP	КТ3102Д
BC109C	КТ342В
BC109CP	КТ3102Е
BC119	КТ630Д
BC139	КТ933Б
BC140	КТ630Г
BC141	КТ630Г
BC142	КТ630Г
BC143	КТ933Б
BC146-01	КТ373А
BC146-02	КТ373Б
BC146-03	КТ373В
BC147A	КТ373А
BC147B	КТ373Б
BC148A	КТ373А
BC148B	КТ373Б
BC148C	КТ373В
BC149B	КТ373Б
BC149C	КТ373В
BC157	КТ361Г
BC158A	КТ349В
BC160-6	КТ933Б
BC161-6	КТ933А
BC167A	КТ373А
BC167B	КТ373Б
BC168A	КТ373А
BC168B	КТ373Б
BC168C	КТ373В
BC169B	КТ373Б
BC169C	КТ373В
BC170A	КТ375Б
BC170B	КТ375В
BC171A	КТ373А
BC171B	КТ373Б
BC172A	КТ373А
BC172B	КТ373Б
BC172C	КТ373В
BC173B	КТ373В
BC173C	КТ373В
BC177AP	КТ3107А
BC177V1P	КТ3107Б
BC178A	КТ349В, КТ326А
BC178AP	КТ3107В
BC178BP	КТ3107Д
BC178V1P	КТ3107В
BC179AP	КТ3107Е
BC179BP	КТ3107Ж
BC182A	КТ3102А
BC182B	КТ3102Б
BC182C	КТ3102Б
BC183A	КТ3102А, КТ3102ЖМ, КТ313Б
BC183B	КТ3102Б
BC183C	КТ3102Г
BC183C	КТ3102Б
BC184A	КТ3102Д
BC184B	КТ3102Е
BC192	КТ351Б

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
BC212A	КТ3107Б
BC212B	КТ3107И
BC212C	КТ3107К
BC213A	КТ3107Б
BC213B	КТ3107И
BC213C	КТ3107К
BC214	КТ313Б1
BC216	КТ351А
BC216A	КТ351А
BC218	КТ340Б
BC218A	КТ340Б
BC226	КТ351Б
BC226A	КТ351Б
BC234	КТ342А
BC234A	КТ342А
BC235	КТ342Б
BC235A	КТ342Б
BC237A	КТ3102А
BC237B	КТ3102Б
BC238A	КТ3102А
BC238A	КТ3102В
BC238B	КТ3102В
BC238C	КТ3102Г
BC239B	КТ3102Д
BC239C	КТ3102Е
BC250A	КТ361А
BC250B	КТ361Б, КТ361Б2
BC285	П308
BC286	КТ630Г
BC300	КТ630Б, 2Т630Б
BC307A	КТ3107Б
BC307B	КТ3107И
BC308A	КТ3107Г, КТ3107Б
BC308B	КТ3107Д, КТ3107Д
BC308C	КТ3107К
BC309B	КТ3107Е, КТ3107Ж
BC309C	КТ3107Л, КТ3107Л
BC317	КТ3102А, КТ313Б-1
BC318	КТ3102Б, КТ313В-1
BC319	КТ3102Е, КТ313Г-1
BC320A	КТ3107Б
BC320B	КТ3107Д
BC321A	КТ3107Б
BC321B	КТ3107И
BC321C	КТ3107К
BC322B	КТ3107Ж
BC322C	КТ3107Л
BC337	КТ660А
BC338	КТ660Б
BC355	КТ352Б
BC355A	КТ352А
BC369	КТ681А
BC382B	КТ3102Б
BC382C	КТ3102Г
BC383B	КТ3102Д
BC383C	КТ3102Е
BC384B	КТ3102О
BC384C	КТ3102Д
BC451	КТ3102В
BC452	КТ3102Б, КТ3102ДМ
BC453	КТ3102Д
BC454A	КТ3107Б

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
BC454B	КТ3107И
BC454C	КТ3107К
BC455A	КТ3107Г
BC455B	КТ3107Д
BC455C	КТ3107К
BC456A	КТ3107Е
BC456B	КТ3107Ж
BC456C	КТ3107Л
BC479	КТ3193Г
BC513	КТ345А
BC521	КТ3102Д
BC521C	КТ3102Д
BC526A	КТ3107И
BC526B	КТ3107И
BC526C	КТ3107К
BC527-10	КТ644Б
BC527-6	КТ644А
BC547A	КТ645Б, КТ3102А, КТ3102АМ
BC547B	КТ3102Б, КТ3102БМ
BC547C	КТ3102Г, КТ3102ВМ
BC548A	КТ3102А
BC548B	КТ3102В, КТ3102ДМ
BC548C	КТ3102Г, КТ3102ГМ
BC549A	КТ3102Д
BC549B	КТ3102Д
BC549C	КТ3102Е, КТ3102ДМ
BC557	КТ361Д
BC557A	КТ3107А
BC557B	КТ3107И
BC558	КТ3107Д
BC558A	КТ3107Г
BC558B	КТ3107Д
BC559	КТ3107Ж
BC847B	КТ3189Б9
BC847C	КТ3189В9
BC847A	КТ3189А9
BC857	КТ3129А9
BC858	КТ3129Б9
BC858A	КТ3129Г9
BC869-10	КТ511И9
BCF29	КТ3129В9
BCF30	КТ3129Г9
BCF32	КТ3130В9
BCF33	КТ3130Е9
BCF70	КТ3129Г9
BCF72	КТ3172F9
BCF81	КТ3130Б9
BCP627A	КТ373А
BCP627B	КТ373Б
BCP627C	КТ373В
BCP628A	КТ373А
BCP628B	КТ373Б
BCP628C	КТ373В
BCV52	КТ317А1
BCV71	КТ3130А9
BCV72	КТ3130Б9
BCW29	КТ3129В9
BCW30	КТ3129Г9
BCW31	КТ3130В9, КТ3151А9
BCW32	КТ3130В9
BCW33	КТ3130Г9
BCW46	КТ314А2
BCW47	КТ373А
BCW48	КТ373 (В, В)
BCW49	КТ373 (Б, В)
BCW57	КТ361Г
BCW58	КТ361Е
BCW60	КТ3153А9
BCW60AA	КТ3145А9, 2Т3145А9
BCW60AB	КТ3145Д9
BCW60AR	КТ3139Б
BCW60B	КТ3130Б9
BCW60BL	КТ3139Г, КТ3145Б9
BCW60BR	КТ3139В
BCW60C	КТ3130В9
BCW60D	КТ3130Е9
BCW61A	КТ3129В9
BCW61B	КТ3129Г9
BCW61C	КТ3129Г9
BCW69	КТ3129Б9
BCW70	КТ3129Г9
BCW71	КТ3130А9
BCW72	КТ3130Б9
BCW81	КТ3130Б9
BCW89	КТ3129Б9
BCX51	КТ664А9, КТ515Б9, 2Т664А91
BCX52	КТ664Б9, КТ515А9, 2Т664Б91
BCX53	КТ664А9, 2Т664А91
BCX54	КТ665А9, КТ516Б9, 2Т665А91
BCX55	КТ665Б9, КТ516А9, 2Т665Б91
BCX56	КТ666А9, 2Т665А91
BCX70	КТ3153А9
BCX70AH	КТ3145А9, 2Т3145А9
BCX70G	КТ3130А9
BCX70H	КТ3130Б9
BCX70J	КТ3130В9
BCX70K	КТ3130В9
BCX71	КТ3146А9, КТ3129А9
BCX71H	КТ3129Г9
BCX71J	КТ3129Г9
BCY10	КТ208Е
BCY11	КТ208Л
BCY12	КТ208Д
BCY30	КТ208Л
BCY31	КТ208М
BCY32	КТ208М
BCY33	КТ208Г
BCY34	КТ208Г
BCY38	КТ501Д
BCY39	КТ501М
BCY40	КТ501Д
BCY42	КТ312Б
BCY43	КТ312В
BCY54	КТ501К
BCY56	КТ3102Б
BCY57	КТ3102Е
BCY58A	КТ342А
BCY58B	КТ342Б
BCY58C	КТ342Б
BCY58D	КТ342В
BCY59-IX	КТ3102Б
BCY59-VII	КТ3102А
BCY59-VIII	КТ3102Б
BCY59-X	КТ3102Д
BCY65-IX	КТ3102Б
BCY65-VII	КТ3102А
BCY65-VIII	КТ3102Б
BCY69	КТ342В
BCY70	КТ3107А
BCY71	КТ3107Е
BCY72	КТ3107В
BCY78	КТ3107Д
BCY79	КТ3102Б
BCY90	КТ208Е
BCY90B	КТ501Г
BCY91	КТ208Е
BCY91B	КТ501Г
BCY92	КТ208Е
BCY93	КТ208К, 2Т3152А
BCY93B	КТ501Л
BCY94	КТ208К
BCY94B	КТ501Л
BCY95	КТ208К
BCY95B	КТ501М
BD109	КТ805Б
BD115	КТ604Б
BD121	КТ902А
BD123	КТ902А
BD123	КТ805Б
BD131	КТ943В
BD132	КТ961Г, КТ932Б, КТ9180А
BD135-6	КТ943А, КТ8272А
BD136	КТ626А, КТ8271А
BD137-6	КТ943Б, КТ8272Б
BD138	КТ626Б, КТ8271Б
BD139-6	КТ943В, КТ8272В
BD140	КТ626В, КТ8271В
BD142	КТ819БМ
BD148	КТ805Б
BD149	КТ805Б
BD165	КТ815А, 2Т815А
BD166	КТ814Б
BD167	КТ815Б
BD168	КТ814В
BD169	КТ815В
BD170	КТ814Г, КТ720А
BD172	КТ721А
BD175	КТ817Б
BD176	КТ816Б
BD177	КТ817В, 2Т817В
BD178	КТ816В
BD179	КТ817Г
BD180	КТ816Г
BD181	КТ819БМ
BD182	КТ819ВМ
BD183	КТ819ГМ
BD201	КТ819В
BD202	КТ818Б
BD203	КТ819Г
BD204	КТ818В
BD216	КТ809А
BD220	КТ817Г
BD221	КТ817В

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
BD222	КТ817Г
BD223	КТ837Н
BD224	КТ837Ф
BD225	КТ837С
BD226	КТ943А
BD227	КТ639Б
BD228	КТ943Б
BD229	КТ639Д
BD230	КТ943В, КТ683Г
BD233	КТ817Б
BD234	КТ816Б, КТ837В
BD235	КТ817В
BD236	КТ816В
BD237	КТ817Г, КТ721А, КТ807АМ
BD238	КТ816Г
BD239	КТ817В
BD239A	КТ817В
BD239B	КТ817Г
BD240	КТ816В
BD240A	КТ816В
BD240B	КТ816Г
BD243A	КТ8125В, КТ8220
BD243B	КТ8125Б
BD243C	КТ8125А
BD244	КТ8221А
BD246	КТ818 (АМ-ГМ)
BD253	КТ809А
BD263	КТ829Б
BD263A	КТ829А
BD265	КТ829Б
BD265	КТ829А
BD267	КТ829Б
BD267A	КТ829А
BD267B	КТ829А
BD291	КТ819А
BD292	КТ818А
BD293	КТ819Б
BD294	КТ818Б
BD295	КТ819В
BD296	КТ818В
BD326	КТ9181А
BD330	КТ9180А
BD331	КТ829В
BD333	КТ829Б
BD335	КТ829А
BD371C	КТ961В
BD375	КТ943А
BD377	КТ943Б
BD379	КТ943В, КТ719А
BD386	КТ644Б
BD410	КТ8137А
BD433	КТ817А
BD434	КТ816А, КТ835Б
BD435	КТ817А
BD436	КТ816А
BD437	КТ817Б
BD436	КТ816Б
BD439	КТ817В
BD440	КТ816В
BD441	КТ817Г
BD442	КТ816Г
BD466	КТ973Б
BD477	КТ972Б
BD501B	КТ723А
BD533	КТ819Б
BD534	КТ818Б, КТ837А
BD535	КТ819В
BD536	КТ818В, КТ837Б
BD537	КТ819Г
BD538	КТ818Г
BD543D	КТ723А
BD545	КТ819Г1
BD545A	КТ819В1
BD545B	КТ819Б1
BD545C	КТ819А1
BD546	КТ818Г1
BD546A	КТ818В1
BD546B	КТ818Б1
BD546C	КТ818А1
BD546D	КТ8102Б
BD566	КТ855А
BD611	КТ817А
BD612	КТ816А
BD613	КТ817А
BD614	КТ816А
BD615	КТ817Б
BD616	КТ816Б
BD617	КТ817В
BD618	КТ816В
BD619	КТ817Г
BD620	КТ816Г
BD643	КТ829В
BD645	КТ829Б
BD647	КТ829А
BD663	КТ819А
BD664	КТ818Б
BD665	КТ829Г
BD675	КТ829Г
BD675A	КТ829Г
BD677	КТ829В
BD677A	КТ829В
BD679	КТ829Б
BD679A	КТ829Б
BD681	КТ829А
BD705	КТ819А
BD706	КТ818Б
BD707	КТ819В
BD708	КТ818В
BD709	КТ819Г
BD710	КТ818Г
BD711	КТ819Г
BD712	КТ818Г
BD719	КТ805БМ
BD720	КТ805ВМ
BD744D	КТ724А
BD802	КТ724А
BD813	КТ815А
BD814	КТ814А
BD815	КТ815Б
BD816	КТ814В
BD817	КТ815В
BD818	КТ814Г
BD825	КТ646А
BD826	КТ639Б
BD827	КТ646А
BD828	КТ639Д
BD840	КТ639В
BD842	КТ639Д
BD875	КТ972Б, КТ8245А5
BD876	КТ973Б, КТ8244А5
BD877	КТ972Б, КТ8245(Б5, В5)
BD878	КТ8244Б5, КТ8244В5
BD879	КТ8245Г5
BD880	КТ8244Г5
BD933	КТ817Б
BD934	КТ816Б
BD935	КТ817В
BD936	КТ816В
BD937	КТ817Г
BD938	КТ816Г
BD944	КТ837Ф
BD945	КТ863Б
BD946	КТ837Ф
BD948	КТ837Ф, КТ837Г
BD949	КТ819Б
BD950	КТ818Б
BD951	КТ819В
BD952	КТ818В
BD953	КТ819Г
BD954	КТ819Г
BDP620	КТ947А
BDT42C	КТ855Б, КТ855В
BDT91	КТ819Б
BDT92	КТ818Б
BDT93	КТ819В, КТ808А3
BDT94	КТ818В, КТ808А3
BDT95	КТ819Г, КТ808Б3
BDT96	КТ818Г
BDV64	КТ896Б, КТ8159А
BDV64A	КТ8159Б
BDV64B	КТ896А
BDV64B	КТ8159В
BDV65	КТ8158А
BDV65A	КТ8158Б
BDV65B	КТ8158В
BDV65F	КТ8251А
BDV66B	КТ8106А, 2Т8106А
BDV91	КТ819Б
BDV92	КТ818Б
BDV93	КТ819В
BDV94	КТ818В
BDV95	КТ819Г
BDV96	КТ818Г
BDW21	КТ819АМ, 2Т875В
BDW21A	КТ819БМ
BDW21B	КТ819ВМ
BDW21C	КТ819ГМ
BDW22	КТ818БМ
BDW22A	КТ818ВМ
BDW22B	КТ818ГМ
BDW22C	КТ818ГМ
BDW23	КТ829Г
BDW23A	КТ829В
BDW23B	КТ829Б
BDW23C	КТ829А
BDW51	КТ819АМ

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
BDW51A	КТ728А
BDW51A	КТ819ВМ
BDW51B	КТ819ГМ
BDW51C	КТ819ГМ
BDW52	КТ818БМ
BDW52A	КТ818ВМ
BDW52B	КТ818ГМ
BDW52C	КТ818ГМ
BDX10	КТ819ГМ
BDX10C	КТ819ГМ
BDX13C	КТ819БМ
BDX18	КТ818ГМ
BDX25	КТ802А
BDX25	КТ808А
BDX34	КТ853В
BDX35	КТ902АМ
BDX53	КТ829Г, КТ8141Г
BDX53A	КТ829В, КТ8141В, КТ853Г
BDX53B	КТ829Б, КТ8141Б
BDX53C	КТ829А, КТ8141А, КТ873А
BDX54A	КТ853Г
BDX54B	КТ853В
BDX54C	КТ853А
BDX54F	КТ712А, КТ712Б
BDX62	КТ825Д
BDX62A	КТ825Г
BDX62B	КТ825Г
BDX63	КТ827Б
BDX63A	КТ827А
BDX64	КТ825Д
BDX64A	КТ825Г
BDX64B	КТ825Г
BDX65	КТ827Б
BDX65A	КТ827А
BDX66	КТ825Д
BDX66A	КТ825Г
BDX66B	КТ825Г
BDX66C	КТ8104А, 2Т8104А
BDX67	КТ827Б
BDX67A	КТ827А
BDX71	КТ819В
BDX73	КТ819Г
BDX77	КТ819Г
BDX78	КТ818Г
BDX85	КТ827В
BDX85A	КТ827В
BDX85B	КТ827Б
BDX85C	КТ827А
BDX86	КТ825Б, 2Т825Б
BDX86A	КТ825Б
BDX86B	КТ825Г, 2Т709Б
BDX86C	КТ825Г, 2Т709А
BDX87	КТ827В
BDX87A	КТ827В
BDX87B	КТ827Б
BDX87C	КТ827А
BDX88	КТ825Д
BDX88A	КТ825Д
BDX88B	КТ825Г
BDX88C	КТ825Г
BDX91	КТ819БМ
BDX92	КТ818БМ

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
BDX93	КТ819БМ
BDX94	КТ818ВМ
BDX95	КТ819ГМ
BDX96	КТ818ГМ, КТ841А
BDY12	КТ805Б
BDY13	КТ805Б
BDY20	КТ819ГМ
BDY23	КТ803А
BDY24	КТ803А
BDY25	КТ812В
BDY34	КТ943А
BDY38	КТ819ГМ
BDY60	КТ805А
BDY61	КТ805Б
BDY71	КТ808БМ
BDY72	КТ802А
BDY73	КТ819ГМ
BDY78	КТ805Б
BDY79	КТ802А
BDY90	КТ945А, КТ908А
BDY91	КТ945А, КТ908А
BDY92	КТ908А, КТ908Б, КТ863А
BDY93	КТ704Б, КТ828
BDY94	КТ812А, КТ704Б
BDY95	КТ704Б
BDY96	КТ8101А
BEP179B	КТ611Б
BF111	КТ611А
BF114	КТ611Г
BF137	КТ611Г
BF140A	КТ611В
BF157	КТ940В
BF173	КТ339В
BF177	КТ602А
BF178	КТ611Г
BF179B	КТ611Б
BF179C	КТ618А
BF182	КТ3127А
BF183	КТ3127А
BF186	КТ611Г
BF197	КТ339Г
BF199	КТ339АМ
BF208	КТ339А
BF223	КТ339В
BF240	КТ312В
BF245C	КП365Б
BF254	КТ339АМ
BF257	КТ611Г
BF258	КТ604Б, КТ940Б
BF259	КТ604Б
BF272	КТ3128А
BF273	КТ339А
BF291	КТ611Г
BF297	КТ940В
BF298	КТ940А
BF299	КТ940А
BF305	КТ611Г
BF306	КТ339В
BF311	КТ339Б
BF316	КТ392А2
BF330	КТ339В
BF336	КТ611Г

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
BF337	КТ604Б
BF338	КТ940А
BF362	КТ3128А
BF363	КТ3128А
BF410C	КП365А
BF419	КТ969А
BF457	КТ940В
BF458	КТ940Б
BF459	КТ940А
BF462	КТ6138В
BF469	КТ940Б
BF470	КТ940А
BF471	КТ605БМ, КТ940А
BF472	КТ9115А
BF480	КТ3120А, КТ3120АМ, 2Т3120А
BF50-35	2П909А
BF506	КТ3126А
BF554	КТ3170А9
BF569	КТ3169А9, КТ3192А9
BF597	КТ368АМ
BF599	КТ368А9
BF615	КТ940Б
BF617	КТ940А
BF620	КТ666А9
BF621	КТ667А9
BF622	КТ9145А9
BF623	КТ9144А9
BF680	КТ3109А
BF715	КТ999А
BF727	КТ3165А
BF849	КТ9115А
BF869	КТ999А
BF905	КП350А
BF960	КП327А, КП350А, КП382А, КП801А
BF961	КП327Б
BF964	КП327В
BF966	КП347А2, КП327Г
BF970	КТ3109В, КТ3165А
BF979	КТ3109А
BF980	КП327А
BF989S	КП383А9
BF991	КП346Б9
BF996	КП346А9
BFFQ54T	КТ6132А
BFG65T	КТ3199А92
BFG67	КТ3186А9, КТ3199А9
BFG92A	КТ3186А9, КТ3198А92
BFG93A	КТ3198Г92
BFJ57	КТ602Б
BFJ70	КТ339В
BFJ93	КТ342Б
BFJ98	КТ611Г
BFN24	КТ3201В9
BFP177	КТ611В
BFP178	КТ611Г
BFP179A	КТ611Г
BFP179C	КТ618А
BFP194	КТ6129А9
BFP196	КТ6130А9
BFP405	КТ3144А

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
BFP67	КТ3199А91
BFP719	КТ315А
BFP720	КТ315Б
BFP721	КТ315В
BFP722	КТ315Г
BFP95	КТ996А2, 2Т996А2
BFQ253	КТ9143А
BFQ54T	КТ6132А
BFQ65	КТ3198Ж
BFQ67	КТ3198Ж9
BFQ98Q	2Т658А2
BFR180W	КТ3143А
BFR34	КТ372Б
BFR34A	КТ372Б
BFR86	КТ6139Д
BFR87	КТ6139Г
BFR88	КТ6139Б
BFR89	КТ6139А
BFR90	КТ3198А
BFR90	КТ371А, КТ3190А
BFR90A	КТ3198Б
BFR91	КТ3198В
BFR91A	КТ3198Г
BFR92	КТ3187А91, КТ3198А9
BFR92A	КТ3187А9, КТ3198Д, Б9
BFR93	КТ3198В9
BFR93A	КТ3198Г9
BFR96T	КТ6141А9
BFR96TS	КТ6141Б9
BFS17	КТ3187В91
BFS17A	КТ3198Д9
BFS62	КТ368А
BFT19A	КТ505Б
BFT28C	КТ505Б
BFT92	КТ3191А9, КТ3191А91
BFT96	2Т658Б2
BFW16	КТ610А
BFW30	КТ399А
BFW45	КТ611Г
BFW89	КТ351Б
BFW90	КТ351Б, КТ371АМ
BFW91	КТ351Б
BFW92	КТ382Б
BFW93	2Т3134А1, 2Т354Б2
BFX12	КТ326АМ
BFX13	КТ326БМ
BFX29	КТ933Б
BFX30	КТ933Б
BFX44	КТ340В
BFX59	КТ3106А2
BFX65	КТ3102Е
BFX73	КТ368А
BFX84	КТ630Г
BFX85	КТ630Г
BFX86	КТ630Д
BFX87	КТ933Б
BFX88	КТ933Б
BFX89	КТ355А
BFX94	КТ3117А
BFY19	КТ326Б
BFY34	КТ630Г
BFY45	КТ611Г

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
BFY46	КТ630Д
BFY50	КТ630Г
BFY51	КТ630Д
BFY52	КТ630Д
BFY53	КТ630Д
BFY55	КТ630Г
BFY56	КТ630Г
BFY56A	КТ630Г
BFY56B	КТ630Г
BFY65	КТ611Г
BFY66	КТ355А
BFY67A	КТ630А
BFY67C	КТ630А
BFY68	КТ630Е
BFY68A	КТ630Б
BFY78	КТ368А
BFY80	П308, КТ601А
BFY90	КТ399А
BLJY55	КТ808А
BLW18	КТ920Б
BLW24	КТ922Г
BLX92	КТ913А
BLX93	КТ913Б
BLX96	КТ981А
BLX97	КТ981Б
BLX98	КТ981В
BLY47	КТ808А
BLY47A	КТ808А
BLY48	КТ808А
BLY48A	КТ808А
BLY49	КТ809А
BLY49A	КТ809А
BLY50	КТ809А
BLY50A	КТ809А
BLY63	КТ920Г
BLY88A	КТ920Г
BM100-28	КТ971А
BM40-12	КТ958А
BM80-28	КТ931А
BRY56	КТ117А
BSD39	КТ514Б9
BSJ36	КТ351Б
BSJ63	КТ340Б
BSS124	КП502А
BSS129	КП503А
BSS131	КП509А9
BSS27	КТ928А
BSS28	КТ928Б
BSS29	КТ928А
BSS295	КП505А
BSS297A	КП523А
BSS315	КП507А
BSS38	КТ503Е, КТ602АМ
BSS38	КТ602АМ
BSS42	КТ630А
BSS44	2Т974А
BSS61	2Т708В
BSS68	КТ502Е
BSS69	КТ3145Б9
BSS88	КП504А
BSS89	КП403А
BSS92	КП402А, КП508А

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
BST15	КТ513Б9, КТ513В9
BST16	КТ513А9
BST39	КТ514В9, КТ6135А9
BST40	КТ514А9, КТ6135В9
BSV15-10	КТ639Д
BSV15-165	КТ639В
BSV15-6	КТ639Г
BSV16	КТ639Д
BSV49A	КТ351Б
BSV59-VIII	КТ3117А
BSV64	КТ321А
BSW19	КТ343Б
BSW20	КТ361Г, КТ361Г3
BSW21	КТ343Б
BSW27	КТ928А
BSW36	КТ603Б
BSW39-10	КТ630Г
BSW39-16	КТ630Г
BSW39-6	КТ630Г
BSW41	КТ616А
BSW51	КТ928Б
BSW52	КТ928Б
BSW61	КТ3117А
BSW62	КТ3117А
BSW65	КТ630Г
BSW66	КТ630Г
BSW66A	КТ630Г
BSW67	КТ630А
BSW67A	КТ630А
BSW68	КТ630В
BSW68A	КТ630В
BSW88A	КТ375А
BSX21	П308
BSX32	КТ928Б
BSX32	КТ928Б
BSX38	КТ802АМ
BSX38A	КТ340А
BSX45	КТ630Г
BSX45-10	КТ630Г
BSX45-16	КТ630Б
BSX45-6	КТ630Г
BSX46	КТ630Г
BSX46-10	КТ630Г
BSX46-16	КТ630Б
BSX46-6	КТ630Г
BSX47	КТ630Б
BSX47-10	КТ630Б
BSX47-6	КТ630А
BSX51	КТ340В
BSX52	КТ340В
BSX53A	КТ340А
BSX59	КТ928А
BSX60	КТ928А
BSX61	КТ928А
BSX62	КТ801Б
BSX63	КТ801А
BSX66	КТ306Д, КТ306А
BSX67	КТ306Д, КТ306А
BSX72	КТ630Д
BSX75	КТ3117А
BSX79A	КТ342А, КТ3117А
BSX79B	КТ342Б

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
BSX80	KT375Б
BSX81A	KT375A
BSX89	KT616A
BSX97	KT3117A
BSXP59	KT928A
BSXP60	KT928A
BSXP6I	KT928A
BSXP87	KT340B
BSY17	KT616Б
BSY18	KT616Б
BSY26	KT340B
BSY27	KT340B
BSY34	KT608A
BSY38	KT340B
BSY39	KT340Б
BSY40	KT343A
BSY41	KT343Б
BSY51	KT630Д
BSY52	KT630E
BSY53	KT630Г
BSY54	KT630Г
BSY55	KT630A
BSY56	KT630Б
BSY58	KT608A
BSY62	KT616Б
BSY72	KT352A
BSY73	KT312Б
BSY79	П309
BSY81	KT347A, KT347Б
BSY95	KT340B
BSY95A	KT340B
BSYP62	KT340B
BSYP63	KT340B
BSZ10	KT104Б
BSZ11	KT104Б
BSZ12	KT203A
BU106	KT812Б
BU108	KT839A
BU109A	KT8110B
BU120	KT809A
BU123	KT802A
BU126	KT704Б, KT828A, KT840Б
BU129	KT809A
BU132	KT704A, KT826A, KT826Б
BU133	KT704Б, KT828A
BU204	KT838A
BU205	KT838A, 2T704Б
BU207	KT838A. KT846Б
BU207A	KT838A. KT8107E2
BU208	KT838Б. KT846B, KT8127Б1, KT8157Б, KT8107Б2, KT8121Б2
BU208A	KT8157A, KT846A. KT8107A2. KT8107B2. KT8127A, KT8121A2
BU208A	KT838A
BU208DX	KT8183A
BU2506D	KT8248A1
BU2508A	KT82224A
BU2508D	KT8224Б
BU2520A	KT856A1
BU2525A	KT8228A

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
BU2525D	KT8228Д
BU286	KT893A
BU326	KT840A, KT8108Б
BU326A	KT828A, KT840A, KT8108B
BU406	KT8130A, KT858A, KT8138Д
BU406D	KT8138E, KT8140A1
BU407	KT8255A
BU408	KT858A, KT8140A, KT8124A
BU408D	KT8136A1
BU409	KT812Б
BU409	KT857A
BU426	KT868Б
BU426A	KT868A
BU508	KT872A, KT8127Б1, KT8107Б, KT8107Г
BU508A	KT886Б1, KT872Б, KT8107A, KT8107Б
BU508D	KT872B, KT895A9, KT8107Д
BU508F1	KT8127A1
BU606	KT840A
BU607	KT840Б
BU608	KT848A
BU608	KT848A
BU807	KT8156A
BU9302P	KT890B
BU931Z	KT897A
BU931ZP	KT898A
BU931ZPFI	KT898A1
BU932Z	KT892Б
BU941Z	KT8231A, KT897Б
BU941ZP	KT8225A, KT8231A1
BU941ZPF	KT8231A2
BUD44D2	KT8261A
BUH100	KT8290A
BUH313D	KT8183Б2
BUH315D	KT8183A2
BUL45D2	KT8247A
BUL47	KT8143Г
BUL47A	KT8143Д, KT8155A
BUP46	KT8143K
BUP47	KT8143A, KT8143Д, KT8143H
BUP47A	KT8143Г
BUP51	KT8143X
BUP52	KT8143Ф
BUP53	KT8143Ж, KT8143M
BUP54	KT8143Г
BUS98	KT885A, 2T885A
BUT11	KT8108Б1
BUT90	KT8143Б
BUT91	KT8143B, 2T891A
BUT92	KT8143A, 2T891A
BUV18	KT8143Г
BUV19	KT8143A
BUV37	KT890A, KT890Б
BUV46	KT8108B1
BUV48	KП953A, 2П953A
BUV66A	KT8108A1
BUV74	KT885A, 2T885A
BUV98A	KT885Б
BUW11	KT868Б
BUW11A	KT868A
BUW24	KT8147Б

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
BUW26	KT8147A
BUW35	KT841E
BUW39	KT874A
BUX15	KT8147Б
BUX21	2T866A
BUX25	KT878B
BUX37	KT848A, KT8146Б
BUX47	KT8147A, KT8108A
BUX48	KT856A
BUX48A	KT856Б
BUX48B	KT8146A
BUX54	KT506A
BUX77	KT908A
BUX82	KT812A
BUX83	KT812A
BUX84	KT506Б, KT859A
BUX86	KT8137A
BUX97	KT828A
BUX97A	KT828A
BUX97B	KT828A
BUX98	KT878A, 2T878A
BUX98A	KT8154Б
BUX98AX	KT8155Б
BUY18	KT840A
BUY21	KT867A
BUY26	KT9166A
BUY43	П702
BUY46	П702A
BUYP52	KT802A
BUYP53	KT802A
BUYP54	KT802A
BUZ111S	KП789A
BUZ220	KП809Д
BUZ307	KП728A
BUZ31	KП704Б
BUZ32	KП704A
BUZ323	KП717Б1
BUZ330	KП718A1
BUZ350	KП813A1
BUZ354	KП718B1
BUZ36	KП722A. KП813A
BUZ385	KП706B, 2П701A
BUZ43	2П701A
BUZ45	KП718A, KП809Б
BUZ45A	KП718Б
BUZ53A	KП705A, 2П803A
BUZ54A	KП803A
BUZ60	KП707A1
BUZ71	KП727A
BUZ80A	KП786A
BUZ90	KП707Б1, KП709Б. KП726Б
BUZ90A	KП726A, KП726A1
BUZ91A	KП787A
BUZ94	KП809B
BUZ98A	2T885Б
C12-12	KT925Б
C12-28	KT934Б
C25-12	KT925B
C25-28	KT934B
C2M-10-28A	KT970A
C3-12	KT925A
C3-28	KT934A

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
CD160	П213Б
CF4-28	2П911А
CF739	АП379А9
CFX14	АП326Б2, АП320В2
CFX31	АП602В2
CFY113	3П345А2
CFY12	АП331А2
CFY18-12	АП381А5
CFY25	АП343А1-2
CFY25-17	АП343А1-2
CFY25-25	АП343А2
CM40-12	КТ960А, КТ980А
CM75-28	КТ930А
CP640	КП601А
CP651	КП601Б, КП903А
D12-28	КТ946А
D41D1	КТ626А
D41D1	КТ626А
D41D4	КТ626Б
D41D7	КТ626В
D42C2N	КТ9181А
D44H1	КТ997Б
D44H2	КТ997В
D44H5	КТ9166В
D44H8	КТ8250А
D45H5	2Т9120А
D45H5	КТ9120В
DM10-28	КТ962А
DM20-28	КТ962Б
DM40-28	КТ962В
DME250	КТ986Б
DME375	КТ986В
DT4305	КТ845А
DV1007	2П909Б
DV1202S	КП902В
DV1202S	2П902А
DV28120	2П913Б, 2П928А
DXL2608A	АП605А2
DXL2608A	АП605А2
DXL3501	АП602А2
DXL3610A	АП604А2
E1201	2П941А
E1202	2П941Б
E3742-3A	3П925В2
ECX591	КТ511Г9
ECX596	КТ511А9
EFT212	П216
EFT213	П216
EFT214	П217
EFT250	П217
EFT306	МП40
EFT307	МП40
EFT308	КТ208Б
EFT311	МП20А
EFT312	МП20А
EFT313	МП20Б
EFT317	П401
EFT319	П401
EFT320	П401
EFT321	МП20А
EFT322	МП20А
EFT323	МП20Б
EFT331	МП20А
EFT332	МП20А
EFT333	МП20Б
EFT341	МП21Д
EFT342	МП21Д
EFT343	МП21Д
EXT555SM	КТ511Б9
EXT4515M	КТ511Д9
F1020	2П920А
F1027	КП928А
F1053	2П933Б
F1053	КП923В
F1201	КП951А2
F1203	КП951Б2
F2001	КП923А
F2002	КП923Б
F2003	КП923В
F2005	КП923Г
F2006	2П933А
F2007	2П923Г
F2012	2П911Б
F2013	2П918А
F2013/H	КП923Б
F2021	2П913А
FHC30LG/FA	АП344А3-2
FHC30LG/FA	АП344А3-2
FJ0880-28	КТ9101АС
FJ201F	КТ3132А2
FJ203	КТ3121А6
FJ203	КТ3126А6
FJ401	КТ3115А2
FJ403	КТ682А2
FJ9295	2Т9137А
FJ9295CC	КТ996Б2, 2Т996Б2
FLC15	3П910А2
FLC253	3П915А2
FLM5964-8C	3П930А2
FLM7177-5	АП915А2
FLX102MH-12	АП607А2
FMMTA13	КТ517А9
FMMTA14	КТ517Б9
FRH01FH	АП330В2-2
FSC10	АП344А2-2
FSC10FA	АП354Б5
FXT565M	КТ528А9
GAT5	АП325А2
GAT6	АП326А2
GC100	ГТ109А
GC101	ГТ109А
GC112	МП26А
GC116	МГТ108Д
GC117	МГТ108Д
GC118	МГТ108Д
GC121	МП39Б
GC121	МП20А
GC122	МП20А
GC123	МП21Г
GC500	ГТ402Д
GC501	ГТ402Е
GC502	ГТ402И
GC507	МП20А
GC508	МП20Б
GC509	МП21Г
GC510K	ГТ403Е
GC512K	ГТ403Е
GC515	МП20А
GC516	МП20А
GC517	МП20Б
GC518	МП20Б
GC519	МП20Б
GC525	МП36А
GC525	МП35А
GC526	МП36А, МП37А
GC527	МП36А, МП38А
GCN55	МП20А
GCN56	МП21Г
GD175	П213Б
GD180	П214А
GD240	П213
GD241	П213
GD242	П214А
GD243	П214А
GD244	П215
GD607	ГТ404Г
GD608	ГТ404Б
GD609	ГТ404Б
GD617	П201АЭ
GD618	П201АЭ
GD619	П203Э
GDI170	П213Б
GES2219	КТ660А
GES5308	КТ517В
GF126	ГТ309Г
GF128	ГТ309Б
GF130	ГТ309Д
GF145	ГТ346А
GF147	ГТ346А
GF501	ГТ313Б
GF502	ГТ313А
GF503	ГТ313Б
GF504	ГТ313А
GF506	ГТ328Б
GF507	ГТ346Б
GF514	ГТ322А
GF514	ГТ313Б
GF515	ГТ322А
GF516	ГТ322А
GF517	ГТ322Б
GFY50	ГТ322Б
GS109	МП42А
GS111	МП42Б
GS112	МП25А
GS121	МП42
HEM3508B-20	КТ9134А
HP3586L	КТ391А2
HUF7507	КП7132А1, КП7132А91
HUF7507P3	КП7132А. КП7132А9
HXTR2101	КТ648А2
HXTR6101	КТ3132В2
HXTR6101	2Т3124Б2
HXTR6102	КТ3132Б2. КТ682А
IM44506	3П925Б2
IRF130	2П912А
IRF132	КП922А

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
IRF150	КП150
IRF240	КП240
IRF250	КП250
IRF3205	КП783А
IRF340	КП340, КП717Е, КП809А
IRF341	КП717Д
IRF350	КП350, КП717Б
IRF352	КП717Г
IRF353	КП717В
IRF420	КП420, 2П802Б
IRF440	КП440
IRF441	КП718Г
IRF450	КП450, КП725А
IRF452	КП718О
IRF453	КП718А, КП718Е
IRF46	КП741А
IRF48	КП741Б
IRF510	КП510, КП743А
IRF511	КП743Б
IRF512	КП743В
IRF520	КП520, КП744А
IRF521	КП744Б
IRF5210	КП7128А, 2П7141А1
IRF522	КП744В
IRF530	КП530, КП745А
IRF531	КП745Б
IRF532	КП745В
IRF540	КП540. 2П797Г, КП746А
IRF540N	КП746А
IRF541	КП746Б
IRF542	КП746В
IRF610	КП610, КП748А
IRF611	КП748Б
IRF612	КП748В
IRF620	КП620, КП749А, КП7135А
IRF621	КП749Б
IRF622	КП749В
IRF630	КП630, КП737А, КП7134А
IRF634	КП737Б
IRF635	КП737В
IRF640	КП640, КП750А, А1
IRF640	КП7133А
IRF640S	КП7133А9
IRF641	КП750Б, КП750Б1
IRF642	КП750В. КП750В1
IRF710	КП710, КП733А, КП731А
IRF7101	КП7131А9
IRF7103	2П7140А1
IRF710A	КП731А
IRF711	КП731Б
IRF712	КП731В
IRF720	КП751А
IRF720A	КП720
IRF721	КП751Б
IRF722	КП751В
IRF730	КП752А, КП707А1
IRF730A	КП707А1. КП730
IRF731	КП752Б
IRF7316	2П7142А1
IRF732	КП752В
IRF740	КП776А, КП7136А
IRF740A	КП740
IRF741	КП776Б
IRF7416	2П7143А
IRF742	КП776Б
IRF744	КП776Г
IRF820	КП820, КП759А, КП780А
IRF821	КП759Б, КП780Б
IRF822	КП759В, КП780В
IRF823	КП759Г
IRF830	КП830, КП753А, КП760А
IRF831	КП760Б, КП753Б
IRF832	КП760В, КП753В
IRF833	КП760Г
IRF840	КП840, КП761А, КП777А
IRF840	КП7137А
IRF841	КП706Б, КП761Б
IRF841	КП777Б
IRF842	КП777В, КП761В
IRF843	КП761Г
IRF9020	КП944А
IRF9130	КП712А
IRF9140	2П7144А1
IRF9540	КП785А
IRF9620	2П703А
IRF9621	2П703Б
IRF9634	КП796А
IRF9Z34	КП784А, КП817В, КП748А
IRFBC20	КП733Г
IRFBC40	КП805Б
IRFBC40	КП7130А
IRFBC40S	КП7130А9
IRFBE30	КП707В1
IRFBE32	КП707В2
IRFD111	КП804А
IRFP150	КП747А
IRFP250	КП778А
IRFP340	КП717Е1
IRFP350	КП781А
IRFP352	КП717Г1
IRFP353	КП717В1
IRFP441	КП718Г1
IRFP450	КП779А
IRFP452	КП717Д1
IRFR020	КП945А
IRFR1N60	КП7138А
IRFR1N60A	КП7138А9
IRFU420	КП780АС1
IRFY340M	КП936Е
IRFZ10	КП739Б
IRFZ14	КП739А
IRFZ15	КП739В
IRFZ20	КП740Б
IRFZ24	КП740А
IRFZ25	КП740В
IRFZ34	КП812В1, КП727Б
IRFZ40	КП723В
IRFZ42	КП723Г
IRFZ44	КП723А, КП812А1, 2П7102А1
IRFZ44E	КП7150А
IRFZ44ES	КП7150А9
IRFZ45	КП723Б, КП812Б1
IRFZ46	КП741Б
IRFZ48	КП741А
IRG4BC30S	КЕ707А
IRG4BC30U	КЕ707Б
IRGBC40M	КП730А. КП731
IRGPH50F	КП730А
IRL520	КП744Г
IRL530	КП745Г
IRL540	КП746Г
IRL630	КП737Г
IRL640	КП750Г
IRLML2402	КП510А9
IRLZ34	КП727В
IRLZ44	КП723Г
IVN5200	КП908А
IVN6000KNR	2П917А
IXTM4N95	КП705Б
J175	2П305А
J175	КП304А
JE8050	КТ524А
JE9013	КТ525А5
JE9015A	КТ519А
JE9015B	КТ519Б
JE9015C	КТ519В
JO2058	КТ9155А
JS830	АП330В1-2
JS8830AS	АП330А2
JS8864AS	АП608А2
K10500	2Т939А
K2113B	КТ382БМ
K2122CB	КТ382АМ
K5002	КТ3120А, 2Т3120А
KC147	КТ373А. КТ373Б
KC148	КТ373А, КТ373Б
KC149	КТ373Б, КТ373В
KC507	КТ342Б
KC508	КТ342Б
KC509	КТ342Б
KD601	КТ803А
KD602	КТ808А
KF173	КТ339В
KF503	КТ602Б
KF504	КТ611Г
KF507	КТ617А
KSA539O	КТ502Г
KSA539R	КТ502В
KSA539Y	КТ502Г
KSA545O	КТ502(Г, Д)
KSA545R	КТ502Д
KSA545Y	КТ502(Г, Д)
KSB907	КП8219А1
KSC1395	КТ316ГМ
KSC1623	КТ220А9
KSC1730	КТ316ОМ
KSC2757	КТ368А9
KSC3074	КТ8218Б
KSC815	КТ503А
KSC853O	КТ503Г
KSC853R	КТ503(Г, Д)
KSC853Y	КТ503Г
KSD1621	КТ512Ж9
KSD227O	КТ503Н
KSD227Y	КТ503Б

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
KSD73	КТ805ИМ
KSH117	КТ8219Г1
KSH1171	КТ8219В
KSH1271	КТ8219Г
KSH2955	КТ8217Б1
KSH2955I	КТ8217Б
KSH3055	КТ8216А
KSH3055I	КТ8216Б1
KSH31	КТ8218А1
KSH31I	КТ8218А
KSH44H11I	КТ8218Г
KSY21	КТ616Б
KSY34	КТ608А
KSY62	КТ606Б
KSY63	КТ616Б
KSY81	КТ347Б
KU601	КТ801Б
KU602	КТ801А
KU605	КТ812В
KU606	КТ808А
KU607	КТ812В
KU611	КТ801Б
KU612	КТ801А
KUY12	КТ812В
LAE4000Q	КТ657Б2, 2Т657Б2
LAE4001RA	КТ6131А
LDA405	К1НТ254
LKE32002T	КТ918Б2
LT1817	КТ9141А1
LT1819	2Т9159А
LT1839	КТ9141А
LT1839	КТ9141А
LT5839	КТ9143А
LT5839	2Т9143А
MA2123	КТ3114Б6
MA4F300-500	3П915Б2
MA909	МП26А
MA910	МП26А
MCF1305	АП354В5
MCF1402	АП354А5
MCF45110	АП357В5
MD1129	КТС395А1
MD1130	КТС394А2
MD3762	2Т687АС2
MD5000	КТС3103А1, КТС393А9
MD5000B	КТС3103Б1, КТС393Б9
MD918A	2ТС398А1
MD918AF	КТС398Б94
MD918F	КТС398А94
MD9762	2Т687АС2
MD986	КТС303А2
MEM3008	2Т9139Б
MEM430394	2Т982А2
MFE121	КП306В
MFE2001	КП307Г
MFE2002	КП307Д
MFE2098	КП302В
MFE2098	КП302В
MFE3004	2П305А
MG25BZ50	КП953В, КП955Б
MGF2116	АП605А2
MGF2324-01	АП606Б2
MGF4310	АП343А2-2
MGF4415	АП343А3-2
MGF4511D	АП357В5
MGF-X35M-01	АП603А2
MHQ2221	КТС631В, КТС631Г
MHQ2369	КТС631А, КТС631Б
MHQ2906	КТС622А
MJ10002	КТ841В
MJ11020	2Т8105А
MJ11020	КТ8105В
MJ11021	2Т8104А
MJ11021	КТ8104В
MJ250	КТ963А2
MJ2500	КТ825Д
MJ2501	КТ825Г
MJ2955	КТ8102А, КТ8149А
MJ3000	КТ827В
MJ3001	КТ827Б
MJ3480	КТ839А
MJ3520	КТ827В
MJ3521	КТ827А
MJ4030	КТ825Д
MJ4031	КТ825Г
MJ4032	КТ825Г
MJ4033	КТ827В
MJ4034	КТ827Б
MJ4035	КТ827А
MJ410	КТ842А
MJ420	КТ618А
MJ4646	КТ505А
MJ480	КТ803А
MJ481	КТ803А
MJD2955	КТ8217В1
MJD3055	КТ8216В1
MJD3055-1	КТ8216В
MJD31	КТ8216А
MJD31A	КТ8216Б
MJD31B	КТ8216В
MJD31BT4	КТ8218В1
MJD31C	КТ8216Г, КТ8216А1
MJD32	КТ8217А
MJD32A	КТ8217Б
MJD32B	КТ8217В
MJD32C	КТ8217Г
MJD41C	КТ8216Г
MJE1002	КТ815В
MJE13001	КТ538А, КТ8201А, КТ8270А
MJE13002	КТ8170Б1
MJE13003	КТ8112А, КТ8170А1, КТ8175А, КТ8203А, КТ8235А
MJE13004	КТ8164Б, КТ8181Б, 2Т8164Б
MJE13005	КТ8138В, КТ8164А, КТ872А, КТ8181А, КТ854Б, КТ8205А, КТ8226А1
MJE13006	КТ8136А, КТ8182Б
MJE13007	КТ8138Г, КТ8126А, КТ8182Б, КТ8207А
MJE13008	КТ8138Ж
MJE13009	КТ8138И, КТ8209А
MJE170	КТ9180Б
MJE171	КТ9180В
MJE172	КТ9180Г
MJE180	КТ683Д, КТ9181Б
MJE181	КТ9181В
MJE182	КТ9181Г
MJE230	КТ9180Б
MJE233	КТ9180В
MJE2955	2Т876А, 2Т876Г
MJE2955T	КТ8149А2
MJE3055	КТ819Б, КТ738А
MJE3055T	КТ8150А2
MJE4343	КТ732А
MJE4353	КТ732Б
MJE4353T	КТ8101А
MJE4553T	КТ8102Б
MJE710	КТ814Б
MJE711	КТ814В
MJE712	КТ814Г
MJE720	КТ815Б
MJE721	КТ815В
MJE722	КТ815Г
MJH11017	КТ709Б
MJH11019	КТ709А, 2Т709А
MJH6285	КТ8106А, 2Т8106А
MJH6286	КТ8106Б
ML3000	КТ602В
ML500	КТ963Б2, 2Т9135А, 2Т995А2
MM1748	КТ316А
MM3000	КТ602А
MM3001	КТ611В
MM3375	КТ904Б
MM404	МП42Б
MM8006	КТ399А
MM8007	КТ399А
MM8015	КТ382А
MMBF54592	КП308А1
MMBF54592	2П308В9
MMBT2222	КТ3117Б9
MMBT3904	КТ3197А9
MMBT3906	КТ3196А9, КТ3140Г
MMBT404A	КТ209К
MMBT6427	КТ517В9
MMBT6427LT1	КТ517Г9
MMBT6517	КТ3201А9
MMBTA13	КТ517А9
MMBTA14	КТ517Б9
MMBTA20	КТ3151Д9
MMBTA42	КТ3201Б9
MMBTA43	КТ3201Г9
MMBTA63	КТ523А9
MMBTA64	КТ523Б9
MMST3906	КТ3146В9
MMT2857	КТ382А
MMT2857	КТ382Б
MP4450-3	3П925А5
MPQ3906	КТ674АС
MPS2711	КТ503А
MPS2712	КТ503Б
MPS2713	КТ306БМ
MPS2714	КТ306БМ
MPS2907AL	КТ685Г
MPS2907AM	КТ685В
MPS2907K	КТ685Б
MPS2925	КТ680А
MPS3395	КТ681А

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
MPS3563	КТ325АМ
MPS3638	КТ351А
MPS3638A	КТ351А
MPS3639	КТ357А
MPS3640	КТ347Б
MPS3702	КТ3107Д
MPS3703	КТ3107А
MPS3705	КТ645А
MPS3707	КТ3102Д
MPS3708	КТ3102В
MPS3709	КТ3102А
MPS3710	КТ3102В
MPS3711	КТ3102Г
MPS3914	КТ680А
MPS404	КТ209Е
MPS404A	КТ209К
MPS5179	КТ368ВМ
MPS6512	КТ3102Д
MPS6513	КТ3102Д
MPS6514	КТ3102Д
MPS6515	КТ3102Д
MPS6516	КТ3107Е
MPS6517	КТ3107Е
MPS6518	КТ3107Ж
MPS6519	КТ3107Л
MPS6530	КТ645А
MPS6532	КТ645А, 2Т645А
MPS6541	КТ316БМ
MPS6543	КТ316ВМ
MPS6562	КТ350А
MPS6563	КТ350А
MPS6565	КТ645А
MPS6566	КТ645А
MPS6571	КТ3102Г
MPS706	КТ645А
MPS706A	КТ375А
MPS834	КТ306ВМ
MPS9600	КТ201ВМ
MPS9601	КТ201БМ
MPSA09	КТ3102Б
MPSA13	КТ517А
MPSA14	КТ517Б
MPSA25	КТ517Г
MPSA26	КТ517Д
MPSA42	КТ6135Б, КТ520А, КТ6139А
MPSA43	КТ6135В, КТ520Б, КТ6139Б
MPSA44	КТ6135А
MPSA63	КТ523А
MPSA64	КТ523Б
MPSA75	КТ523Б
MPSA76	КТ523Г
MPSA77	КТ523Д
MPSA92	КТ521А, КТ6138А
MPSA93	КТ521Б, КТ6138Б
MPS-H37	КТ339АМ
MPSL01	КТ632Б1
MPSL07	КТ363А
MPSL08	КТ363А
MPSL51	КТ638А, КТ632В1
MPSU01	КТ807Б
MPSU01A	КТ807Б
MPSU04	КТ850Б

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
MPSU05	КТ807Б
MPSU06	КТ807Б
MPSU07	КТ807А
MPSU51	КТ639Б
MPSU51A	КТ639Б
MPSU55	КТ639Г
MPSU56	КТ639Б, КТ626Б
MPSW13	КТ8240Д5
MPSW14	КТ8240Е5
MPSW63	КТ8241А5
MPSW64	КТ8241Б5
MQ2218	КТС613А
MRA0510-50H	КТ9156БС
MRA0610-18	КТ9104Б, 2Т988А
MRA0610-3	КТ9104А
MRA1014-35	2Т9118В
MRA1214-55	2Т9118Б
MRA1417-25	2Т989А
MRF148	КП908Б
MRF2005M	КТ948А
MRF2010	КТ942В
MRF2010	2Т942А
MRF430	КТ9160А
MS0146	КТ937А2
MSA7505	КТ907А
MSC1075M	КТ984А
MSC1250M	КТ984Б
MSC1550M	КТ9109А
MSC1827	3П927А2
MSC2001M	КТ919В
MSC2003	КТ913А
MSC2003M	КТ919Б
MSC2005M	КТ919А
MSC4001	КТ938А2
MSC81550	КТ9127А
MSC85606	2Т640А1-2
MSM1718-05	3П927Б2
MSM3742-5	3П925А2
MSM5964-10	3П930Б2
MSM7785-10	3П929А2
MSPL01	2Т638А
MT9003	2Т316А
MTM15N50	КП706А
MTM2N85	2П803Б
MTM475	2П701Б
MTM8N35	2П702А
MTP3N08L	КП727Б, КП727В
MTP6N60	КП724А, 2П724А
MTS102	КТ3166Б
MU4894	КТ117Г
NDP506A	КП734А
NDP506B	КП734Б
NDP601	КП734В
NDP605A	КП735В
NDP605B	КП735Г
NDP606A	КП735А
NDP606B	КП735В
NDPU506AL	КП734А1
NDPU506BL	КП734Б1
NE021-60	КТ657А2
NE045	3П353А5, АП358В5
NE1010E	КТ913Б

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
NE13783	АП320Б2
NE13783	АП355В5
NE388-06	АП339А2
NE4203	2Т9103Б2
NE46383	АП328А2
NE500	КП302Г
NE567-55	КТ647А2, 2Т671А2
NE695	АП320А2
NE72089A	АП344А2
NE73435	КТ3114В6, 2Т3114А6
NE75083	АП356В5
NE76184A	АП344А1-2
NE90089A	АП605А1-2
NEM2020	2Т9122А
NEM4205	2Т9103А2
NEZ1112	АП602Б2
NKT11	МГТ108Г
NKT73	МГТ108Б
NT2222	КТ3117А1
NTE107	КТ316АМ
OC1016	ГТ703В
OC1044	ГТ109Е
OC1045	ГТ109Д
OC1070	МП40А
OC1071	МП40А, МП39Б
OC1072	МП41А, МП39Б
OC1074	МП20А
OC1075	МП41А, МП39Б
OC1076	МП42Б, МП20А
OC1077	МП21Г
OC1079	МП20А
OC112	МП26
OC170	ГТ309Г, ГТ322Б
OC171	ГТ309Г
OC200	КТ104Г
OC201	КТ104Б
OC202	КТ104В
OC203	КТ203А
OC204	КТ208Г
OC205	КТ208Л
OC206	КТ208Г
OC207	КТ208А
OC25	П216
OC26	ГТ703Д
OC27	ГТ703Г
OC28	П217
OC30	П201Э
OC35	П217
OC41	П29
OC42	П29А
OC57	ГТ109А
OC58	ГТ109Б
OC59	ГТ109В
OC60	ГТ109В
OC70	МП40А
OC71	МП40А
OC75	МП40А, МП41А
OC76	МП40А
OC77	МП26Б
PBC107A	КТ373А
PBC107B	КТ373Б
PBC108A	КТ373А

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
PBC108B	КТ373В
PBC108C	КТ373В
PBC109B	КТ373Б
PBC109C	КТ373В
PBMS3906	КТ3146Г9
PBMT3906	КТ3146О9, КТ3140В
PH1114-50	2Т9118А
PH1114-50C	КТ976А
PH1114-60	КТ979А, 2Т979А
PKB23003U	КТ919Г
PKB23003U	КТ919Г
PKB3000U	КТ918А2
PN2219	КТ530А
PN2484	КТ3102(Б, Д)
PN4888	КТ6138Г
PPC9030	3П927В2
PT6680	КТ909В
PT9788A	2Т951А
PT9790A	КТ9111А, 2Т979А
PTB42003X	КТ937Б2
PZ1214B1504	2Т975Б
PZ2023U	2Т9149Б
PZ2024B10V	2Т9149А
PZ2327B150	2Т9158А
PZ2731B16V	2Т9139А
PZB16040U	КТ979А
QF505	ГТ328Б
RFD401	КТ606Б
RFD410	КТ913А
RFD420	КТ913Б
RFD421	КТ904А
RFK10N15	КП748Б
RFK10N45	КП718Г
RFK10N50	КП440
RFK12N35	КП717Д
RFK12N40	КП340
RFK25N20	КП240
RFM12N10	2П922Б
RFM18N10	2П912А
RFP12N08	КП743Б
RFP12N10	КП743А
RFP15N15	КП750Б
RFP18N08	КП745Б
RFP18N10	КП745А, КП530
RFP25N06	КП746Б
RFP3N45	КП759Б
RFP4N40	КП751В1, КП733Б
RFP6N45	КП753Б
RFP7N35	КП752Б
RFP7N40	КП752А
RFP8N18	КП749Б
RFP8N20	КП748А, КП610
RFR3N50	КП759А
RFR6N50	КП753А
S10-12	КТ965А, КТ921А
S10-28	КТ955А
S150-28	КТ957А
S2000F1	КТ8183А1
S30-12	КТ966А
S3640	КТ3126Б
S70-12	КТ967А
S80-28	КТ956А, КТ944А

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
S8870	АП355В5
S89	2Т996А2
SC206D	КТ373А
SC206E	КТ373Б
SC206F	КТ373В
SC207D	КТ373А
SC207E	КТ373Б
SC207F	КТ373Б
SD1300	КТ399А
SD1301	КТ399А
SD1308	КТ938Б
SD1505	2Т9140А
SD1540	КТ9164А
SD1543	КТ9134Б
SD1546	КТ9774
SD1565	КТ9136АС, КТ9161АС, 2Т9136АС, 2Т914А
SD200	КП310А
SD201	КП310Б
SD211	КП980Б
SD300	КП314А
SDN6000	КТ834В
SDN6001	КТ834Б
SDN6002	КТ834А
SDN6251	КТ834В
SDN6252	КТ834Б
SDN6253	КТ834А
SDT3207	КТ908Б
SDT3208	КТ908А
SDT5504	2Т881Б
SDT7012	КТ908Б
SDT7013	КТ908А
SE9300	КТ716Г
SF121A	КТ617А
SF121B	КТ617В
SF122A	КТ617А
SF122B	КТ617А
SF123A	КТ602В
SF123B	КТ602Г
SF123C	КТ602Г
SF126A	КТ617А
SF126B	КТ617А
SF126C	КТ617А
SF128A	КТ630Г
SF128B	КТ630Г
SF128C	КТ630Г
SF128D	КТ630Г
SF129A	КТ630А
SF129B	КТ630А
SF129C	КТ630А
SF129D	КТ630Б
SF131E	КТ3102В
SF131F	КТ3102Г
SF132E	КТ3102Б
SF132F	КТ3102Г
SF136D	КТ342А
SF136E	КТ342Б
SF136F	КТ342В
SF137D	КТ342А
SF137E	КТ342Б
SF137F	КТ342В
SF150B	КТ611Г

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
SF150C	КТ611Г
SF21	КТ617А
SF215C	КТ375Б, КТ373А
SF215D	КТ373А
SF215E	КТ373Б
SF216C	КТ375А, КТ373Г
SF216D	КТ373А
SF216E	КТ373Б
SF22	КТ617А
SFE264	КП312А
SFT124	КТ501Е
SFT125	КТ501Е
SFT130	КТ501Е
SFT131	КТ501Е
SFT143	КТ501Ж
SFT144	КТ501И
SFT145	КТ501Ж
SFT146	КТ501И
SFT163	П423
SFT187	КТ602А
SFT212	ГТ703Г
SFT213	ГТ703Г
SFT214	П217
SFT223	МП20Б
SFT238	П216
SFT239	П217
SFT240	П217
SFT250	П217, ГТ701А
SFT251	МП20А, МП39Б
SFT252	МП20А, МП39Б
SFT253	МП20А, МП39Б
SFT306	МП39Б
SFT307	КТ208В
SFT308	КТ208В
SFT316	П422
SFT319	П416
SFT320	П416
SFT321	МП20А
SFT322	МП20Б
SFT323	МП20Б
SFT325	ГТ402И
SFT351	МП39Б
SFT352	МП39Б
SFT353	МП39Б
SFT354	П422
SFT357	П422
SFT358	П423
SFT377	ГТ404Ж
SGM2004M	КТ379Б9
SGSD200	КТ896А
SGSF344	КТ8121А
SGSF444	КТ8114Б, КТ8127Б
SGSF564	КТ8107Д2, КТ8183Б
SGSP201	КП727Ж
SGSP574	КП718Б, КП718Б1
SL362	КТС3174АС2
SL362	2ТС3174АС2
SMBTA05	КТ3184А9
SML3552	КТ830Б
SS106	КТ340В
SS108	КТ340В
SS109	КТ340В

Зарубежный транзистор	Приближенный отечественный аналог
SS125	КТ617А
SS126	КТ608А
SS216	КТ375Б, КТ340Г
SS218	КТ375Б, КТ349Г
SS219	КТ375Б, КТ340Г
SS8050B	КТ6114А, КТ6134А
SS8050C	КТ6114Б, КТ6134Б
SS8050D	КТ6114В, КТ6134В
SS8550B	КТ6115А, КТ6133А
SS8550C	КТ6115Б, КТ6133Б
SS8550D	КТ6115В, КТ6133В
SS9012D	КТ6109А
SS9012E	КТ6109Б
SS9012F	КТ6109В
SS9012G	КТ6109Г
SS9012H	КТ6109Д
SS9013	КТ525А
SS9013D	КТ6110А
SS9013E	КТ6110Б
SS9013F	КТ6110В
SS9013G	КТ6110Г
SS9013H	КТ6110Д
SS9014	КТ526А
SS9014A	КТ6111А
SS9014B	КТ6111Б
SS9014C	КТ6111В
SS9014D	КТ6111Г
SS9015A	КТ6112А
SS9015B	КТ6112Б
SS9015C	КТ6112В
SS9016D	КТ6128А
SS9016E	КТ6128Б
SS9016F	КТ6128В
SS9016G	КТ6128Г
SS9016H	КТ6128Д
SS9016I	КТ6128Е
SS9018	КТ6140А
SS9018D	КТ6113А
SS9018E	КТ6113Б
SS9018F	КТ6113В
SS9018G	КТ6113Г
SS9018H	КТ6113Д
SS9018I	КТ6113Е
SSU1N60	КП7129А
SSY20	КТ617А
STH75N06	КП742А
STH80N05	КП742Б
STHI08100	КП810А
STHI20N50	КП953А, КП955А
STHI20N50	КП955Б, КП953А
STP40N10	2П771А, КП771А
STP60S	КТ888Б, 2Т888Б
STP70S	КТ888А, 2Т888А
SVT7571	2Т878В
SXTA42	КТ6135А9
T241	МП20А
T242	МП21В
T243	МП21Г
T316H	П402, П416А
T317	П401
T319	П401
T320	П401
T321N	МП38, МП37А
T322N	МП37Б
T323N	МП38А
T354H	П403, П416А
T357H	П403А
T358H	П403
TCH98	КТ208Е
TCH98B	КТ501К
TCH99	КТ208К
TG2	МГТ108А
TG3A	МГТ108В
TG3F	МГТ108Г
TG4	МГТ108А
TG5	ГТГ15Б
TG50	МП20А
TG51	МП21Г
TG52	МП20А
TG53	МП20А
TG55	МП20А
TG5E	ГТ115А, П27
TH430	2Т9131А
TH430	КТ9126А, КТ980Б
TIP110	КТ716А, КТ8214А, КТ8243В5
TIP111	КТ716Б, КТ8214Б, КТ8243Б5
TIP112	КТ716В, КТ8214В, КТ8243А5
TIP115	КТ852В, КТ8215А, КТ8242В5
TIP116	КТ852Б, КТ8215Б, КТ8242Б5
TIP117	КТ852А, КТ8215В, КТ8243А5
TIP120	КТ716В, КТ829В, КТ8116А, КТ8234В5
TIP121	КТ716Б, КТ829Б, КТ8116Б, КТ8234Б5
TIP122	КТ716А, КТ829А, КТ8116В, КТ8243А5
TIP125	КТ853В, КТ8115А, КТ8233В5
TIP126	КТ853Б, КТ8115Б, КТ8233Б5
TIP127	КТ853А, КТ8115В, КТ8233А5
TIP132	КТ899А
TIP146	КТ896А
TIP151	КТ8109А
TIP29	КТ815А, 2Т815А
TIP2955	КТ8149А1, КТ739А
TIP29A	КТ815Б
TIP29B	КТ815В
TIP29C	КТ815Г
TIP30	КТ814А
TIP3055	КТ8150А1, КТ738А
TIP30A	КТ814Б
TIP30B	КТ814В
TIP30C	КТ814Г
TIP31	КТ817А, КТ734А
TIP31A	КТ817Б, КТ8176А, КТ734Б
TIP31B	КТ817В, КТ8176Б, КТ734В
TIP31C	КТ817Г, КТ8176В, КТ734Г
TIP32	КТ816А, КТ8177А, КТ735А
TIP32A	КТ816Б, КТ8177Б, КТ735Б
TIP32B	КТ816В, КТ8177В, КТ735В
TIP32C	КТ816Г, КТ735Г
TIP35F	КТ8229А
TIP36F	КТ8230А
TIP41	КТ819А, КТ736А
TIP41A	КТ819Б, КТ736Б, КТ8212В
TIP41B	КТ819В, КТ736В, КТ8212Б
TIP41C	КТ819Г, КТ736Г, КТ8212А
TIP42	КТ737А
TIP42A	КТ737Б, КТ8213В
TIP42B	КТ737В, КТ8213Б
TIP42C	КТ737Г, КТ8213А, КТ837А
TIP50	КТ854А
TIP519	КТ842Б
TIP61	КТ815А
TIP61A	КТ815Б
TIP61B	КТ815В
TIP61C	КТ815Г
TIP62	КТ814А
TIP62A	КТ814Б
TIP62B	КТ814В
TIP62C	КТ814Г
TIP661	КТ892Б
TIP662	КТ892В
TIX3024	ГТ341Б
TIXM101	ГТ341А
TIXM103	ГТ362А
TIXM104	ГТ341В
TIXS36	2П914А
TN0535	КП511А
TN0540	КП511Б
TPQ4071	2ТС693АС
TPQ7041	КТ693АС
TPV375	КТ9116Б
TPV376	КТ9133А1, КТ91173А1
TPV394	КТ9116А
TPV5051	КТ9153А, 2Т9142А
TPV595A	КТ9150А
TRSP5014	КТ509А
TRW2020	2Т9122Б
TRW2020	КТ948А
U291	КП601А
U320	КП601Б
U320	КП601Б
UC714	КП302А
UDR500	КТ9136АС, 2Т9136АС
UF28100	КП928Б
UMIL40FT	2П920А
UMIL40FT	КП923А
UPT315	КТ841Г, КТ506Б
VMP1	КП901А
VMP4	КП902А
VN89AD	КП901Б
VSF9330	АП331А2
WSH71G	КТ3129Б9
XGSR10040	КТ862Б
YTF4125	КТ3140А
YTF4126	КТ3140Б
YTF623	2П703А
YTF832	КП805А
ZT2475	КТ316Б
ZTX658	КТ6135А
ZVN2120	КП501А

5.6. Аналоги отечественных транзисторов

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
1Т101	
1Т101А	
1Т101Б	
1Т102	
1Т102А	
1Т115А	АС107, 2N107
1Т115Б	2N506
1Т115В	2N535A
1Т115Г	АС122, 2N536
1Т116А	
1Т116Б	
1Т116В	
1Т116Г	
1Т303	
1Т303А	
1Т303Б	
1Т303В	
1Т303Г	
1Т303Д	
1Т305А	2N499
1Т305Б	AFY39
1Т305В	2N1292
1Т308А	2N797
1Т308Б	2N796
1Т308В	2N2048
1Т308Г	—
1Т3110А-2	
1Т311А	2N2699
1Т311Б	2N2699
1Т311Г	2N1585
1Т311Д	2N2482
1Т311К	
1Т311Л	
1Т313А	AFY11
1Т313Б	2N1742
1Т313В	2N741
1Т320А	2N3883
1Т320Б	2N711A
1Т320В	2N705
1Т321А	2SA479
1Т321Б	2SA412
1Т321В	2SA78
1Т321Г	2N1384
1Т321Д	2SA312
1Т321Е	2N1204
1Т329А	2N5041
1Т329Б	2N5043
1Т329В	
1Т330А	
1Т330Б	
1Т330В	
1Т330Г	
1Т335А	
1Т335Б	
1Т335В	
1Т335Г	

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
1Т335Д	
1Т341А	TIXM101
1Т341Б	TIX3024
1Т341В	TIXM104, 2N2999
1Т362А	TIXM103
1Т374А-6	
1Т376А	2N700A, 2N2360, 2N2415
1Т383А-2	2N5043
1Т383Б-2	TIXM105
1Т383В-2	
1Т386А	
1Т387А-2	
1Т387Б-2	
1Т403А	AD152
1Т403Б	AD152, AD164
1Т403В	ASY77
1Т403Г	ADP466, ASY77
1Т403Д	ASY80
1Т403Е	AD155, AD169
1Т403Ж	5NU72
1Т403И	AC124
1Т612А-4	
1Т614А	
1Т615	
1Т702А	
1Т702Б	
1Т702В	
1Т806А	AL102, AUY35
1Т806Б	AL103, AU108
1Т806В	AL100, AUY38
1Т813А	
1Т813Б	
1Т813В	
1Т901А	
1Т901Б	
1Т905А	AUY10
1Т906А	
1Т910АД	
2Е701А	—
2Е701Б	—
2Е701В	
2Е701Г	
2П101А	
2П101Б	
2П101В	
2П103А	2N3329
2П103АР	
2П103Б	
2П103БР	
2П103В	
2П103ВР	
2П103Г	
2П103ГР	
2П103Д	
2П103ДР	
2П201А-1	

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
2П201Б-1	
2П201В-1	
2П201Г-1	
2П201Д-1	
2П201Е-1	
2П201Ж-1	
2П202Д-1	
2П202Е-1	
2П301А	
2П301А-1	
2П301А-5	
2П301Б	2N4038
2П301Б-1	
2П301В	
2П301В-1	
2П302А	UC714, 2N3791
2П302А-1	
2П302Б	2N5397
2П302Б-1	
2П302В	MFE2098
2П302В-1	
2П303А	2N3823
2П303Б	2N5556
2П303В	
2П303Г	
2П303Д	2N3823
2П303Е	MFE3006
2П303И	2N3822
2П304А	2N4268, J175
2П305А	MFE3004, J175
2П305А-2	
2П305Б	2N4224
2П305Б-2	
2П305В	
2П305В-2	
2П305Г	
2П305Г-2	
2П306А	MFE3107
2П306Б	TA7262
2П306В	MFE121
2П306Г	
2П306Д	
2П306Е	
2П307А	2N5394
2П307Б	2N4223, 2N4220
2П307В	2N4224
2П307Г	MFE2001, 2N4216
2П307Д	MFE2002
2П308А	
2П308А-1	MMBF54592
2П308А-9	
2П308Б	
2П308Б-1	
2П308Б-9	
2П308В	
2П308В-1	

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
2П308В-9	MMBF54592
2П308Г	
2П308Г-1	
2П308Г-9	
2П308Д	
2П308Д-1	
2П308Д-9	
2П308Е-9	
2П310А	SD200
2П310Б	SD201
2П312А	SFE264
2П312А-5	
2П312Б	2N4416
2П312Б-5	
2П313А	
2П313Б	
2П313В	
2П322А	3SK68
2П333А	2N4393
2П333Б	
2П333В	
2П333Г	
2П334А	
2П334Б	
2П335А-2	
2П335Б-2	
2П336А-1	
2П336Б-1	
2П337АР	
2П337БР	
2П338АР-1	
2П340А	IRF340
2П340А-1	
2П340Б-1	
2П341А	2SK316
2П341Б	2SK508
2П347А-2	BF966
2П350А	3N140
2П350Б	BF905
2П601А	CP640, U291
2П601А9	
2П601Б	
2П609А	
2П609А-5	
2П609Б	
2П609Б-5	
2П701А	BUZ385, BUZ43
2П701Б	MTM475
2П702А	MTM8N35
2П703А	YTF623, IRF9620
2П703Б	IRF9621
2П706А	MTM15N50
2П706Б	IRF841
2П706В	BUZ385
2П7102А1	IRFZ44
2П7118А	
2П7118Б	
2П7118В	
2П7118Г	

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
2П7118Д	
2П7118Е	
2П7118Ж	
2П7118И	
2П7118К	
2П7118Л	
2П712А	IRF9130
2П712А-5	
2П712Б	
2П712Б-5	
2П712В	
2П712В-5	
2П7140А1	IRF7103
2П7141А1	IRF5210
2П7142А1	IRF7316
2П7143А1	IRF7416
2П7144А1	IRF9140
2П7145А	
2П724А	MTP6N60
2П762А	
2П762Б1	
2П762В	
2П762Г1	
2П762Г1-5	
2П762Д	
2П762Е1	
2П762Е1-5	
2П762Ж	
2П762И2	
2П762И2-5	
2П762К	
2П762Л	
2П762М	
2П762Н	
2П771А	STP40N10
2П771А91	
2П797Г	IRF540
2П797Г91	
2П802А	2SK215, IRF420
2П802Б	IRF420
2П803А	BUZ54A
2П803Б	MTM2N85, BUZ53A
2П815А	
2П815Б	
2П815В	
2П815Г	
2П816А	
2П816Б	
2П816В	
2П816Г	
2П901А	VMP1
2П901А-5	
2П901Б	VN89AD
2П901Б-5	
2П902А	VMP4, DV1202S
2П902Б	2NL234B
2П903А	CP651
2П903А-5	
2П903Б	

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
2П903Б-5	
2П903В	
2П903В-5	
2П904А	B850-35
2П904Б	MRF148
2П905А	2N4092
2П905А-5	
2П905Б	
2П907А	
2П907Б	
2П908А	3N169, IVN5200
2П908Б	
2П909А	BF50-35
2П909Б	DV1007
2П909В	
2П909Г	
2П911А	CF4-28
2П911Б	F2012
2П912А	IRF130, REM18N10
2П912Б	2N6658, 2N6755
2П913А	F1021
2П913Б	DV28120
2П914А	TIXS36, 2N4391
2П917А	IVN6000KNR
2П917Б	
2П918А	F2013
2П918Б	
2П920А	UMIL40FT, F1020
2П920Б	DV28120
2П922А	IRF132
2П922А-5	
2П922Б	RFM12N10
2П922Б-5	
2П923А	F2001, UMIL40FT
2П923Б	F2002, F2013/H
2П923В	F2003, F1053
2П923Г	F2005, F2007
2П926А	
2П926Б	
2П928А	F1027, DV28120
2П928Б	UF28100U
2П933А	F2006
2П933Б	F1053
2П934А	
2П934Б	
2П938А	
2П938Б	
2П938В	
2П938Г	
2П938Д	
2П941А	F1201
2П941Б	F1202
2П941В	
2П941Г	
2П941Д	
2П942А	
2П942А-5	
2П942Б	
2П942Б-5	

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
2П942В	
2П942В-5	
2П953А	STHI20N50
2П953Б	—
2П953В	—
2П953Г	—
2ПС104А	
2ПС104Б	
2ПС104В	
2ПС104Г	
2ПС104Д	
2ПС104Е	
2ПС202А-2	
2ПС202Б-2	
2ПС202В-2	
2ПС202Г-2	
2ПС202Д-1	
2ПС202Е-1	
2ПС316А-1	
2ПС316Б-1	
2ПС316В-1	
2ПС316Г-1	
2Т104А	2N1028
2Т104Б	BSZ10
2Т104В	OC202
2Т104Г	OC200, 2N1219
2Т117А	BRY56
2Т117А-5	
2Т117Б	2N2647
2Т117В	2N4893
2Т117Г	MU4894
2Т118А	3N105, 3N74
2Т118А-1	3N105, 3N74
2Т118Б	3N106
2Т118Б-1	3N106, 3N107
2Т118В	3N107
2Т126А-1	
2Т126Б-1	
2Т126В-1	
2Т126Г-1	
2Т127А-1	
2Т127Б-1	
2Т127В-1	
2Т127Г-1	
2Т201А	2N2432
2Т201Б	2N2432A
2Т201В	2N1590
2Т201Г	2N2617
2Т201Д	2N2617
2Т202А-1	
2Т202Б-1	
2Т202В-1	
2Т202Г-1	
2Т202Д-1	
2Т203А	OC203
2Т203Б	2N923
2Т203В	2N2277
2Т203Г	
2Т203Д	

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
2Т205А-3	
2Т205Б-3	
2Т208А	2N2332
2Т208Б	2N2333
2Т208В	BCY91
2Т208Г	BCY33, 2N2334
2Т208Д	BCY12, 2N2335
2Т208Е	BCY10, BCY90
2Т208Ж	2N923
2Т208И	BCY92
2Т208К	BCY93
2Т208Л	BCY11
2Т208М	BCY31
2Т211А-1	—
2Т211Б-1	—
2Т211В-1	—
2Т214А-1	—
2Т214А-5	—
2Т214А-9	2N1036
2Т214Б-1	—
2Т214Б-5	—
2Т214Б-9	2N1655
2Т214В-1	—
2Т214В-5	—
2Т214В-9	—
2Т214Г-1	—
2Т214Г-5	—
2Т214Г-9	—
2Т214Д-1	—
2Т214Д-5	—
2Т214Д-9	—
2Т214Е-1	—
2Т214Е-5	—
2Т214Е-9	—
2Т215А-1	2N1573
2Т215А-5	—
2Т215А-9	—
2Т215Б-1	2N1923
2Т215Б-5	—
2Т215Б-9	—
2Т215В-1	—
2Т215В-5	—
2Т215В-9	—
2Т215Г-1	—
2Т215Г-5	—
2Т215Г-9	—
2Т215Д-1	—
2Т215Д-5	—
2Т215Д-9	—
2Т215Е-1	—
2Т215Е-5	—
2Т215Е-9	—
2Т301Г	2N1390
2Т301Д	2N842
2Т301Е	BC101
2Т301Ж	2N843
2Т306А	BSX66
2Т306Б	2SC601
2Т306В	2SC400

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
2Т306Г	BSX67
2Т307А-1	—
2Т307Б-1	—
2Т307В-1	—
2Т307Г-1	—
2Т3101А-2	2SC1236
2Т3106А-2	2SC1254
2Т3108А	2N3250
2Т3108Б	2N3251
2Т3108В	2N3250A
2Т3114А-6	NE73435
2Т3114Б-6	MA2123
2Т3114В-6	2N5650
2Т3115А-2	
2Т3115А-6	—
2Т3115Б-2	FJ401
2Т3117А	2N2121, 2N2221
2Т3117Б	2N2121A, 2N2222
2Т3120А	BF480, K5002
2Т3121А-6	FJ203
2Т3123А-2	2N3953, 2SA967
2Т3123Б-2	2SC2369
2Т3123В-2	2SC2368
2Т3124А-2	HP122
2Т3124Б-2	HXTR6101
2Т3124В-2	—
2Т3129А9	BCW89
2Т3129Б9	BCW69
2Т3129В9	BCF29, BCW29
2Т3129Г9	BCF30, BCW30
2Т3129Д9	2SB709
2Т312А	2N702
2Т312Б	BCY42, 2SC105
2Т312В	BCY43, 2N703
2Т3130А-9	BCW71, BCW60A
2Т3130Б-9	BCF81, BCW72
2Т3130В-9	BCF32, BCW60C
2Т3130Г-9	BCW33
2Т3130Д-9	BCW32
2Т3130Е-9	BCF33
2Т3132А-2	FJ201F, 2N6617
2Т3132Б-2	HXTR6102
2Т3132В-2	HXTR6101
2Т3132Г-2	—
2Т3133А	
2Т3133А-2	
2Т3134А-1	BFW93
2Т3135А-1	
2Т313А	2N2906,2SA530
2Т313Б	2N3250, 2SA718
2Т3145А9	BCW60AA, BCX70AN
2Т3150Б2	
2Т3152А	BCY93
2Т3152Б	—
2Т3152В	—
2Т3152Г	—
2Т3152Д	—
2Т3152Е	—
2Т3154А-1	—

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
2Т3155АС-1, БС-1	—
2Т3156А-2	—
2Т3158А-2	—
2Т3160А-2	
2Т3162А	
2Т3162А5	
2Т3164А	
2Т3167А-7	
2Т316А	МТ9003, 2N3010
2Т316Б	2N709
2Т316В	2N709A
2Т316Г	2SC40
2Т316Д	2N2784
2Т3174АС-2	SL362
2Т3175А	—
2Т317А-1	
2Т317Б-1	
2Т317В-1	—
2Т3187А-9	—
2Т3187А-91	—
2Т318А-1	—
2Т318Б-1	—
2Т318В-1	—
2Т318В1-1	—
2Т318Г-1	—
2Т318Д-1	—
2Т318Е-1	—
2Т319А-1	—
2Т319Б-1	—
2Т319В-1	—
2Т321А	BSV64
2Т321Б	MM2260
2Т321В	—
2Т321Г	—
2Т321Д	—
2Т321Е	—
2Т324А-1	—
2Т324Б-1	—
2Т324В-1	—
2Т324Г-1	—
2Т324Д-1	—
2Т324Е-1	—
2Т325А	2N2615
2Т325Б	2N2616
2Т325В	2SC612
2Т326А	BC178
2Т326Б	BFY19
2Т331А-1	A141
2Т331Б-1	—
2Т331В-1	—
2Т331Г-1	—
2Т331Д-1	—
2Т332А-1	—
2Т332Б-1	—
2Т332В-1	—
2Т332Г-1	—
2Т332Д-1	—
2Т333А-3	—
2Т333Б-3	—

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
2Т333В-3	—
2Т333Г-3	—
2Т333Д-3	—
2Т333Е-3	—
2Т336А	—
2Т336Б	—
2Т336В	—
2Т336Г	—
2Т336Д	—
2Т336Е	—
2Т348А-3	—
2Т348Б-3	—
2Т348В-3	—
2Т354А-2	2N1219
2Т354Б-2	BFW93
2Т355А	
2Т360А-1	
2Т360Б-1	
2Т360В-1	
2Т363А	2N3516, 2N4260
2Т363Б	2N4261
2Т364А-2	
2Т364Б-2	
2Т364В-2	
2Т366А	BFS62
2Т366А-1	
2Т366Б-1	
2Т366Б1-1	
2Т366В-1	
2Т367А	
2Т368А	2N918
2Т368А-9	—
2Т368Б	2N917
2Т368Б-9	—
2Т370А-1	—
2Т370А9	—
2Т370Б-1	—
2Т370Б9	—
2Т371А	BFR90
2Т372А	2SC1090
2Т372Б	BFR34
2Т372В	2N5652
2Т377А1-2	—
2Т377А-2	—
2Т377Б1-2	—
2Т377Б-2	—
2Т377В1-2	—
2Т377В-2	—
2Т378А1-2	—
2Т378А-2	—
2Т378Б1-2	—
2Т378Б-2	—
2Т378Б-2-1	—
2Т381А-1	—
2Т381Б-1	—
2Т381В-1	—
2Т381Г-1	—
2Т381Д-1	—
2Т382А	MMT2857

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
2Т382Б	BFW92
2Т384А-2	2N3511
2Т384АМ-2	
2Т385А-2	2N4401
2Т385А-9	
2Т385АМ-2	
2Т388А-2	
2Т388А-5	
2Т388АМ-2	
2Т389А-2	2N5456
2Т391А-2	HP3586L
2Т391Б-2	
2Т392А-2	BF316
2Т396А-2	2N3839
2Т397А-2	2SC784
2Т399А	BFW30, 2N2857
2Т504А	2N3439
2Т504А-5	2N5663
2Т504Б	2N2727
2Т504Б-5	—
2Т504В	2N3440
2Т505А	2N5416, MJ4646
2Т505А-5	—
2Т505Б	BFT19A, BFT28C
2Т506А	BUX54
2Т506А-5	—
2Т506Б	BUX84
2Т509А	TRSP5014
2Т509А-5	—
2Т528А-9	—
2Т528Б-9	—
2Т528В-9	—
2Т528Г-9	—
2Т528Д-9	—
2Т602А	BF177
2Т602АМ	BSS38, 2SD668
2Т602Б	2N1566A
2Т602БМ	2SC1567
2Т603А	BSW36
2Т603Б	2SC796
2Т603В	2N2237
2Т603Г	BSW36
2Т603И	2SC151H
2Т606А	2N5090
2Т607А-4	—
2Т608А	BSY34
2Т608Б	2N1959
2Т610А	—
2Т610Б	—
2Т624А-2	2N3303
2Т624АМ-2	—
2Т625А-2	—
2Т625АМ-2	—
2Т625Б-2	—
2Т625БМ-2	—
2Т629А-2	2N3245
2Т629А-5	—
2Т629АМ-2	2N3467
2Т630А	BFY67A, 2N1893

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
2Т630А-5	—
2Т630Б	BC300, 2N1890
2Т632А	2N3495, 2N3497
2Т633А	2N2369
2Т634А-2	—
2Т635А	2N4960
2Т637А-2	
2Т638А	MPSL01, 2SC589
2Т640А1-2	MSC85606
2Т640А-2	NE21960
2Т640А-5	—
2Т640А-6	—
2Т642А1-2	—
2Т642А1-5	
2Т642А-2	AT41485
2Т642А-5	
2Т642Б1-2	—
2Т642В1-2	—
2Т642Г1-2	
2Т643А-2	
2Т643А-5	—
2Т643Б-2	HXTR4101, NE98203
2Т645А	MPS6532
2Т647А-2	NE56755
2Т647А-5	
2Т648А-2	HXTR2101
2Т648А-5	—
2Т649А-2	—
2Т652А	—
2Т652А-2	—
2Т653А	2N4271
2Т653Б	
2Т657А-2	NE021-60
2Т657Б-2	LAE4000
2Т657В-2	—
2Т658А-2	BFQ98B
2Т658Б-2	BFT96
2Т658В-2	—
2Т663А	—
2Т663Б	—
2Т664А9-1	BCX51, BCX53
2Т664Б9-1	BCX52
2Т665А9-1	BCX54, BCX56
2Т665Б9-1	BCX55, 2N1777
2Т669А	
2Т669А1	
2Т670АС	—
2Т671А-2	NE567-55
2Т672А-2	
2Т679А-2	
2Т679А-5	
2Т679Б-2	
2Т679Б-5	
2Т682А-2	HXTR6102, FJ403
2Т682Б-2	AT41435-2
2Т685А	2N6015
2Т685Ж	2N5356
2Т687АС2	MD3762
2Т687БС2	
2Т688А2	
2Т688Б2	
2Т689АС	—
2Т691А2	2SA1224
2Т693АС	TPQ4071
2Т704А	2N3585, BU143
2Т704Б	BDY93, BU204
2Т708А	2SB678
2Т708Б	
2Т708В	BSS61
2Т709А	BDX86C, MJH11019
2Т709А2	
2Т709Б	BDX86B
2Т709Б2	
2Т709В	
2Т709В2	
2Т713А	
2Т716А	TIP112, TIP122
2Т716А-1	
2Т716Б	TIP111, TIP121
2Т716Б-1	
2Т716В	TIP110, TIP120
2Т716В-1	
2Т718А	
2Т718Б	
2Т803А	BDY23
2Т808А	BLY47
2Т808А-2	
2Т809А	BD216, BLY49
2Т8104А	MJ11021, BDX66C
2Т8105А	MJ11020, 2SD1287
2Т8106А	BDV66B, MJH6285
2Т812А	BDY94
2Т812Б	
2Т815А	BD165, TIP29
2Т8164А	MJE13004
2Т817В	BD177
2Т818А	BD292
2Т818А-2	
2Т818Б	BD202, BDT92
2Т818Б-2	
2Т818В	BD204, BDT94
2Т818В-2	
2Т819А	BD291, TIP41
2Т819А-2	2N6130
2Т819Б	BD202, BDT91
2Т819Б-2	
2Т819В	BD201, BDT93
2Т819В-2	
2Т824А	
2Т824АМ	
2Т824Б	
2Т824БМ	
2Т825А	2N6287
2Т825А-2	
2Т825А-5	
2Т825Б	2N6286, BDX86
2Т825Б-2	
2Т825В	2N6285
2Т825В-2	
2Т826А	BU132
2Т826А-5	—
2Т826Б	2SD312
2Т826В	BU132
2Т827А	BDX63A, MJ3521
2Т827А-2	—
2Т827А-5	—
2Т827Б	BDX65
2Т827Б-2	—
2Т827В	BDX85, MJ3520
2Т827В-2	—
2Т828А	BU326A
2Т828Б	2SD640
2Т830А	2N4234, 2N5781
2Т830Б	SML3552, 2N4235
2Т830В	2N4236
2Т830В-1	
2Т830Г	2N4236
2Т830Г-1	
2Т831А	2N4300
2Т831Б	
2Т831В	
2Т831В-1	
2Т831Г	
2Т831Г-1	
2Т832А	
2Т832Б	
2Т834А	SVT6002,SDN6002
2Т834Б	SDN6001
2Т834В	SDN6000
2Т836А	2N3204
2Т836А-5	
2Т836Б	
2Т836В	
2Т836Г	
2Т837А	BD534, TIP42C
2Т837Б	BD536
2Т837В	BD234
2Т837Г	BD225
2Т837Д	2SB434
2Т837Е	2N6125
2Т839А	MJ3480, 2SD380
2Т841А	BDX96, 2N6560
2Т841А-1	
2Т841Б	2SC2122
2Т841Б-1	
2Т841В	
2Т842А	2SB506A
2Т842А-1	
2Т842Б	TIP519
2Т842Б-1	
2Т844А	UPT732
2Т845А	DT4305
2Т847А	2N6678, 2N6672
2Т847Б	
2Т848А	BU608, BUX37
2Т851В	2SA740, 2SB548
2Т856А	BUX48A

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
2Т856Б	BUX48
2Т856В	
2Т856Г	
2Т860А	
2Т860Б	
2Т860Б	
2Т861А	
2Т861Б	
2Т861В	
2Т862А	2N6560
2Т862Б	2N6672
2Т862В	
2Т862Г	
2Т863А	BDY92, 2N6669
2Т866А	BUX21
2Т867А	BUY21, 2N6341
2Т874А	BUW39
2Т874Б	2N5672
2Т875А	2N5626
2Т875Б	2N4130
2Т875В	BDW21
2Т875Г	2SC1115
2Т876А	MJE2955
2Т876Б	2N5625
2Т876В	2N5621
2Т876Г	MJE2955
2Т877А	2N6286
2Т877Б	2N6285
2Т877В	
2Т878А	BUX98A
2Т878Б	BUX98, 2N6678
2Т878В	SVT7571
2Т879А	2N6282, 2N6281
2Т879Б	
2Т880А	
2Т880А-5	—
2Т880Б	2N6730
2Т880Б-5	—
2Т880В	2N5149
2Т880Г	
2Т881А	
2Т881А-5	—
2Т881Б	SDT5504
2Т881Б-5	—
2Т881В	2N5150
2Т881Г	2N5321
2Т882А	
2Т882Б	
2Т882В	
2Т883А	
2Т883Б	
2Т884А	
2Т884Б	
2Т885А	BUS98, BUV74
2Т885Б	BUZ98A
2Т886А	2SC3061
2Т886Б	
2Т887А	AP1009
2Т887Б	

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
2Т888А	STP70S
2Т888Б	STP60S
2Т891А	BUT91, BUT92
2Т903А	2N2947
2Т903Б	2SC517
2Т904А	2N3375
2Т907А	2N3733
2Т908А	BDY92
2Т909А	2N5177
2Т909Б	2N5178
2Т9101АС	FJ0880-28
2Т9102А-2	
2Т9102Б-2	
2Т9103А-2	NEM4205
2Т9103Б-2	NE4203
2Т9104А	MRA0610-3
2Т9104Б	MRA0610-18
2Т9105АС	MRA0610-100
2Т9107А-2	
2Т9108А-2	
2Т9109А	MSC1550M
2Т9110А-2	
2Т9110Б-2	
2Т9111А	PT9790A
2Т9112А	
2Т9113А	
2Т9114А	
2Т9114Б	
2Т9117А	
2Т9117Б	2N6553
2Т9117В	—
2Т9117Г	—
2Т9118А	PH1114-50
2Т9118Б	MRA1214-55
2Т9118В	MRA1014-35
2Т911А	2N4976
2Т911Б	2N4429
2Т9120А	D45H5
2Т9121А	AM82731-45
2Т9121Б	27AM05
2Т9121В	
2Т9121Г	
2Т9122А	NEM2020
2Т9122Б	TRW2020
2Т9123А	—
2Т9123Б	—
2Т9124А	—
2Т9124Б	—
2Т9125АС	BALO105-50
2Т9126А	TH430
2Т9127А	MSC81550M
2Т9127Б	—
2Т9127В	—
2Т9127Г	—
2Т9127Д	—
2Т9127Е	
2Т9127Ж	
2Т9127И	
2Т9127К	

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
2Т9128АС	BALO102-150
2Т9129А	AM83135-40
2Т912А	2N5070, 2N6093
2Т912А-5	—
2Т912Б	2N6093
2Т912Б-5	—
2Т9130А	2SC2688N, 2SC400
2Т9131А	TH430
2Т9132АС	
2Т9133А	TRV376
2Т9134А	HEM3508B-20
2Т9134Б	SD1543
2Т9135А-2	ML500
2Т9136АС	SD1565, UDR500
2Т9137А	FJ9295
2Т9137Б	
2Т9138А	
2Т9139А	P72731B16V
2Т9139Б	MEM3008
2Т9139В	
2Т9139Г	
2Т913А	BLX92, 2N4430
2Т913Б	BLX93, 2N4431
2Т913В	NE1010E-28
2Т9140А	SD1505
2Т9142А	2SC3218, TRY5051
2Т9143А	LT5839
2Т9146А	AM1416-200
2Т9146Б	—
2Т9146В	—
2Т9146Г	—
2Т9146Д	—
2Т9146Е	—
2Т9146Ж	—
2Т9146И	—
2Т9146К	—
2Т9147АС	—
2Т9149А	PZ2024B10V
2Т9149Б	PZ2023-6
2Т914А	2N5161
2Т9153АС	
2Т9153БС	TPV5051
2Т9155А	2SC3217
2Т9155Б	2SC3218
2Т9155В	J02058
2Т9156АС	
2Т9156БС	MRA0510-50H
2Т9158А	PZ2327B15U
2Т9158Б	—
2Т9159А	LT1819
2Т9159А5	—
2Т9161АС	SD1565
2Т9162А	
2Т9162Б	
2Т9162В	
2Т9162Г	
2Т9164А	SD1540
2Т916А	2SC1805
2Т9175А	

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
2Т9175А-4	
2Т9175Б	
2Т9175Б-4	
2Т9175В	
2Т9175В-4	
2Т9183А-5	
2Т9184А	
2Т9188А	
2Т919А	2N5596, MSC2005
2Т919А-2	—
2Т919Б	2N5768, MSC2003
2Т919Б-2	—
2Т919В	2N5483, MSC2001
2Т919В-2	—
2Т920А	2N5589
2Т920Б	BLW18
2Т920В	2N5591
2Т921А	2N5707, S10-12
2Т921А-4	—
2Т922А	2N5641
2Т922Б	2N5642
2Т922В	2N5643
2Т925А	C3-12
2Т925Б	C12-12
2Т925В	C25-12
2Т926А	2N1902
2Т928А	BSS29, 2N2217
2Т928Б	BSX32, 2N2218
2Т929А	B2-8Z, 2N5719
2Т930А	2N6362, CM75-28
2Т930Б	2N6364
2Т931А	2N6369, BM80-28
2Т932А	2N3741
2Т932Б	BD132
2Т933А	BC160-2
2Т933Б	BC139
2Т934А	C3-28, 2N6202, 2SC1021
2Т934Б	C12-28, 2N6203, BLY22
2Т934В	C25-28, 2N6204, BLY92A
2Т935А	BDU53
2Т935А-5	—
2Т937А-2	MS0146
2Т937А-5	—
2Т937Б-2	PTB42003X
2Т938А-2	MSC1001
2Т939А	2SC1262, 2N3866
2Т939А1	—
2Т939Б	K10800
2Т941А	
2Т942А	MRF2010
2Т942А-5	
2Т942Б	
2Т942Б-5	
2Т944А	S80-28
2Т945А	BDY90, 2SC519A
2Т945А-5	—
2Т945Б	2SC408
2Т945В	—
2Т946А	MSC1330, D12-28

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
2Т947А	2N6047, BDP620
2Т948А	MRF2005M
2Т948Б	TRW2020
2Т949А	
2Т950А	A70-28
2Т950Б	
2Т951А	PT9788A
2Т951Б	
2Т951В	
2Т955А	S10-28
2Т956А	S80-28
2Т957А	S150-28
2Т958А	BM40-12
2Т960А	CM40-12
2Т962А	DM10-28
2Т962Б	DM20-28
2Т962В	DM40-28
2Т963А-2	MJ250
2Т963А-5	—
2Т963Б-2	ML500
2Т964А	A70-28
2Т965А	S10-12
2Т966А	S30-12
2Т967А	S70-12
2Т968А	
2Т968А-5	—
2Т970А	C2M100-28A
2Т971А	BM100-128
2Т974А	BSS44
2Т974Б	2N5672
2Т974В	
2Т974Г	
2Т975А	AMPAC1214-125
2Т975Б	PZ1214B1504
2Т976А	PH1114-50C
2Т977А	SD1546
2Т978А	
2Т978Б	
2Т979А	PZB16040U, PH1114-60
2Т980А	CM40-12
2Т980Б	TH430
2Т981А	A50-12
2Т982А-2	MEM430394
2Т982А-5	—
2Т983А	—
2Т983Б	—
2Т983В	—
2Т984А	MSC1075M
2Т984Б	MSC1250M
2Т985АС	BALO204-125
2Т986А	1214P400
2Т986Б	DME250
2Т986В	DME375
2Т986Г	
2Т987А	BALO710-75
2Т988А	MRA0610-18
2Т988Б	
2Т989А	MRA1417-25
2Т989Б	

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
2Т989В	
2Т989Г	
2Т990А-2	
2Т991АС	BALO105-50
2Т993А	
2Т994А-2	AM1416-200
2Т994Б-2	
2Т994В-2	
2Т995А-2	ML500
2Т996А-2	BFP95, S-89
2Т996А-5	FJ9295CC
2Т996Б-2	FJ9295CC
2Т996Б-5	
2Т998А	
2ТС303А-2	MD986
2ТС3103А	MD5000
2ТС3103Б	MD5000B
2ТС3111А-1	—
2ТС3111Б-1	—
2ТС3111В-1	—
2ТС3111Г-1	—
2ТС3111Д-1	—
2ТС3136А-1	—
2ТС3174АС-2	SL362
2ТС393А-1	
2ТС393А-9	MD5000
2ТС393Б-1	
2ТС393Б-9	MD5000B
2ТС398А-1	—
2ТС398А-94	
2ТС398Б-1	
2ТС398Б-94	
2ТС613А	MQ2218
2ТС613Б	MQ2218A
2ТС622А	
2ТС622Б	MH2906, 2N5146
2ТС622Б-1	
2ТС687АС-2	
2ТС843А	
2ТС941А-2	
3П320А-2	NE695
3П320Б-2	NE13783
3П321А-2	
3П324А-2	2SK123
3П324Б-2	2SK124
3П324В-2	AT8040, CFX13
3П325А-2	GAT-5
3П325А-5	
3П326А-2	AT8041, GAT6
3П326А-5	
3П326Б-2	CFX14
3П328А-2	NE46383
3П328А-5	
3П330А-2	JS8830AS
3П330А-5	
3П330Б-2	NE673
3П330В1-2	JS830AS
3П330В-2	CFX14
3П330В2-2	FRH01FH

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
3П330В3-2	FRH01FH
3П331А-2	CFY12, VSF9330
3П331А-5	
3П339А-2	NE388-06
3П343А1-2	CFY25-17, 2SK1616
3П343А-2	CFY25-20
3П343А2-2	MGF4310
3П343А3-2	MGF4415
3П344А1-2	NE76184A
3П344А-2	NE72089A
3П344А2-2	FSC10, ATF0135
3П344А3-2	
3П344А4-2	
3П345А-2	CFY13
3П345А-5	
3П345Б-2	
3П348А-2	
3П349А-2	AT8110
3П351А1-2	
3П351А-2	
3П351А-5	
3П353А-5	NE045
3П372А-2	
3П373А-2	
3П373Б-2	
3П373В-2	
3П376А-5	
3П384А-5	
3П385А-2	
3П385А-5	
3П385Б-2	
3П385Б-5	
3П385В-2	
3П385В-5	
3П602А-2	DXL3501
3П602Б-2	NEZ1112
3П602Б-5	
3П602В-2	CFX31
3П602Г-2	MTC-T1250
3П602Д-2	
3П602Д-5	
3П603А1-2	
3П603А-2	MGF-X35M-01
3П603Б1-2	
3П603Б-2	
3П603Б-5	
3П604А1-2	
3П604А-2	DXL3610A
3П604А-5	
3П604Б1-2	
3П604Б-2	
3П604Б-5	
3П604В1-2	
3П604В-2	
3П604В-5	
3П604Г1-2	
3П604Г-2	
3П604Г-5	
3П605А-2	DXL2608A

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
3П605А-5	
3П606А-2	MGF2116
3П606Б-2	MGF2324-01
3П606Б-5	
3П606В-2	
3П606В-5	
3П607А-2	FLX102MH-12
3П608А-2	JS8864AS
3П608А-5	—
3П608Б-2	—
3П608В-2	—
3П608Г-2	—
3П608Д-5	—
3П608Е-5	—
3П910А-2	FLC15
3П910А-5	—
3П910Б-2	—
3П910Б-5	—
3П915А-2	FLC253, FLM7177-5
3П915Б-2	MA4F300-500
3П925А-2	MSM3742-5
3П925А-5	MP4450-3
3П925Б-2	IM44506
3П925В-2	E3742-3A
3П927А-2	MSC1827
3П927Б-2	MSM1718-05
3П927В-2	PRC9030
3П927Г-2	—
3П927Д-2	—
3П929А-2	MSM7785-10
3П930А-2	FLM5964-8C
3П930Б-2	MSM5694-10
3П930В-2	—
АП320А-2	NE695
АП320Б-2	NE13783
АП324А-2	2SK123
АП324Б-2	2SK124
АП324Б-5	—
АП324В-2	AT8040, CFX13
АП325А-2	GAT-5
АП326А-2	AT8041, CAT6
АП326Б-2	CFX14
АП328А-2	NE46383
АП330А-2	JS8830AS
АП330Б-2	NE673
АП330В1-2	JS830
АП330В-2	CFX14
АП330В2-2	FRH01FH
АП330В3-2	FRH01FH
АП331А-2	CFY12, VSF9330
АП331А-5	—
АП339А-2	NE388-06
АП343А1-2	CFY25-17, 2SK1616
АП343А-2	CFY25-20
АП343А2-2	MGF4310
АП343А3-2	MGF4415
АП344А1-2	NE76184A
АП344А-2	NE72089A
АП344А2-2	FSC10, ATF0135

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
АП344А3-2	FHC30LC/FA
АП344А4-2	
АП354А-5	MCF1402
АП354Б-5	FSC10FA
АП354В-5	MCF1305
АП355А-5	ALF3000
АП355Б-5	S8870
АП355В-5	NE13783
АП356А-5	AT10650-1
АП356Б-5	—
АП356В-5	NE75083
АП357А-5	—
АП357Б-5	—
АП357В-5	MGF4511D
АП358А-5	—
АП358Б-5	—
АП358В-5	NE045
АП362А-9	—
АП362Б-9	—
АП379А-9	CF739
АП379Б-9	SGM2004M
АП381А-5	CFY18-12
АП602А-2	DXL3501
АП602Б-2	NEZ1112
АП602В-2	CFX311
АП602Г-2	MTC-T1250
АП602Д-2	
АП603А-1-2	
АП603А-2	MGF-X35M-01
АП603А-5	
АП603Б-1-2	
АП603Б-2	
АП603Б-5	
АП604А1-2	
АП604А-2	DXL3610A
АП604Б1-2	
АП604Б-2	
АП604В1-2	
АП604В-2	
АП604Г1-2	
АП604Г-2	
АП605А1-2	NE90089A
АП605А-2	DXL2608A
АП605А2-2	AT8250
АП606А-2	MGF2116
АП606А-5	
АП606Б-2	MGF2324-01
АП606Б-5	
АП606В-2	
АП606В-5	
АП607А-2	FLX102MH-12
АП608А-2	JS8864AS
АП608А-5	
АП608Б-2	
АП608В-2	
АП608О-5	
АП608П-5	
АП915А-2	FLM7177-5
АП915Б-2	

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
АП925А-2	
АП925Б-2	
АП925В-2	
АП930А-2	
АП930Б-2	
АП930В-2	
АП967А-2	
АП967Б-2	
АП967В-2	
АП967Г-2	
АП967О-2	
АП967П-2	
АП967Т-2	
ГТ108А	2N130A
ГТ108Б	2N1352
ГТ108В	2N220
ГТ108Г	2N1471
ГТ109А	OC57
ГТ109Б	OC58, 2N77
ГТ109В	OC59
ГТ109Г	2SB90
ГТ109Д	2SA53
ГТ109Е	2N139, 2SA49
ГТ109Ж	2SB90
ГТ109И	2SA49
ГТ115А	FC107, 2N107
ГТ115Б	2N506
ГТ115В	2N535A
ГТ115Г	AC122
ГТ115Д	2SB262
ГТ122А	2N438
ГТ122Б	2N233A
ГТ122В	2N1366
ГТ122Г	2N1366
ГТ124А	2SA195
ГТ124Б	2SA40
ГТ124В	2SA277
ГТ124Г	2SB55
ГТ125А	2SA211
ГТ125Б	2SA173
ГТ125В	2SA391
ГТ125Г	2SA396
ГТ125Д	2SA205
ГТ125Е	2SA204
ГТ125Ж	2SA206
ГТ125И	2SB15
ГТ125К	2SB55
ГТ125Л	2SB15
ГТ305А	2N499A
ГТ305Б	AFY39
ГТ305В	2N1292
ГТ308А	2N797
ГТ308Б	2N796
ГТ308В	2N2048
ГТ308Г	—
ГТ309А	2SA272
ГТ309Б	AF178
ГТ309В	2SA272
ГТ309Г	2SA266

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
ГТ309Д	2SA268
ГТ309Е	2SA69
ГТ310А	2SA260
ГТ310Б	2N503
ГТ310В	AFY13
ГТ310Г	2SA116
ГТ310Д	2N128
ГТ310Е	2SA105
ГТ311А	2N2699
ГТ311Б	2N2699
ГТ311В	2N2482
ГТ311Г	2N1585
ГТ311Д	2N2482
ГТ311Е	2N2699
ГТ311Ж	2N1585
ГТ311И	2N797
ГТ313А	AFY11
ГТ313Б	2N1742
ГТ313В	2N741
ГТ320А	2N3883
ГТ320Б	2N711A
ГТ320В	2N705
ГТ321А	2SA479
ГТ321Б	2SA312
ГТ321В	2SA78
ГТ321Г	2N1384
ГТ321Д	2SA312
ГТ321Е	2N1384
ГТ322А	AF124
ГТ322Б	AF275
ГТ322В	AF271
ГТ322Г	2SA338
ГТ322Д	2SA321
ГТ322Е	2SA322
ГТ323А	
ГТ323Б	
ГТ323В	
ГТ328А	AF109R, AF200
ГТ328Б	AF106, AFY12
ГТ328В	AF106A
ГТ329А	2N5044
ГТ329Б	2N5043
ГТ329В	—
ГТ329Г	—
ГТ330Д	—
ГТ330Ж	AF279, 2NN5044
ГТ330И	AF280
ГТ335А	—
ГТ335Б	—
ГТ335В	—
ГТ335Г	—
ГТ335Д	—
ГТ338А	ASZ23
ГТ338Б	
ГТ338В	
ГТ341А	TIXM101
ГТ341Б	TIX3024
ГТ341В	TIXM104, 2N2999
ГТ346А	AF239, AF253

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
ГТ346Б	AF139, AF240
ГТ346В	AF239S
ГТ362А	TIXM103
ГТ362Б	TIXM103
ГТ376А	2N700A, 2N2360
ГТ383А-2	2N5043
ГТ383Б-2	TIXM105
ГТ383В-2	
ГТ402А	AC152
ГТ402Б	AC132
ГТ402В	AC124
ГТ402Г	AC117
ГТ402Д	AC152
ГТ402Е	AC132, AC188
ГТ402Ж	AC124
ГТ402И	AC117, AC138
ГТ403А	AD152
ГТ403Б	AD152, AD164
ГТ403В	ASY77
ГТ403Г	ADP466, ASY77
ГТ403Д	ASY80
ГТ403Е	AD155, AD169
ГТ403Ж	5NU72
ГТ403И	AC124
ГТ403Ю	ASY80
ГТ404А	AC176
ГТ404Б	AC127, AC141B
ГТ404В	GD607
ГТ404Г	AC181
ГТ404Д	AC141B
ГТ404Е	2SD127
ГТ404Ж	2SD128A
ГТ404И	2SD128
ГТ405А	AC152
ГТ405Б	AC132
ГТ405В	AC124
ГТ405Г	AC117
ГТ406А	AD164
ГТ612А-4	
ГТ701А	AD314, AD542
ГТ703А	AD148
ГТ703Б	2NU73
ГТ703В	AD148, ADY27
ГТ703Г	AD150, AD162
ГТ703Д	4NU73
ГТ705А	2N1292
ГТ705Б	2N4077
ГТ705В	2N326
ГТ705Г	2N1218
ГТ705Д	AD161
ГТ804А	
ГТ804Б	
ГТ804В	
ГТ806А	AL102, AUY35
ГТ806Б	AL103, AU108
ГТ806В	AL100, AUY38
ГТ806Г	AUY35
ГТ806О	AU110
ГТ810А	AU104, AU113

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
ГТ905А	AUY10
ГТ905Б	2N2148
ГТ906А	
ГТ906АМ	
ГТС609А	
ГТС609Б	
ГТС609В	
К129НТ1(А1-И1)	—
К129НТ1А-1	
К129НТ1Б-1	
К129НТ1В-1	
К129НТ1Г-1	
К129НТ1Д-1	
К129НТ1Е-1	
К129НТ1Ж-1	
К129НТ1И-1	
К1НТ251	LDA405
К1НТ661А	2SC1515K
КЕ702А	
КЕ702Б	
КЕ702В	
КЕ707А	IRG4BC30S
КЕ707А2	
КЕ707Б	IRG4BC30U
КЕ707Б2	
КП101Г	
КП101Д	
КП101Е	
КП103Е	2N3329
КП103Е9	
КП103ЕР1	
КП103Ж	
КП103Ж9	
КП103ЖР1	
КП103И	
КП103И9	
КП103ИР1	
КП103К	
КП103К9	
КП103КР1	
КП103Л	
КП103Л9	
КП103ЛР1	
КП103М	
КП103М9	
КП103МР1	2N4360
КП150	RFK35N10, IRF150
КП201Е-1	
КП201Ж-1	
КП201И-1	
КП201К-1	
КП201Л-1	
КП202Д-1	
КП202Е-1	
КП214А-9	2N7200LT1
КП240	IRF240, RFK25N20
КП250	IRF250, 2N6766
КП301Б	2N4038
КП301В	

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КП301Г	
КП302А	UC714, 2N3791
КП302АМ	2N3771
КП302Б	2N5397
КП302БМ	2N3824
КП302В	MFE2098
КП302ВМ	2N3972
КП302Г	NF500, 2N4093
КП302ГМ	2N3971, 2N4393
КП303А	2N3823
КП303А9	
КП303Б	2N5556
КП303Б9	
КП303В	
КП303В9	
КП303Г	
КП303Г9	
КП303Д	2N3823
КП303Д9	
КП303Е	MFE3006
КП303Е9	
КП303Ж	2N3821
КП303Ж9	
КП303И	2N3822
КП303И9	
КП304А	2N4268, JI75
КП305Д	MFE3004, 2N4223
КП305Е	2N4224
КП305Ж	MFE3004, 2N4223
КП305И	2N4224
КП306А	MFE3107
КП306Б	TA7262
КП306В	MFE121
КП307А	2N5394
КП307А1	—
КП307Б	2N4223, 2N4220
КП307Б1	—
КП307В	2N4224
КП307Г	MFE2001, 2N4216
КП307Г1	—
КП307Д	MFE2002
КП307Е	—
КП307Е1	—
КП307Ж	—
КП307Ж1	—
КП308А-1	MMBF54592
КП308Б-1	—
КП308В-1	—
КП308Г-1	—
КП308Д-1	—
КП310А	3N225, SD200
КП310Б	SD201
КП312А	SFE264
КП312Б	—
КП313А	—
КП313Б	—
КП313В	—
КП314А	SD300
КП322А	3SK68

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КП323А-2	2N4416, SD301
КП323Б-2	SD300, 2SK316
КП327А	BF960, BF980
КП327Б	BF961
КП327В	BF964
КП327Г	BF966
КП329А	2N5104
КП329Б	2N3821
КП333А	2N4393
КП333Б	—
КП340	RFK12N40, IRF340
КП341А	2SK316
КП341Б	2SK508
КП346А-9	BF996
КП346Б-9	BF991
КП346В-9	—
КП347А-2	BF966
КП350	IRF350
КП350А	3N140
КП350Б	BF905
КП350В	BF960
КП361А	—
КП364А	—
КП364Б	—
КП364В	—
КП364Г	—
КП364Д	—
КП364Е	—
КП364Ж	—
КП364И	—
КП365А	BF410C, BF410C
КП365Б	BF245C
КП382А	BF960
КП383А-9	BF989S
КП401АС	—
КП401БС	—
КП402А	BSS92
КП403А	BSS89
КП440	RFK10N50, IRF440
КП450	2N6770, IRF450
КП501А	ZVN2120
КП501Б	ZVN2120
КП501В	—
КП502А	BSS124
КП503А	BSS129
КП504А	BSS88
КП504Б	—
КП504В	—
КП505А	BSS295
КП505Б	
КП505В	
КП505Г	
КП507А	BSS315
КП508А	BSS92
КП509А-9	BSS131
КП509Б-9	—
КП509В-9	—
КП510	RFP12N10,IRF510
КП510А9	IRLML2402

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КП511А	TN0535
КП511Б	TN0540
КП520	IRF520
КП523А	BSS297A
КП523Б	—
КП523В	
КП523Г	
КП530	RFP18N10, IRF530
КП540	IRF540
КП601А	CP643
КП601Б	CP651
КП610	RFP8N20, IRF610
КП620	IRF620
КП630	IRF630
КП640	IRF640
КП704А	BUZ32
КП704Б	BUZ31
КП705А	BUZ53A
КП705Б	IXTM4N95
КП705В	—
КП706А	MTM15
КП706Б	IRF841
КП706В	BUZ385
КП707А	2SK298
КП707А1	IRF730, BUZ60
КП707А2	—
КП707Б	—
КП707Б1	BUZ90
КП707В	—
КП707В1	IRFBE30
КП707В2	IRFBE32
КП707Г	—
КП707Г1	—
КП707Д	—
КП707Д1	IRF830
КП707Е	
КП707Е1	—
КП708А	—
КП708Б	—
КП709А	—
КП709Б	BUZ90A
КП709В	BUZ90
КП709Г	—
КП709Д	—
КП710	IRF710
КП7128	IRF5210
КП7129А	SSU1N60
КП712А	IRF9130
КП712Б	
КП712В	
КП7130А	IRFBC40
КП7130А2	—
КП7130А9	IRFBC40S
КП7130Б	—
КП7130В	—
КП7131А-9	IRF7101
КП7132А	HUF7507P3
КП7132А1	—
КП7132А9	HUF7507

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КП7132А91	HUF7507
КП7132Б	—
КП7132Б1	—
КП7132Б9	—
КП7132Б91	—
КП7133А	IRF640
КП7133А9	IRF640S
КП7134А	IRF630
КП7135А	IRF620
КП7136А	IRF740
КП7137А	IRF840
КП7138А	IRFR1N60
КП7138А9	—
КП7138А91	IRFR1N60A
КП7150А	IRFZ44E
КП7150А2	—
КП7150А9	IRFZ44ES
КП717А	2N6769
КП717А1	IRFP453
КП717Б	IRF350, 2N6768
КП717Б1	BUZ323
КП717В	2N6767, IRF353
КП717В1	IRFP353
КП717Г	IRF352
КП717Г1	IRFP352
КП717Д	RFK12N35, IRF341
КП717Д1	IRFP341
КП717Е	RFK12N40, IRF340
КП717Е1	IRFP340
КП718А	BUZ45
КП718А1	BUZ330
КП718Б	SGSP57
КП718Б1	SGAP57
КП718В	BUZ45A
КП718В1	BUZ354
КП718Г	RFK10N45, IRF441
КП718Г1	IRFP441
КП718Д	IRF452
КП718Д1	IRFP452
КП718Е	IRF453
КП718Е1	IRFP453
КП720	IRF720
КП722А	BUZ36
КП723А	IRFZ44
КП723Б	IRFZ45
КП723В	IRLZ34, IRFZ40
КП723Г	IRLZ44, IRF42
КП724А	MTP6N60
КП724Б	IRF842
КП725А	IRF450
КП726А	BUZ90A
КП726А1	BUZ90A
КП726Б	BUZ90
КП726Б1	BUZ90
КП727Е	2SK700
КП727А	BUZ71, IRF720
КП727Б	MTP3N08L
КП727В	MTP3N08L
КП727Г	2SK1057

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КП727Д	2SK1087
КП727Е	2SK700
КП727Ж	SGSP201
КП728А	BUZ307
КП728Г1	—
КП728Г2	—
КП728Е1	—
КП728Е2	—
КП728С1	—
КП728С2	—
КП730	IRF730
КП730А	IRGPH50F
КП731	IRGBC40M
КП731А	IRF710
КП731Б	IRF711
КП731В	IRF712
КП733А	IRF710
КП733Б	RFP4N40
КП733В-1	—
КП733Г	IRFBC20
КП733Д	—
КП734А	NDP506A
КП734А-1	NDP506AL
КП734Б	NDP506B
КП734Б-1	NDP506BL
КП734В	NDP601
КП735А	NDP606A
КП735Б	NDP606B
КП735В	NDP605A
КП735Г	NDP605B
КП737А	IRF630
КП737Б	IRF634
КП737В	IRF635
КП737Г	IRL630
КП739А	IRFZ14
КП739Б	IRFZ10
КП739В	IRFZ15
КП740	IRF740
КП740А	IRFZ24
КП740Б	IRFZ20
КП740В	IRFZ25
КП741А	IRF48
КП741Б	IRF46
КП742А	STH75N06
КП742Б	STH80N05
КП743А	IRF510, RFP12N10
КП743А1	—
КП743Б	IRF511, RFP12N08
КП743В	IRF512
КП744А	IRF520
КП744Б	IRF521
КП744В	IRF522
КП744Г	IRL520
КП745А	IRF530, RFP18N10
КП745Б	IRF531, RFP18N08
КП745В	IRF532
КП745Г	IRL530
КП746А	IRF540N
КП746А1	—

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КП746Б	IRF541, RFP25N06
КП746Б1	—
КП746В	IRF542
КП746В1	—
КП746Г	IRL540
КП746Г1	—
КП747А	IRFP150, 2N6764
КП748А	IRF610, RFP8N20
КП748Б	IRF611, RFP10N15
КП748В	IRF612
КП749А	IRF620
КП749Б	IRF621, RFP8N18
КП749В	IRF622
КП750А	IRF640
КП750А1	IRF640
КП750Б	IRF641, RFP15N15
КП750Б1	IRF641
КП750В	IRF642
КП750В1	IRF642
КП750Г	IRL640
КП751А1	IRF720
КП751Б1	IRF721
КП751В1	IRF722, RFP4N40
КП752А	IRF730, RFP7N40
КП752Б	IRF731, RFP7N35
КП752В	IRF732
КП753А	IRF830, RFP6N50
КП753Б	IRF831, RFP6N45
КП753В	IRF832
КП759А	IRF820, RFP3N50
КП759Б	IRF821, RFP3N45
КП759В	IRF822
КП759Г	IRF823
КП760А	IRF830
КП760Б	IRF831
КП760В	IRF832
КП760Г	IRF833
КП761А	IRF840
КП761Б	IRF841
КП761В	IRF842
КП761Г	IRF843
КП771А	
КП771Б	STP40N10
КП771В	—
КП775А	2SK2498A
КП775Б	2SK2498B
КП775В	—
КП776А	IRF740
КП776Б	IRF741
КП776В	IRF742
КП776Г	IRF744
КП777А	IRF840
КП777Б	IRF841
КП777В	IRF842
КП778А	IRFP250
КП779А	IRFP450
КП780А	IRF820
КП780АС1	IRFU420
КП780Б	IRF821
КП780В	IRF822
КП781А	IRFP350
КП783А	IRF3205
КП784А	IRF9Z34
КП785А	IRF9540
КП786А	BUZ80A
КП787А	BUZ91A
КП789А	BUZ111S
КП796А	IRF9634
КП801А	BF960, 2SK60
КП801Б	2SK76A
КП801В	2SK134
КП801Г	2SK133
КП802А	2SK215, IRF420
КП802Б	IRF420
КП803А	BUZ54A
КП804А	IRFD111
КП805А	YTF832
КП805Б	IRFBC40
КП805В	
КП809А	IRF340
КП809А1	
КП809Б	BUZ45
КП809Б1	
КП809В	BUZ94
КП809В1	
КП809Г	
КП809Г1	
КП809Д	BUZ220
КП809Д1	
КП809Е	
КП809Е1	
КП809К	
КП810А	STH108100
КП810Б	
КП810В	STH108N100
КП812А1	IRFZ44
КП812Б1	IRFZ45
КП812В1	IRFZ34
КП813А	BUZ36
КП813А1	BUZ350
КП813А1-5	—
КП813Б	
КП813Б1	
КП813Б1-5	—
КП813Г	
КП814А	
КП814Б	
КП814В	
КП814Г	
КП814Д	
КП814Е	
КП814Ж	
КП814И	
КП814К	
КП814Л	
КП814М	
КП814Н	
КП814П	
КП814Р	
КП814С	
КП814Т	
КП814У	
КП814Ф	
КП817А	
КП817Б	
КП817В	IRF9Z34
КП820	IRF820
КП830	IRF830
КП840	IRF840
КП901А	VMP1
КП901Б	VN89AD
КП902А	VMP4
КП902Б	2NL234B
КП902В	DV1202S
КП903А	CP651
КП903Б	
КП903В	
КП904А	B850-35
КП904Б	MRF148
КП905А	2N4092
КП905Б	
КП905В	
КП907А	
КП907Б	
КП907В	
КП908А	3N169, IVN5200
КП908Б	
КП921А	
КП921Б	
КП922А	IRF132
КП922А1	
КП922Б	
КП922Б1	
КП922В	
КП922В1	
КП922Г1	
КП923А	F2001, UMIL40FT
КП923Б	F2002, F2013/H
КП923В	F2003, F1053
КП923Г	F2004
КП928А	F1027
КП928Б	UF28120
КП931А	
КП931Б	
КП931В	
КП932А	
КП934А	
КП934А1	
КП934Б	
КП934Б1	
КП934В	
КП934В1	
КП936А	—
КП936А-5	—
КП936Б	—
КП936Б-5	—
КП936В	—

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КП936В-5	—
КП936Г	—
КП936Г-5	—
КП936Д	2SK1917M
КП936Д-5	—
КП936Е	IRFY340M
КП936Е-5	—
КП937А	2SK1409
КП937А-5	
КП938А	
КП938Б	
КП938В	
КП938Г	
КП938Д	
КП944А	IRF9020
КП944Б	
КП945А	IRFR020
КП945Б	
КП946А	—
КП946Б	—
КП948А	
КП948Б	
КП948В	
КП948Г	
КП951А-2	F1201
КП951Б-2	
КП951В-2	
КП953А	STHI20N50
КП953Б	—
КП953В	MG25BZ50
КП953Г	—
КП953Д	
КП954А	
КП954Б	
КП954В	
КП954Г	
КП954Д	
КП955А	STHI20N50
КП955Б	MG25BZ50
КП956А	
КП956Б	
КП957А	
КП957Б	
КП957В	
КП958А	
КП958Б	
КП958В	
КП958Г	
КП959А	
КП959Б	
КП959В	
КП960А	
КП960Б	
КП960В	
КП961А	
КП961Б	
КП961В	
КП961Г	
КП961Д	

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КП961Е	
КП962А	
КП962А-5	—
КП963А	—
КП963А-5	—
КП964А	—
КП964Б	
КП964В	
КП964Г	
КП965А	
КП965Б	
КП965В	
КП965Г	
КП965О	
КП971А	
КП971Б	
КП973А	
КП973Б	
КПС104А	
КПС104Б	
КПС104В	
КПС104Г	
КПС104Д	
КПС104Е	
КПС202А-2	
КПС202Б-2	
КПС202В-2	
КПС202Г-2	
КПС203А-1	
КПС203Б-1	
КПС203В-1	
КПС203Г-1	
КПС315А	
КПС315Б	
КПС316Д-1	
КПС316Е-1	
КПС316Ж-1	
КПС316И-1	
КТ104А	2N1028
КТ104Б	BSZ10
КТ104В	OC202
КТ104Г	OC200, 2N1219
КТ117А	BRY56
КТ117Б	2N2647
КТ117В	2N4893
КТ117Г	MU4894
КТ118А	3N105, 3N74
КТ118Б	3N106
КТ118В	3N107
КТ119А	2N1671
КТ119Б	2N4891
КТ120А	
КТ120А-1	
КТ120А-5	
КТ120Б	
КТ120В	
КТ120В-1	
КТ120В-5	
КТ127А-1	

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ127Б-1	
КТ127В-1	
КТ127Г-1	
КТ132А	2N2646
КТ132Б	2N2647
КТ133А	2N4870
КТ133Б	2N4871
КТ201А	2N2432
КТ201АМ	2N3565
КТ201Б	2N2432A
КТ201БМ	MPS9601
КТ201В	2N1590
КТ201ВМ	MPS9600
КТ201Г	2N2617
КТ201ГМ	2N2932
КТ201Д	2N2617
КТ201ДМ	2N2933
КТ202А-1	
КТ202Б-1	
КТ202В-1	
КТ202Г-1	
КТ202Д-1	
КТ203А	OC203
КТ203АМ	
КТ203Б	2N923
КТ203БМ	
КТ203В	2N2277
КТ203ВМ	
КТ206А	
КТ206Б	
КТ207А	
КТ207Б	
КТ207В	
КТ208А	2N2332
КТ208Б	2N2333
КТ208В	BCY91
КТ208Г	BCY33, 2N2334
КТ208Д	BCY12, 2N2335
КТ208Е	BCY10, BCY90
КТ208Ж	2N923
КТ208И	BCY92
КТ208К	BCY93
КТ208Л	BCY11
КТ208М	BCY31
КТ209А	MPS404
КТ209Б	MPS404
КТ209В	MPS404
КТ209В2	MPS404
КТ209Г	MPS404
КТ209Д	MPS404
КТ209Е	MPS404
КТ209Ж	MPS404
КТ209И	MPS404
КТ209К	MPS404A
КТ209К9	MMBT404A
КТ209Л	MPS404A
КТ209М	MPS404A
КТ210А	
КТ210Б	

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ210В	
КТ211А-1	МП35, МП39
КТ211Б-1	МП35, МП39
КТ211В-1	МП35, МП39
КТ214А-1	
КТ214Б-1	
КТ214В-1	
КТ214Г-1	
КТ214Д-1	
КТ214Е-1	
КТ215А-1	
КТ215Б-1	
КТ215В-1	
КТ215Г-1	
КТ215Д-1	
КТ215Е-1	
КТ216А	
КТ216Б	
КТ216В	
КТ218А-9	КТ214
КТ218Б-9	КТ214
КТ218В-9	КТ214
КТ218Г-9	КТ214
КТ218Д-9	КТ214
КТ218Е-9	КТ214
КТ220А9	KSC1623
КТ220Б9	KSC1623
КТ220В9	KSC1623
КТ220Г9	KSC1623
КТ301	
КТ301А	
КТ301Б	
КТ301В	
КТ301Г	2N1390
КТ301Д	2N842
КТ301Е	BC101
КТ301Ж	2N843
КТ302А	
КТ302Б	
КТ302В	
КТ302Г	
КТ306А	BSX66
КТ306АМ	MPS2713
КТ306Б	2SC601
КТ306БМ	MPS2713
КТ306В	2SC400
КТ306ВМ	MPS834
КТ306Г	BSX67
КТ306ГМ	MPS2714
КТ306Д	BSX67
КТ306ДМ	MPS834
КТ307А-1	
КТ307Б-1	
КТ307В-1	
КТ307Г-1	
КТ3101А-2	
КТ3101АМ	2SC1236
КТ3102А	BC107AP, BC317
КТ3102А2	
КТ3102АМ	BC182A
КТ3102Б	BC107BP, BC318
КТ3102Б2	
КТ3102БМ	BC182B
КТ3102БМ	
КТ3102В	BC108AP, 2SC1815
КТ3102В2	
КТ3102ВМ	BC183B
КТ3102Г	BC108CP
КТ3102Г2	
КТ3102ГМ	BCY57
КТ3102Д	BC184A, 2N2484
КТ3102Д2	
КТ3102ДМ	BC452
КТ3102ДМ	BC547A
КТ3102Е	BC109CP, BC547B
КТ3102Е2	
КТ3102ЕМ	BC538, BC548B
КТ3102ЕМ	2SC923K
КТ3102Ж	2N4123
КТ3102Ж2	
КТ3102ЖМ	BC183A, BC549C
КТ3102И	BCY65
КТ3102И2	
КТ3102ИМ	2N4123
КТ3102К	BC452
КТ3102К2	
КТ3102КМ	2N4124, BC548B
КТ3104А	—
КТ3104Б	—
КТ3104В	—
КТ3104Г	—
КТ3104Д	—
КТ3104Е	—
КТ3106А-2	BFX59, 2SC1254
КТ3106А-9	—
КТ3107А	BC557A, MPS3703
КТ3107Б	BC308A, BC212A
КТ3107В	BC178AP, BCY72
КТ3107Г	BC308A, BC558A
КТ3107Д	BC308A, BC178BP
КТ3107Е	BC179AP, BC309B
КТ3107Ж	BC309B, BC179BP, BC559
КТ3107И	BC307B, BC212C
КТ3107К	BC308C, BC213C
КТ3107Л	BC309C, BC322C
КТ3108А	2N3250
КТ3108Б	2N3251
КТ3108В	2N3250A
КТ3109А	BF680, 2SA983
КТ3109Б	BF979
КТ3109В	BF970
КТ3114Б-6	MA2123
КТ3114В-6	NE73435
КТ3115А-2	FJ401
КТ3115В-2	
КТ3115Г-2	
КТ3115Д-2	
КТ3117А	2N2121, 2N2221
КТ3117А-1	BFX94, NT2222
КТ3117А9	
КТ3117Б	2N2122, 2N2222
КТ3117Б9	MMBT2222
КТ3120АМ	BF480, K5002
КТ3121А-6	FJ203
КТ3122А	2N3033
КТ3122Б	2N5236, 2N5270
КТ3123А-2	2N3953
КТ3123АМ	2SA967
КТ3123Б-2	2SC2369
КТ3123БМ	
КТ3123В-2	2SC236
КТ3123ВМ	
КТ3126А	BF506, 2N4411
КТ3126А-9	2SC2188
КТ3126Б	S3640
КТ3127А	BF182, BF183
КТ3128А	BF272, BF362, BF363
КТ3128А-1	
КТ3128А-9	
КТ3128Б-1	
КТ3129А-9	BC857, BCW89
КТ3129Б-9	BC858, BCW69
КТ3129В-9	BCX71, BCF29, BCW29
КТ3129Г-9	BC858B, BCF30, BCW30
КТ3129Д-9	2SB709
КТ312А	2N702
КТ312А1	
КТ312Б	BCY42, 2SC105
КТ312Б1	2SC33
КТ312В	BCY43, 2N703
КТ312В1	
КТ3130А-9	BCW71, BCW60A
КТ3130Б-9	BCF81, BCW72
КТ3130В-9	BCF32, BCW60C
КТ3130Г-9	BCW33
КТ3130Д-9	BCW32
КТ3130Е-9	BCF33
КТ3130Ж-9	2SD601
КТ3132А-2	FJ201F, 2N6617
КТ3132Б-2	HXTR6102
КТ3132В-2	HXTR6101
КТ3132Г-2	
КТ3132Д-2	
КТ3132Е-2	
КТ3139А	BCW60A
КТ3139Б	BCW60AR
КТ3139В	BCW60BR
КТ3139Г	BCW60BL
КТ313А	2N2906, 2SA530
КТ313А-1	2N3250, 2SA718
КТ313Б	2N4123, BC178
КТ313Б-1	BC317,BC214
КТ313В-1	BC318, 2N4126
КТ313Г-1	BC319
КТ3140А	YTS4126
КТ3140Б	YTS4125
КТ3140В	PMBT3906

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ3140Г	MMBT3906
КТ3140Д	MMBT3906
КТ3142А	2N2369, 2N5769
КТ3143А	BFR180W
КТ3144А	BFP405
КТ3145А-9	BCW60AA
КТ3145Б-9	BCW60BL
КТ3145В-9	BCW60AR
КТ3145Г-9	BCW60A
КТ3145Д-9	BCW60AB
КТ3146А-9	BCX71
КТ3146Б-9	BSS69
КТ3146В-9	MMST3906
КТ3146Г-9	PBMS3906
КТ3146Д-9	PBMT3906
КТ314А-2	BCW46
КТ3150Б-2	
КТ3151А-9	BCW31
КТ3151Б-9	—
КТ3151В-9	—
КТ3151Г-9	—
КТ3151Д-9	2SC1009A, MMBTA20
КТ3151Е-9	2N2246
КТ3153А-5	—
КТ3153А-9	BCW60, BCX70
КТ3157А	BF423, 2SA1320
КТ315А	BFP719
КТ315А-1	
КТ315Б	BFP20, 2N2712
КТ315Б-1	
КТ315В	BFP721
КТ315В-1	
КТ315Г	BFP722
КТ315Г-1	
КТ315Д	2SC641
КТ315Д-1	
КТ315Е	2N3397
КТ315Е-1	
КТ315Ж	2N2711
КТ315Ж-1	
КТ315И	2SC634
КТ315И-1	
КТ315Н	2SC633
КТ315Н-1	
КТ315Р	BFP722
КТ315Р-1	
КТ3165А	BF727, BP970
КТ3165А-9	—
КТ3166А	2SD602
КТ3166Б	MTS102
КТ3166В	—
КТ3166Г	—
КТ3168А-9	2SC2351
КТ3169А-9	BF569
КТ3169А91	—
КТ316А	2N3010
КТ316АМ	2N4254, NTE107
КТ316Б	2N709
КТ316БМ	MPS6541

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ316В	2N709A
КТ316ВМ	
КТ316Г	2SC40
КТ316ГМ	2N4255, KSC1395
КТ316Д	2N2784
КТ316ДМ	KSC1730
КТ3170А-9	2SC2295, BF554
КТ3171А-9	2SB970, 2SD1742
КТ3172А-9	BCF72, 2N3974
КТ3173А-9	2SB710
КТ3176А-9	2SD602
КТ3179А-9	2SD814
КТ317А-1	—
КТ317Б-1	—
КТ317В-1	—
КТ3180А-9	—
КТ3184А9	SMBTA05
КТ3184Б9	SMBTA05
КТ3186А-9	BFG67, BFG92A
КТ3186Б-9	—
КТ3186В-9	—
КТ3187А-9	BFR92A
КТ3187А-91	BFR92
КТ3187Б-91	BFS17
КТ3187В-91	BFS17
КТ3189А-9	BC847A
КТ3189Б-9	BC847B
КТ3189В-9	BC847C
КТ318А-1	—
КТ318Б-1	—
КТ318В-1	—
КТ318Г-1	—
КТ318Д-1	—
КТ318Е-1	—
КТ3191А	BFQ51
КТ3191А-9	BFT92
КТ3191А91	BFT92
КТ3192А-9	BF569
КТ3193А	2SA1090
КТ3193Б	2N4964
КТ3193В	2N4058
КТ3193Г	BC479
КТ3193Д	2SA550
КТ3193Е	
КТ3196А-9	MMBT3906
КТ3197А-9	MMBT3904
КТ3198А	BFR90
КТ3198А9	BFR92
КТ3198А92	BFG92A
КТ3198Б	BFR90A
КТ3198Б9	BFR92A
КТ3198В	BFR91
КТ3198В9	BFR93
КТ3198Г	BFR91A
КТ3198Г9	BFR93A
КТ3198Г92	BFG93A
КТ3198Д	BFR92A
КТ3198Д9	BFS17A
КТ3198Е	2SC3358

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ3198Е9	2SC3356
КТ3198Ж	BFQ65
КТ3198Ж9	BFQ67
КТ3199А9	BFG67
КТ3199А91	BFP67
КТ3199А92	BFG65T
КТ319А-1	
КТ319Б-1	
КТ319В-1	
КТ3201А9	MMBT6517
КТ3201Б9	MMBTA42
КТ3201В9	BFN24
КТ3201Г9	MMBTA43
КТ321А	BSV64
КТ321Б	MM2260
КТ321В	
КТ321Г	
КТ321Д	
КТ321Е	
КТ324А-1	—
КТ324Б-1	—
КТ324В-1	—
КТ324Г-1	—
КТ324Д-1	—
КТ324Е-1	—
КТ325А	2N2615
КТ325АМ	2SC1188, MPS3563
КТ325Б	2SC1215
КТ325БМ	2SC612
КТ325В	2N2616
КТ325ВМ	2N5770, 2SC1395
КТ326А	BC178
КТ326АМ	BFY19
КТ326Б	BFX12
КТ326БМ	BFX13
КТ331А-1	
КТ331Б-1	
КТ331В-1	
КТ331Г-1	
КТ332А-1	
КТ332Б-1	
КТ332В-1	
КТ332Г-1	
КТ332Д-1	
КТ333А-3	
КТ333Б-3	
КТ333В-3	
КТ333Г-3	
КТ333Д-3	
КТ333Е-3	
КТ336А	
КТ336Б	
КТ336В	
КТ336Г	
КТ336Д	
КТ336Е	
КТ337А	2N3304
КТ337Б	2N4207
КТ337В	2N3451

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ339А	BF208
КТ339АМ	BF199
КТ339Б	BF311
КТ339В	BF173
КТ339Г	BF197
КТ339Д	MPSH37
КТ340А	BSX38A, 2N753
КТ340Б	BC218
КТ340В	BFX44, 2N706A
КТ340Г	BSY38
КТ340Д	BSY26
КТ342А	BC107A, 2N929
КТ342АМ	BC109C
КТ342Б	2SC454B
КТ342БМ	BC239C
КТ342В	BC107B
КТ342ВМ	BC108C
КТ342Г	BC239B
КТ342ГМ	2N4124
КТ342ДМ	2N4123
КТ343А	2N3545
КТ343Б	BSW19
КТ343В	BSY40
КТ345А	BC513
КТ345Б	BSY81, 2N3249
КТ345В	2SA568
КТ347А	2N869A
КТ347Б	BSY81
КТ347В	BSY81
КТ348А-3	
КТ348Б-3	
КТ348В-3	
КТ349А	2N726
КТ349Б	2N727
КТ349В	BC158A
КТ350А	MPS6563
КТ351А	BC216
КТ351Б	BC192
КТ352А	BC355A, 2N869
КТ352Б	BC355
КТ354А-2	
КТ354Б-2	
КТ355А	BFX89, 2N5842
КТ355АМ	2SC1954
КТ357А	2SC628
КТ357Б	2SA495G
КТ357В	MPS3639
КТ357Г	2SA495
КТ358А	2N3709
КТ358Б	2N3710
КТ358В	2N3710
КТ359А-3	
КТ359Б-3	
КТ359В-3	
КТ360А-1	
КТ360Б-1	
КТ360В-1	
КТ361Е	BC557
КТ361А	BC520A, 2SA778

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ361А1	2SA555
КТ361А-2	2N4126, 2SA610
КТ361А-3	2N4125
КТ361Б	BC250B
КТ361Б-2	BC250B
КТ361В	BCW58
КТ361В-2	2N3905
КТ361Г	BC157, 2N3905
КТ361Г1	BCW58
КТ361Г-2	2N3906
КТ361Г-3	BSW20
КТ361Д	BC557
КТ361Д1	BC157
КТ361Д-2	—
КТ361Д-3	—
КТ361Е	2SA566
КТ361Е-2	2SA555
КТ361Ж	BC157
КТ361Ж-2	—
КТ361И	BC157
КТ361И-2	—
КТ361К	BCW62A
КТ361К-2	—
КТ361Л	2N3964
КТ361Л-2	—
КТ361М	BC157
КТ361М-2	—
КТ361Н	2SA556
КТ361Н-2	—
КТ361П-2	—
КТ363А	2N3546, 2N4260
КТ363АМ	2N5771, 2N4258A
КТ363Б	2N4261
КТ363БМ	MPSL08
КТ364А-2	
КТ364Б-2	
КТ364В-2	
КТ366А	BFS62
КТ366Б	
КТ366В	
КТ368А	2N918
КТ368А-5	
КТ368А-9	KSC2757, BF599
КТ368АМ	BF597
КТ368Б	2N917
КТ368Б-9	2SC568, 2SC3827
КТ368БМ	2SC3801
КТ368ВМ	MPS5179
КТ369А	
КТ369А-1	
КТ369Б	
КТ369Б-1	
КТ369В	
КТ369В-1	
КТ369Г	
КТ369Г-1	
КТ370А-1	
КТ370А-9	
КТ370Б-1	

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ370Б-9	
КТ371А	BFR90
КТ371АМ	BFR90
КТ372А	2SC1090
КТ372Б	BFR34
КТ372В	2N5652
КТ373А	BC147A, BC168A
КТ373Б	BC147B, BC167B
КТ373В	BC148C, BC168C
КТ373Г	BC157, BCW47
КТ375А	BCW88A, 2N3903
КТ375Б	BSX80, 2N3904
КТ379А	
КТ379Б	
КТ379В	
КТ379Г	
КТ380А	
КТ380Б	
КТ380В	
КТ381Б	
КТ381В	
КТ381Г	
КТ381Д	
КТ381Е	
КТ382А	MMT2857
КТ382АМ	K2122CB
КТ382Б	BSW92
КТ382БМ	K2113B
КТ384А-2	2N3511
КТ384АМ-2	2N3511
КТ385А-2	2N4401
КТ385АМ-2	
КТ385БМ-2	
КТ388Б-2	
КТ388БМ-2	
КТ389Б-2	2N5456
КТ391А-2	HP3568L
КТ391Б-2	
КТ391В-2	
КТ392А-2	BF316
КТ396А-2	2N3839
КТ396А-9	
КТ397А-2	2SC784
КТ399А	BSW30, 2N2857
КТ399АМ	2SC988B, 2SC1789
КТ501А	SFT130
КТ501Б	SF125
КТ501В	SF131
КТ501Г	BCY90B, 2N1221
КТ501Д	BCY38
КТ501Е	SFT124
КТ501Ж	SFT143
КТ501И	SFT144
КТ501К	BCY54
КТ501Л	BCY94B
КТ501М	BCY39, BCY95B
КТ502А	KSA539R
КТ502Б	KSA539O
КТ502В	KSA545O

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ502Г	KSA539Y
КТ502Д	KSA545R
КТ502Е	BSS68
КТ503А	KSC815, KSD227O
КТ503Б	MPS2712
КТ503В	KSC853R
КТ503Г	KSC853R
КТ503Д	KSC853R
КТ503Е	BSS38
КТ504А	2N3439
КТ504Б	2N2727
КТ504В	2N3440
КТ505А	2N5416, MJ4646
КТ505Б	BFT19A,BFT28C
КТ506А	BUX54
КТ506Б	UPT315, BUX84
КТ509А	TRSP5014
КТ511А9	ECX596
КТ511Б9	EXT555SM
КТ511В9	2SA1416R
КТ511Г9	ECX591
КТ511Д9	EXT4515M
КТ511Е9	2SA1213
КТ511Ж9	2SA1214
КТ511И9	BC869-10
КТ511К9	—
КТ512А9	—
КТ512Б9	—
КТ512В9	2SC3647
КТ512Г9	—
КТ512Д9	—
КТ512Е9	2SD1624
КТ512Ж9	KSD1621
КТ512И9	—
КТ512К9	—
КТ513А9	BST16
КТ513Б9	BST15
КТ513В9	BST15
КТ513Г9	—
КТ513Д9	—
КТ514А9	BST40
КТ514Б9	BSD39
КТ514В9	BST39
КТ514Г9	—
КТ514Д9	—
КТ515А9	BCX52
КТ515Б9	BCX51
КТ515В9	—
КТ516А9	BCX55
КТ516Б9	BCX54
КТ516В9	—
КТ517А	MPSA13
КТ517А-1	—
КТ517А-9	MMBTA13, FMMTA13
КТ517Б	MPSA14
КТ517Б-1	—
КТ517Б-9	MMBTA14, FMMTA14
КТ517В	2N6427, GES5308
КТ517В-1	—

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ517В-9	MMBT6427LT1
КТ517Г	MPSA25
КТ517Г-1	—
КТ517Г-9	MMBT6427
КТ517Д	MPSA26
КТ517Д-1	—
КТ517Д-9	—
КТ517Е	2SD1111
КТ517Е-1	—
КТ517Е-9	—
КТ519А	JE9015A
КТ519Б	JE9015B
КТ519В	JE9015C
КТ520А	MPSA42
КТ520Б	MPSA43
КТ521А	MPSA92
КТ521Б	MPSA93
КТ523А	MPSA63
КТ523А9	MMBTA63
КТ523Б	MPSA64
КТ523Б9	MMBTA64
КТ523В	MPSA75
КТ523В9	—
КТ523Г	MPSA76
КТ523Г9	—
КТ523Д	MPSA77
КТ523Д9	—
КТ524А	JE8050
КТ524А-5	—
КТ525А	SS9013
КТ525А-5	JE9013
КТ526А	SS9014
КТ526А-5	SS9014
КТ528А9	FXT56SM
КТ528Б9	2SC4272
КТ528В9	2SC2873, 2SD1624
КТ528Г9	—
КТ528Д9	—
КТ529А	2SA891
КТ530А	PN2219
КТ538А	MJE13001
КТ601А	BFY80
КТ601АМ	
КТ602А	BF177
КТ602АМ	BSS38, 2SD668
КТ602Б	2N1566A
КТ602БМ	2SC1567
КТ602В	MM3000
КТ602Г	SF123C
КТ603А	BSW36
КТ603Б	2SC796
КТ603В	2N2237
КТ603Г	BSW36
КТ603Д	BSW36
КТ603Е	BSW36
КТ603И	2SC151H
КТ604А	2N3742
КТ604АМ	BD115
КТ604Б	2SC2611

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ604БМ	2SC1611
КТ605А	BC100
КТ605АМ	2SC1056
КТ605Б	BF471
КТ605БМ	BF471
КТ606А	2N5090
КТ606Б	RFD401
КТ607А-4	—
КТ607Б-4	—
КТ608А	BSY34
КТ608Б	2N1959
КТ6102А	
КТ6103А	
КТ6104А	
КТ6105А	
КТ6107А	
КТ6108А	
КТ6109А	SS9012D
КТ6109Б	SS9012E
КТ6109В	SS9012F
КТ6109Г	SS9012G
КТ6109Д	SS9012H
КТ610А	BFW16, 2N6135
КТ610Б	
КТ6110А	SS9013D
КТ6110Б	SS9013E
КТ6110В	SS9013F
КТ6110Г	SS9013G
КТ6110Д	SS9013H
КТ6111А	SS9014A
КТ6111Б	SS9014B
КТ6111В	SS9014C
КТ6111Г	SS9014D
КТ6112А	SS9015A
КТ6112Б	SS9015B
КТ6112В	SS9015C
КТ6113А	SS9018D
КТ6113Б	SS9018E
КТ6113В	SS9018F
КТ6113Г	SS9018G
КТ6113Д	SS9018H
КТ6113Е	SS9018I
КТ6114А	SS8050B
КТ6114Б	SS8050C
КТ6114В	SS8050D
КТ6114Г	2SC2001M
КТ6114Д	2SC2001L, 2SD1513L
КТ6114Е	2SC2001K, 2SD1513K
КТ6115А	SS8550B
КТ6115Б	SS8550C
КТ6115В	SS8550D
КТ6115Г	2SA952M
КТ6115Д	2SA952L
КТ6115Е	2SA952K
КТ6116А	2N5401
КТ6116Б	2N5400
КТ6117А	2N5551
КТ6117Б	2N5550
КТ611А	BF111

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ611АМ	2SD668A
КТ611Б	BF179B
КТ611БМ	2SD668
КТ611Б	BF140A
КТ611Г	BF114
КТ6127А	—
КТ6127Б	—
КТ6127В	—
КТ6127Г	—
КТ6127Д	—
КТ6127Е	—
КТ6127Ж	—
КТ6127И	—
КТ6127К	—
КТ6128А	SS9016D
КТ6128Б	SS9016E
КТ6128В	SS9016F
КТ6128Г	SS9016G
КТ6128Д	SS9016H
КТ6128Е	SS9016I
КТ6129А-9	BFP194
КТ6129Б-2	
КТ6130А-9	BDP196
КТ6131А	LAE4001RA
КТ6132А	BFQ54T
КТ6133А	SS8550B
КТ6133Б	SS8550C
КТ6133В	SS8550D
КТ6134А	SS8050B
КТ6134Б	SS8050C
КТ6134В	SS8050D
КТ6135А	ZTX658, MPSA44
КТ6135А9	BST39
КТ6135Б	MPSA42
КТ6135Б9	SXTA42
КТ6135В	MPSA43
КТ6135В9	BST40
КТ6135Г	—
КТ6135Г9	—
КТ6135Д	—
КТ6135Д9	—
КТ6136А	2N3906
КТ6137А	2N3904
КТ6138А	MPSA92, 2SA1091
КТ6138Б	MPSA93, 2SA1544
КТ6138В	BF462, 2SA1376
КТ6138Г	2N5401, PN4888
КТ6138Д	2N5400, 2SA1016F
КТ6139А	MPSA42, BFR89
КТ6139Б	MPSA43, BFR88
КТ6139В	2N6515
КТ6139Г	2N5551, BFR87
КТ6139Д	2N5550, BFR86
КТ6140А	SS9018
КТ6141А9	BFR96T
КТ6141Б9	BFR96TS
КТ6142А	2SC3355
КТ6142А9	2SC3357
КТ6142Б	2SC2570A

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ616А	BSX89
КТ616Б	BSY17, 2N914
КТ617А	2N1838
КТ618А	BF179C, MJ420
КТ620А	2N3671
КТ620Б	2N2904AL
КТ624А-2	2N3303
КТ624АМ-2	
КТ625А	
КТ625АМ	
КТ625АМ-2	
КТ626А	BD136, D41D1
КТ626Б	BD138
КТ626В	BD140
КТ626Г	2SA1356
КТ626Д	2SA1356
КТ629А-2	2N3245
КТ629Б-2	2N3467
КТ629БМ-2	
КТ630А	2N1893, 2N2405
КТ630А-5	—
КТ630Б	BC300, 2N1890
КТ630Б-5	—
КТ630В	2N2990, 2N1711
КТ630В-5	—
КТ630Г	BC140, 2N1889
КТ630Г-5	—
КТ630Д	BC119, 2N697
КТ630Е	BFY68
КТ632Б	
КТ632Б-1	MPSL51
КТ632В-1	MPSL51
КТ633А	2N2369
КТ633Б	2N2368
КТ634А-2	
КТ634Б-2	
КТ635А	2N4960
КТ635Б	2N3725
КТ637А-2	—
КТ637Б-2	—
КТ638А	MPSL01
КТ638А1	—
КТ639А	BD227
КТ639А-1	
КТ639Б	BD227
КТ639Б-1	
КТ639В	BD840
КТ639В-1	
КТ639Г	MPSU55
КТ639Г-1	
КТ639Д	BD229
КТ639Д-1	
КТ639Е	MPSU56
КТ639Е-1	
КТ639Ж	2SA743A
КТ639Ж-1	
КТ639И	2SA715B
КТ639И-1	
КТ640А-2	NE21960

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ640Б-2	2SC1950
КТ640В-2	—
КТ642А-2	AT41485
КТ642А-5	—
КТ643А-2	HXTR410, NF98203
КТ644А	BC527-6
КТ644Б	BC527-10
КТ644В	—
КТ644Г	—
КТ645А	MPS6532
КТ645Б	BC547, 2SC367G
КТ646А	2SC495, BD827
КТ646Б	2SC496
КТ646В	—
КТ647А-2	NE56755
КТ647А-5	
КТ648А-2	HXTR2101
КТ648А-5	—
КТ653А	2N4271
КТ653Б	
КТ657А-2	NE021-60
КТ657А-5	—
КТ657Б-2	LAE4000Q
КТ657Б-5	—
КТ657В-2	—
КТ657В-5	—
КТ659А	2N3725, 2N3737
КТ660А	BC337, GES2219
КТ660Б	BC338, 2SD467D
КТ661А	2N2907A
КТ662А	2N2905A
КТ664А-9	BCX51, BCX53
КТ664Б-9	BCX52
КТ665А-9	BCX54, BCX56
КТ665Б-9	BCX55, 2N1777
КТ666А-9	BF620
КТ667А-9	BF621
КТ668А	2SA1032
КТ668Б	2SA1030B
КТ668В	2SA1030
КТ674АС	MPQ3906
КТ674АС	MPQ3906
КТ677АС	—
КТ677АС	—
КТ678АС	—
КТ678АС	—
КТ680А	MPS3914, MPS2925, BC368
КТ681А	BC369, MPS3395
КТ682А-2	HXTR6102, FJ403
КТ682А-5	—
КТ682Б-2	AT41485
КТ682Б-5	—
КТ683А	2SC1080
КТ683Б	2SC2481
КТ683В	2SD414
КТ683Г	2N6178, BD230
КТ683Д	MJE180, 2SD415
КТ683Е	2N6179
КТ684А	2N6488

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ684Б	2N4291
КТ684В	2SA1274
КТ684Г	—
КТ685А	2N6015
КТ685Б	MPS2907K
КТ685В	MPS2907AM
КТ685Г	MPS2907AL
КТ685Д	2N6013
КТ685Е	2N3703, 2N5334
КТ685Ж	2N5356
КТ686А	2N5373
КТ686Б	2SA1515
КТ686В	2SA966Y
КТ686Г	2N3638, 2S564
КТ686Д	2SA1160A, 2SA952L
КТ686Е	2SA1160B, 2SA952K
КТ686Ж	2N4889, 2N3638A
КТ692А	2N4234, 2N3717
КТ693АС	TPQ7041
КТ695А	—
КТ698А	—
КТ698Б	—
КТ698В	—
КТ698Г	—
КТ698Д	—
КТ698Е	—
КТ698Ж	—
КТ698И	—
КТ698К	—
КТ704А	2N3585, BU143
КТ704Б	BDY93
КТ704В	2N3583
КТ708А	—
КТ708Б	—
КТ708В	—
КТ709А	MJH11019
КТ709Б	MJH11017
КТ709В	—
КТ710А	2SD621, 2SD838
КТ712А	BDX54F
КТ712Б	BDX54F
КТ715А	2SD621, 2SD995
КТ716А	TIP112, TIP122
КТ716Б	TIP111, TIP121
КТ716В	TIP110, TIP120
КТ716Г	SE9300
КТ719А	BD379, MJE290
КТ720А	BD170
КТ721А	BD172, BD237
КТ722А	2SA1021, BD236
КТ723А	BD501B, BD543D
КТ724А	BD744D, BD802
КТ728А	BDW51A
КТ729А	2N3771, 2SD630
КТ729Б	2N3237, 2N3772
КТ730А	2N3240, 2N3773
КТ731А	—
КТ731Б	—
КТ731В	—

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ731Г	—
КТ732А	MJE4343
КТ733А	MJE4353
КТ734А	TIP31
КТ734Б	TIP31A
КТ734В	TIP31B
КТ734Г	TIP31C
КТ735А	TIP32
КТ735Б	TIP32A
КТ735В	TIP32B
КТ735Г	TIP32C
КТ736А	TIP41
КТ736Б	TIP41A
КТ736В	TIP41B
КТ736Г	TIP41C
КТ737А	TIP42
КТ737Б	TIP42A
КТ737В	TIP42B
КТ737Г	TIP42C
КТ738А	TIP3055
КТ739А	TIP2955
КТ740А	MJE4343
КТ740А1	
КТ801А	BSX63
КТ801Б	BSX62
КТ802А	BDX25, 2N5051
КТ803А	BDY23
КТ805А	BDY60
КТ805АМ	2SC3422
КТ805Б	BD109, BD123
КТ805БМ	BD719
КТ805ВМ	BD720
КТ807А	MPSU07
КТ807АМ	BD237
КТ807Б	MPSU05
КТ807БМ	2N4923
КТ808А	BLY47
КТ808А1	
КТ808А3	BDT93, BDT94
КТ808АМ	2SC1619A
КТ808Б1	
КТ808Б3	BDT95
КТ808БМ	BDY71, 2SC1618
КТ808В1	
КТ808ВМ	2SC1619A
КТ808Г1	
КТ808ГМ	2N5427
КТ809А	BD216, BLY49
КТ8101А	MJE4343, BDY96
КТ8101Б	2SA1106
КТ8102А	MJ2955
КТ8102Б	BD546D, MJE4353
КТ8104А	MJ11021, BDX66C
КТ8105А	MJ11020, 2SD1287
КТ8106А	BDV66B, MJH6285
КТ8106Б	2SB883, MJH6286
КТ8107А	BU508A, BUV48A
КТ8107А2	BU208A
КТ8107Б	BU508

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ8107Б2	BU208
КТ8107В	BU508A
КТ8107В2	BU208A
КТ8107Г	BU508
КТ8107Г2	BU208
КТ8107Д	SGSF464
КТ8107Д2	SGSF564
КТ8107Е	BU508D
КТ8107Е2	BU207A
КТ8108А	BUX47
КТ8108А-1	BUV66A
КТ8108Б	BU326
КТ8108Б-1	BUT11
КТ8108В	BU326A
КТ8108В-1	BUV46
КТ8109А	TIP151
КТ8109Б	
КТ8110А	2SC4242, 2N6499
КТ8110Б	2SC4106
КТ8110В	BU109P, 2SC4106L
КТ8111А9	
КТ8111Б9	
КТ8111В9	
КТ8112А	MJE13003
КТ8113А	—
КТ8113Б	—
КТ8113В	—
КТ8114А	BU508A
КТ8114Б	SGSF444
КТ8114В	
КТ8114Г	
КТ8115А	TIP127
КТ8115Б	TIP126
КТ8115В	TIP125
КТ8116А	TIP122
КТ8116Б	TIP121
КТ8116В	TIP120
КТ8117А	2SC3306
КТ8117Б	2N6931
КТ8118А	2SC3150
КТ8120А	2N6928
КТ8121А	2SGSF344
КТ8121А-1	
КТ8121А-2	BU208A
КТ8121Б	2SC4756
КТ8121Б-1	
КТ8121Б-2	BU208
КТ8123А	2N6477
КТ8124А	BU408
КТ8124Б	
КТ8124В	
КТ8125А	BD243C
КТ8125Б	BD243B
КТ8125В	BD243A
КТ8126А1	MJE13007
КТ8126Б1	MJE13006
КТ8127А	BU208A
КТ8127А-1	BU508F1, 2SD1577F1
КТ8127Б	BU208

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ8127Б-1	BU508, 2SC3480
КТ8127В	SGSF444
КТ8127В-1	2SC3459
КТ8129А	2SD1174
КТ812А	BDY94
КТ812Б	BU106
КТ812В	BDY25
КТ8130А	2N6034, BU406
КТ8130Б	2N6035, BD876
КТ8130В	2N6036
КТ8131А	2N6037, BD875
КТ8131Б	2N6038
КТ8131В	2N6039
КТ8133А	
КТ8133Б	
КТ8134А	
КТ8135А	
КТ8136А	MJE13006
КТ8136А-1	BU408D
КТ8137А	BD410, BUX86
КТ8138А	2SC4106, 2SC2335
КТ8138Б	2SC4242, 2SC3056
КТ8138В	MJE130056 2SC4542
КТ8138Г	MJE13007
КТ8138Д	BU406, 2SC3057
КТ8138Е	BU406D
КТ8138И	MJE13009, 2N6930
КТ8138Т	MJE13008, 2N6929
КТ8140А	BU408
КТ8140А-1	BU408D
КТ8141А	BDX53C
КТ8141Б	BDX53B
КТ8141В	BDX53A
КТ8141Г	BDX53
КТ8143А	BUP47, BUV19
КТ8143Б	BUT90
КТ8143В	BUT91
КТ8143Г	BUL47A, BUP54
КТ8143Д	BUP47, 2N6274
КТ8143Е	BUP47
КТ8143Ж	BUP53
КТ81433	BUT92
КТ8143И	2SD372
КТ8143К	BUP46
КТ8143Л	2SD373
КТ8143М	2SD374, BUP53
КТ8143Н	BUP47
КТ8143П	2SD373
КТ8143Р	2SD373
КТ8143С	2SD372
КТ8143Т	BUV18
КТ8143У	BUP51
КТ8143Ф	BUP52
КТ8144А	MJ13334, BUX98
КТ8144Б	2SC1139
КТ8145А	MJE13009
КТ8145Б	MJE13009, 2SC4109
КТ8146А	BUX48B, 2N6575
КТ8146Б	BUX37

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ8147А	BUX47, BUW26
КТ8147Б	BUW24, BUX15
КТ8149А	MJ2955
КТ8149А-1	TIP2955
КТ8149А-2	MJE2955T
КТ814А	TIP30
КТ814Б	BD166, MJE710
КТ814В	BD168, MJE711
КТ814Г	BD170, MJE712
КТ8150А	2N3055
КТ8150А-1	TIP3055
КТ8150А-2	MJE3055T
КТ8154А	2SC1141
КТ8154Б	BUX98A, 2SC1144
КТ8155А	BUL47A, ESG99
КТ8155Б	BUX98AX, 2SC2147
КТ8156А	BU807
КТ8156Б	—
КТ8157А	BU208A, 2SD350
КТ8157Б	2SC3688, BU208
КТ8158А	BDV65
КТ8158Б	BDV65A
КТ8158В	BDV65B
КТ8159А	BDV64
КТ8159Б	BDV64A
КТ8159В	BDV64B
КТ815А	BD165, TIP29
КТ815Б	BD167, MJE720
КТ815В	BD169, MJE721
КТ815Г	BD818, MJE722
КТ8163А	—
КТ8164А	MJE13005
КТ8164Б	MJE13004
КТ8165А	—
КТ8165Б	—
КТ8165В	—
КТ8165Г	—
КТ8166А	—
КТ8166Б	—
КТ8166В	—
КТ8166Г	—
КТ8167А	2N5675
КТ8167Б	2N6303
КТ8167В	2N3719
КТ8167Г	2N5333
КТ8167Д	2N3720
КТ8168А	2N4300
КТ8168Б	2N3507
КТ8168В	2N3506
КТ8168Г	2N5320
КТ8168Д	2N5321
КТ816А	BD436, TIP32
КТ816А-2	2SB435U
КТ816Б	BD176, BD234
КТ816В	BD178, BD236
КТ816Г	BD180, BD238
КТ8170А-1	MJE13003
КТ8170Б-1	MJE13002
КТ8171А	

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ8175А	MJE13003, BUX79
КТ8175А-1	2N6773, 2SC2333
КТ8175Б	2SC3840
КТ8175Б-1	2N6772
КТ8176А	TIP31A
КТ8176Б	TIP31B
КТ8176В	TIP31C
КТ8177А	TIP32A
КТ8177Б	TIP32B
КТ8177В	TIP32C
КТ817А	BD433, TIP31
КТ817Б	BD175, BD233
КТ817Б-2	2SD880
КТ817В	BD177, BD235
КТ817Г	BD179, BD237
КТ817Г-2	BD179-16, 2SC1826
КТ8181А	MJE13005
КТ8181Б	MJE13004
КТ8182А	MJE13007
КТ8182Б	MJE13006
КТ8183А	BU208DX
КТ8183А-1	S2000F1
КТ8183А-2	BUH315D
КТ8183Б	SGSF564
КТ8183Б-1	SGSF464
КТ8183Б-2	BUH313D
КТ818А	BD292, BD202
КТ818А-1	BD546C
КТ818АМ	2N6469, BDW52
КТ818Б	BD202, BDT92
КТ818Б-1	BD546B
КТ818БМ	BDW22, BDX92
КТ818В	BD204, BDT94
КТ818В-1	BD546A
КТ818ВМ	BDW52A, 2N5867
КТ818Г	BD538, BDT96
КТ818Г-1	BD546
КТ818ГМ	BDW22C, BDX18
КТ8196А	
КТ8197А-2	
КТ8197Б-2	
КТ8197В-2	
КТ8199А	D45H2A
КТ819А	BD2921, TIP41
КТ819А-1	BD545C
КТ819АМ	BD181,BD130
КТ819Б	BD202, BDT91
КТ819Б-1	BD545B
КТ819БМ	BD142, BDW21A
КТ819В	BD201, BDT93
КТ819В-1	BD545A
КТ819ВМ	BD182, BDX91
КТ819Г	BD203, BDT95
КТ819Г-1	BD545
КТ819ГМ	BD183, 2N3055
КТ8201А	MJE13001
КТ8203А	MJE13003
КТ8205А	MJE13005
КТ8207А	MJE13007

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ8209А	MJE13009
КТ820А-1	—
КТ820Б-1	—
КТ820В-1	—
КТ8212А	TIP41C
КТ8212Б	TIP41B
КТ8212В	TIP41A
КТ8213А	TIP42C
КТ8213Б	TIP42B
КТ8213В	TIP42A
КТ8214А	TIP110
КТ8214Б	TIP111
КТ8214В	TIP112
КТ8215А	TIP115
КТ8215Б	TIP116
КТ8215В	TIP117
КТ8216А	KSH3055, MJD31
КТ8216А1	MJD31C
КТ8216Б	MJD31A
КТ8216Б1	KSH3055I
КТ8216В	MJD3055-1, MJD31B
КТ8216В1	MJD3055
КТ8216Г	MJD41C, MJD31C
КТ8216Г1	
КТ8217А	MJD32
КТ8217А1	2SB1450Q
КТ8217Б	KSH2955I, MJD32A
КТ8217Б1	KSH2955
КТ8217В	MJD32B
КТ8217В1	MJD2955
КТ8217Г	MJD42C1, MJD32C
КТ8217Г1	2SB1452Q
КТ8218А	KSH31I
КТ8218А1	KSH31
КТ8218Б	KSC3074
КТ8218Б1	2SC4668
КТ8218В	—
КТ8218В1	MJD31BT4
КТ8218Г	KSH44H11I
КТ8218Г1	2SD2200Q
КТ8219А	2N6034
КТ8219А1	KSB907
КТ8219Б	2SB1214
КТ8219Б1	2SB1474A
КТ8219В	KSH117I
КТ8219В1	2SB1316A
КТ8219Г	KSH127I
КТ8219Г1	KSH117, MJD117
КТ821А-1	—
КТ821Б-1	—
КТ821В-1	—
КТ8220А	BD243
КТ8220Б	
КТ8220В	
КТ8220Г	
КТ8221А	BD244
КТ8221Б	
КТ8221В	
КТ8221Г	
КТ8224А	BU2508A
КТ8224Б	BU2508D
КТ8225А	BU941ZP
КТ8228А	BU2525A
КТ8228Б	BU2525D
КТ8229А	TIP35F
КТ822А-1	—
КТ822Б-1	—
КТ822В-1	—
КТ8230А	TIP36F
КТ8231А	BU941Z
КТ8231А1	BU941ZP
КТ8231А2	BU941ZPF
КТ8232А1	—
КТ8232Б1	—
КТ8233А5	TIP127
КТ8233Б5	TIP126
КТ8233В5	TIP125
КТ8234А5	TIP122
КТ8234Б5	TIP121
КТ8234В5	TIP120
КТ8235А	MJE13003
КТ823А-1	—
КТ823Б-1	—
КТ823В-1	—
КТ8240А5	
КТ8240Б5	
КТ8240В5	
КТ8240Г5	
КТ8240Д5	MPSW13
КТ8240Е5	MPSW14
КТ8240Ж5	
КТ8241А5	MPSW63
КТ8241Б5	MPSW64
КТ8241В5	
КТ8241Г5	
КТ8241Д5	
КТ8241Е5	
КТ8241Ж5	
КТ8242А5	TIP117
КТ8242Б5	TIP116
КТ8242В5	TIP115
КТ8243А5	TIP112
КТ8243Б5	TIP111
КТ8243В5	TIP110
КТ8244А5	BD876
КТ8244Б5	BD878
КТ8244В5	BD878
КТ8244Г5	BD880
КТ8245А5	BD875
КТ8245Б5	BD877
КТ8245В5	BD877
КТ8245Г5	BD879
КТ8246А	
КТ8246Б	
КТ8246В	
КТ8246Г	
КТ8247А	BUL45D2
КТ8248А1	BU2506D
КТ8250А	D44H8
КТ8250Б	—
КТ8250Г	—
КТ8250Д	—
КТ8251А	BDV65F
КТ8254А	
КТ8255А	BU407
КТ825Г	BDX62A, MJ4031
КТ825Д	BDX62, MJ2500
КТ825Е	BDX86
КТ8261А	BUD44D2
КТ826А	BU132
КТ826Б	2SD312
КТ826В	BU132
КТ8270А	MJE13001
КТ8271А	BD163
КТ8271Б	BD138
КТ8271В	BD140
КТ8272А	BD135
КТ8272Б	BD137
КТ8272В	BD139
КТ827А	BDX63A, MJ3521
КТ827Б	BDX65
КТ827В	BDX85, MJ3520
КТ828А	BU326A
КТ828Б	2SD640
КТ828В	BUX97B
КТ828Г	2SD640
КТ8290А	BUH100
КТ829А	BD267B, TIP122
КТ829АМ	
КТ829АП	
КТ829АТ	
КТ829Б	BD267A, BD263, TIP121
КТ829В	BD331, TIP120
КТ829Г	BD665, BD675
КТ830А	2N5781, 2N4234
КТ830Б	2N4235
КТ830В	2N4236, SML3552
КТ830Г	2N4236
КТ831А	2N4300
КТ831Б	
КТ831В	
КТ831Г	
КТ834А	SDN6002
КТ834Б	SDN6001
КТ834В	SDN6000
КТ835А	2SB906
КТ835Б	BD434
КТ836А	2N3204
КТ836Б	
КТ836В	
КТ837А	BD534, TIP42C
КТ837Б	BD536, 2N6106
КТ837В	BD234
КТ837Г	BD225
КТ837Д	2SB434, 2N6108
КТ837Е	2N6125
КТ837Ж	2N6124, 2N6132

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ837И	2SB435
КТ837К	BD944, 2N6110
КТ837Л	2N6126
КТ837М	BD223
КТ837Н	BD223
КТ837П	2SB435G
КТ837Р	2SB434
КТ837С	BD225
КТ837Т	BD948
КТ837У	2SB435
КТ837Ф	BD224
КТ838А	BU204
КТ838Б	BU208
КТ839А	MJ3480, 2SD380
КТ840А	2N6543, BU326A
КТ840Б	BU126, 2N6542
КТ840В	BU326, 2N5805
КТ841А	BDX96, 2N6560
КТ841Б	2SC2122, 2SC1308
КТ841В	MJ10002
КТ841Г	UPT315, BDX96
КТ841Д	2SD418, 2SC2139
КТ841Е	BUW35
КТ842А	2SB506A
КТ842Б	TIP519
КТ842В	MJ410
КТ844А	UPT732
КТ845А	DT4305
КТ846А	BU208A
КТ846Б	BU207
КТ846В	BU208
КТ847А	2N6678, 2N6672
КТ847Б	
КТ848А	BU608, BUX37
КТ848Б	
КТ850А	2SC216B, 2SD610
КТ850Б	MPSU04
КТ850В	2N6477
КТ851А	2SB546A, 2SB630
КТ851Б	2SA1009
КТ851В	2SA740, 2SB546
КТ852А	TIP117, 2SB1286
КТ852Б	TIP116, 2SB750A
КТ852В	TIP115, 2SB973A
КТ852Г	TIP115
КТ853А	TIP127, BDX54C
КТ853Б	TIP126, BDX54B
КТ853В	TIP125, BDX34
КТ853Г	BDX54A
КТ854А	2SC3257, TIP50
КТ854Б	MJE13006, 2N5540
КТ855А	BD566
КТ855Б	BDT42C
КТ855В	BDT45C
КТ856А	BUX48A
КТ856А-1	2SC3450, BU2520A
КТ856Б	BUX48
КТ856Б-1	2N6932, 2SC3277
КТ857А	BU409

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ858А	BU408, BU406
КТ859А	BUX84, 2SD841
КТ862Б	XGSR10040
КТ862В	
КТ862Г	
КТ863А	BDY92, 2N6669
КТ863Б	BD245, BD945
КТ863В	2SC2516, 2SC3568M
КТ864А	2SD536, 2N6216
КТ865А	2SA1180, 2SA1073
КТ866А	
КТ866Б	
КТ867А	BUY21, 2N6341
КТ868А	BU426A, BUW11A
КТ868Б	BU426, BUW11
КТ872А	BU508, MJE13005
КТ872Б	BU508A
КТ872В	BU508D
КТ874А	BUW39
КТ874Б	2N5672
КТ878А	BUX98
КТ878Б	2N6516
КТ878В	2N6678, BUX25, BUX98
КТ879А	2N6279, 2N6282
КТ879Б	2N6278, 2N6281
КТ885А	BUS98, BUV74
КТ885Б	BUV98A
КТ886А-1	2SC3061
КТ886Б-1	BU508A, 2SC3637
КТ887А	
КТ887Б	AP1009
КТ888А	STP70S
КТ888Б	STP60S
КТ890А	BUV37
КТ890Б	BUV37
КТ890В	BU9302P
КТ892А	TIP661
КТ892Б	BU932Z
КТ892В	TIP662
КТ893А	BU286
КТ895А9	BU508D
КТ896А	BDV64B, SGSD200
КТ896Б	BDV64, TIP146
КТ897А	BU931Z
КТ897Б	BU941Z
КТ898А	BU931ZP
КТ898А-1	BU931ZPFI
КТ898Б	
КТ898Б-1	
КТ899А	TIP132
КТ902А	BD121
КТ902АМ	BDX35
КТ903А	2N2947
КТ903Б	2SC517
КТ904А	2N3375
КТ904Б	2SC549
КТ907А	2N3733
КТ907Б	2N4440
КТ908А	BDY92

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ908Б	BDY92
КТ909А	2N5177
КТ909Б	2N5178
КТ909В	2SC2042
КТ909Г	2SC2173
КТ9101АС	FJ0880-28
КТ9104А	MRA0610-3
КТ9104Б	MRA0610-18
КТ9105АС	BAL0105-100
КТ9106АС-2	—
КТ9106БС-2	—
КТ9109А	MSC1550M
КТ9111А	PT9790A
КТ9115А	BF472, BF849
КТ9115Б	2SA794
КТ9116А	TPV394
КТ9116Б	TPV375
КТ911А	2N4976
КТ911Б	2N4429
КТ911В	2N5481
КТ911Г	2SC3607
КТ9120А	D45H5, BD706
КТ9121А	AM82731-45
КТ9121Б	
КТ9121В	
КТ9121Г	27AM05
КТ9125АС	BAL0105-50
КТ9126А	TH430
КТ9127А	MSC81550M
КТ9127Б	
КТ9128АС	BAL0102-50
КТ912А	2N5070, 2N6093
КТ912Б	2N6093
КТ9130А	2SC2688N, 2SC4001
КТ9131А	
КТ9132АС	
КТ9133А	TPV376
КТ9134А	HEM3508B-20
КТ9134Б	SD1543
КТ9136АС	SD1565, UDR500
КТ913А	MSC2003, BLX92, 2N4430
КТ913Б	BLX93, 2N4431
КТ913В	NE10101E-28
КТ9141А	LT1839
КТ9141А-1	LT1817
КТ9142А	2SC3218, TRY5051
КТ9143А	LT5839, BFQ253
КТ9143Б	
КТ9143В	
КТ9144А-5	
КТ9144А-9	BF623, 2SA1584
КТ9145А-5	
КТ9145А-9	BF622
КТ9146А	AM1416-200
КТ9146Б	
КТ9146В	
КТ9147АС	
КТ914А	2N5161

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ9150А	TPV595A
КТ9151А	2SC3812
КТ9152А	2SC3660
КТ9153АС	
КТ9153БС	TPV5051
КТ9155А	
КТ9155Б	2SC3217
КТ9155В	2SC3218
КТ9156АС	J02058
КТ9156БС	MRA0510-50H
КТ9157А	2SC2270
КТ9160А	MRF430
КТ9160Б	
КТ9160В	
КТ9161АС	SD1565
КТ9164А	SD1540
КТ9166А	D44H5, BUY26
КТ916А	2SC1805
КТ916Б	2N5596, 2N6208
КТ9173А	TPV376
КТ9174А	
КТ9176А	2SB772
КТ9177А	2SD882
КТ9180А	BD132, BD330
КТ9180Б	MJE170, MJE230
КТ9180В	MJE171, MJE233
КТ9180Г	MJE172
КТ9181А	BD326, D42CC2N
КТ9181Б	2SD1348,MJE180
КТ9181В	MJE181
КТ9181Г	MJE182
КТ9182А	SD1492
КТ9186А	
КТ9186Б	
КТ9186В	
КТ9186Г	
КТ9186Д	
КТ9189А-2	
КТ9189Б-2	
КТ9189В-2	
КТ918А-2	PKB3000U
КТ918Б-2	LKE32002T
КТ9190А	
КТ9190А-4	
КТ9192А-2	
КТ9192Б-2	
КТ9193А	
КТ9193А-4	
КТ9193Б	
КТ9193Б-4	
КТ919А	2N5596, MSC2005M
КТ919Б	2N5768, MSC2003M
КТ919В	2N5483, MSC2001M
КТ919Г	PKB23003U
КТ920А	2N5589
КТ920Б	BLW18, 2N5590
КТ920В	2N5591
КТ920Г	BLY88A
КТ921А	2N5707, S10-12

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ921Б	
КТ922А	2N5641
КТ922Б	2N5642
КТ922В	2N5643
КТ922Г	BLW24
КТ922Д	2N4128
КТ925А	C3-12
КТ925Б	C12-12
КТ925В	C25-12
КТ925Г	2SC1001
КТ926А	2N1902
КТ926Б	2N1904
КТ927А	2N4933
КТ927Б	2N6093
КТ927В	—
КТ928А	BSS29, 2N2217
КТ928Б	BSX32, 2N2219
КТ928В	2N2219A
КТ929А	B2-8Z, 2N5719
КТ930А	2N6362, CM75-28
КТ930Б	2N6364
КТ931А	2N6369, BM80-28
КТ932А	2N3741
КТ932Б	BD132
КТ932В	2N4898
КТ933А	BC160-2
КТ933Б	BC139
КТ934А	C3-28, 2N6202, 2SC1021
КТ934Б	C12-28, 2N6203, BLY22
КТ934В	C25-28, 2N6204, BLY92A
КТ934Г	2N5589
КТ934Д	2N5590
КТ935А	BDU53
КТ936А	2N5709
КТ936Б	—
КТ937А-2	MS0146
КТ937Б-2	PTB42003X
КТ938А-2	MSC4001
КТ938Б-2	
КТ939А	2SC1262, 2N3866
КТ939Б	SD1308
КТ940А	BF298, 2N3440S
КТ940А1	
КТ940А-5	
КТ940А9	
КТ940Б	BF458, BF459
КТ940Б1	
КТ940Б-5	
КТ940Б9	
КТ940В	BF297, BF157
КТ940В1	
КТ940В-5	
КТ942В	MRF2010
КТ943А	BD375
КТ943Б	BD377
КТ943В	BD131
КТ943Г	BD230
КТ943Д	BD379
КТ944А	S80-28

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ945А	BDY90, 2SC519A
КТ945Б	
КТ945В	
КТ945Г	
КТ946А	D12-28
КТ947А	2N6047, BDP620
КТ948А	MRF2005M
КТ948Б	TRW2020
КТ955А	S10-28
КТ956А	S80-28
КТ957А	S150-28
КТ958А	BM40-12
КТ960А	CM40-12
КТ961А	BD139
КТ961А1	
КТ961Б	BD137, BD371C
КТ961Б1	
КТ961В	BD135
КТ961В1	
КТ961Г	BD132
КТ962А	DM10-28
КТ962Б	DM20-28
КТ962В	DM40-28
КТ963А-2	MJ250
КТ963А-5	
КТ963Б-2	ML500
КТ963Б-5	
КТ965А	S10-12
КТ966А	S30-12
КТ967А	S70-12
КТ969А	BF469, BF419
КТ969А1	
КТ969А-5	
КТ970А	C2M100-28A
КТ971А	BM100-28
КТ972А	BD877
КТ972Б	BD875, BD477
КТ972В	
КТ972Г	
КТ973А	BD876
КТ973Б	BD466B
КТ973В	
КТ973Г	
КТ976А	PH1114-50C
КТ977А	SD1546
КТ979А	PZB16040U, PH1114-60
КТ980А	CM40-12
КТ980Б	TH430
КТ981А	A50-12
КТ983А	BLX96
КТ983Б	BLX97
КТ983В	BLX98
КТ984А	MSC1075M
КТ984Б	MSC1250M
КТ985АС	BAL0204-125
КТ986А	1214P400
КТ986Б	DME250
КТ986В	DME375
КТ986Г	—

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
КТ991АС	BAL0105-50
КТ996А-2	
КТ996А-5	
КТ996Б-2	FJ9295CC
КТ996Б-5	
КТ996В-2	
КТ996В-5	
КТ997А	2N6609
КТ997Б	D44H1
КТ997В	D44H2
КТ999А	BF869, BF715
КТД8264А	—
КТД8264А5	—
КТД8275А	—
КТД8275Б	—
КТД8275В	—
КТД8276А	—
КТД8276Б	—
КТД8276В	—
КТД8276Г	—
КТС303А-2	MD986
КТС3103А	MD5000
КТС3103А1	
КТС3103Б	MD5000B
КТС3103Б1	
КТС3161АС	
КТС3174АС-2	SL362
КТС381Б	
КТС381В	
КТС381Г	
КТС381Д	
КТС381Е	
КТС393А	
КТС393А-1	
КТС393А-9	MD5000
КТС393Б	
КТС393Б-1	
КТС393Б-9	MD5000B
КТС394А-2	MD1130
КТС394Б-2	
КТС395А-1	MD1129
КТС395А-2	
КТС395Б-1	
КТС395Б-2	
КТС395В-2	
КТС398А-1	MD918
КТС398А94	MD918F
КТС398Б-1	
КТС398Б94	MD918AF
КТС613А	MQ2218
КТС613Б	MQ2218A
КТС613В	MQ2218
КТС613Г	MQ2218
КТС622А	
КТС622Б	MHNQ2906, 2N5146
КТС631А	MHQ2369
КТС631Б	MHQ2369
КТС631В	MHQ2221
КТС631Г	MHQ2221

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
МГТ108А	2N130
МГТ108Б	NKT73
МГТ108В	2N132
МГТ108Г	AC170, AC171
МГТ108Д	AC150
МП10	
МП10А	
МП10Б	
МП11	
МП11А	
МП13	
МП13Б	
МП14	
МП14А	
МП14Б	
МП14И	
МП15	
МП15А	
МП15И	
МП16	
МП16А	
МП16Б	
МП16Я1	
МП16Я11	
МП20А	AC121, ASY26
МП20Б	AC125, AC132
МП21В	2N60A
МП21Г	2N60C
МП21Д	2N59C
МП21Е	2N61C
МП25	2N189
МП25А	AC116
МП25Б	2N43
МП26	OC112
МП26А	MA909
МП26Б	ACY24
МП35	2N444
МП36А	AC183
МП37А	2N444A
МП37Б	2SD75
МП38	2N94
МП38А	AC183
МП39	SFT306
МП39Б	AC540
МП40	2SB173
МП40А	OC70, 2N44A
МП41	AC540
МП41А	AC542
МП42	ASY70
МП42А	ASY26
МП42Б	AF266, ASX11
МП9А	
П201АЭ	ADP670
П201Э	ADP671
П202Э	ADP672
П203Э	2SB467
П207	
П207А	
П208	

Отечественный транзистор	Зарубежный аналог
П208А	
П209	
П209А	
П210	2N3614
П210А	2N3614
П210Б	AD142, AD545
П210В	AD143
П210Ш	2N3614
П213	AD139, AD262
П213А	2N2835
П213Б	AD1202
П214	2N2660
П214А	AD263, AD457
П214Б	AD1203
П214В	AD263
П214Г	AF262
П215	AD469, AD439
П216	AD138, AD302
П216А	AD130
П216Б	2N178
П216В	AD145
П216Г	AD313
П216Д	AD312
П217	AD310, AD163
П217А	ASZ16
П217Б	AUY19
П217В	ASZ18, ASZ1017
П217Г	ASZ17
П27	2N175
П27А	2N220
П28	AC160
П29	OC41
П29А	OC42
П30	AFY15
П401	SFT317
П402	SFT316H
П403	2N2089, SFT357
П403А	2N2089
П416	2N602
П416А	2N604
П416Б	2SA279
П417	2N1727
П417А	2N1726
П417Б	2N1865
П422	2N1524
П423	2SA111
П605	2SA416
П605А	2SA416
П606	2SA416
П606А	2SA416
П607	AUY10
П607А	AUY10
П608	AUY10
П608А	AUY10
П609	2SA374
П609А	2SA374

Литература

1. Нефедов А. В., Гордеева В. И. Отечественные полупроводниковые приборы и их зарубежные аналоги. Справочник. М.: Радио и связь, 1990.

2. Нефедов А. В., Аксенов А. И. Кремниевые транзисторы для бытовой и промышленной радиоэлектронной аппаратуры. Справочник. УПЦ ИПК «Московская правда», 1993.

3. Аксенов А. И., Нефедов А. В., Юшин А. М. Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Диоды. Транзисторы. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1988.

4. Аксенов А. И., Нефедов А. В. Отечественные полупроводниковые приборы. Справочное пособие. 5-е изд. М.: СОЛОН-Пресс, 2005. Серия «Ремонт», выпуск 59.

5. Петухов В. М. Транзисторы и их зарубежные аналоги. Справочник. Т. 5. М.: РадиоСофт, 2002.

6. Петухов В. М. Зарубежные транзисторы и их аналоги. Справочник. Т. 5. М.: РадиоСофт, 2002.

7. Кроуфорд Р. Схемные применения МОП-транзисторов. М.: Мир, 1970.

8. Тугов Н. М., Глебов Б. А., Чарыков Н. А. Полупроводниковые приборы. М.: Энергоатомиздат, 1990.

9. Образцов А., Смердов В. Биполярные транзисторы с изолированным затвором // Ремонт & Сервис. 2004. № 11.

10. Каталог «Полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы». Минск: УП Завод «Транзистор», 2004.

11. Каталог «Полупроводниковые приборы, интегральные микросхемы и силовые модули». Брянск: Группа Кремний, 2003.

12. Каталог изделий АООТ ВЗПП. Воронеж, 1996.

13. Каталог «Кремниевые транзисторы». Воронеж: НПО «Электроника», 1993.

14. Кожевников В., Асессоров В., Асессоров А., Дикарев В. Мощные низковольтные СВЧ транзисторы для подвижных средств связи // Радио. 1999. № 10.

15. Каталог «Полупроводниковые приборы». Вел. Новгород: ООО «НПО Планета», 2003.

16. Технический каталог микросхем и транзисторов. АООТ «НИИМЭ и Микрон». 2000.

17. Нефедов А. В. Мощные полевые транзисторы nМОП-типа КП734, КП735, КП759, КП760, КП761 // Ремонт & Сервис. 2002. № 11.

18. Нефедов А. В. Биполярные транзисторы КТ519, КТ524, КТ525, КТ526, КТ734, КТ735, КТ736, КТ737, КТ6140, КТ8199, КТ8201, КТ8203, КТ8205, КТ8207, КТ8209 // Ремонт & Сервис. 2001. № 12.

19. Нефедов А. В. Транзисторы типов КТ511, КТ512, КТ513, КТ514, КТ515, КТ517, КТ520, КТ521, КТ523, КТ528 // Ремонт & Сервис. 2002. № 1.

20. Нефедов А. В. Полевые транзисторы КП523, КП731, КП737, КП739—КП753, КП775—КП781, КП783—КП787 // Ремонт & Сервис. 2002. № 5.

21. Нефедов А. В. Биполярные транзисторы КТ6128, КТ6136, КТ6137, КТ722, КТ733, КТ739, КТ8120, КТ8212—КТ8290 // Ремонт & Сервис. 2002. № 6.

22. Нефедов А. В. Новые биполярные и полевые транзисторы // Ремонт & Сервис. 2004. № 12.

23. Аксенов А. И., Нефедов А. В. Отечественные полупроводниковые приборы специального назначения. М.: СОЛОН-Р, 2002. Серия «Ремонт», выпуск 62.

24. Нефедов А. В. Зарубежные аналоговые микросхемы и их аналоги. Т. 1—8. М.: РадиоСофт, 1999—2000.

25. Транзисторы, Справочные данные по полупроводниковым приборам. Номенклатура. Таблицы параметров. Изготовители. 1996.

26. Каталог «Компоненты и услуги». Минск: НПО «Интеграл», 2005.

Серия «Ремонт», выпуск 90

Нефедов Анатолий Владимирович
Аксенов Алексей Иванович

Транзисторы для бытовой, промышленной и специальной аппаратуры

Справочное пособие

Ответственный за выпуск
В. Митин

Верстка
С. Тарасов

Обложка
Е. Жбанов

ООО «СОЛОН-Пресс»
123242, г. Москва, а/я 20
Телефоны:
(095) 254-44-10, 252-36-96, 252-25-21
E-mail: Solon-Avtor@coba.ru
www.solon-press.ru

По вопросам приобретения обращаться:
ООО «АЛЬЯНС-КНИГА КТК»
Тел: (095) 258-91-94, 258-91-95
www.abook.ru

ООО «СОЛОН-Пресс»
127051, г. Москва, М. Сухаревская пл., д. 6, стр. 1 (пом. ТАРП ЦАО)
Формат 60×88/8. Объем 75 п. л. Тираж 1000

Зак. 9
ООО "Арт-диал"
143980, Московская обл., г. Железнодорожный,
ул. Керамическая, д. 2а.